

# 最新 FET [電界効果トランジスタ] 規格表

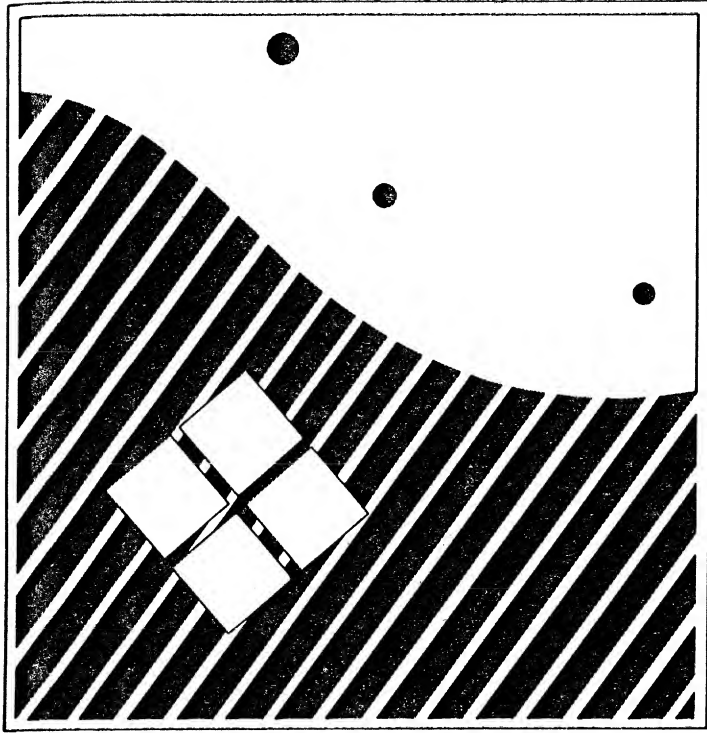
## '85

パワー-MOS FET (海外製)  
主要規格付き

復刻版

CQ出版社





# 最新 FET [電界効果トランジスタ] 規格表

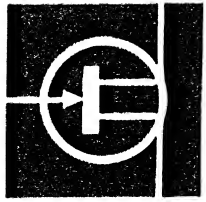
## ☆規格表ご利用の際のお願い

本規格表の仕様はメーカー発表の資料に基づき作成しておりますが、メーカーによって予告なく規格・外形等を変更する場合がありますので、量産品等、大量に素子を使用して製品を生産する必要がある際には、事前に該当メーカーにお問合わせの上、仕様をご確認ください。



このページは空白です。





# 規格表の 使い方



# FET を活用するための用語の説明

FET関係の記事、文献をはじめてみた場合、トランジスタでは見馴れない、また聞き馴れない用語が次から次へととびだし、誰でも少なからず、面くらうものです。

しかし、これだけで、FETを難解なものであると決めつけ、敬遠してしまったのでは、例えばせっかく宝物の埋めてある場所につきながら、たまたま掘りおこす道具を持ち合わせなかったという理由だけで、すくすく引き返えすようなもので、実に惜しむべきことといわねばなりません。用語というのは、FETの本質を知るための道具、手段のようなものですから、一通りの知識を身につけておくことは、ぜひ必要です。

さて、FETの用語、記号は、現在のところ統一されていないので、各社それぞれ独自のものを使っていますが、ここでは、これらのうち、主なものについて簡単に説明していきましょう。

まず、最大定格をあらわすものとして、耐圧関係がいくつかあります。

## \* $V_{GDS}$ (ドレイン-ソース短絡ゲート-ドレイン間電圧)

3文字の添字は、トランジスタの場合と同じで、1番目が起点となる電極、2番目が入出力の共通電極、最後は第3の電極が共通電極に対して、どういう状態にあるかを表わします。

3番目にくる添字としては、

S…短絡、O…開放

X…指定されたバイアス電圧を加える

R…指定された抵抗を接続する

などがあります。

さて、ゲート-ドレイン間の耐圧は、普通、接合型FETで用いられ、ゲート-ドレイン間のPN接合のブレイクダウン電圧に相当します。

この規格以上の逆電圧をかけて使った場合、素子のバラツキにより異なりますが、必ずある電圧でブレイクダウン領域に入り逆電流が急増するためPN接合が破壊される恐れがあります。したがって、メーカーで保証している最大定格内で使用するよう設計することが望ましいわけで、定格オーバーで使って、もしこわれたとしても文句

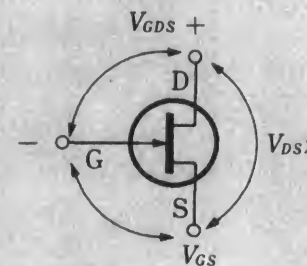
はいえません。

このゲート-ドレイン間耐圧としては、 $V_{GDS}$ の他に、 $V_{GDO}$ 、 $V_{GDX}$ がありますが、普通の接合型FETでは、内部構造上、ゲートに対してドレイン-ソースは対称ですから、 $V_{GDS} \approx V_{GDO} \approx V_{GDX}$ になります。

## \* $V_{DSX}$ (ドレイン-ソース間電圧)

これは、主としてMOS型FETの場合に使われます。というのは、MOS型ではゲート-ドレイン間の耐圧は、酸化膜の耐圧そのものに相当し、実際回路で問題になるドレイン-ソース間の耐圧と直接関係がないためです。これに対し、接合型では、 $V_{GDS}$ と $V_{DSX}$ の間に次のような関係式が成立します。

〈図1〉  $V_{GDS}$  と  $V_{DSX}$  の関係





$$V_{DSX} \approx V_{GDS} - V_{GS}$$

このことは、**図1**からも明らかで、ドレイン-ソース間に実際加えることができる電圧は、ゲート-ソース間のバイアス電圧により異なりますが、必ず $V_{GDS}$ より小さな値になり、カットオフ時に最小になります。

$$(V_{DSX})_{\min} = V_{GDS} - |V_p|$$

ここで、 $V_p$ というのは、ピンチオフ電圧とよばれる、カットオフ時のバイアス値を示します。普通 $V_{DSX}$ というのは、カットオフの時の耐圧で表わされますが、接合型の場合、いま述べたように、 $V_{DSX}$ に相当するものは、 $V_{GDS}$ ではなく、 $V_{GDS}$ からピンチオフ電圧を差引いたものになりますから、この点充分注意を要します。

#### \* $V_{GS0}$ (ゲート-ソース間電圧)

これは、主としてMOS型で用いられ、トランジスタの $V_{EBO}$ と同様に特にスイッチング回路などで問題になります。

#### \* $I_G$ (ゲート電流)

接合型で、ゲート-ソース間を順方向にバイアスするとゲート電流が流れはじめ、等価的にトランジスタと同じ動作をし、 $I_{DSS}$ よりはるかに大きいドレイン電流が流れます。したがって、ドレイン側の許容損失で普通押えられてしまいましたが、ゲート側も一応の目安として最大順方向電流が決めら

れています。これに対しMOSでは、構造上、接合型のゲート順方向電流に相当するものは存在しないので、 $I_G$ のかわりに $I_D$ の最大値が規定されているのが普通です。

#### \* $P_d$ (許容損失)

トランジスタの $P_c$ に相当し、周囲温度25°Cの時の最大許容値で示されます。

また、実際のパワーは、チャンネルで消費されるので、 $P_{ch}$ (許容チャンネル損失)で表わされることもあります。

#### \* $T_j$ (接合部温度)

接合型の場合、トランジスタと同様に $T_j$ で、一方MOS型では、 $T_{ch}$ (チャンネル温度)で表わされるのが普通です。

### <電気的特性に関する用語>

次に電気的特性を表わすのに使われる用語に話を進めましょう。

#### \* $I_{GSS}$ (ゲートしゃ断電流)

これは、入力インピーダンスの目安を与

えるもので、ドレインとソースを短絡し、ゲート-ソース間に逆電圧を印加した時に流れるリーク電流です (**図2**参照)。

接合型の場合、 $I_{GSS}$ はPN接合の逆方向電流に相当しますが、MOS型では、酸化膜を通して流れる電流で、接合型とは桁が違います。したがって、MOSの場合、FETの外囲器や、測定の際用いるソケットの漏洩電流の方が、素子自身を流れる電流より、むしろ大きい場合があります。

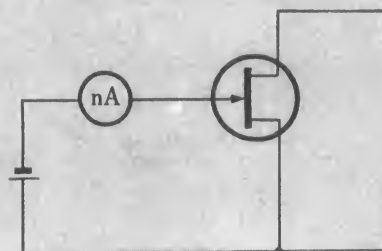
#### \* $I_{DSS}$ (ドレイン電流)

ゲートとソースを短絡、すなわち零バイアスの時流れる電流で、この時のドレイン-ソース間電圧としては、ピンチオフ電圧の絶対値より充分大きく、ブレイクダウン電圧より小さい、電流が充分飽和している電圧が選ばれます (**図3**)。

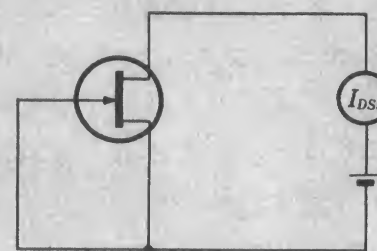
FETを静特性で分類すると**図4**に示すように

#### (a)デプレッション型

<図2>  $I_{GSS}$ 測定回路(Nチャンネル)



<図3>  $I_{DSS}$ 測定回路





- (b)デプレッション+エンハンスメント型
- (c)エンハンスメント型

の3つに分けることができますが、(a)と(c)では、 $I_{DSS}$ の大きさがまったく対称的です。

すなわち、デプレッション型では、 $I_{DSS}$ が、最大飽和電流に相当し、かなり大きな値を示しますが、エンハンスメント型の場合、カットオフ電流になりますから、非常に小さい値になるわけです。

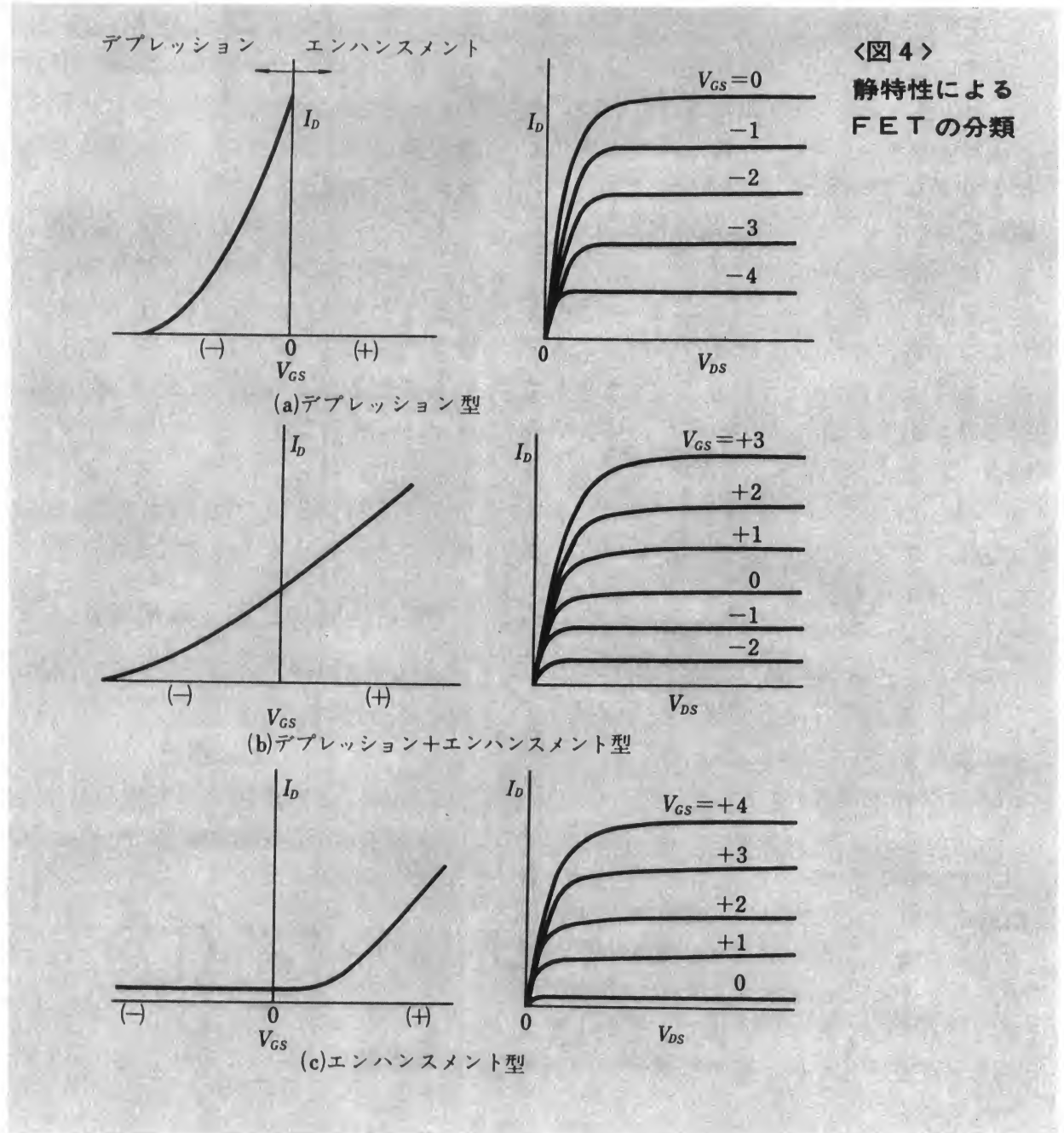
**\*  $V_p$  (ピンチオフ電圧)**

これは、 $I_{DSS}$ の説明文中の、(a)と(b)のタイプの場合に適用され、一定のドレイン-ソース間電圧のもとで、バイアスを深くしてゆき、電流が零になる時のゲート-ソース間電圧で、 $V_p$ 以外に $V_{GSC}$ 、 $V_{GS(off)}$ (いずれもゲート-ソース・カットオフ電圧とよばれる)などが使われます。

しかし、実際の測定では、電流が零というのは、判定しにくいので、充分小さな規定電流値、メーカーによって異なりますが、普通、 $I_D=0.1\mu A, 1\mu A, 10\mu A$ の時のバイアス値を読みとります (図5)。

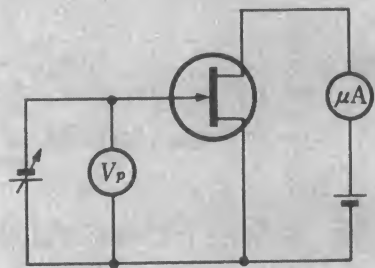
一方、(c)のエンハンスメント型の場合は、電流が流れはじめる点ということで $V_p$ ではなく $V_{th}$ (スレッシユホールド電圧)が用いられます (図6)。

**\*  $g_m$  (相互コンダクタンス)**





<図5>  $V_p$ 測定回路

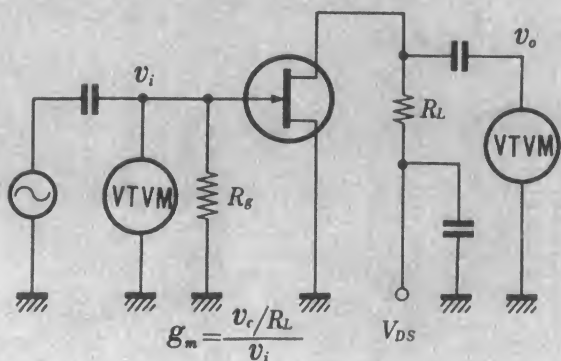


$g_m$ の定義は次式で与えられますが、 $g_m$ の他に  $|Y_{fs}|$  (ソース接地小信号順伝達アドミタンス) という記号が用いられることもあります。

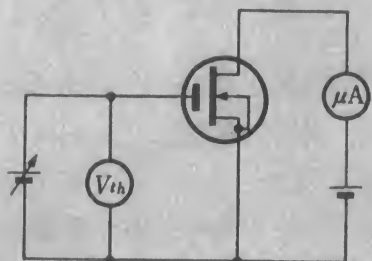
$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS}=\text{一定}}$$

またバイアス条件としては、 $I_{DSS}$ と同じ条件が用いられることが多いようですが、ドレイン電流を規定する場合があります。

<図7>  $g_m$ 測定回路



<図6>  $V_{th}$ 測定回路



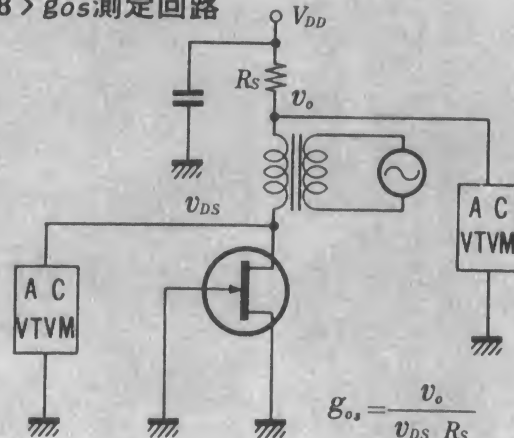
測定回路としては、図7が用いられ、普通、1kHzで測られます。

\*  $g_{os}$  (出力コンダクタンス)

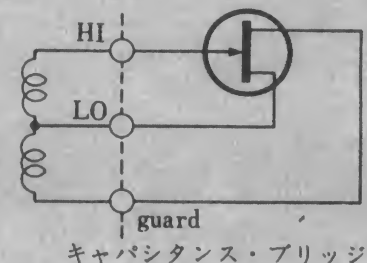
$|Y_{os}|$ と書かれる場合もありますが真空管でいえば、プレート抵抗  $r_p$ の逆数に相当するものです。電流によって大きく変化しますが普通は、 $g_m$ と同じバイアス条件で測定されます (図8)。

\*  $C_{is}$  (ソース接地入力容量)

<図8>  $g_{os}$ 測定回路

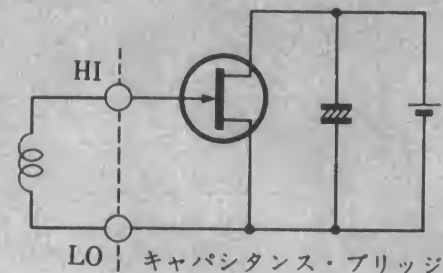


<図10>  $C_{is}$ 測定回路 (3端子法)



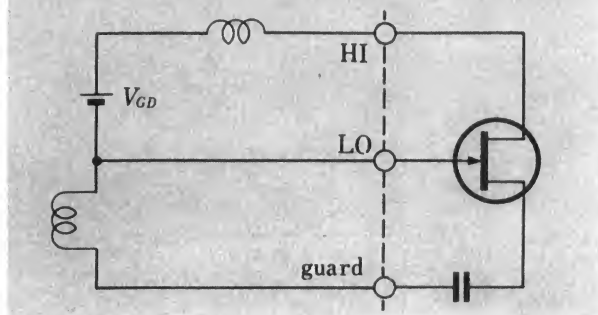
この  $C_{is}$  の測定条件は各社まちまちですが、特に接合型の場合、入力容量は、PNジャンクションの逆バイアス容量になりますから、バイアス条件で値は大きくも、小さくもなります。しかし、一般に零バイアス、すなわち  $C_{is}$  が最大になる点で測定することが多いようです。測定方法としては図9のようにドレイン-ソース間に電圧をかけ、キャパシタンス・ブリッジの2端子法を用いたり、あるいは、ドレイン-ソース間には電圧をかけずに3端子法で純粹にゲート-ソース間の容量だけを測定する図

<図9>  $C_{is}$ 測定回路 (2端子法)





〈図11〉  $C_{rs}$ 測定回路(3端子法)

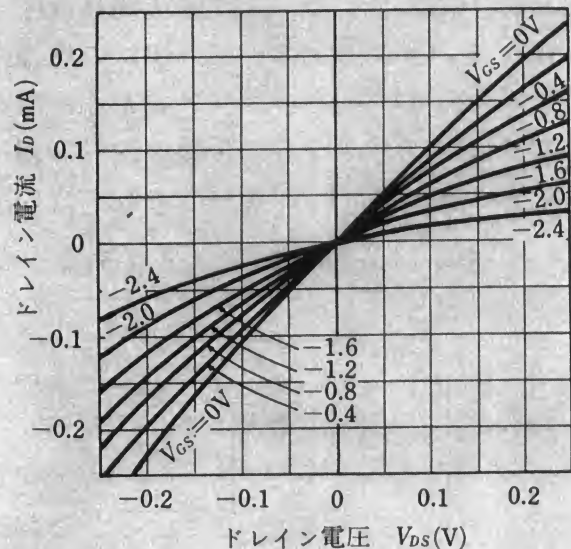


10の回路などがあります。

\*  $C_{rs}$  (ソース接地帰還容量)

低周波回路でも、この  $C_{rs}$  が大きいと、ミラー効果により、等価入力容量が増加し上限周波数が下がってしまい問題になりますが、高周波回路では、 $g_m$ と共に、 $C_{rs}$  の

〈図12〉  $V_{DS}-I_D$ 特性例



大きさが高周波特性の良さの一つの目安となります。すなわち  $g_m/C_{rs}$  は大きければ大きいほどよいわけです。

$C_{rs}$  の測定回路の一例を図11に示します。

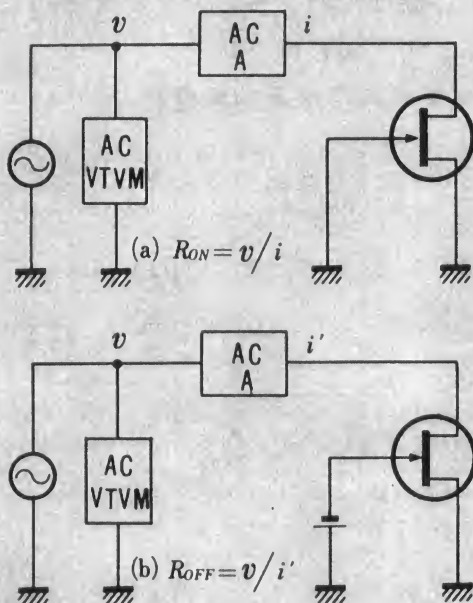
\*  $R_{ON}$  (オン抵抗)、 $R_{OFF}$  (オフ抵抗)

FETをチョッパに使う場合、この2つのパラメータが重要な意味をもってきます。

FETの静特性の立ち上がりの部分(3極管領域)は、トランジスタとちがって、オフセット電圧が存在しなく、バイアス電圧により抵抗値が変化する可変抵抗と考えることができます(図12参照)。

図12で、 $V_{GS} = 0$  の時の直線の傾きに相

〈図13〉  $R_{ON}$ ,  $R_{OFF}$ 測定回路



当するのが  $R_{ON}$ 、カットオフ時が  $R_{OFF}$  というわけで、測定回路は図13になります。

■ 略称・記号の説明

(1) メーカー名 (50音順)

- 富士通 富士通株式会社
- 三洋 東京三洋電機株式会社
- 東芝 株式会社 東芝
- 日電 日本電気株式会社
- 日立 株式会社日立製作所
- 三菱 三菱電機株式会社
- ソニー ソニー株式会社
- 松下 松下電子工業株式会社

(2) 構造

- J Junction (接合) 型
- MOS (Metal Oxide Semiconductor)
- V Vertical (縦型)
- GaAs ガリウム砒素 J型
- GaAsSB ガリウム砒素 ショットキバリヤゲート型

(3) モード

- D デプレッション
- E エンハンスメント
- D+E デプレッション+エンハンスメント

(4) 区分

- 通工 通信工業用
- 一般 一般用

# 特性図の見方・使い方

FETのカタログをみると、各種の特性グラフがのっていますが、ここでは、そのうちの主なものを用途別にいくつか選び、どういう点に注目すればよいか、またどのように活用すればよいか順を追って、みていきたいと思ひます。

## 1. 静特性の見方

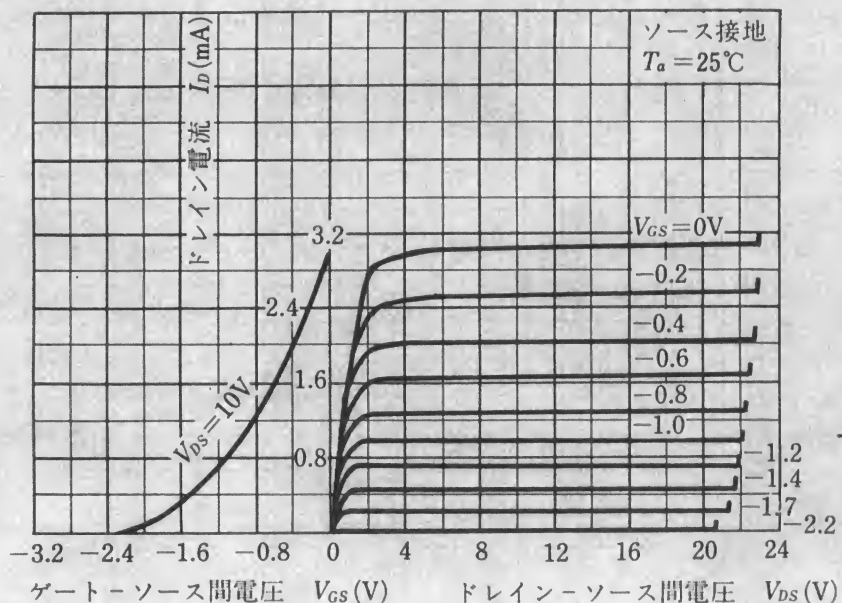
FETの基本特性である伝達特性と出力特性を表わしたもので、これ一つあれば低周波のパラメータは、ほとんどわかってし

まうといっても決して過言ではありません。

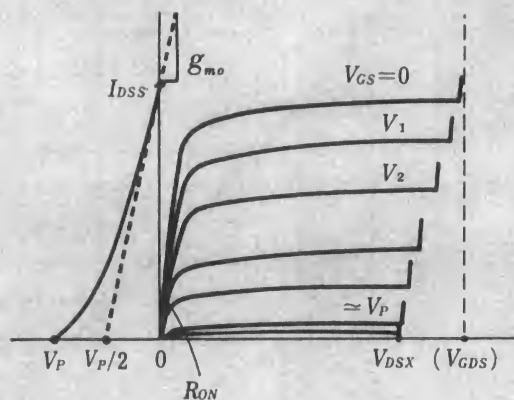
まず、グラフから、 $I_{DSS}$ 、ピンチオフ電圧、 $V_{GDS}$  ( $V_{DSX}$ ) の標準値を知ることができます(図1、2)。

また、伝達特性の各点における傾きを計算すれば、任意のバイアスにおける $g_m$ が求

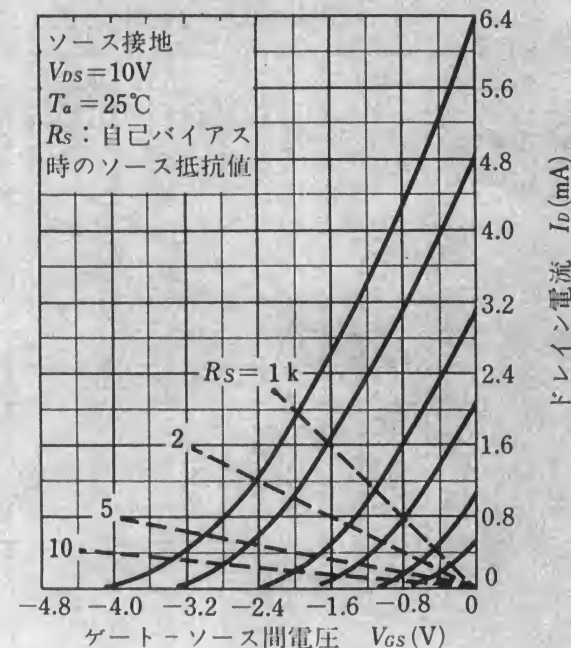
〈図1〉静特性の例



〈図2〉静特性の見方



〈図3〉 $I_D$ - $V_{GS}$  特性例





まります。この $g_m$ は次に示すように近似式を用いても、簡単に計算できます。

FETの5極管領域(飽和領域)では、二乗近似が非常によくあてはまりますが、これを使うと、

$$I_D = I_{DSS} (1 - V_{GS}/V_p)^2 \quad V_{DS} = \text{一定}$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{DS} = \text{一定}}$$

$$= \frac{2 I_{DSS}}{(-V_p)} (1 - V_{GS}/V_p)$$

$$= g_{m0} (1 - V_{GS}/V_p)$$

ここで、

$$g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{(-V_p)}$$

すなわち、上式に、グラフから読みとった、 $I_{DSS}$ と $V_p$ の値を代入すれば、よいわけです。

このようにして、各バイアスにおける $g_m$ が求まったら、次の関係式からオン抵抗も

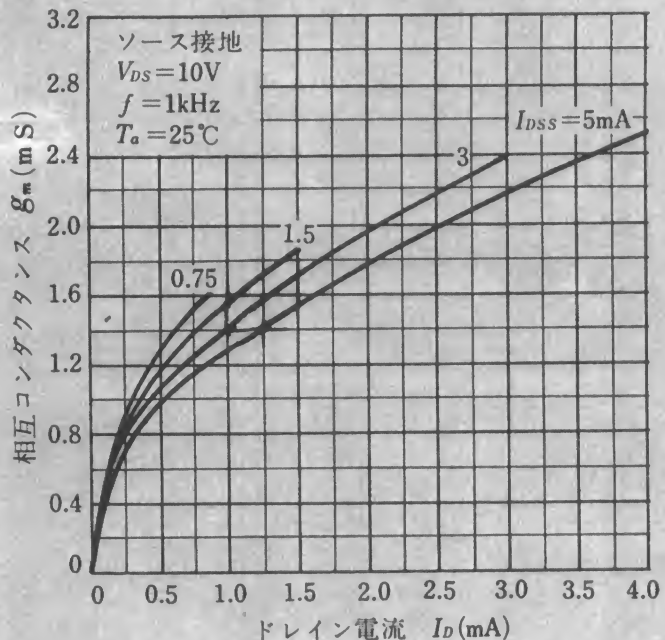
計算できます。

$$\left[ R_{ON} \right]_{\substack{I_D=0 \\ V_{GS}=V_1}} = \left[ 1/g_m \right]_{V_{GS}=V_1}$$

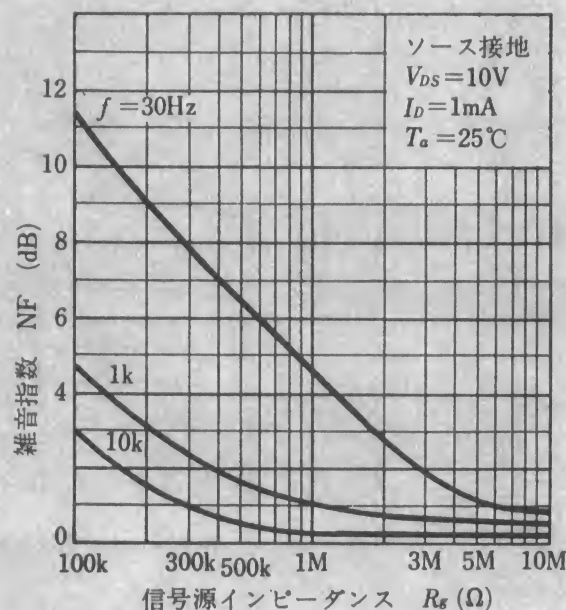
$g_{OS}$ ,  $R_{OFF}$ も静特性から求めようと思えば、求まりますが、誤差が大きく実用にはなりません。

また、出力特性のパラメータになっている、ゲート-ソース間のバイアスの符号をみれば、デプレッション、エンハンスメントのどのモードで働く素子か判断できます。

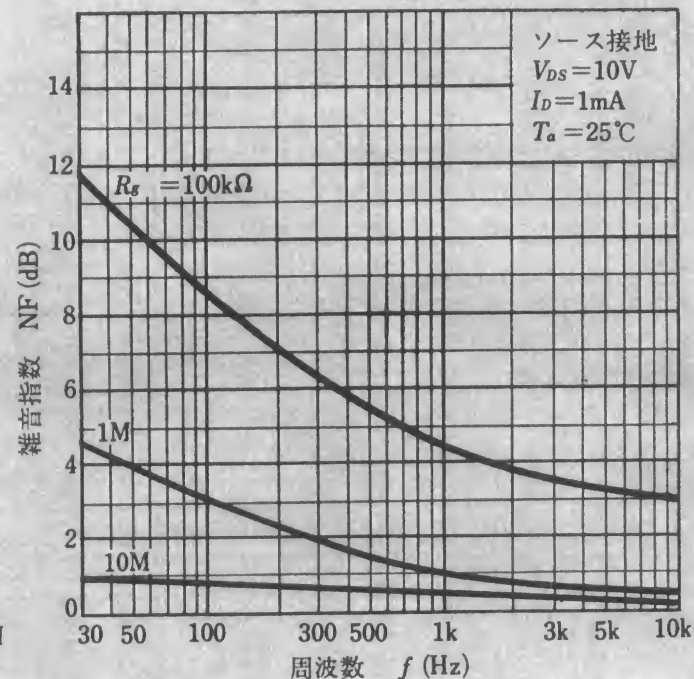
<図4>  $I_D - g_m$  特性例



<図5> NF- $R_g$  特性例



<図6> NF-f 特性例



## 用途別に分けた特性の見方

以上、示したように静特性というのは、FETの特性の基礎となるもので、カタログには不可欠のものですが、他の特性は用途によって、当然かわってきます。そこで、次に各用途別に分けて主な特性をみていきましょう。

### ■直流、低周波増幅用

まず、図3の $I_D - V_{GS}$ 、図4の $I_D - g_m$ のように素子のバラツキを併せ示したグラフがあれば、机上の計算だけで、簡単に回路の基本設計ができます。

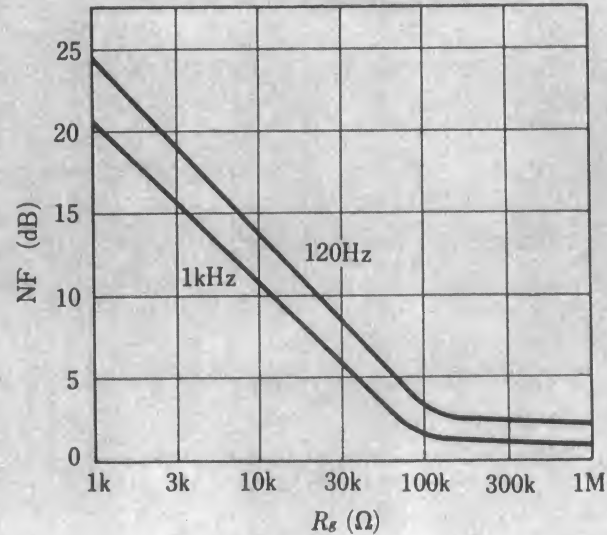
次に、低信号レベル増幅回路としてどうしてもかかせないのが、雑音特性です。雑音特性は、一般に測定条件により大きく変化するので、雑音の対信号源インピーダンス

ス、対周波数、対ドレイン-ソース間電圧、対ドレイン電流特性などが必要になります(図5, 6)。

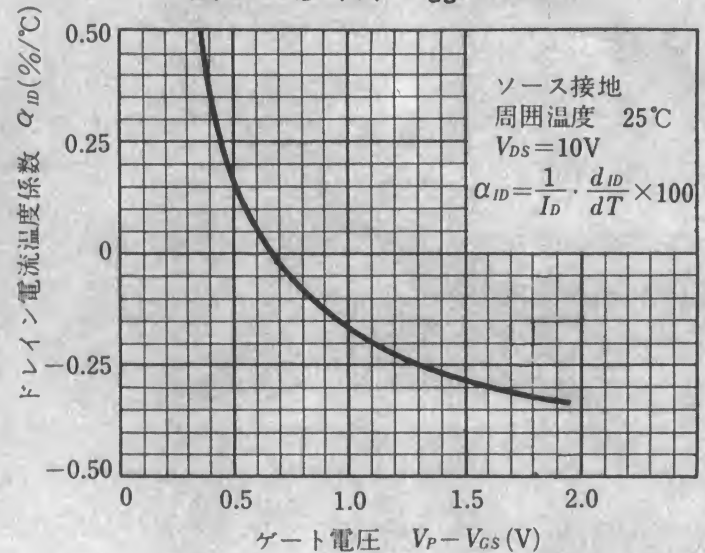
NF(雑音指数)の他に、入力換算雑音電圧で雑音特性を表わす方法がありますが、このうち、対信号源インピーダンス特性は $NF - R_g$ 特性と形が違いますから、両者を単純に比較することはできません。

例えば、図7と図5をみると、図7の方が低信号源インピーダンスで雑音特性がよ

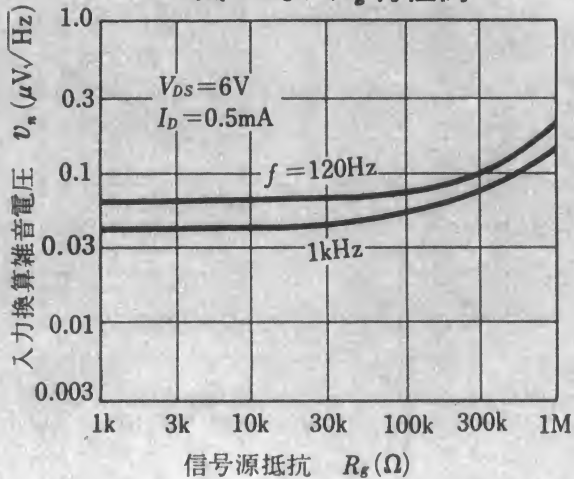
〈図8〉NF- $R_g$ 特性例



〈図9〉 $\alpha_{ID} - (V_P - V_{GS})$ 特性例



〈図7〉 $v_n - R_g$ 特性例





さそうですが、**図7**の $v_n$ を信号源抵抗から発生する熱雑音電圧を計算し、NFに換算すると**図8**になり、**図5**と同じ傾向になることがわかります。

**図7**では、 $v_n$ の単位として、 $\mu V/\sqrt{Hz}$ が使われていますが、これは、帯域幅で規格化したもので、例えば、 $R_g$ の抵抗の熱雑音電圧はボルツマン定数を $K$ 、絶対温度を $T$ とすれば

$$v_n = \sqrt{4KTR_g \Delta f}$$

で表わされますが、 $v_n$ と同じ単位に直せば、 $v_n = \sqrt{4KTR_g}$  になるわけです。

最後に直流増幅器の設計にぜひ必要なものとして、FETの各パラメータの温度特性関係のグラフがあります。

これには、 $I_D$ ,  $g_m$ ,  $I_{GSS}$ の標準値の温度特性を示したものと**図9**のように、バイアスと温度係数の関係を表わしたものがああります。

例えば**図9**の場合は、ピンチオフ電圧よ

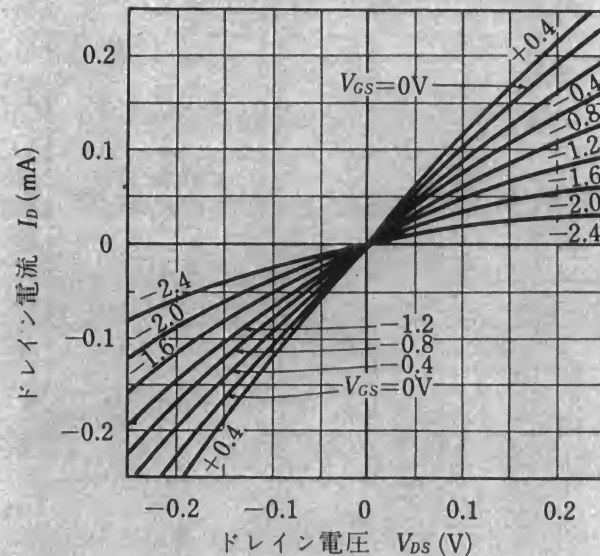
り約0.65V高いバイアスで使えば、ドレイン電流の温度係数を零に押えることができるということを意味しています。

### ■チョッパ用

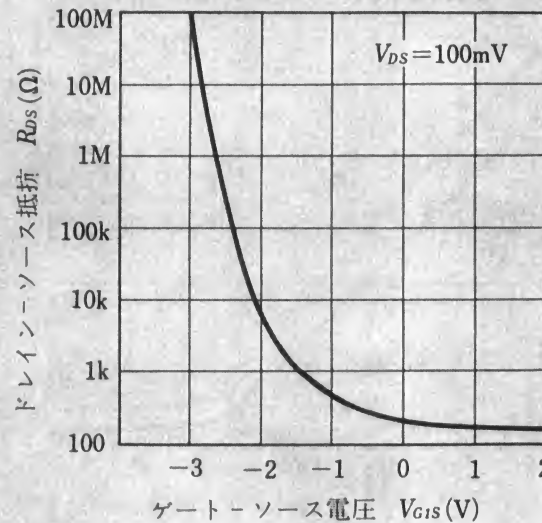
FETの立上がりの部分の特性が重要になってくるので、**図10**のような小レベルの出力特性が示されます。

FETの種類は違いますが**図10**で、 $V_{DS}$ を一定にして、ドレイン-ソース抵抗-ゲ-

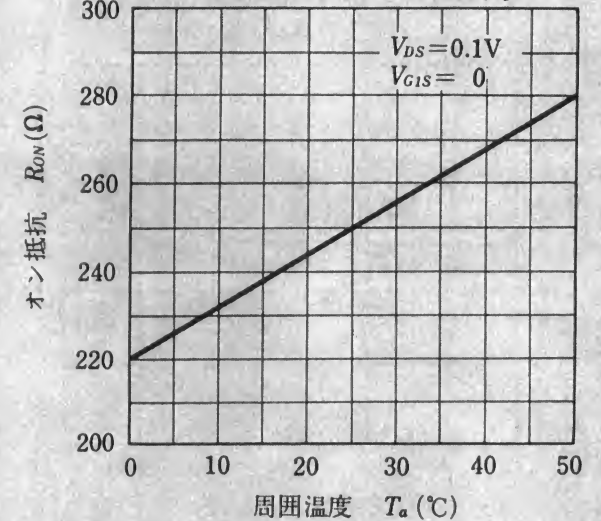
<図10>  $V_{DS}-I_D$  特性例



<図11>  $R_{DS}-V_{G1S}$  特性例



<図12>  $R_{ON}-T_a$  特性例



ト - ソース電圧特性を求めたのが図11です。

またチョッパ用の場合、オン抵抗やオフ抵抗の温度特性を知る必要があります、一例を図13に示します。

### ■高周波用

普通、高周波回路の設計には、Yパラメータが一番使われるので、Yパラメータの周波数特性、電圧電流依存性などが中心になります。図14に、ソース接地、図15にゲ

ート接地のYパラメータの一例を示します。

\* \* \*

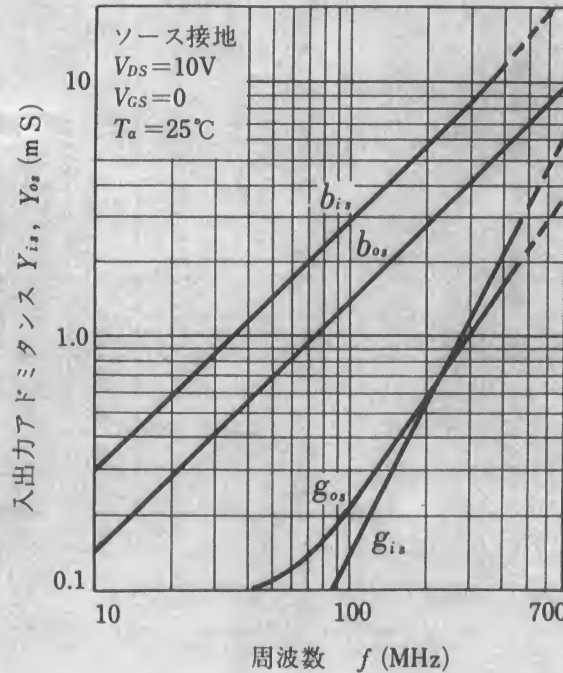
特性グラフではありませんが、高周波用として、問題になるものとして、高周波電力利得、雑音指数があります。

雑音指数の方は、各素子の最適信号源インピーダンスに合わせて、入力側でノイズマッチングをとったような形で、普通測定されるので、それほど問題はありますが、電力利得の方は、極端に言えば、測定回路

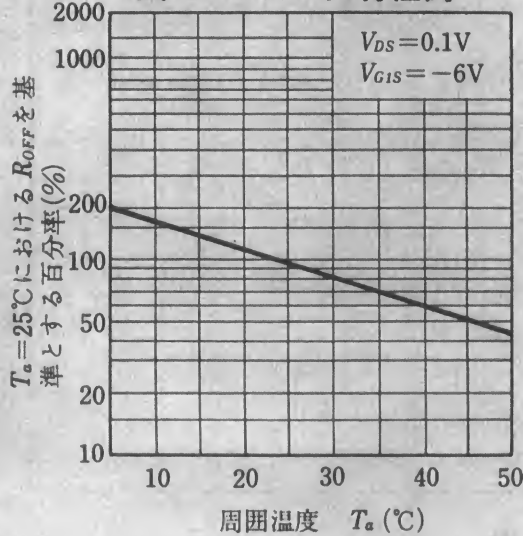
によって、ある程度自由に利得の大きさが変えられるので、P.G.の絶対値だけを比較しても意味がありません。

すなわち各メーカーのカタログにのっているのは、それぞれの測定回路で測った場合に、それだけの利得が得られるということで、個々の素子の比較は、同一の測定回路で測るか、あるいは、Yパラメータから計算するよりしょうがありません。

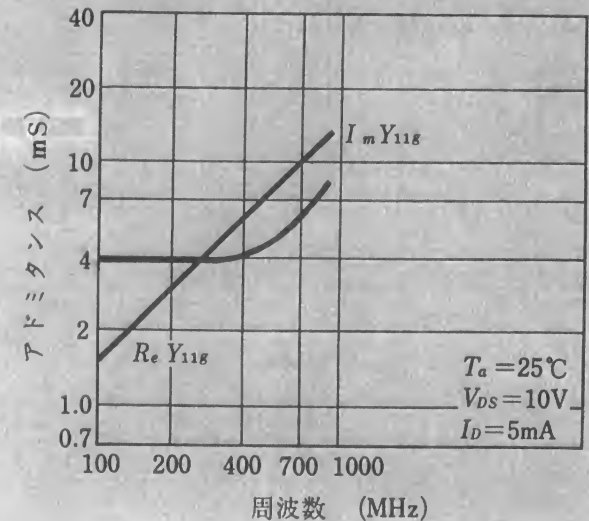
＜図14＞  $Y_{is} \cdot Y_{os} - f$  特性例



＜図13＞  $R_{OFF} - T_a$  特性例



＜図15＞  $Y_{ig} - f$  特性例





■用途別早見表&索引 (注 DG:デュアルゲート, 索引・特性図欄「'82年」とあるのは'82年版で収録)

型名	用途				高入カ スイン 回路	DC・AC コン デン サ マイ ク	低雑音 増幅 回路	低周波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索引(頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社名	構造	モード	区分																	
2SJ17	ソニー	J	D	一般		●												34	—		
" 18	"	J(V)	"	"					●									34	—		
" 22	"	J	"	"		●												34	—		
" 39	三菱	MOS	"	"	●		●											34	'83年	2SJ×2	
" 40	"	J	"	"				●				●						34	134		
" 43	松下	"	"	"	●		●											34	135		
" 44	日電	"	"	"			●											34	—		
" 45	"	"	"	"	●													34	—		
" 48	日立	MOS	E	"						●								34	'83年		
" 49	"	"	"	"						●								34	'83年		
" 50	"	"	"	"						●								34	'83年		
" 55	"	MOS	"	"						●								34	136		
" 56	"	"	"	"						●								34	136		
" 56Ⓣ	"	"	"	通工							●			●				40	136		
" 68	"	J	D	一般			●											34	'84年		
" 69	"	"	"	"			●											34	'84年		
" 70	"	"	"	"			●											34	'84年		
" 72	東芝	"	"	"	●		●											36	'83年		
" 73	"	"	"	"	●		●											36	'84年	2SJ×2	
" 74	"	"	"	"	●		●											36	'84年		
" 75	"	"	"	"	●		●											36	'84年	2SJ×2	
" 76	日立	MOS	E	"						●		●		●				36	137		
" 77	"	"	"	"						●		●		●				36	137		
" 77Ⓣ	"	"	"	通工							●			●				40	137		
" 78	"	"	"	一般						●		●		●				36	137		
" 79	"	"	"	"						●		●		●				36	137		
" 79Ⓣ	"	"	"	通工							●			●				40	137		
" 81	"	"	"	一般						●								36	'83年		
" 82	"	"	"	"						●								36	'83年		

型 名	用 途				DC・AC 高入力 インピ ダス 回路	コン テン サ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SJ 83	日 立	MOS	E	一 般						●								36	'83年		
" 84	松 下	J	D	"	●													36	138		
" 96	日 立	MOS	E	"						●			●					36	139		
" 99	"	"	"	"						●			●					36	140		
" 100	"	"	"	"						●			●					36	140		
" 101	"	"	"	"						●			●					38	141		
" 102	"	"	"	"						●			●					38	141		
" 103	東 芝	J	D	"	●							●						38	142		
" 104	"	"	"	"	●							●						38	143		
" 105	"	"	"	"	●							●						38	142		
" 106	"	"	"	"	●							●						38	142		
" 107	"	"	"	"	●							●						38	143		
" 108	"	"	"	"	●		●											38	'84年		
" 109	"	"	"	"	●		●											38	144	2SJ×2	
" 110	"	"	"	"	●							●						38	145		
" 111	"	"	"	"	●		●											38	145		
" 112	日 立	MOS	E	"							●		●					38	146		
" 113	"	"	"	"							●		●					38	146		
" 114	"	"	"	"							●		●					38	147		
" 115	東 芝	"	"	"						●								38	148		
" 116	日 立	"	"	"							●		●					38	149		
" 117	"	"	"	"							●		●					38	150		
" 118	"	"	"	"							●		●					38	140		
" 119	"	"	"	"							●		●					38	140		
" 120	"	"	"	"							●		●					38	151		
" 122	"	"	"	"							●		●					38	152		
" 123	東 芝	"	"	"						●								38	153		
" 125	三 菱	J	D	"			●					●						38	134		
" 126	東 芝	MOS	E	通 工							●							40			
3SJ 11A	日 電	"	"	"	●						●							40	'82年	3SJ×2	



型 名	用 途				D C 高 入 カ イ ン ス 回 路	コン デン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ デ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SK11	東 芝	J	D	通 工	●														42	'82年	
" 12	"	"	"	"	●		●												42	'82年	
" 15	"	"	"	"	●		●												42	'82年	
" 16Ⓣ	日 立	"	"	"	●														42	'82年	
" 18	東 芝	"	"	"	●														42	—	2SK×2
" 18A	"	"	"	"	●														42	—	2SK×2
" 23A	ソニー	"	"	一 般			●					●				●			42	—	
" 30ATM	東 芝	"	"	"	●		●												42	'83年	
" 33	三 菱	"	"	"												●			42	'82年	
" 34	"	"	"	"	●		●												42	'82年	
" 37	日 電	"	"	"												●			42	'83年	
" 38A	三 菱	MOS	D+E	"	●											●			42	'83年	
" 40	日 立	J	D	"	●		●												42	'82年	
" 42	ソニー	"	"	"						●						●			44	'82年	
" 43	"	"	"	"			●			●									44	'83年	
" 43Ⓢ	"	"	"	通 工	●		●				●								44	'83年	
" 43Ⓢ-D	"	"	"	"	●		●				●	●							44	'83年	
" 46	三 菱	"	"	一 般	●	●	●												44	'82年	
" 48	東 芝	"	"	通 工	●		●												44	'82年	
" 49	日 電	"	"	一 般												●			44	'82年	
" 54	日 立	"	"	"												●			44	'82年	
" 55	"	"	"	"												●			44	'82年	
" 57	日 電	"	"	"												●			44	'83年	
" 58	ソニー	"	"	"	●														44	—	2SK×2
" 59	日 立	"	"	"		●													44	'83年	
" 60	ソニー	J(V)	"	"															44	'83年	
" 63	"	"	"	"	●						●								44	'83年	
" 65	松 下	J	"	"		●													44	'83年	
" 66	"	"	"	"	●		●		●										44	'83年	
" 67	日 電	"	"	"			●												44	—	

型 名	用 途				D 高 入 カ イ ン ビ ル ス 回 路	コ ン テ ン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SK 67A	日 電	J	D	一 般	●													46	'83年		
" 68	"	"	"	"	●							●						46	'83年		
" 68A	"	"	"	"	●	●						●						46	'83年		
" 72	東 芝	"	"	通 工	●	●												46	—	2SK×2	
" 73	松 下	"	"	一 般	●				●									46	—		
" 79	ソニー	J(V)	"	"	●				●									46	'83年		
" 83	松 下	J	"	"										●				46	'83年		
" 84	"	"	"	"	●	●												46	'83年		
" 85	日 電	GaAsSB	"	通 工													●	46	'83年		
" 92	"	J	"	一 般		●												46	'83年		
" 93	ソニー	"	"	"		●												46	'83年		
" 94	日 電	"	"	"			●						●					46	'83年		
" 97	ソニー	"	"	"	●													46	'83年	2SK×2	
" 103	日 電	"	"	"		●												48	—		
" 104	"	"	"	"			●						●					48	'83年		
" 105	"	"	"	"			●						●					48	154		
" 107	ソニー	"	"	"	●	●					●		●					48	'83年		
" 108	三 菱	"	"	"			●						●					48	155		
" 109A	"	"	"	"	●	●												86	155	2SK×2	
" 110	"	"	"	"			●											48	156		
" 111	"	"	"	"	●	●												48	'83年	2SK×2	
" 112	東 芝	"	"	通 工	●	●					●	●						48	'83年		
" 113	"	"	"	"							●	●	●					48	'83年		
" 117	"	"	"	一 般	●	●												48	'83年		
" 118	"	"	"	"	●	●	●											48	'83年		
" 119	日 電	"	"	通 工	●								●					48	'83年		
" 120	ソニー	"	"	一 般											●			48	'83年		
" 121	"	"	"	"	●	●				●	●							48	—		
" 123	松 下	"	"	"		●												48	157		
" 124	日 電	GaAsSB	"	"													●	48	'83年		



型 名	用 途				高 入 カ イ ン ピ ー グ レ ッ ス 回 路	D C ・ A C 回 路	コ ン テ ン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ デ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R F F M I X	U R F F M I X	S R F F M I X	索 引 (頁)		備 考
									電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モード	区 分																		
2SK125	ソニー	J	D	一 般										●					48	'84年		
" 127	松 下	"	"	"	●		●												50	—		
" 127A	"	"	"	"	●		●												86	—		
" 128	"	"	"	"	●		●												50	158		
" 130	日 電	"	"	"			●						●						50	'83年		
" 130A	"	"	"	"			●												86	'83年		
" 131	"	"	"	"			●												50	159	2SK×2	
" 133	日 立	MOS	E	"							●								50	'83年		
" 134	"	"	"	"							●								50	'83年		
" 135	"	"	"	"							●								50	'83年		
" 136	松 下	J	D	"	●		●												50	160		
" 137	"	"	"	"			●												50	—		
" 137A	"	"	"	"			●												50	—		
" 138	日 電	GaAsSB	"	"													●		50	'84年		
" 140	"	"	"	"													●		50	'84年		
" 141	"	J	"	通 工	●								●						50	'83年		
" 141A	"	"	"	"	●								●						50	'83年		
" 146	東 芝	"	"	一 般	●		●												50	'84年	2SK×2	
" 147	"	"	"	"			●												50	'83年		
" 148	松 下	"	"	"												●			50	—		
" 149	日 電	"	"	通 工												●	●		50	'84年		
" 152	ソニー	"	"	一 般			●			●						●			52	'84年		
" 154	松 下	"	"	"												●			52	—		
" 155	"	"	"	"	●														52	161		
" 156	三 洋	"	"	"		●													52	'83年		
" 158	松 下	"	"	"			●												52	—		
" 160	日 電	"	"	"			●						●			●			52	154		
" 160A	"	"	"	"			●						●			●			86	154		
" 161	東 芝	"	"	"												●			52	'83年		
" 162	日 電	"	"	"			●												52	'84年		

型 名	用 途				高 入 カ イ ン ス 回 路	D C ・ A C 回 路	コ ン テ ン サ ウ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
									電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																		
2SK163	日 電	J	D	一 般			●												52	'84年		
" 165	松 下	"	"	"							●								52	162		
" 168	日 立	"	"	"											●				52	'83年		
" 169	松 下	"	"	"	●		●												52	—		
" 170	東 芝	"	"	"	●		●												52	'83年		
" 171	三 菱	"	"	"	●		●												52	'83年	2SK×2	
" 175	日 立	MOS	E	"						●									52	163		
" 176	"	"	"	"						●									54	163		
" 176①	"	"	"	通 工								●		●					86	163		
" 184	東 芝	J	D	一 般	●		●												54	'83年		
" 185	ソニー	"	"	"	●		●												54	—	2SK×2	
" 186	日 立	"	"	"			●												54	'84年		
" 187	"	"	"	"			●												54	164		
" 190	"	"	"	"			●												54	'84年		
" 191	"	"	"	"			●												54	'84年		
" 192A	東 芝	"	"	"											●				54	'84年		
" 193	日 電	"	"	"											●				54	'84年		
" 194	"	"	"	"			●												54	'84年	2SK×2	
" 195	"	"	"	"											●				54	'84年		
" 196①	日 立	MOS	E	通 工								●		●					54	'84年		
" 197	"	J	D	一 般											●				54	'84年		
" 198	松 下	"	"	"	●														54	158		
" 199	"	"	"	"											●				54	—		
" 201	日 電	GaAs	"	"													●		56	'84年		
" 203	"	"	"	"													●		56	'84年		
" 208	東 芝	J	"	"			●												56	'83年		
" 209	"	"	"	"	●														56	'83年		
" 210	"	"	"	"											●				56	'84年		
" 211	"	"	"	"											●				56	'83年		
" 212	三 洋	"	"	"											●				56	'84年		



型名	用途				高入カインピ D・C・A・C 回路	コンデンサマイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョップパ回路	S W 回路	可変抵抗回路	高周波出力	V R F F M I X	U R F F M I X	S R F F M I X	索引(頁)		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覽	特性図	
	社名	構造	モード	区分																	
2SK213	日立	MOS	E	一般					●			●		●				56	165		
" 214	"	"	"	"					●			●		●				56	165		
" 214Ⓞ	"	"	"	通工								●		●				86	165		
" 215	"	"	"	一般					●			●		●				56	165		
" 216	"	"	"	"					●			●		●				56	165		
" 216Ⓞ	"	"	"	通工								●		●				86	165		
" 217	"	J	D	一般											●			56	'84年		
" 218	松下	"	"	"						●								56	166		
" 220Ⓞ	日立	MOS	E	通工								●		●				56	'84年		
" 221Ⓞ	"	"	"	"								●		●				56	'84年		
" 222	三洋	J	D	一般			●											56	167		
" 223	"	"	"	"					●									56	'84年		
" 225	日立	MOS	E	"														56	168		
" 226	"	"	"	"														58	168		
" 227	"	"	"	"														58	168		
" 238	日電	J	D	"											●			58	'84年		
" 240	東芝	"	"	"	●		●											58	'84年	2SK×2	
" 241	"	MOS	D+E	"											●			58	'84年		
" 242	三洋	J	D	"											●			58	169		
" 246	東芝	"	"	"	●													58	'84年		
" 247	松下	"	"	"	●													58	170		
" 258Ⓞ	日立	MOS	E	通工								●		●				60	'84年		
" 259Ⓞ	"	"	"	"								●		●				60	'84年		
" 260Ⓞ	"	"	"	"								●		●				60	'84年		
" 265	東芝	J	D	一般	●		●											-	-	2SK×2	
" 266	"	"	"	"			●											60	171		
" 277	日電	MOS	E	通工								●						62	172		
" 278	"	"	"	"								●						62	172		
" 280	"	GaAs	D	一般													●	62	'84年		
" 281	"	"	"	"											●	●	●	62	'84年		

型 名	用 途				高 入 カ イ ン ビ ル 回 路	D C ・ A C	コ ン デ ン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ヨ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
									電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																		
2SK283	三 洋	J	D	一 般						●									62	'84年		
" 286	日 立	MOS	E	"								●		●					62	173		
" 287Ⓞ	"	"	"	通 工								●		●					62	174		
" 288Ⓞ	"	"	"	"								●		●					62	174		
" 291	"	J	D	一 般	●														62	175		
" 292	日 電	"	"	"												●			62	'84年		
" 293	"	MOS	E	通 工								●							62	176		
" 293A	"	"	"	"								●							62	176		
" 294	日 立	"	"	一 般								●		●					62	177		
" 295	"	"	"	"								●		●					62	177		
" 296	"	"	"	"								●		●					62	'84年		
" 298	"	"	"	"								●		●					62	178		
" 299	"	"	"	"								●		●					62	178		
" 301	松 下	J	D	"	●							●							64	179		
" 302	東 芝	MOS	D+E	"												●			64	'84年		
" 303	三 洋	J	D	"	●								●						64	180		
" 304	"	"	"	"	●								●						64	180		
" 308	日 立	MOS	E	"									●		●				64	'84年		
" 310	"	"	"	"									●		●				64	181		
" 311	"	"	"	"									●		●				64	181		
" 312	"	"	"	"									●		●				64	182		
" 313	"	"	"	"									●		●				64	182		
" 314	日 電	J	D	通 工			●												64	183		
" 315	三 洋	"	"	一 般												●			64	184		
" 316	松 下	"	"	"							●								64	185		
" 317	日 立	MOS	E	"											●				64	186		
" 318	"	"	"	"											●				64	187		
" 319	"	"	"	"								●		●					64	188		
" 320	"	"	"	"								●		●					64	188		
" 321	松 下	J	D	"	●							●							64	189		

型 名	用 途				DC・AC 高入力インピ ダンス回路	コンデンサマイク	低雑音増幅回路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ヨ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R F M I X	U R F M I X	S R F M I X	索 引 (頁)		備 考
	社 名	構 造	モード	区 分				電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
2SK322	日 立	J	D	一 般	●						●							64	190		
" 323	"	"	"	"	●													64	191		
" 324	東 芝	MOS	E	通 工							●							64	192		
" 325	"	"	"	"							●							64	193		
" 330	"	J	D	一 般	●							●						66	194		
" 331	三 洋	"	"	"		●												66	'83年		
" 332	"	"	"	"	●													66	195	2SK×2	
" 333	"	"	"	"	●													66	196	2SK×2	
" 334	"	"	"	"		●												66	'83年		
" 336	"	MOS	E	"								●						66	197		
" 337	日 電	"	"	通 工							●							66	198		
" 343	日 立	"	"	一 般							●			●				66	199		
" 344	"	"	"	"							●			●				66	199		
" 345	"	"	"	"							●			●				66	200		
" 346	"	"	"	"							●			●				66	200		
" 347	"	"	"	"							●			●				66	201		
" 349	"	"	"	"							●			●				66	202		
" 350	"	"	"	"							●			●				66	202		
" 351	"	"	"	"							●			●				68	203		
" 352	"	"	"	"							●			●				68	204		
" 353	日 電	GaAs	D	"													●	68	205		
" 354	"	"	"	"													●	68	206		
" 354 A	"	"	"	"													●	90	206		
" 355	東 芝	MOS	E	通 工							●							68	207		
" 356	"	"	"	"							●							68	208		
" 357	"	"	"	"							●							68	209		
" 358	"	"	"	"							●							68	210		
" 359	日 立	"	D+E	一 般											●			68	211		
" 360	"	"	"	"											●			68	211		
" 362	東 芝	J	D	"	●								●					68	212		



型 名	用 途				DC・AC 高入力 スイッチ 回路	コン デン サ マイ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F M I X	U H F M I X	S H F M I X	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SK363	東 芝	J	D	一 般	●								●					68	213		
" 364	"	"	"	"	●								●					68	214		
" 365	"	"	"	"	●								●					68	212		
" 366	"	"	"	"	●								●					68	214		
" 367	"	"	"	"	●													68	215		
" 368	"	"	"	"	●													68	215		
" 369	"	"	"	"			●											68	'83年		
" 370	"	"	"	"			●											68	'83年		
" 371	"	"	"	"			●											68	'83年		
" 372	"	"	"	"	●								●					68	213		
" 373	"	"	"	"	●													68	216		
" 374	松 下	"	"	"	●							●						68	179		
" 375	日 立	MOS	E	"								●		●				68	217		
" 376	三 洋	J	D	"		●												70	218		
" 377	"	"	"	"		●												70	218		
" 378	松 下	GaAs	"	"												●		70	219		
" 379	"	MOS	E	"								●						70	220		
" 380	"	"	"	"								●						70	221		
" 381	三 菱	J	D	"			●						●					70	222		
" 382	日 立	MOS	E	"								●		●				70	223		
" 383	"	"	"	"								●		●				70	224		
" 384	"	"	"	"								●		●				70	225		
" 385	東 芝	"	"	通 工								●						70	226		
" 386	"	"	"	"								●						70	227		
" 387	"	"	"	"								●						70	228		
" 388	"	"	"	"								●						70	229		
" 389	"	J	D	一 般	●		●											70	230	2SK×2	
" 398	日 立	MOS	E	"								●		●				70	231		
" 399	"	"	"	"								●		●				70	232		
" 400	"	"	"	"								●		●				70	233		

型 名	用 途				DC・AC 高入カイン ダレンス回 路	コン テンサマイ ク	低 雑音増幅 回路	低 周 波			ビ テオ増幅	チ ョッパ回 路	S W 回 路	可 変抵抗回 路	高 周波出力	V RFF M IX	U RFF M IX	S RFF M IX	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SK401	日 立	MOS	E	一 般								●		●				72	234		
" 402	"	"	"	"								●		●				72	235		
" 403	"	"	"	"								●		●				72	235		
" 404	三 洋	J	D	"				●										72	236		
" 405	東 芝	MOS	E	"						●								72	237		
" 406	日 電	GaAs	D	"													●	72	238		
" 407	"	"	"	"													●	72	238		
" 408	日 立	MOS	E	"										●				72	239		
" 409	"	"	"	"										●				72	239		
" 410	"	"	"	"										●				72	240		
" 411	"	"	"	"							●			●				72	241		
" 412	"	"	"	"							●			●				72	242		
" 413	"	"	"	"							●			●				72	243		
" 414	"	"	"	"							●			●				72	243		
" 415	"	"	"	"							●			●				72	244		
" 416	"	"	"	"							●			●				72	245		
" 417	東 芝	"	"	通 工							●							72	246		
" 418	"	"	"	"							●							72	247		
" 419	"	"	"	"							●							72	248		
" 420	"	"	"	"							●							72	249		
" 421	"	"	"	"							●							72	250		
" 422	"	"	"	"							●							72	251		
" 423	"	"	"	"							●							72	252		
" 424	日 電	"	"	"							●							72	253		
" 425	"	J	D	一 般			●											72	254		
" 426	"	"	"	"			●											74	254		
" 427	三 洋	"	"	"				●							●			74	255		
" 428	日 立	MOS	E	"							●			●				74	256		
" 429	"	"	"	"							●			●				74	257		
" 430	"	"	"	"							●			●				74	258		

型名	用途				DC・AC 高入力インピ ダンス回路	コンデンサマイク	低雑音増幅回路	低周波			ビデオ増幅	チョップ回路	S W 回路	可変抵抗回路	高周波出力	VHF RFF MIX	UHF RFF MIX	SHF RFF MIX	索引(頁)		備考
								電圧増幅	ドライバ	出力									規格一覽	特性 図	
	社名	構造	モード	区分																	
2SK431	日立	J	D	一般	●													74	164		
" 433	三菱	"	"	"				●					●					74	222		
" 435	日立	"	"	"	●		●											74	259		
" 436	三洋	"	"	"				●							●			74	255		
" 437	松下	GaAs	"	"												●		74	260		
" 437①	"	"	"	"												●		90	260		
" 438	"	"	"	"												●		74	260		
" 439	日立	MOS	D+E	"											●			74	211		
" 440	"	"	E	"							●			●				74	261		
" 441	"	"	"	"							●			●				74	262		
" 442	東芝	"	"	"					●		●							74	263		
" 443	三洋	J	D	"						●								74	264		
" 444	"	"	"	"						●								74	264		
" 445	"	"	"	"						●								74	264		
" 446	日電	MOS	E	"						●								74	265		
" 447	東芝	"	"	通工						●								74	266		
" 448	日電	"	"	"						●								74	267		
" 449	"	"	"	"						●								74	268		
" 453	"	"	"	"										●				76	-		
" 454	"	"	"	"										●				76	-		
" 455	東芝	J	D	一般		●												76	269		
" 456	"	"	"	"		●												76	269		
" 457	日立	GaAs	"	"											●	●		76	-		
" 458	日電	MOS	E	通工						●								76	-		
" 459	"	"	"	"						●								76	-		
" 462	"	"	"	一般						●								76	-		
" 463	"	"	"	通工						●								76	-		
" 464	"	"	"	"						●								76	-		
" 468	"	"	"	一般						●								76	-		
" 470	"	"	"	"						●								76	-		



型 名	用 途				DC・AC 高入力 インピ ダンス 回路	コン デン サ マイ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V H F F M I X	U H F F M I X	S H F F M I X	索 引 (頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
2SK477	日 電	MOS	E	通 工.								●						78	—		
" 482	"	"	"	"								●						78	—		
" 492	三 菱	J	D	一 般			●						●					78	155		
" 493	三 洋	"	"	"								●						78	270		
" 494	日 立	"	"	"	●		●												259		
" 505	日 電	"	"	"	●							●						80	271		
" 507	"	"	"	"	●							●						80	271		
" 508	"	"	"	"	●							●						80	271		
" 511	日 立	MOS	E	"								●		●				80	272		
" 512	"	"	"	"								●						80	273		
" 513	"	"	"	"								●		●				80	274		
" 518	日 電	J	D	"									●					80	275		
" 519	"	"	"	"									●					80	275		
" 520	"	"	"	"									●					80	275		
" 525	東 芝	MOS	E	通 工.								●						80	—		
" 526	"	"	"	"								●						82	—		
" 527	"	"	"	"								●						82	—		
" 528	"	"	"	"								●						82	—		
" 529	"	"	"	"								●						82	—		
" 530	"	"	"	"								●						82	—		
" 531	"	"	"	"								●						82	—		
" 532	"	"	"	"								●						82	—		
" 534	日 立	"	"	一 般								●						82	276		
" 535	"	"	"	"								●						82	277		
" 537	東 芝	"	"	通 工.								●						82	—		
" 538	"	"	"	"								●						82	—		
" 539	"	"	"	"								●						82	—		
" 572	"	"	"	一 般								●						84			
" 573	"	"	"	"								●						84			
2N4392	日 電	J	D	通 工.								●	●					42	'83年		

型 名	用 途				グ 高 入 カ ス 回 路	D C ・ A C	コ ン テ ン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ テ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R H F M I X	U R H F M I X	S R H F M I X	索 引 (頁)		備 考
									電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																		
2N4393	日 電	J	D	通 工															42	'83年		
3SK 14	"	MOS	D+E	"	●														92	'82年		
" 20Ⓣ	日 立	"	"	"	●														92	'83年		
" 21Ⓣ	"	"	"	"															92	'83年		
" 22	東 芝	J	D	一 般												●			92	—		
" 28	"	"	"	通 工	●		●				●					●			92	'83年		
" 29	日 電	MOS	D+E	"	●														92	'83年		
" 37	ソニー	"	"	一 般												●			96	—	DG	
" 38A	東 芝	"	E	通 工															92	'83年		
" 39	松 下	"	D+E	一 般												●			96	'83年	DG	
" 39㉔	"	"	"	通 工												●			96	—	DG	
" 40	日 電	"	"	一 般												●			96	'83年	DG	
" 45	日 立	"	"	"												●			96	'83年	DG	
" 47	日 電	"	"	通 工									●			●			96	285	DG	
" 48	ソニー	"	"	一 般													●		96	—	DG	
" 49	松 下	"	"	"												●			96	'83年	DG	
" 49NC	"	"	"	"												●			96	—	DG	
" 49㉔	"	"	"	通 工												●			96	—	DG	
" 51	日 立	"	"	一 般												●			96	'83年	DG	
" 53	"	"	"	"													●		96	'83年	DG	
" 59	東 芝	"	"	通 工												●			96	—	DG	
" 60	日 立	"	"	一 般												●			96	286	DG	
" 61	ソニー	"	"	"												●			96	—	DG	
" 63	東 芝	"	"	通 工												●			96		DG	
" 66	松 下	"	"	一 般													●		96	—	DG	
" 70	日 立	"	"	"													●		96	'83年	DG	
" 71	日 電	J	D	"			●												94	287		
" 72	松 下	MOS	D+E	"												●			96	'84年	DG	
" 73	東 芝	"	"	"												●			96	'83年	DG	
" 74	日 電	"	"	"												●			96	'84年	DG	

型 名	用 途				DC・AC 高入力インピ ダンス回路	コンデンサマイク	低雑音増幅回路	低 周 波			ビデオ増幅	チヨツパ回路	S W 回路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R F F M I X	U R F F M I X	S R F F M I X	索引(頁)		備 考
								電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 、 一 覧	特 性 図	
	社 名	構 造	モ ー ド	区 分																	
3SK 77	東 芝	MOS	D+E	一 般											●			98	'83年	DG	
" 79	松 下	"	"	"												●		98	-	DG	
" 80	日 立	"	"	"												●		98	'84年	DG	
" 81	"	"	"	"											●			98	288	DG	
" 82	"	"	"	"												●		98	289	DG	
" 83	"	"	"	"											●			98	'84年	DG	
" 85	"	"	"	"											●			98	'84年	DG	
" 87	日 電	"	"	"												●		98	'84年	DG	
" 88	"	"	"	"												●		98	'84年	DG	
" 95	日 立	"	"	"												●		98	'84年	DG	
" 96	"	"	"	"											●			98	290	DG	
" 97	松 下	GaAs	D	"												●		98	'84年	DG	
" 100	"	MOS	D+E	"												●		98	291	DG	
" 101	東 芝	"	"	"											●			100	'84年	DG	
" 102	"	"	"	"												●		100	'84年	DG	
" 103	日 立	"	"	"												●		100	292	DG	
" 104	"	"	"	"												●		100	293	DG	
" 104 V	"	"	"	"											●			102	-	DG	
" 107	三 洋	"	"	"											●			100	315	DG	
" 108	"	"	E	"											●			100	294	DG	
" 113	日 立	GaAs	D+E	"												●		100	295	DG	
" 114	東 芝	MOS	"	"											●			100	296	DG	
" 115	"	"	"	"												●		100	-	DG	
" 116	松 下	"	"	"											●			100	297	DG	
" 121	東 芝	GaAs	D	"												●		100	298	DG	
" 123	日 電	MOS	D+E	"												●		100	299	DG	
" 126	東 芝	"	"	"											●			102	300	DG	
" 127	"	"	"	"												●		102	301	DG	
" 129	松 下	GaAs	D	"												●		102	-		
" 131	日 電	MOS	D+E	"											●			102	302	DG	



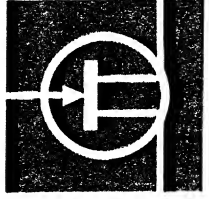
型 名	用 途				DC・AC 高入力イン ダクタ回路	コンデンサマイク	低雑音増幅回路	低 周 波			ビデオ増幅	チヨツパ回路	S W 回路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R F F M I X	U R F F M I X	S R F F M I X	索 引 (頁)		備 考
	社 名	構 造	モード	区 分				電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
3SK132	H 電	MOS	D+E	一 般												●		102	303	DG	
" 133	"	"	"	"												●		102	304	DG	
" 136	日 立	"	"	"											●			102	288	DG	
" 137	"	"	"	"												●		102	—	DG	
" 138	"	"	"	"												●		102	292	DG	
" 140	東 芝	GaAs	D	"												●		102	305	DG	
" 141	松 下	"	"	"												●		102	—		
" 145	東 芝	MOS	D+E	"												●		—	306	DG	
" 146	"	"	"	"												●		86	306	DG	
" 150	"	"	"	"											●			102	307	DG	
" 151	"	"	"	"											●			104	307	DG	
FLC 08ME	富士通	GaAs	D	"													●	86	278		
" 15ME	"	"	"	"													●	86	278		
" 30ME	"	"	"	"													●	86	278		
" 081 WF	"	"	"	"													●	86	279		
" 151WF	"	"	"	"													●	86	279		
" 301MG	"	"	"	"													●	86	279		
FLM3472	"	"	"	"													●	86	—		
" 4450	"	"	"	"													●	86	—		
" 5964	"	"	"	"													●	86	—		
" 6472	"	"	"	"													●	88	—		
" 7177	"	"	"	"													●	88	—		
" 7785	"	"	"	"													●	88	—		
FLS09/ME	"	"	"	"													●	88	280		
" 16/ME	"	"	"	"													●	88	280		
" 31/ME	"	"	"	"													●	88	280		
" 50/ME	"	"	"	"													●	88	280		
FLX03MB	"	"	"	"													●	88	'84年		
" 06MB	"	"	"	"													●	88	'84年		
" 12MB	"	"	"	"													●	88	'84年		

型 名	用 途				高 入 カ ・ A C 回 路	コ ン テ ン サ マ イ ク	低 雑 音 増 幅 回 路	低 周 波			ビ デ オ 増 幅	チ ョ ッ パ 回 路	S W 回 路	可 変 抵 抗 回 路	高 周 波 出 力	V R F F M I X	U R F F M I X	S R F F M I X	索 引 (頁)		備 考
	社 名	構 造	モード	区 分				電 圧 増 幅	ド ラ イ バ	出 力									規 格 一 覧	特 性 図	
FSC05FA	富士通	GaAs	D	一 般													●	—	—		
" 06FA	"	"	"	"													●	—	—		
" 07FA	"	"	"	"													●	—	—		
FSX51W/WF	"	"	"	"													●	88	'84年		
" 52W/WF	"	"	"	"													●	88	'84年		
" 53W/WF	"	"	"	"													●	88	'84年		
M21F	松 下	MOS	—	"		●												—	—		
" 46F	"	J	D	"			●	●										40	—	2SJ×2	
" 47F	"	"	"	"	●													88	281	2SK×2	
MGF-1100	三 菱	GaAs	"	"												●	●	103	308	DG	
" -1202	"	"	"	"													●	88	309		
" -1402	"	"	"	"													●	88	310		
" -1403	"	"	"	"													●	88	311		
" -1404	"	"	"	"													●	88	312		
" -1412	"	"	"	"													●	88	312		
" -1801	"	"	"	"													●	90	313		
" -1802	"	"	"	"													●	90	313		
" -2116	"	"	"	"													●	90	—		
" -2117	"	"	"	"													●	90	—		
" -2124	"	"	"	"													●	90	314		
" -2124F	"	"	"	"													●	90	314		
" -2124G	"	"	"	"													●	90	314		
" -2148	"	"	"	"													●	90	315		
" -2148F	"	"	"	"													●	90	315		
" -2148G	"	"	"	"													●	90	315		
" -2172	"	"	"	"													●	90	316		
" -2205	"	"	"	"													●	90	316		
" -X34M	"	"	"	"													●	90	316		
PM1210B	日 立	MOS	E	"								●						94	282	2SK×2モジュール	
" 1220B	"	"	"	"								●						94	283	2SK×2モジュール	





このページは空白です。



規格一覽表  
外形寸法図

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>CDX</sub> <sup>*</sup>	V <sub>DSX</sub> <sup>*</sup>	V <sub>GSO</sub> <sup>*</sup>	I <sub>G</sub>	P <sub>a</sub>	T <sub>i</sub>	I <sub>GSS</sub>	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GStoff</sub> , V <sub>th</sub> <sup>*</sup> (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ <sup>*</sup>			g <sub>os</sub> (mS)				
				(V)	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(nA)	min	max	V <sub>DS</sub>	min	max	V <sub>DS</sub>	I <sub>D</sub>	min	typ	max	V <sub>DS</sub>	I <sub>D</sub>	r <sub>D</sub> <sup>*</sup> (Ω)		
★ 2SJ11	東芝	DC, 低周波 チョップパ	J	20			-10	100	150	1	10	-0.05	-0.9	-10	0.7	5.0	-10	-0.1	0.1		0.6	-10	I <sub>DSS</sub>		
★ 2SJ12	"	"	"	20			-10	100	150	0.1	10	-0.09	-0.9	-10	0.7	5.0	-10	-0.1	0.1		0.6	-10	"		
★ 2SJ13	"	"	"	20			-100	600	150	10	10	-1.0	-12	-10	1.0	6.0	-10	-0.1	1.5		6.0	-10	"		
★ 2SJ15	富士通	DC, 低周波	"	18 <sup>*</sup>		15	-10	200	175	50	9	-1.5typ		-12		6.0	-10	-10	0.2	1.0	3.0	-12	"		
★ 2SJ16	"	"	"	18 <sup>*</sup>		15	-10	200	175	10	9	-1.5typ		-12		6.0	-10	-10	0.2	1.0	3.0	-12	"		
2SJ17	ソニー	コンデンサ・マイク	"	20 <sup>*</sup>		0.3	0.5 1	10	85	0.1	0.1	I <sub>DSS</sub> -0.11 -0.16		-9					0.2						
2SJ18	"	低周波電力増幅	J(V)	170 <sup>*</sup>		分類有	(A) -0.5, -5	63W	120	I <sub>DGO</sub> -100μA	V <sub>DC</sub> -100				7.5	25	-60	-100mA		4 <sup>*</sup>		-20	-1A	16Ω <sup>*</sup>	
★ 2SJ19	日電	低周波ドライバ	"	140 <sup>*</sup>	-140	30	-20 -100	800	150	10μA	20	-1.8	-48	-5						30 <sup>*</sup>		-10	-10	1.5	
★ 2SJ20	"	低周波電力増幅	"	100 <sup>*</sup>	-100	40	-100 -10A <sup>*</sup>	100W	150	100μA	30	-3A	-8A	-5	5.5	16.5	-35	-50mA	2 <sup>*</sup>	4 <sup>*</sup>		-10	-1A	10 <sup>*</sup>	
2SJ22	ソニー	コンデンサ・マイク	J	80 <sup>*</sup>		0.5	0.5 1 <sup>*</sup>	50	85	I <sub>DGR</sub> -0.05	V <sub>GD</sub> 20	-0.3	-0.7	-20					0.2			-20			
2SJ39	三菱	低周波	"	50 <sup>*</sup>		50	-10 -20 <sup>*</sup>	150 unit	125 <sup>*</sup>	1	30	-1	-12	-10		6	-10	-10	1.5			-10	I <sub>DSS</sub>		
2SJ40	"	低周波電圧増幅 アナログSW	"	50 <sup>*</sup>			-10	300	125 <sup>*</sup>	1	30	-1	-12	-10	0.3	6	-10	-10	1.5	4		-10	"		
2SJ43	松下	低周波	"	50			20 <sup>*</sup>	250	125	0.1μA	30	-0.5	-12	-10	0.2	3	-10	-10	3	9		-10	"		
2SJ44	日電	低周波・低雑音	"	40 <sup>*</sup>	-40	40	-10 -30 <sup>*</sup>	400	125	1	20	-1	-18	-10	0.2	1.5	-10	-10	7	9		-10	-1		
2SJ45	"	低周波	"	40 <sup>*</sup>	-40	40	-10 -30 <sup>*</sup>	400	125	1	20	-1	-18	-10	0.2	1.5	-10	-10	7	9		-10	-1		
★ 2SJ47	日立	低周波電力増幅	MOS		-100	±14 <sup>*</sup>	-7A <sup>*</sup>	100W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						0 <sup>*</sup>	-1.5 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.6	(S) 1	1.3	-10	≈-3A		
2SJ48	"	"	"		-120	±14 <sup>*</sup>	-7A <sup>*</sup>	100W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						-0.15 <sup>*</sup>	-1.45 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
2SJ49	"	"	"		-140	±14 <sup>*</sup>	-7A <sup>*</sup>	100W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						-0.15 <sup>*</sup>	-1.45 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
2SJ50	"	"	"		-160	±14 <sup>*</sup>	-7A <sup>*</sup>	100W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						-0.15 <sup>*</sup>	-1.45 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
★ 2SJ51	"	低周波・低雑音	J	40 <sup>*</sup>	-40	40 <sup>*</sup>	-10 -200 <sup>*</sup>	800 <sup>*</sup>	125 <sup>*</sup>	10	40	-6	-50	-10	0.2	1.1	-10	-10	33	40		-10	-5		
2SJ55	"	低周波電力増幅	MOS		-180	±20 <sup>*</sup>	-8A <sup>*</sup>	125W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						-0.15 <sup>*</sup>	-1.45 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4				
2SJ56	"	"	"		-200	±20 <sup>*</sup>	-8A <sup>*</sup>	125W <sup>*</sup>	150 <sup>*</sup>						-0.15 <sup>*</sup>	-1.45 <sup>*</sup>	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4				
2SJ68	"	低周波, 低雑音	J		-40	40 <sup>*</sup>	-10 -30 <sup>*</sup>	300	150 <sup>*</sup>	10	30	-1.6	-12	-10	0.13	1.5	-10	-10	8	12		-10	-3		
2SJ69	"	"	"		-40	40 <sup>*</sup>	-10 -30 <sup>*</sup>	300	150 <sup>*</sup>	10	30	-2.5	-20	-10	0.13	1.5	-10	-10	18	21		-10	-3		
2SJ70	"	"	"		-40	40 <sup>*</sup>	-10 -200 <sup>*</sup>	800	150 <sup>*</sup>	10	30	-6	-50	-10	0.13	1.5	-10	-10	35	45		-10	-5		

電 気 的 特 性 (T <sub>a</sub> =25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
C <sub>i</sub> . (pF)				C <sub>o</sub> . (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>r</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)									
typ	max	V <sub>Gs</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max	V <sub>Gd</sub> (V) V <sub>Gs</sub> (V)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max						V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	
2	4	1	0					1		-10	I <sub>DSS</sub>						2	2SJ11	★		
2	4	1	0					0.5		-10							2	2SJ12	★		
8	12	1	0					入力換算雑音電圧 5μV <sub>max</sub> (V <sub>Ds</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-1mA, Δf=10~100Hz, R <sub>r</sub> =1MΩ)								35	2SJ13	★			
6		1	0					4		-6	-0.5						1	2SJ15	★		
6		1	0					4		-6	-0.5						1	2SJ16	★		
																	47	2SJ17			
190		15	0					V <sub>ON</sub> =-10V <sub>max</sub> (I <sub>G</sub> =-0.2A, I <sub>D</sub> =-3A, t=100ms)				2SK60とコンプリメンタリ				45	2SJ18				
								μ=10min (V <sub>Ds</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-10mA)				2SK69とコンプリメンタリ				41	2SJ19	★			
710		-100*	-10														42	2SJ20	★		
																	48	2SJ22			
20		0	-10					(f=100Hz, R <sub>r</sub> =100kΩ) 5   -10   -1				I <sub>DSS</sub> 小/I <sub>DSS</sub> 大=0.85min (V <sub>Ds</sub> =-10V) ΔV <sub>Gs</sub> =50mV <sub>max</sub> (V <sub>Ds</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-1mA)				81	2SJ39				
18		0	-10					R <sub>DS(ON)</sub> =220Ω <sub>typ</sub> (f=1kHz, V <sub>Ds</sub> =10mV <sub>rms</sub> ) V <sub>Gs</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA				2SK381とコンプリメンタリ				151	2SJ40				
22		0	-10	3.6		0*	-10	NV=80mV <sub>max</sub> (R <sub>r</sub> =100kΩ, G <sub>v</sub> =80dB)								80A	2SJ43				
50		0	0	10		0*	-10	NV=20mV <sub>max</sub> (指定回路による)								53A	2SJ44				
50		0	-10	10		0*	-10	NV=50mV <sub>max</sub> ( " )								53A	2SJ45				
900		-5		40		5*		V <sub>DS(sat)</sub> =-12V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> =-7A, V <sub>GD</sub> =0)				2SK132とコンプリメンタリ				28A	2SJ47	★			
900		5	-10	40		5*	-10	"				2SK133とコンプリメンタリ				28A	2SJ48				
900		5	-10	40		5*	-10	"				2SK134とコンプリメンタリ				28A	2SJ49				
900		5	-10	40		5*	-10	"				2SK135とコンプリメンタリ				28A	2SJ50				
								1	3	(R <sub>r</sub> =1kΩ) -10   -5							2SK151とコンプリメンタリ	2SJ70	97	2SJ51	★
1,000		5	-10	50		5*	-10	V <sub>DS(sat)</sub> =-12V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> =-8A, V <sub>GD</sub> =0)				2SK175とコンプリメンタリ				28A	2SJ55				
1,000		5	-10	50		5*	-10	"				2SK176とコンプリメンタリ				28A	2SJ56				
32		0	-10	7.5		0*	-10	V <sub>N</sub> =25mV <sub>max</sub>								79	2SJ68				
82		0	-10	19		0*	-10	V <sub>N</sub> =20mV <sub>max</sub>								79	2SJ69				
150		-5*	-10					V <sub>N</sub> =10mV <sub>max</sub>								97	2SJ70				



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電氣的特性 (Ta=25°C)																
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> V <sub>GDX</sub> (V)	V <sub>DSX</sub> V <sub>DSS</sub> (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> V <sub>Gsx</sub> (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA)*	max		I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>GStoff</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)			
														min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> typ	r <sub>D</sub> max		
2SJ72	東芝	低周波, 低雑音	J	25			-10	600	125	1	25	-5	-30	-10	0.3	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-5mA)			10	I <sub>DSS</sub>		
2SJ73	"	"	"	25			-10	600 unit	125	1	25	-5	-30	-10	0.3	2.0	-10	-0.1	25	40		-10	"		
2SJ74	"	"	"	25			-10	400	125	1	25	-1	-20	-10	0.15	2.0	-10	-0.1	8	22		-10	"		
2SJ75	"	"	"	25			-10	400 unit	125	1	25	-2.6	-20	-10	0.15	2.0	-10	-0.1	15	22		-10	"		
2SJ76	日立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		-140	±15*	-500*	30W*	150*						-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10		
2SJ77	"	"	"		-160	±15*	-500*	30W*	150*						-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10		
2SJ78	"	"	"		-180	±15*	-500*	30W*	150*						-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10		
2SJ79	"	"	"		-200	±15*	-500*	30W*	150*						-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10		
2SJ81	"	低周波電力増幅	"		-120	±15*	-7A*	100W*	150*						-0.15	-1.45	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
2SJ82	"	"	"		-140	±15*	-7A*	100W*	150*						-0.15	-1.45	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
2SJ83	"	"	"		-160	±15*	-7A*	100W*	150*						-0.15	-1.45	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A		
2SJ84	松下	低周波	J	15			-10, -20	200	125	0.1μA	15	-0.5	-12	-10	0.2	3	-10	-10		9		-10	I <sub>DSS</sub>		
2SJ88																									
2SJ89																									
★ 2SJ90	東芝	低周波, 低雑音	J	30			-10	200 unit	125	10	30	-2.6	-20	-10	0.2	2.0	-10	-0.1	8	22		-10	I <sub>DSS</sub>		
★ 2SJ91	"	低周波電力増幅	MOS		-140	±8*	-8A*	120W	150*	±1μA	±8				-0.8	-2.4	-10	-100mA	1	(S) 1	1.5	-10	-2A		
★ 2SJ92	"	"	"		-140	±8*	-7A	100W	150*	±1μA	±8				-0.8	-2.4	-10	-100mA	1	(S) 1	1.5	-10	-2A		
2SJ93																									
2SJ94																									
2SJ95																									
2SJ96	日立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		-60	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20				-0.2	-1.5	-10	-10mA	1	(S) 1.6	2.5	-10	-3A		
2SJ97																									
2SJ98																									
2SJ99	日立	低高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		-140*	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20	-1	-120	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.8			-10	-4A		
2SJ100	"	"	"		-160*	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20	-1	-140	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.8			-10	-4A		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)										そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>o</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)						NF (f=100MHz) (dB)			
typ	max	V <sub>Gs</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max	V <sub>Gd</sub> (V) V <sub>Gs</sub> (V)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max					V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max
185		0	-10	55		10	I <sub>D</sub> =0	(R <sub>g</sub> =100Ω) 1 2			NF=10dBmax (V <sub>Ds</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-5mA) R <sub>g</sub> =100Ω, f=100Hz			2SK147とコンプリメンタリ	74A	2SJ72	
185		0	-10	55		10	I <sub>D</sub> =0	1	2	(R <sub>g</sub> =100Ω) -10   -5			ΔV <sub>Gs</sub> =20mVmax		2SK146とコンプリメンタリ	98	2SJ73
105		0	-10	32		10	I <sub>D</sub> =0	0.5	2	(R <sub>g</sub> =1kΩ) -10   -1					2SK170とコンプリメンタリ	90	2SJ74
105		0	-10	32		10	I <sub>D</sub> =0	0.5	2	(R <sub>g</sub> =1kΩ) -10   -1			ΔV <sub>Gs</sub> =20mVmax		2SK240とコンプリメンタリ	99	2SJ75
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	V <sub>Ds(sat)</sub> = -2Vmax (I <sub>D</sub> = -10mA, V <sub>Gd</sub> = 0)						2SK213とコンプリメンタリ	116A	2SJ76	
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	"						2SK214とコンプリメンタリ	116A	2SJ77	
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	"						2SK215とコンプリメンタリ	116A	2SJ78	
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	"						2SK216とコンプリメンタリ	116A	2SJ79	
900		5	-10	40		5*	-10	V <sub>Ds(sat)</sub> = -12Vmax (I <sub>D</sub> = -7A, V <sub>Gd</sub> = 0)						2SK225とコンプリメンタリ	117A	2SJ81	
900		5	-10	40		5*	-10	"						2SK226とコンプリメンタリ	117A	2SJ82	
900		5	-10	40		5*	-10	"						2SK227とコンプリメンタリ	117A	2SJ83	
22		0	-10													103A	2SJ84
																	2SJ88
																	2SJ89
95		0	-10	29		10		2		(R <sub>g</sub> =1kΩ) -10   -1					2SJ109	75	2SJ90
1,500		0	-10	90		0*	-10	C <sub>Ds</sub> = 460pF <sub>typ</sub> (V <sub>Os</sub> = -10V, V <sub>Gs</sub> = 0)						2SJ115	118	2SJ91	
1,500		0	-10	90		0*	-10	"						2SJ115	119	2SJ92	
																	2SJ93
																	2SJ94
																	2SJ95
850		5	-10					V <sub>Ds(Ox)</sub> = -4Vmax (I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>Gs</sub> = -15V)						2SK286とコンプリメンタリ	117A	2SJ96	
																	2SJ97
																	2SJ98
1,050		0	-10	80		0*	-10	V <sub>Ds(Ox)</sub> = -2Vmax (I <sub>D</sub> = -4A, V <sub>Gs</sub> = -15V)						2SK343とコンプリメンタリ	117B	2SJ99	
1,050		0	-10	80		0*	-10	"						2SK344とコンプリメンタリ	117B	2SJ100	

★  
★  
★

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GD0</sub> V <sub>GDX</sub> (V)	V <sub>Dsx</sub> V <sub>DSS</sub> (V)	V <sub>Gso</sub> V <sub>GSS</sub> V <sub>Gsx</sub> (V)	I <sub>c</sub> I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA)*	max V <sub>Gs</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GStoff</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS) r <sub>D</sub> * (Ω)			
												min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max
2SJ101	日立	低周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		-40*	±20*	-5A*	30W*	150*	±1μA	±20		-1	-30	-2	-5	-10	-1mA	0.5	(S) 1		-10	-3A		
2SJ102	"	"	"		-60*	±20*	-5A*	30W*	150*	±1μA	±20		-1	-50	-2	-5	-10	-1mA	0.5	(S) 1		-10	-3A		
2SJ103	東芝	低周波, アナログSW	J	50			-10	300	125	1	30	-1.2	-14	-10	0.3	6	-10	-0.1	1	4		-10	I <sub>DSS</sub>		
2SJ104	"	"	"	25			-10	400	125	1	25	-2.6	-20	-10	0.2	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-5mA) 12 30			-10	"		
2SJ105	"	"	"	50			-10	200	125	1	30	-1.2	-14	-10	0.3	6	-10	-0.1	1	4		-10	"		
2SJ106	"	"	"	50			-10	150	125	1	30	-1.2	-14	-10	0.3	6	-10	-0.1	1	4		-10	"		
2SJ107	"	"	"	25			-10	200	125	1	25	-2.6	-20	-10	0.2	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-5mA) 12 30			-10	"		
2SJ108	"	低周波, 低雑音	"	25			-10	200	125	1	25	-2.6	-20	-10	0.15	2	-10	-0.1	8	22		-10	"		
2SJ109	"	"	"	30			-10	200	125	1	30	-2.6	20	-10	0.2	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-3mA) 8 22			-10	"		
2SJ110	"	低周波増幅 アナログSW	"	25			-10	400	125	1	25	-5	-30	-10	0.3	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-15mA) 25 60			-10	"		
2SJ111	"	低周波, 低雑音	"	25			-10	400	125	1	25	-5	-30	-10	0.3	2	-10	-0.1	(I <sub>DSS</sub> =-5mA) 30 40			-10	"		
2SJ112	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		-100*	±20*	-10A*	100W*	150*	±1μA	±20		-1	-80	-2	-5	-10	-1mA	1.5	(S) 2		-10	-5A		
2SJ113	"	"	"		-100*	±20*	-10A*	100W*	150*	±1μA	±20		-1	-80	-2	-5	-10	-1mA	1.5	(S) 2		-10	-5A		
2SJ114	"	"	"		-200*	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20		-1	-160	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.8		-10	-4A		
2SJ115	東芝	低周波電力増幅	"		-160*	±20*	-8A*	100W	150	±1	±20				-0.8	-2.8	-10	100mA	1	(S) 2		-10	-2A		
2SJ116	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	"		-400*	±20*	-8A*	125W*	150*	±1μA	±20		-1	-320	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.6		-20	-4A		
2SJ117	"	"	"		-400*	±20*	-2A*	40W*	150*	±1μA	±20		-1	-320	-2	-5	-10	-1mA	0.4	(S) 0.7		-20	-1A		
2SJ118	"	"	"		-140*	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20		-1	-120	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.8		-10	-4A		
2SJ119	"	"	"		-160*	±20*	-8A*	100W*	150*	±1μA	±20		-1	-140	-2	-5	-10	-1mA	1	(S) 1.8		-10	-4A		
2SJ120	"	"	"		-40*	±20*	-2A*	10W*	150*	±1μA	±20		-1	-35	-1	-4	-10	-1mA	0.1	(S) 0.25		-10	-1A		
2SJ121																									
2SJ122	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		-60*	±20*	-10A*	50W*	150*	±1μA	±20		-1	-50	-2	-5	-10	-1mA	1.5	(S) 2.2		-10	-5A		
2SJ123	東芝	低周波電力増幅 高速SW	"		-70*	±20*	-10A*	30W	150	±1	±20		-1	-70	-1	-3	-5	-1mA	1	(S) 1.7		-5	-2A		
2SJ124																									
2SJ125	三菱	低周波電力増幅 アナログSW	J	50*			-10	150	125*	1	30	-1	-12	-10	0.3	6	-10	-10	1.5	4		-10	I <sub>DSS</sub>		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)												そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>r</sub> =1MΩ) (dB)								NF (f=100MHz) (dB)			
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GS</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)					typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
660		0	-10	140		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -1.2V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -3A, V <sub>GS</sub> = -15V)								2SK345とコンプリメンタリ	116B	2SJ101	
660		0	-10	140		0*	-10	"								2SK346とコンプリメンタリ	116B	2SJ102	
18		0	-10	3.6		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 270Ω typ (V <sub>DS</sub> = -10mV, V <sub>GS</sub> = 0, I <sub>DSS</sub> = -5mA)				2SK246とコンプリメンタリ	82B	2SJ103					
105		0	-10	32		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 40Ω typ ( " )				2SK364とコンプリメンタリ	82C	2SJ104					
18		0	-10	3.6		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 270Ω typ ( " )				2SK330とコンプリメンタリ	70A	2SJ105					
18		0	-10	3.6		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 270Ω typ ( " )					105A	2SJ106					
105		0	-10	32		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 40Ω typ ( " )				2SK366とコンプリメンタリ	70B	2SJ107					
105		0	-10	32		10	I <sub>D</sub> =0	(f=10Hz, R <sub>r</sub> =1kΩ) 1   10   -10   -1				2SK370とコンプリメンタリ	70B	2SJ108					
95		0	-10	25		10	I <sub>D</sub> =0	(f=10Hz, R <sub>r</sub> =1kΩ) 1.5   11   -10   -1				ΔV <sub>GS</sub> = 20mV <sub>max</sub>	2SK389とコンプリメンタリ	148	2SJ109				
185		0	-10	55		10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> = 20Ω typ (V <sub>DS</sub> = 10mV, V <sub>GS</sub> = 0, I <sub>DSS</sub> = -15mA)				2SK363とコンプリメンタリ	82C	2SJ110					
185		0	-10	55		10	I <sub>D</sub> =0	(R <sub>r</sub> =100Ω) 1   2   -10   -5				2SK369とコンプリメンタリ	82C	2SJ111					
1,100		0	-10	90		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -1.75V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK398とコンプリメンタリ	28B	2SJ112					
1,100		0	-10	90		0*	-10	"				2SK399とコンプリメンタリ	149	2SJ113					
1,000		0	-10	70		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -3.2V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -4V, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK400とコンプリメンタリ	149	2SJ114					
800		0	-10	110		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -7V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>GS</sub> = -10V)				2SK405とコンプリメンタリ	119	2SJ115					
1,400		0	-10	25		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -9V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -4A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK298とコンプリメンタリ	28B	2SJ116					
520		0	-10	15		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -7V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -1A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK310とコンプリメンタリ	116B	2SJ117					
1,050		0	-10	80		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -2V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -4A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK413とコンプリメンタリ	149	2SJ118					
1,050		0	-10	80		0*	-10	"				2SK414とコンプリメンタリ	149	2SJ119					
150		0	-10	25		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -1.5V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -1A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK416とコンプリメンタリ	150	2SJ120					
														2SJ121					
1,200		0	-10	170		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -1V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -5A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK428とコンプリメンタリ	116B	2SJ122					
650		0	-10	250		0*	-10	V <sub>DS(ON)</sub> = -2.8V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> = -7A, V <sub>GS</sub> = -15V)				2SK442とコンプリメンタリ	138	2SJ123					
														2SJ124					
18		0	-10					R <sub>DS(ON)</sub> = 220Ω typ (f=1kHz, V <sub>DS</sub> = 10mV <sub>rms</sub> ) (V <sub>GS</sub> = 0, I <sub>DSS</sub> = 5mA)					152	2SJ125					



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GD0</sub> * V <sub>GDX</sub> ** (V)	V <sub>Dsx</sub> V <sub>DSS</sub> * (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> * V <sub>Gsx</sub> ** (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> * (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> * (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> * (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA)*	I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)					
										max V <sub>GS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω)	typ
2SJ126	東芝	DC-DCコンバータ	MOS		-60*		-10A*	40W							(V <sub>th</sub> ) -1.5	-3.5		-1mA		(S) 2.5		-10	-5A		
2SJ127																									
2SJ128																									
2SJ129																									
2SJ130																									
2SJ131																									
2SJ132																									
2SJ133																									
2SJ134																									
2SJ135																									
2SJ136																									
2SJ137																									
2SJ138																									
2SJ139																									
2SJ140																									
2SJ141																									
2SJ142																									
2SJ143																									
2SJ144																									
★ 2SJ49Ⓞ	日立	高速度電力SW	MOS		-140	±14*	-7A*	100W*	150*						-0.15	-1.45	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4				
★ 2SJ50Ⓞ	"	"	"		-160	±14*	-7A*	100W*	150*						-0.15	-1.45	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4				
2SJ56Ⓞ	"	高周波電力増幅 高速度電力SW	"		-200	±20*	-8A*	125W*	150*			-3	-160	-0.55	-3	-10	-100mA	0.7	(S) 1	1.4	-10	-3A			
2SJ77Ⓞ	"	"	"		-160	±15*	-500*	30W*	150*					-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10			
2SJ79Ⓞ	"	"	"		-200	±15*	-500*	30W*	150*					-0.2	-1.5	-10	-10mA	20	35		-20	-10			
M46F	松下	低周波	J	30	-30		-30*	250	125												8	10	I <sub>DSS</sub>		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>n</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
R <sub>DS(ON)</sub> =0.4Ω max (I <sub>D</sub> =-5A, V <sub>GS</sub> =-10V)																	2SJ126		
																		2SJ127	
																		2SJ128	
																		2SJ129	
																		2SJ130	
																		2SJ131	
																		2SJ132	
																		2SJ133	
																		2SJ134	
																		2SJ135	
																		2SJ136	
																		2SJ137	
																		2SJ138	
																		2SJ139	
																		2SJ140	
																		2SJ141	
																		2SJ142	
																		2SJ143	
																		2SJ144	
900		5	-10	40		5*	-10	V <sub>DS(sat)</sub> = -12Vmax (I <sub>D</sub> = -7A, V <sub>GD</sub> = 0)				2SK134Ⓢとコンプリメンタリ				28A	2SJ49Ⓢ	★	
900		5	-10	40		5*	-10	"				2SK135Ⓢとコンプリメンタリ				28A	2SJ50Ⓢ	★	
1,200		5	-10	60		5		V <sub>DS(ON)</sub> = -6Vmax (I <sub>D</sub> = -4A, V <sub>GS</sub> = -15V)								28A	2SJ56Ⓢ		
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	V <sub>DS(sat)</sub> = -2Vmax (I <sub>D</sub> = -10mA, V <sub>GD</sub> = 0)								116A	2SJ77Ⓢ		
120		-10*	-10	4.8		-10mA	-10	"								116A	2SJ79Ⓢ		
								2.5		(R <sub>g</sub> =1kΩ) 10   -1								M47Fとコンプリメンタリ	M46F

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)															
				V <sub>GD</sub> S	V <sub>D</sub> SX	V <sub>G</sub> S0	I <sub>G</sub>	P <sub>d</sub>	T <sub>j</sub>	I <sub>GSS</sub>	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> * (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)					
				V <sub>GD</sub> O*	V <sub>D</sub> SS*	V <sub>G</sub> SS*	I <sub>D</sub> *	P <sub>e</sub> *	T <sub>ch</sub> *		max	min	max	V <sub>D</sub> S	min	max	V <sub>D</sub> S	I <sub>D</sub>	min	typ	max	V <sub>D</sub> S	I <sub>D</sub>	typ	max	
				V <sub>GD</sub> X**	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*	V <sub>G</sub> S (V)	(V)	(V)	(μA)	(V)	(mA)	(mA)	(Ω)	(Ω)							
2N4392	日電	SW, チョッパ	J	-40*	40	-40	50	300	200	-100*	-20	(パルス測定) 25   75		20	-2	-5	20	1nA								
2N4393	"	"	"	-40*	40	-40	50	300	200	-100*	-20	(パルス測定) 5   30		20	-0.5	-3	20	1nA								
2SK11	東芝	DC, 低周波 チョッパ	"	-20			10	100	150	-1	-10	0.3	6.5	10	-0.5	-6.0	10	0.1	0.7		3.2	10	I <sub>DSS</sub>			
2SK12	"	"	"	-20			10	100	150	-0.1	-10	0.45	5.0	10	-0.65	-4.5	10	0.1	0.8		3.2	10	"			
★ 2SK13	"	DC, 低周波 チョッパ	"	-12			10	100	150	-0.1	-10	0.45	5.0	10	-0.65	-4.5	10	0.1	0.8		3.2	10	"			
2SK15	"	DC, 低周波, 低雑音	"	-20			10	100	150	-0.1	-10	0.45	5.0	10	-0.65	-5.0	10	0.1	0.8		3.2	10	"			
2SK16Ⓞ	日立	高入力 インピーダンス増幅	"			-20*	10, 10*	100*	150*	-1	-6	0.5	7.0	6	-0.5	-5.0	6	0.1	1	3	6	6	"			
★ 2SK17	東芝	オーディオ	"	-20			10	100	125	-1	-10	0.3	6.5	10	-0.5	-6.0	10	0.1	0.7	2.0		10	"			
2SK18	"	DC	"	-40			10	200	150	I <sub>G</sub> -0.1	V <sub>D</sub> S=10V I <sub>D</sub> =0.4mA	0.45	2.8	10	-0.65	-3.5	10	0.1	0.8		3	10	"			
2SK18A	"	"	"	-40			10	200	150	I <sub>G</sub> -0.1	V <sub>D</sub> S=10V I <sub>D</sub> =0.4mA	0.45	2.8	10	-0.65	-3.5	10	0.1	0.8		3	10	"			
★ 2SK19TM	"	FM, VHF	"	-18*			10	200	125	-10	-1	3	24	10	-1.2		10	1		7		10	"			
2SK23A-8 2SK23A-9	ソニー	DC, VHF	"	-27* -40*		-9	10, 20*	250	100	-10	-6	2.7	12.1	10	-0.45	-3.85	10	30	2.7			10	"		(100MHz) 0.05	
★ 2SK24	三洋	低周波 AM/RF	"	-40	40*	-40	10	100	125	-10	-10	0.6	24	10		-6	10	10	1.5		12	10	"			
★ 2SK25	"	FM, RF, MIX	"	-18	18*	-18	10	100	125	-100	-10	0.6	24	10		-7.2	10	10		6		10	"			
★ 2SK30	東芝	低周波	"	-50			10	100	125	-1	-30	0.3	6.5	10	-0.4	-5.0	10	0.1	1.5			10	"			
2SK30ATM	"	低周波, 低雑音	"	-50			10	100	125	-1	-30	0.3	6.5	10	-0.4	-5.0	10	0.1	1.2			10	"			
2SK33	三菱	FM, VHF	"	-20*			10	150	125*	-100	-1	2.5	20	10	-1	-8	10	10	4.5	7		10	"			
2SK34	"	低周波, 低雑音	"	-50*			10	150	125*	-10	-10	0.3	12	10	-0.3	-6.0	10	10	1.0	3		10	"	0.01		
2SK37	日電	FM, RF/MIX	"	-20*		-15	10, 20*	100	125*	-10	-10	0.5	6	5	-0.3	-4.5	5	10	1.5	2		5	0.5			
★ 2SK38	三菱	煙感知器, DC	MOS		20	±10	20*	100	100*	-1*	-10	0.4	5	10		-9	10	10	0.5	0.8		10	1	0.01		
2SK38A	"	"	"		20	±10	20*	100	100*	-1*	-10	0.1	7	10		-5	10	10	1	1.5		10	1	0.02		
★ 2SK39	ソニー	エレクトレット マイクロフォン	J	-20*						-0.25	-0.1	[I <sub>DSS</sub> ] 0.035   0.564		9					0.09		0.55	9				
★ 2SK39A	"	コンデンサ・マイク	"	-20*		-0.5	0.5, 1*	10	85	-0.25	0.1	[I <sub>DSS</sub> ] 0.048   0.564		9					0.11		0.67	9				
2SK40	日立	低周波, 低雑音	"	-50		-50*	10	100*	150*	-10	-30	0.6	6.5	15	-0.4	-5.0	15	0.1	1			15				
2SK41	三洋	FM, RF/MIX	"	-18			10	200	125	-10	-1	0.6	24	10			10	10		7		10	I <sub>DSS</sub>			

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
Ci (pF)				Cs (pF)				NF (f=1kHz, Rg=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	VGS(V) ID(mA)*	VDS(V)	typ	max	VGD(V) VGS(V)*	VDS(V)	typ	max	VDS(V)	ID(mA)	typ	max					VDS(V)	ID(mA)
9	14	0	20	2.7	3.5	-7*	0	rDS(ON)=60Ω max (VGS=0, ID=6mA)										73	2N4392
10	14	0	20	3	3.5	-5*	0	rDS(ON)=100Ω max (VGS=0, ID=1mA)										73	2N4393
3	5	-10	0														2	2SK11	
3	5	-10	0					3	10	0.45							2	2SK12	
2.3	3.5	-10	0					2	10	0.45							2SK12	2	2SK13
3	5	-10	0					(Rg=10kΩ) 3	10	0.45		VNI(P)=4μVmax (VDS=5V, ID=0.45mA Rg=10kΩ, df=5~50Hz)					2	2SK15	
9		-1	6	2		-6	0	0.15μV/√Hz		6	0.5						RON=350Ω typ (VDS=0.1V, VGS=0)	3	2SK16Ⓞ
4	6	0	0	1.2	2.0	-10	0	1		10	IDSS						2SK30ATM	7	2SK17
4.5	6	VGD=0		2.0	2.5	-10	0	Δ VGS1-VGS2 /ΔTa=100μV/°C max (VDS=10V, ID=200μA Ta=0~60°C)										19	2SK18
4.5	6			2	2.5	-10	0	Δ VGS1-VGS2 /ΔTa=20μV/°C max (VDS=10V, ID=200μA Ta=0~60°C)										19	2SK18A
4		0	0	0.45	0.65	-10						2.0	3.5	10 (VDD)		PG=20dB typ (f=100MHz)	2SK192A	82A	2SK19TM
5		0	10	1.8		0*	10	13nV/√Hz		10	IDSS	2		10	IDSS	PG=18dB typ (f=100MHz)		5	2SK23A-8 2SK23A-9
7.4			10	2.0			10	1	2.5	10		NF=10dB max (f=30Hz, Rg=1MΩ, VDS=10V)				2SK44SP	6	2SK24	
				1.1		0*	10					2.5		10	3	PG=21dB typ (f=100MHz)	2SK41NP	6	2SK25
8.2		0	0	2.6		-10	0	(f=120Hz, Rg=100kΩ) 0.5   5.0   15		IDSS							2SK30ATM	7	2SK30
8.2		0	0	2.6		-10	0	(f=120Hz, Rg=100kΩ) 0.5   5.0   15		IDSS								82B	2SK30ATM
				0.5		0*	10					2.5		10	IDSS	PG=20dB typ (f=100MHz)		153A	2SK33
8		0	10	1.5		0*	10	(f=100Hz, Rg=100kΩ) 3.0   6.0   10		0.1								153B	2SK34
				1	1.5	0*	5											10	2SK37
6		0	0																2SK38
8		0	0															11	2SK38A
																		12	2SK39
												S/N=50dB min (VDS=9V, Ci=100pF, Vin=-60dB, f=1kHz)				2SK93	12	2SK39A	
6.7		0	15	1.6		0*	15	(f=120Hz, Rg=100kΩ) 1   5   15		IDSS								13	2SK40
				0.35	0.75	0*	10					3.5	10	3		PG=22dB typ (f=100MHz) (2SK41NPを名称変更したため同型名 で旧タイプのもがある。45ページ参照)		57A	2SK41



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)									電気的特性 (Ta=25°C)												
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSX</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> *	V <sub>Gsx</sub> V <sub>Gsx</sub> **	I <sub>c</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>GSS</sub> (nA)	max	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GStoff</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)		
				V <sub>GDX</sub> ** (V)	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*	V <sub>Gs</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω)	typ
★ (旧)2SK41	三洋	FM, RF/MIX	J	-18*			10	150	125	-10	-1	0.6	24	10			10	10		7		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK42	ソニー	FM/AM, RF	"	-10*	10		10 (I <sub>S</sub> )	50	65			1	5	4	-0.3		4	100	3.5	5.5		4	"		
2SK43	"	低周波, 低雑音	"	-30*		-30	5, 20*	300	100*	-1	-15	0.9	14.3	10	-0.18	-1.49	10	30	6.3			10	"		
2SK43Ⓢ	"	DC, 低周波	"	-30*		-30	5, 20*	300	100	-0.1	-15	0.9	14.3	10	-0.18	-1.49	10	30	6.3			10	"		
2SK43Ⓢ-D	"	DC, アナログSW	"	-30*		-30	5, 20*	300	100	-0.1	-15	8.1	14.3	10	-0.72	-1.49	10	30	14			10	"		
2SK44	三洋	低周波, 低雑音	"	-20	20*		10	100	125	-1	-10	0.06	3	10		-4	10	1	0.6	2		10	"		
★ (旧)2SK44	"	低周波, 低雑音	"	-20	20*		10	100	125	-1	-3	0.06	3	10		-4	10	1	0.6	2		10	"		
★ 2SK45	日電	DC, 高周波	"	-22*	20	-22	10, 20*	100	150	-10	-10	0.5	6	5	-0.3	-4.5	5	10	1.5	2		5	0.5		
2SK46	三菱	コンデンサ・マイク	"	-30*			10	150	125	-10	-10	0.3	3	10	-0.3	-5	10	10	1	3		10	I <sub>DSS</sub>	0.01	
★ 2SK47	日電	低周波・高周波	"	-20*		-15	10, 20*	200	125	-10	-10	0.5	6	5	-0.3	-4.5	5	10	1.5	2		5	0.5		
2SK48	東芝	低周波, 低雑音	"	-20			10	100	150	-0.1	-10	0.3	3	10	-0.35	-2.3	10	0.1	1		5	10	I <sub>DSS</sub>		
2SK49	日電	FM, RF	"	-20*			10, 10*	72 (60°C)	80	-50	-0.5	0.5	6	5		-2.5	5	10	1.9	5.5		5	"		
★ 2SK50	松下	エレクトレット コンデンサ・マイク	"	-10*	10		2, 2*	20	80			0.07 (R <sub>L</sub> =2.2kΩ)	1.0	4.5					0.35 (R <sub>L</sub> =2.2kΩ)			4.5	0 (V <sub>Gs</sub> )		
2SK54	日立	VHF, RF/MIX	"	-15*			10	150*	125*	-10	-0.5	0.8	5	10	-0.3	-5.5	10	10	3	6		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK55	"	"	"	-18*			10	150*	125*	-10	-0.5	3	14	10	-0.3	-5.5	10	10	3	8		10	"		
★ 2SK56	松下	VHF, RF	"	-10	10		10, 10*	100	125	-0.5μA	-1	0.7	10	5		-4	5	10		4		5	"		
2SK57	日電	高周波増幅	"	-20*		-15	10, 20*	100	125	-10	-10	0.5	6	5	-0.3	-4	5	10	1.5	2		5	0.5		
2SK58	ソニー	DC, VHF	"	-27*		-9	10, 20*	270	100	-10	-6	1	16.5	10	-0.45	-4.95	10	30	2.7			10	I <sub>DSS</sub>		
★ 2SK59	日立	エレクトレット コンデンサ・マイク	"	-30		-30*	10	50	125*	-1	-10	0.3	1.4	10	-0.4	-5	10	0.1	1			10	"		
2SK60	ソニー	低周波電力増幅	J(V)	-170*		分類有	(A)* 0.5, 5	63W	120	I <sub>DGO</sub> 100μA	V <sub>DC</sub> 100					-7.5	-25	60	100mA	4*		20	1A	16Ω*	
2SK61-LV	東芝	FM, VHF	J	-18*			10	200	125	-10	-0.5	1	6	10	-0.4	-4	10	1	9			10	I <sub>DSS</sub>		
2SK63	ソニー	小信号電圧増幅	J(V)	-120*		-10	20 200*	470	120	-200	-6					-9.5	100	300	14			50	4	0.5	
2SK65	松下	低周波インピー ダンス変換	J	-12*	12		2, 2*	20	80			(R <sub>S</sub> =2.2kΩ) 0.04	0.8	4.5					(R <sub>S</sub> =2.2kΩ) 0.3	0.5		4.5	V <sub>Gs</sub> 0		
2SK66	"	低周波, 低雑音	"	-55*			10	100	125	-100	-30	0.3	6.5	10	-0.4	-5	10	0.1	1.2			10	I <sub>DSS</sub>		
2SK67	日電	エレクトレット コンデンサ・マイク	"	-20*	20		10, 10*	80	100			0.02	1			-0.8	5	1	1.5			5	"		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
C <sub>is</sub> (pF)				C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)									
typ	max	V <sub>Gs</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max	V <sub>Gd</sub> (V) V <sub>Gs</sub> (V)*	V <sub>Ds</sub> (V)	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)		
				0.35	0.75	0*	10						3.5	10	3	PG=22dB typ (f=100MHz)	2SK41	14	(旧)2SK41	★	
				0.085	0.12		4						2.5	4	I <sub>DSS</sub>	PG=12dB min (f=100MHz)		15	2SK42		
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/√Hz		(R <sub>g</sub> =10kΩ) 10	I <sub>DSS</sub>							16	2SK43		
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/√Hz		(R <sub>g</sub> =10kΩ) 10	I <sub>DSS</sub>							16	2SK43S		
13		0	10	2.4		0*	10	13nV/√Hz		(R <sub>g</sub> =10kΩ) 10	I <sub>DSS</sub>					RON=80Ω max (V <sub>Ds</sub> =0.1V, V <sub>Gs</sub> =0)		16	2SK43S-D		
																(2SK44SPを名称変更したため同型名で 旧タイプのものがある)		58A	2SK44		
																	2SK44	28	(旧)2SK44	★	
4	5.5	0	5	1	1.5	0*	5	(f=1MHz) 1.5		5	0.5							30	2SK45	★	
8		0	10	1.5		0*	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 3		6	0.1							20	2SK46		
4.5		0	5	1.5	2	0*	5											18	2SK47	★	
5	8	-10	0					(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5		5	0.45			V <sub>N(P,P)</sub> =4μVmax (V <sub>Ds</sub> =5V, I <sub>D</sub> =0.45mA R <sub>g</sub> =10kΩ, Δf=5~50Hz)				2	2SK48		
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3.5	6	5	I <sub>DSS</sub>	PG=18dB typ (f=100MHz)		40	2SK49		
								V <sub>N</sub> =4μVmax (V <sub>Ds</sub> =4.5V, R <sub>L</sub> =2.2kΩ, C <sub>o</sub> =70pF)									2SK65	80D	2SK50	★	
3		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )		PG=15dB typ (f=100MHz)		37A	2SK54		
3		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )		PG=18dB typ (f=100MHz)		37A	2SK55		
4		0	5	0.1		0*	5					4.5	5	1		PG=12dB min (f=100MHz)	2SK83	80D	2SK56	★	
																				2SK57	
				2		0*	10					ΔV <sub>Gs</sub> =100mVmax (V <sub>Ds</sub> =10, I <sub>D</sub> =1mA)						49	2SK58		
								(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5		3	I <sub>DSS</sub>								50	2SK59	★
190		-15	0					V <sub>ON</sub> =10Vmax (I <sub>C</sub> =0.2A, I <sub>D</sub> =3A, t=100ms)									2SJ18とコンプリメンタリ		45	2SK60	
				0.1	0.25	-5						2.5	3.5	(V <sub>DD</sub> ) 10		PG=18dB typ (f=100MHz)		82A	2SK61-LV		
16		4	50					(f=10Hz, R <sub>g</sub> =500kΩ) 30		50	4	μ=15min 30typ (V <sub>Ds</sub> =50V, I <sub>D</sub> =40mA)						51	2SK63		
								NV=4μVmax (V <sub>Ds</sub> =4.5V, R <sub>s</sub> =2.2kΩ, C <sub>C</sub> =10pF)										52	2SK65		
8.2		0	0	2.6		-10	0	(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5		5	15								80D	2SK66	
5.5		0	5					C <sub>os</sub> =2.7pF typ (V <sub>Ds</sub> =5V, V <sub>Gs</sub> =0)										60	2SK67		



電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名			
Ci (pF)				Cr (pF)				NF (f=1kHz, Rg=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	VGS(V) ID(mA)*	VDS(V)	typ	max	VGD(V) VGS(V)*	VDS(V)	typ	max	VDS(V)	ID(mA)	typ	max					VDS(V)	ID(mA)	
5.5		0	5					Cos=2.7pF typ (VDS=5V, VGS=0)									60	2SK67A		
13		0	10	2.6		0*	10										53A	2SK68		
13		0	10	2.6		0*	10	(Rg=1kΩ) 0.6	1.5	10	IDSS						53A	2SK68A		
								μ=10min(VDS=10V, ID=10mA)										41	2SK69	★
430		100*	10														2SK389	42	2SK70	★
	9	-10	0					(f=120Hz, Rg=100kΩ) 0.5	5	10	0.45	ΔVGS=10mVmax (VDS=10V, ID=0.05, 0.2, 0.4mA)					43	2SK72		
																		54	2SK73	
16		4*	50					(f=10Hz, Rg=500kΩ) 30	50	4		μ=15min 30typ (VDS=50V, ID=4mA)					55	2SK79		
4		0	5	0.07	0.15	0*	5					3.5	5	1				80B	2SK83	
8.2		0	0	2.6		-10	0	(f=120Hz, Rg=100kΩ) 0.5	5	15								52	2SK84	
												(f=8GHz) 3.5	4.5	3	10			56	2SK85	
7.2		0	15	2.1		0*	15	(f=120Hz, Rg=100kΩ) 1	5	15	IDSS							61	2SK87①	★
																			2SK88	
																			2SK89	★
																			2SK90	
																			2SK91	
5.5		0	5					Cos=2.7pF typ (VDS=5V, VGS=0)									18	2SK92		
								S/N=50dB min (VDS=9V, Cg=100pF, 1kHz, VIN=-60dB)									62	2SK93		
13		0	10	2.6		0*	10											78	2SK94	
																			2SK95	
																			2SK96	
				2.4			10											49	2SK97	
																			2SK98	
																			2SK99	
																			2SK100	



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)													
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> *	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>GSS</sub> (nA)	I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)				
				V <sub>GDX</sub> (V)		V <sub>G SX</sub> (V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)	min	max	V <sub>DSS</sub> (V)	min	max	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>id</sub> (Ω)	
2SK101																								
2SK102																								
2SK103	日電	エレクトレット コンデンサ・マイク	J	-20*	20		10,10*	80	100				0.02	1			-0.8	5	1		1.5		5	I <sub>DSS</sub>
2SK104	"	高周波, 低周波	"	-30*		-30	10,20*	250	125	-10	-30	0.5	12	5	-0.25	-4.5	5	10	1.5	4.1		5	"	
2SK105	"	低周波	"	-50*	50	-50	10,20*	250	125	-1	-30	0.5	12	5	-0.25	-4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5	
★ 2SK106	日立	低周波, 低雑音	"			-50*	10,20*	300*	125*	-10	-30	0.5	12	10	-0.13	-1.5	10	10	4.5	13		10	I <sub>DSS</sub>	
2SK107	ソニー	DC, VHF	"	-27*		-9	10,20*	250	100	-10	-6	2.7	12.1	10	-0.45	-3.85	10	30	2.7			10	"	
2SK108	三菱	低周波, 低雑音 アナログSW	"	-50*		-50	10,20*	300	125*	-1	-30	1	12	10		-3	10	10	6	15		10	"	
★ 2SK109	"	低周波, 低雑音	"	-50*		-50	10,20*	150 unit	125*	-1	-30	1	12	10		-3	10	10	6	12		10	"	0.01
2SK110	"	"	"	-30*		-30	10,50*	900	125*	-1	-20	2.5	35	5		-2	5	10	35	45		5	5	
2SK111	"	"	"	-30*		-30	10,50*	200 unit	125*	-1	-20	2.5	35	5		-2	5	10	35	45		5	5	
2SK112	東芝	DC, 低雑音 チョップSW	"	-50			10	250	150	-0.1	-30	1.2	9	15	-0.25	-1.2	15	0.1	7		34	15	I <sub>DSS</sub>	
2SK113	"	アナログSW チョップSW	"	-50			10	250	150	-0.1	-20	5	150	20	-0.3	-10	20	0.1						
2SK114																								
2SK115																								
2SK116																								
2SK117	東芝	低周波, 低雑音	J	-50			10	300	125	-1	-30	1.2	14	10	-0.2	-1.5	10	0.1	4	15		10	I <sub>DSS</sub>	
2SK118	"	コンデンサ・マイク	"	-50			10	100	125	-1	-30	0.3	6.5	10	-0.4	-5.0	10	0.1	1.2			10	"	
2SK119	日電	DC, アナログSW	"	-30*	30	-30	10,20*	250	150	-0.1	-20	0.5	12	10	-0.2	-4.5	10	10	1.0	4.2		10	"	
2SK120	ソニー	VHF, RF, MIX	"	-15*			10*	200	85				1	5	4	-0.3		4	100	3.5	5.5		4	"
2SK121	"	DC, 低雑音 SW	"	-30*		-50	5,20*	300	100	-1	-15	0.9	14.3	10	-0.18	-1.49	10	30	6.3			10	"	
2SK122																								
2SK123	松下	エレクトレット コンデンサ・マイク	J	-20*	20		2.2*	200	100				0.13	0.47	4.5					0.9	1.6		4.5	I <sub>DSS</sub>
2SK124	日電	Xバンド 低雑音増幅・発振	GaAs SB	-8*	5		100*	500	125				30	100	3	-1		3	100					
2SK125	ソニー	UHF, RF, MIX	J	-25*		-25	10,100*	500*	120*	-10	-15	30	75	10	-2	-6	10	100	10	14		10	10	

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
C <sub>is</sub> (pF)				C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)									
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)		
																		2SK101			
																		2SK102			
5.5		0	5					C <sub>OS</sub> =2.7pF typ (V <sub>DS</sub> =5V, V <sub>GS</sub> =0)									63	2SK103			
4.1	6	0	10	0.9	1.3	0*	10											40	2SK104		
4.1	6.0	0	10	0.9	1.3	0*	10											53A	2SK105		
								V <sub>N</sub> =-130dB max								2SK106Aも廃止	2SK186	79	2SK106	★	
5		0	10	1.8			10	(R <sub>g</sub> =10kΩ) 0.1	10	I <sub>DSS</sub>	2		10	I <sub>DSS</sub>				PG=18dB typ (f=100MHz)	62	2SK107	
20		0	10					(f=100Hz, R <sub>g</sub> =1kΩ) 1   2.5   10		1								R <sub>DS(ON)</sub> =70Ω typ (f=1kHz, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA)	153B	2SK108	
20		0	10					(f=100Hz, R <sub>g</sub> =10kΩ) 1   10		1	ΔV <sub>GS</sub> =50mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)						84	2SK109	★		
55		5*	5					1   (R <sub>g</sub> =100Ω) 2   5		5								R <sub>DS(ON)</sub> =18Ω typ (f=1kHz, V <sub>DS</sub> =10mVrms, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =10mA)	154	2SK110	
55		5*	5					1   (R <sub>g</sub> =100Ω) 2   5		5	ΔV <sub>GS</sub> =30mVmax (V <sub>DS</sub> =5V, I <sub>D</sub> =5mA)						84	2SK111			
12		0	15	3		0*	15	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 1   2		15	1							NF=10dB max (V <sub>DS</sub> =15V, I <sub>D</sub> =1mA, f=10Hz, R <sub>g</sub> =1kΩ)	69	2SK112	
10	14	0	20	3	5		0											R <sub>DS(ON)</sub> =100Ω max (V <sub>GS</sub> =0, I <sub>D</sub> =1mA)	69	2SK113	
																			2SK114		
																			2SK115		
																			2SK116		
13		0	10	3		-10	I <sub>D</sub> =0	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 1   2		10	0.5							NF=10dB max (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =0.5mA, R <sub>g</sub> =1kΩ, f=10Hz)	82C	2SK117	
8.2		0	10		2.6	-10	I <sub>D</sub> =0	(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5   5   15		I <sub>DSS</sub>									70A	2SK118	
4.8	6.0	0	10	1.2	1.5	0*	10												71	2SK119	
4.6		0	4	0.14	0.17		4					1.9	2.5	4	I <sub>DSS</sub>			PG=16dB typ (f=100MHz)	64	2SK120	
13		0	10	2.4		0*	10	(R <sub>g</sub> =10kΩ) 0.1   10		I <sub>DSS</sub>									62	2SK121	
																			2SK122		
																			NV=4μVmax (V <sub>D</sub> =4.5V, R <sub>L</sub> =2.2kΩ, C <sub>O</sub> =10pF)	131	2SK123
												(f=12GHz) 3   4	3	10				MAG=11dB typ (f=12GHz)	56	2SK124	
				2.6	3	-10						(ゲート接地) 1.8   2.5	10 (V <sub>DC</sub> )	10				PG=12.5dB typ ゲート接地 (f=100MHz)	72	2SK125	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電氣的特性 (Ta=25°C)																		
				V <sub>GDS</sub>	V <sub>Dsx</sub>	V <sub>GSo</sub>	I <sub>C</sub>	P <sub>d</sub>	T <sub>j</sub>	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA)*	max V <sub>Gs</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GSteff</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)						
				V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSS</sub> *	I <sub>D</sub> *	P <sub>ch</sub> *	T <sub>ch</sub> *			min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	r <sub>p</sub> * (Ω)		
				V <sub>GDX</sub> *	V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSS</sub> *	(mA)	(mW)	(°C)			max	min														max	max
2SK126																												
2SK127	松下	低周波	J	-50*		-50	20*	250	125			0.5	12	10						3				10	I <sub>DSS</sub>			
2SK128	"	低周波, 低雑音	"	-30*	30	-30	10, 20*	250	125	-100	-30	0.5	12	10	-0.1	-1.5	10	10		4	12			10	"			
2SK129																												
2SK130	日電	低周波, アナログSW	J	-30*	30	-30	10, 50*	250	125	-1	-20	5	30	5		-1.5	5	10		28				5	I <sub>DSS</sub>			
2SK131	"	低周波, 低雑音	"	-30*	30	-30	10, 50*	250 unit	125	-1	-20	5	30	5		-1.5	5	10		28	32			5	5			
★2SK132	日立	低周波電力増幅	MOS			±14*	7A*	100W*	150*							0	1.5	10	100mA	0.6	(S) <sub>1</sub>	1.3	10	3A				
2SK133	"	"	"			±14*	7A*	100W*	150*							0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) <sub>1</sub>	1.4	10	3A				
2SK134	"	"	"			±14*	7A*	100W*	150*							0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) <sub>1</sub>	1.4	10	3A				
2SK135	"	"	"			±14*	7A*	100W*	150*							0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) <sub>1</sub>	1.4	10	3A				
2SK136	松下	低周波, 低雑音	J	-30*	30	-30	10, 20*	250	125	-100	-20	0.5	20	10	-0.1	-2	10	10		5	21			10	I <sub>DSS</sub>			
2SK137 2SK137A	"	"	"	-15*	15		50*	100	125				40	5							80			5	I <sub>DSS</sub>			
2SK138	日電	Xバンド, RF, OSC	GaAs SB			5	-10	100*	300	125*	-1μA	-5	30	100	3	-1.5		3	100		15	27			3	10		
2SK139																												
2SK140	日電	Xバンド, RF, OSC	GaAs SB			5	-8	100*	300	125	-10μA	-5	30	100	3	-1.0		3	100		20	35			3	10		
2SK141 2SK141A	"	DC, アナログSW	J	-30*	30	-30	10, 20*	250	150	-100*	-5*	-20	0.5	12	10	-0.2	-4.5	10	10		1.0	4.2			10	I <sub>DSS</sub>		
2SK142																												
2SK143																												
2SK144																												
2SK145																												
2SK146	東芝	低周波, 低雑音	J	-40			10	600 unit	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.2	10	0.1		(I <sub>DSS</sub> =5mA) 30 40				10	5			
2SK147	"	"	"	-40			10	600	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.2	10	0.1		(I <sub>DSS</sub> =5mA) 30 40				10	I <sub>DSS</sub>			
2SK148	松下	VHF, RF	"	-25	23		10, 10*	100	125					12	5						1.9			5	"			
2SK149	日電	UHF, RF, MIX	"	-20*		-10	10, 35*	350	150	-50	-8	8	32	10	-0.35	-2.2	10	10			30			10	"			
★2SK150	東芝	低周波, 低雑音	"	-50			10	200 unit	125	-1	-30	1	14	10	-0.3	-2	10	0.1			5	12			10	3		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名					
Ci (pF)				Cr (pF)				NF (f=1kHz, Rg=1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)										
typ	max	VGS(V) ID(mA)*	VDS(V)	typ	max	VGD(V) VGS(V)*	VDS(V)	typ	max	VDS(V)	ID(mA)	typ	max					VDS(V)	ID(mA)			
																		2SK126				
9		0	10	2		-3*	10	NV=80mVmax (VDS=10V, ID=1mA, Rg=100kΩ)				2SJ43とコンプリメンタリ					80	2SK127				
14		0	10	3.5		0*	10	(Rg=1kΩ) 0.6   1.5   10   IDSS									80A	2SK128				
																		2SK129				
55		5*	10	10		5mA	10											53A	2SK130			
55		5*	10	10		5mA	10	NV=35mVmax, IDSS小/IDSS大=0.9min, ΔVGS=20mVmax									109	2SK131				
600		5		10		-5*		VDS(sat)=12Vmax (ID=7A, VGD=0)				2SJ47とコンプリメンタリ					28A	2SK132				
600		-5	10	10		-5*	10	"				2SJ48とコンプリメンタリ					28A	2SK133				
600		-5	10	10		-5*	10	"				2SJ49とコンプリメンタリ					28A	2SK134				
600		-5	10	10		-5*	10	"				2SJ50とコンプリメンタリ					28A	2SK135				
13		-3	10	5		-3*	10	(Rg=1kΩ) 1   10   IDSS									80A	2SK136				
																		83	2SK137 2SK137A			
(fosc) max=55GHz typ												2.6	(f=8GHz) 3.5   3		10	MAG=12dB typ (f=8GHz)					100	2SK138
																			2SK139			
(fosc) max=80GHz typ												2.7	(f=12GHz) 3.5   3		10	MAG=11dB typ (f=12GHz)					100	2SK140
4.8	6.0	0	10	1.2	1.5	0	10											73	2SK141 2SK141A			
																			2SK142			
																			2SK143			
																			2SK144			
																			2SK145			
75		0	10	15		-10	ID=0	(Rg=100Ω) 1   2   10				ΔVGS=20mVmax (VDS=10V, ID=5mA) 2SJ73とコンプリメンタリ					85	2SK146				
75		0	10	15		-10	ID=0	(Rg=100Ω) 1   2   10				NF=10dB max (VDS=10V, ID=5mA, Rg=100Ω, f=100Hz) 2SJ72とコンプリメンタリ					74A	2SK147				
												2.5		5	1				101	2SK148		
7.5		3*	10	2		3mA	10					(ゲート接地, f=400MHz) 2   10   3		(ゲート接地) PG=12dB typ (f=400MHz)			102A	2SK149				
15		0	10	3		-10		(Rg=1kΩ) 2   1				ΔVGS=30mVmax				NF=10dB max (VDS=10V, ID=1mA, Rg=1kΩ, f=10Hz)		2SK272	75	2SK150		

★

★

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> *	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>GSS</sub> (nA)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)				
				V <sub>GDX</sub> ** (V)	(V)	V <sub>GSS</sub> ** (V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)	min	max	V <sub>DSS</sub> (V)	min	max	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DSS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>o</sub> * (Ω)	typ	max
★ 2SK151	日立	低周波, 低雑音	J	-40*	40	-40*	10 200*	800*	125	-10	-40	6	50	10	-0.2	-1.1	10	10	33	40		10	5		
2SK152	ソニー	高周波/低周波, 低雑音	"	-15*		-15	5, 50*	300	100	-2	-7	9.5	42	5	-0.55	-2	5	100	21	30		5	I <sub>DSS</sub>		
2SK153																									
2SK154	松下	VHF, RF	J	-20*	20		10, 30*	350	125				18	10					2.5			10	I <sub>DSS</sub>		
2SK155	"	低周波, 低雑音	"	-20*		-20	30*	400	125	-100	-20	0.5	30	10	-0.1	-1.5	10	10	8	45		10	"		
2SK156	三洋	コンデンサ・マイク	"	-20*			10	100	125			0.06	1.5	10											
★ 2SK157	日立	低周波	"			-50*	10, 20*	150*	125*	-10	-30	0.5	12	10	-0.13	-1.5	10	10	4.5	10		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK158	松下	"	"	-55			10	70	125				6.5	10						1.2		10	"		
2SK159																									
2SK160	日電	低周波, VHF	J	-30*		-30	10, 20*	150	125	-10	-30	0.5	12	5	-0.25	-4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5		
2SK161	東芝	FM, VHF	"	-18*			10	200	125	-10	-0.5	1	10	10	-0.4	-4	10	1		9		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK162	日電	低周波, 低雑音	"	-40*	40	-40	10, 50*	400	125	-1	-20	5	30	5		-1.2	5	10	40	45		5	5		
2SK163	"	"	"	-50*	50	-50	10, 30*	400	125	-1	-20	1	18	10	-0.2	-1.2	10	10	7	9		10	1		
2SK164																									
2SK165	松下	広帯域低雑音 ビデオカメラ	J	-15*		-15	5, 50*	300	100*	-2	-7	8	32	5		-3	5	100	3	14		5	I <sub>DSS</sub>		
2SK166																									
2SK167																									
2SK168	日立	VHF, RF, MIX, OSC	J	-30*		-1*	10, 20*	200*	150*	-10	-0.5	4	20	5		-3	5	10	8	10		5	I <sub>DSS</sub>		
2SK169	松下	低周波, 低雑音	"	-15	15		50*	400	125				50	5											
2SK170	東芝	"	"	-40			10	400	125	-1	-30	2.6	20	10	-0.2	-1.5	10	0.1		22		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK171	三菱	"	"	-20*		-20	10, 80*	200 unit	125*	-1	-10	5	60	5		-2	5	10		10		5	8		
2SK172																									
2SK173																									
2SK174																									
2SK175	日立	低周波電力増幅	MOS		180	±20*	8A*	125W*	150*						0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		



電 気 的 特 性 (Ta=25°C)												そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名														
C <sub>i</sub> , (pF)				C <sub>r</sub> , (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)								NF (f=100MHz) (dB)													
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)					typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)										
								(R <sub>g</sub> =200Ω) 0.5   1   10									2SJ51とコンプリメンタリ	2SK190	97	2SK151	★								
8	9	0	5					1.2nV/√Hz e <sub>n</sub> (R <sub>g</sub> =0) 5				10	(ゲート接地) 1.8   5   10								57A	2SK152							
														1.5	10						80B	2SK154							
40		-3	10	17		-3*	10					e <sub>n</sub> =0.7nV/√Hz typ (V <sub>DS</sub> =10V, V <sub>GS</sub> =0, f=1kHz)								80A	2SK155								
Z <sub>in</sub> =20MΩ min (f=1kHz)								V <sub>NO</sub> =-110dB (V <sub>IN</sub> =0)													58A	2SK156							
								(f=120Hz) 5   15														2SK323	87A	2SK157	★				
																							103	2SK158					
																								2SK159					
4.1		0	10	0.9		0*	10																	78A	2SK160				
					0.15	-10						2.5	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )	PG=18dB typ (f=100MHz)									70C	2SK161				
55		0	10	10		0*	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100Ω) 1.1   2.5   5				5												53A	2SK162				
13		0	10	3.2		0*	10	NV=20mVmax (指定回路による)																	53A	2SK163			
																										2SK164			
7.5		0	5																						80C	2SK165			
																											2SK166		
																											2SK167		
6.8		0	5	0.1		0*	5					1.7		5	I <sub>DSS</sub>	PG=27dB typ (f=100MHz)										89	2SK168		
																											2SK169		
30		0	10	6		I <sub>D</sub> =0	10	0.5	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 2   10			1	NF=10dB max (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA, R <sub>g</sub> =1kΩ, f=10Hz)													82C	2SK170		
200		5*	5					(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100Ω) 1   5			5	ΔV <sub>GS</sub> =50mVmax (V <sub>DS</sub> =5V, I <sub>D</sub> =5mA)														84	2SK171		
																											2SK172		
																												2SK173	
																												2SK174	
700		-5	10	8		-5*	10	V <sub>DS(sat)</sub> =12Vmax (I <sub>D</sub> =8A, V <sub>GD</sub> =0)								2SJ55とコンプリメンタリ										28A	2SK175		





型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)															
				V <sub>GD<sub>S</sub></sub> V <sub>GD<sub>O</sub></sub> V <sub>GD<sub>X</sub></sub> ** (V)	V <sub>D<sub>SX</sub></sub> V <sub>D<sub>SS</sub></sub> (V)	V <sub>G<sub>SO</sub></sub> V <sub>G<sub>SS</sub></sub> V <sub>G<sub>SX</sub></sub> ** (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> * (mA)	P <sub>a</sub> P <sub>ch</sub> * (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> * (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA)*	max V <sub>G<sub>S</sub></sub> (V)		I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>G<sub>S(off)</sub></sub> , V <sub>th</sub> * (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS) r <sub>D</sub> * (Ω)			
				min	max	V <sub>D<sub>S</sub></sub> (V)	min	max	V <sub>D<sub>S</sub></sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	max	min	typ	max	V <sub>D<sub>S</sub></sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> typ	max							
2SK201	日電	C-Xバンド 中出力増幅発振	GaAs		10	-10	400*	1.3W	175	-3μA	-5	180	400	3	-3	-7	3	1mA	35	50		3	100			
2SK202																										
2SK203	日電	C-Xバンド 中出力増幅発振	GaAs		10	-10	180*	0.8W	175	-1.5μA	-5	90	180	3	-3	-7	3	500	18	30		3	50			
2SK204																										
2SK205																										
2SK206																										
2SK207																										
2SK208	東芝	コンデンサ・マイク	J	-50			10	100	125	-1	-30	0.3	6.5	10	-0.4	-5	10	0.1	1.2				10	I <sub>DSS</sub>		
2SK209	"	低周波	"	-50			10	150	125	-1	-30	0.6	14	10	-0.2	-1.5	10	0.1	4	15			10	"		
2SK210	"	VHF, RF	"	-18			10	100	125	-10	-1	3	24	10	-1.2	-3	10	1		7			10	"		
2SK211	"	FMチューナ VHF, RF	"	-18*			10	150	125	-10	-0.5	1	10	10	-0.4	-4	10	1		9			10	"		
2SK212	三洋	FM, RF	"	-20*			10, 20*	200	125	-10	-0.5	0.6	12	5		-2.5	5	10	2	6			5	"		
2SK213	日立	低/高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		140	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK214	"	"	"		160	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK215	"	"	"		180	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK216	"	"	"		200	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK217	"	VHF, RF	J	-30*			10, 20*	150*	150*	-10	-0.5	2.5	12	5		-2.5	5	10		8			5	I <sub>DSS</sub>		
2SK218	松下	ビデオカメラ	"	-15*		-15	5, 50*	300	100	-2	-7	5	42	5		-3	5	100	15	30			5	"		
2SK219																										
2SK220Ⓔ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		160*	±20*	8A*	100W*	150*				1	120		0.4*	3*	10	10mA	600	900		10	3A		
2SK221Ⓔ	"	"	"		200*	±20*	8A*	100W*	150*				1	160		0.4*	3*	10	10mA	600	900		10	3A		
2SK222	三洋	低周波・低雑音	J	-40	40*		10	300	125	-1	-20	0.6	12	10		(typ) -0.5	10	10		17			10	I <sub>DSS</sub>		
2SK223	"	高電圧ドライブ	"	-80	80*		10	400	125	-1	-30	1.2	24	30		(typ) -0.75	30	10		20			30	"		
2SK224																										
2SK225	日立	低周波電力増幅	MOS		120	±15*	7A*	100W*	150*							0.15*	1.45*	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
												(f=8GHz) 3	4	15	MAG=9dB typ (f=8GHz)	120	2SK201		
																	2SK202		
												(f=8GHz) 2.6	4	10	MAG=11dB typ (f=8GHz)	120	2SK203		
																	2SK204		
																	2SK205		
																	2SK206		
																	2SK207		
8.2		0	10	2.6		-10	I <sub>D</sub> =0	0.5	(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 15 I <sub>DSS</sub>								105A	2SK208	
13		0	10	3		-10	I <sub>D</sub> =0	1	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 10								105A	2SK209	
					0.65	-10						1.8	3.5	(V <sub>DD</sub> ) 10	PG=24dB typ (f=100MHz)	105B	2SK210		
					0.15	-10						2.5	3.5	(V <sub>DD</sub> ) 10	PG=18dB typ (f=100MHz)	105B	2SK211		
4		0	5	0.04	0.15	0*	5					3.5	6	(V <sub>DD</sub> ) 5	I <sub>DSS</sub> PG=21dB typ (f=100MHz)	58B	2SK212		
90		10*	10	2.2		10mA	10	V <sub>DS(sat)</sub> =2V <sub>max</sub> (I <sub>D</sub> =10mA, V <sub>GD</sub> =0)						2SJ76とコンプリメンタリ		116A	2SK213		
90		10*	10	2.2		10mA	10	"						2SJ77とコンプリメンタリ		116A	2SK214		
90		10*	10	2.2		10mA	10	"						2SJ78とコンプリメンタリ		116A	2SK215		
90		10*	10	2.2		10mA	10	"						2SJ79とコンプリメンタリ		116A	2SK216		
				0.1		0*	5										87B	2SK217	
8		0	5														80C	2SK218	
																		2SK219	
600		-5	10			(I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =15V, R <sub>L</sub> =15Ω) t <sub>on</sub> =25ns typ, t <sub>off</sub> =45ns typ										28A	2SK220Ⓞ		
600		-5	10			"											28A	2SK221Ⓞ	
14		0	10	3.5		0*	10	1	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =1kΩ) 3			10	I <sub>DSS</sub>				57B	2SK222	
12		0	30	2.5		0*	30	1	(R <sub>g</sub> =10kΩ) 10			3					57B	2SK223	
																		2SK224	
600		-5	10	10		-5*	10	t <sub>on</sub> =180ns typ, t <sub>off</sub> =60ns typ (V <sub>DD</sub> =20V, I <sub>D</sub> =4A)						2SJ81とコンプリメンタリ		117A	2SK225		







型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)																			
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> * V <sub>GDX</sub> ** (V)	V <sub>Dsx</sub> V <sub>DSS</sub> * (V)	V <sub>Gso</sub> V <sub>Gss</sub> * V <sub>Gsx</sub> ** (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> * (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> * (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> * (°C)	I <sub>CSS</sub> (nA) (pA)*	I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>ih</sub> * (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)										
											max V <sub>Gs</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω) typ	max					
2SK251																														
2SK252																														
2SK253																														
2SK254																														
2SK255																														
2SK256																														
2SK257																														
2SK258Ⓞ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		250*	±20*	8A*	125W*	150*				1	200	0.4*	3*	10	10mA	0.9 <sup>(S)</sup> 1.3		10	3A								
2SK259Ⓞ	"	"	"		350*	±20*	5A*	125W*	150*				1	280	0.4*	3*	10	10mA	0.6 <sup>(S)</sup> 1		20	3A								
2SK260Ⓞ	"	"	"		400*	±20*	5A*	125W*	150*				1	320	0.4*	3*	10	10mA	0.6 <sup>(S)</sup> 1		20	3A								
★ 2SK261	"	低周波電力増幅																												
★ 2SK262	"	"																												
★ 2SK263	"	"																												
★ 2SK264	"	"																												
2SK265																														
2SK266	東芝	コンデンサ・マイク インピーダンス変換	J	-15*			10	100	125	I <sub>D</sub> =0.6mAmax (V <sub>DD</sub> =6V, R <sub>L</sub> =1kΩ, ゲート, ソース; 15pF ショート)																				
2SK267																														
2SK268																														
2SK269																														
★ 2SK270	東芝	低周波, 低雑音	J	-40			10	300 unit	125	-10	-30	1	20	10	-0.2	-2	10	0.1	8	20		10	3							
★ 2SK271	"	低周波電力増幅	MOS		140	±8	8A*	120W	150*	±1μA	±8				0.8	2.4	10	0.1A	1 <sup>(S)</sup> 1.5		10	2A								
★ 2SK272	"	"	"		140	±8	7A*	100W	150*	±1μA	±8				0.8	2.4	10	0.1A	1 <sup>(S)</sup> 1.5		10	2A								
★ 2SK273	三菱	S-Xバンド 低雑音増幅	GaAs		8	-6	100*	300	150			30	100	3	-1	-5	3	100	20	30		3	30							
★ 2SK274	"	"	"		8	-6	100*	300	150			30	100	3	-1	-5	3	100	25	35		3	30							
★ 2SK275	"	"	"		8	-6	100*	300	150			30	100	3	-1	-5	3	100	25	35		3	30							

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名			
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	
																		2SK251		
																		2SK252		
																		2SK253		
																		2SK254		
																		2SK255		
																		2SK256		
																		2SK257		
800		-5	10					t <sub>on</sub> =25ns typ. t <sub>off</sub> =140ns typ (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>CS</sub> =15V)									28A	2SK258④		
800		-5	10	15		-5		"									28A	2SK259④		
800		-5	10	15		-5		"									28A	2SK260④		
																		2SK261 ★		
																		2SK262 ★		
																		2SK263 ★		
																		2SK264 ★		
																		2SK265		
Z <sub>in</sub> =200MΩ min (V <sub>DD</sub> =6V, C <sub>g</sub> =15pF, R <sub>L</sub> =1kΩ, f=50Hz)								V <sub>N</sub> =40mVmax (V <sub>DD</sub> =6V, R <sub>L</sub> =1kΩ, G <sub>V</sub> =80dB, C <sub>g</sub> =15pF)									155	2SK266		
																		2SK267		
																		2SK268		
																		2SK269		
25		0	10	5.5		-10		(R <sub>g</sub> =1kΩ) 2	10	1		ΔV <sub>GS</sub> =30mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)						75	2SK270 ★	
800		0	10	60		0*	10	V <sub>DS(sat)</sub> =8Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =8V)					2SJ91とコンプリメンタリ			2SK405	118	2SK271 ★		
800		0	10	60		0*	10	"					2SJ92とコンプリメンタリ			2SK405	119	2SK272 ★		
最大発振周波数 50GHz typ												(f=12GHz) 4.5	3	10	(MGF-1400)			122	2SK273 ★	
" 70GHz typ												(f=12GHz) 3	3	10	(MGF-1402)			122	2SK274 ★	
" 70GHz typ												(f=4GHz) 0.8	1	3	10	(MGF-1412)			122	2SK275 ★



電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名			
C <sub>i</sub> , (pF)				C <sub>r</sub> , (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>n</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)								
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	
最大発振周波数 90GHz typ												(f=18GHz) 2.8	3	10	(MGF-1403)		122	2SK276	★	
950	1,500	-5	10	10		-5*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =6Vmax, R <sub>DS(ON)</sub> =1.5Ω max (V <sub>GS</sub> =15V, I <sub>D</sub> =4A)									108	2SK277		
950	1,500	-5	10	10		-5*	10	"										108	2SK278	
最大発振周波数 45GHz typ								直線電力利得 9dB typ (f=8GHz)							(MGF-1801)		122	2SK279	★	
												(f=15GHz) 2.3	3	10	MAG=8dB typ (f=15GHz)		123	2SK280		
												(f=8GHz) 1.8	3	10	MAG=10dB typ (f=8GHz)		123	2SK281		
																		2SK282		
12		0	30	2.5		0*	30										126	2SK283		
																		2SK284		
																		2SK285		
500		-5	10					V <sub>DS(ON)</sub> =4Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =15V)							2SJ96とコンプリメンタリ		117A	2SK286		
500		-5	10					t <sub>on</sub> =25ns typ, t <sub>off</sub> =350ns typ (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =15V)									117A	2SK287Ⓔ		
500		-5	10					"									117A	2SK288Ⓔ		
500		-5	10					"									28A	2SK289Ⓔ	★	
500		-5	10					"									28A	2SK290Ⓔ	★	
8.5		0	5					e <sub>n</sub> =1.2nV/√Hz typ (V <sub>DS</sub> =5V, I <sub>D</sub> =5mA, R <sub>g</sub> =0, f=100kHz)									37B	2SK291		
5	6.5	0	5	0.07	0.25	0*	5					3	6	5	I <sub>DSS</sub>	PG=21dB typ (f=100MHz)		104A	2SK292	
950	1,500	-5	10	10		-5*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =5.2Vmax, R <sub>DS(ON)</sub> =1.3Ω max (V <sub>GS</sub> =15V, I <sub>D</sub> =4A)									108	2SK293		
450		0	10	140		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.7Vmax (I <sub>D</sub> =3A, V <sub>GS</sub> =15V)									116B	2SK294		
450		0	10	140		0*	10	"									116B	2SK295		
140		0	10	23		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =4Vmax (I <sub>D</sub> =1A, V <sub>GS</sub> =15V)									116B	2SK296		
																		2SK297		
800		0	10	20		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =7Vmax (I <sub>D</sub> =4A, V <sub>GS</sub> =15V)							2SJ116とコンプリメンタリ		28B	2SK298		
800		0	10	20		0*	10	"									28B	2SK299		
																		2SK300		



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> V <sub>GDX</sub> ** (V)	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> * (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> * V <sub>Gsx</sub> ** (V)	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> * (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> * (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> * (°C)	I <sub>CSS</sub> (nA) (pA)*	max	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)			
				min	max	V <sub>DS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max								
2SK301	松下	低周波増幅, SW	J	-55*	55	-55	10, 30*	250	125	-10	-30	0.5	20	10		-5	10	10	2.5	7.5		10	I <sub>DSS</sub>		
2SK302	東芝	VHF, RF	MOS		20	±5	30*	150	125	±50	±5	1.5	14	10		-2.5	10	100		10		10	"		
2SK303	三洋	低周波電力増幅	J	-30	30*		10, 20*	150	125	-1	-20	0.6	12	10		-4	10	1	2.5	6		10	"		
2SK304	"	"	"	-30	30*		10, 20*	150	125	-1	-20	0.6	12	10		-4	10	1	2.5	6		10	"		
2SK305																									
2SK306																									
2SK307																									
2SK308	日立	高周波電力増幅	MOS		120*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	100	1*	4.5*	10	1mA	1.5 <sup>(S)</sup>	2		10	5A		
2SK309																									
2SK310	日立	高周波電力増幅 高速度電力 SW	MOS		400*	±20*	3A*	40W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	0.6	<sup>(S)</sup> 1		10	2A		
2SK311	"	"	"		450*	±20*	3A*	40W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	0.6	<sup>(S)</sup> 1		10	2A		
2SK312	"	"	"		400*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1.5	<sup>(S)</sup> 2.5		10	6A		
2SK313	"	"	"		450*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1.5	<sup>(S)</sup> 2.5		10	6A		
2SK314	日電	低周波, 低雑音	J	-40*	40	-40	10, 50*	250	150	-100*	-20	5	30	10	-0.5	-3	10	10	8	12		10	5		
2SK315	三洋	FMチューナ	"	-20*			10, 25*	200	125	-10	-0.5	2.5	24	5		-3.5	5	10	6	12		5	I <sub>DSS</sub>		
2SK316	松下	ビデオカメラ	"	-10*		-10	5, 50*	200	100*	-2	-7	5	24	5		-3	5	100	15			5	"		
2SK317	日立	HF, VHF 電力増幅	MOS		180*	±20*	8A*	120W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.9	<sup>(S)</sup> 1.25		20	3A		
2SK318	"	"	"		180*	±20*	4A*	70W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.4	<sup>(S)</sup> 0.6		20	1.5A		
2SK319	"	高周波電力増幅 高速度電力 SW	"		400*	±20*	5A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1	<sup>(S)</sup> 1.5		10	3A		
2SK320	"	"	"		450*	±20*	5A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1	<sup>(S)</sup> 1.5		10	3A		
2SK321	松下	広帯域低雑音増幅 ビデオカメラ	J	-15*		-15	5, 50*	200	100*	-2	-7	5	42	5		-3	5	100	15	30		5	I <sub>DSS</sub>		
2SK322	日立	HF広帯域増幅	"	-15*		-15	5, 50*	150*	150*	-10	-7	6	50	5		-3	5	100	25	45		5			
2SK323	"	低周波増幅	"			-40*	10, 30*	150*	150*	-10	-30	1.6	12	10	-0.13	-1.5	10	10	8	12		10	3		
2SK324	東芝	高速高電圧 SW	MOS		400	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	3	<sup>(S)</sup> 5		10	5A		
2SK325	"	"	"		450	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	3	<sup>(S)</sup> 5		10	5A		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)												そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名				
Ci, (pF)				Cr, (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)								NF (f=100MHz) (dB)			
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)					typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
6.5		0	10	1.9		0*	10	(f=120Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5 I <sub>DSS</sub>										80A	2SK301
3		0	10	0.035	0.05	0*	10					1.7	3	10	I <sub>DSS</sub>		PG=28dB typ (f=100MHz)	105B	2SK302
5		0	10	1.5		0*	10											126A	2SK303
5		0	10	1.5		0*	10											58A	2SK304
																			2SK305
																			2SK306
																			2SK307
1,130		0	10	80		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.5Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =15V)										28B	2SK308
																			2SK309
440		0	10	13		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =8Vmax (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =15V)				2SJ117とコンプリメンタリ					116B	2SK310	
440		0	10	13		0*	10	"									116B	2SK311	
1,500		0	10	35		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =5.4Vmax (I <sub>D</sub> =6A, V <sub>GS</sub> =15V)									28B	2SK312	
1,500		0	10	35		0*	10	"									28B	2SK313	
9		0	10	2.6		0*	10	0.6		(R <sub>g</sub> =1kΩ) 1.5 10	5	NF=10dB max (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =5mA, R <sub>g</sub> =1kΩ, f=10Hz)					73	2SK314	
8		0	5	0.08	0.3	0*	5					2.2	4	5	I <sub>DSS</sub>	PG=23dB typ (f=100MHz)		58B	2SK315
	5	5*	5															103A	2SK316
600		5	0	0.5		-50		V <sub>DS(ON)</sub> =6Vmax (I <sub>D</sub> =4A, V <sub>GS</sub> =10V)				P <sub>o</sub> =120W min (f=100MHz)				129	2SK317		
300		5	0	0.3		-50		V <sub>DS(ON)</sub> =6Vmax (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =10V)				P <sub>o</sub> =90W typ (f=100MHz)				129	2SK318		
800		0	10	20		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =5.5Vmax (I <sub>D</sub> =3A, V <sub>GS</sub> =15V)								116B	2SK319		
800		0	10	20		0*	10	"								116B	2SK320		
8		0	5															103A	2SK321
																		87A	2SK322
																		87A	2SK323
1,500	2,000	0	10	150	300	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =7Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)								134	2SK324		
1,600	2,000	0	10	140	300	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =8Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)								134	2SK325		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)						電気的特性 (Ta=25°C)													
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> V <sub>GDX</sub> ** (V)	V <sub>DSX</sub> V <sub>DSS</sub> (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> V <sub>Gsx</sub> ** (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) V <sub>CS</sub> (pA)*	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)		
										max	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω) typ
2SK326																							
2SK327																							
2SK328																							
2SK329																							
2SK330	東芝	低周波, 定電流回路, アナログSW	J	-50			10	200	125	-1	-30	1.2	14	10	-0.7	-6	10	0.1	1.5	4		10	I <sub>DSS</sub>
2SK331	三洋	コンデンサ・マイク	"	-20*			10	100	125			0.06	1.5	10									
2SK332	"	差動増幅	"	-40	40*		10, 20*	200 unit	125	-1	-20	1.2	12	10	(typ) -0.5		10	10		17		10	I <sub>DSS</sub>
2SK333	"	"	"	-80	80*		10, 20*	200 unit	125	-1	-30	1.2	12	30		-3	30	10	5	15		30	"
2SK334	"	コンデンサ・マイク	"	-20*			10	100	125			0.06	1.5	10									
2SK335																							
2SK336	三洋	アナログSW	MOS		50*	±12	400*	600	125	10	10		1μA	20	0.3	2.5	10	100	20	35		10	50
2SK337	日電	高耐圧SW	"		500*	±20*	±100*	10W	150*	±100	±20		10μA	500	1	5	10	1mA	10	30		10	20
2SK338																							
2SK339																							
2SK340																							
2SK341																							
2SK342																							
2SK343	日立	低周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		140*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	120	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A
2SK344	"	"	"		160*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	140	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A
2SK345	"	"	"		40*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	30	2*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	3A
2SK346	"	"	"		60*	±20*	5A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	50	2*	5*	10	1mA	0.5	(S) 0.9		10	3A
2SK347	"	高周波電力増幅 高速度電力SW	"		400*	±20*	1A*	10W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	0.1	(S) 0.3		10	0.5A
2SK348																							
2SK349	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		400*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	320	1*	5*	10	1mA	1.3	(S) 2.5		10	5A
2SK350	"	"	"		450*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	360	1*	5*	10	1mA	1.3	(S) 2.5		10	5A

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
																		2SK326	
																		2SK327	
																		2SK328	
																		2SK329	
9		0	10	2.5		-10	I <sub>D</sub> =0			R <sub>DS(ON)</sub> =320Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA) 2SJ105とコンプリメンタリ						70A	2SK330		
Z <sub>in</sub> =20MΩ min (f=1kHz)										V <sub>NO</sub> =-110dB max (V <sub>IN</sub> =0)						127	2SK331		
13		0	10	3		0*	10	0.6	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 1.5	10	I <sub>DSS</sub>	ΔV <sub>GS</sub> =30mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)				107	2SK332		
11		0	30	2		0*	30	1	(R <sub>g</sub> =10kΩ)	30	3	ΔV <sub>GS</sub> =30mVmax (V <sub>DS</sub> =30V, I <sub>D</sub> =1mA)				107	2SK333		
Z <sub>in</sub> =20MΩ min (f=1kHz)												V <sub>NO</sub> =-110dB max (V <sub>IN</sub> =0)						106	2SK334
																		2SK335	
17		0	10	2.2		0*	10										R <sub>DS(ON)</sub> =12Ω typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =10mA)	57A	2SK336
20	100	0	10	1		0*	10	R <sub>DS(ON)</sub> =100Ω max (V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =20mA)						135	2SK337				
																		2SK338	
																		2SK339	
																		2SK340	
																		2SK341	
																		2SK342	
800		0	10	60		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =2Vmax (I <sub>D</sub> =4A, V <sub>GS</sub> =15V)						2SJ99とコンプリメンタリ		117B	2SK343		
800		0	10	60		0*	10	"						2SJ100とコンプリメンタリ		117B	2SK344		
350		0	10	80		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.2Vmax (I <sub>D</sub> =3A, V <sub>GS</sub> =15V)						2SJ101とコンプリメンタリ		116B	2SK345		
350		0	10	80		0*	10	"						2SJ102とコンプリメンタリ		116B	2SK346		
125		0	10	6		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =6Vmax (I <sub>D</sub> =0.5A, V <sub>GS</sub> =15V)								150	2SK347		
																		2SK348	
1,500		0	10	35		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =4.5Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =15V)								149	2SK349		
1,500		0	10	35		0*	10	"								149	2SK350		

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)													
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> <sup>*</sup> V <sub>GDX</sub> <sup>**</sup> (V)	V <sub>DSS</sub> <sup>*</sup> V <sub>DSS</sub> <sup>*</sup> (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> <sup>*</sup> V <sub>GSS</sub> <sup>**</sup> (V)	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> <sup>*</sup> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> <sup>*</sup> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> <sup>*</sup> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) (pA) <sup>*</sup>	max V <sub>Gs</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>Gsoff</sub> , V <sub>th</sub> <sup>*</sup> (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ <sup>*</sup>			g <sub>os</sub> (mS)		
				min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> <sup>*</sup> (Ω)			
2SK351	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		800*	±20*	5A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	640	1*	5*	10	1mA	1	(S) 2	10	3A		
2SK352	"	"	"		250*	±9*	300*	8W*	150*	±1μA	±9		1	200	1	5	10	1mA	50	80		20	150	
2SK353	日電	C~Kuバンド 低雑音増幅	GaAs		5	-6	120*	270	125*	-10μA	-5	20	120	3	-0.5	-6	3	100	20	40	100	3	10	
2SK354	"	VHF~Cバンド 低雑音増幅	"		5	-6	150*	300	125*	-10μA	-5	30	150	3	-0.8	-6	3	100	20	40	100	3	10	
2SK355	東芝	高速高電圧SW	MOS		150	±20*	12A*	120W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A	
2SK356	"	"	"		250	±20*	12A*	120W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A	
2SK357	"	"	"		150	±20*	5A*	40W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	0.8	(S) 1.8		10	3A	
2SK358	"	"	"		250	±20*	5A*	40W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.3		10	3A	
2SK359	日立	VHF, RF	"		20	±5	±1,30*	400*	150*	±20	±5	4	12	10	0	-2	10	10	8	14		10	I <sub>DSS</sub>	
2SK360	"	"	"		20	±5	±1,30*	150*	150*	±20	±5	4	12	10	0	-2	10	10	8	14		10	I <sub>DSS</sub>	
2SK361																								
2SK362	東芝	低周波, アナログSW	J	-50			10	300	125	-1	-30	1.2	14	10	-0.25	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 5   19			10	I <sub>DSS</sub>	
2SK363	"	"	"	-40			10	400	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.2	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =15mA) 25   60			10	"	
2SK364	"	"	"	-40			10	400	125	-1	-30	2.6	20	10	-0.2	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 12   28			10	"	
2SK365	"	"	"	-50			10	200	125	-1	-30	1.2	14	10	-0.25	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 5   19			10	"	
2SK366	"	"	"	-40			10	200	125	-1	-30	2.6	20	10	-0.2	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 12   28			10	"	
2SK367	"	低周波高電圧増幅 定電流回路	"	-100			10	200	125	-1	-80	0.6	6.5	10	-0.4	-3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	"	
2SK368	"	"	"	-100			10	150	125	-1	-80	0.6	6.5	10	-0.4	-3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	"	
2SK369	"	低周波, 低雑音	"	-40			10	400	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.2	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 25   40			10	"	
2SK370	"	"	"	-40			10	200	125	-1	-30	2.6	20	10	-0.2	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =3mA) 8   22			10	"	
2SK371	"	"	"	-40			10	200	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.5	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =5mA) 25   40			10	"	
2SK372	"	低周波, アナログSW	"	-40			10	200	125	-1	-30	5	30	10	-0.3	-1.2	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =15mA) 25   60			10	"	
2SK373	"	低周波高電圧増幅 定電流回路	"	-100			10	400	125	-1	-80	0.6	6.5	10	-0.4	-3.5	10	0.1	1.5	4.6		10	"	
2SK374	松下	低周波増幅, SW	"	-55*	55	-55	10, 30*	200	125	-10	-30	1	20	10		-5	10	10	2.5	7.5		10	5	
2SK375	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		300*	±20*	1A*	10W*	150*	±1μA	±20		1	240	1*	5*	10	1mA	200	400		10	500	

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)											そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名					
C <sub>is</sub> (pF)				C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>s</sub> =1MΩ) (dB)							NF (f=100MHz) (dB)				
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GS</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)					I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
1,900		0	10	40		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =9Vmax (I <sub>D</sub> =3A, V <sub>GS</sub> =15V)										28B	2SK351
20		0	10	2.5		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =5Vmax (I <sub>D</sub> =100mA, V <sub>GS</sub> =9V)										136	2SK352
最大発振周波数 90GHz typ											2.3		3	10	MAG=8dB typ (f=15GHz)			123	2SK353
最大発振周波数 60GHz typ											2		3	10	MAG=10dB typ (f=8GHz)			137	2SK354
1,600	2,200	0	10	350	600	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.8Vmax (I <sub>D</sub> =40A, V <sub>GS</sub> =10V)										134	2SK355
1,600	2,000	0	10	220	320	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =2.5Vmax (I <sub>D</sub> =30A, V <sub>GS</sub> =10V)										134	2SK356
260	350	0	10	50	100	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =9.5Vmax (I <sub>D</sub> =8A, V <sub>GS</sub> =10V)										138	2SK357
380	500	0	10	60	120	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =12Vmax (I <sub>D</sub> =8A, V <sub>GS</sub> =10V)										138	2SK358
2.5		0	10	0.03		0*	10					2		10	I <sub>DSS</sub>	PG=30dB typ (f=100MHz)		37A	2SK359
2.5		0	10	0.03		0*	10					2		10	I <sub>DSS</sub>	PG=30dB typ (f=100MHz)		87D	2SK360
																			2SK361
13		0	10	3		-10	I <sub>D</sub> =0									R <sub>DS(ON)</sub> =80Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA)		82C	2SK362
75		0	10	15		-10	I <sub>D</sub> =0									R <sub>DS(ON)</sub> =20Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =15mA)		82C	2SK363
30		0	10	6		-10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> =50Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA)								2SJ104とコンプリメンタリ		82C	2SK364
13		0	10	3		-10	I <sub>D</sub> =0									R <sub>DS(ON)</sub> =80Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA)		70B	2SK365
30		0	10	6		-10	I <sub>D</sub> =0	R <sub>DS(ON)</sub> =50Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA)								2SJ107とコンプリメンタリ		70B	2SK366
13		0	10	3		I <sub>D</sub> =0	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5   10   I <sub>DSS</sub>										70A	2SK367
13		0	10	3		I <sub>D</sub> =0	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5   10   I <sub>DSS</sub>										105A	2SK368
75		0	10	15		-10	I <sub>D</sub> =0	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 5   10   5										82C	2SK369
30		0	10	6		-10	I <sub>D</sub> =0	(f=10Hz, R <sub>g</sub> =1kΩ) 1   10   10   10				1				2SJ108とコンプリメンタリ		70B	2SK370
75		0	10	15		-10	I <sub>D</sub> =0	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100Ω) 5   10   5										70B	2SK371
75		0	10	15		-10	I <sub>D</sub> =0									R <sub>DS(ON)</sub> =20Ω typ (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =15mA)		70B	2SK372
13		0	10	3		I <sub>D</sub> =0	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5   10   I <sub>DSS</sub>										82B	2SK373
6.5		0	10	1.9		0*	10	(f=100Hz, R <sub>g</sub> =100kΩ) 0.5   10   I <sub>DSS</sub>										103A	2SK374
140		0	10	23		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =4Vmax (I <sub>D</sub> =1A, V <sub>GS</sub> =15V)										150	2SK375



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)									電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)														
				V <sub>CDs</sub> V <sub>GD0*</sub> V <sub>GDx**</sub> (V)	V <sub>DsX</sub> V <sub>DsS*</sub> (V)	V <sub>Cs0</sub> V <sub>CsS*</sub> V <sub>CsX**</sub> (V)	I <sub>C</sub> I <sub>D*</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch*</sub> (mW)	T <sub>i</sub> T <sub>ch*</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA) V <sub>Gs</sub> (pA)* (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>Gs(off)</sub> , V <sub>th*</sub> (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)						
											min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω) typ	max			
2SK376	三 洋	コンデンサ・マイク	J	-20*			10	100	125				0.06	0.8	5												
2SK377	"	"	"	-20*			10	100	125				0.06	0.8	5												
2SK378	松 下	UHF 広帯域低雑音	GaAs		5	-4	1,130*	350	125	-80μA	-4	15	130	3		-4	3	500	40	75		3	30				
2SK379	"	SW電源 DC-DCコンバータ	MOS		400*	±20*	8A*	100W	150*				1	400	1*	5*	V <sub>Cs</sub>	1mA	2.5	(S) 4		25	5A				
2SK380	"	"	"		450*	±20*	8A*	100W	150*				1	400	1*	5*	V <sub>Cs</sub>	1mA	2.5	(S) 4		25	5A				
2SK381	三 菱	低周波電圧増幅 アナログSW	J	-50*			10	300	125*	-1	-30	0.3	12	10	-0.3	-6	10	10	1	3		10	I <sub>DSS</sub>				
2SK382	日 立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		500*	±20*	2A*	30W*	150*	±1μA	±20		1	400	2*	5*	10	1mA	400	700		10	1A				
2SK383	"	"	"		100*	±20*	10A*	50W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2.8		10	5A				
2SK384	"	"	"		500*	±20*	300*	10W*	150*	±1μA	±20		1	400	1*	5*	10	1mA	60	100		10	200				
2SK385	東 芝	高速高電圧SW	"		400	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A				
2SK386	"	"	"		450	±20*	10A*	120W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 5		10	5A				
2SK387	"	"	"		150	±20*	12A*	150W	150*	±100	±20		1	150	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A				
2SK388	"	"	"		250	±20*	12A*	150W	150*	±100	±20		1	250	1.5	3.5	10	1mA	3	(S) 6		10	10A				
2SK389	"	低周波低雑音 差動増幅	J	-50			10	200	125	-1	-30	2.6	20	10	-0.15	-2	10	0.1	(I <sub>DSS</sub> =3mA) 8	20		10	I <sub>DSS</sub>				
2SK390																											
2SK391																											
2SK392																											
2SK393																											
2SK394																											
2SK395																											
2SK396																											
2SK397																											
2SK398	日 立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		100*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A				
2SK399	"	"	"		100*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	80	2*	5*	10	1mA	1.5	(S) 2		10	5A				
2SK400	"	"	"		200*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	160	2*	5*	10	1mA	1	(S) 1.8		10	4A				

電 気 的 特 性 (T <sub>a</sub> =25°C)											そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名					
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>o</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)							NF (f=100MHz) (dB)				
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)					I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
Z <sub>in</sub> =18MΩ min (f=1kHz)								V <sub>NO</sub> =-110dBmax (V <sub>IN</sub> =0)									156	2SK376	
"								"									127	2SK377	
												(f=800MHz) 3 3 30				PG=10dBtyp (f=800MHz)	91A	2SK378	
800		0	20	30		0*	20	R <sub>DS(ON)</sub> =1.5Ω max (V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =5A)									140	2SK379	
800		0	20	30		0*	20	R <sub>DS(ON)</sub> =2Ω max (V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =5A)									140	2SK380	
8		0	10	1.5		0*	10	R <sub>DS(ON)</sub> =250Ω typ (f=1kHz, V <sub>DS</sub> =10mVrms) V <sub>GS</sub> =0, I <sub>DSS</sub> =5mA								2SJ40とコンプリメンタリ	151	2SK381	
440		0	10	13		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =4Vmax (I <sub>D</sub> =1A, V <sub>GS</sub> =15V)									116B	2SK382	
1,100		0	10	80		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =0.9Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =15V)									116B	2SK383	
70		0	10	5		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =10Vmax (I <sub>D</sub> =200mA, V <sub>GS</sub> =15V)									150	2SK384	
1,500	2,000	0	10	140	300	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =7Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)									141	2SK385	
1,500	2,000	0	10	140	300	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =8Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)									141	2SK386	
1,600	2,200	0	10	350	600	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.8Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)									141	2SK387	
1,600	2,000	0	10	220	320	0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =2.5Vmax (I <sub>D</sub> =10A, V <sub>GS</sub> =10V)									141	2SK388	
25		0	10	5.5		-10	I <sub>D</sub> =0	(R <sub>g</sub> =1kΩ) 0.5 2 10 1				V <sub>GS</sub>  =20mVmax				2SJ109とコンプリメンタリ	148	2SK389	
																	2SK390		
																	2SK391		
																	2SK392		
																	2SK393		
																	2SK394		
																	2SK395		
																	2SK396		
																	2SK397		
800		0	10	70		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =1.25Vmax (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =15V)								2SJ112とコンプリメンタリ	28B	2SK398	
800		0	10	70		0*	10	"								2SJ113とコンプリメンタリ	149	2SK399	
750		0	10	60		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =2.8Vmax (I <sub>D</sub> =4A, V <sub>GS</sub> =15V)								2SJ114とコンプリメンタリ	149	2SK400	

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)															
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> V <sub>GDX</sub> (V)	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> (V)	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> V <sub>Gsx</sub> (V)	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA)	max	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GStoff</sub> , V <sub>th</sub> (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)				
												min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>ip</sub> (Ω)	typ	max
2SK401	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		250*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	200	2*	5*	10	1mA	1.6	(S) 2.5		10	5A			
2SK402	"	"	"		400*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	320	2*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A			
2SK403	"	"	"		450*	±20*	8A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	360	2*	5*	10	1mA	1.2	(S) 1.7		10	4A			
2SK404	三洋	低周波, 高周波 増幅	J	-20	20*		10, 20*	200	125	-1	-10	1.2	12	5		-2	5	10	5	10		5	I <sub>DSS</sub>			
2SK405	東芝	低周波電力増幅	MOS		160*	±20*	8A*	100W	150	±1	±20				0.8	2.8	10	100mA	1	(S) 2		10	2A			
2SK406	日電	C~Kuバンド 低雑音増幅	GaAs		5	-6	120*	270	120*	-10μA	-5	20	120	3	-0.5	-3.5	3	100	20	50	100	3	10			
2SK407	"	"	"		5	-6	120*	270	120*	-10μA	-5	20	120	3	-0.5	-3.5	3	100	20	50	100	3	10			
2SK408	日立	HF, VHF 電力増幅	MOS		180*	±20*	2A*	30W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	200	300		20	1A			
2SK409	"	"	"		180*	±20*	2A*	30W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	200	300		20	1A			
2SK410	"	"	"		180*	±20*	8A*	120W*	150*				1	140	0.5*	3*	10	1mA	0.9	(S) 1.25		20	3A			
2SK411	"	高周波電力増幅 高速度電力SW	"		600*	±20*	5A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	500	2	5	10	1mA	1.5	(S) 2.3		10	3A			
2SK412	"	"	"		250*	±20*	10A*	100W*	150*	±1μA	±20		1	200	2*	5*	10	1mA	1.6	(S) 2.5		10	5A			
2SK413	"	"	"		140*	±20*	8A*	100W	150*	±1μA	±20		1	120	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A			
2SK414	"	"	"		160*	±20*	8A*	100W	150*	±1μA	±20		1	140	2*	5*	10	1mA	1	(S) 2		10	4A			
2SK415	"	"	"		800*	±20*	3A*	80W	150*	±1μA	±20		1	640	2*	5*	10	1mA	0.4	(S) 0.7		20	2A			
2SK416	"	"	"		40*	±20*	2A*	10W	150*	±1μA	±20		1	35	1*	4*	10	1mA	0.2	(S) 0.4		10	1A			
2SK417	東芝	高速大電流SW	"		60	±20*	10A*	60W	150*	±100	±20		1	60	1.5	3.5	10	1mA	2	(S) 4		10	5A			
2SK418	"	高速度電圧SW	"		400	±20*	2A*	50W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	0.6	(S) 1.2		10	1A			
2SK419	"	"	"		450	±20*	2A*	50W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	0.6	(S) 1.2		10	1A			
2SK420	"	"	"		400	±20*	5A*	60W	150*	±100	±20		1	400	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.5		10	3A			
2SK421	"	"	"		450	±20*	5A*	60W	150*	±100	±20		1	450	1.5	3.5	10	1mA	1	(S) 2.5		10	3A			
2SK422	"	高速SW	"		60	±20*	0.7A*	900	150*	±100	±20		1	60	1.5*	3.5*	10	1mA	80	220		10	500			
2SK423	"	"	"		100	±20*	0.5A*	900	150*	±100	±20		1	100	1.5*	3.5*	10	1mA	50	150		10	300			
2SK424	日電	高耐圧大電流SW	"		600*	±20	3A*	100W	150*	±100	±20		5	600	0.5	5	10	10mA	0.5	(S) 2	5	25	3A			
2SK425	"	低周波	J	-50*		-50	10, 30*	200	150	-1	-20	1	18	10	-0.2	-1.2	10	10	7	9		10	1			

















型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電 気 的 特 性 (Ta=25°C)																				
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>Dsx</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSo</sub> V <sub>Gsx</sub> *	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>CSS</sub> (nA)	max V <sub>Gs</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> * (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)									
				V <sub>GDX</sub> (V)	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*		min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	min	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>Ds</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω)	typ	max					
2SK501																															
2SK502																															
2SK503																															
2SK504																															
2SK505	日電	ビデオ帯, 高周波増幅	J	-15*	15	-15	5.50*	400	125	-1	-10	10	50	5	-0.6	-3.5	5	10	14	26		5	I <sub>DSS</sub>								
2SK506																															
2SK507	日電	ビデオ帯, 高周波増幅	J	-15*	15	-15	5.50*	350	150	-1	-10	10	50	5	-0.6	-3.5	5	10	14	26		5	I <sub>DSS</sub>								
2SK508	"	"	"	-15*	15	-15	5.50*	200	150	-1	-10	10	50	5	-0.6	-3.5	5	10	14	26		5	I <sub>DSS</sub>								
2SK509																															
2SK510																															
2SK511	日立	高速度電力SW 高周波電力増幅	MOS		250*	±9*	300*	8W*	150*	±1μA	±9		1	200	1*	5*	10	1mA	50	80		20	500								
2SK512	"	高速度電力SW	"		500*	±20*	12A*	125W*	150*	±1μA	±20		1	400	2*	4*	10	1mA	2.5	(S) 3.5		10	6A								
2SK513	"	高速度電力SW 高周波電力増幅	"		800*	±20	3A*	60W*	150*	±1μA	±20		1	640	2*	4*	10	1mA	0.4	(S) 0.7		20	2A								
2SK514																															
2SK515																															
2SK516																															
2SK517																															
2SK518	日電	高周波増幅	J	-30*	30	-30	10.50*	400	150	-1	-20	30	110	10	-1.5	-9	10	10		22		10	I <sub>DSS</sub>								
2SK519	"	"	"	-30*	30	-30	10.50*	350	150	-1	-20	30	110	10	-1.5	-9	10	10		22		10	I <sub>DSS</sub>								
2SK520	"	"	"	-30*	30	-30	10.50*	200	150	-1	-20	30	110	10	-1.5	-9	10	10		22		10	I <sub>DSS</sub>								
2SK521																															
2SK522																															
2SK523																															
2SK524																															
2SK525	東芝	DC-DCコンバータ	MOS		150*		10A*	40W							(V <sub>th</sub> ) 1.5   3.5			1mA		(S) 4		10	5A								

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>i</sub> (pF)				C <sub>r</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>s</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
																		2SK501	
																		2SK502	
																		2SK503	
																		2SK504	
4.8		10*	5	1.6		10mA	5										53B	2SK505	
																		2SK506	
4.8		10*	5	1.6		10mA	5										104B	2SK507	
4.8		10*	5	1.6		10mA	5										78A	2SK508	
																		2SK509	
																		2SK510	
20		0	10	2.5		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =5Vmax (I <sub>D</sub> =100mA, V <sub>GS</sub> =9V)									136	2SK511	
1,800		0	10	50		0*	10	V <sub>DS(ON)</sub> =3.9Vmax (I <sub>D</sub> =6A, V <sub>GS</sub> =15V)									28B	2SK512	
470		0	10	22		0*	10	R <sub>DS(ON)</sub> =6Ω max (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =15V)									116B	2SK513	
																		2SK514	
																		2SK515	
																		2SK516	
																		2SK517	
6		10*	10	2		10mA	10										53A	2SK518	
6		10*	10	2		10mA	10										104B	2SK519	
6		10*	10	2		10mA	10										78A	2SK520	
																		2SK521	
																		2SK522	
																		2SK523	
																		2SK524	
								R <sub>DS(ON)</sub> =0.28Ω max (I <sub>D</sub> =5A, V <sub>GS</sub> =10V)										2SK525	









電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>is</sub> (pF)				C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>s</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
																		2SK551	
																		2SK552	
																		2SK553	
																		2SK554	
																		2SK555	
																		2SK556	
																		2SK557	
																		2SK558	
																		2SK559	
																		2SK560	
																		2SK561	
																		2SK562	
																		2SK563	
																		2SK564	
																		2SK565	
																		2SK566	
																		2SK567	
																		2SK568	
																		2SK569	
																		2SK570	
																		2SK571	
																		2SK572	
																		2SK573	
																		2SK574	
																		2SK575	

R<sub>DS(ON)</sub>=0.18Ω max (I<sub>D</sub>=10A, V<sub>GS</sub>=10V)

R<sub>DS(ON)</sub>=0.3Ω max (I<sub>D</sub>=10A, V<sub>GS</sub>=10V)

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)									電気的特性 (Ta=25°C)													
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> V <sub>GDX</sub> (V)	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> (V)	V <sub>CSO</sub> V <sub>GSS</sub> V <sub>Gsx</sub> (V)	I <sub>G</sub> I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> (mW)	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>GSS</sub> (nA)		I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>CS(off)</sub> , V <sub>th</sub> (V)				g <sub>m</sub> (mS) μ <sup>*</sup>			g <sub>os</sub> (mS)				
										(pA)	V <sub>GS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>th</sub> (Ω)	typ	max
2SK109A	三菱	低周波, 低雑音	J	-50*		-50	10, 20*	150 unit	125	-1	-30	1	12	10		-3	10	10	6	15		10	I <sub>DSS</sub>			
2SK127A	松下	低周波	"	-80			10, 20*	250	125			0.5	12	10					3			10	"			
2SK130A	日電	低周波, 低雑音	"	-30*	30	-30	10, 50*	250	125	-1	-20	5	30	5		-1.5	5	10	28			5	"			
★ 2SK134Ⓟ	日立	高速度電力SW	MOS		140	±15*	7A	100W*	150*							0.15	1.45	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
★ 2SK135Ⓟ	"	"	"		160	±14*	7A*	100W*	150*							0.15	1.45	10	100mA	0.7	(S) 1	1.4	10	3A		
2SK160A	日電	低周波, VHF	J	-50*		-50	10, 20*	150	125	-1	-30	0.5	12	5	-0.25	-4.5	5	10	1.5	2.1		5	0.5			
2SK176Ⓟ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		200*	±20	8A*	125W	150				3	160	0.55*	3*	10	100mA	0.7	(S)	1.4	10	3A			
★ 2SK192A	東芝	FM, VHF	J	-18*			10	200	125	-10	-1	3	24	10	-1.2		10	1		7		10	I <sub>DSS</sub>			
2SK214Ⓟ	日立	高周波電力増幅 高速度電力SW	MOS		160	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK216Ⓟ	"	"	"		216	±15*	500*	30W*	150*							0.2*	1.5*	10	10mA	20	40		20	10		
2SK293A	日電	高耐压高速度 大電流SW	"		300*	±20*	7A*	100W	150*	±100	±20		1	300	0.4	3	10	50mA	0.6	(S) 1		10	3A			
FLC08ME	富士通	Cバンド高出力	GaAs		15	-5		3W	175*				450	5	-2		3	10mA		100		5	160			
FLC15ME	"	"	"		15	-5		6W	175*				900	5	-2		3	20mA		200		5	300			
FLC30ME	"	"	"		15	-5		11.5W	175*				1.8A	5	-2		3	40mA		400		5	600			
FLC081WF	"	"	"		15	-5		3.3W	175*				550	5	-2		3	10mA		130		5	200			
FLC151WF	"	"	"		15	-5		6.5W	175*				1.1A	5	-2		3	20mA		250		5	400			
FLC301MG-4	"	"	"		15	-5		15W	175*				2.2A	5	-2		3	40mA		500		5	800			
FLC301MG-6	"	"	"		15	-5		15W	175*				2.2A	5	-2		3	40mA		500		5	800			
FLC301MG-8	"	"	"		15	-5		15W	175*				2.2A	5	-2		3	40mA		500		5	800			
FLM3742-3	"	"	"		15	-5		18.8W	175*				2.4A	5	-2		3	50mA		500		5	800			
FLM3742-5	"	"	"		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A			
FLM4450-3	"	"	"		15	-5		18.8W	175*				2.4A	5	-2		3	50mA		500		5	800			
FLM4450-5	"	"	"		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A			
FLM5964-3	"	"	"		15	-5		18.8W	175*				2.4A	5	-2		3	50mA		500		5	800			
FLM5964-5	"	"	"		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A			

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)											そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名					
C <sub>iss</sub> (pF)				C <sub>oss</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>g</sub> =1MΩ) (dB)							NF (f=100MHz) (dB)				
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)					I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
20		0	10					(f=100Hz, R <sub>g</sub> =1kΩ) 1   2.5   10   1				ΔV <sub>GS</sub> =30mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)				84	2SK109A		
								NV=80mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA, R <sub>g</sub> =100kΩ)								80	2SK127A		
55		5*	10	10		5mA	10	(R <sub>g</sub> =100Ω) 1.2   2   5   5				NF=3dB max (V <sub>DS</sub> =5V, I <sub>D</sub> =5mA) (f=100Hz, R <sub>g</sub> =100Ω)				53A	2SK130A		
600		-5	10	10		-5*	10	V <sub>DS(sat)}</sub> =12Vmax (I <sub>D</sub> =7A, V <sub>GD</sub> =0)				2SJ49Ⓢとコンプリメンタリ				28A	2SK134Ⓢ★		
600		-5	10	10		-5*	10	"				2SJ50Ⓢとコンプリメンタリ				28A	2SK135Ⓢ★		
4.1		0	10	0.9		0*	10									78A	2SK160A		
800		-5	10					t <sub>on</sub> =60ns typ, t <sub>off</sub> =200ns typ (I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =15V, R <sub>L</sub> =15Ω)								28A	2SK176Ⓢ		
				0.65		-10						2	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )		PG=20dBtyp (f=100MHz)	88	2SK192A★	
90		10*	10	2.2		10mA	10	V <sub>DS(sat)}</sub> =2Vmax (I <sub>D</sub> =10mA, V <sub>GD</sub> =0)								116A	2SK214Ⓢ		
90		10*	10	2.2		10mA	10	"								116A	2SK216Ⓢ		
950	1,500	-5	10	10		-5*	10	V <sub>DS(ON)}</sub> =5.2Vmax, R <sub>DS(ON)}</sub> =1.3Ωmax (V <sub>GS</sub> =15V, I <sub>D</sub> =4A)								108	2SK293A		
								P <sub>out</sub> =28dBm typ, G <sub>p</sub> =9dB typ (V <sub>DS</sub> =8.5V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4GHz, P <sub>in</sub> =19dBm)								145	FLC08ME		
								P <sub>out</sub> =31dBm typ, G <sub>p</sub> =7.5dB typ (V <sub>DS</sub> =8.5V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4GHz, P <sub>in</sub> =23.5dBm)								145	FLC15ME		
								P <sub>out</sub> =34dBm typ, G <sub>p</sub> =6.5dB typ (V <sub>DS</sub> =8.5V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4GHz, P <sub>in</sub> =27.5dBm)								145	FLC30ME		
								P <sub>out</sub> =28.5dBm typ, G <sub>p</sub> =6.5dB typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=8GHz, P <sub>in</sub> =22dBm)								143	FLC081WF		
								P <sub>out</sub> =30.5dBm typ, G <sub>p</sub> =5.5dB typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=8GHz, P <sub>in</sub> =25dBm)								143	FLC151WF		
								P <sub>out</sub> =33dBm typ, G <sub>p</sub> =8dB typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4.2GHz, P <sub>in</sub> =25dBm)								144	FLC301MG-4		
								P <sub>out</sub> =33dBm typ, G <sub>p</sub> =7dB typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=7.2GHz, P <sub>in</sub> =26dBm)								144	FLC301MG-6		
								P <sub>out</sub> =33dBm typ, G <sub>p</sub> =6dB typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=8.5GHz, P <sub>in</sub> =27dBm)								144	FLC301MG-8		
								P <sub>out</sub> =35dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=3.7~4.2GHz, P <sub>in</sub> =28.5dBm)								146	FLM3742-3		
								P <sub>out</sub> =37dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=3.7~4.2GHz, P <sub>in</sub> =28.5dBm)								146	FLM3742-5		
								P <sub>out</sub> =35dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4.4~5.0GHz, P <sub>in</sub> =29dBm)								146	FLM4450-3		
								P <sub>out</sub> =37dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=4.4~5.0GHz, P <sub>in</sub> =29dBm)								146	FLM4450-5		
								P <sub>out</sub> =35dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=5.9~6.4GHz, P <sub>in</sub> =30dBm)								146	FLM5964-3		
								P <sub>out</sub> =37dBm typ (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>DS</sub> ≒I <sub>DSS</sub> /2, f=5.9~6.4GHz, P <sub>in</sub> =31dBm)								146	FLM5964-5		



型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSX</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSSO</sub> V <sub>GSSX</sub> **	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>a</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>GSS</sub> (nA)	max V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)			
				V <sub>GDX</sub> *	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*		min	max	V <sub>DS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>D</sub> * (Ω)	typ
FLM6472-5	富士通	Cバンド, 高出力	GaAs		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
FLM7177-5	"	"	"		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
FLM7785-4	"	"	"		15	-5		26.3W	175*				4.4A	5	-2		3	80mA		(S) 1		5	1.6A		
★ FLS02W	"	Sバンド, 高出力	GaAs SB		12	-5		1.5W	175*				250	5	-2		3	1mA	22	50		5	50		
FLS09	"	"	"		15	-5		3W	175*				450	5	-2		3	10mA	45	90		5	160		
FLS09ME	"	"	GaAs		15	-5		3W	175*				450	5	-2		3	10mA		90		5	160		
FLS16	"	"	"		15	-5		6W	175*				900	5	-2		3	20mA		180		5	300		
FLS16ME	"	"	"		15	-5		6W	175*				900	5	-2		3	20mA		180		5	300		
FLS31	"	"	"		15	-5		11.5W	175*				1.8A	5	-2		3	40mA		350		5	600		
FLS31ME	"	"	"		15	-5		11.5W	175*				1.8A	5	-2		3	40mA		350		5	600		
FLS50	"	"	GaAs SB		15	-5		15W	175*				2400	5	-2		3	50mA	250	500		5	800		
FLS50ME	"	"	GaAs		15	-5		15W	175*				2.4A	5	-2		3	50mA		500		5	800		
FLX03MB	"	Xバンド 高出力, 発振	"		12	-5		2.5W	175*			typ 290	5							80		5	150		
FLX06MB	"	"	"		12	-5		5W	175*			typ 650	5							150		5	300		
FLX12MB	"	"	"		12	-5		8.8W	175*			typ 1500	5							300		5	700		
★ FLX30MB	"	"	"		12	-5		15W	175*			typ 2500	5							500		5	1200		
FSX51W/WF	"	Sバンド, 低雑音	"		5	-5		1W	175*			30	120	3	-1	-5	3	1mA	10	25		3	30		
FSX52W/WF	"	Cバンド, 低雑音	"		12	-5		1.5W	175*			100	220	3	-2		3	2mA		50		3	60		
FSX53W/WF	"	"	"		12	-5		3W	175*			200	450	3	-2		3	5mA		100		3	120		
M47F	松下	低周波, 低雑音	J	-30	30	-30	30*	250	125	-1	-20	0.5	20	10	-0.1	-2	10	10	4	8		10	1		
MGF1202	三菱	L帯~C帯 低雑音増幅	GaAs	-6*	8	-6	100*	300	150*	-10μA	-3	30	100	3	-0.5	-5	3	100	25	35		3	30		
MGF1402	"	S帯~X帯 低雑音増幅	"	-6*	8	-6	100*	300	150*	-10μA	-3	30	100	3	-0.3	-5	3	100	25	35		3	30		
MGF1403	"	S帯~Ku帯 低雑音増幅	"	-6*	6	-6	80*	200	150*	-10μA	-3	20	80	3	-0.3	-5	3	100	20	30		3	30		
MGF1404	"	"	"	-6*	6	-6	80*	200	150*	-10μA	-3	15	80	3	-0.3	-5	3	100	20	30		3	15		
MGF1412	"	S帯~X帯 低雑音増幅	"	-6*	8	-6	100*	300	150*	-10μA	-3	30	100	3	-0.3	-5	3	100	25	35		3	30		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>is</sub> (pF)		C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>n</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)									
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>GS</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)						
																	146	FLM6472-5	
																		146	FLM7177-5
																		146	FLM7785-4
																		93	FLS02W ★
																		94	FLS09
																		145	FLS09ME
																		94	FLS16
																		145	FLS16ME
																		94	FLS31
																		145	FLS31ME
																		94	FLS50
																		145	FLS50ME
																		95	FLX03MB
																		95	FLX06MB
																		95	FLX12MB
																		95	FLX30MB ★
																		96	FSX51W/WF
																		130	FSX52W/WF
																		(WF)	FSX53W/WF
																		38	M47F
																		166	MGF1202
																		122	MGF1402
																		122	MGF1403
																		122	MGF1404
																		122	MGF1412

P<sub>out</sub>=37dBm typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=6.4~7.2GHz, P<sub>in</sub>=32dBm)

P<sub>out</sub>=37dBm typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=7.1~7.7GHz, P<sub>in</sub>=33dBm)

P<sub>out</sub>=36dBm typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=7.7~8.5GHz, P<sub>in</sub>=32dBm)

P<sub>out</sub>=22dBm min, G<sub>p</sub>=12dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1/2 I<sub>DSS</sub>, f=4GHz, P<sub>in</sub>=11dBm)

P<sub>out</sub>=28dBm typ, G<sub>p</sub>=9dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>≈1/2 I<sub>DSS</sub>, f=4GHz, P<sub>in</sub>=19dBm)

P<sub>out</sub>=28dBm typ, G<sub>p</sub>=9dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=19dBm)

P<sub>out</sub>=31dBm typ, G<sub>p</sub>=7.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=23.5dBm)

P<sub>out</sub>=31dBm typ, G<sub>p</sub>=7.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=23.5dBm)

P<sub>out</sub>=34dBm typ, G<sub>p</sub>=6.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=27.5dBm)

P<sub>out</sub>=34dBm typ, G<sub>p</sub>=6.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=27.5dBm)

P<sub>out</sub>=36dBm typ, G<sub>p</sub>=5.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>≈1/2 I<sub>DSS</sub>, f=4GHz, P<sub>in</sub>=30.5dBm)

P<sub>out</sub>=36dBm typ, G<sub>p</sub>=5.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>DS</sub>≈I<sub>DSS</sub>/2, f=4GHz, P<sub>in</sub>=30.5dBm)

P<sub>out</sub>=23dBm min, G<sub>p</sub>=8dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1/2 I<sub>DSS</sub>, f=12GHz, P<sub>in</sub>=16dBm)

P<sub>out</sub>=26dBm min, G<sub>p</sub>=7dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1/2 I<sub>DSS</sub>, f=12GHz, P<sub>in</sub>=20dBm)

P<sub>out</sub>=29.5dBm min, G<sub>p</sub>=5.5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1/2 I<sub>DSS</sub>, f=12GHz, P<sub>in</sub>=25dBm)

P<sub>out</sub>=34dBm min, G<sub>p</sub>=5dB typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1/2 I<sub>DSS</sub>, f=8GHz, P<sub>in</sub>=30dBm)

P<sub>out</sub>=18dBm typ, G<sub>p</sub>=10dB typ (V<sub>DS</sub>=8V, I<sub>D</sub>≈1/2 I<sub>DSS</sub>, f=8GHz, P<sub>in</sub>=8dBm)

P<sub>out</sub>=23dBm typ, G<sub>p</sub>=10dB typ (V<sub>DS</sub>=8V, I<sub>D</sub>≈1/2 I<sub>DSS</sub>, f=8GHz, P<sub>in</sub>=13dBm)

P<sub>out</sub>=25dBm typ, G<sub>p</sub>=8dB typ (V<sub>DS</sub>=8V, I<sub>D</sub>≈1/2 I<sub>DSS</sub>, f=8GHz, P<sub>in</sub>=17dBm)

e<sub>n</sub>=1.9nV/√Hz typ (V<sub>DS</sub>=10V, I<sub>D</sub>=1mA, f=1kHz)

(f=4GHz)  
1.4 | 1.8    3    10    G<sub>S</sub>=11dB typ (f=4GHz)

最大発振周波数 70GHz typ (f=4GHz)  
1.1 | 1.4    3    10    G<sub>S</sub>=13dB typ (f=4GHz)

" 90GHz typ (f=12GHz)  
1.8 | 2.3    3    10    G<sub>S</sub>=10.5dB typ (f=12GHz)

(f=12GHz)  
1.6 | 1.7    3    10    G<sub>S</sub>=10.5dB typ (f=12GHz)

最大発振周波数 70GHz typ (f=4GHz)  
0.8 | 1.0    3    10    G<sub>S</sub>=13dB typ (f=4GHz)

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)													
				V <sub>GDS</sub> V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSS</sub> V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSO</sub> V <sub>GSS</sub> *	I <sub>C</sub> I <sub>D</sub> *	P <sub>d</sub> P <sub>ch</sub> *	T <sub>j</sub> T <sub>ch</sub> *	I <sub>GSS</sub> (nA)	I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)				
				V <sub>GDX</sub> (V)	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*	min	max	V <sub>GS</sub> (V)	min	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (μA)	min	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	r <sub>p</sub> typ	(Ω) max
MGF1801	三菱	S帯~X帯 中電力増幅	GaAs	-8*	8	-8	250*	1W	150*	-20μA	-3	150	250	3	-1.5	-6	3	100	70	90	3	100		
MGF1802	"	C帯~X帯 中電力増幅	"		8	-8	250*	1.5W	150*			150	250	3	-2	-6	3	100	70	90	3	100		
MGF2116	"	S帯~X帯 中電力増幅	"		11	-10	550*	3W	150*			300	550	3	-2	-7	3	1mA		175	3	200		
MGF2117	"	C帯~X帯 中電力増幅	"		11	-10	550*	3W	150*			300	550	3	-2	-7	3	1mA		175	3	200		
MGF2124	"	C帯~Ku帯 電力増幅	"		11	-11	800*	4.2W	150*			450	800	3	-2	-7	3	1mA	180	250	3	300		
MGF2124F	"	~Ku帯 電力増幅	"		11	-11	800*	4W	150*			450	800	3	-2	-7	3	1mA	180	250	3	300		
MGF2124G	"	"	"		11	-11	800*	4W	150*			450	800	3	-2	-7	3	1mA	180	250	3	300		
MGF2148	"	C帯~Ku帯 電力増幅	"		11	-11	1.6A*	8.3W	150*			(A) 0.9   1.6		3	-2	-7	3	1mA	360	500	3	600		
MGF2148F	"	~Ku帯 電力増幅	"		11	-11	1.6A*	8W	150*			(A) 0.9   1.6		3	-2	-7	3	1mA	360	500	3	600		
MGF2148G	"	"	"		11	-11	1.6A*	8W	150*			(A) 0.9   1.6		3	-2	-7	3	1mA	360	500	3	600		
MGF2172	"	S帯~X帯 電力増幅	"		11	-11	2.3A*	12.5W	150*			(A) 1.5   2.3		3	-2	-7	3	1mA	540	750	3	900		
MGF2205	"	S帯~C帯 電力増幅	"		11	-11	3.6A*	12.5W	150*			(A) 2   3.6		3	-2	-7	3	10mA		800	3	1.4A		
MGF-X34M	"	10GHz 電力増幅	"		11	-11	2.3A*	12.5W	150*			(A) 1.5   2.3		3	-2	-7	3	1mA	540	750	3	900		
★ MK10	"	DC~VHF	J	-30*	20	-10	10, 20*	150	125	-100	-10	1	20	10		-8	10	10	1.9	4	10	I <sub>DSS</sub>	0.05	
★ μPA50A	日電	低周波	"	-60*	60	±60	10, 20*	200 unit	150	-10	-10	(Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> ) 1.5   18		10	-0.3	-2.4	10	10	2	4	8	10	1	
μPA60A	"	差動増幅	"	-40*	40	-40	50	250 unit	175	-0.1	-20	0.5	5	10	-0.2	-2.5	10	10	1	2		10	0.5	0.015
μPA61A	"	"	"	-40*	40	-40	50	250 unit	175	-0.1	-20	0.5	5	10	-0.2	-2.5	10	10	1	2		10	0.5	0.015
μPA62C	"	差動増幅 バランスMIX	"	-20*		-10	10, 32*	350	125	-50	-8	8	32	10	-0.35	-2.2	10	10	12.5	15		10	3	
μPA63H	"	低周波	"	-60*	60	-60	10, 30*	250 unit	125	-1	-20	1.5	20	10	-0.3	-4.2	10	10	2	4	8	10	1	
μPA68H	"	低周波, 低雑音	"	-50*	50	-50	10, 30*	250 unit	125	-1	-20	1	18	10	-0.15	-2.5	10	10	5	7		10	1	
μPA70A	"	DC	"	-40*	40	-40	50	250	175	-0.1	-20	0.5	5	10	-0.2	-2.5	10	10	1	2		10	0.5	4
μPA71A	"	"	"	-40*	40	-40	50	250	175	-0.1	-20	0.5	5	10	-0.2	-2.5	10	10	1	2		10	0.5	4
2SK437Ⓞ	松下	SHFチューナ 低雑音増幅		-6*	5	-6	120*	270	125*	-10μA	-3	20	120	3		-3.5	3	100	20	50	100	3	10	
2SK354A	日電	VHF~Cバンド 低雑音増幅	GaAs	-6*	5	-6	150*	300	125*	-10μA	-5	30	100	3	-0.8	-6	3	100	20	40	100	3	10	

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)														そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>11</sub> (pF)				C <sub>12</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>n</sub> =1MΩ) (dB)				NF (f=100MHz) (dB)							
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	typ	max					V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)
				最大発振周波数 45GHz typ												Gp=9dB typ (f=8GHz)	167	MGF1801	
																Gp=7dB typ (f=12GHz)	170	MGF1802	
				最大発振周波数 40GHz typ												Gp=7dB typ (f=12GHz)	169	MGF2116	
																Gp=7dB typ (f=12GHz)	170	MGF2117	
				最大発振周波数 35GHz typ												Gp=6dB typ (f=12GHz)	124	MGF2124	
																Gp=5.5dB typ (f=14GHz)	171	MGF2124F	
																Gp=5.5dB typ (f=14GHz)	172	MGF2124G	
				最大発振周波数 30GHz typ												Gp=5dB typ (f=12GHz)	124	MGF2148	
																Gp=4.7dB typ (f=14GHz)	171	MGF2148F	
																Gp=4.7dB typ (f=14GHz)	172	MGF2148G	
				最大発振周波数 25GHz typ												Gp=5.5dB typ (f=8GHz)	124	MGF2172	
																Gp=6.5dB typ (f=6GHz)	173	MGF2205	
																Gp=6dB typ (f=9.6~10.2GHz)	174	MGF-X34M	
				1.3				2		10	0.5	3.0		10	5	PG=20dB typ (f=100MHz)	9	MK10	
(Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> ) 5 7		1*	10	(Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> ) 1.3 2	1mA	10	(f=10Hz) 60nV 30 / √Hz	10	1	ΔI <sub>DSS</sub> =10%max (V <sub>DS</sub> =10V)						44	μPA50A		
2.5	5	0	10	0.5	1.5	0*	10					ΔV <sub>GS</sub> =5mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =0.2mA)				111	μPA60A		
2.5	5	0	10	0.5	1.5	0*	10					ΔV <sub>GS</sub> =40mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =0.2mA)				111	μPA61A		
7.5		3*	10	2.5		3mA	10					(f=400MHz) 2	10	3	PG=12dB typ (f=400MHz)	76	μPA62C		
6	8	1*	10	1.6	2.5	1mA	10	(f=10Hz, nV/√Hz) 10 30 10	1	ΔV <sub>GS</sub> =60mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)						66	μPA63H		
15		0	10	3		0*		NV=35mVmax (V <sub>DD</sub> =15V, R <sub>n</sub> =1kΩ), ΔV <sub>GS</sub> =20mVmax (V <sub>GS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA)						66	μPA68H				
	5	0	10	1.5	0*	10						ΔV <sub>GS</sub> =5mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =200μA)				e <sub>n</sub> =10nV/√Hz max (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =200μA, f=1kHz)	77	μPA70A	
	5	0	10	1.5	0*	10						ΔV <sub>GS</sub> =40mVmax (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =200μA)				e <sub>n</sub> =20nV/√Hz max (V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =200μA, f=10Hz)	77	μPA71A	
												(f=12GHz) 1.6 1.8 3 10	雑音最小電力利得 10.5dB typ (f=12GHz)				103	2SK437Ⓞ	
				NF=2dB typ (f=8GHz)										MAG=10dB typ (f=8GHz), 7.5dB typ (f=12GHz)		9	2SK354A		

★ ★

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)							電気的特性 (Ta=25°C)														
				V <sub>GDS</sub>	V <sub>DSS</sub>	V <sub>GSO</sub>	I <sub>C</sub>	P <sub>d</sub>	T <sub>j</sub>	I <sub>CSS</sub>	I <sub>DSS</sub> (mA)			V <sub>GS(off)</sub> , V <sub>th</sub> *(V)				g <sub>m</sub> (mS) μ*			g <sub>os</sub> (mS)				
				V <sub>GDO</sub> *	V <sub>DSS</sub> *	V <sub>GSS</sub> *	I <sub>D</sub> *	P <sub>ch</sub> *	T <sub>ch</sub> *	(nA)	min	max	V <sub>Ds</sub>	min	max	V <sub>Ds</sub>	I <sub>D</sub>	min	typ	max	V <sub>Ds</sub>	I <sub>D</sub>	r <sub>11</sub> *		
				V <sub>GDX</sub> **	(V)	(V)	(mA)	(mW)	(°C)	(pA)*	(V)	(V)	(V)	(μA)	(V)	(μA)	(V)	(mA)	(V)	(mA)	(Ω)	typ	max		
★ 3SJ11	日電	スイッチング	MOS		-30*	-30*	-10*	100	100*	-100	-10		-0.1μA	-10	-3.0	-6.5	-10	-10		0.8		-10	-10V (V <sub>GS</sub> )		
3SJ11A	"	DC スイッチング	"		-30*	±40*	-50*	225*	75*	-10*	-10		-10μA	-10	-1.5	-3.5	-10	-10	0.5	1		-10	-1	0.07	
★ 3SK11Ⓞ	日立	小信号増幅	"																						
★ 3SK12Ⓞ	"	チョッパ	"																						
★ 3SK13Ⓞ	"	DC	"																						
3SK14	日電	DC, チョッパ	"		20	±30*	10*	100	100*	2*	10		3	10		-5	10	10	0.5	0.8		10	-1	0.01	
★ 3SK15	三菱	DC	"		25	+2 -10	10*	100	100*	-10*	-10		10	6		-9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★ 3SK15A	"	"	"		25	+2 -10	10*	100	100*	-10*	-10		10	6		-9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★ 3SK16	"	チョッパ スイッチング	"		25	+2 -10	10*	100	100*	-10*	-10		10	6		-9	6	1	0.5	1.0		6	1	0.04	
★ 3SK17	"	低周波	"		25	+2 -10	10*	100	100*	-1	-10		10	6		-9	6	10	0.5	1.0		6	1	0.04	
★ 3SK18	"	チョッパ スイッチング	"		15	±10*	10*	100	100*	-10*	-10		5	6		-6	6	10	0.5	1.0		6	1	0.3	
★ 3SK19	"	VHF	"		15	±10*	10*	100	100*	-10*	-10		5	6		-6	6	10	0.5	1.0		0	1	0.05 0.1	
3SK20Ⓞ	日立	DC, 低周波	"		20	+5** -20	10*	100*	150*	-1*	-6	0.4	5.0	6		-3.5	6	10	0.4			6	I <sub>DSS</sub>	0.18	
3SK21Ⓞ	"	チョッパ	"		20	+5** -20	10*	100*	150*	-1*	-6	3	16	6		-6	6	10	2.5			6	"		
3SK22	東芝	FM, VHF	J	-18*			10	200	150	-100	-10	3	24	10	-1.2		10	1		7.0		10	"		
★ 3SK23	"	ビジコンカメラ ヘッドアンプ	"	-15*			10	200	150	-100	-10	6	24	10	-1.8		-5.5	1	6		12	10			
★ 3SK24	松下		MOS																						
★ 3SK25	"		"																						
3SK28	東芝	ビデオ, VHF	J	-18			10	200	150	-10	-15	3.7	22	10	-1.2	-5.5	10	1	4.5		13.0	10	I <sub>DSS</sub>		
3SK29	日電	低周波	MOS		20	±30*	10*	80	100*	10*	10		1 (typ)	10		-5	10	10	0.5	0.8		10	1	0.01	
★ 3SK30	日立	FM/AM RF, MIX	J			-15*	10	200*	150*	-100	-10	3	20	10		-5	10	20	4	7.5		10	I <sub>DSS</sub>		
★ 3SK30A	"	"	"			-18*	10	200*	150*	-100	-10	3	20	10		-6	10	20	4	7.5		10	"		
★ 3SK33	日電	FM, VHF	MOS		25	±30*	20*	250	150*	-1	-10	4	15	10		-4	10	50	4	6		10	5		
★ 3SK38	東芝	チョッパ	"	10	20*	10*	10*	200	125	200	10		50nA	6	0*	3*	6	50nA	0.35			6	3 (V <sub>GS</sub> )		
3SK38A	"	"	"	±12	20*	±12*	10*	200	125	±25	±12		50nA	6	0*	3*	6	50nA	0.35			6	3 (V <sub>GS</sub> )		

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)											そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名								
C <sub>is</sub> (pF)			C <sub>rs</sub> (pF)				NF (f=1kHz, R <sub>s</sub> =1MΩ) (dB)			NF (f=100MHz) (dB)												
typ	max	V <sub>GS</sub> (V) I <sub>D</sub> (mA)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>GD</sub> (V) V <sub>GS</sub> (V)*	V <sub>DS</sub> (V)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)						I <sub>D</sub> (mA)	typ	max	V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)		
5		-10						R <sub>ON</sub> =1kΩ max (V <sub>DS</sub> =-1V, V <sub>GS</sub> =-10V)			t <sub>pb(ON)</sub> =0.4μs typ t <sub>pb(OFF)</sub> =0.4μs typ				3SJ11A	23	3SJ11	★				
8		0	-10					R <sub>ON</sub> =500Ω max (V <sub>DS</sub> =-1V, V <sub>GS</sub> =-10V)									23	3SJ11A				
																		3SK20Ⓢ	26	3SK11Ⓢ	★	
																		3SK21Ⓢ	26	3SK12Ⓢ	★	
																		3SK20Ⓢ	26	3SK13Ⓢ	★	
3		0	10					5		10	1								23	3SK14		
4		0	0																24	3SK15	★	
4		0	0																24	3SK15A	★	
4		0	0					R <sub>ON</sub> =1kΩ max (V <sub>DS</sub> =0.1V, V <sub>GS</sub> =0), R <sub>OFF</sub> =10MΩ min (V <sub>DS</sub> =0.1V, V <sub>GS</sub> =-6V)										24	3SK16	★		
4		0	0																24	3SK17	★	
0.3		1*	6	0.1		1mA	6	R <sub>ON</sub> =1.2kΩ max (V <sub>DS</sub> =0.1V, V <sub>G1S</sub> =V <sub>G2S</sub> =0)			t <sub>ON</sub> =20ns max t <sub>OFF</sub> =25ns max							25	3SK18	★		
0.3		1*	6	0.1		1mA	6					(200MHz) 4	6	1	PG=20dB typ (f=200MHz)				25	3SK19	★	
5		0	6																26	3SK20Ⓢ		
5		0	6					R <sub>ON</sub> =300Ω max (V <sub>DS</sub> =0.1V, V <sub>G1S</sub> =V <sub>G2S</sub> =0), R <sub>OFF</sub> =100MΩ min (V <sub>DS</sub> =0.1V, V <sub>G1S</sub> =-6V, V <sub>G2S</sub> =0)										26	3SK21Ⓢ			
					0.6	-10						2	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )	PG=20dB typ (f=100MHz)				27	3SK22		
	3	0	0	0.4		-10														27	3SK23	★
																				39	3SK24	★
																				39	3SK25	★
	6	0	10		0.6	-10		2.5	10	I <sub>DSS</sub>		2.5	10 (V <sub>DD</sub> )	PG=17dB min (f=100MHz)				27	3SK28			
3		0	10																	23	3SK29	
5		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )	PG=17dB typ (f=100MHz)			2SK54	29	3SK30	★	
5		0	10	0.4	0.6	0*	10					2.0	3.5	10 (V <sub>DD</sub> )	PG=17dB typ (f=100MHz)			2SK55	29	3SK30A	★	
3		5*	10		0.3	5mA	10					3	10	5	PG=15dB min (f=100MHz)				30	3SK33	★	
	4.5	0	0		4.5	0	0	R <sub>ON</sub> =500Ω max (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>GS</sub> =3V), R <sub>OFF</sub> =100MΩ min (V <sub>DS</sub> =±10nV, V <sub>GS</sub> =0)											31	3SK38	★	
	2.5	0	0		2.5	0*	0	ΔC <sub>C</sub> =0.3pF max, R <sub>DS(ON)</sub> =500Ω max (V <sub>DS</sub> =10mV, V <sub>G1S</sub> =3V, V <sub>G2S</sub> =0)											31	3SK38A		













電 気 的 特 性 (Ta=25°C)												そ の 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名		
C <sub>iss</sub> (pF)		I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	C <sub>rss</sub> (pF)		I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	NF (dB) (200MHz)		V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)						
typ	max			V <sub>G1S</sub> * (V)	V <sub>G2S</sub> (V)			typ	max							typ	max
																	3SK76
4.25		10	15 4	0.03	0.05	10	15 4		2.2	3.2	V <sub>DD</sub> =15V		PG=20dB typ (f=200MHz)			92	3SK77
					0.03	10	15 4		(f=800MHz) 4.5	5.5	15 4	10	PG=16dB typ (f=800MHz)	3SK102, 115	93	3SK78	★
									(f=800MHz) 5		15 10	10	PG=10dB min (f=800MHz)			91	3SK79
	5	7	15 4	0.02		7	15 4		(f=900MHz) 6		15 4	7	PG=10dB min (f=900MHz)			115	3SK80
5		10	15 4	0.03		10	15 4			3.3	15 4	10	PG=17dB min (f=200MHz)			115	3SK81
	5	10	6 3	0.02		10	6 3		(f=900MHz) 5.5		6 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)			115	3SK82
	5	10	6 3	0.02		10	6 3			3	6 3	10	PG=20dB min (f=200MHz)			115	3SK83
																	3SK84
3.3		10	15 4	0.03		10	15 4			3.2	15 4	10	PG=18dB typ (f=200MHz)			115	3SK85
																	3SK86
2.5	3.5	10	10 4	0.02	0.03	10	10 4		(f=900MHz) 3.8	5.5	10 4	10	PG=18dB typ (f=900MHz)			114	3SK87
2.0	2.5	10	10 4	0.02	0.03	10	10 4		(f=900MHz) 3.8	5.5	10 4	10	PG=16dB typ (f=900MHz)			114	3SK88
																	3SK89
																	3SK90
																	3SK91
																	3SK92
																	3SK93
																	3SK94
2.6		10	6 3	0.02		10	6 3		(f=900MHz) 5.5		6 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)			115	3SK95
4.5		10	6 3	0.03		10	6 3			3	6 3	10	PG=22dB min (f=200MHz)			115	3SK96
1.2	2	-6*	5 -6	0.02	0.04	-6*	5 -6		(f=1GHz) 1.7	2.8	5 2	10	PG=16dB typ (f=1GHz)			91B	3SK97
																	3SK98
																	3SK99
1.6	2.5	-5*	10 -5	0.02		-5*	10 -5		(f=800MHz) 2.6	4	10 4	10	PG=14.5dB typ (f=800MHz)			91B	3SK100







型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (Ta=25°C)							電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)																			
				Vc <sub>DS</sub> (V)	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>cSO</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	P <sub>d</sub> (mW)	T <sub>ch</sub> (°C)	I <sub>G1SS</sub> I <sub>G2SS</sub> (nA)	max V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>DSS</sub> (mA)		V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>P1</sub> (V)	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>P2</sub> (V)	V <sub>DS</sub> (V)	g <sub>m</sub> (mS)			V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)	g <sub>os</sub> (mS)						
												min	max						max	max	max			min	typ	max	V <sub>GS</sub> (V)	V <sub>GS</sub> <sup>*</sup> (V)	typ	max
3SK126	東 芝	TV, FMチューナ VHF, RF, MIX	MOS		15	±9	30	150	125	±50	±7	0	6	6	-1	6	-0.5	6	13	20		6	10							
3SK127	"	UHF, TVチューナ RF, MIX	"		15	±8	30	150	125	±50	±6	0	6	6	-1.5	6	-1	6		17		6	10							
3SK128																														
3SK129	松 下	UHF, RF	GaAs		13	-3.5	50	350	125	±20	±3.5	8.5	40	5	-3.5	5	-3.5	5	18	25		5	10							
3SK130																														
3SK131	日 電	VHF, TVチューナ RF, MIX	MOS		20	±8	25	200	125	±20	±8	7	25	6	-2	8	-1.5	8	22	28		6	10							
3SK132	"	UHF チューナ RF	"		20	±10	25	200	125	±20	±10	0.5	8	10	-2	10	-0.7	10	18	22		10	10							
3SK133	"	UHF, TVチューナ RF	"		20	±10	25	200	125	±20	±10	0.01	6	10	-2	10	-0.7	10	14	17		10	10							
3SK134																														
3SK135																														
3SK136	日 立	VHF, TVチューナ RF	MOS		20	±8	35	150	125	±100	±8	5	25	15	-3	15	-2	15	8			15	10							
3SK137	"	UHF, TVチューナ RF	"		15	±10	35	150	125	±100	±8		20	6	-2	10	-2	10	14			6	10							
3SK138	"	UHF, TVチューナ RF	"		15	±10	35	150	125	±100	±8		10	6	-1	10	-1	10	10	15		6	10							
3SK139																														
3SK140	東 芝	TVチューナ UHFRF, MIX	GaAs		10	-6	50	150	125	-20μA	-5	20	45	5	-4	5	-4	5		17		5	10							
3SK141	松 下	UHF, RF	"		13	-3.5	50	200	125	±20	±3.5	8.5	40	5	-3.5	5	-3.5	5	18	25		5	10							
3SK144																														
3SK145	東 芝	TVチューナ UHFRF, MIX	MOS		13.5	±8	30	200	125	±50	±6	0	6	6	-1.5	6	-1	6		16		6	10							
3SK146	"	"	"		13.5	±8	30	150	125	±50	±6	0	6	6	-1.5	6	-1	6		16		6	10							
3SK147																														
3SK148																														
3SK149																														
3SK150	東 芝	TVチューナ UHFRF, MIX	MOS		15	±8	30	200	125	±50	±6	3	14	6	-1.5	6	-1	6	22	27		6	10							
3SK104V	日 立	VHF, TVチューナ RF	"		15	±10	35	200	125	±100	±8		20	6	-2	10	-2	10	14			6	10							
MGF1100	三 菱	UHF, SHF 低雑音増幅	GaAs		8	-6	60	150	150			15	60	3	-5	3	-5	3	10	15		3	15							

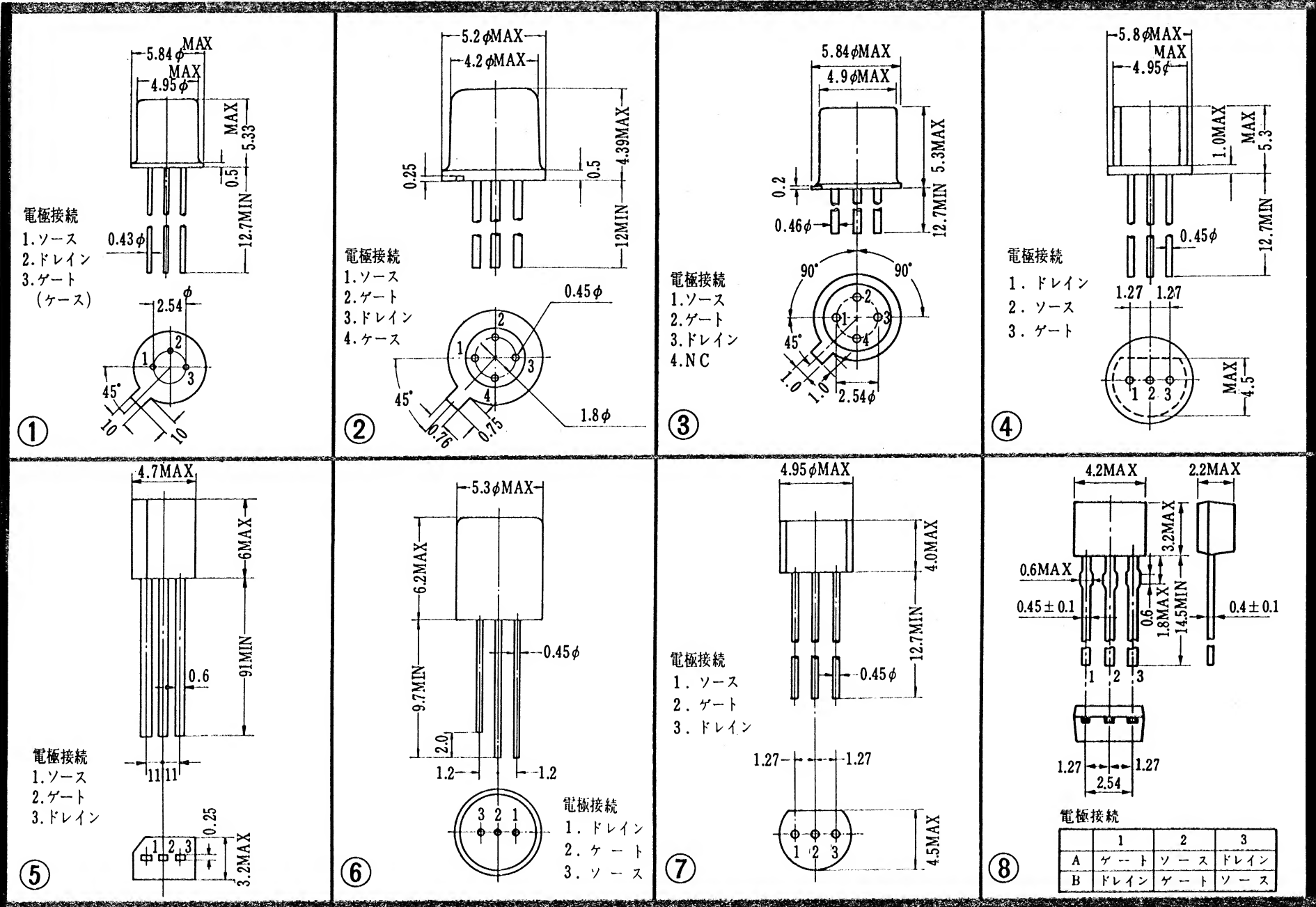
電 氣 的 特 性 (Ta=25°C)													其 他	代 替 品 型 名	外 形	型 名
C <sub>i</sub> (pF)		I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	C <sub>r</sub> (pF)		I <sub>D</sub> (mA)	V <sub>DS</sub> (V)	NF (dB) (200MHz)		V <sub>DS</sub> (V)	I <sub>D</sub> (mA)					
typ	max			typ	max			typ	max			typ				
4.25	5.5	10	6 3	0.03	0.05	10	6 3	1.4	2.8	6 3	10	PG=25dB typ (f=200MHz)	176	3SK126		
2		10	6 3		0.03	10	6 3	(f=800MHz) 3.2		6 3	10	PG=16dB typ (f=800MHz)	176	3SK127		
														3SK128		
0.6	1.5	-3.5*	5 -3.5	0.02	0.04	-3.5*	5 -3.5	(f=1GHz) 1.2	2	5 1.5	10	PG=17dB typ (f=1GHz)	91B	3SK129		
														3SK130		
5	6.5	10	6 3	0.05	0.08	10	6 3	1.3	2.5	10 5	10	PG=24dB typ (f=200MHz)	177	3SK131		
2.5	3.5	10	10 4	0.02	0.03	10	10 4	(f=900MHz) 3.8	5.5	10 4	10	PG=18dB typ (f=900MHz)	177	3SK132		
2	2.5	10	10 4	0.02	0.03	10	10 4	(f=900MHz) 3.8	5.5	10 4	10	PG=16dB typ (f=900MHz)	177	3SK133		
														3SK134		
														3SK135		
5		10	15 4	0.03		10	15 4		3.3	15 4	10	PG=17dB min (f=200MHz)	176	3SK136		
2.6		10	6 3	0.02		10	6 3	(f=900MHz) 5		6 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)	176	3SK137		
2		10	6 3	0.02		10	6 3	(f=900MHz) 5		6 3	10	PG=10dB min (f=900MHz)	176	3SK138		
														3SK139		
0.9	2	10	5 0	0.02	0.05	10	5 0	(f=800MHz) 1.5	2.5	5 1	10	PG=20.5dB typ (f=800MHz)	176	3SK140		
0.6	1.5	-3.5*	5 -3.5	0.02	0.04	-3.5*	5 -3.5	(f=1GHz) 1.2	2	5 1.5	10	PG=17dB typ (f=1GHz)	147B	3SK141		
														3SK144		
1.8		10	6 3	0.02	0.03	10	6 3	(f=800MHz) 2.6	4	6 3	10	PG=17.5dB typ (f=800MHz)	125	3SK145		
1.8		10	6 3	0.02	0.03	10	6 3	(f=800MHz) 2.6	4	6 3	10	PG=17.5dB typ (f=800MHz)	176	3SK146		
														3SK147		
														3SK148		
														3SK149		
2.7	3.6	10	6 3	0.025	0.04	10	6 3	変換雑音指数 NF <sub>CS</sub> =5.5dB max (200/245MHz)				変換利得 G <sub>CS</sub> =24.5dB typ(200/245MHz)		125	3SK150	
2.6		10	6 3	0.02		10	6 3		3	6 3	10	PG=20dB min (f=200MHz)	175A	3SK104V		
								(f=4GHz) 2.5	3.3	3 0	10	G <sub>S</sub> =9dB typ (f=4GHz)	168	MGF1100		



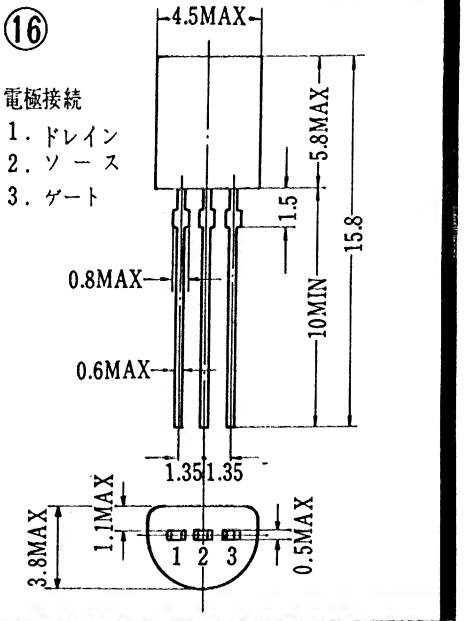
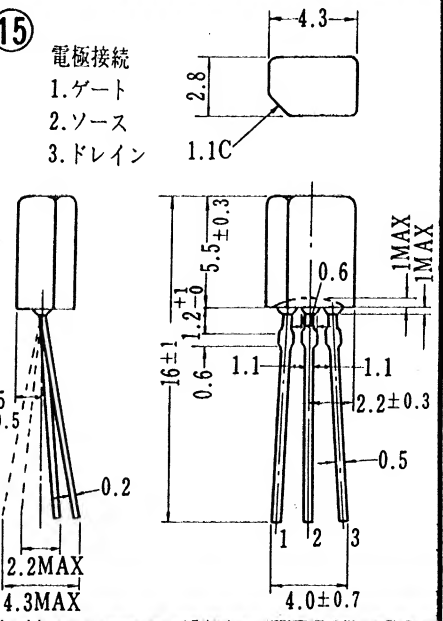
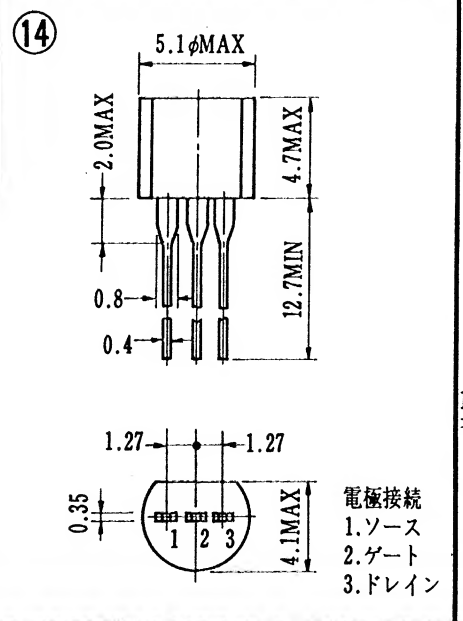
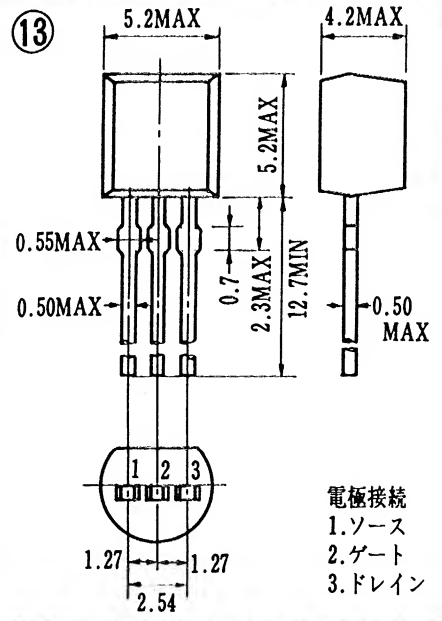
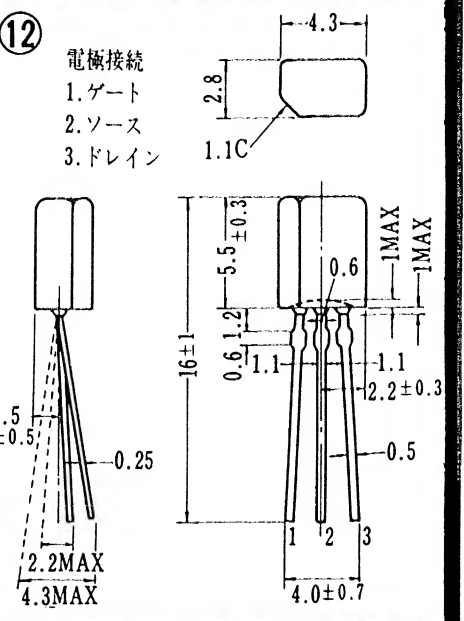
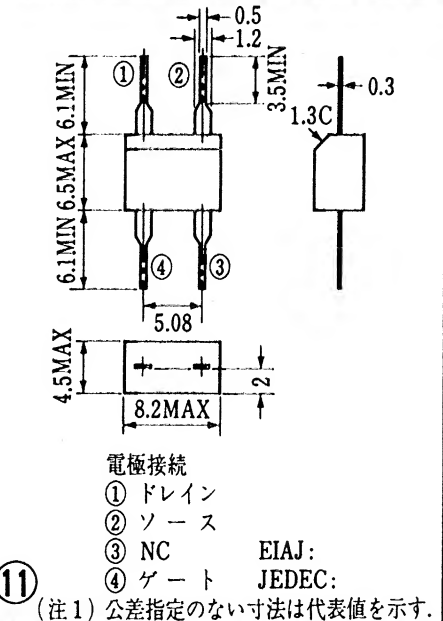
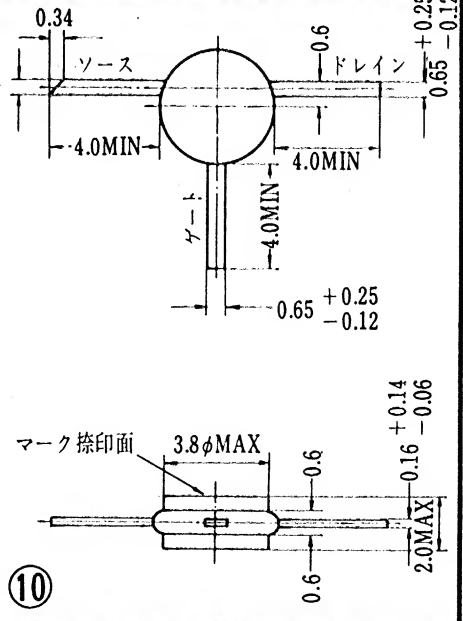
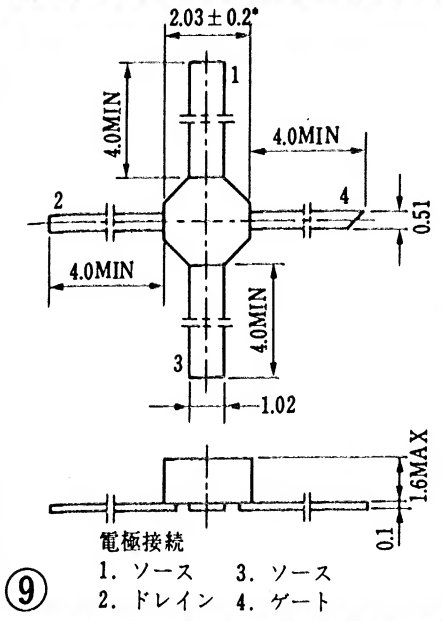


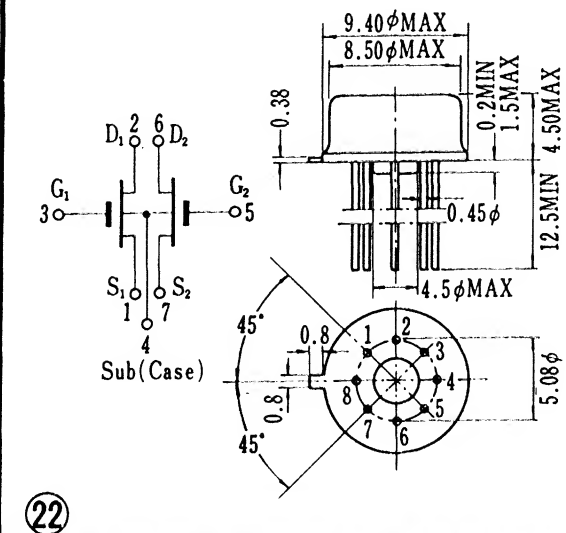
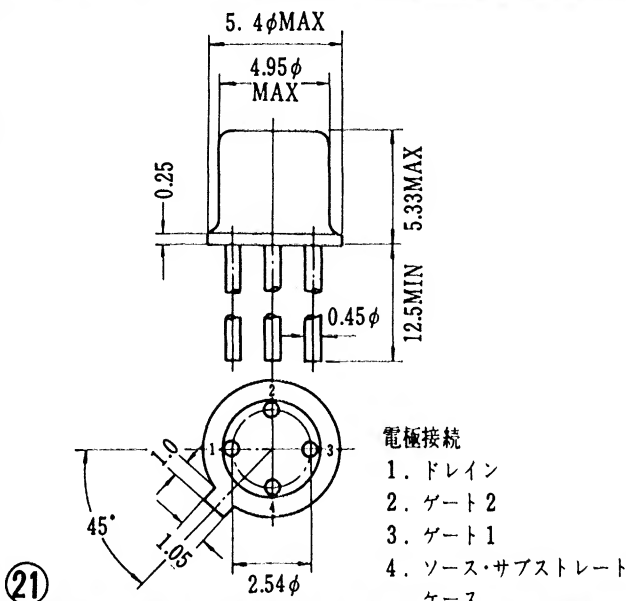
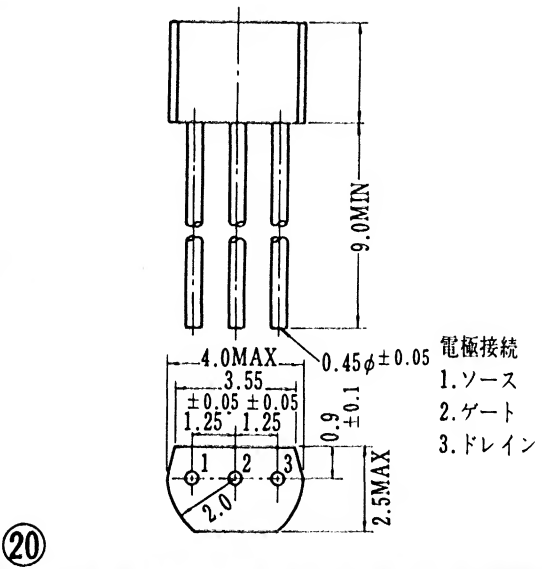
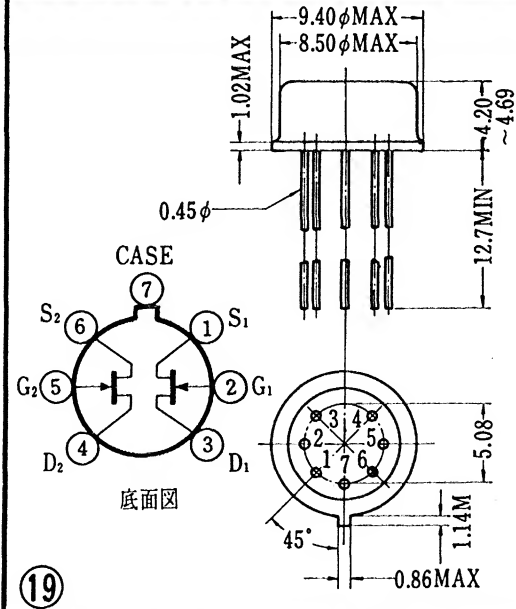
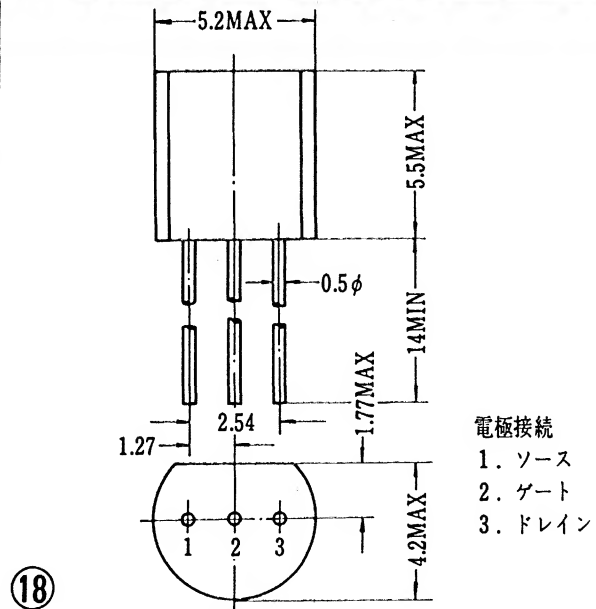
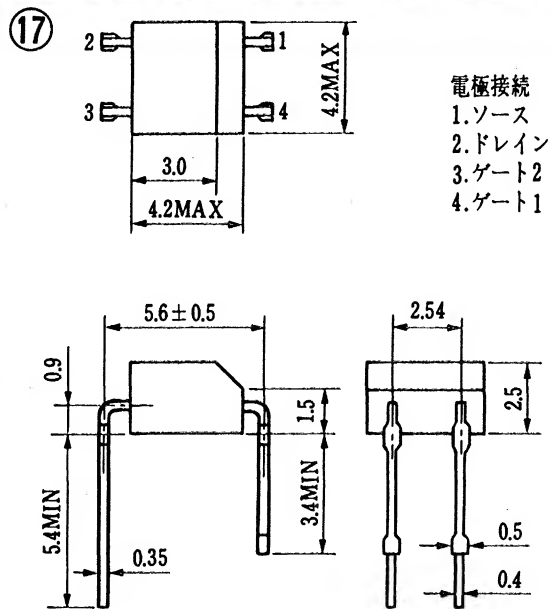


外形寸法図

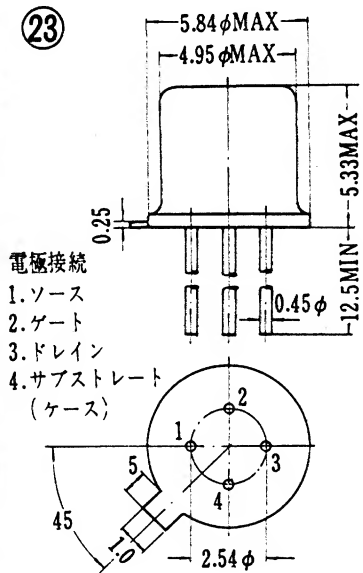


<寸法図単位：mm>

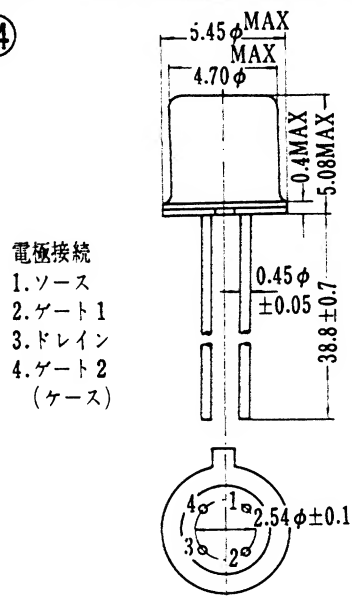




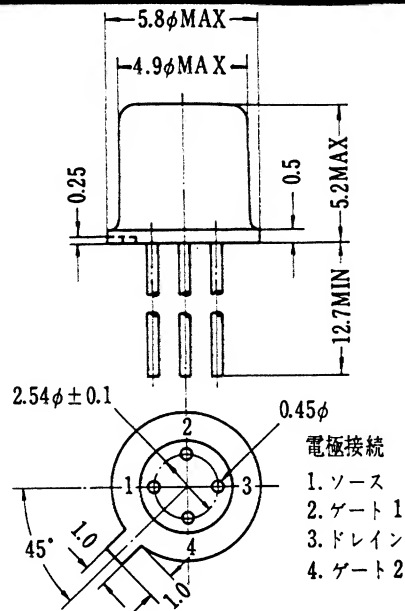
23



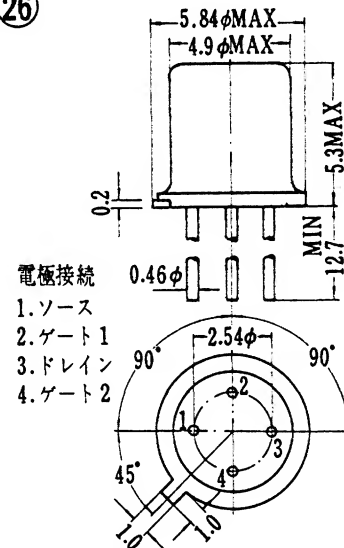
24



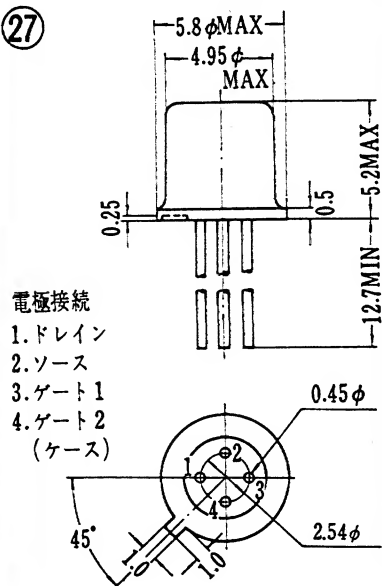
25



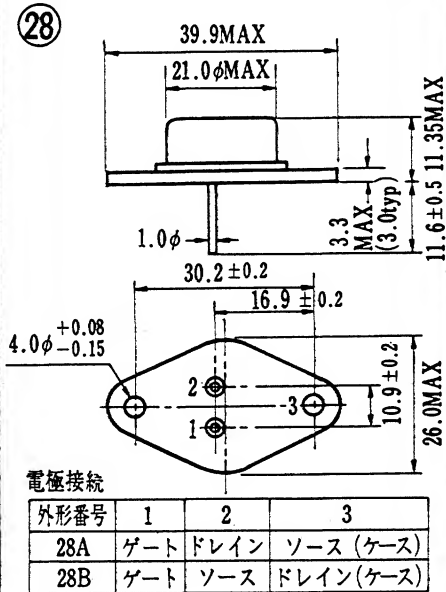
26



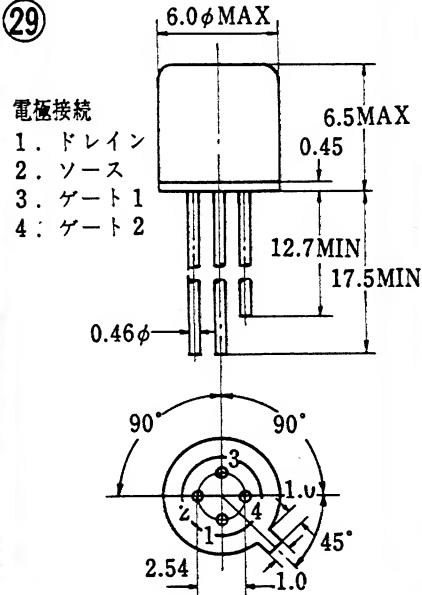
27



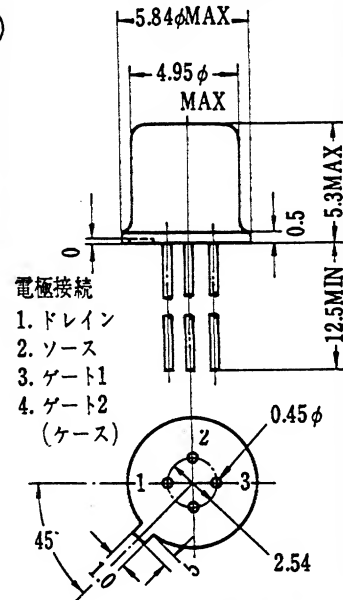
28

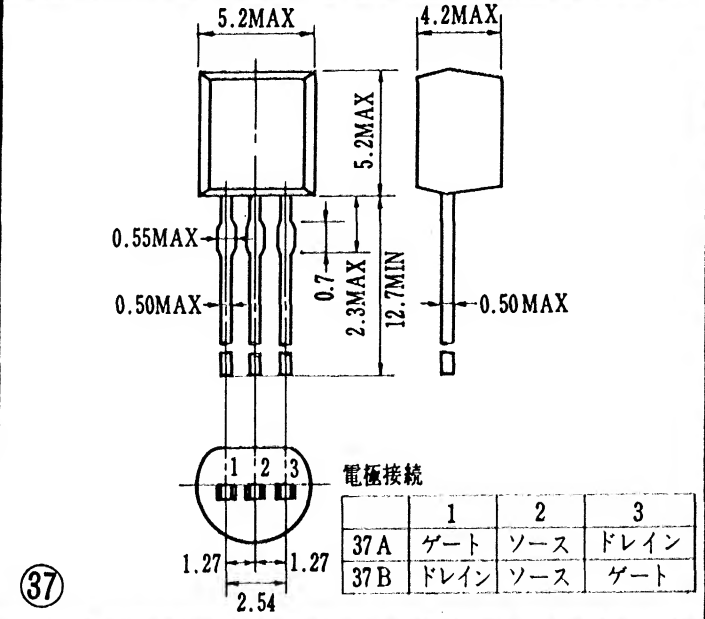
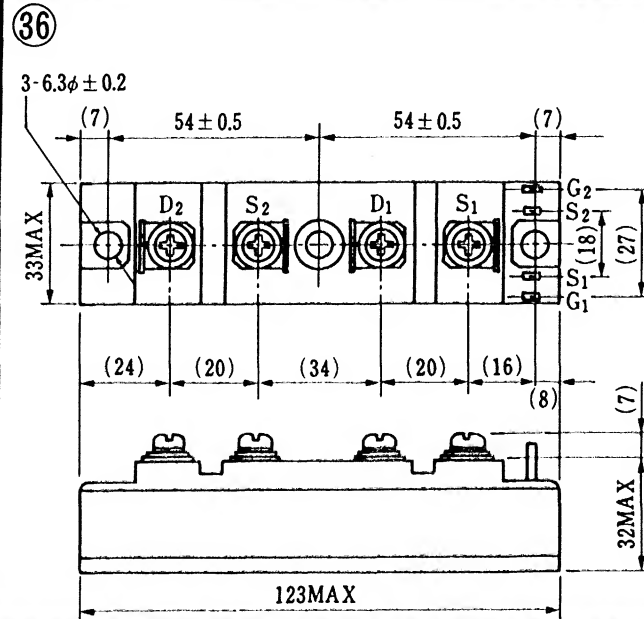
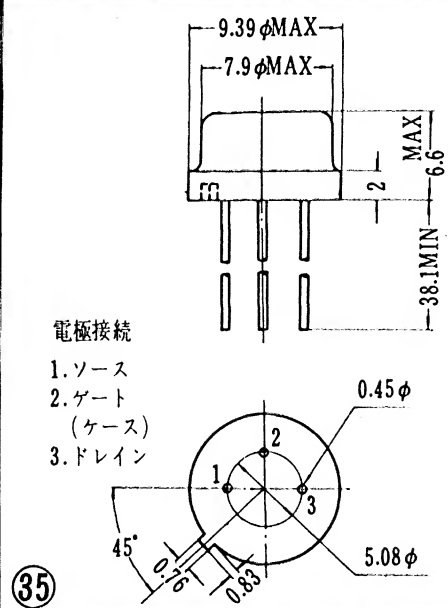
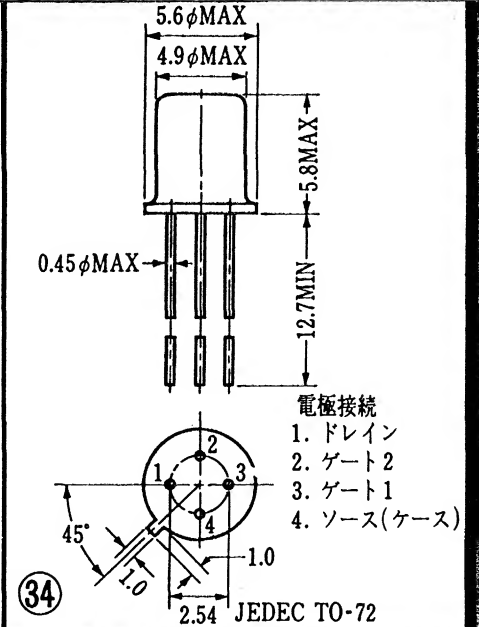
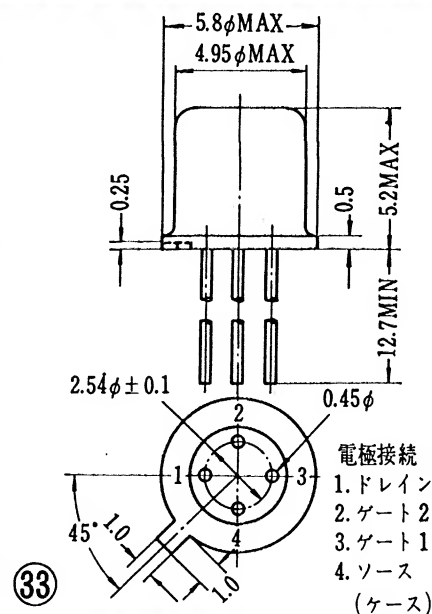
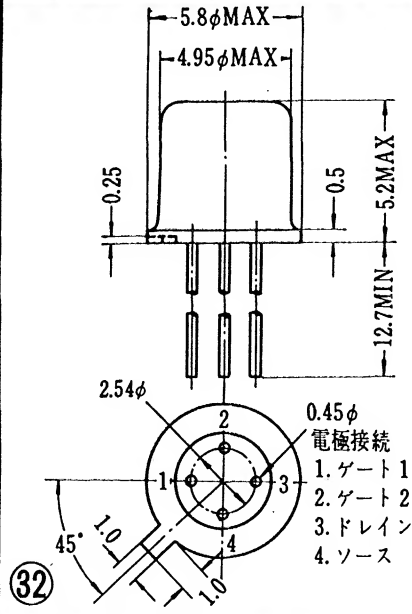
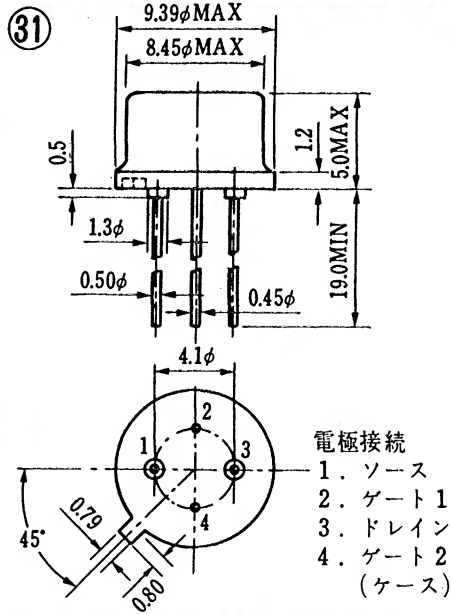


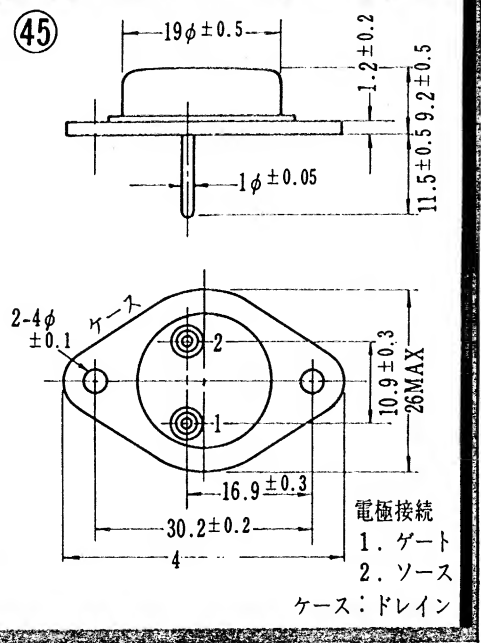
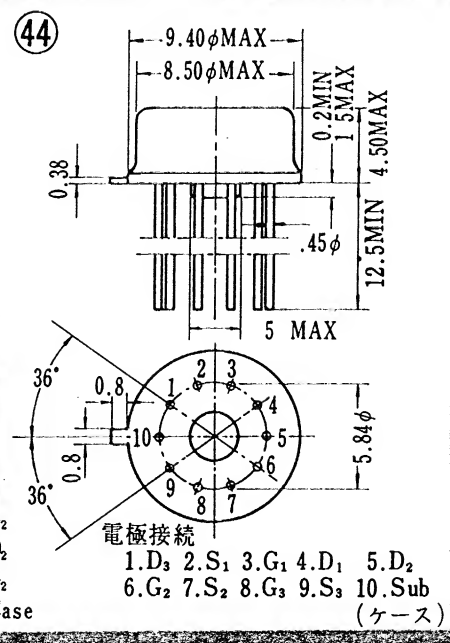
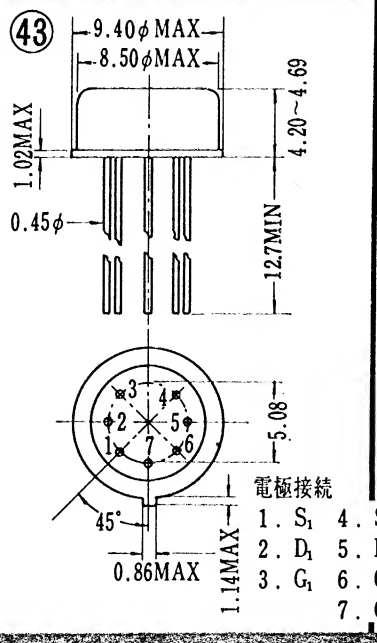
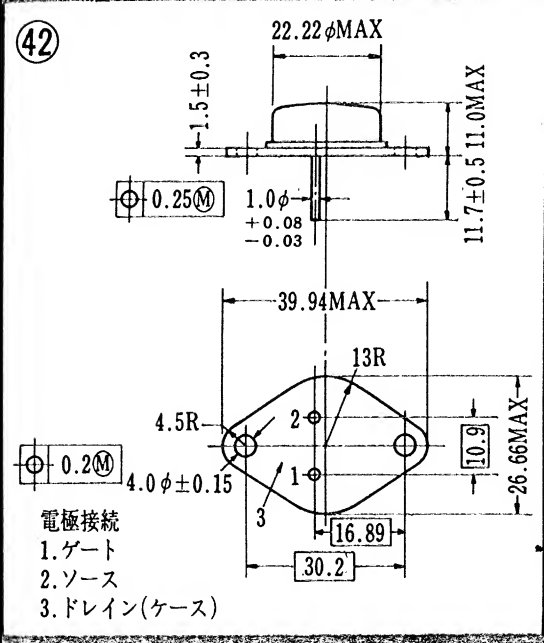
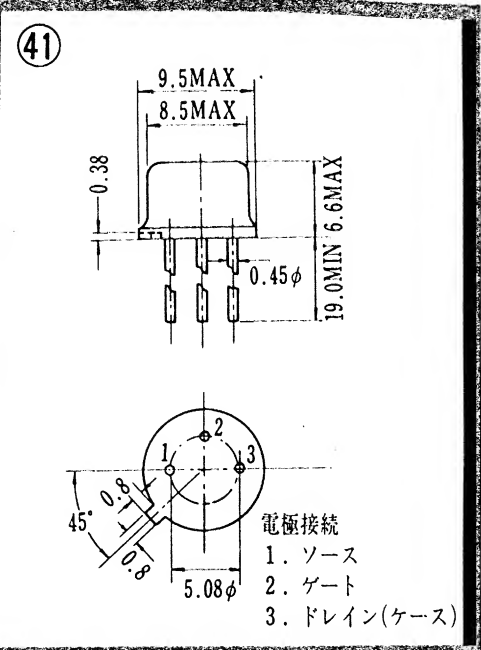
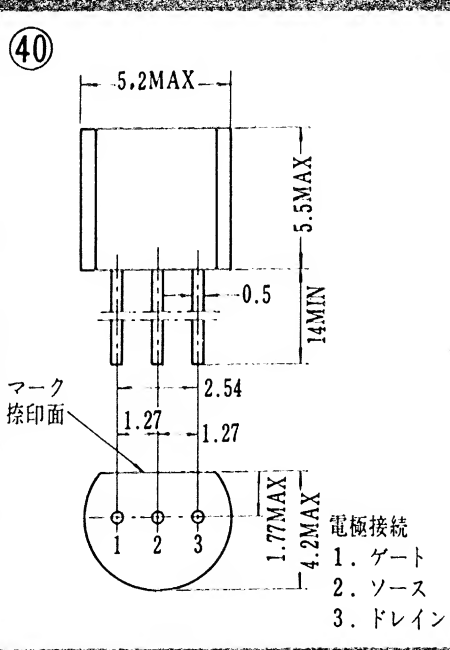
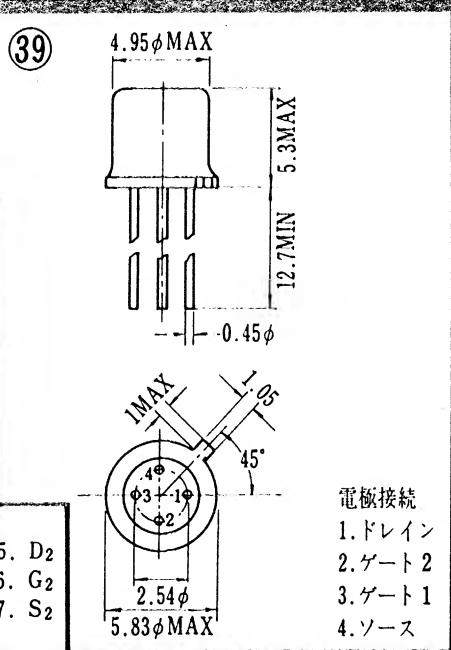
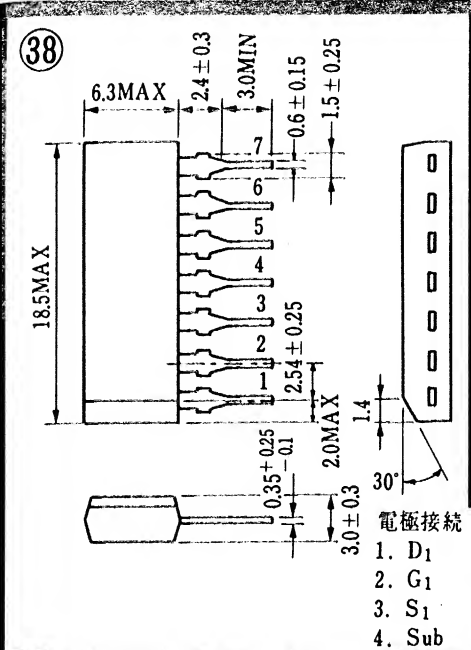
29



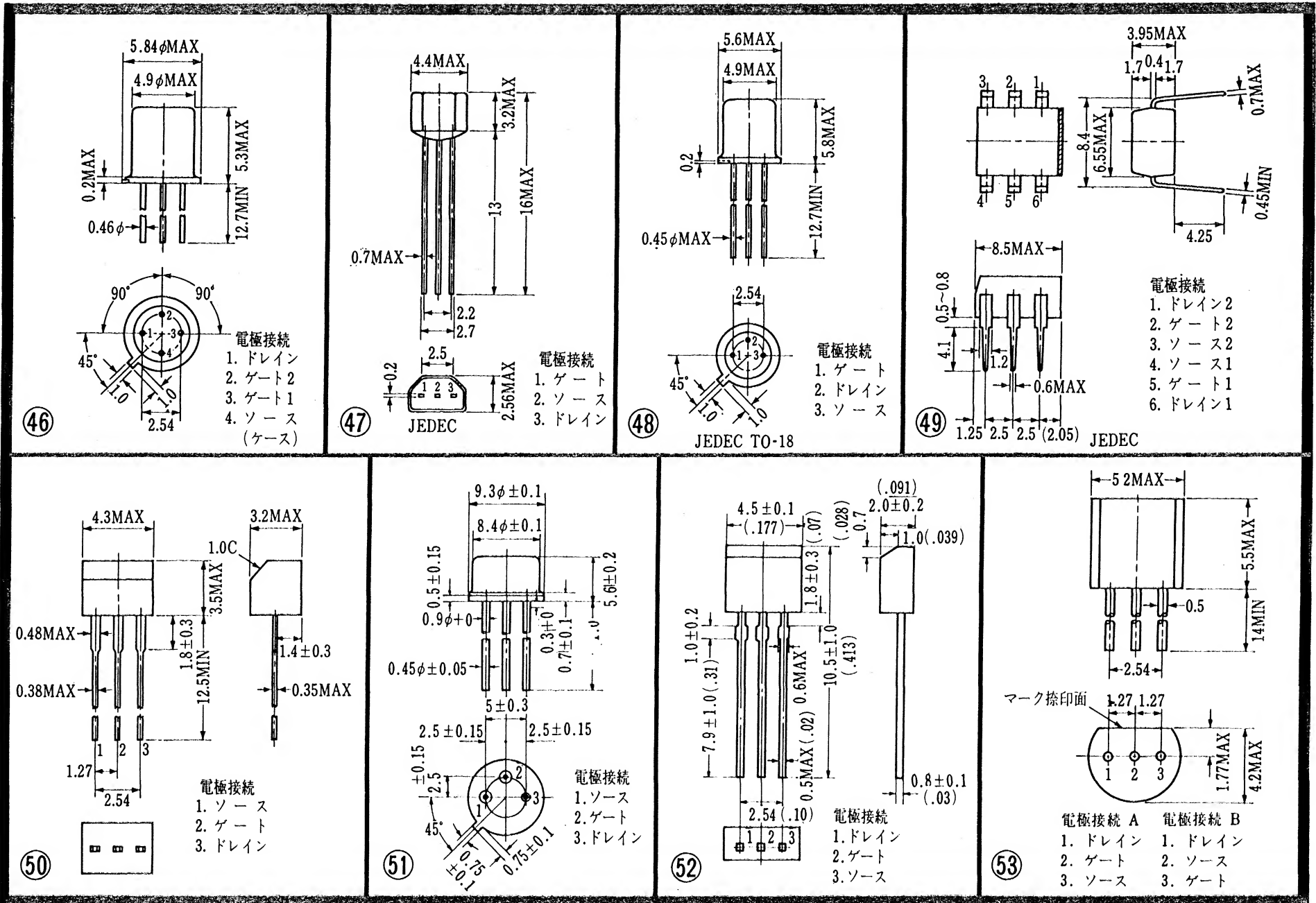
30



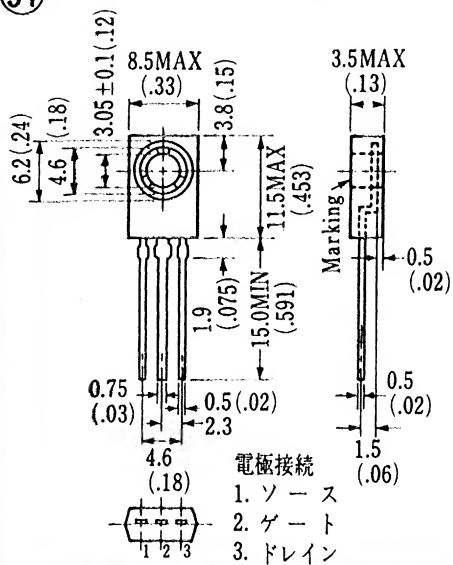




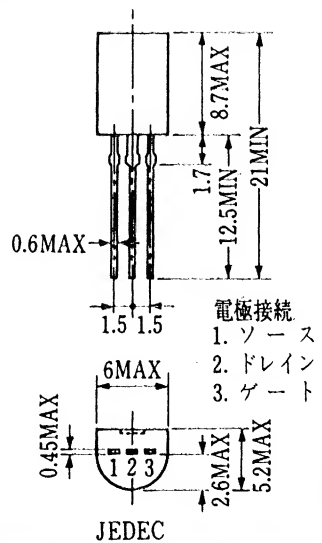




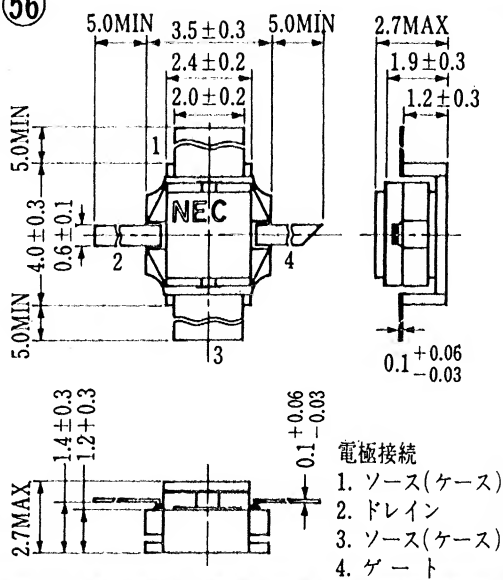
54



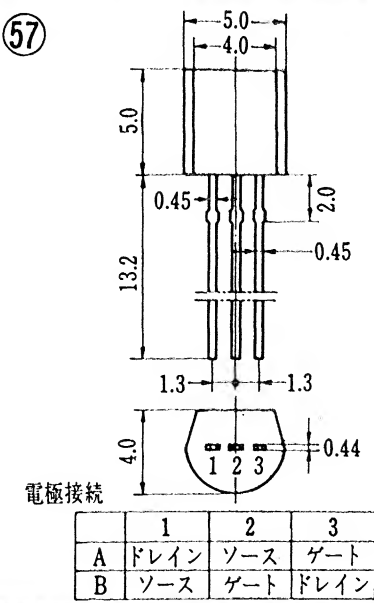
55



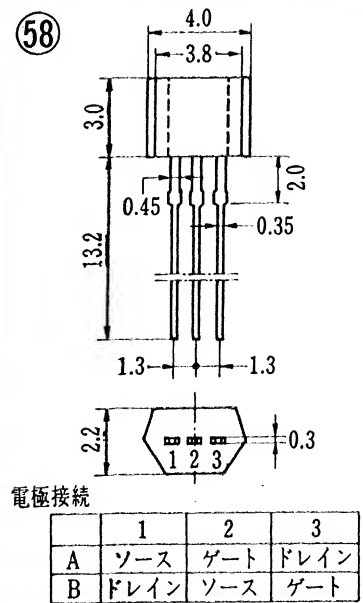
56



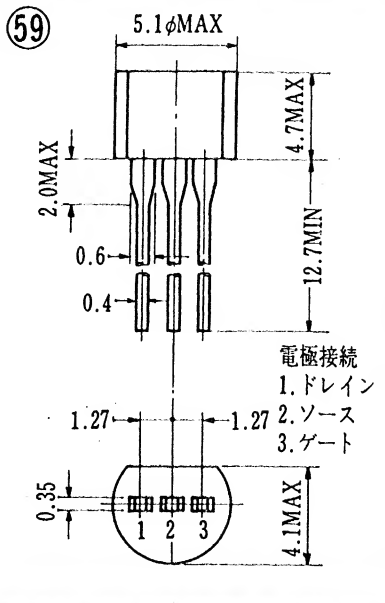
57



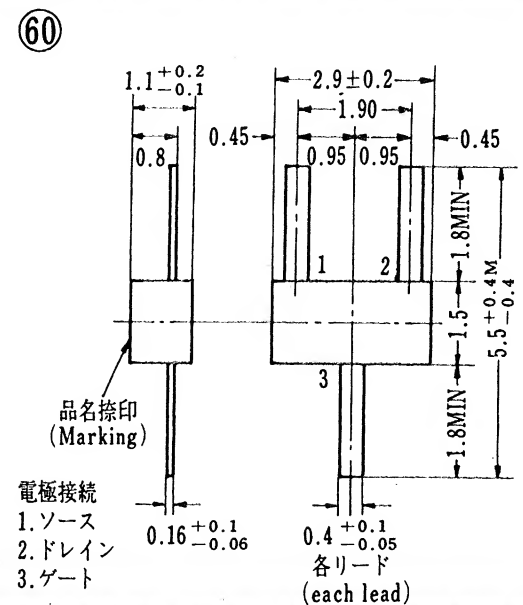
58



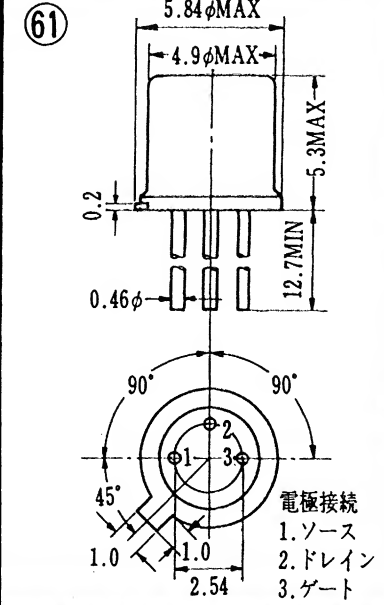
59

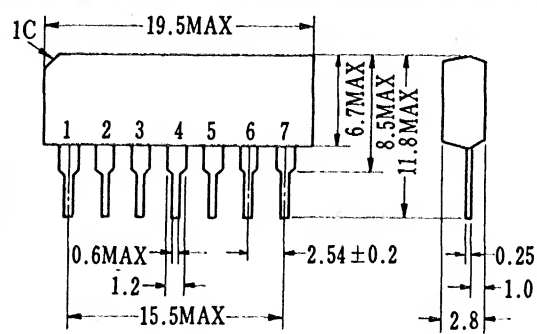
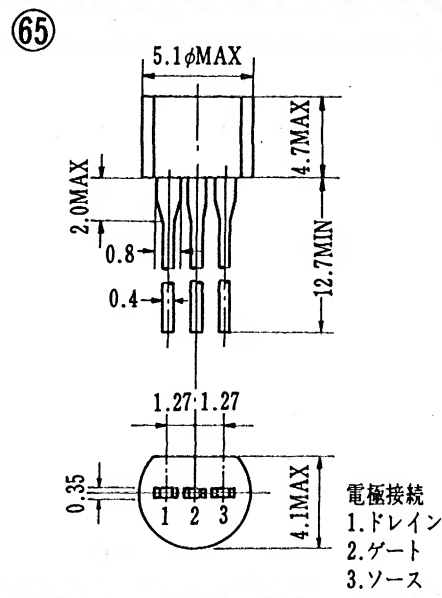
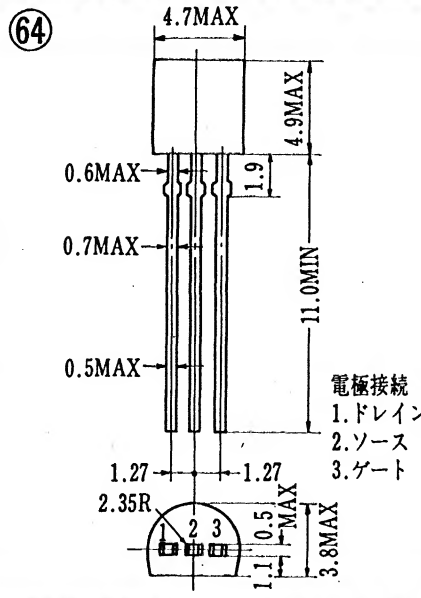
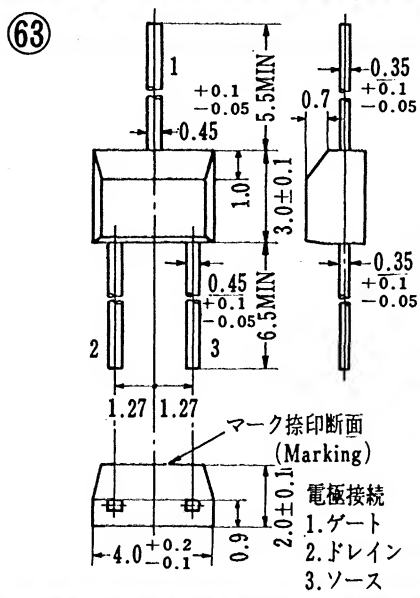
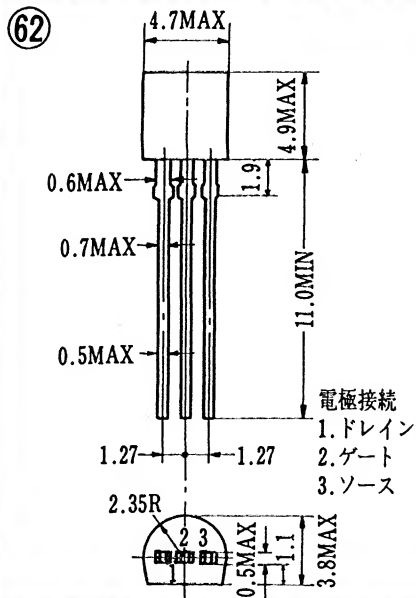


60



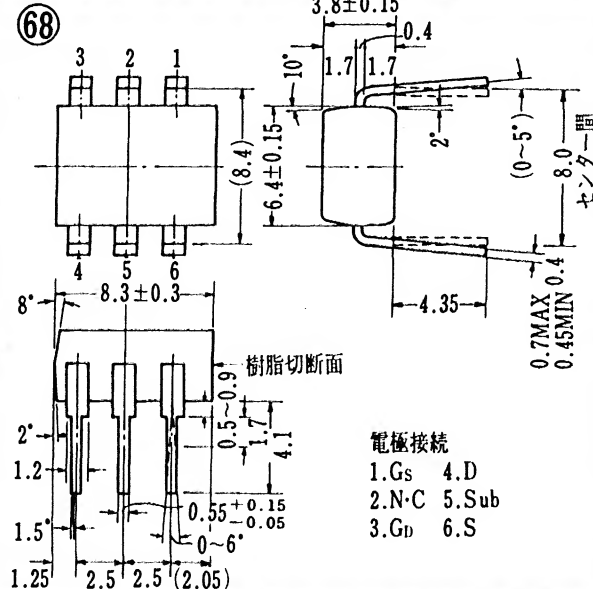
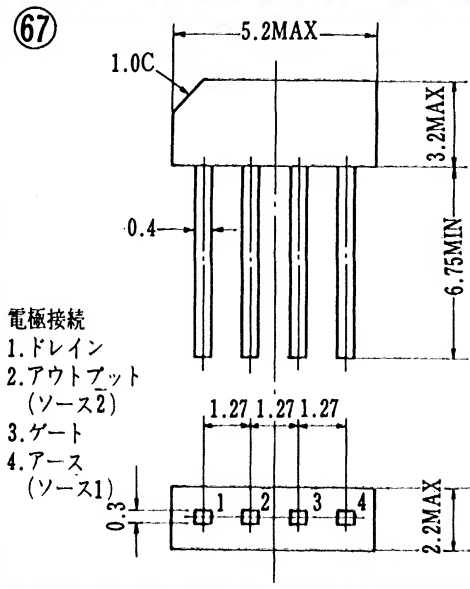
61

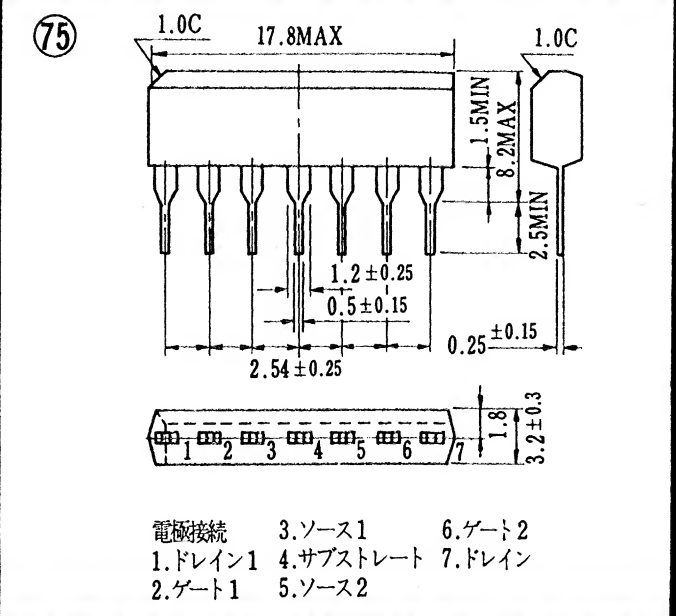
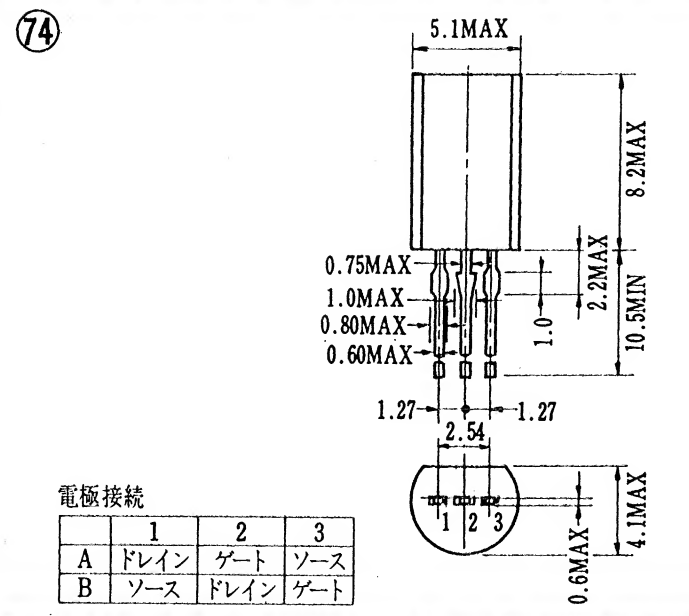
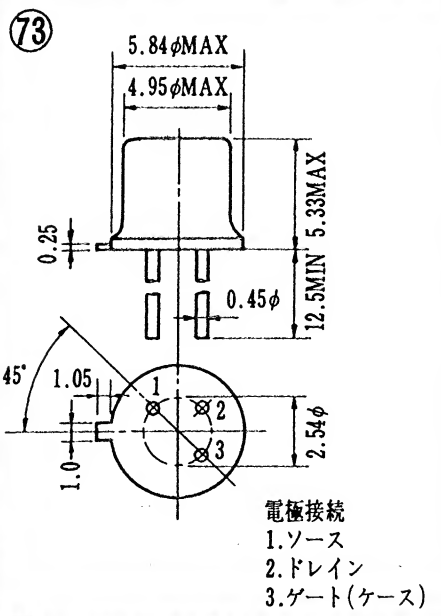
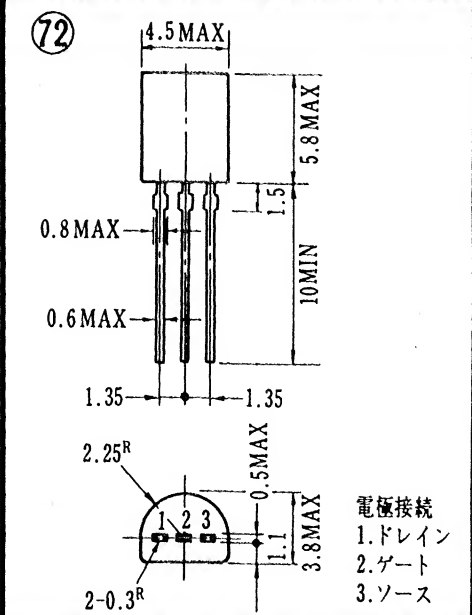
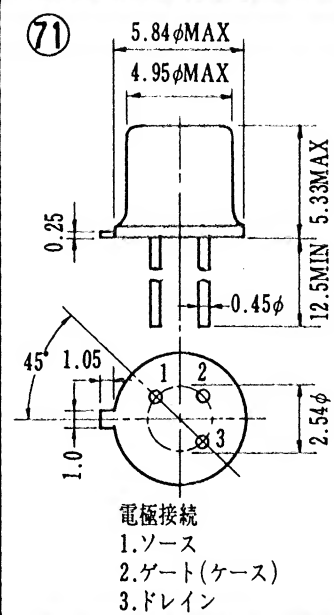
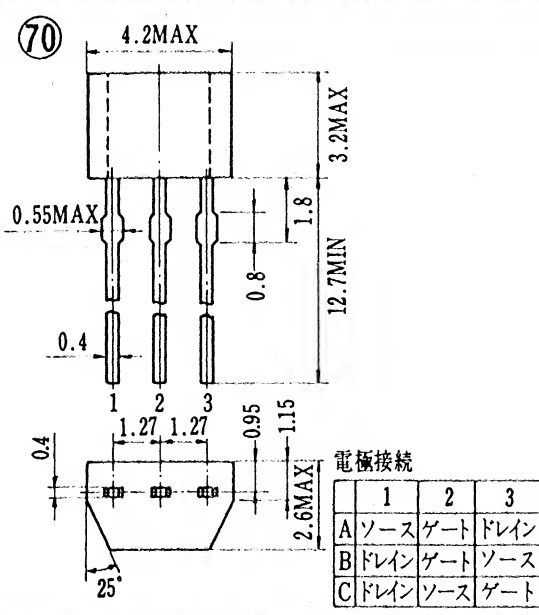
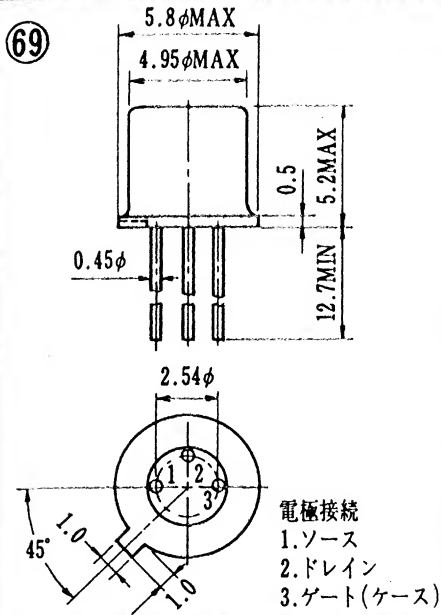


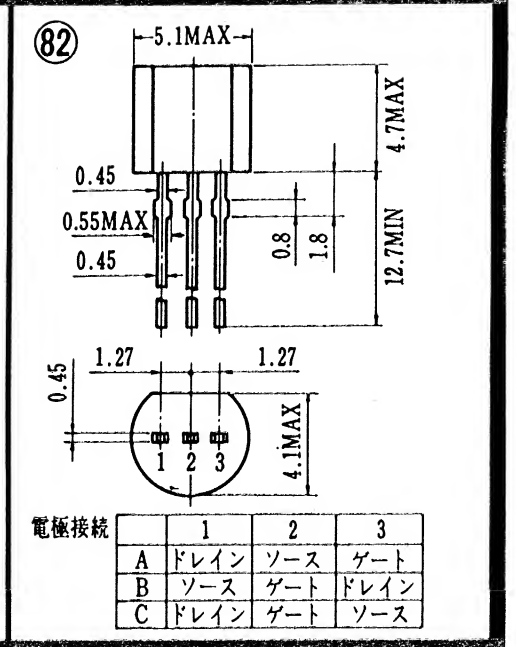
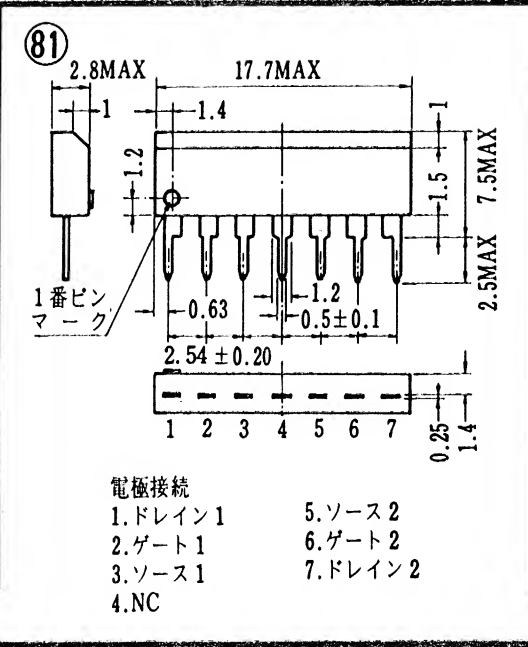
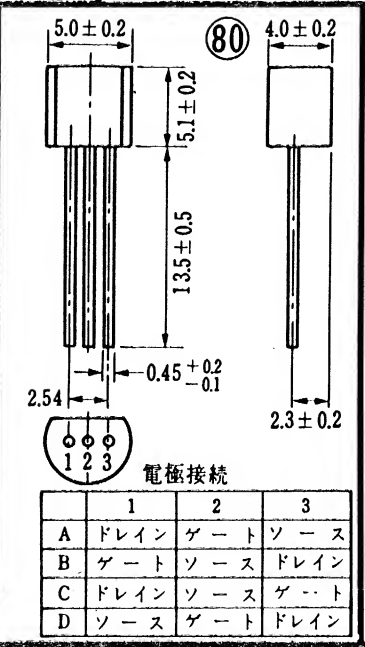
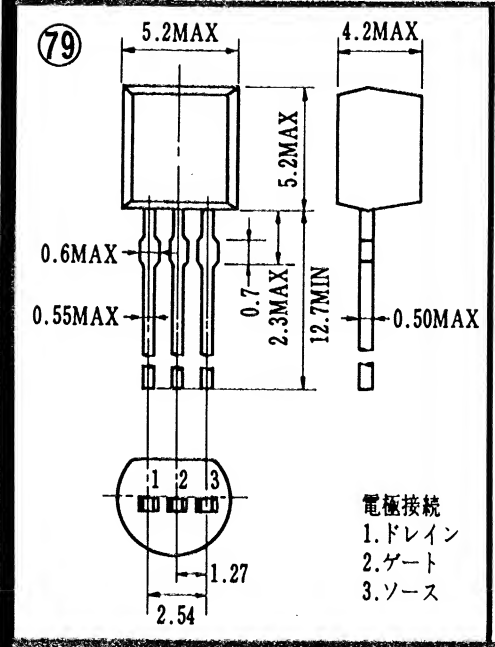
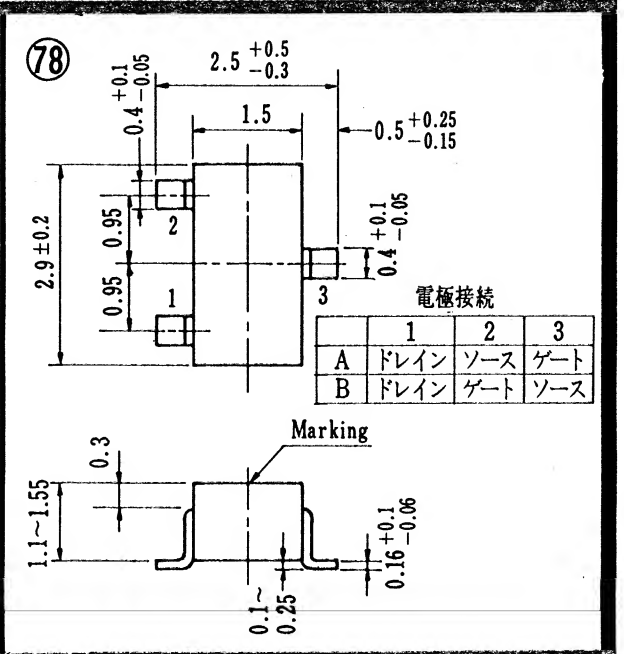
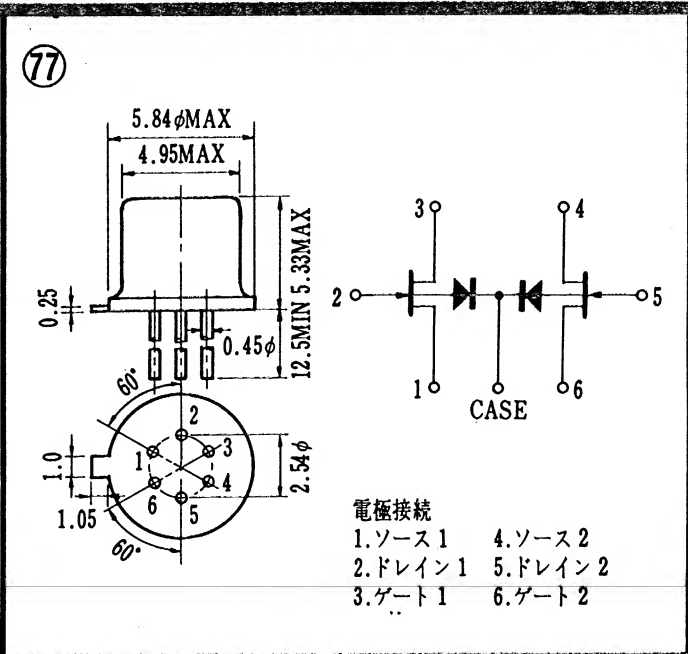
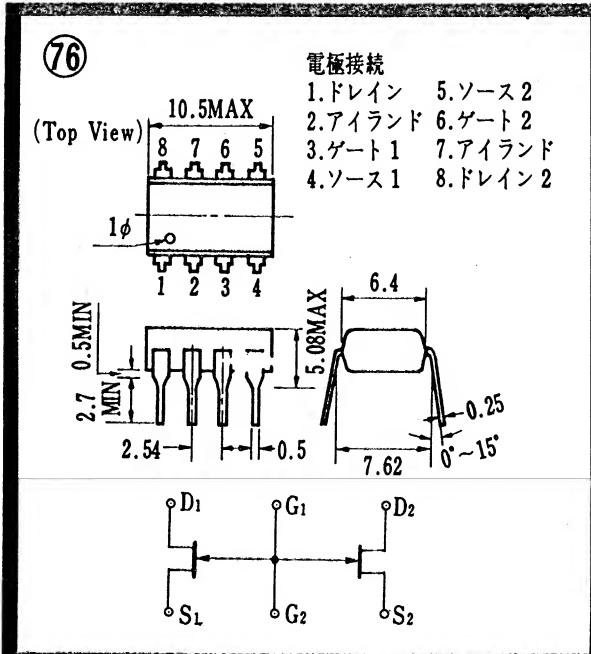


端子接続

端子No.	機能	端子No.	機能
1	1D	5	2S
2	1G	6	2G
3	1S	7	2D
4	Sub		

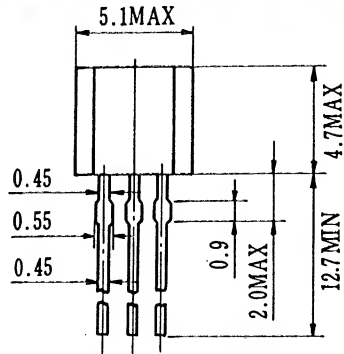






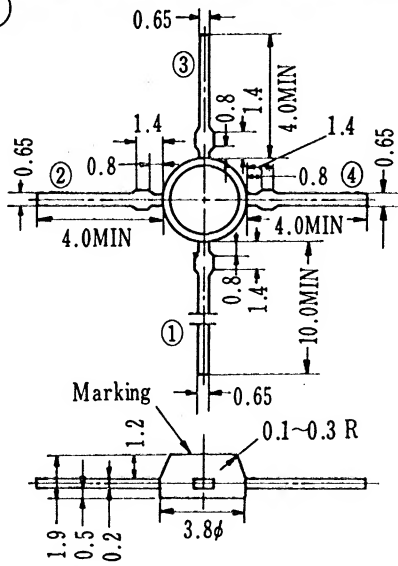


90



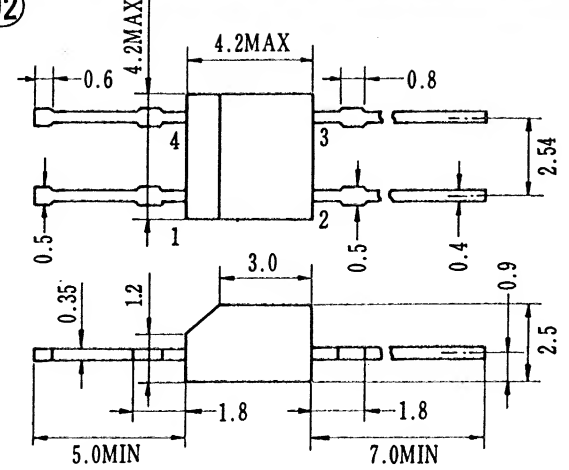
電極接続  
1.ドレイン  
2.ゲート  
3.ソース

91



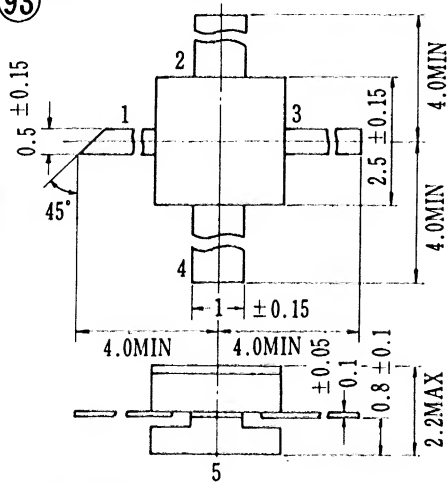
電極接続  
A  
1.ドレイン  
2.ソース  
3.ゲート  
4.NC  
B  
1.ドレイン  
2.ソース  
3.ゲート1  
4.ゲート2

92



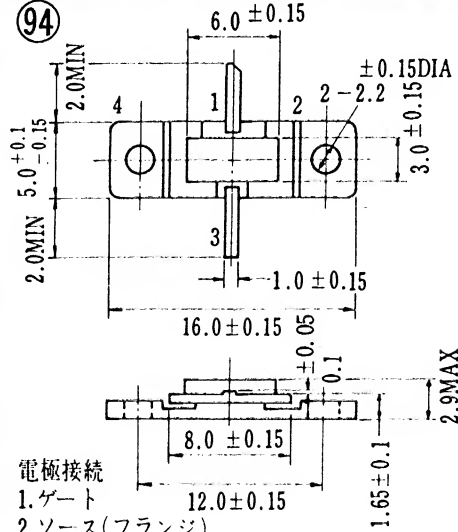
電極接続  
1.ソース  
2.ドレイン  
3.ゲート2  
4.ゲート1

93



電極接続  
1.ゲート  
2.ソース  
3.ドレイン  
4.ソース  
5.ソース

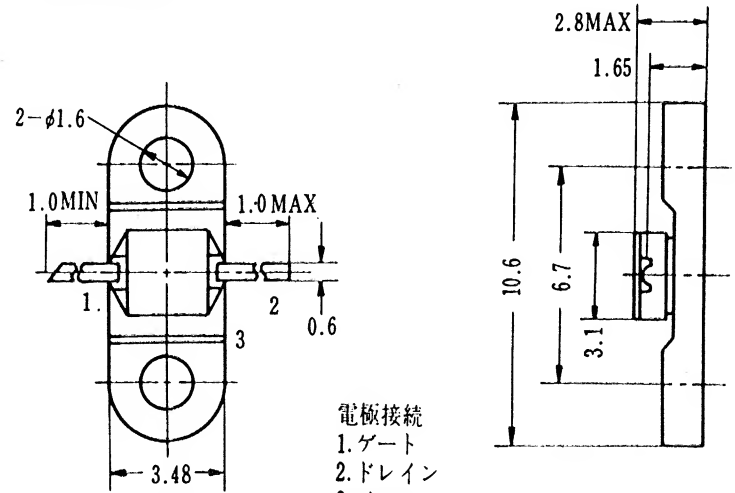
94



電極接続  
1.ゲート  
2.ソース(フランジ)  
3.ドレイン  
4.ソース(フランジ)

95

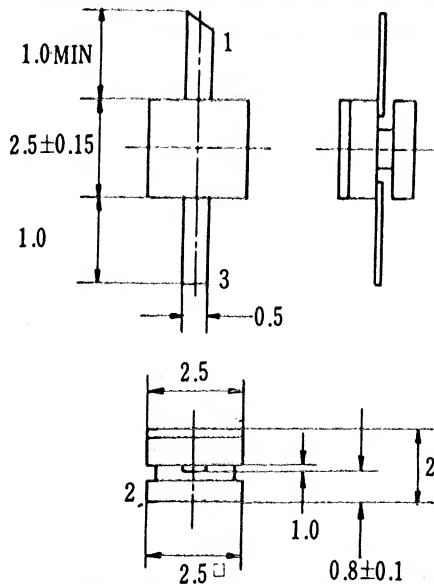
MB (package)



電極接続  
1.ゲート  
2.ドレイン  
3.ソース

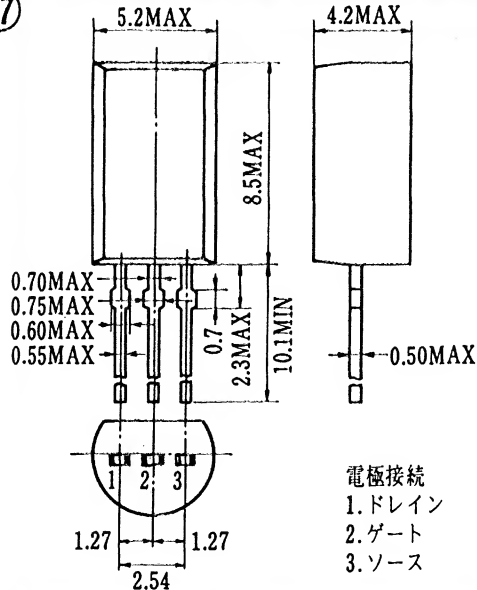


96



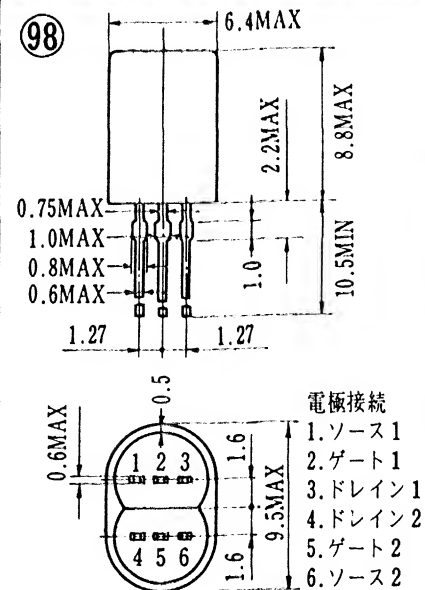
電極接続  
1. ゲート  
2. ソース  
3. ドレイン

97



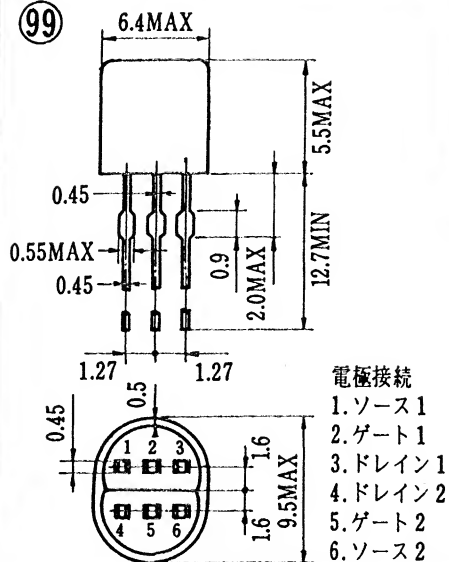
電極接続  
1. ドレイン  
2. ゲート  
3. ソース

98



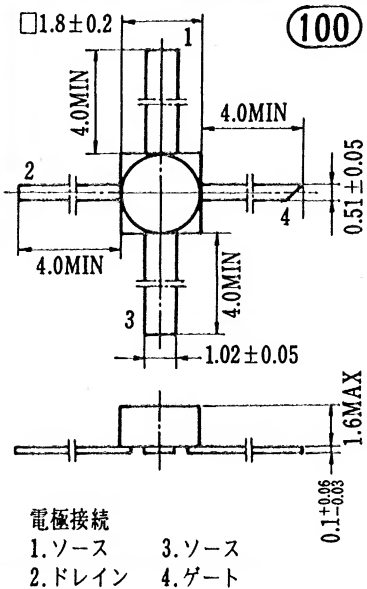
電極接続  
1. ソース 1  
2. ゲート 1  
3. ドレイン 1  
4. ドレイン 2  
5. ゲート 2  
6. ソース 2

99



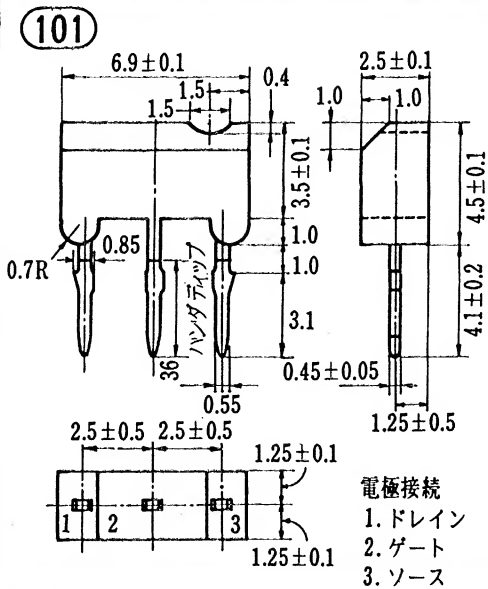
電極接続  
1. ソース 1  
2. ゲート 1  
3. ドレイン 1  
4. ドレイン 2  
5. ゲート 2  
6. ソース 2

100



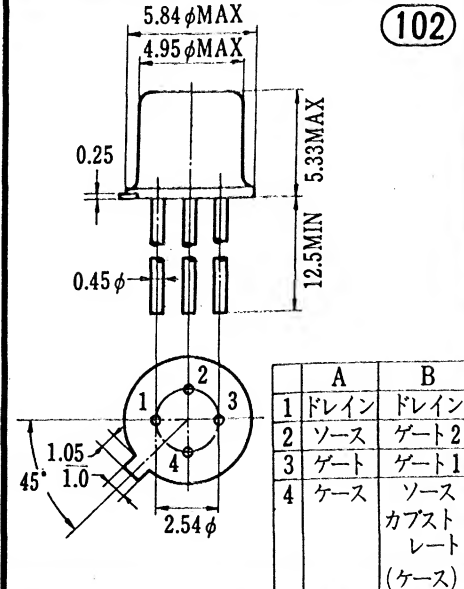
電極接続  
1. ソース 3. ソース  
2. ドレイン 4. ゲート

101



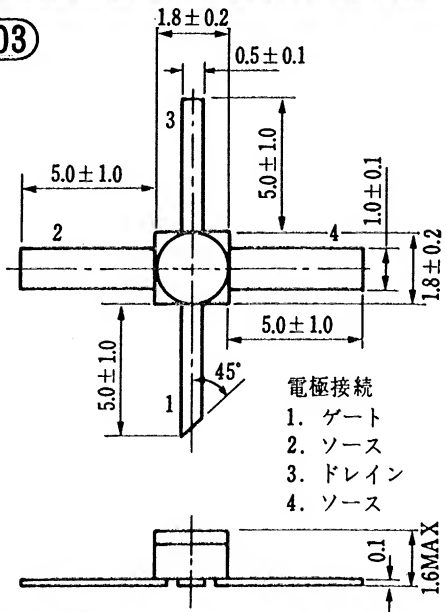
電極接続  
1. ドレイン  
2. ゲート  
3. ソース

102

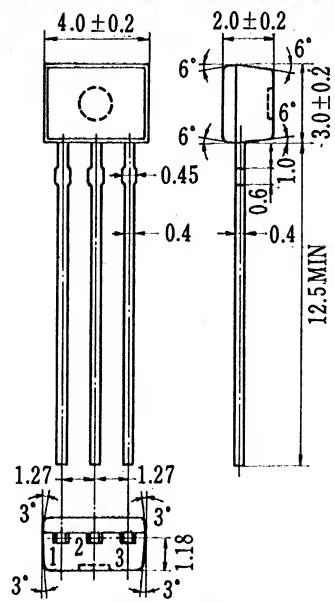


	A	B
1	ドレイン	ドレイン
2	ソース	ゲート 2
3	ゲート	ゲート 1
4	ケース	ソース カブスト レート (ケース)

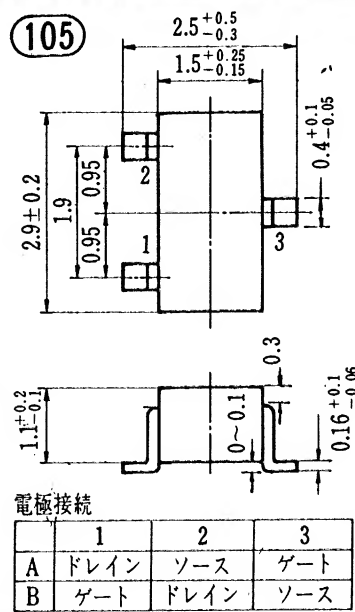
103



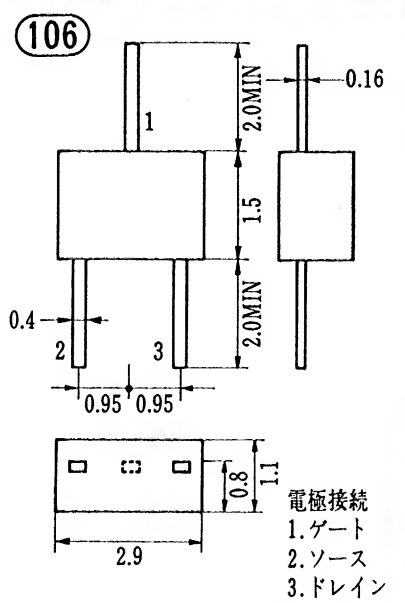
104



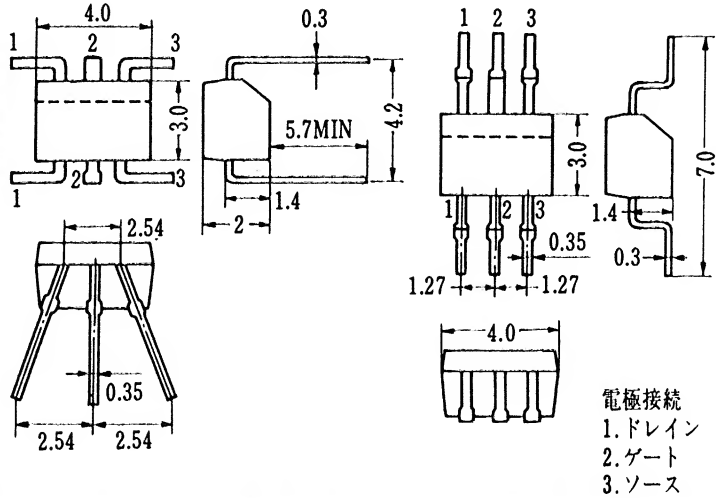
105



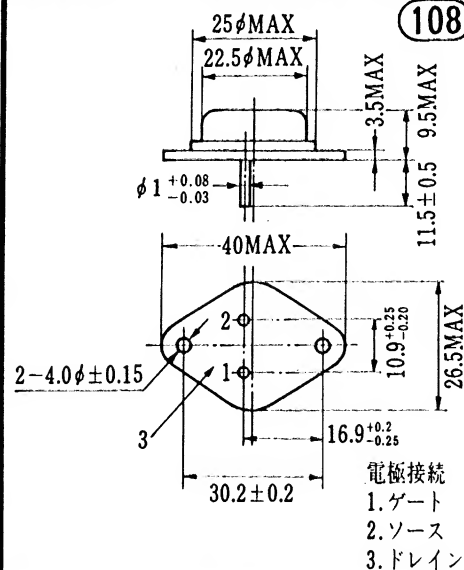
106



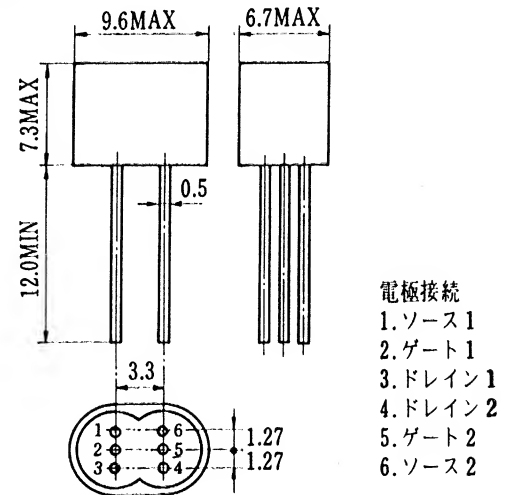
107



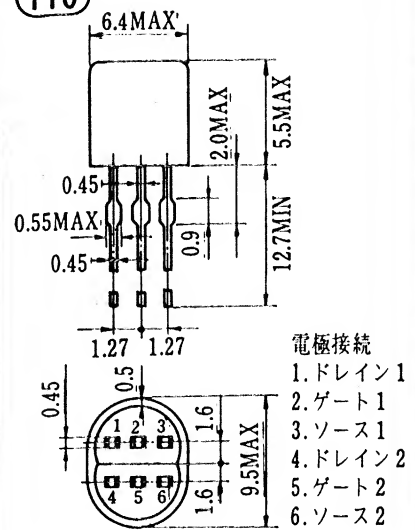
108



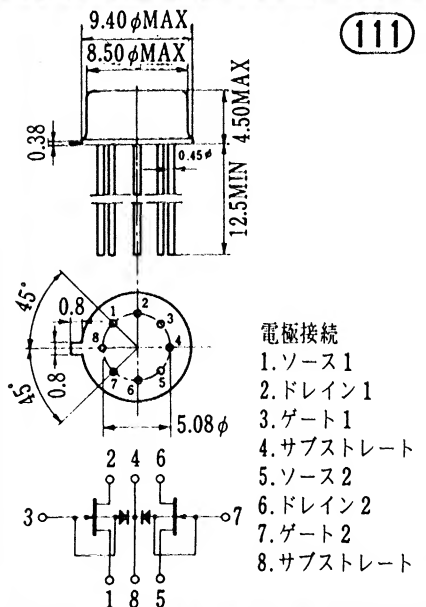
109



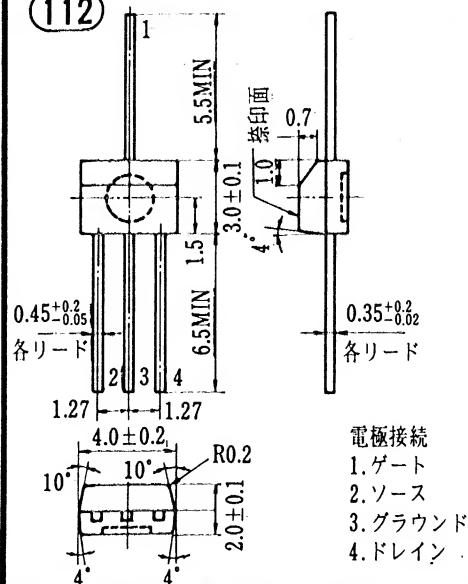
110



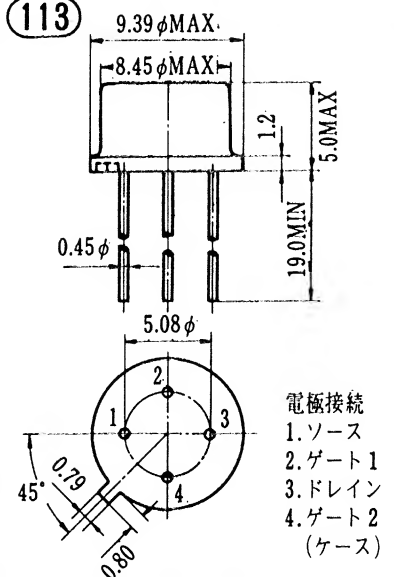
111



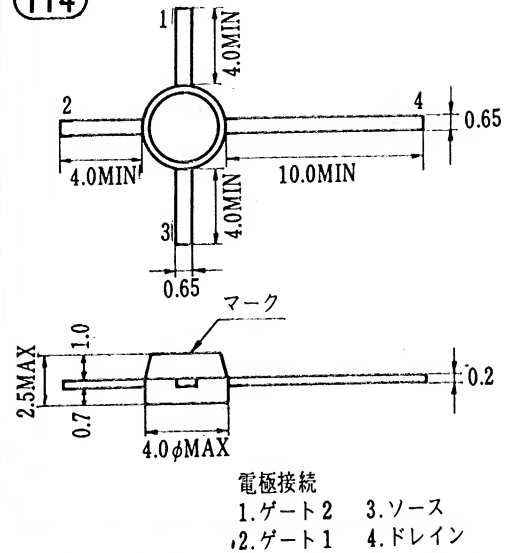
112



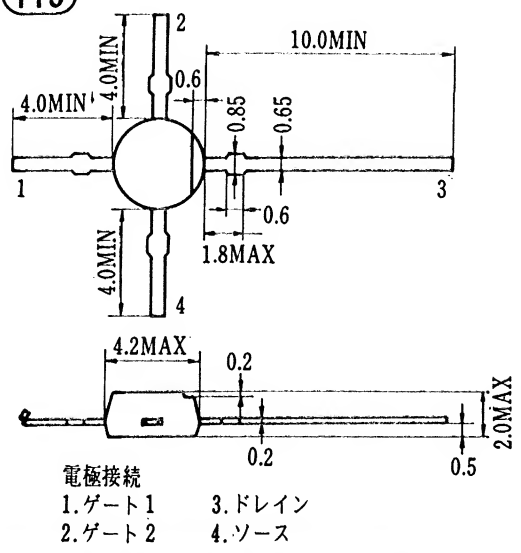
113



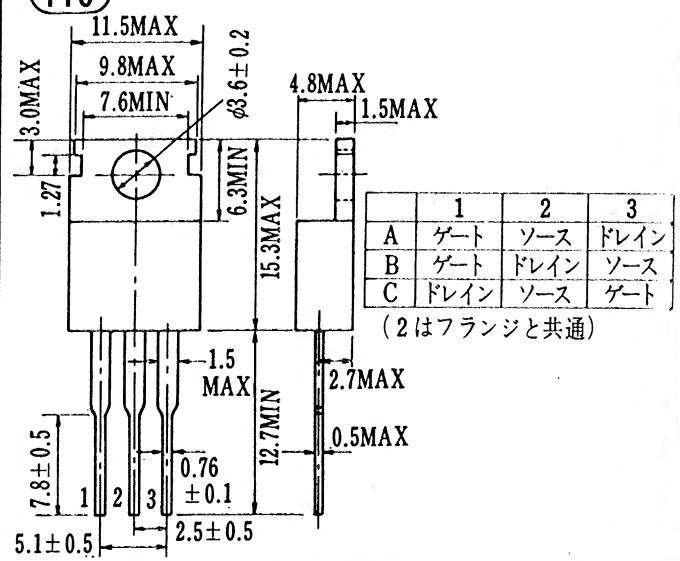
114



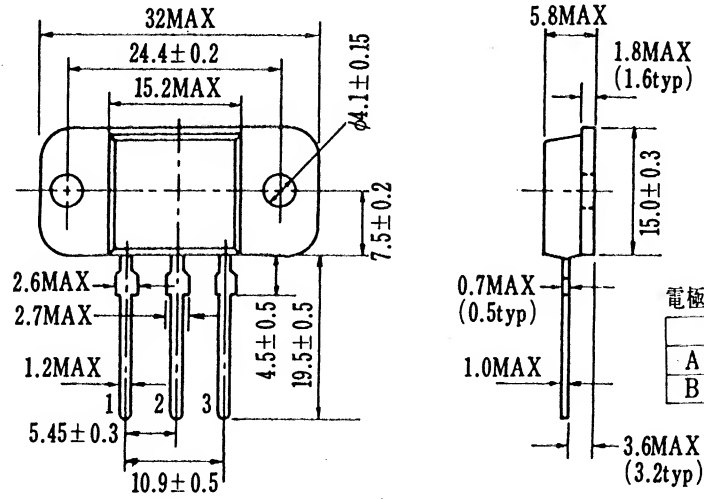
115



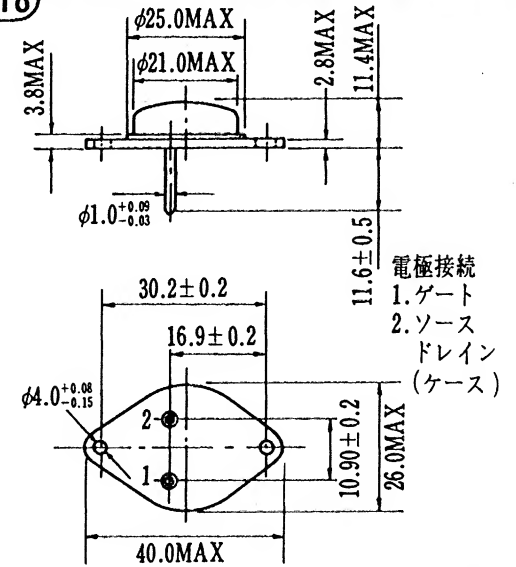
116



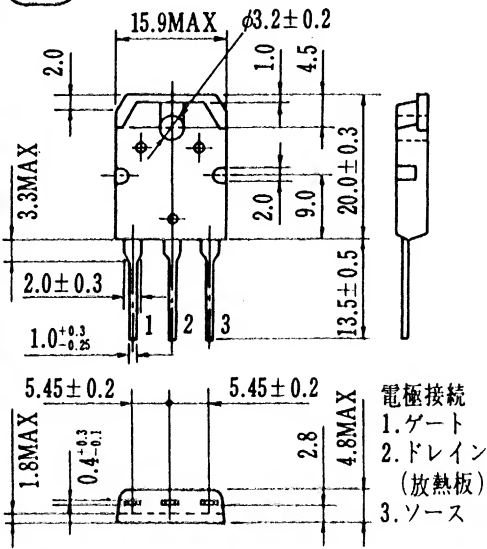
117



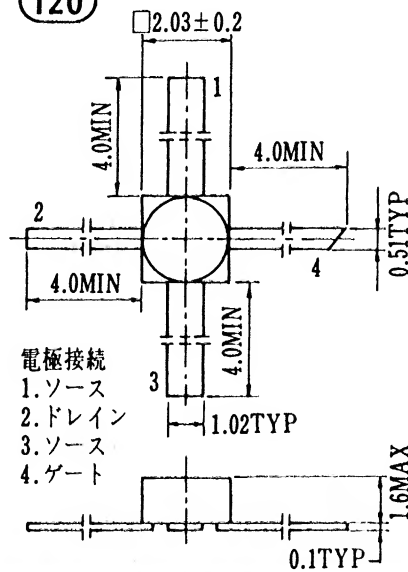
118



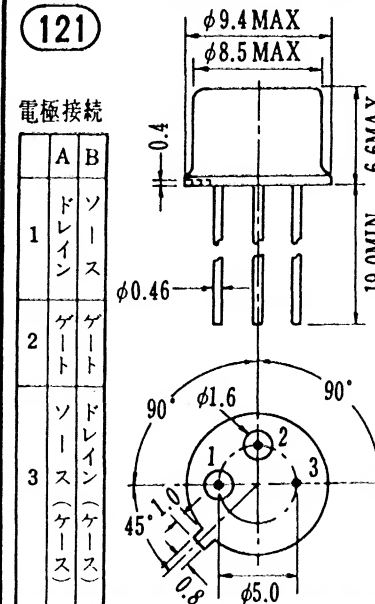
119



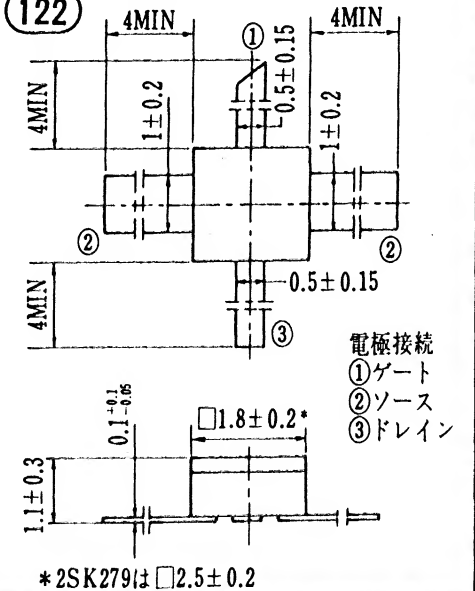
120



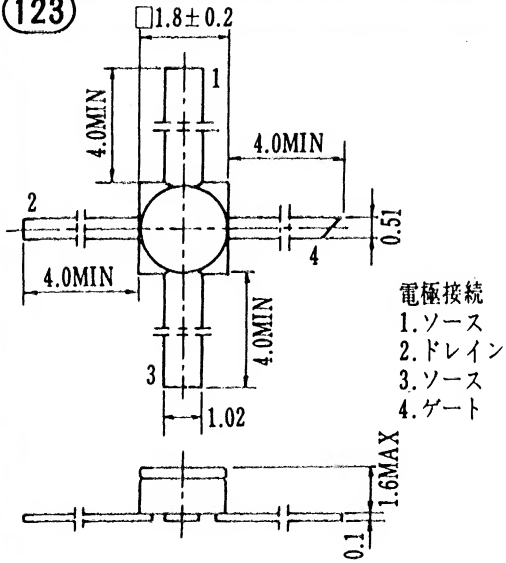
121



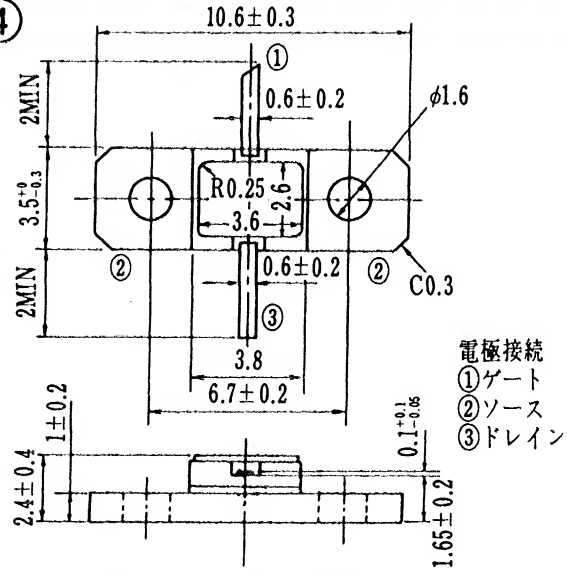
122



123

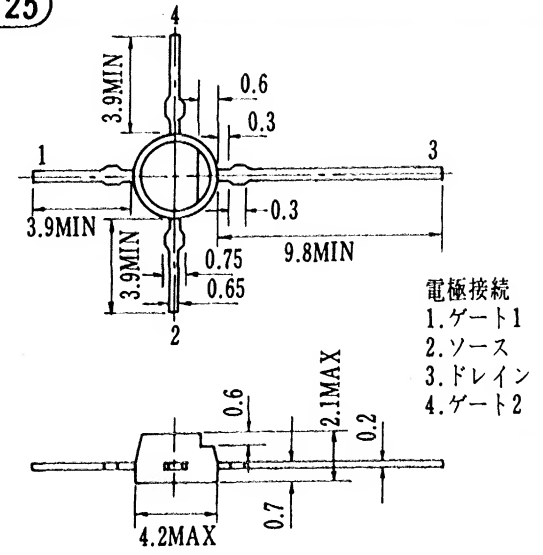


124

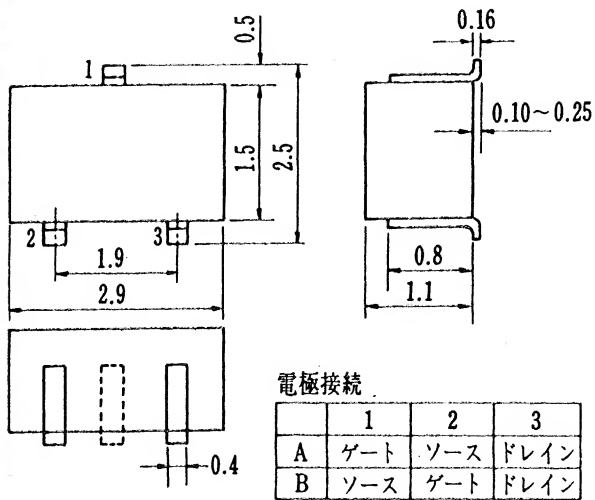


(注) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

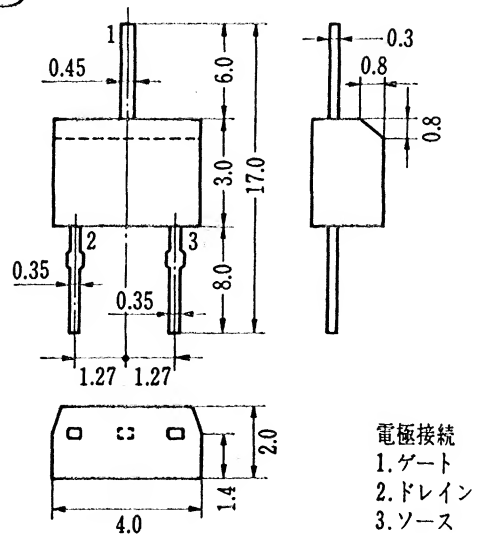
125



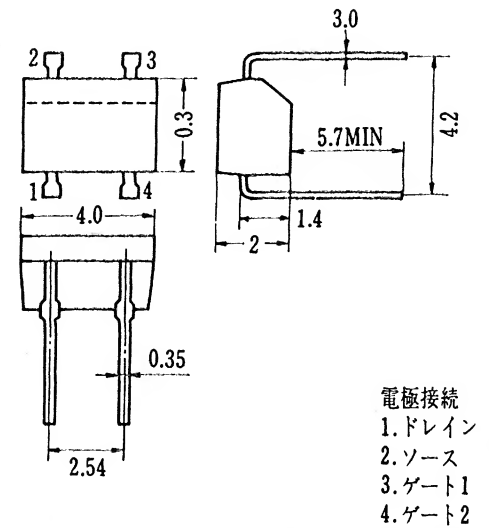
126



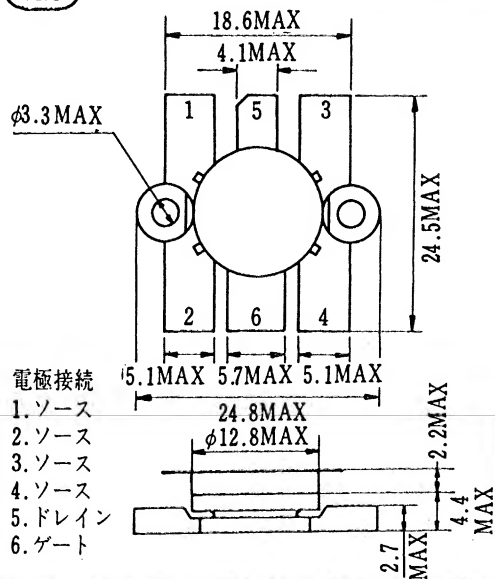
127



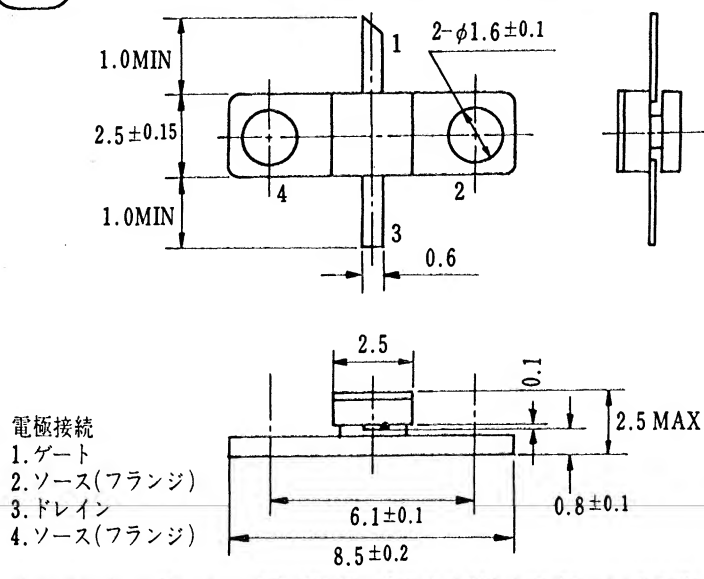
128



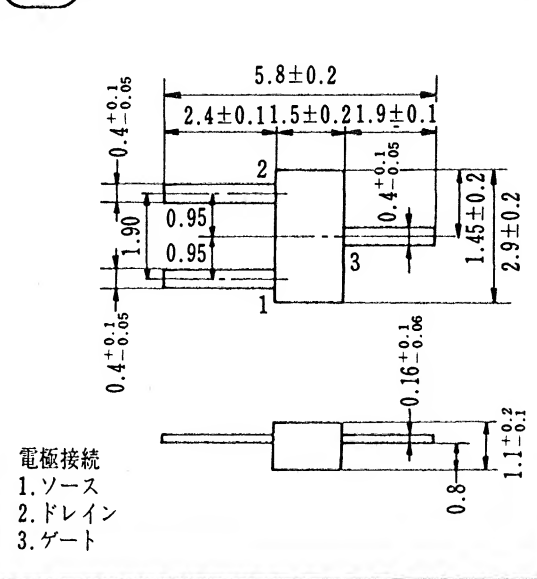
129



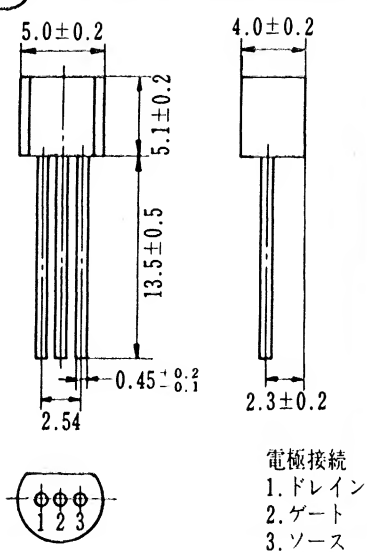
130



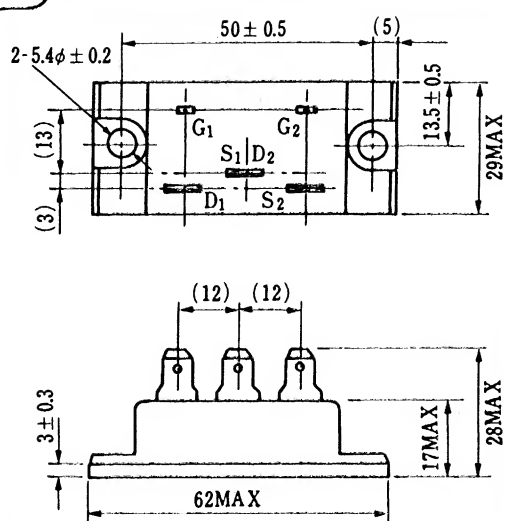
131



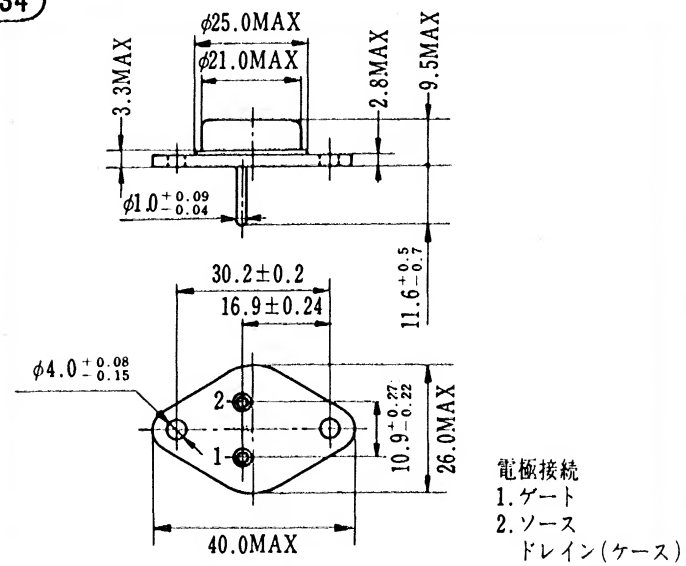
132



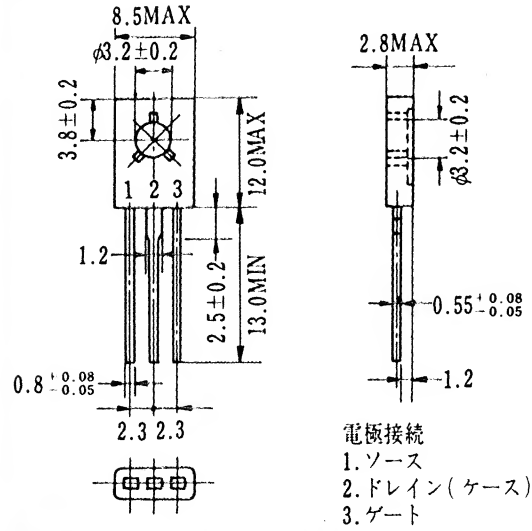
133



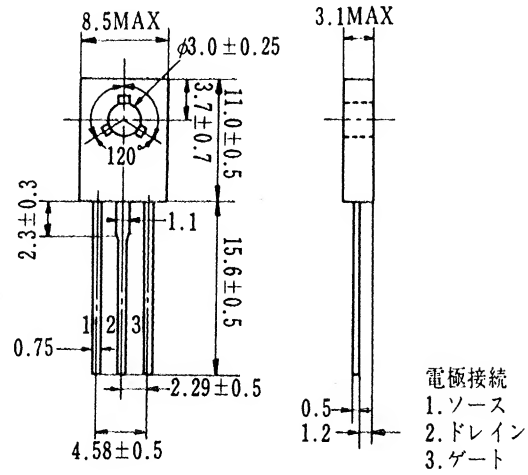
134



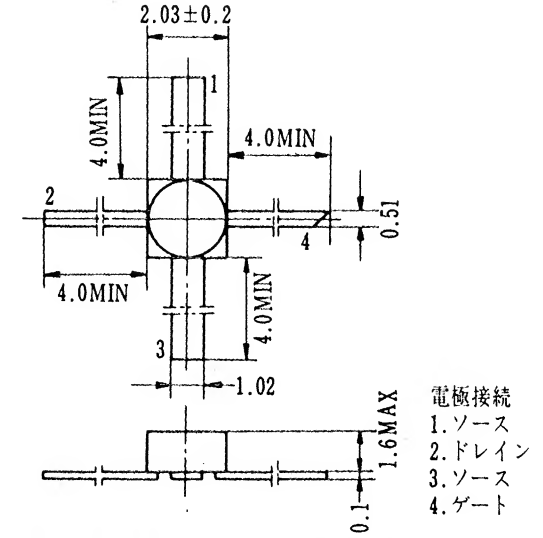
135



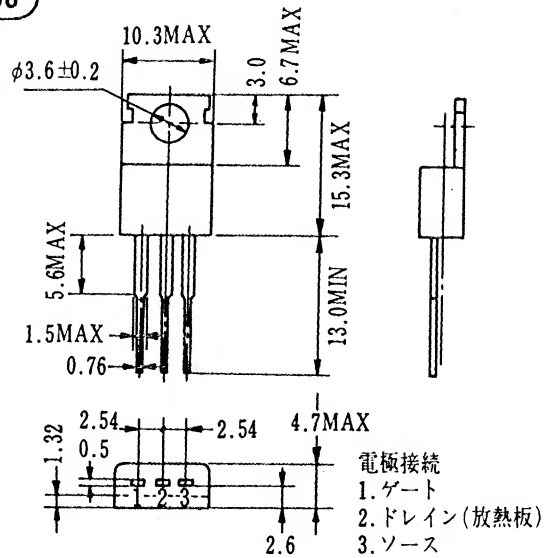
136



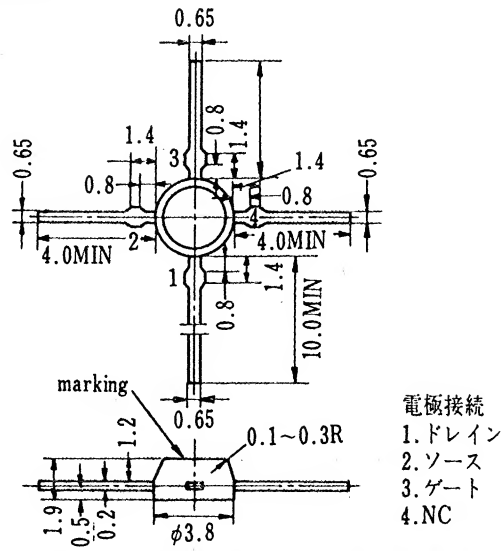
137



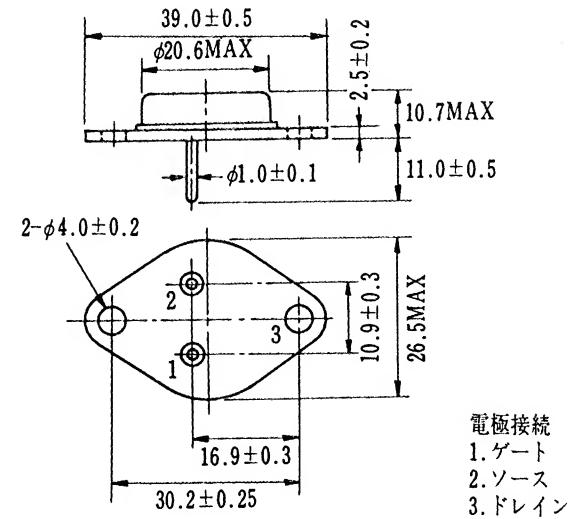
138



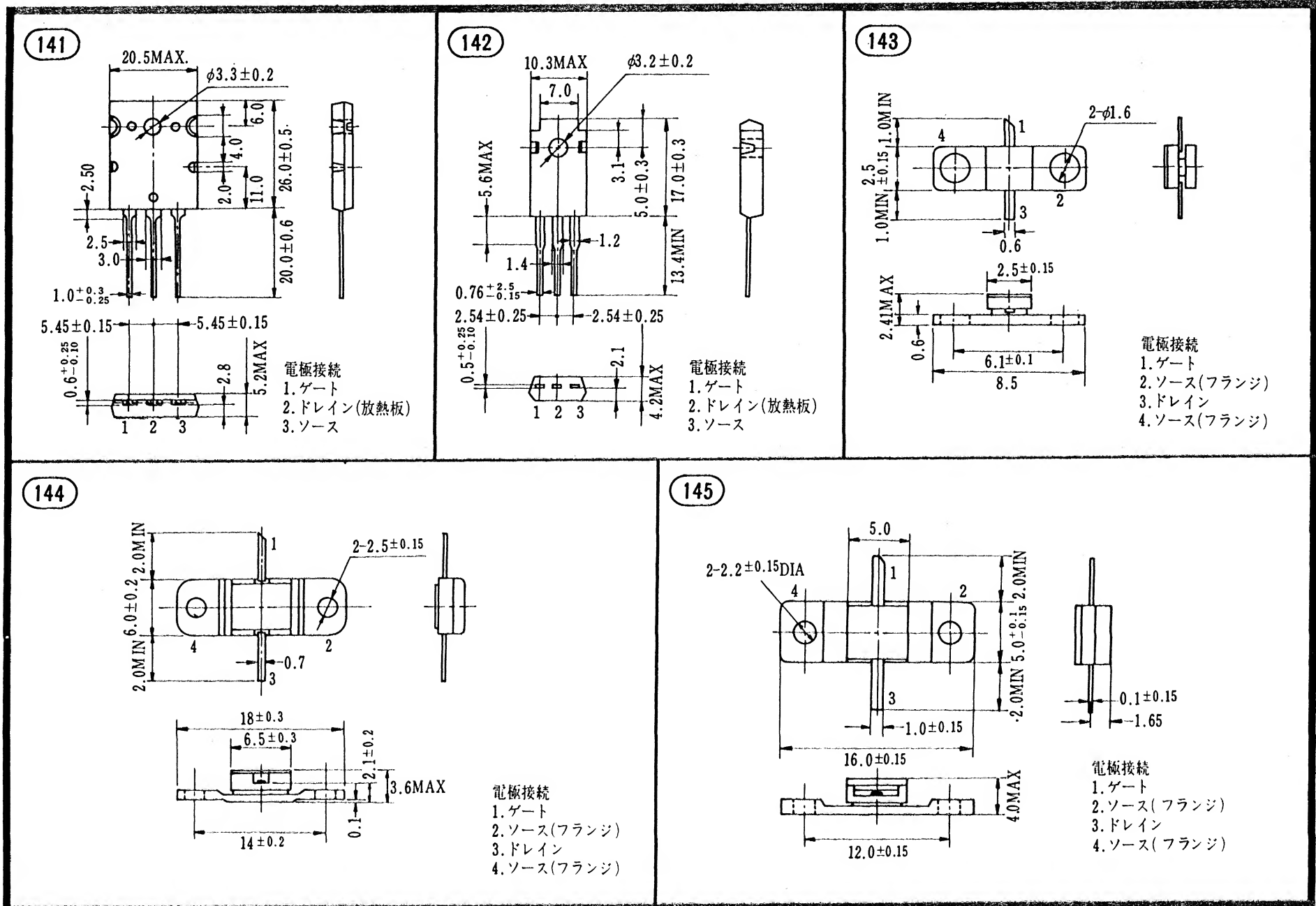
139



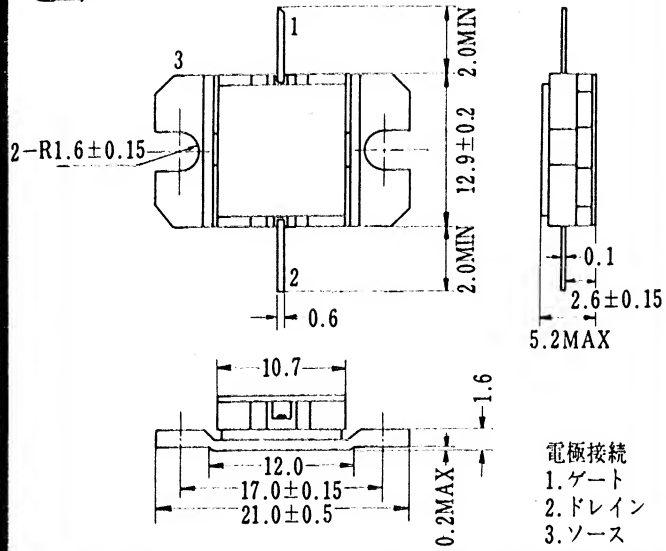
140



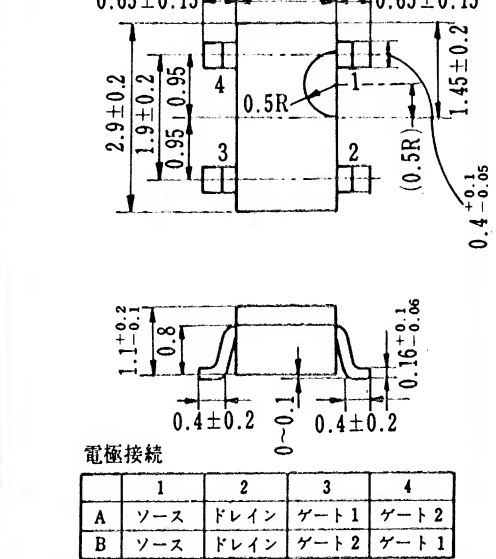




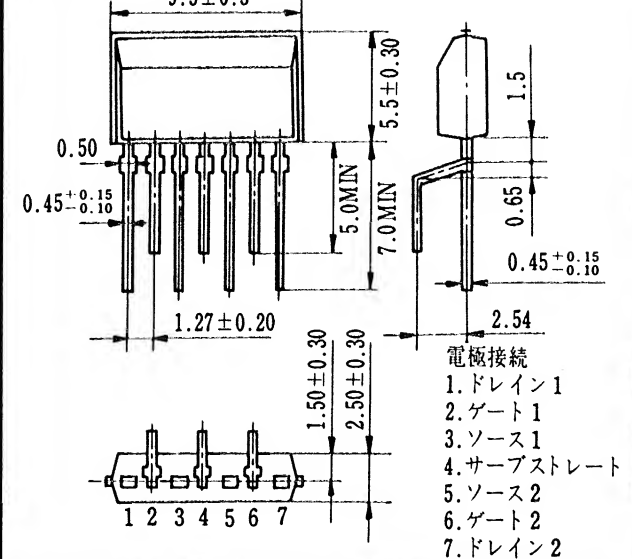
146



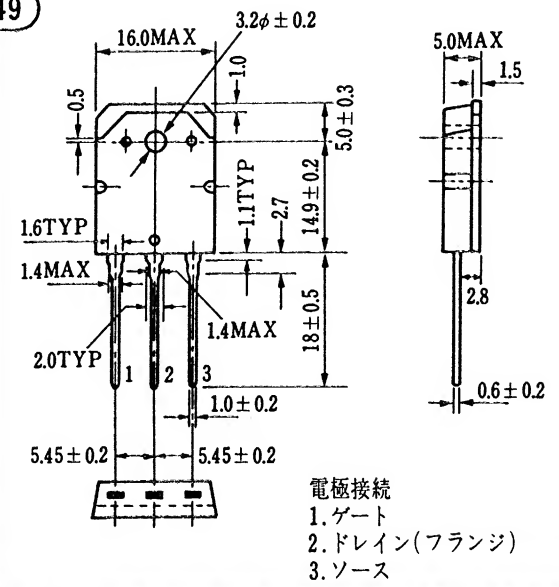
147



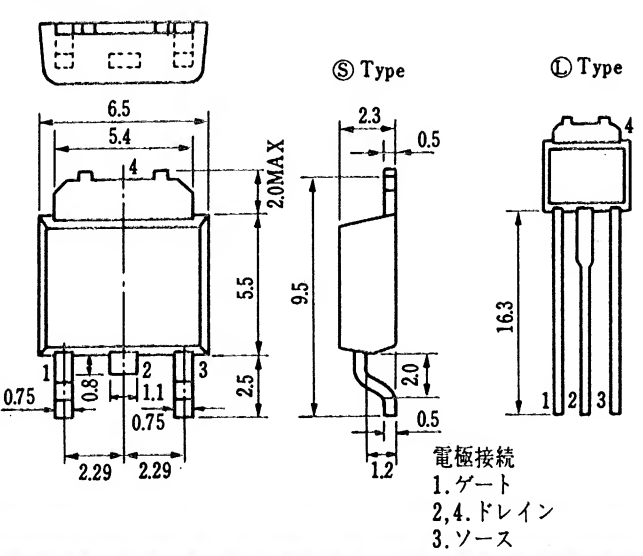
148



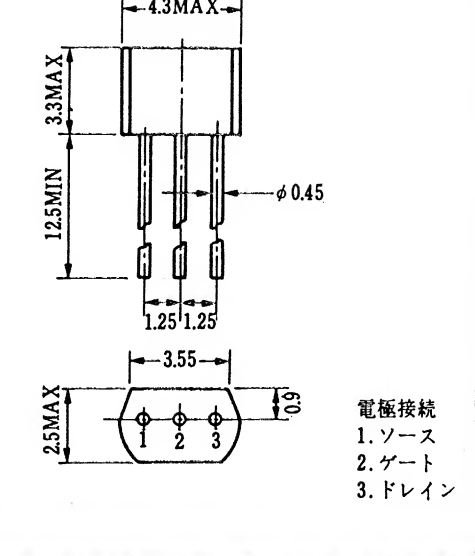
149

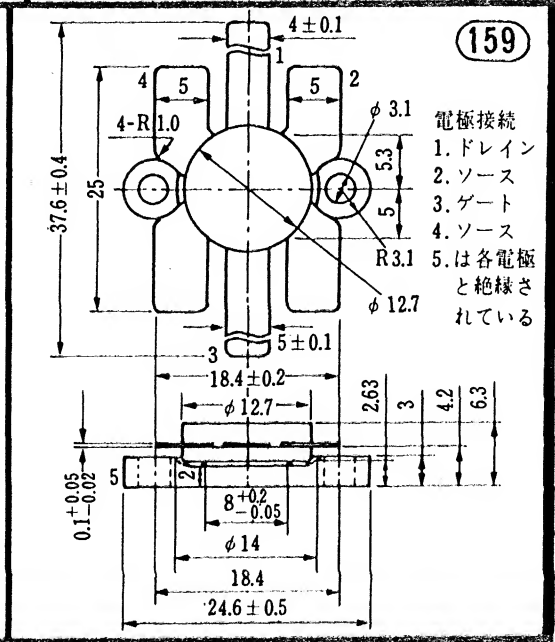
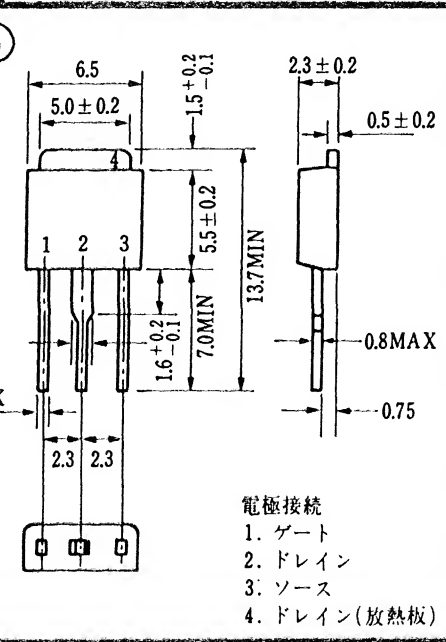
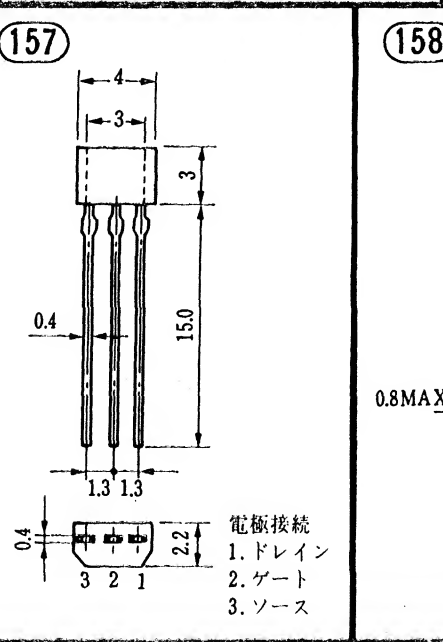
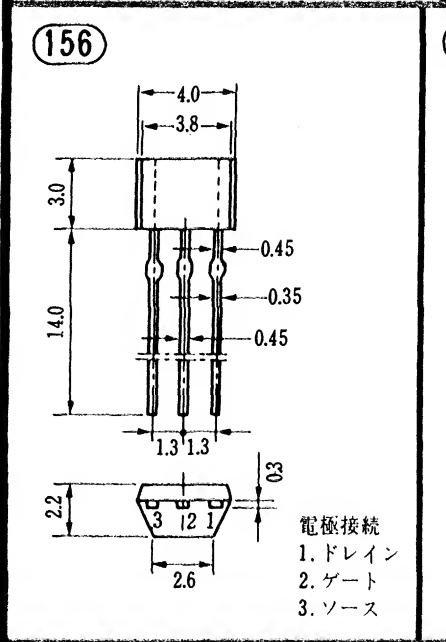
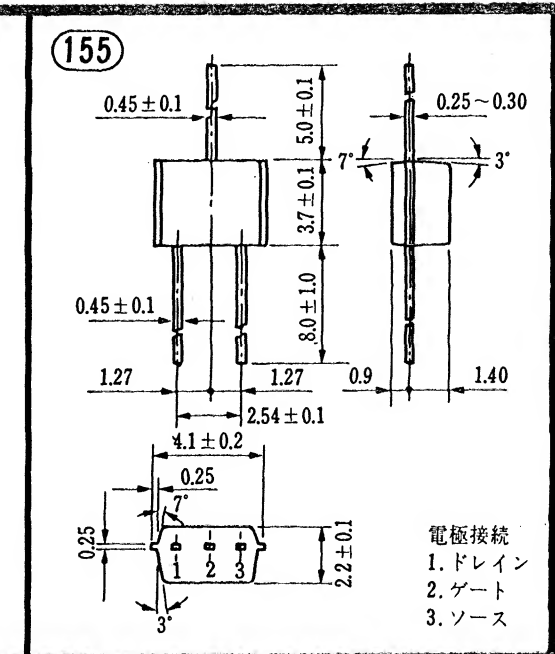
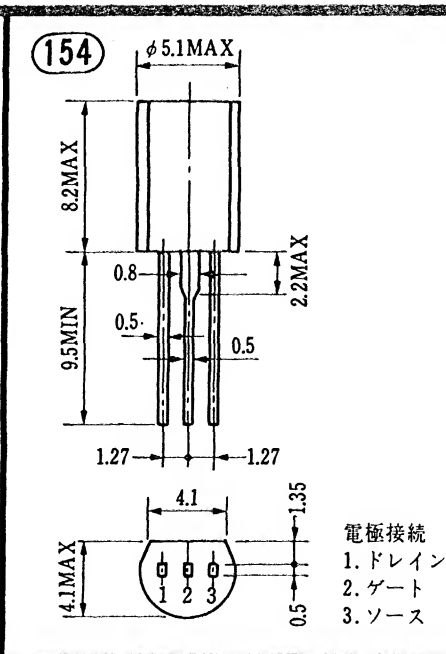
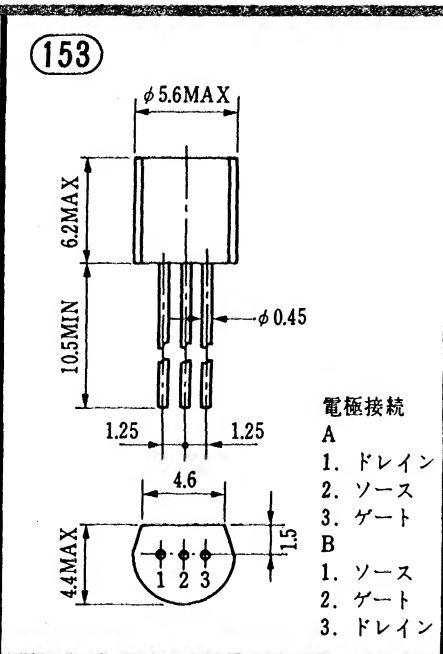
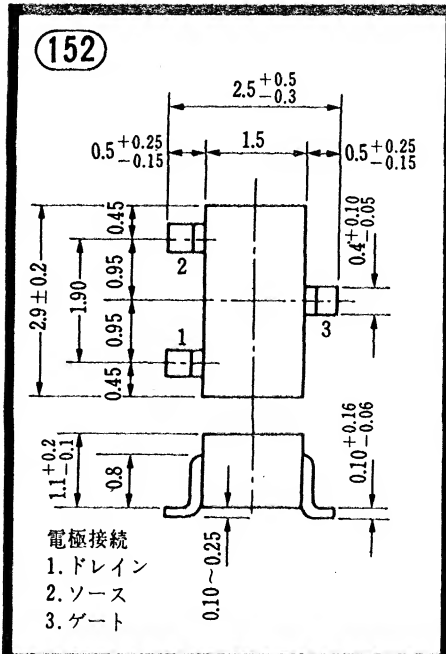


150

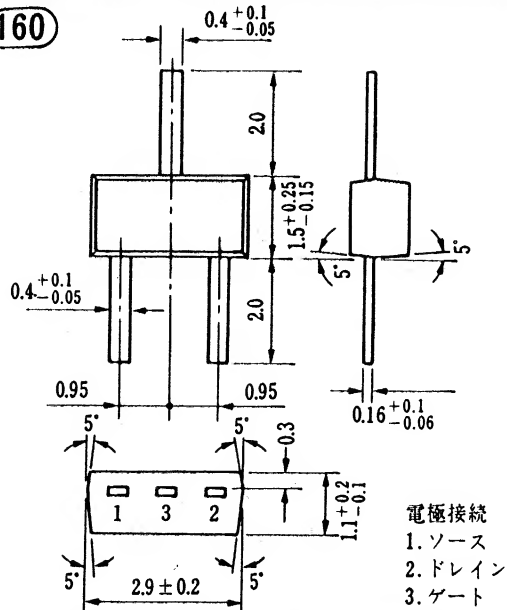


151



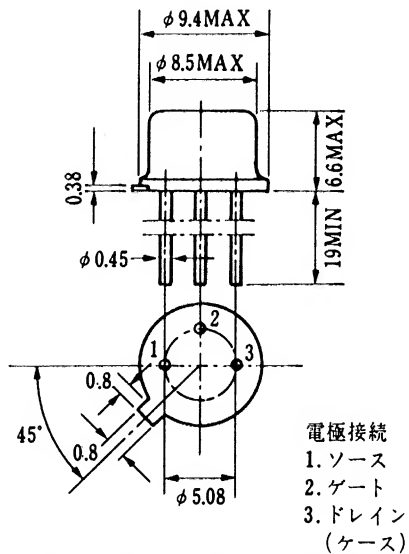


160



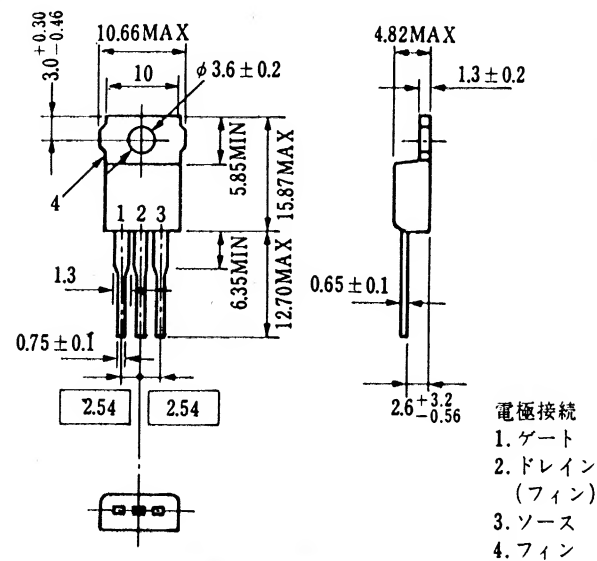
電極接続  
1. ソース  
2. ドレイン  
3. ゲート

161



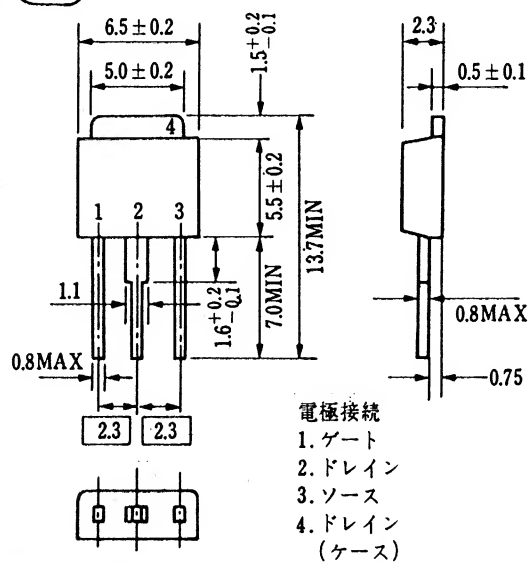
電極接続  
1. ソース  
2. ゲート  
3. ドレイン  
(ケース)

162



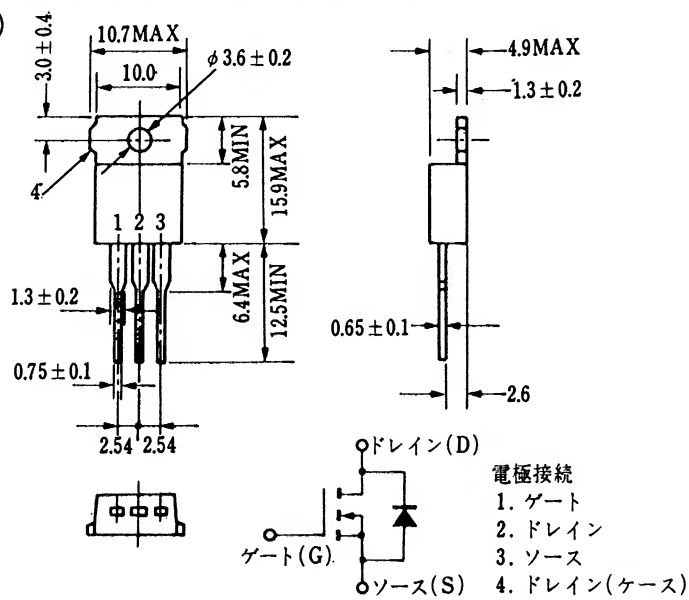
電極接続  
1. ゲート  
2. ドレイン  
(フィン)  
3. ソース  
4. フィン

163



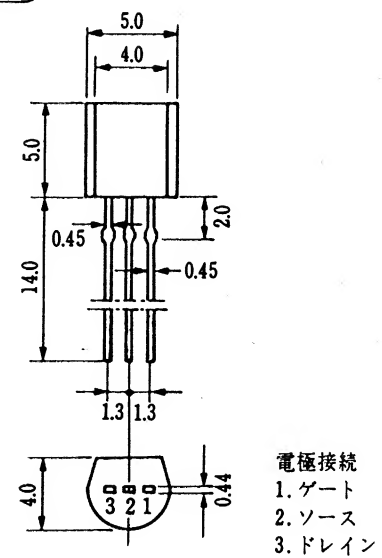
電極接続  
1. ゲート  
2. ドレイン  
3. ソース  
4. ドレイン  
(ケース)

164

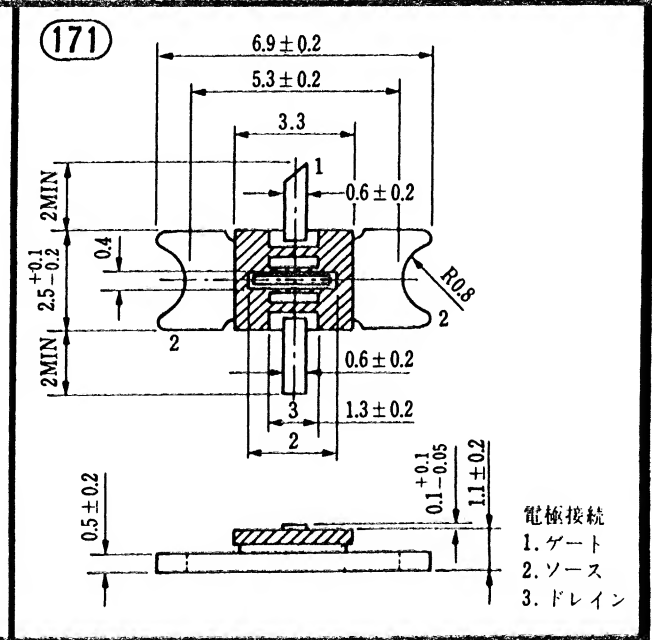
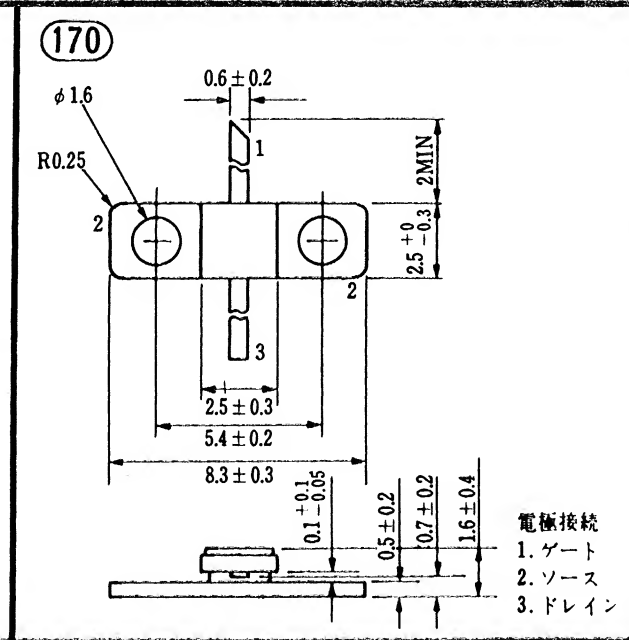
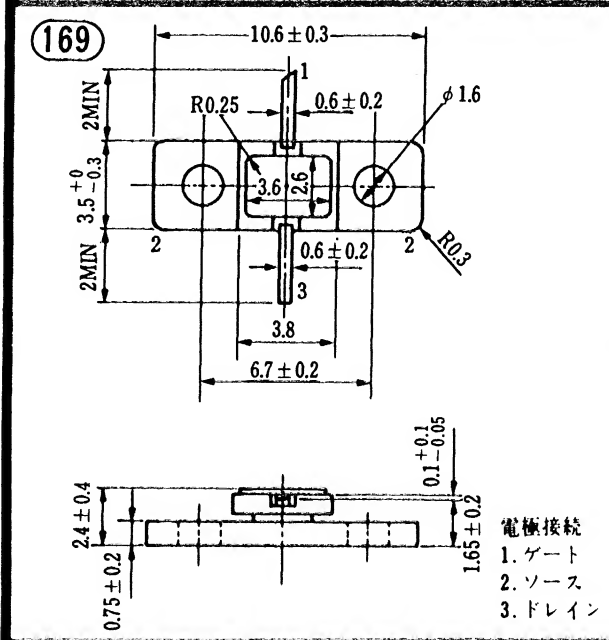
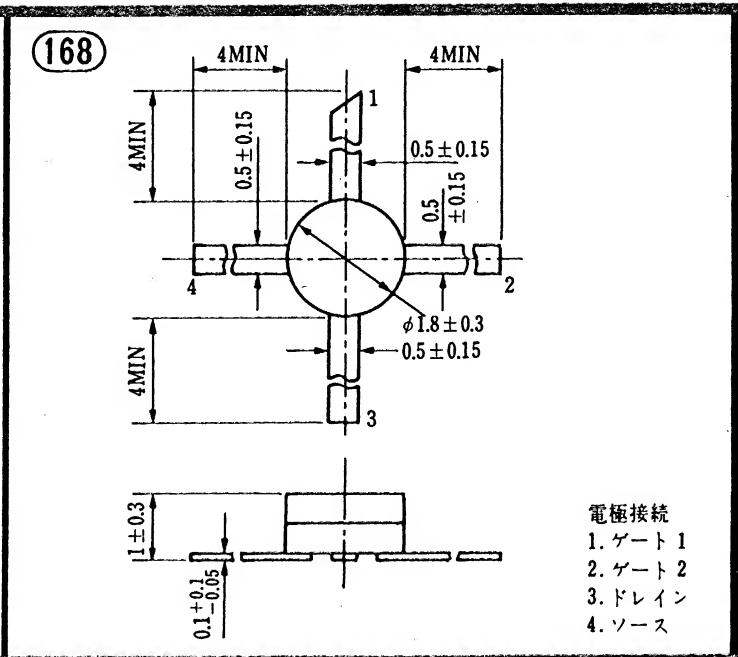
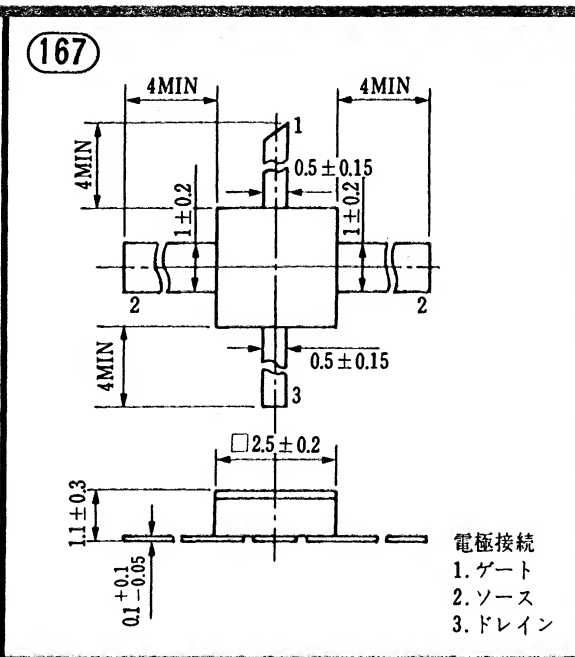
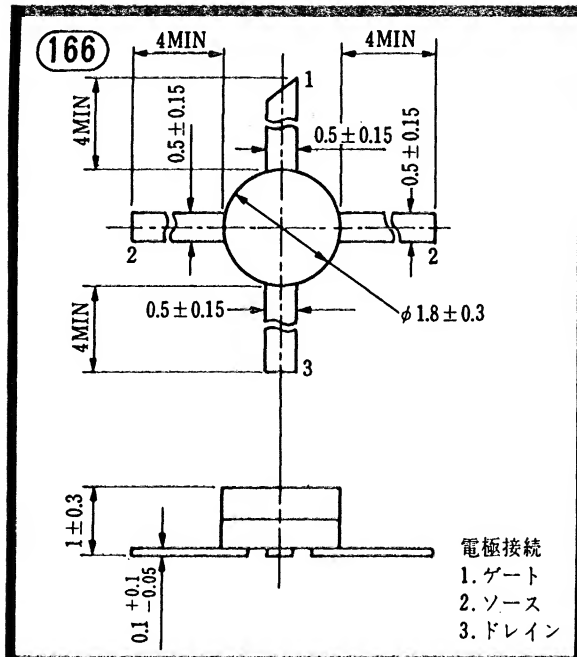


電極接続  
1. ゲート  
2. ドレイン  
3. ソース  
4. ドレイン(ケース)

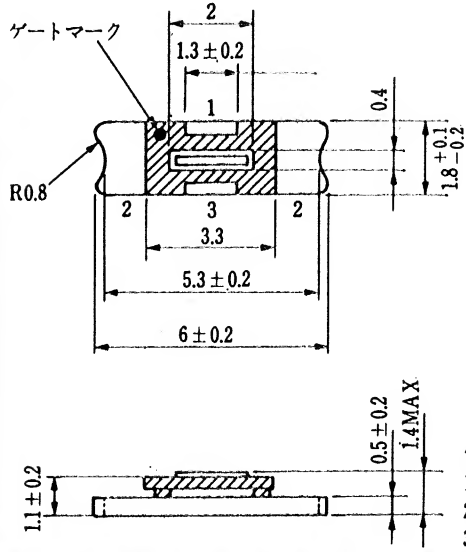
165



電極接続  
1. ゲート  
2. ソース  
3. ドレイン



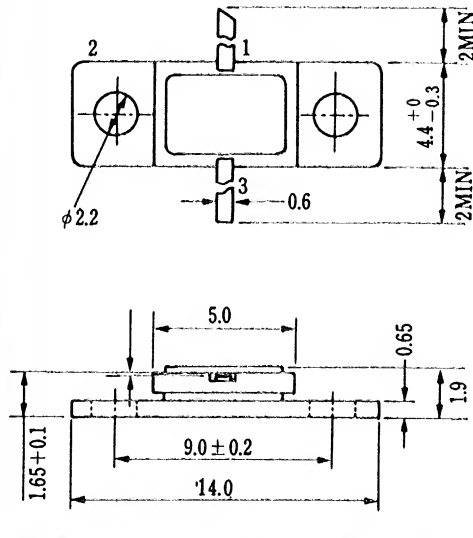
172



電極接続

1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン

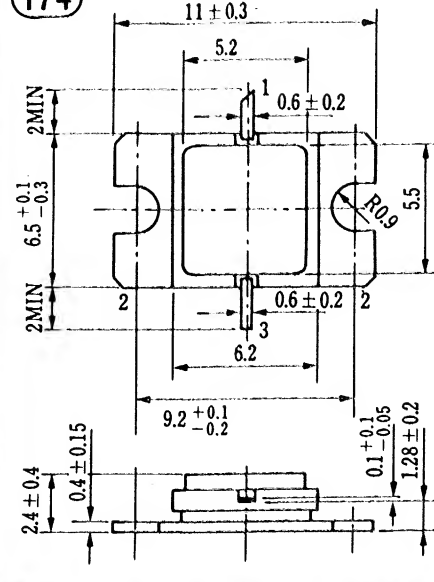
173



電極接続

1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン

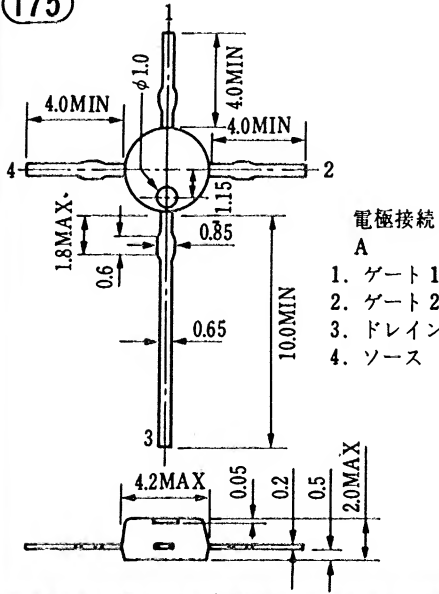
174



電極接続

1. ゲート
2. ソース
3. ドレイン

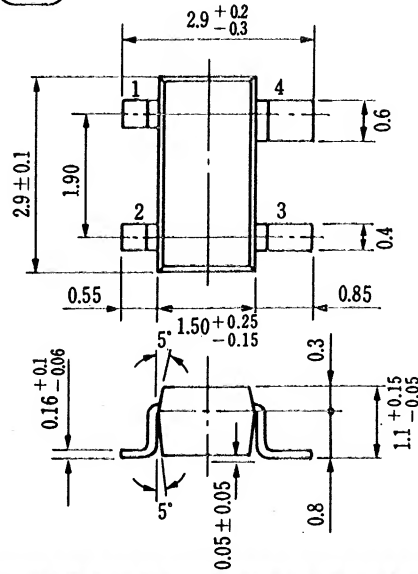
175



電極接続

- |          |      |
|----------|------|
| A        | B    |
| 1. ゲート 1 | ゲート  |
| 2. ゲート 2 | ソース  |
| 3. ドレイン  | ドレイン |
| 4. ソース   | ソース  |

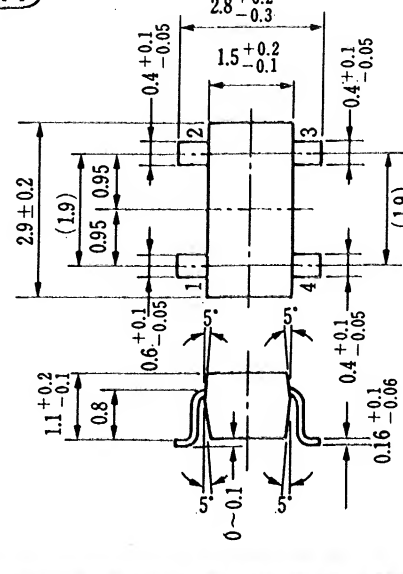
176



電極接続

1. ゲート 1
2. ゲート 2
3. ドレイン
4. ソース

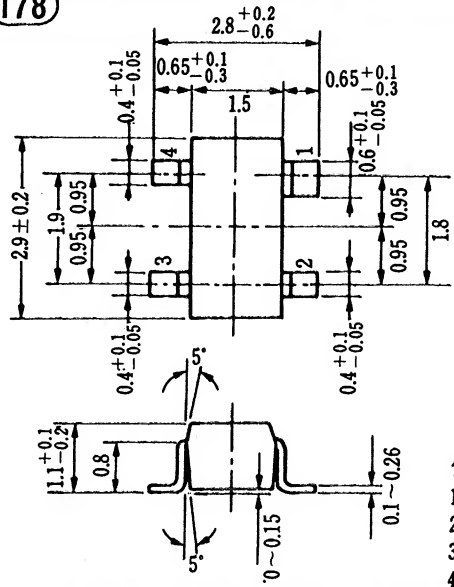
177



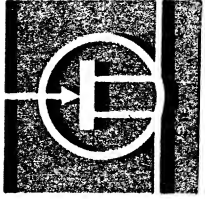
電極接続

1. ソース
2. ドレイン
3. ゲート 2
4. ゲート 1

178







個別特性図

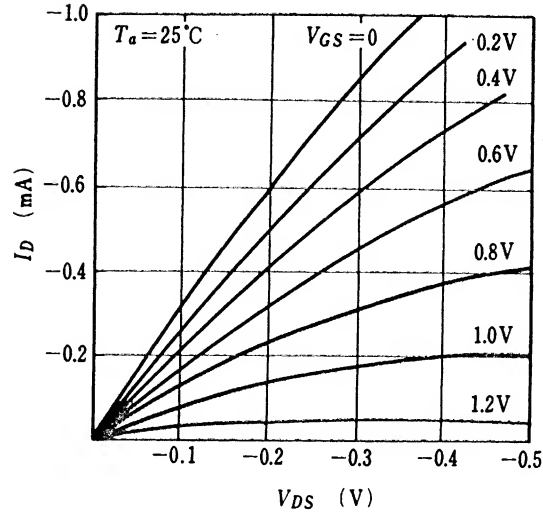
# 2SJ40, 125

Si 接合型  
Pチャンネル

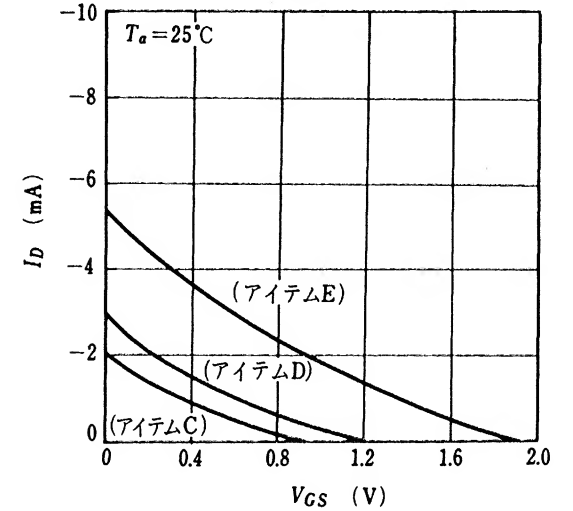
三 菱

アイテム	C	D	E
$I_{DSS}$ (mA)	1.0~3.0	2.5~6.0	5.0~12

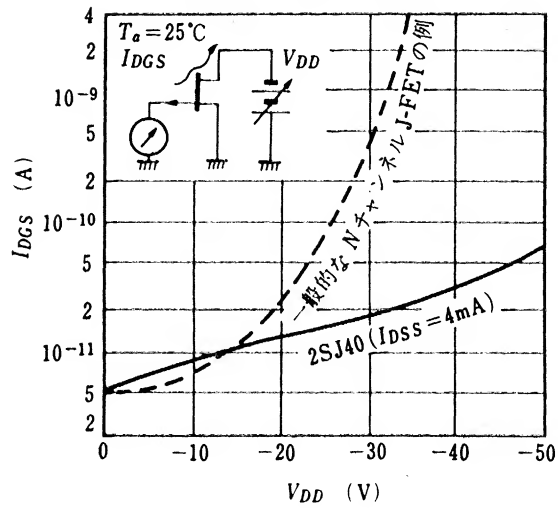
ソース接地出力特性



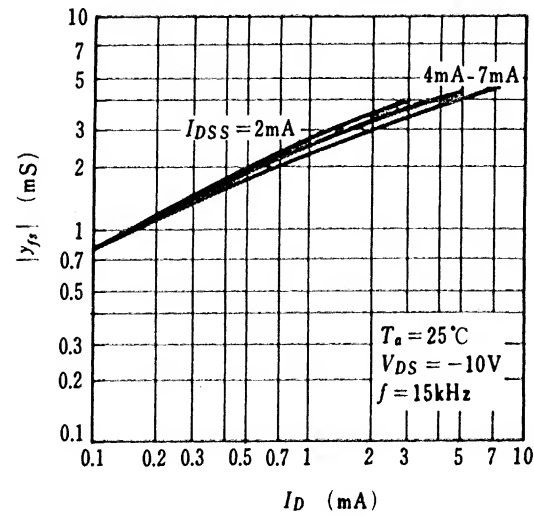
ソース接地伝達特性



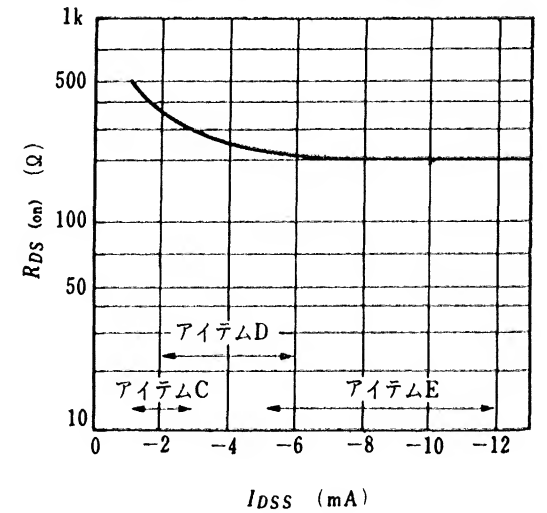
$I_{DGS} - V_{DD}$  特性



$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - I_{DSS}$  特性



# 2SJ43

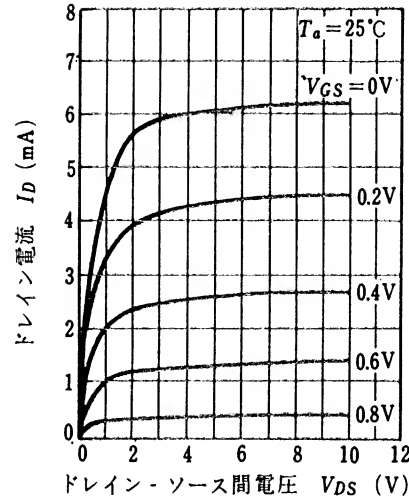
## Si 接合型 Pチャンネル

松下

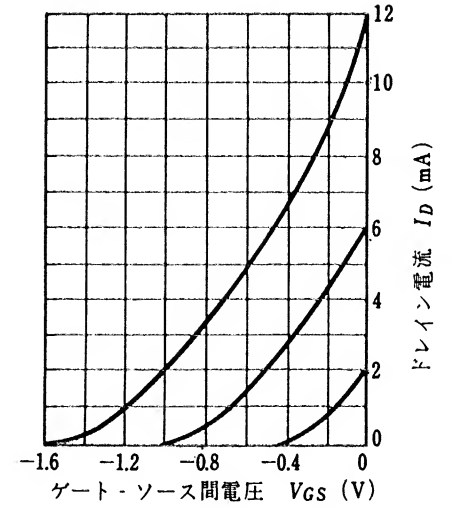
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~3	2~6	4~12

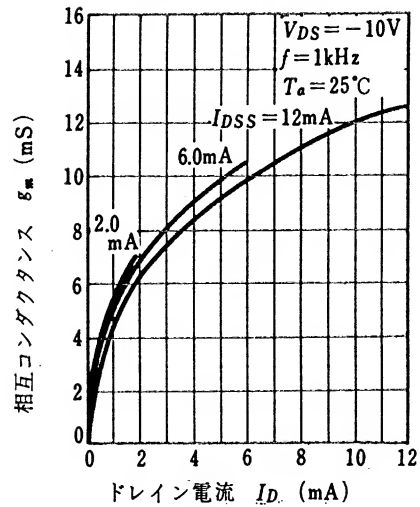
$I_D - V_{DS}$  特性



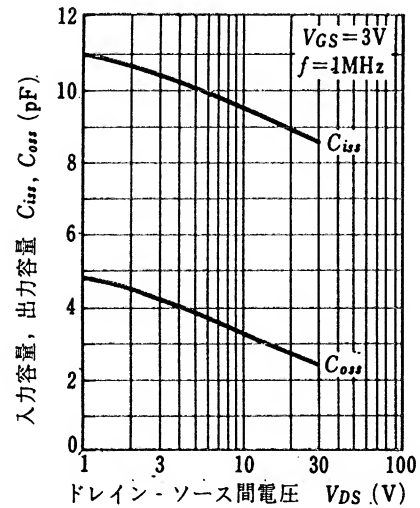
$I_D - V_{GS}$  特性



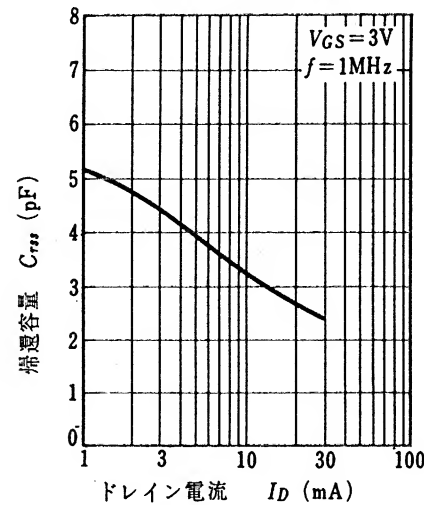
$g_m - I_D$  特性



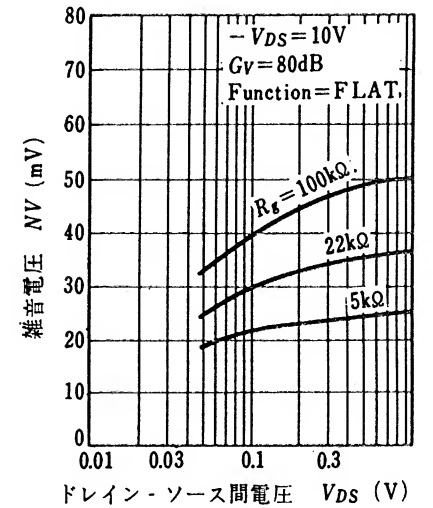
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$NV - I_D$  特性

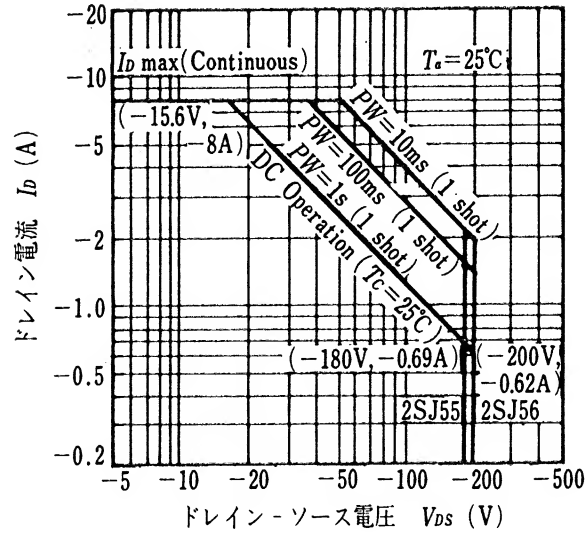


# 2SJ55, 56, 56(H)

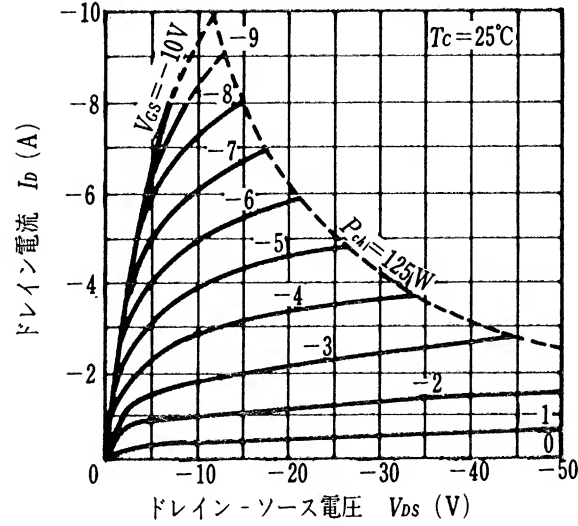
Si MOS型  
Pチャンネル

日 立

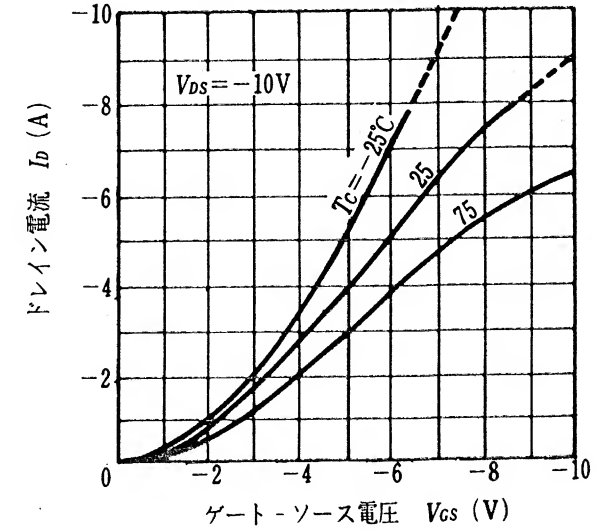
安全動作領域



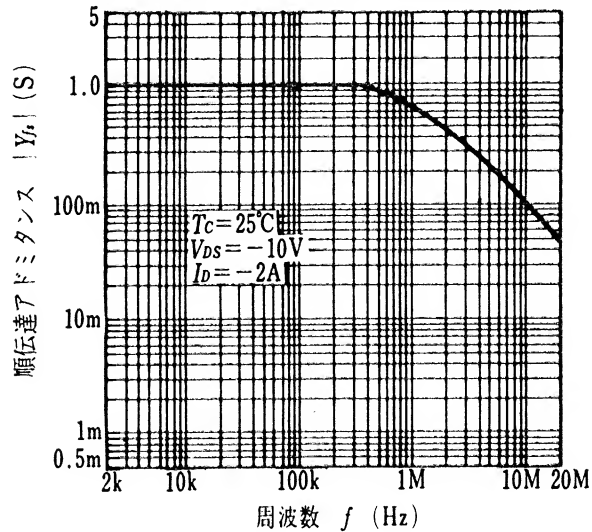
ソース接地出力静特性



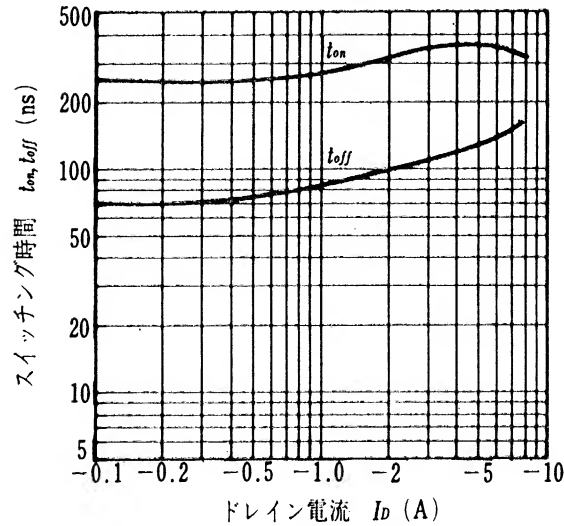
ソース接地伝達静特性



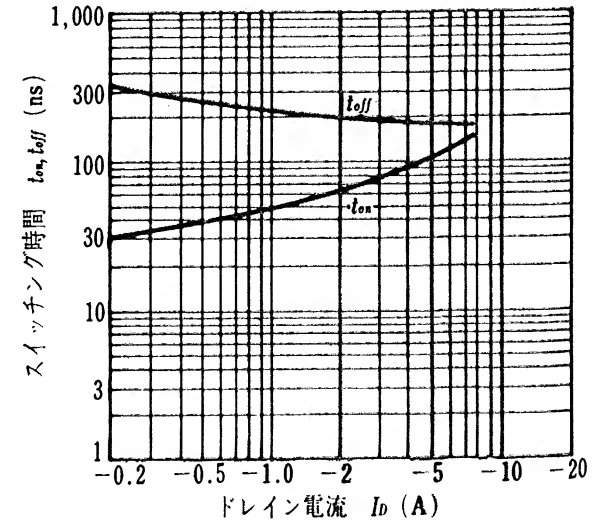
順伝達アドミタンス対周波数特性



2SJ55, 56 スイッチング時間対ドレイン電流特性



2SJ56(H) スイッチング時間対ドレイン電流特性



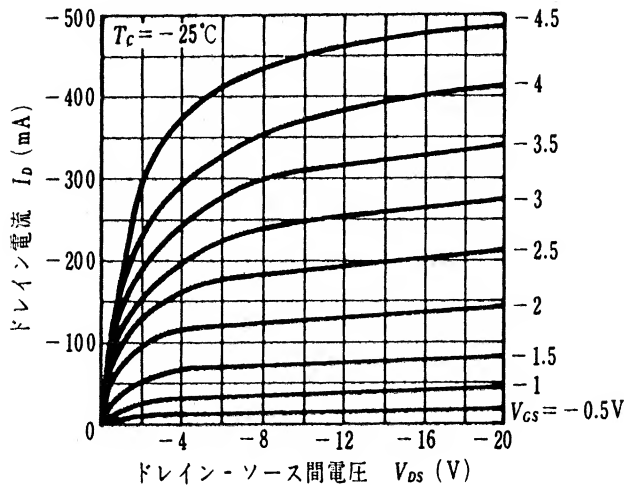


# 2SJ76, 77, 77(K), 78, 79, 79(K)

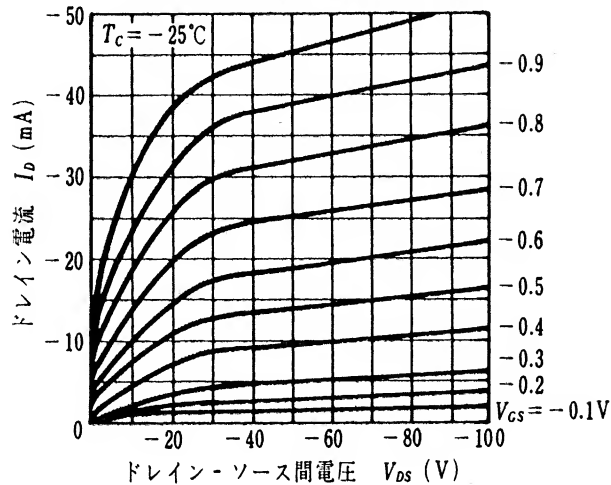
Si MOS型  
Pチャンネル

日立

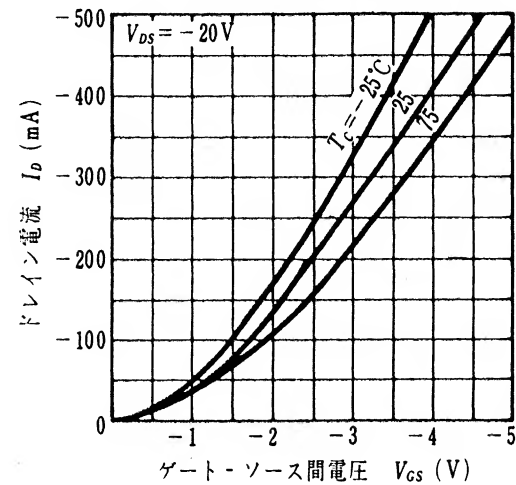
ソース接地出力静特性 (1)



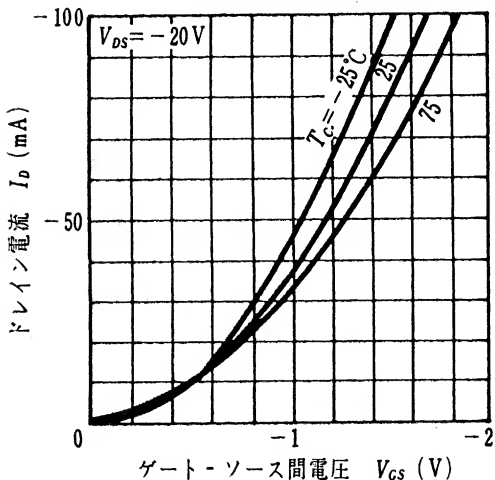
ソース接地出力静特性 (2)



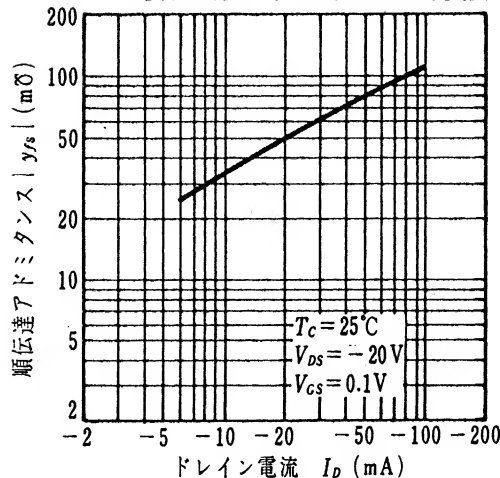
ソース接地伝達静特性 (1)



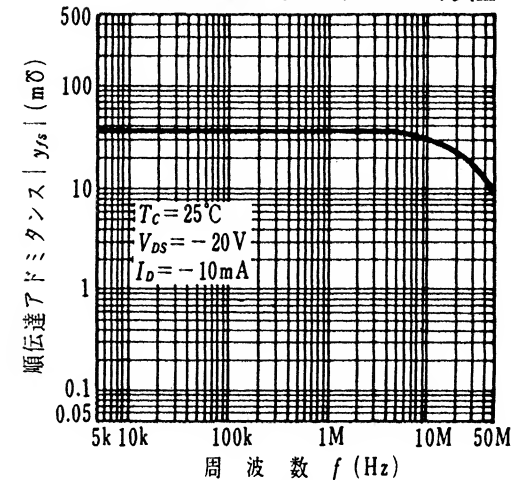
ソース接地伝達静特性 (2)



ドレイン電流 -  
順伝達アドミタンス特性



周波数 -  
順伝達アドミタンス特性



# 2SJ84

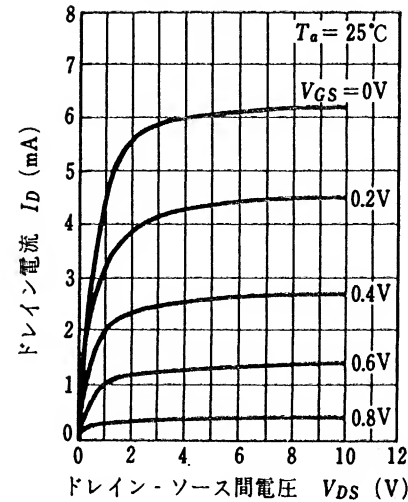
Si 接合型  
Pチャンネル

松下

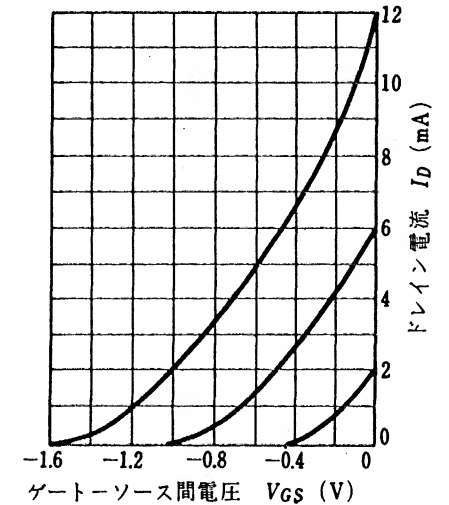
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~3	2~6	4~12
Marking Symbol	1MP	1MQ	1MR

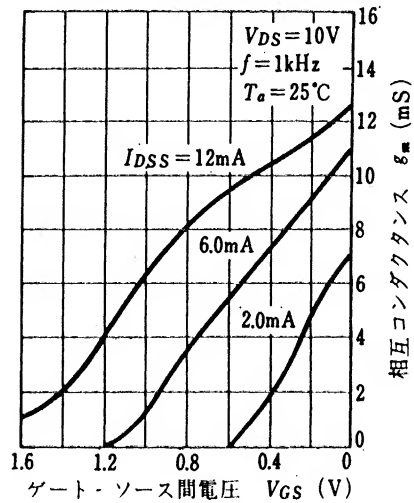
$I_D - V_{DS}$  特性



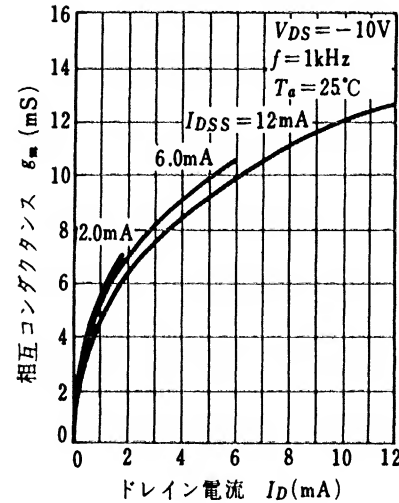
$I_D - V_{GS}$  特性



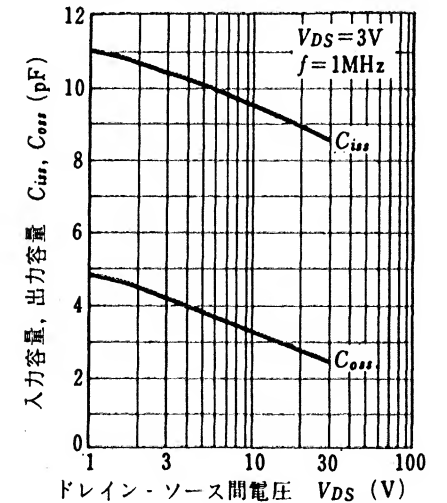
$g_m - V_{GS}$  特性



$g_m - I_D$  特性



$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



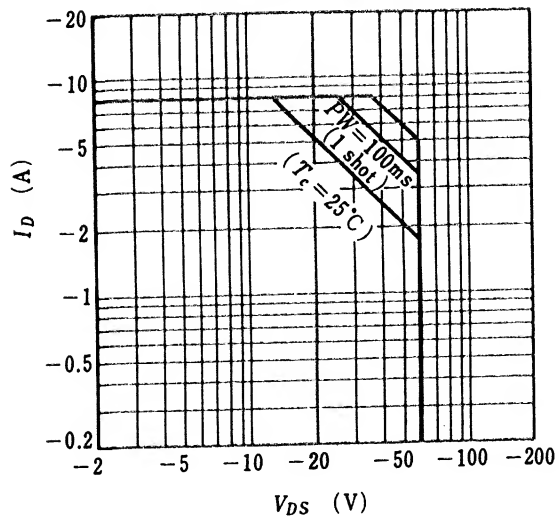


# 2SJ96

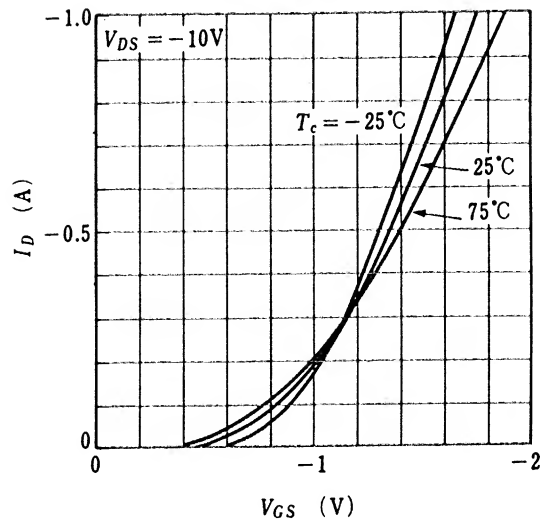
## Si MOS型 Pチャンネル

日立

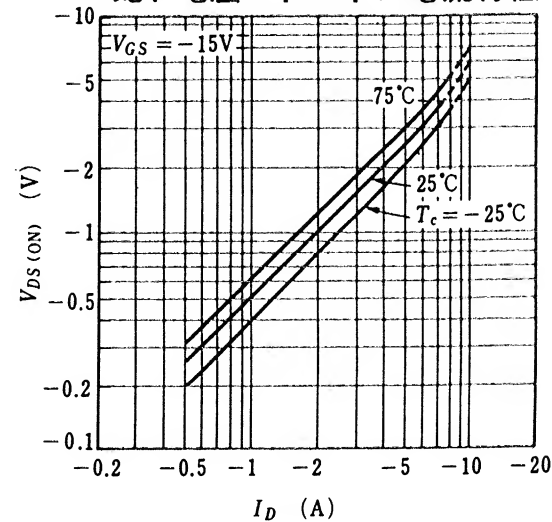
### 安全動作領域



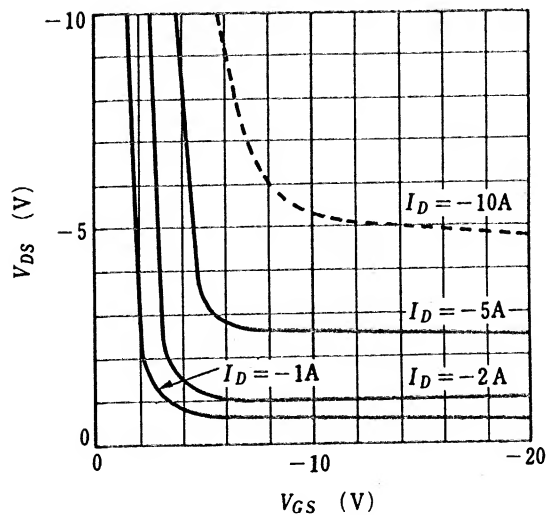
### 伝達特性



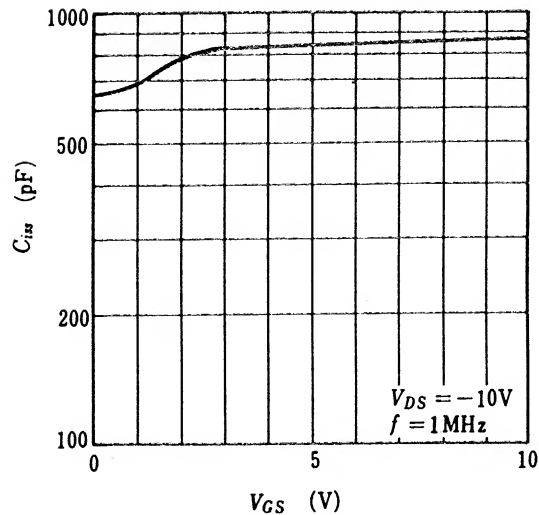
### ドレイン-ソース間 飽和電圧-ドレイン電流特性



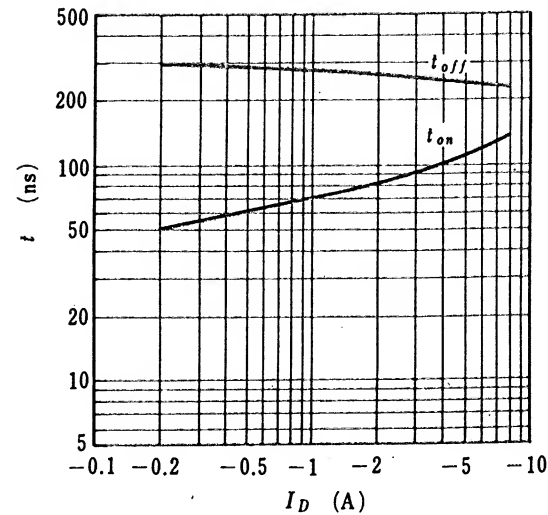
### Vds - Vgs 特性



### Ciss - Vgs 特性



### スイッチング特性



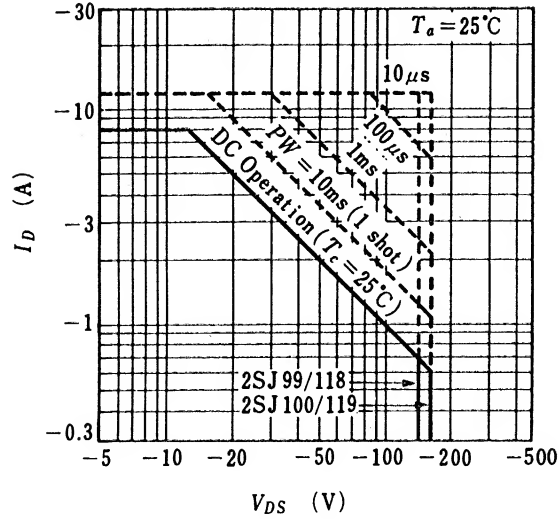


# 2SJ99, 100, 118, 119

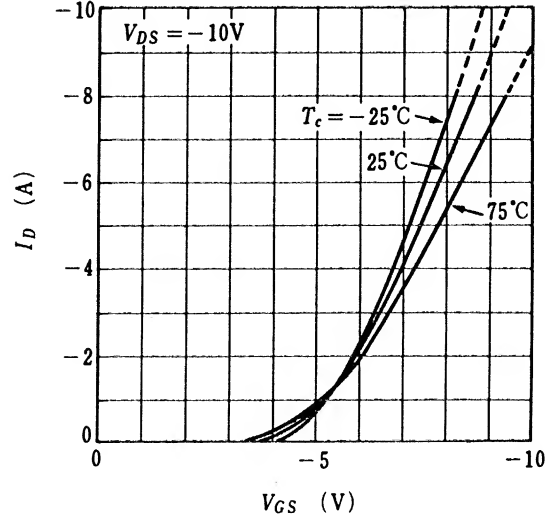
Si MOS 型  
Pチャンネル

日 立

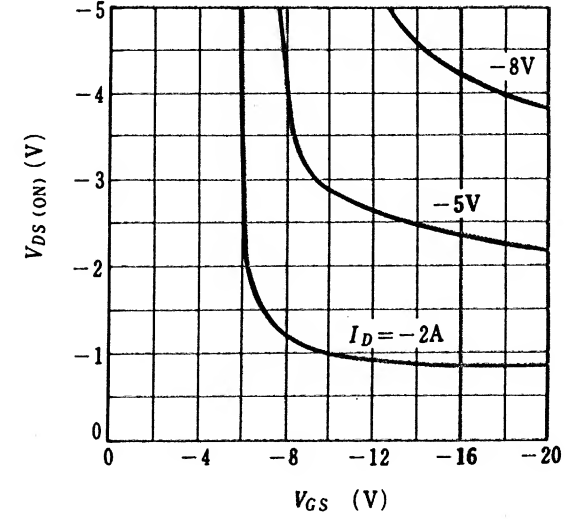
安全動作領域



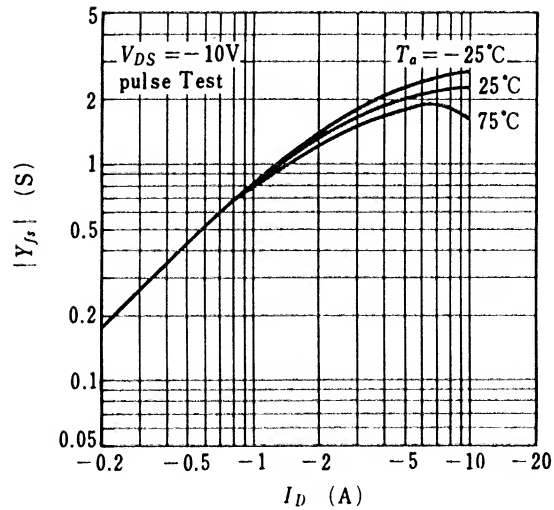
伝達特性



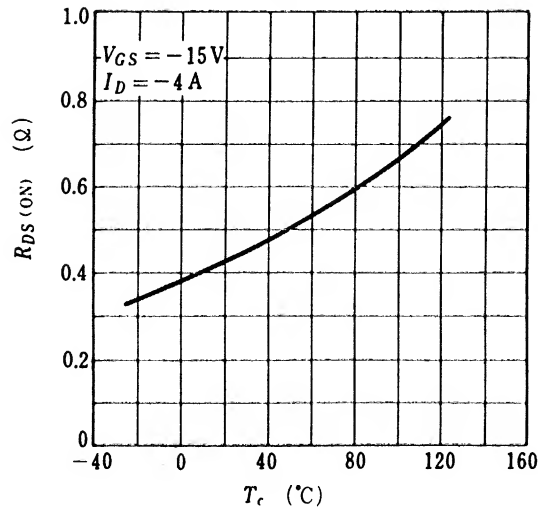
VDS (ON) - VGS 特性



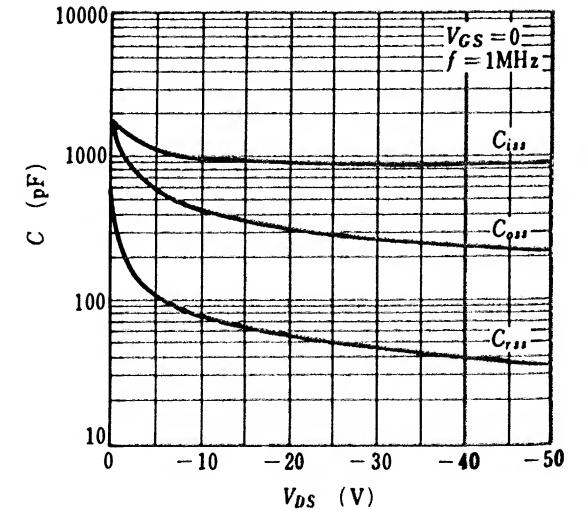
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性



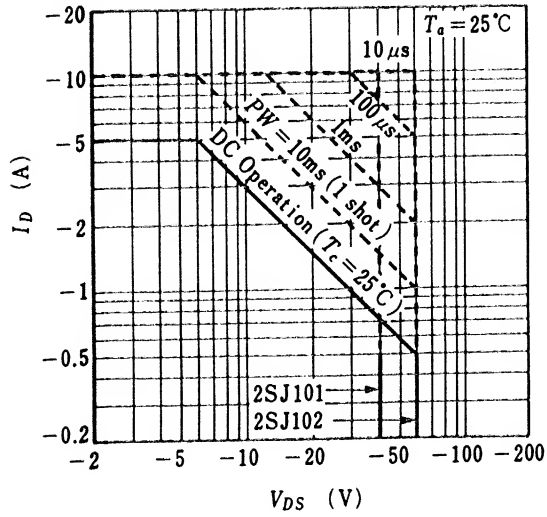


# 2SJ101, 102

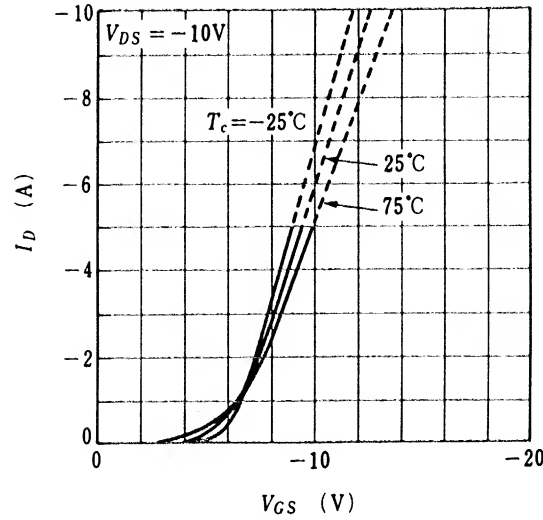
## Si MOS型 Pチャンネル

日 立

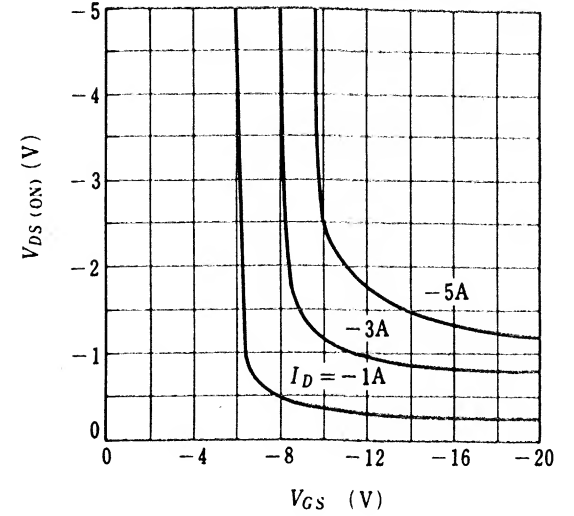
### 安全動作領域



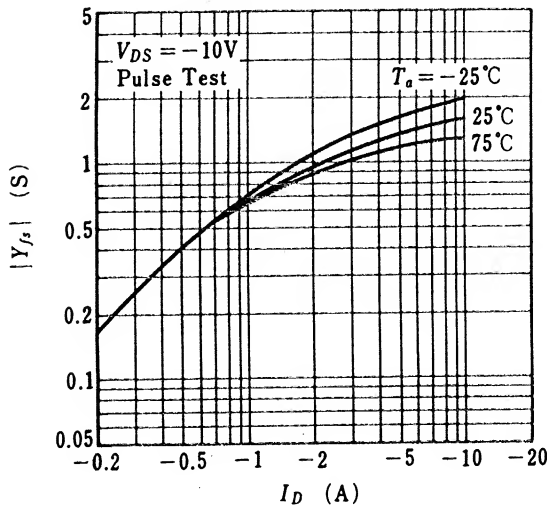
### $I_D - V_{GS}$ 特性



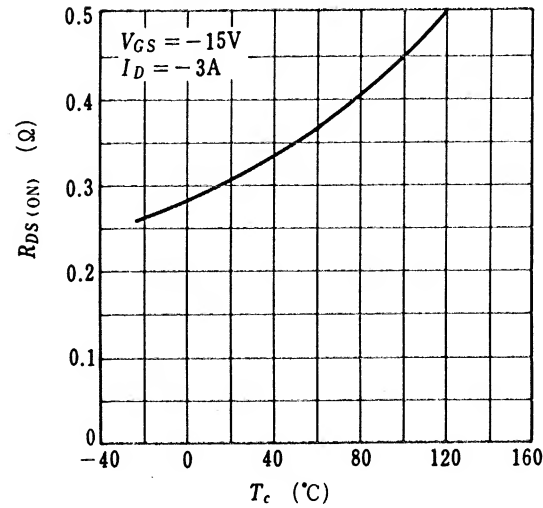
### $V_{DS(ON)} - V_{GS}$ 特性



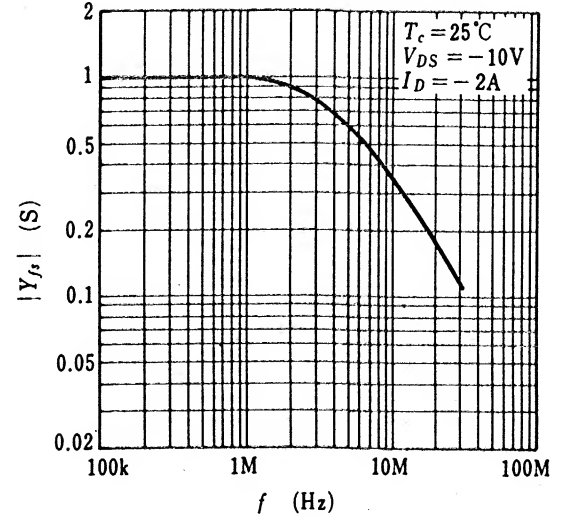
### $|Y_{fs}| - I_D$ 特性



### $R_{DS(ON)} - T_c$ 特性



### $|Y_{fs}| - f$ 特性



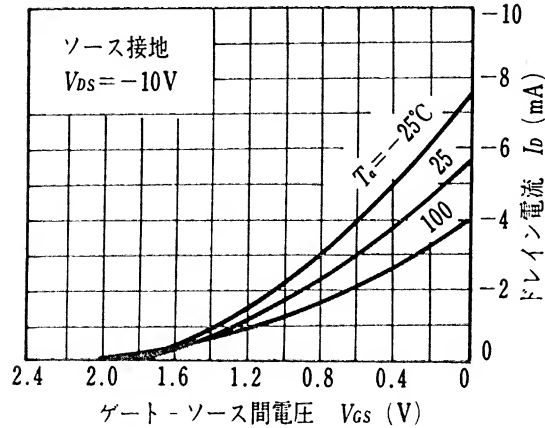
# 2SJ103, 105, 106

Si 接合型  
Pチャンネル

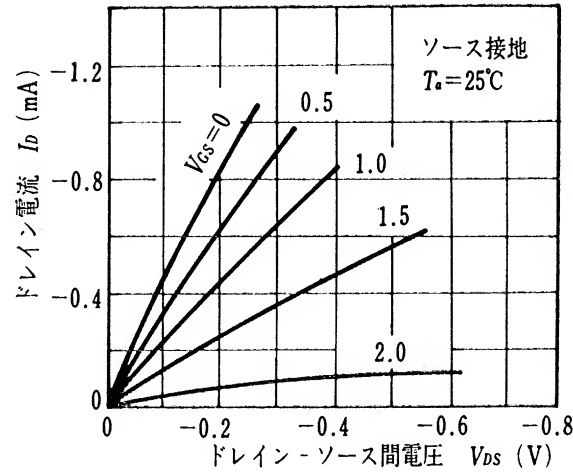
東 芝

$I_{DSS}$ 分類 Y:  $-1.2 \sim -3.0$  mA  
GR:  $-2.6 \sim -6.5$  mA  
BL:  $-6 \sim -14$  mA

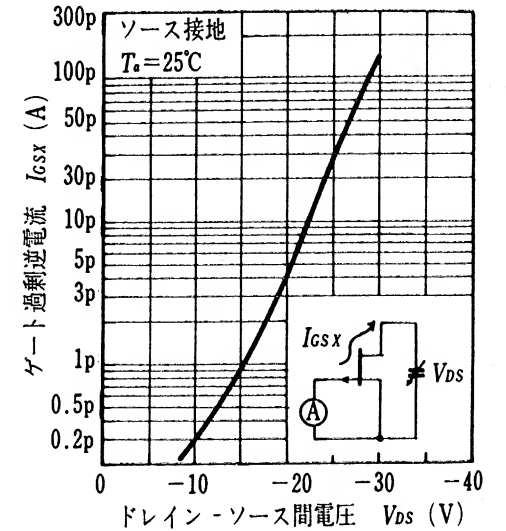
$I_D - V_{GS}$  特性



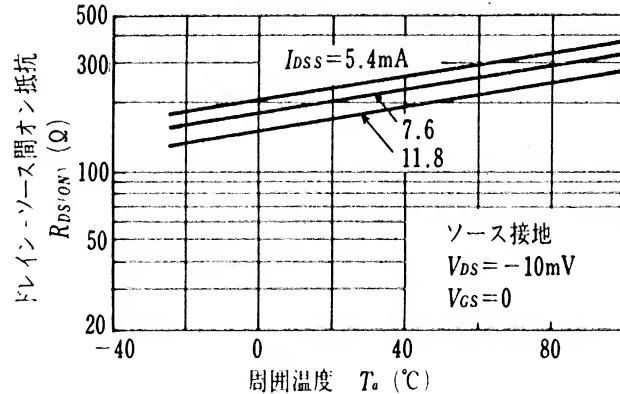
$I_D - V_{DS}$  (低電圧領域) 特性



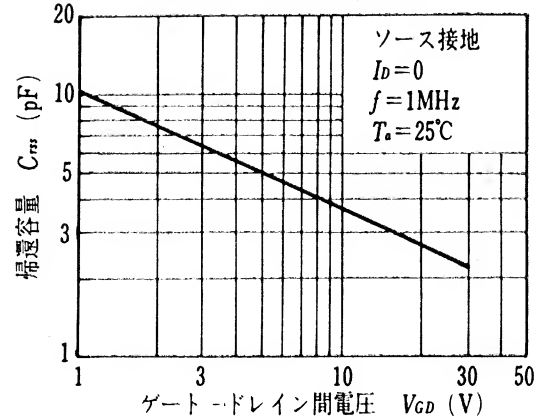
$I_{GSX} - V_{DS}$  特性



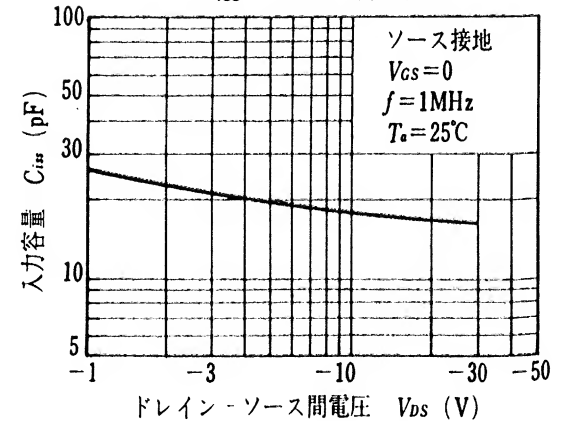
$R_{DS(ON)} - T_a$  特性



$C_{rss} - V_{GD}$  特性



$C_{iss} - V_{DS}$  特性

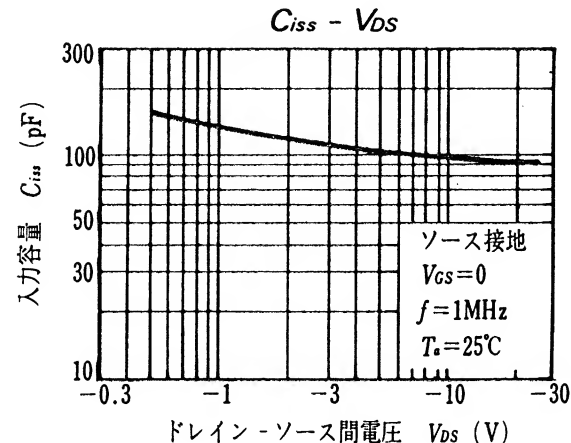
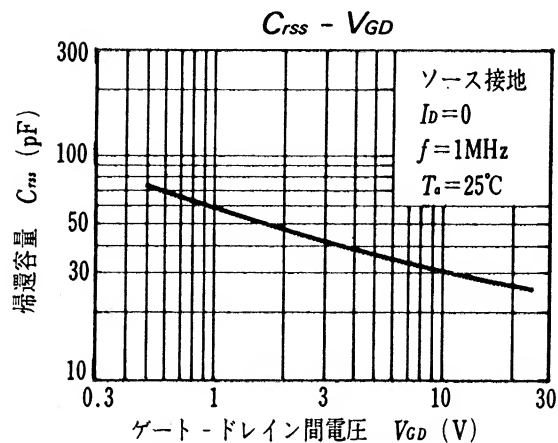
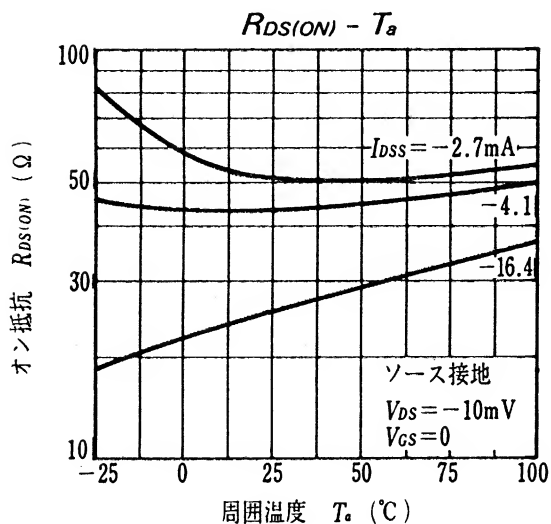
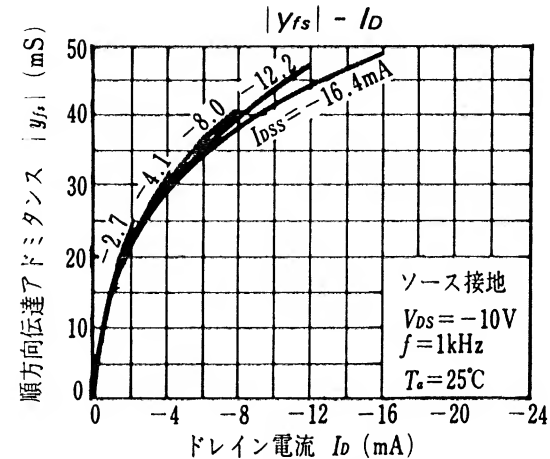
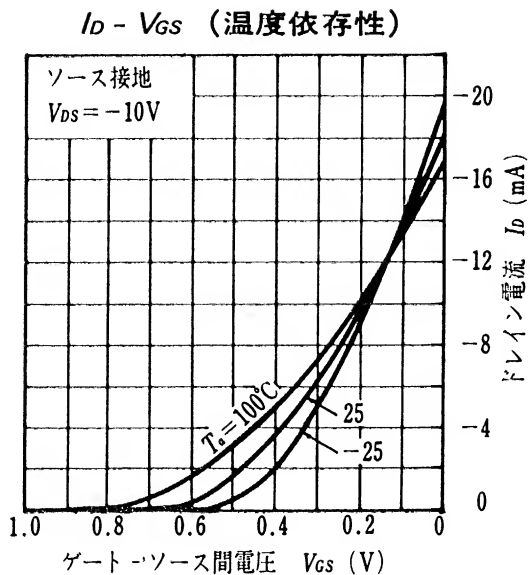
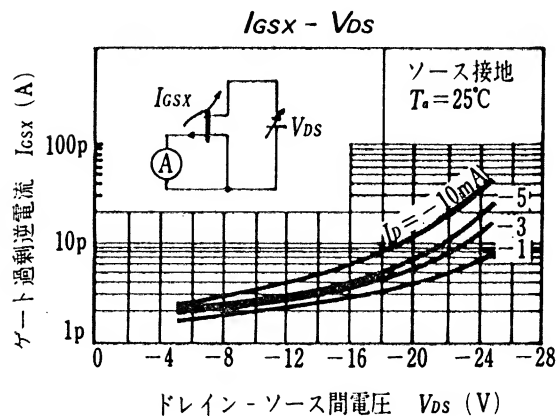


# 2SJ104, 107

Si 接合型  
Pチャンネル

東 芝

$I_{DSS}$ 分類 GR:  $-2.6 \sim -6.5$ , BL:  $-6 \sim -12$ ,  
V:  $-10 \sim -20$

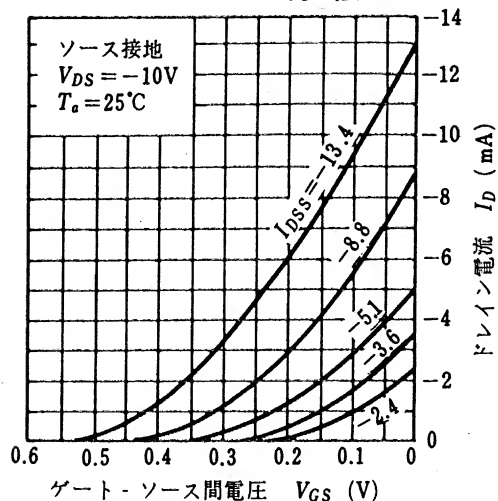


# 2SJ109

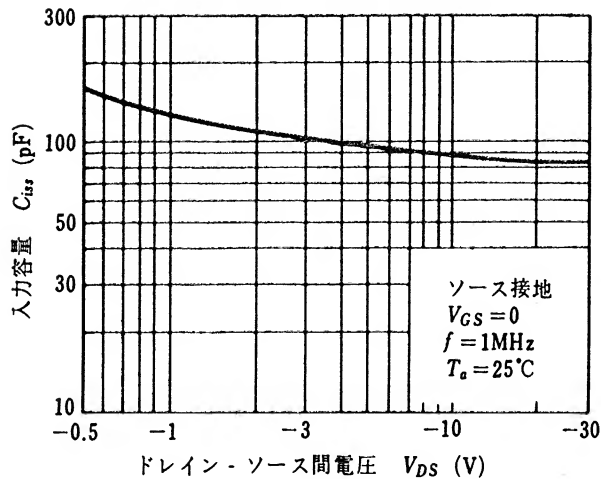
## Si 接合型 Pチャンネル

東 芝

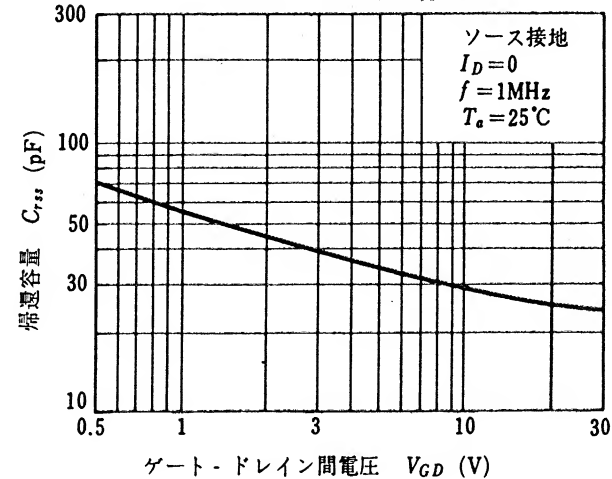
$I_D - V_{GS}$  特性



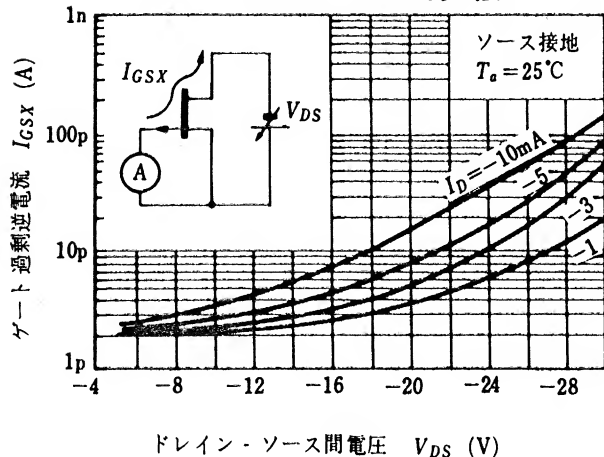
$C_{iss} - V_{DS}$  特性



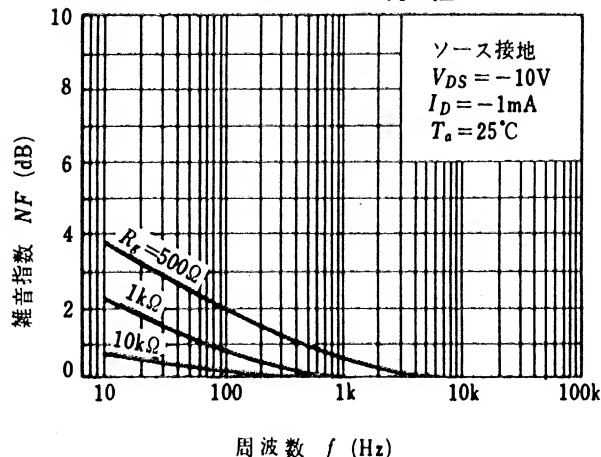
$C_{rss} - V_{GD}$  特性



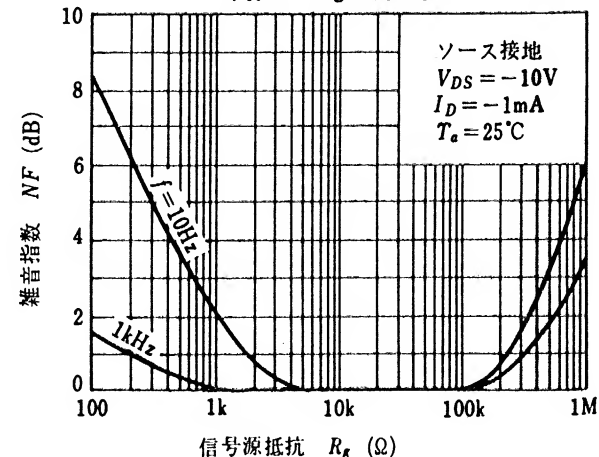
$I_{GSX} - V_{DS}$  特性



$NF - f$  特性



$NF - R_g$  特性



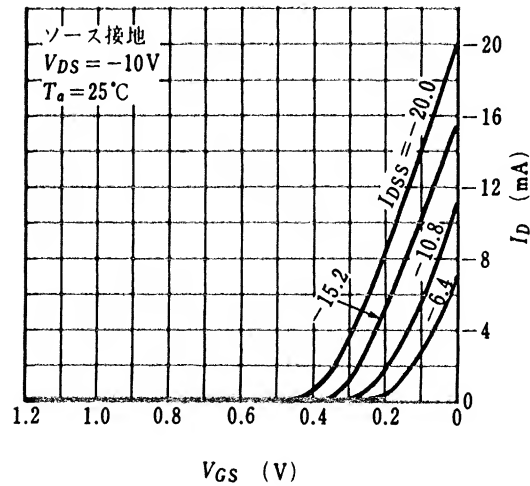
# 2SJ110, 111

## Si 接合型 Pチャンネル

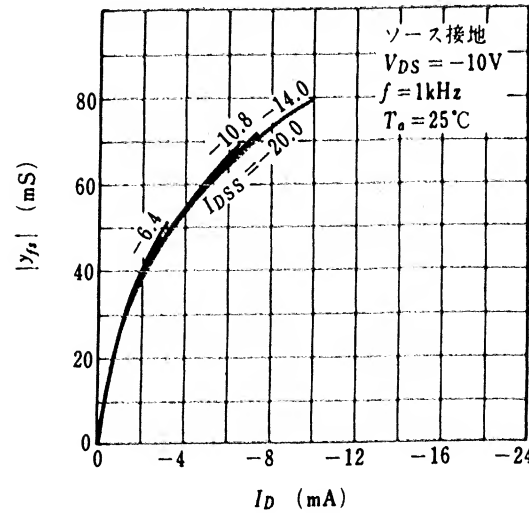
東 芝

$I_{DSS}$  分類 GR: -5.0~-10.0, BL: -8.0~-16.0, V: -14.0~-30.0

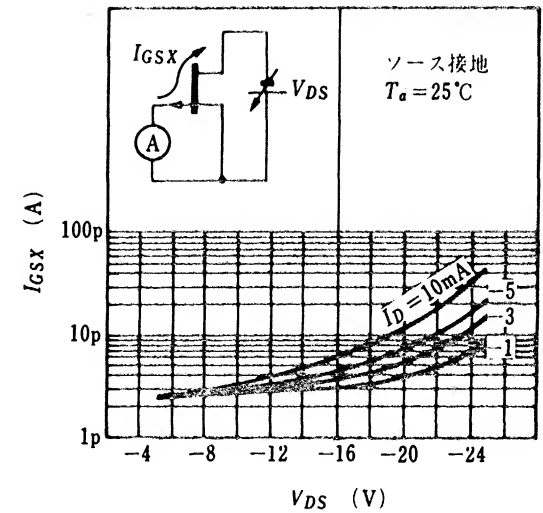
### $I_D - V_{GS}$ 特性



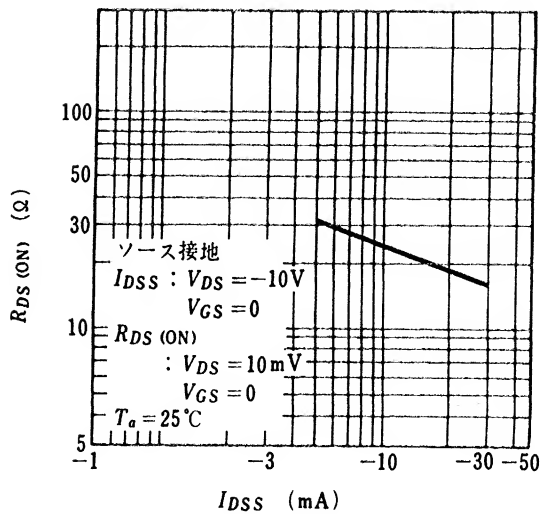
### $|Y_{fs}| - I_D$ 特性



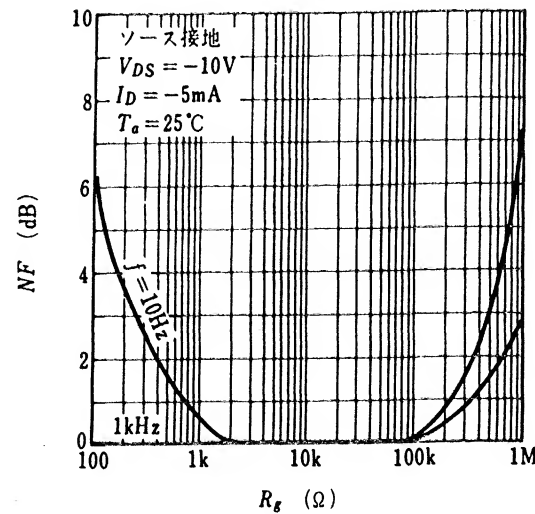
### $I_{GSX} - V_{DS}$ 特性



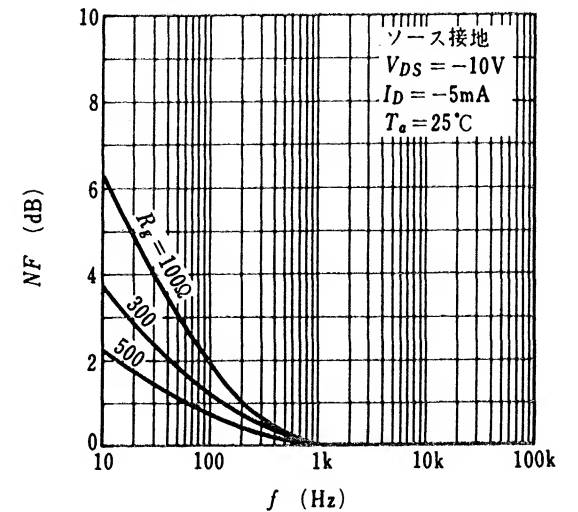
### $R_{DS(ON)} - I_{DSS}$ 特性 (2SJ110)



### NF - $R_g$ 特性 (2SJ111)



### NF - f 特性 (2SJ111)

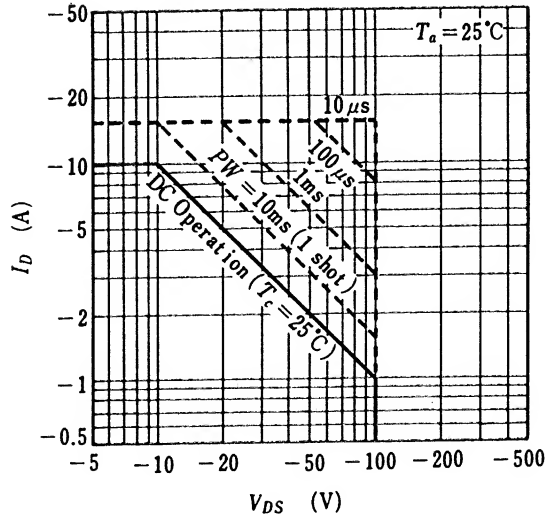


# 2SJ112, 113

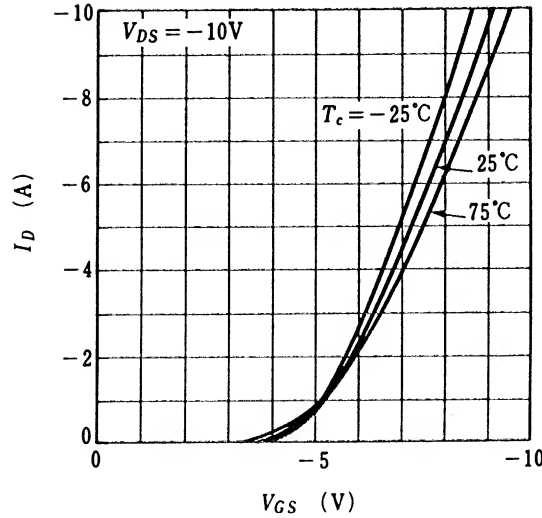
Si MOS 型  
Pチャンネル

日 立

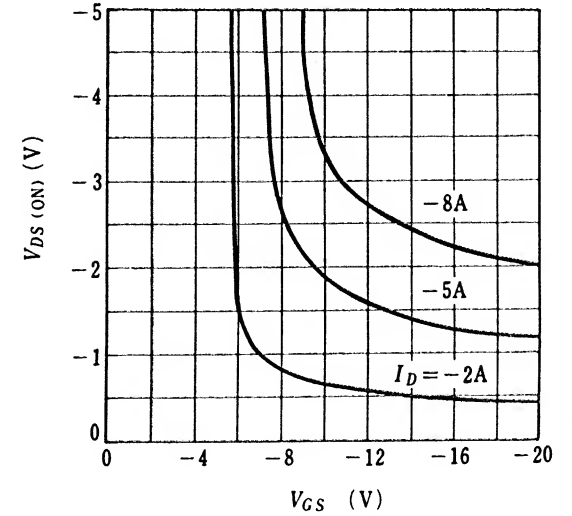
安全動作領域



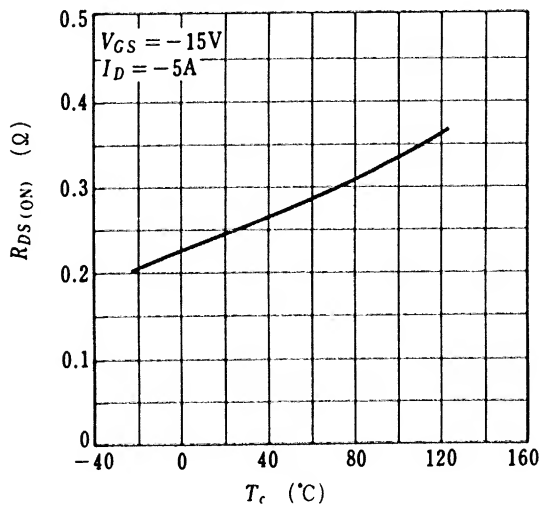
伝達特性



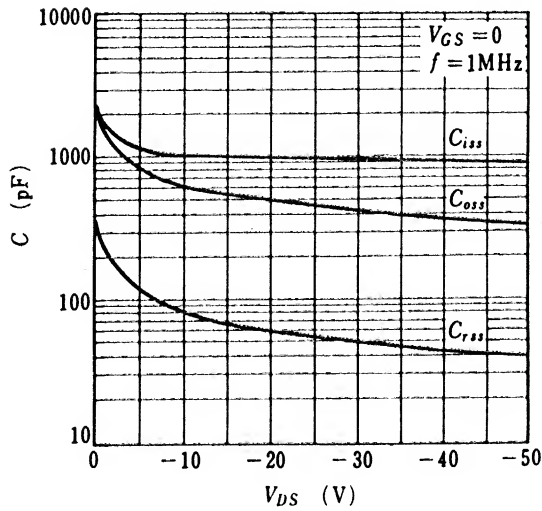
V\_DS(ON) - V\_GS 特性



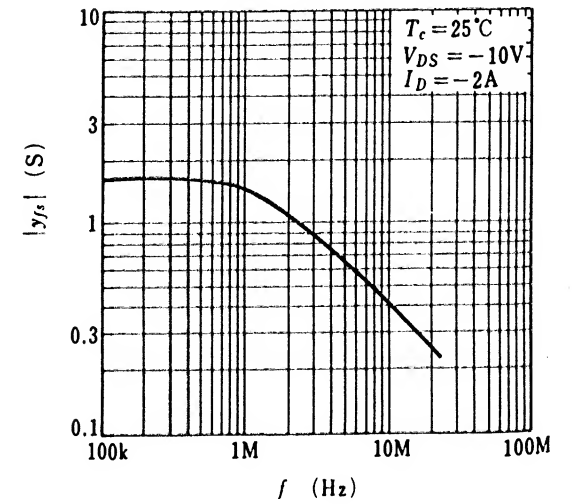
R\_DS(ON) - T\_c 特性



C\_iss, C\_oss, C\_rss - V\_DS 特性



|Y\_fs| - f 特性





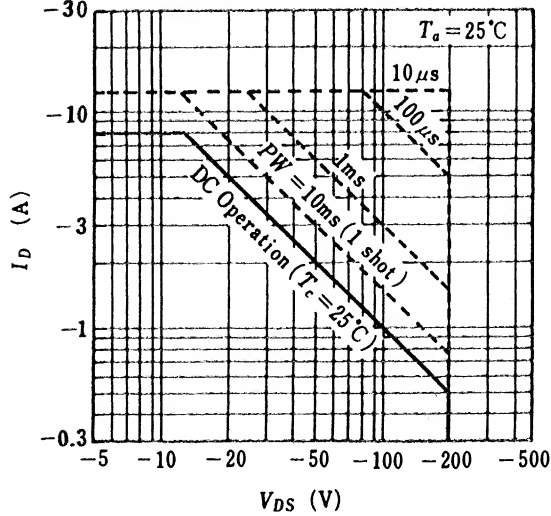


# 2SJ114

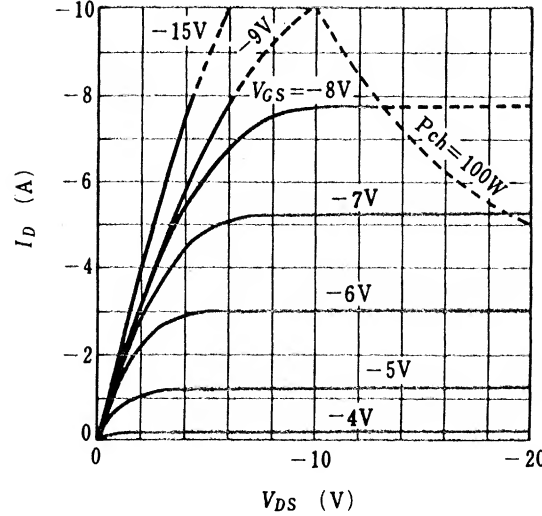
## Si MOS型 Pチャンネル

日 立

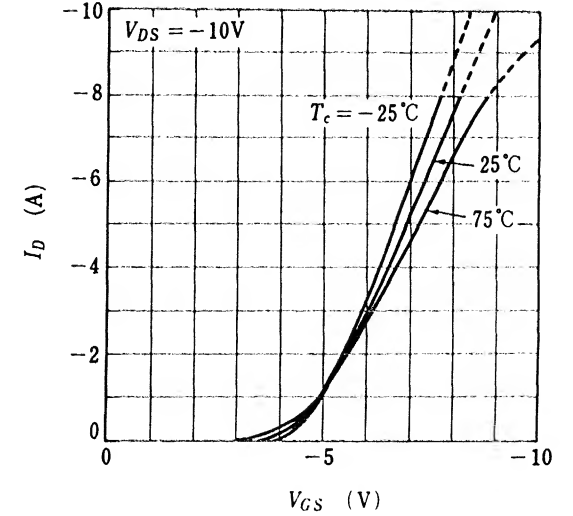
### 安全動作領域



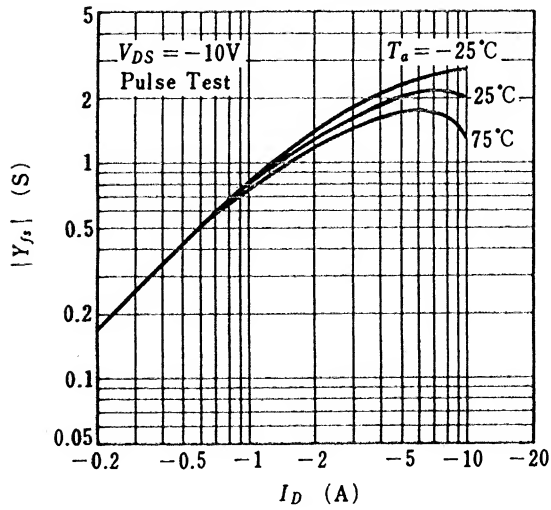
### $I_D - V_{DS}$ 特性



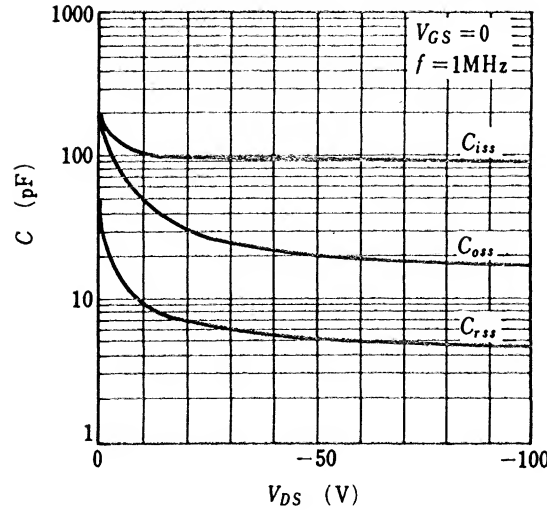
### $I_D - V_{GS}$ 特性



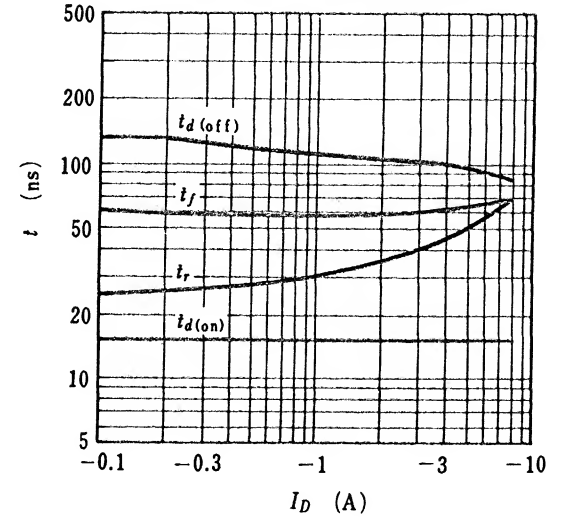
### $|Y_{fs}| - I_D$ 特性



### $C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$ 特性



### スイッチング特性

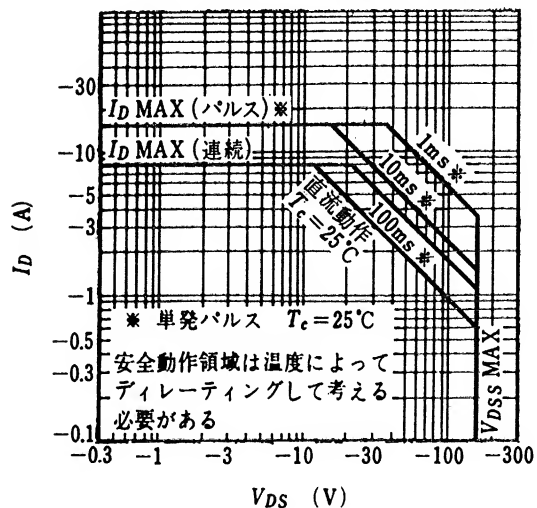


# 2SJ115

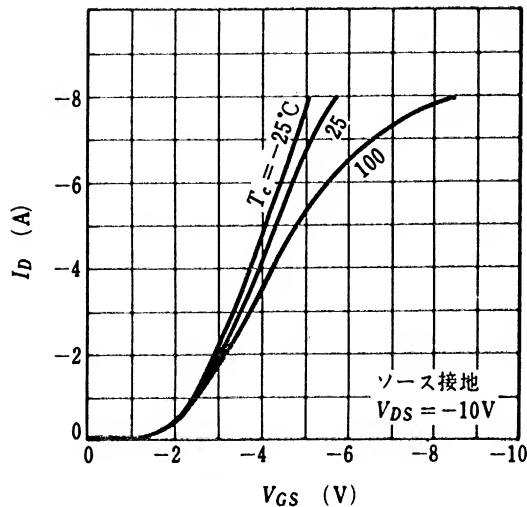
## Si MOS型 Pチャンネル

東 芝

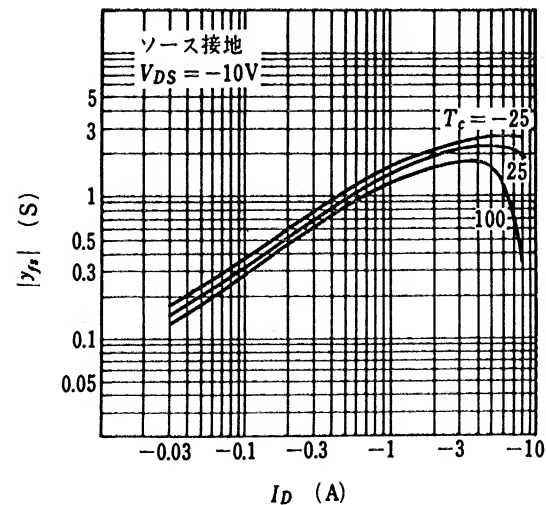
安全動作領域



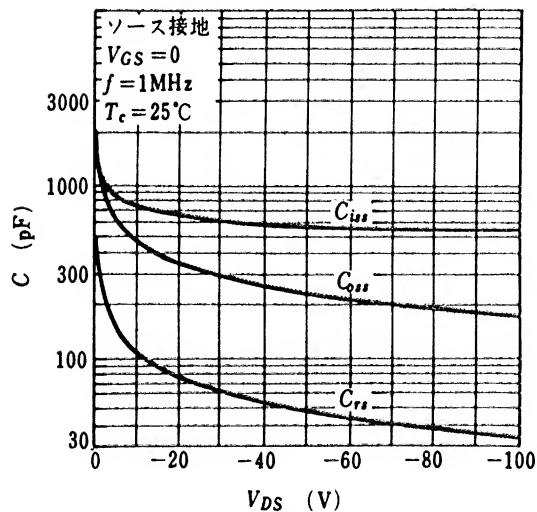
$I_D - V_{GS}$  特性



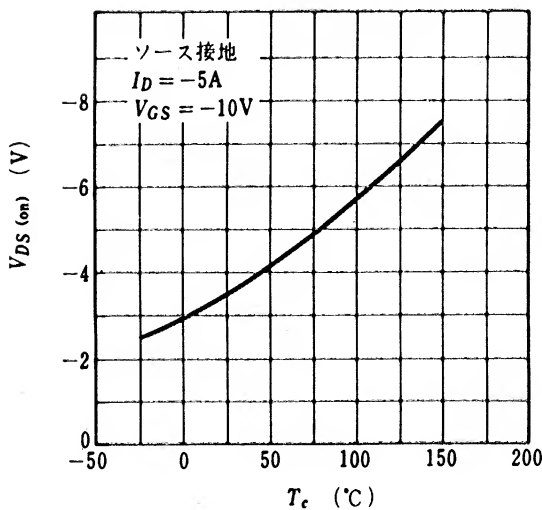
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



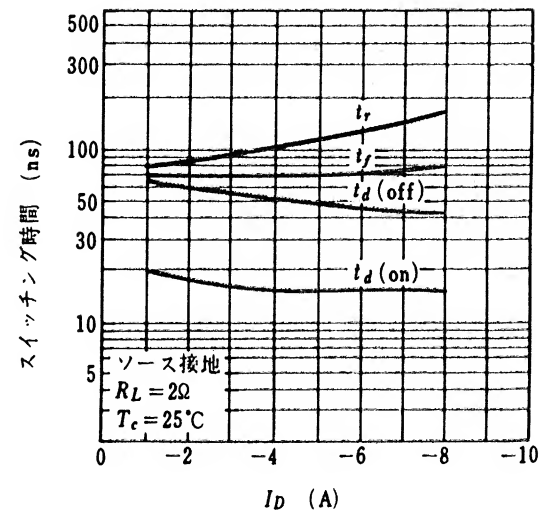
静電容量 -  $V_{DS}$  特性



$V_{DS(on)} - T_c$  特性



スイッチング特性

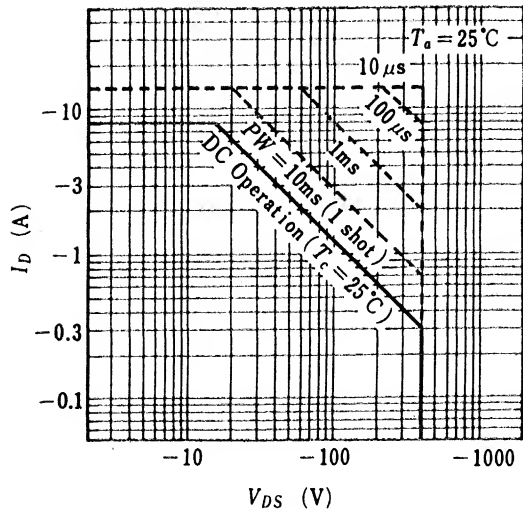


# 2SJ116

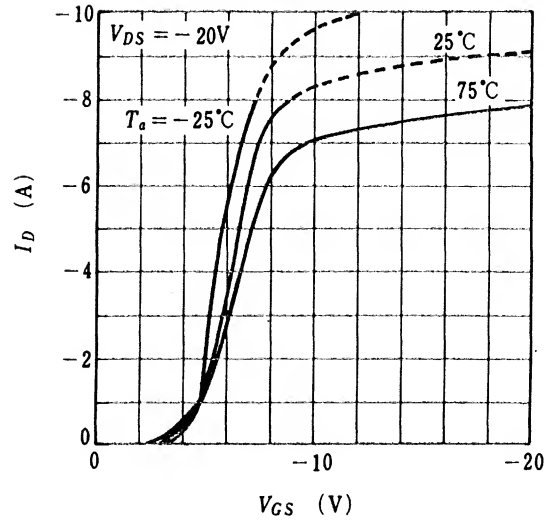
## Si MOS 型 Pチャンネル

日 立

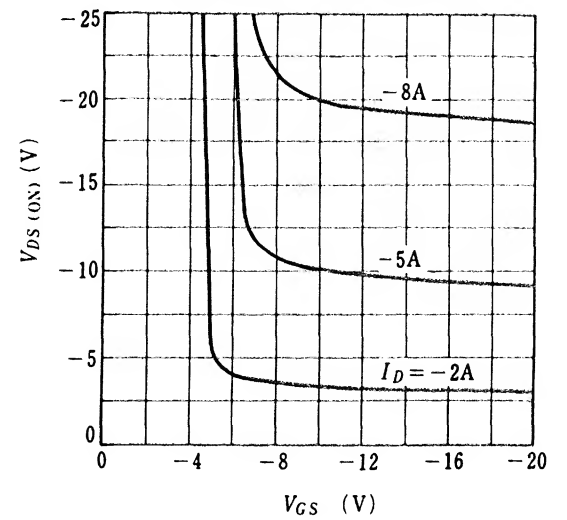
### 安全動作領域



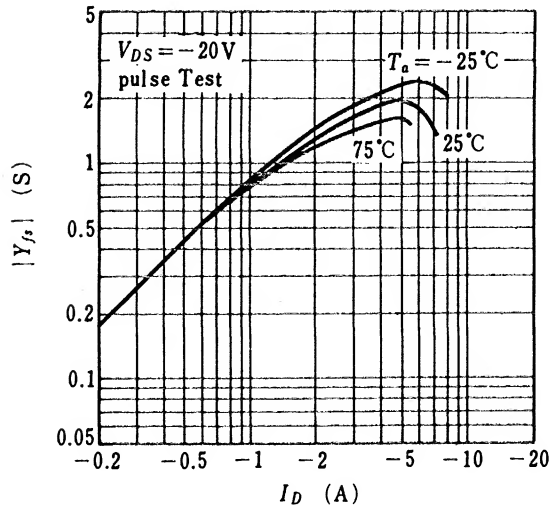
### 伝達特性



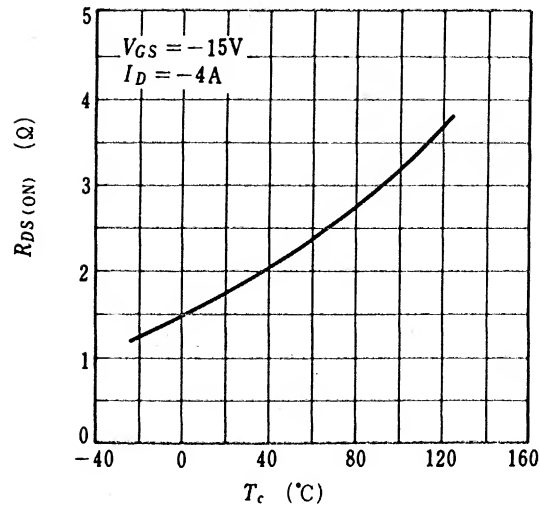
### VDS(ON) - VGS 特性



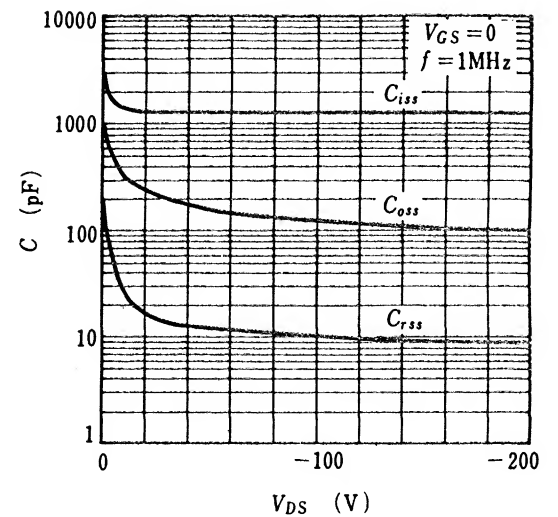
### |Yfs| - ID 特性



### RDS(ON) - Tc 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

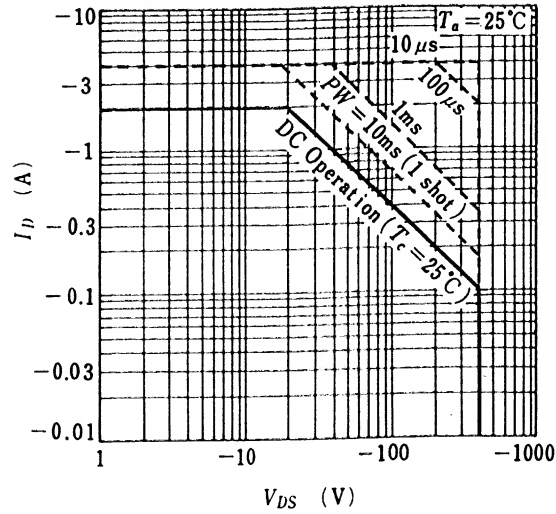


# 2SJ117

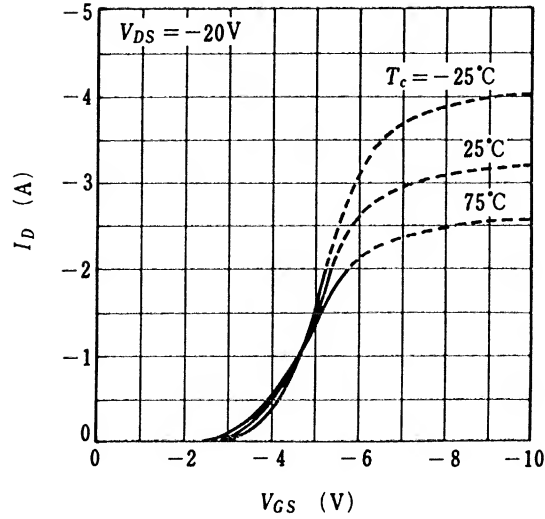
## Si MOS 型 Pチャンネル

日立

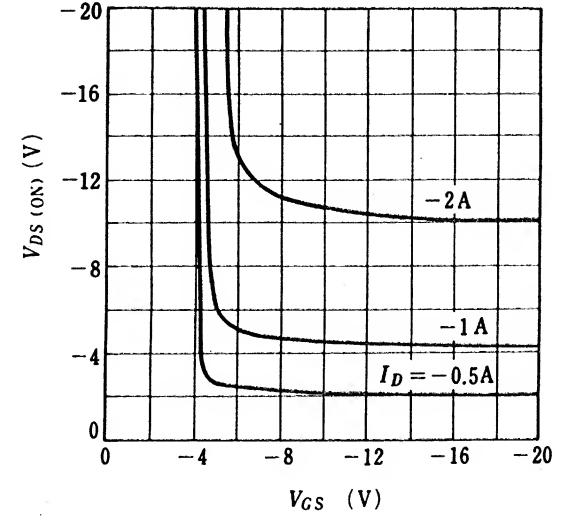
安全動作領域



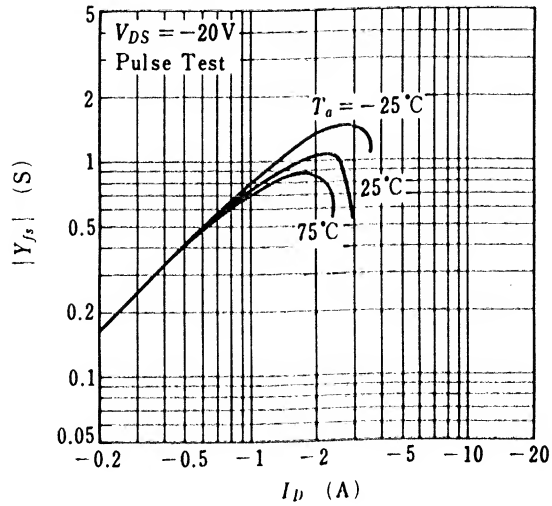
伝達特性



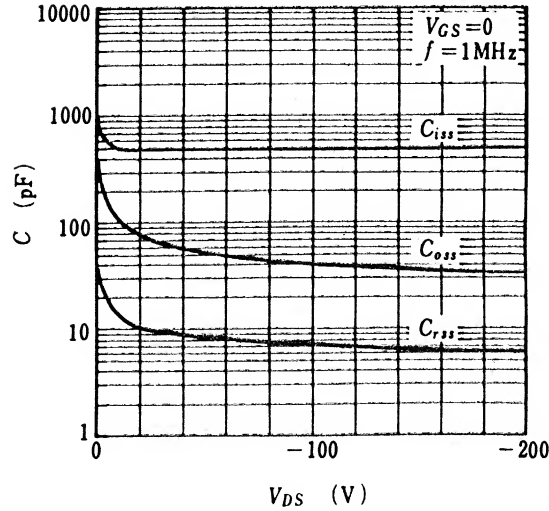
V\_DS (ON) - V\_GS 特性



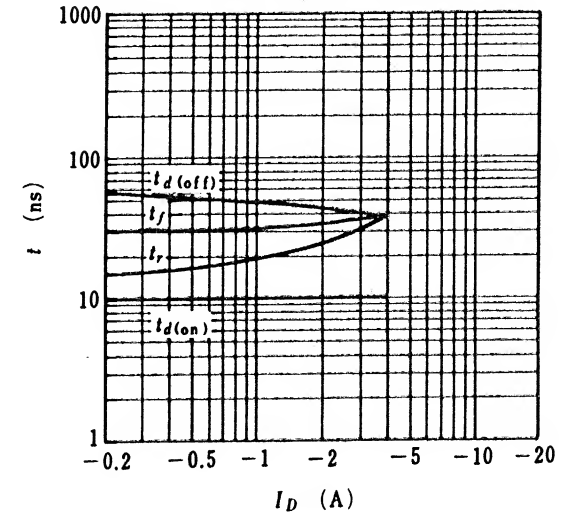
|Y\_fs| - I\_D 特性



C\_iss, C\_oss, C\_rss - V\_DS 特性



スイッチング特性

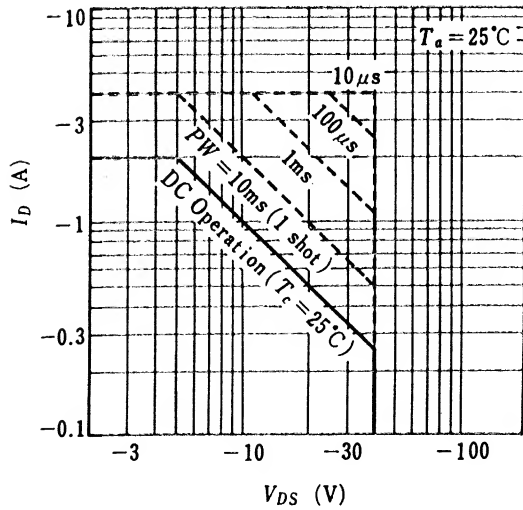


# 2SJ120

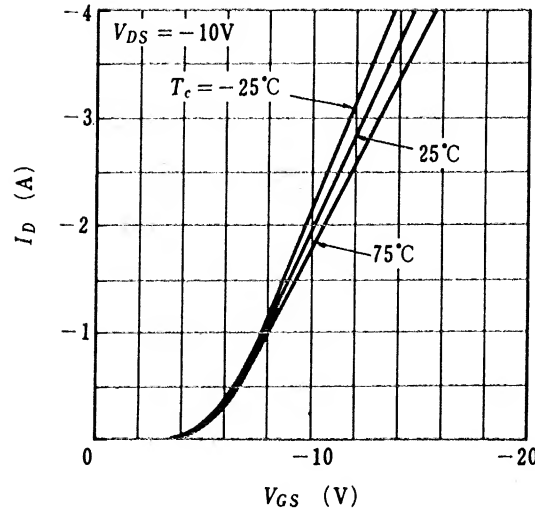
## Si MOS型 Pチャンネル

日立

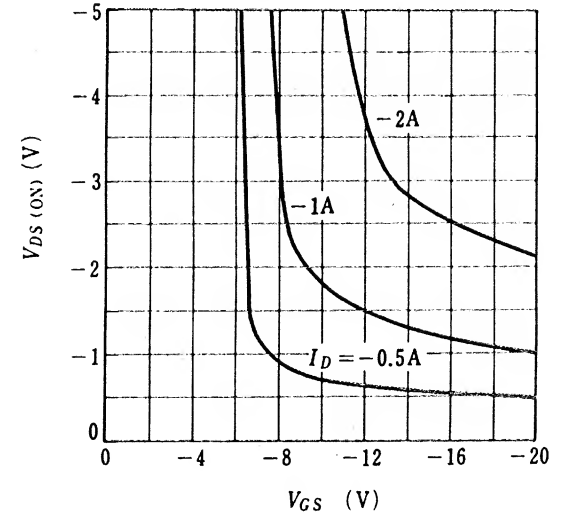
### 安全動作領域



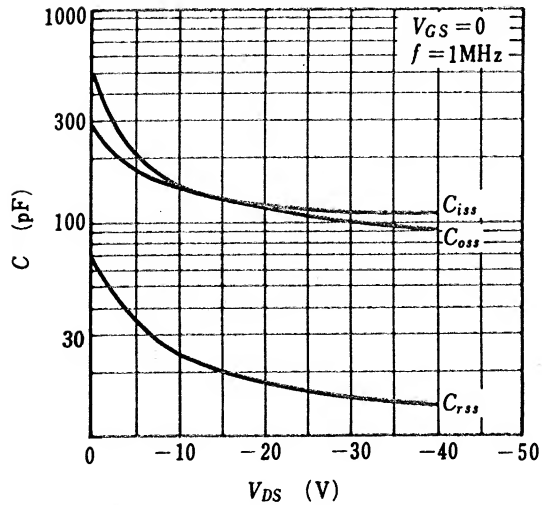
### 伝達特性



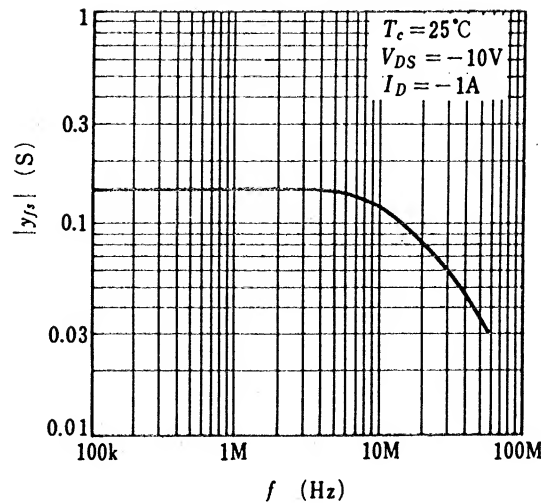
### VDS (ON) - VGS 特性



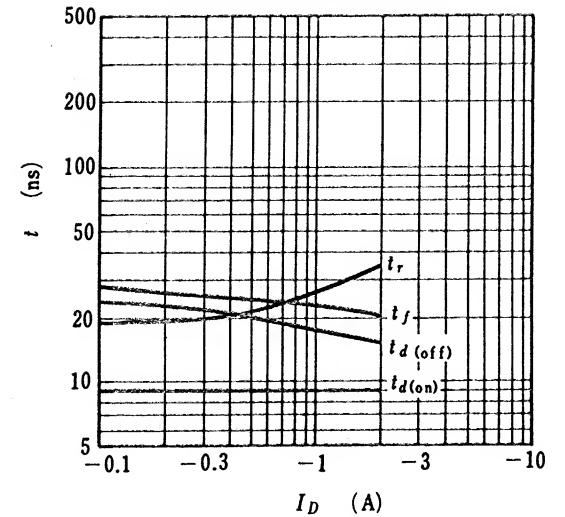
### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性



### |Yfs| - f 特性



### スイッチング特性

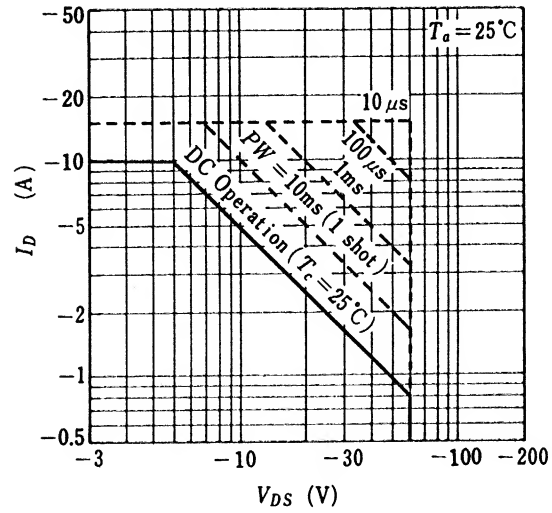


# 2SJ122

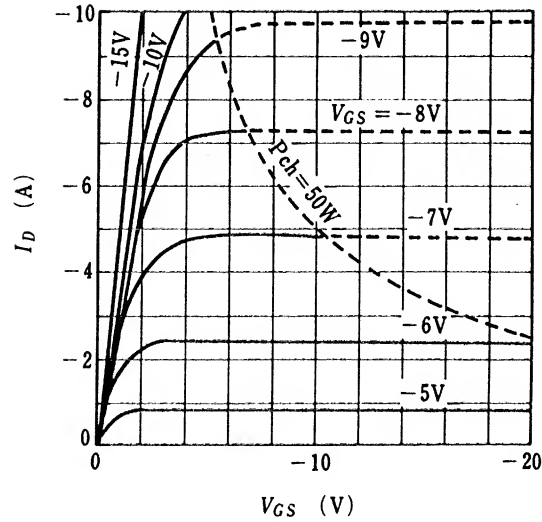
## Si MOS 型 Pチャンネル

日 立

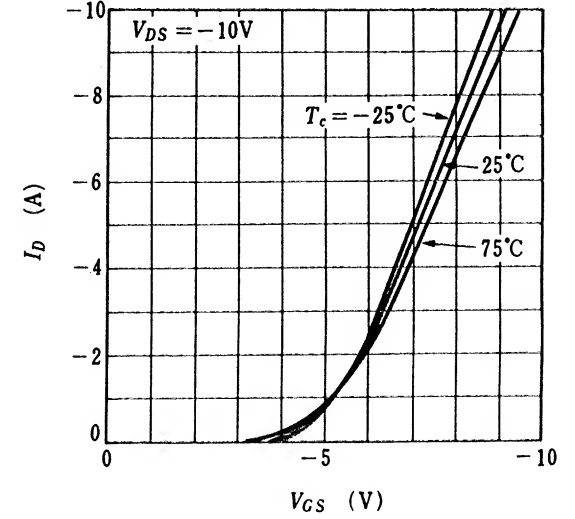
安全動作領域



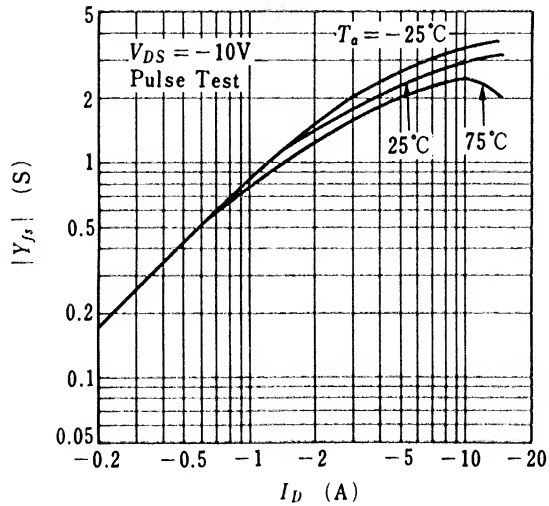
出力特性



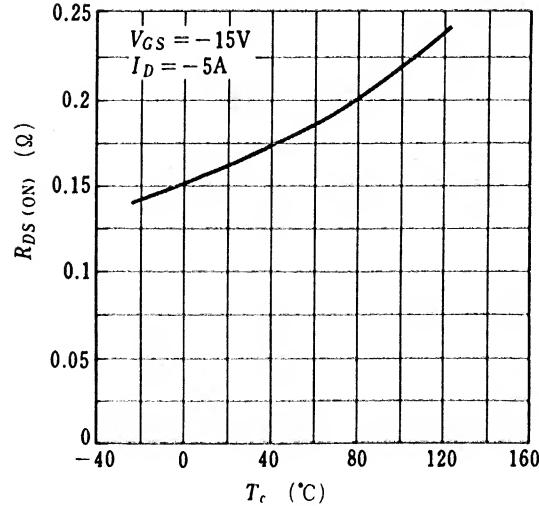
伝達特性



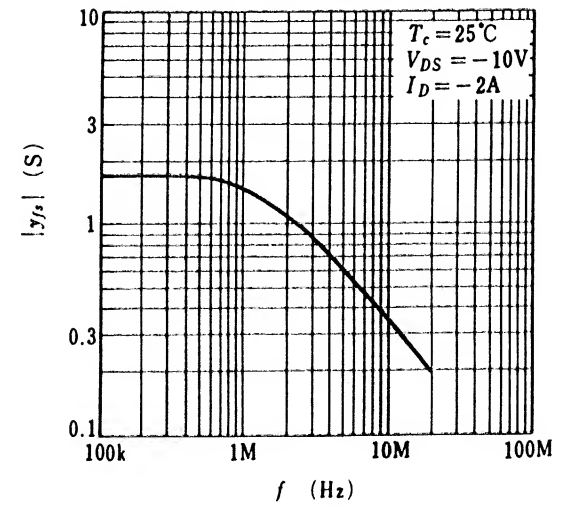
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$|Y_{fs}| - f$  特性

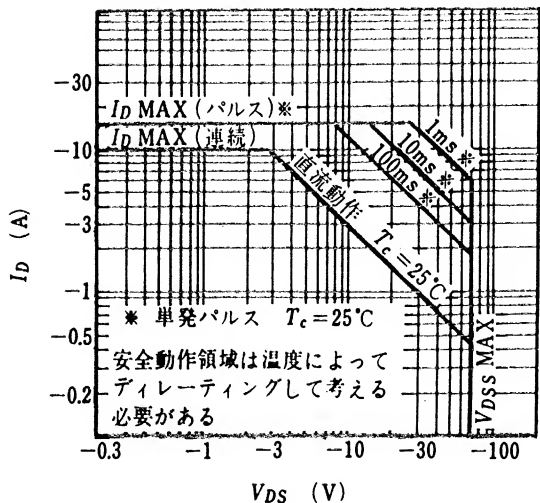


# 2SJ123

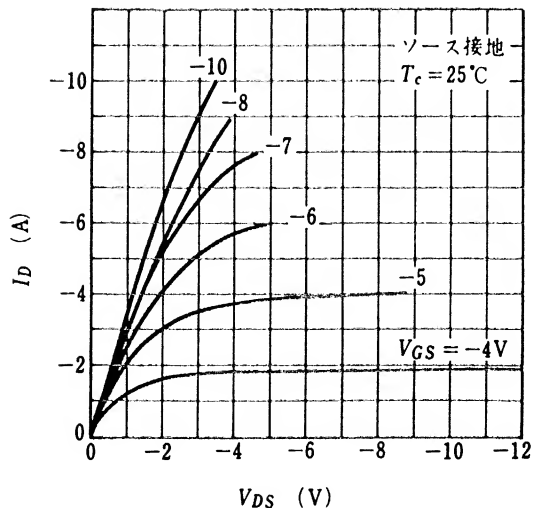
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

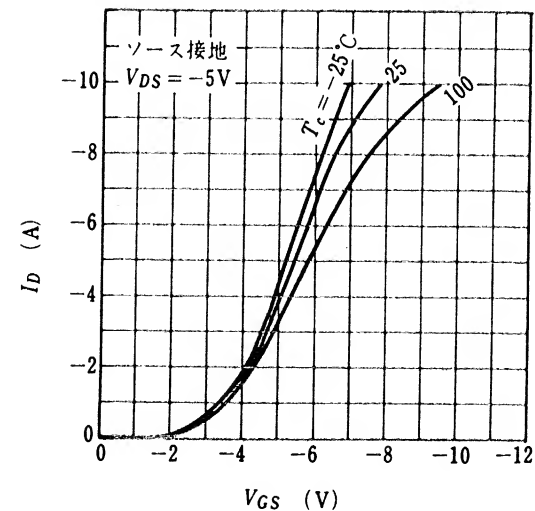
### 安全動作領域



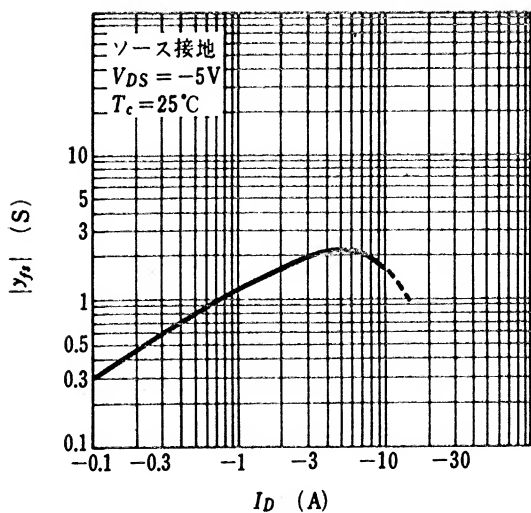
### ID - VDS 特性



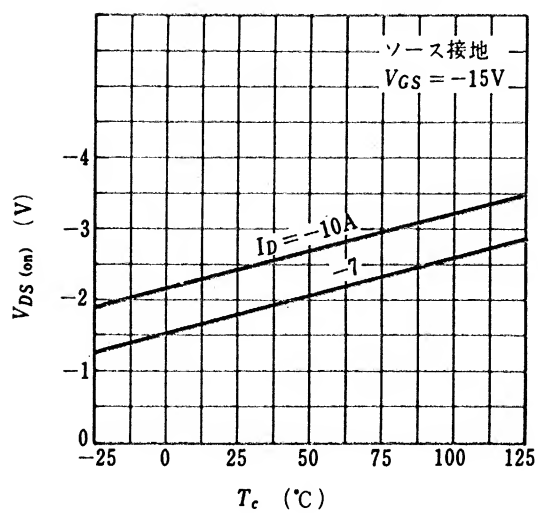
### ID - VGS 特性



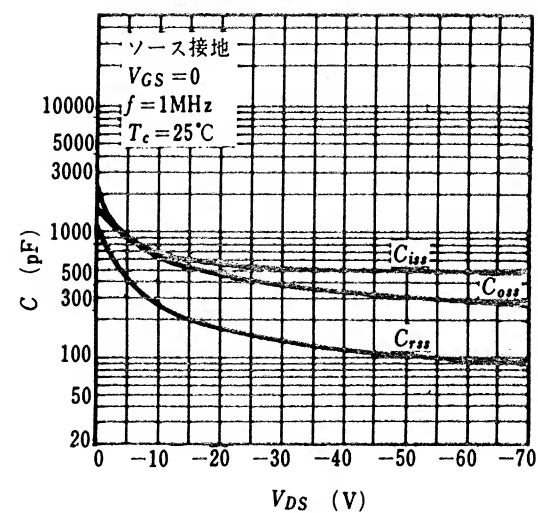
### |Yfs| - ID 特性



### VDS(on) - Tc 特性



### 静電容量 - VDS 特性

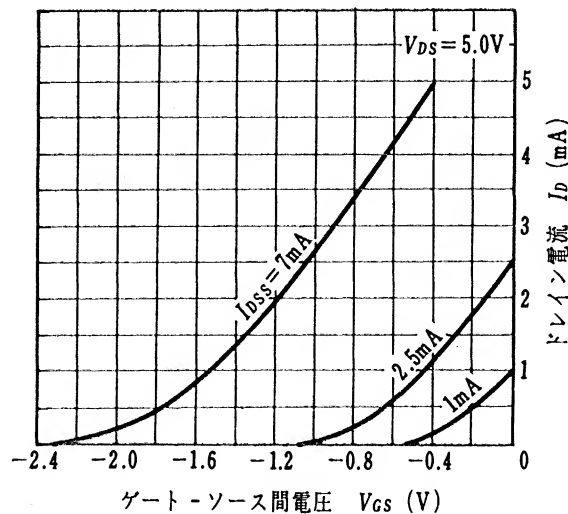




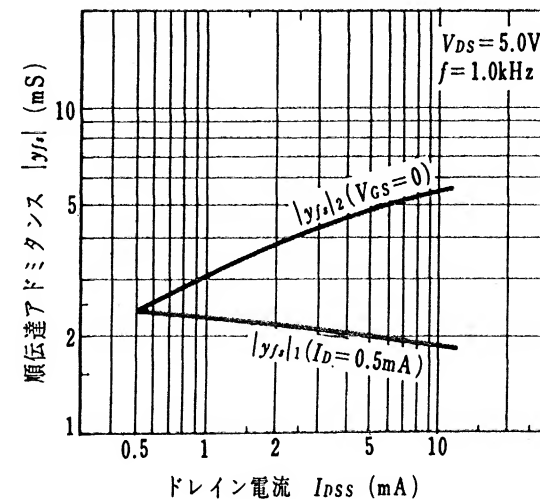
# 2SK105, 2SK160, 160A Si接合型 Nチャンネル

$I_{DSS}$ 区分	0.5~1.5	1.0~3.0	2.0~6.0	4.0~12
2SK105	E	F	H	J
2SK160	K4	K5	K6	K7
2SK160A	K24	K25	K26	K27

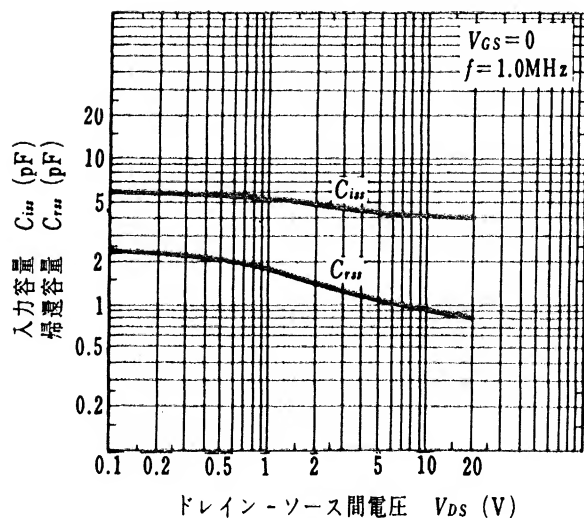
$I_D - V_{GS}$  特性



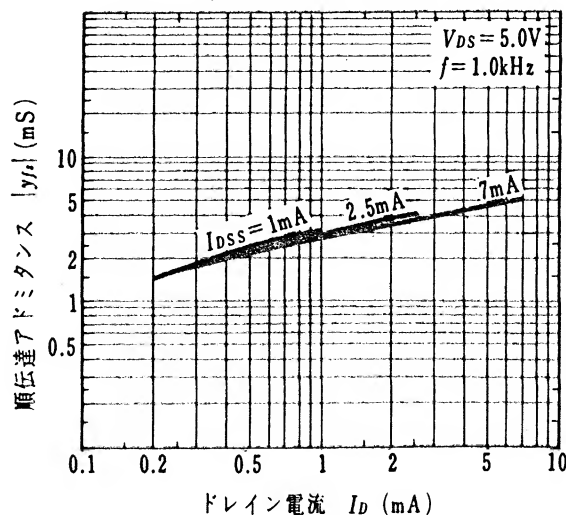
$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



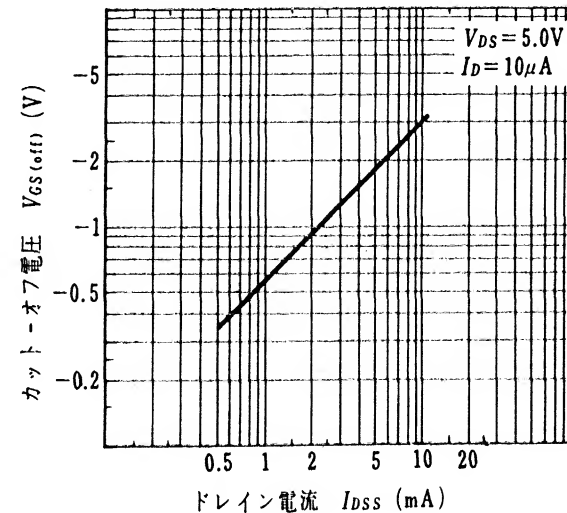
$C_{iss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



$|y_{fs}| - I_D$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



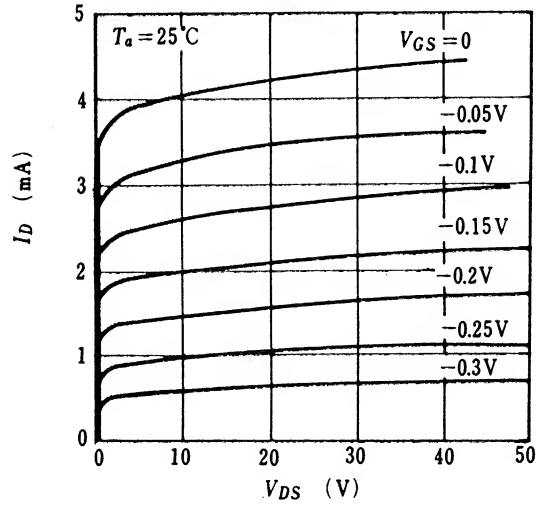
# 2SK108, 492

Si 接合型  
Nチャンネル

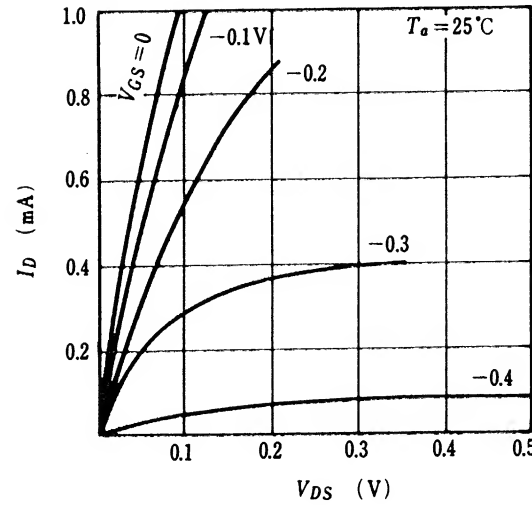
三 菱

アイテム	C	D	E
$I_{DSS}$ (mA)	1~3	2.5~6	5~12

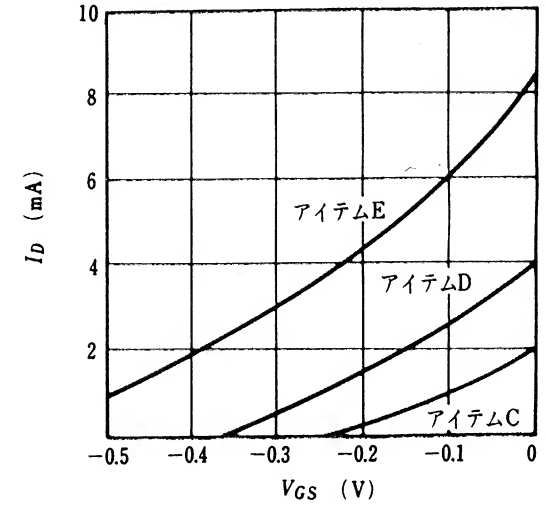
出力特性



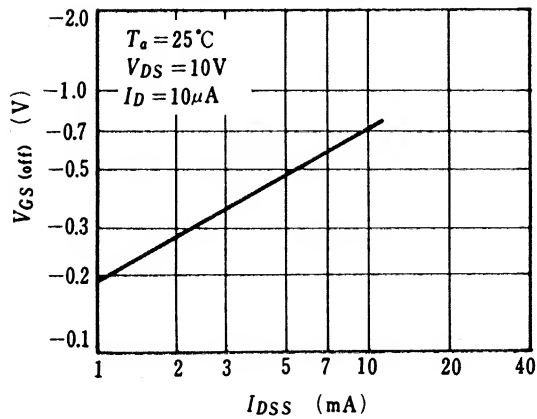
ソース接地出力特性



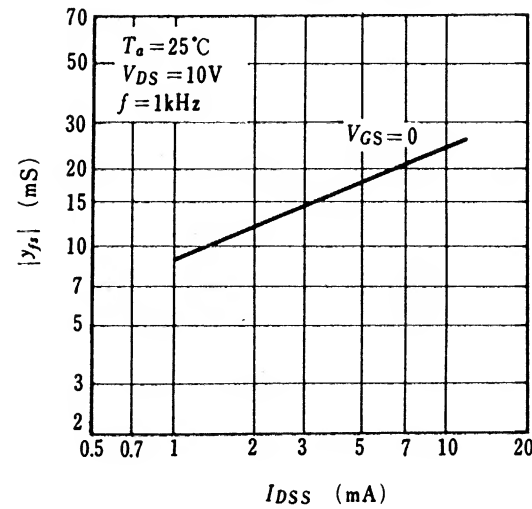
ソース接地伝達特性



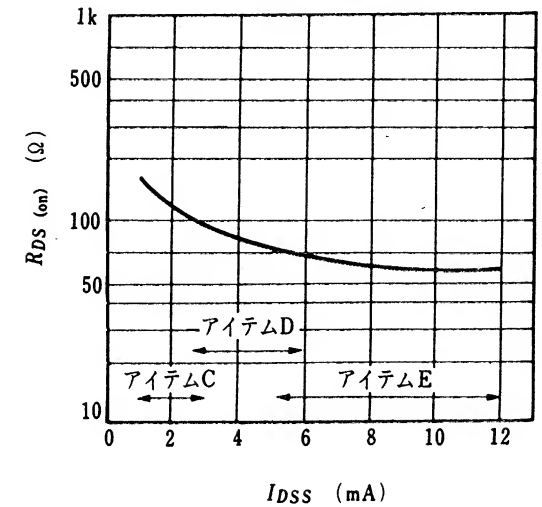
$V_{GS(off)}$  -  $I_{DSS}$  特性



$|Y_{fs}|$  -  $I_{DSS}$  特性



$R_{DS(on)}$  -  $I_{DSS}$  特性



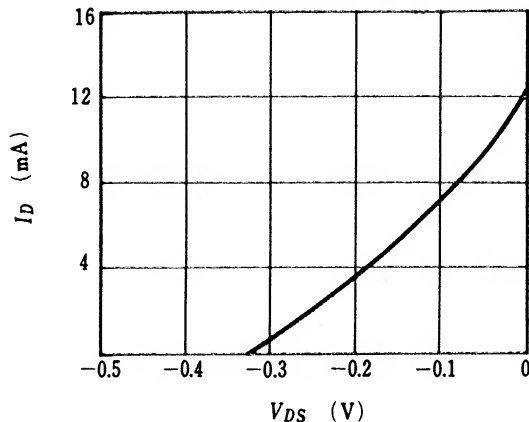
Si 接合型  
Nチャンネル

三 菱

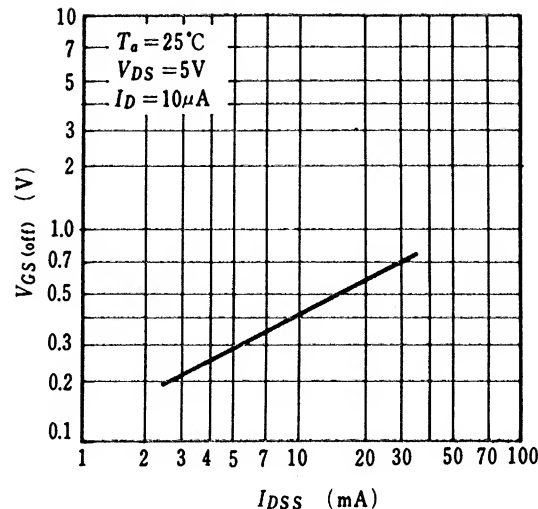
2SK110

アイテム	D	E	F	G
$I_{DSS}$ (mA)	2.5~6	5~12	10~20	17~36

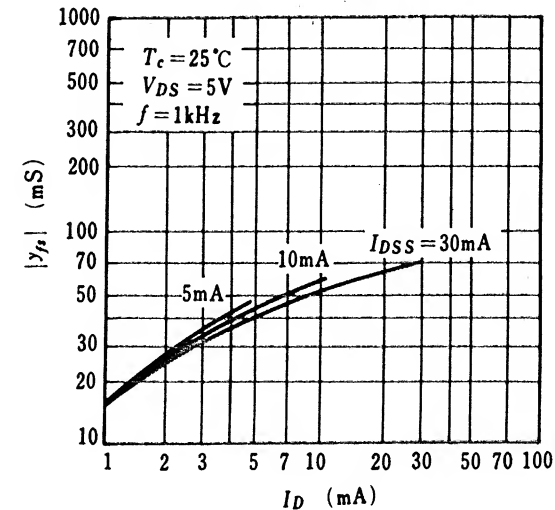
ソース接地伝達特性



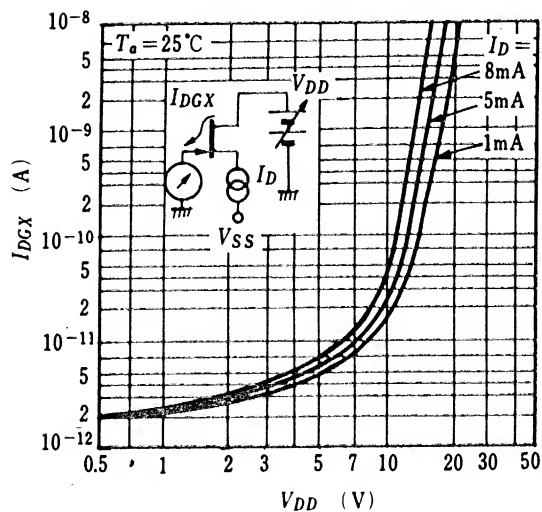
$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



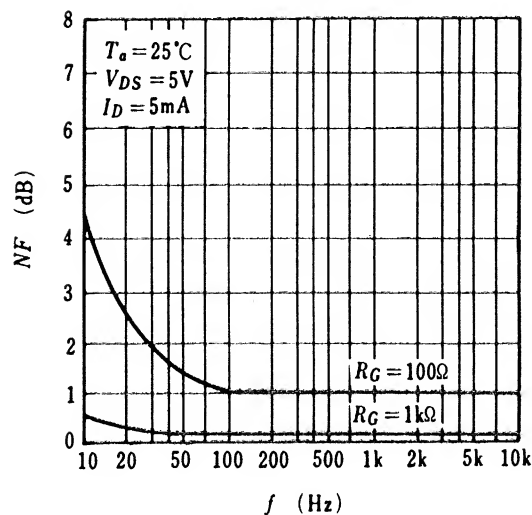
$|y_{fs}| - I_D$  特性



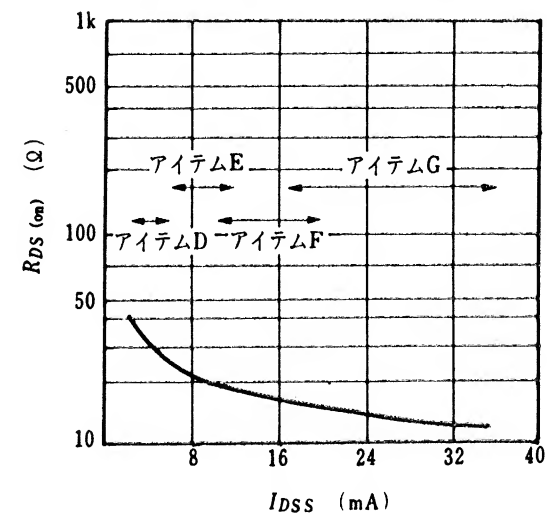
$I_{DGX} - V_{DD}$  特性



NF - f 特性



$R_{DS(on)} - I_{DSS}$  特性



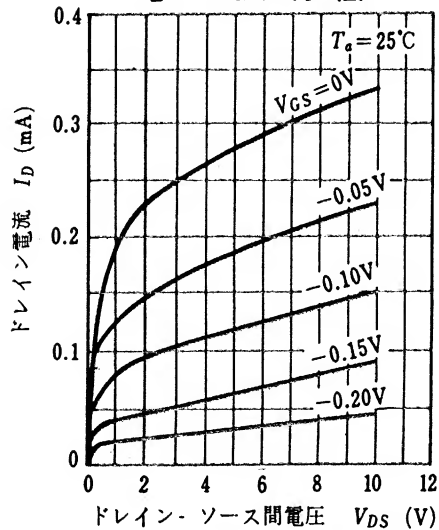


# 2SK123

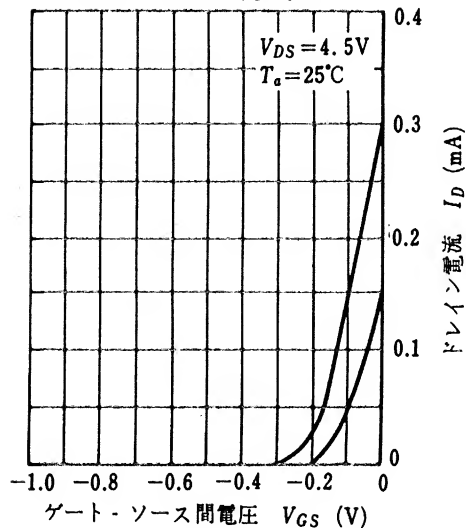
## Si 接合型 Nチャンネル

松下

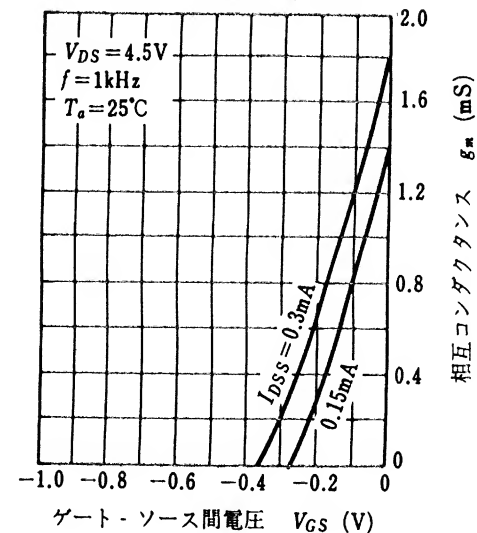
$I_D - V_{DS}$  特性



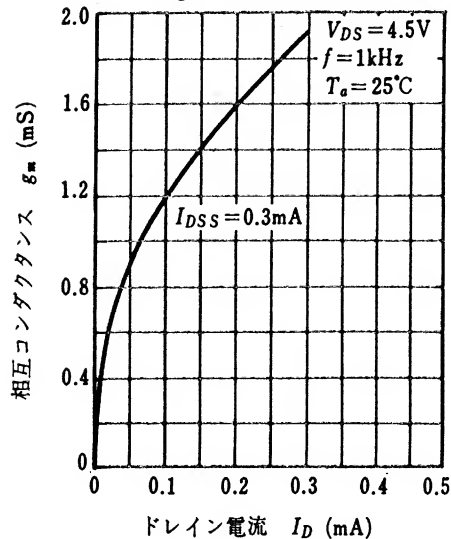
$I_D - V_{GS}$  特性



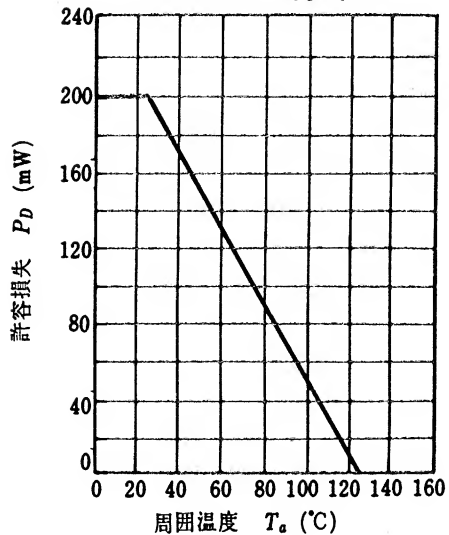
$g_m - V_{GS}$  特性



$g_m - I_D$  特性



$P_D - T_a$  特性



# 2SK128, 198

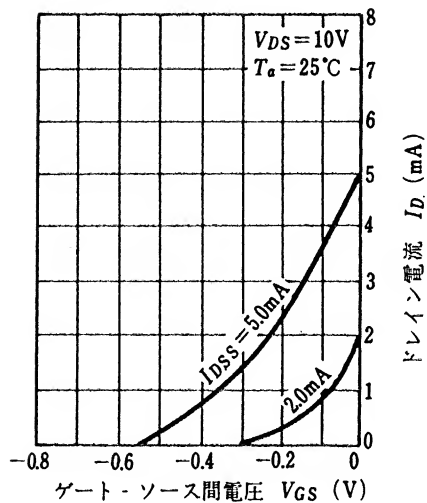
Si 接合型  
Nチャンネル

松下

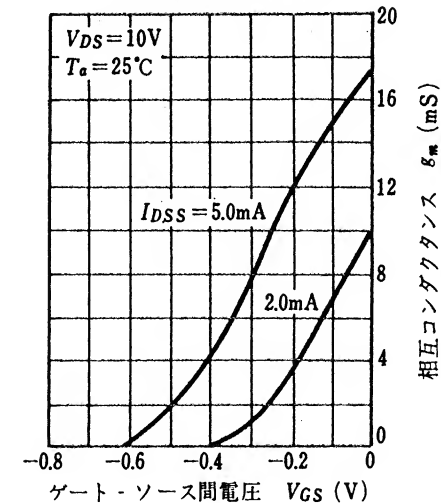
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~3	2~6	4~12

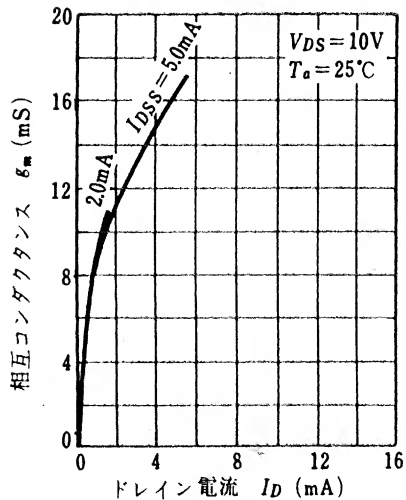
$I_D - V_{GS}$  特性



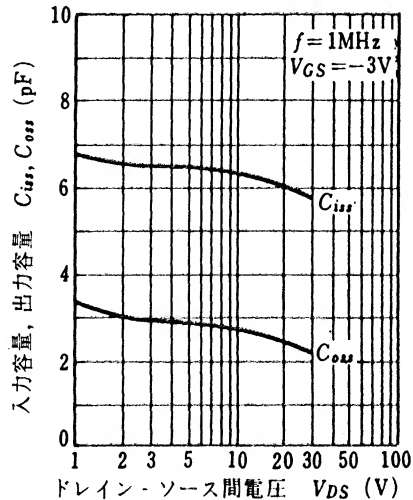
$g_m - V_{GS}$  特性



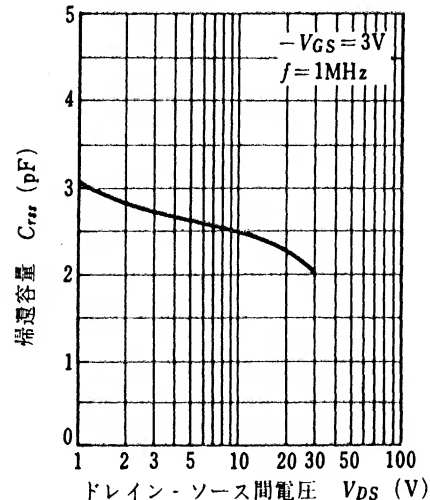
$g_m - I_D$  特性



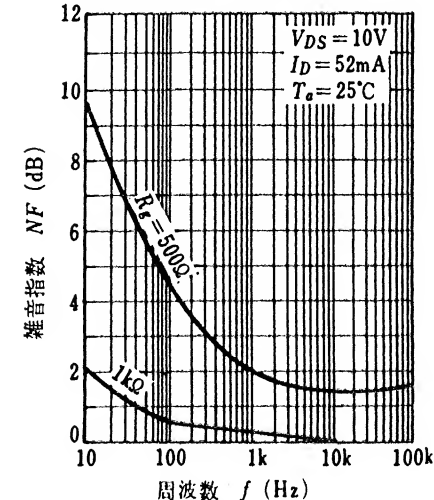
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$NF - f$  特性

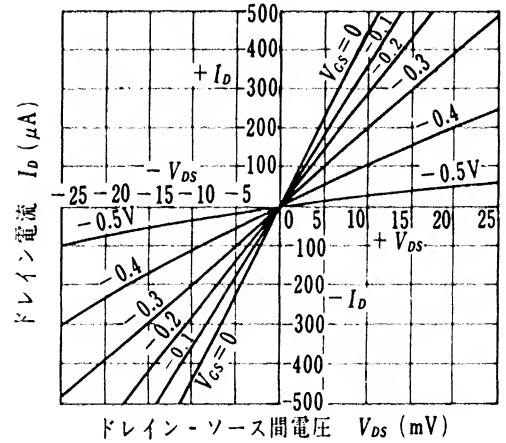


# 2SK131

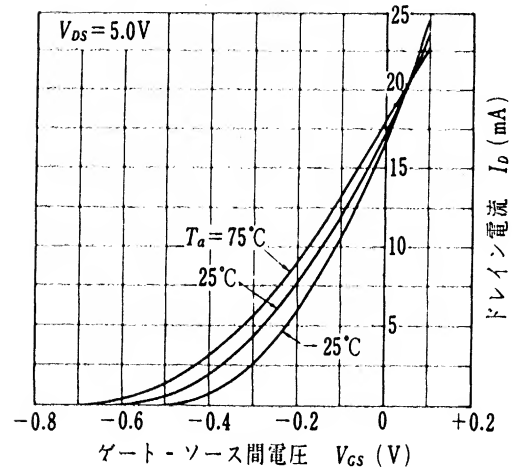
## Si 接合型 Nチャンネル

日 電

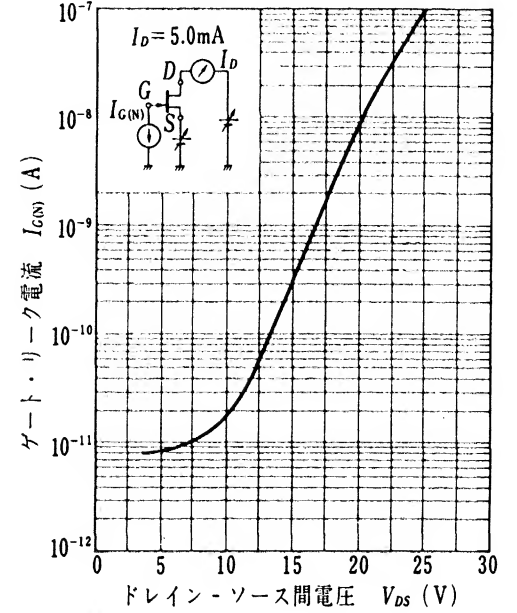
### $I_D - V_{DS}$ 特性



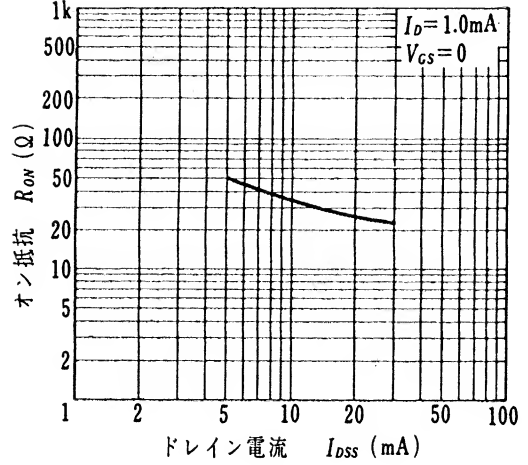
### $I_D - V_{GS}$ 特性



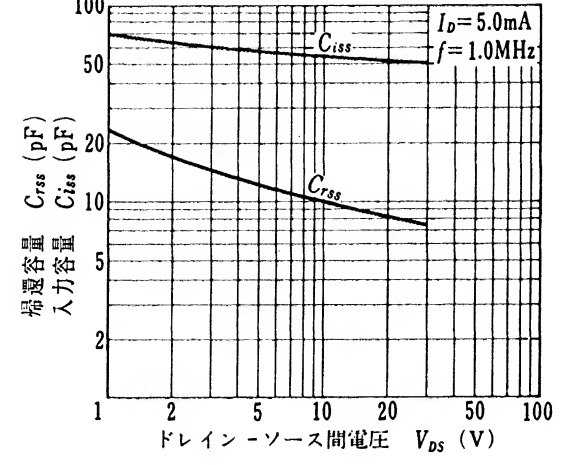
### $I_G - V_{DS}$ 特性



### $R_{ON} - I_{DSS}$



### $C_{iss}, C_{rss} - V_{DS}$ 特性



# 2SK136

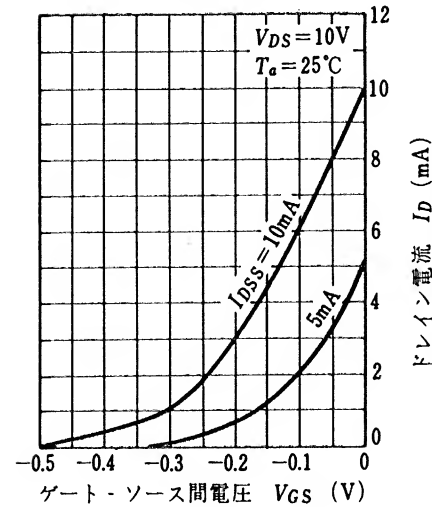
## Si 接合型 Nチャンネル

松下

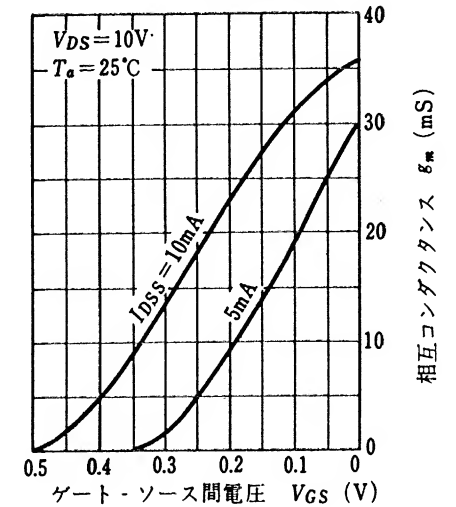
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~3	2~6	4~12	10~20

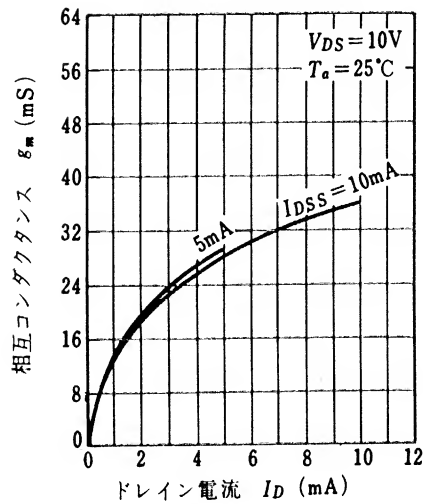
$I_D - V_{GS}$  特性



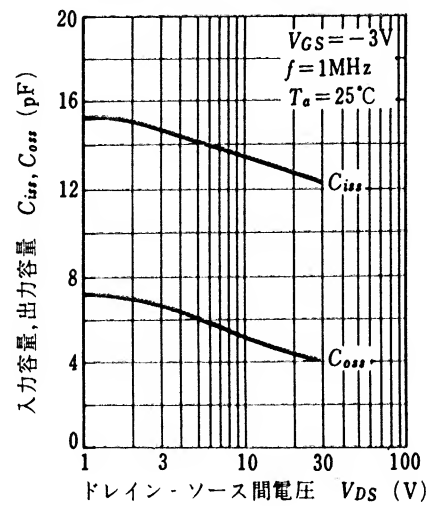
$g_m - V_{GS}$  特性



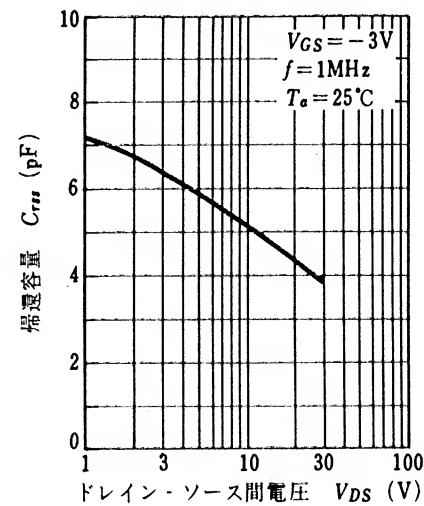
$g_m - I_D$  特性



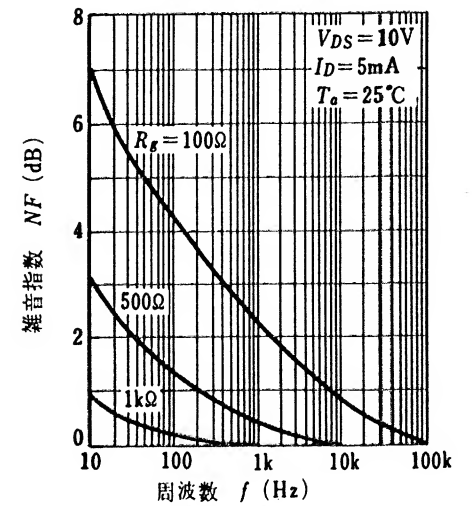
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



NF - f 特性





# 2SK155

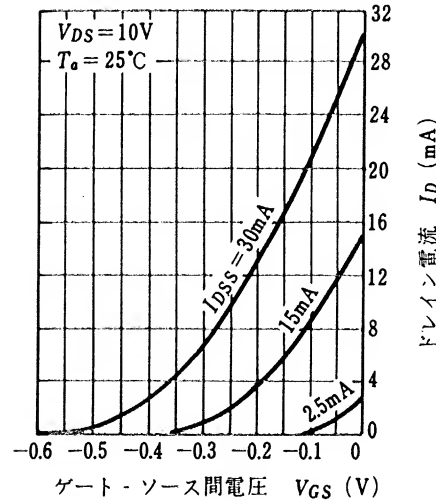
## Si 接合型 Nチャンネル

松下

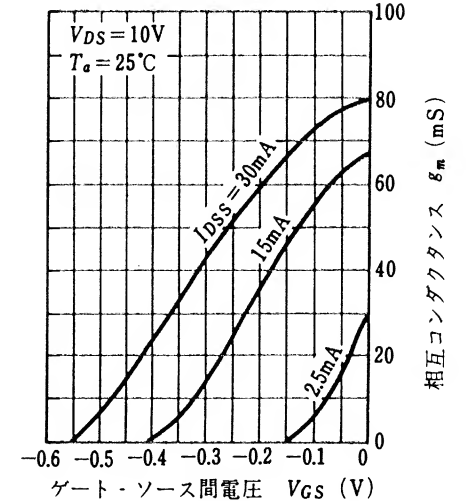
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R	S	T
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~4	2~6	4~12	10~20	18~30

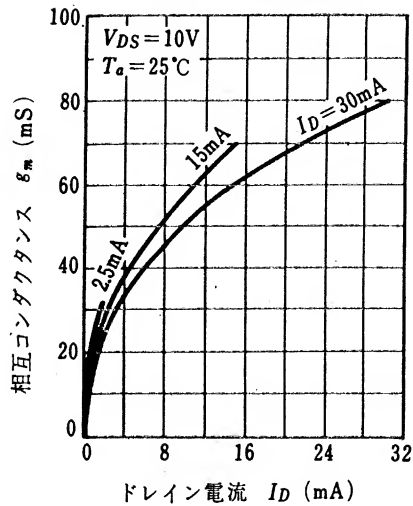
$I_D - V_{GS}$  特性



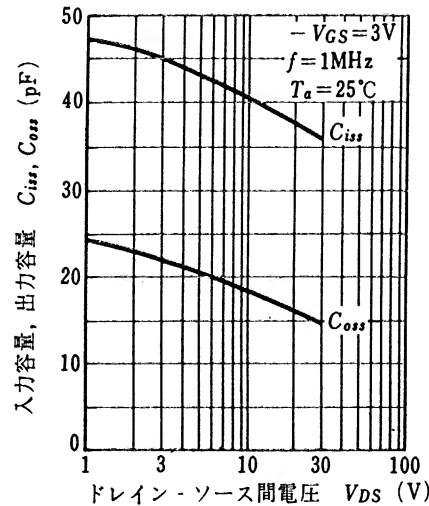
$g_m - V_{GS}$  特性



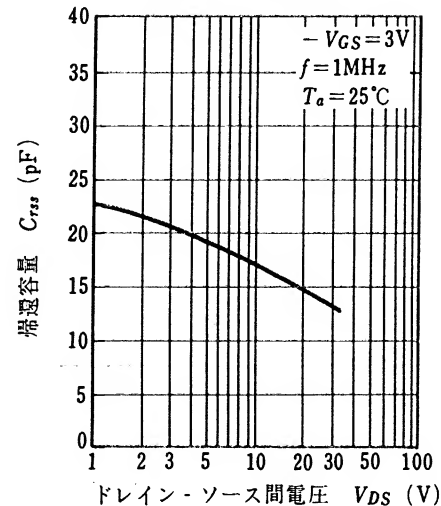
$g_m - I_D$  特性



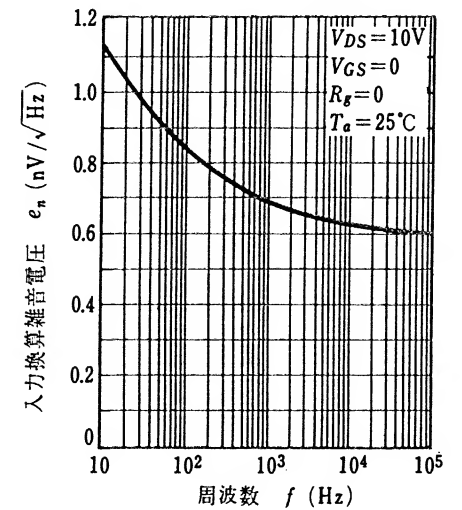
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$e_n - f$  特性



# 2SK165

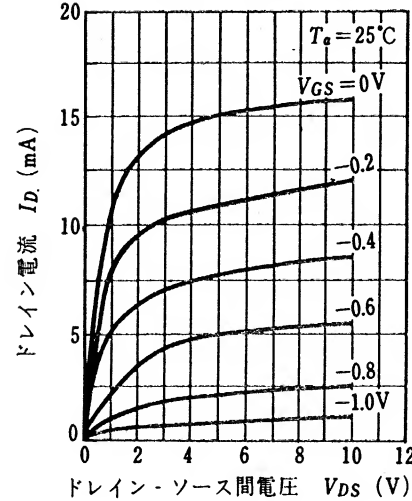
## Si 接合型 Nチャンネル

松下

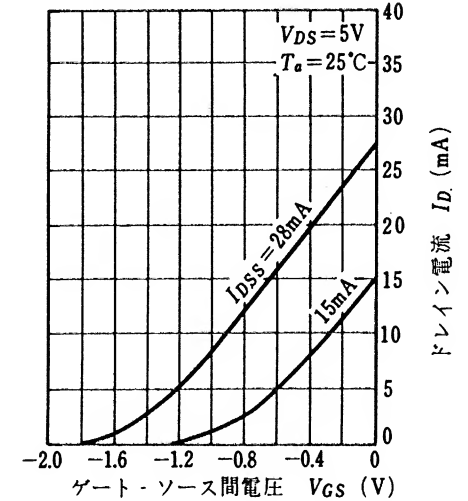
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	8~16	14~24	20~32

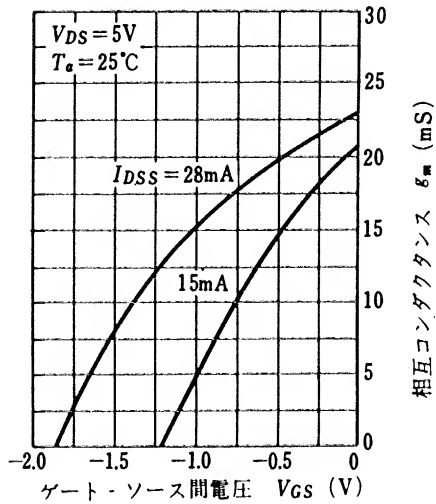
$I_D - V_{DS}$  特性



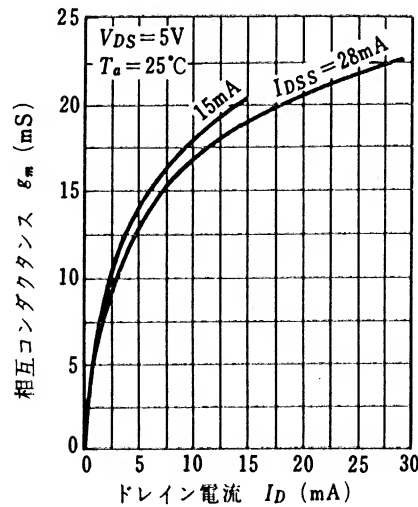
$I_D - V_{GS}$  特性



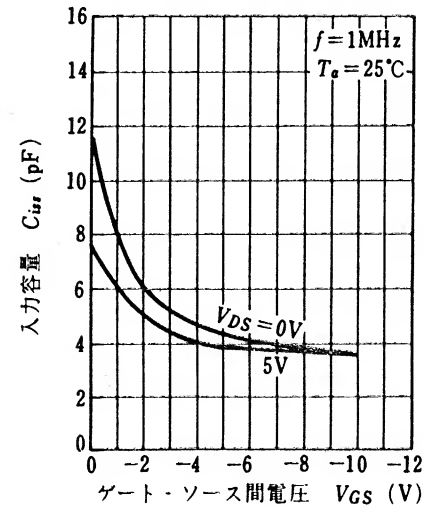
$g_m - V_{GS}$  特性



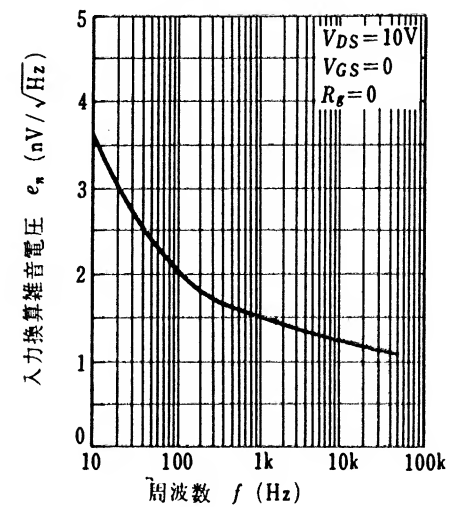
$g_m - I_D$  特性



$C_{iss} - V_{GS}$  特性



$e_n - f$  特性

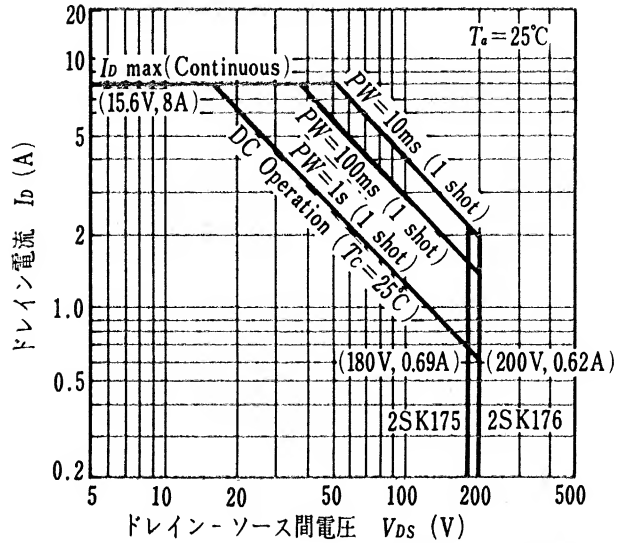


# 2SK175, 176, 176(H)

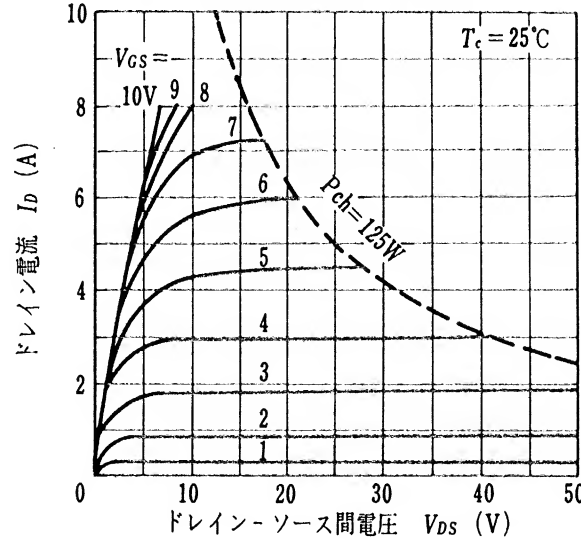
Si MOS型  
Nチャンネル

日立

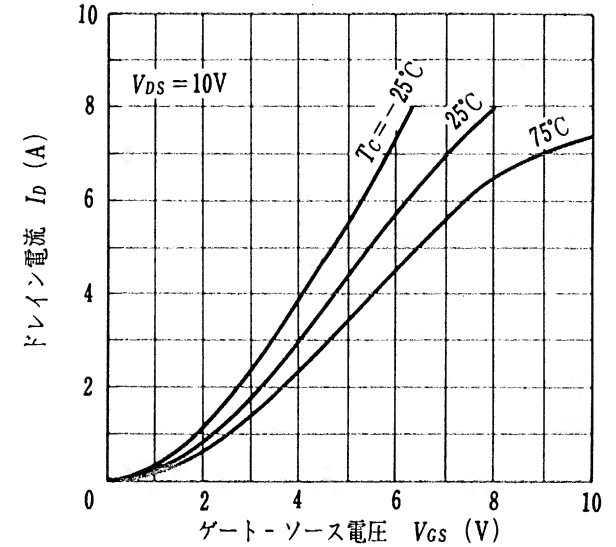
安全動作領域 (A.S.O.)



ソース接地出力静特性

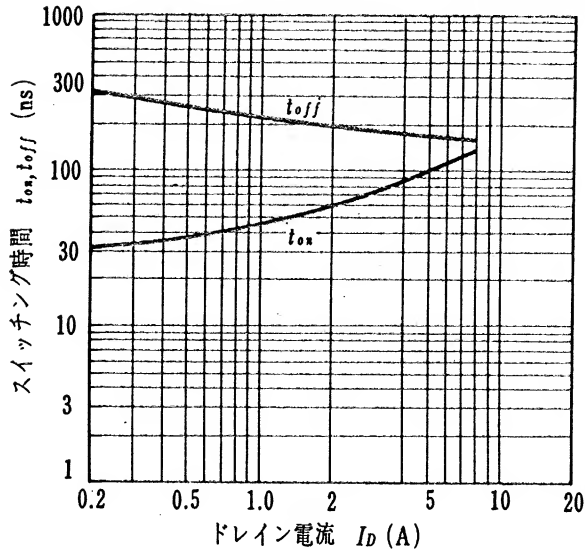


ソース接地伝達静特性

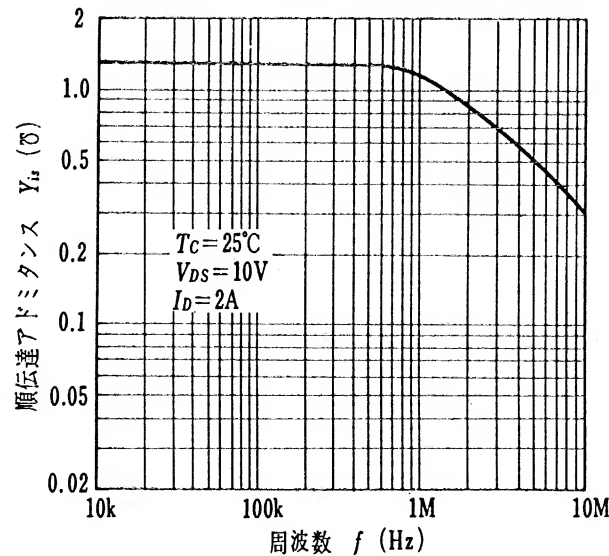


(2SK176(H))

スイッチング時間対ドレイン電流特性

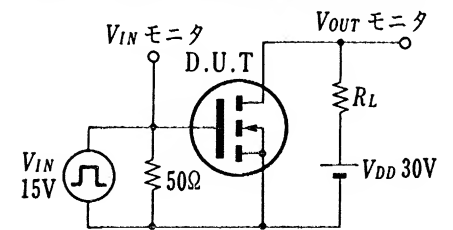


順伝達アドミタンス対周波数特性

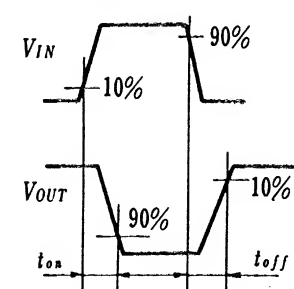


(2SK176(H))

スイッチング時間測定回路



応答波形



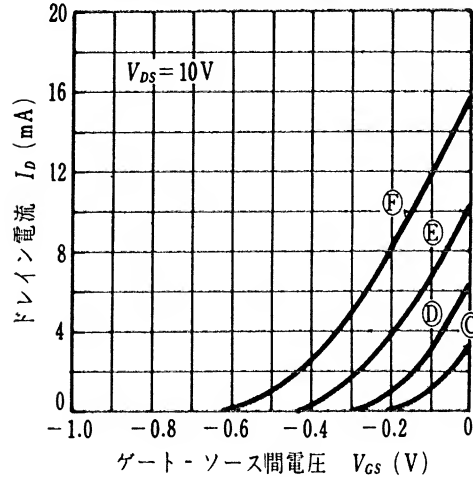
# 2SK187, 431

## Si 接合型 Nチャンネル

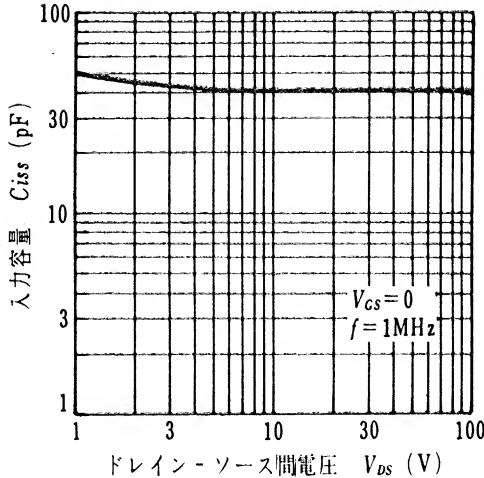
$I_{DSS}$ の値により下記のように4区分し、現品に表示してある。

Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
2.5~5	4~8	6~12	10~20

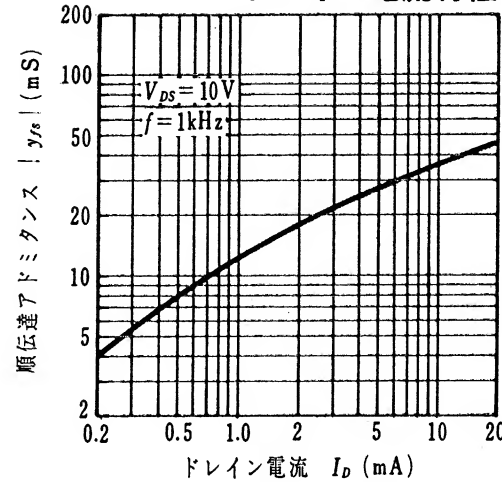
ソース接地伝達静特性



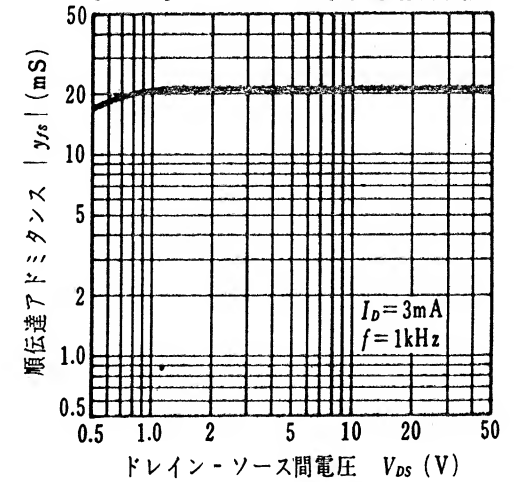
入力容量対  
ドレイン-ソース間電圧特性



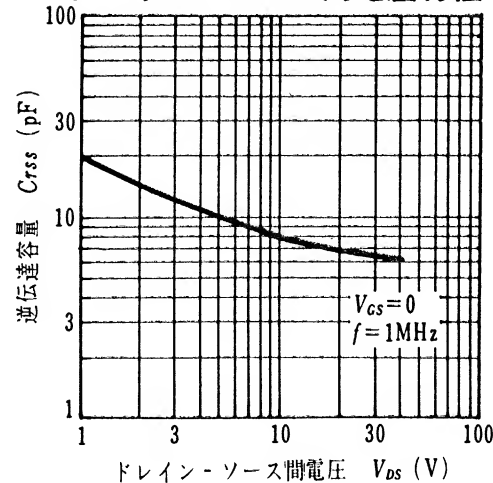
順伝達アドミタンス-  
ドレイン電流特性



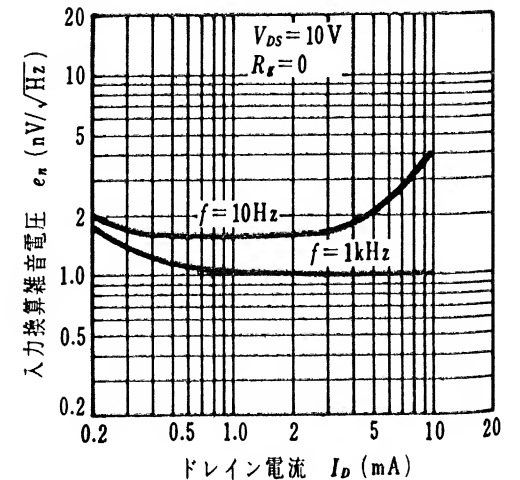
順伝達アドミタンス対  
ドレイン-ソース間電圧特性



逆伝達容量対  
ドレイン-ソース間電圧特性



入力換算雑音電圧-  
ドレイン電流特性



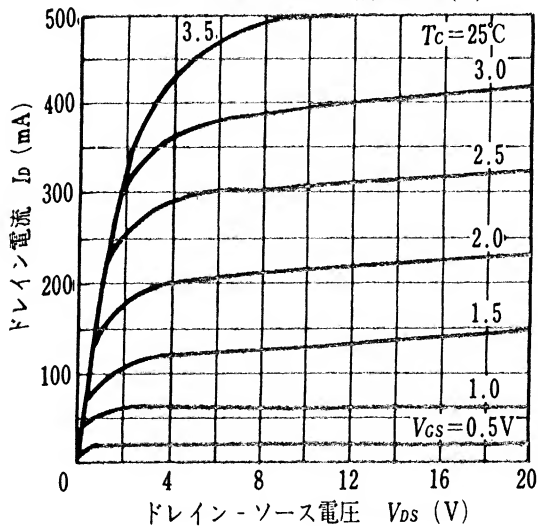


# 2SK213, 214, 214(K), 215, 216, 216(K)

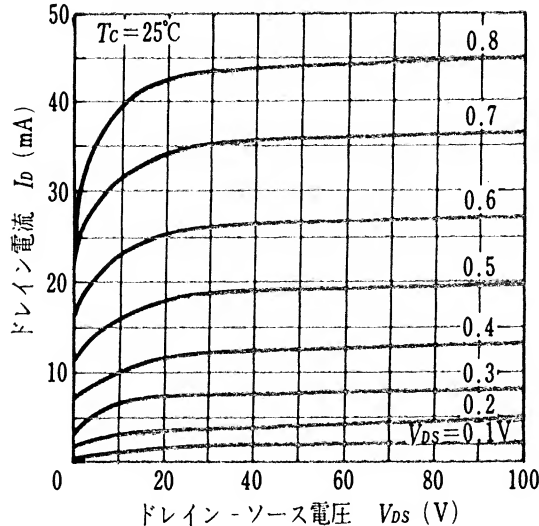
Si MOS型  
Nチャンネル

日立

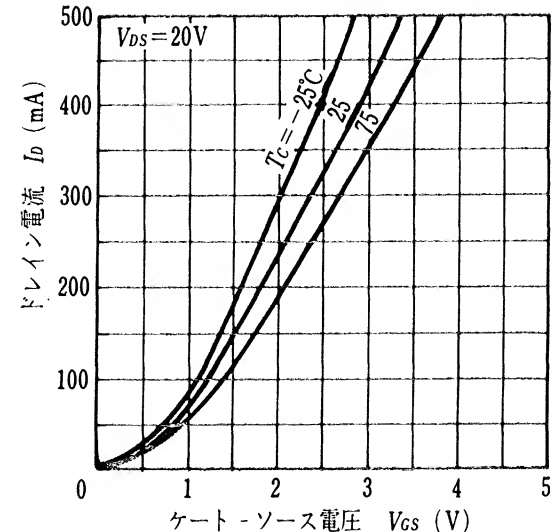
ソース接地出力静特性(1)



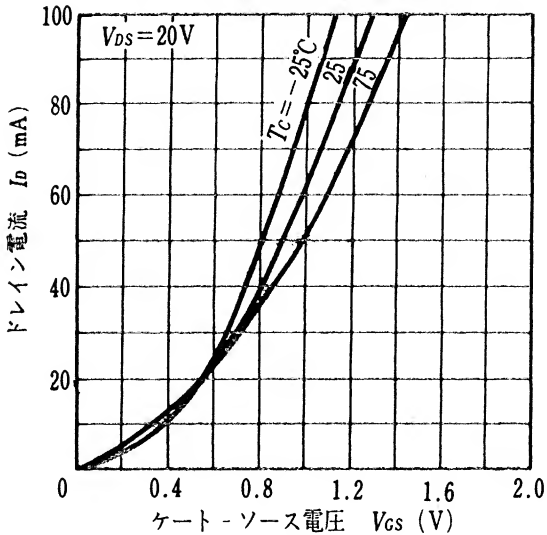
ソース接地出力静特性(2)



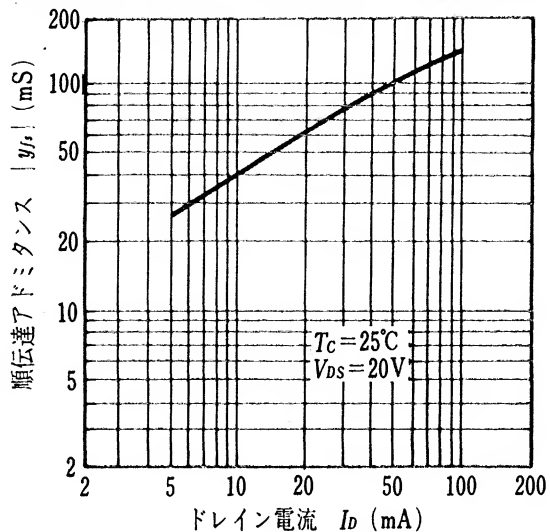
ソース接地伝達静特性(1)



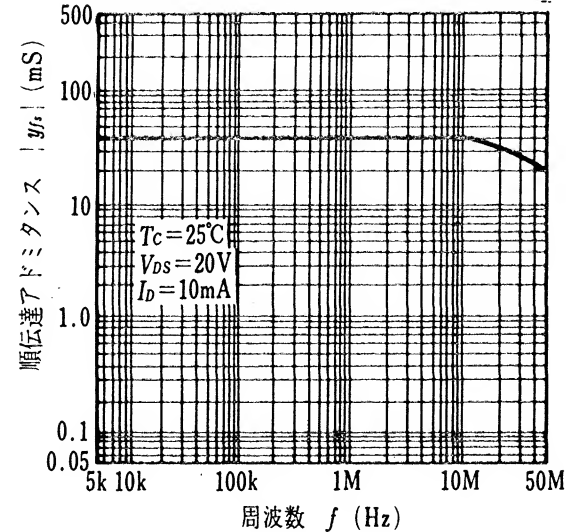
ソース接地伝達静特性(2)



順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性



順伝達アドミタンス対周波数特性



# 2SK218

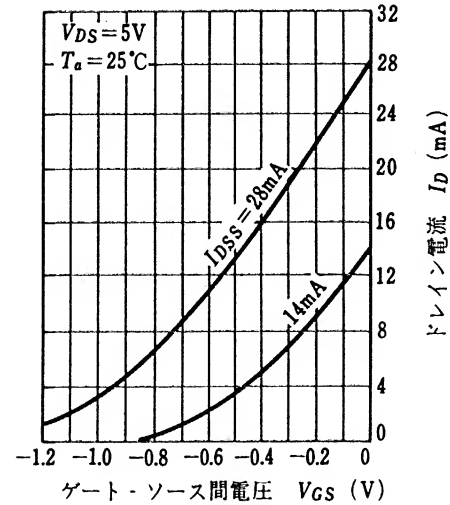
Si 接合型  
Nチャンネル

松 下

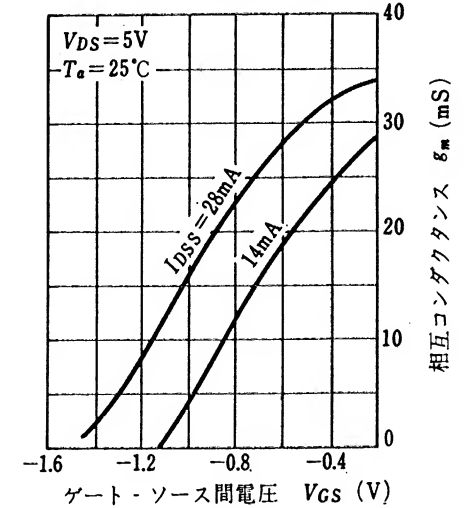
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	5~16	14~24	20~32	28~42

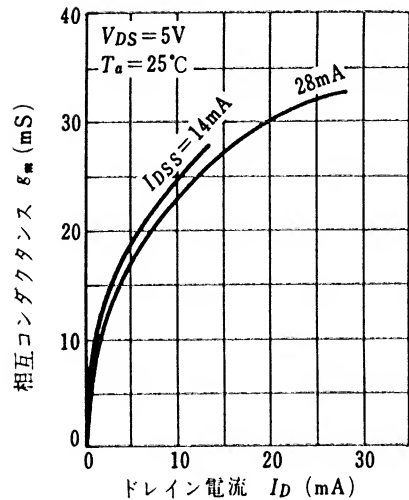
$I_D - V_{GS}$  特性



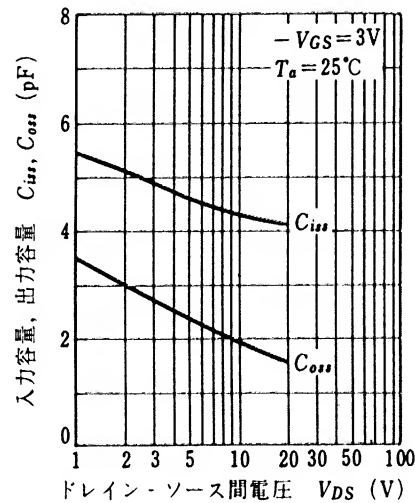
$g_m - V_{GS}$  特性



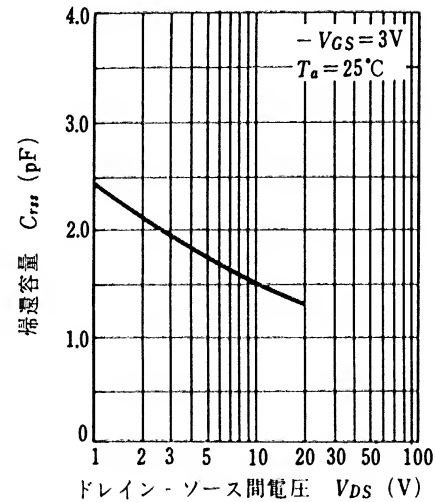
$g_m - I_D$  特性



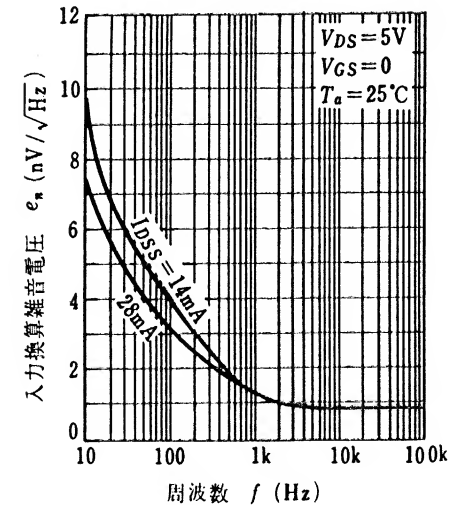
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$e_n - f$  特性



# 2SK222

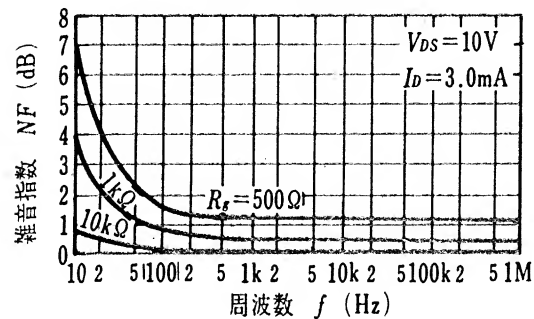
## Si 接合型 Nチャンネル

三 洋

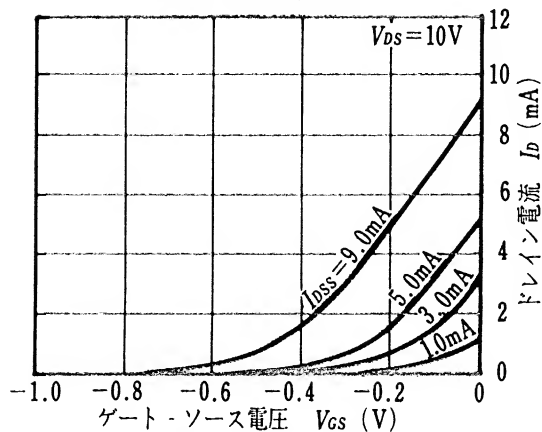
$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

0.6	C	1.5	1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

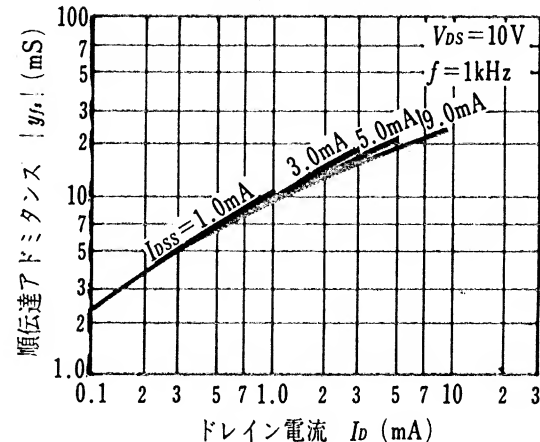
NF - f 特性



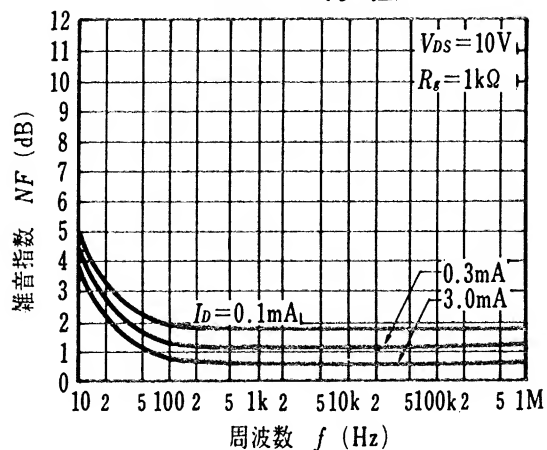
$I_D - V_{GS}$  特性



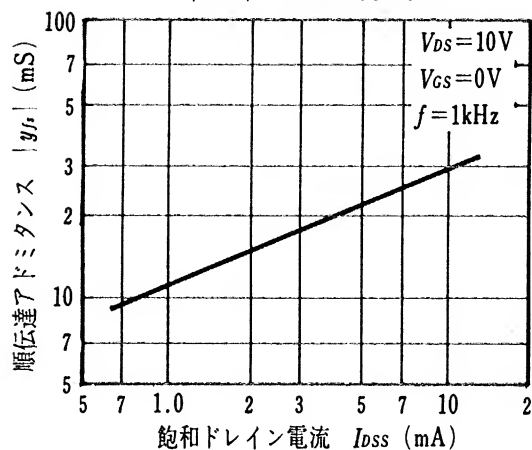
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



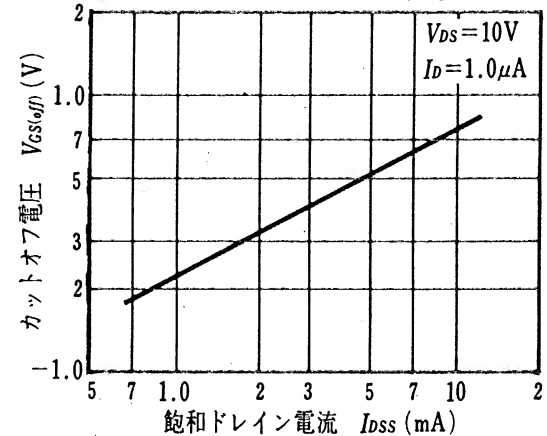
NF - f 特性



$|Y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



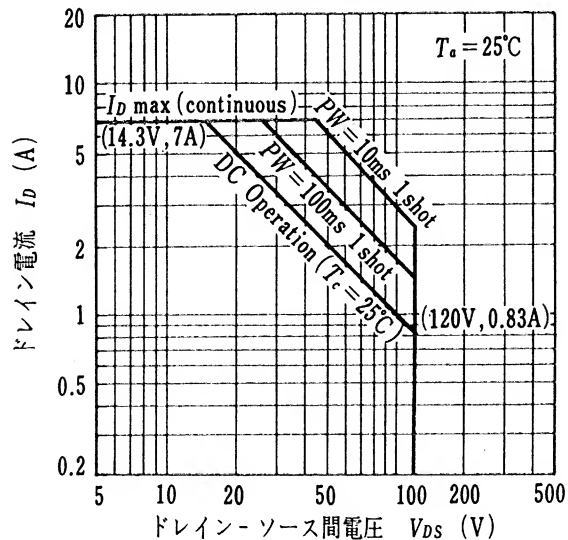


# 2SK225, 226, 227

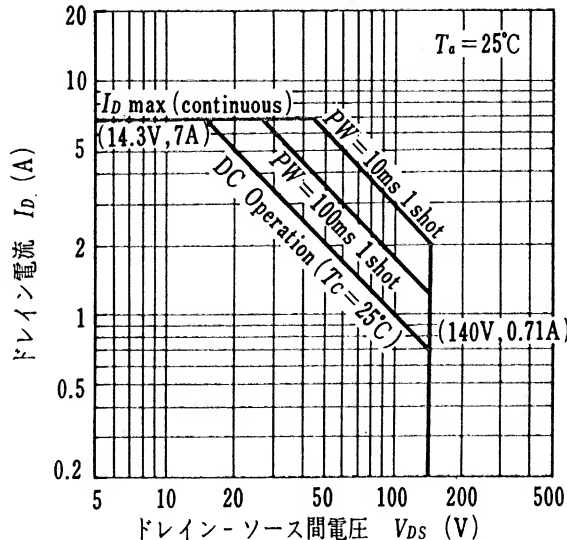
Si MOS型  
Nチャンネル

日 立

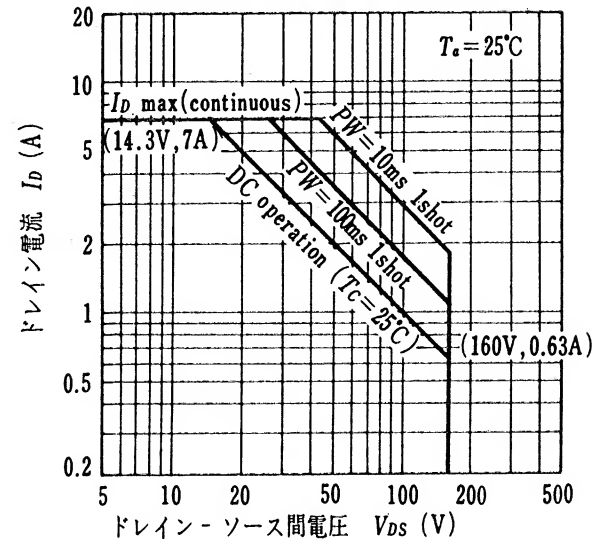
2SK225 安全動作領域



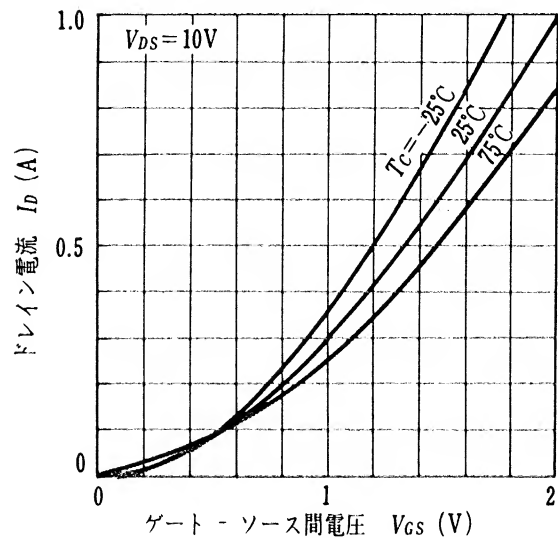
2SK226 安全動作領域



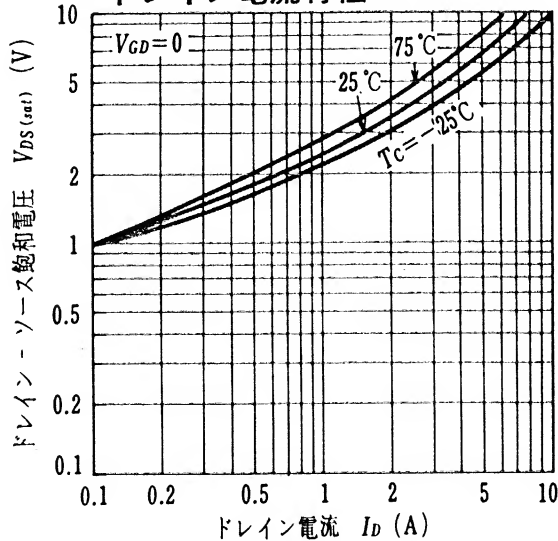
2SK227 安全動作領域



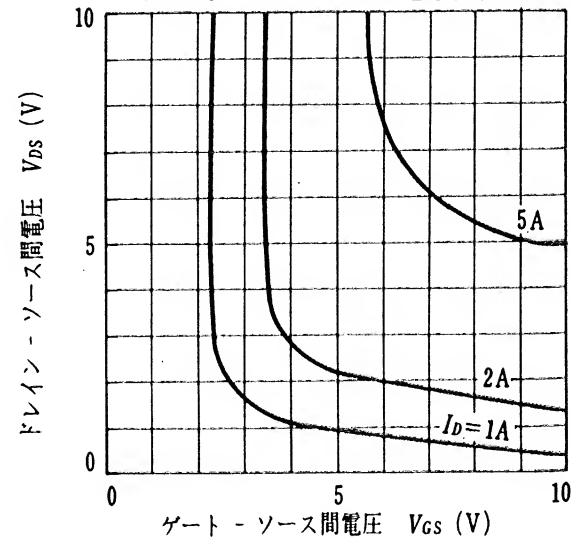
ソース接地伝達特性



ドレイン-ソース間飽和電圧対ドレイン電流特性



ドレイン-ソース間電圧対ゲート-ソース間電圧特性



# 2SK242

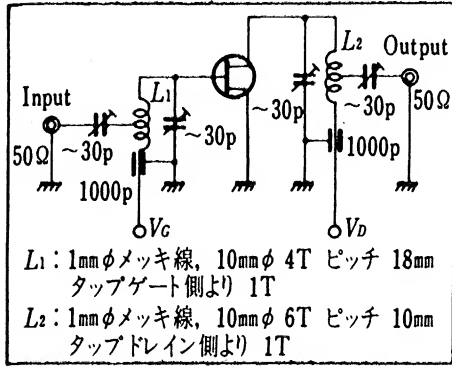
## Si 接合型 Nチャンネル

三 洋

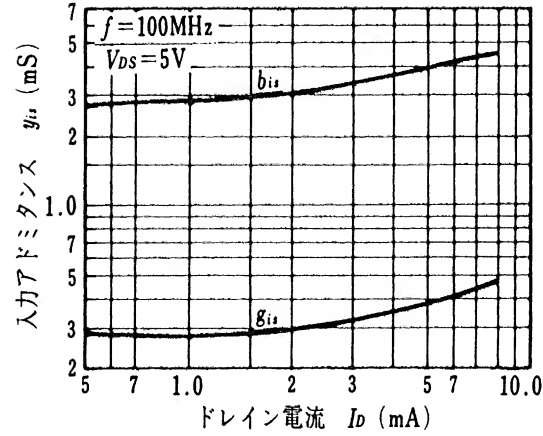
$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

0.6	C	1.5	1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

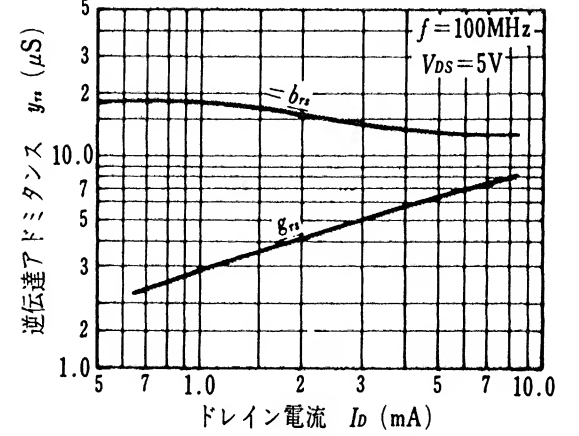
PG, NF 測定回路



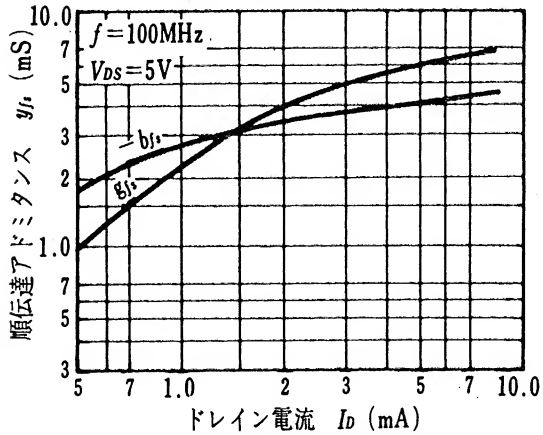
$y_{is} - I_D$  特性



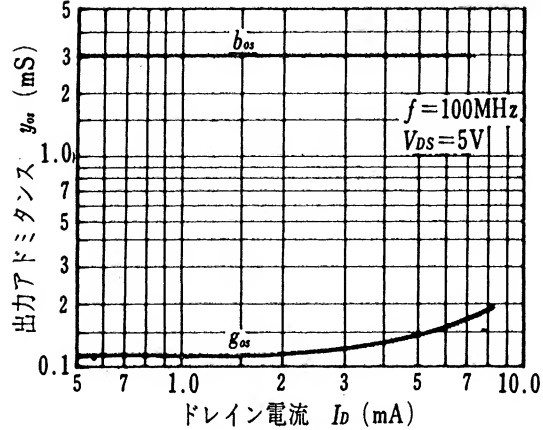
$y_{rs} - I_D$  特性



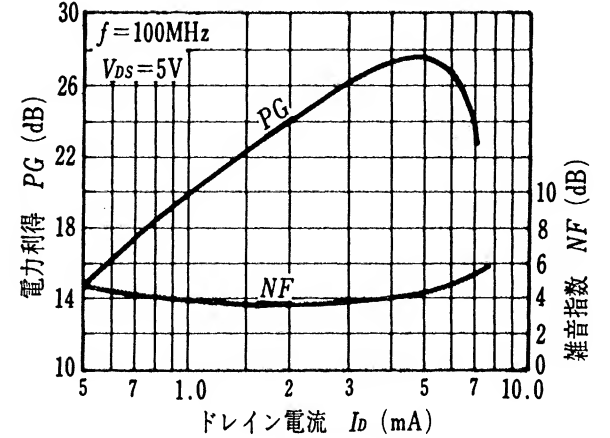
$y_{fs} - I_D$  特性



$y_{os} - I_D$  特性



PG, NF -  $I_D$  特性



# 2SK247

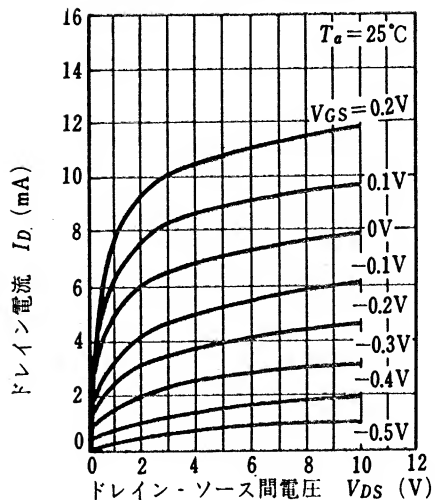
Si 接合型  
Nチャンネル

松下

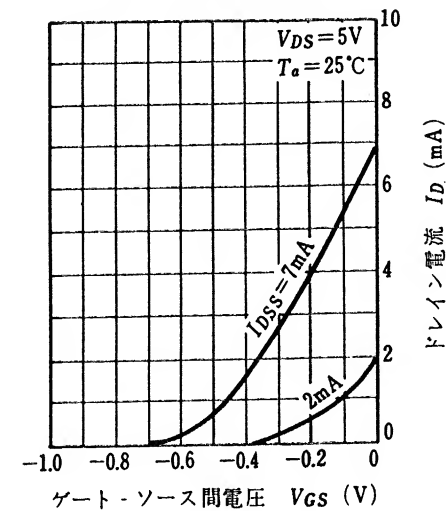
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~1.5	1~3	2~6	4~12

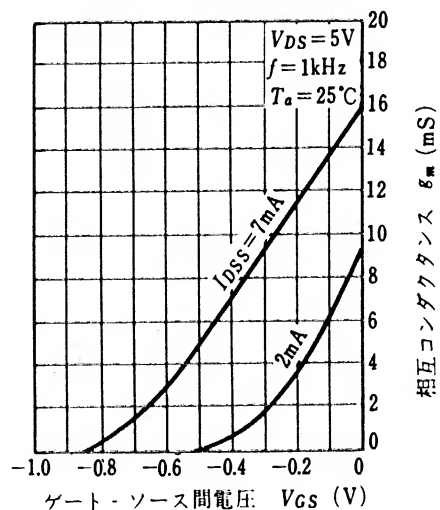
$I_D - V_{DS}$  特性



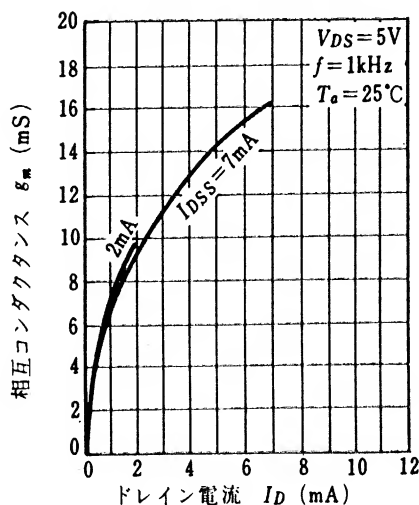
$I_D - V_{GS}$  特性



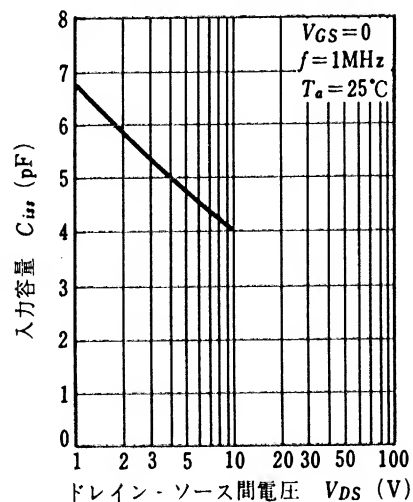
$g_m - V_{GS}$  特性



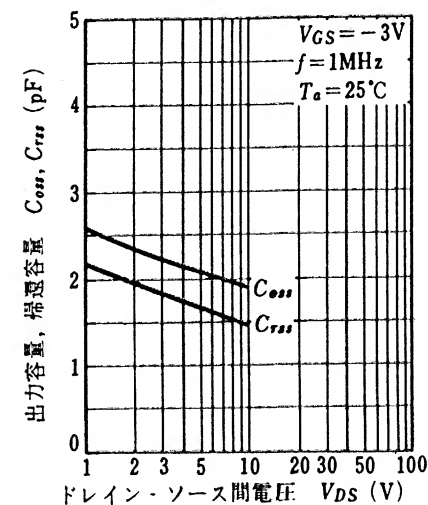
$g_m - I_D$  特性



$C_{iss} - V_{DS}$  特性



$C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性

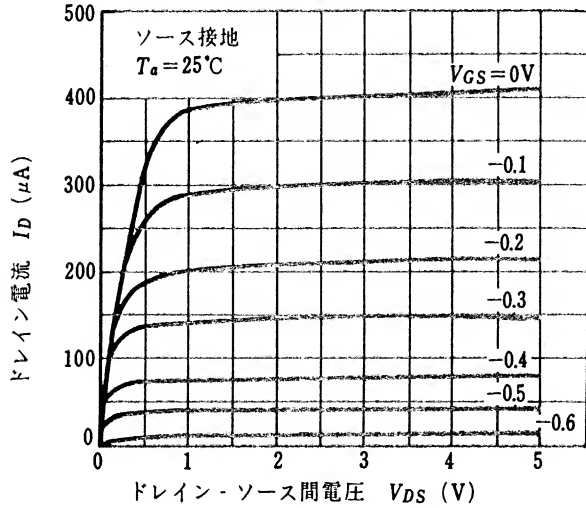


# 2SK266

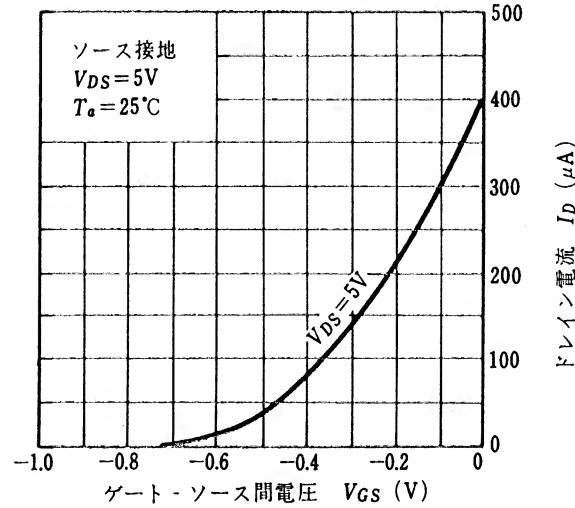
## Si 接合型 Nチャンネル

東 芝

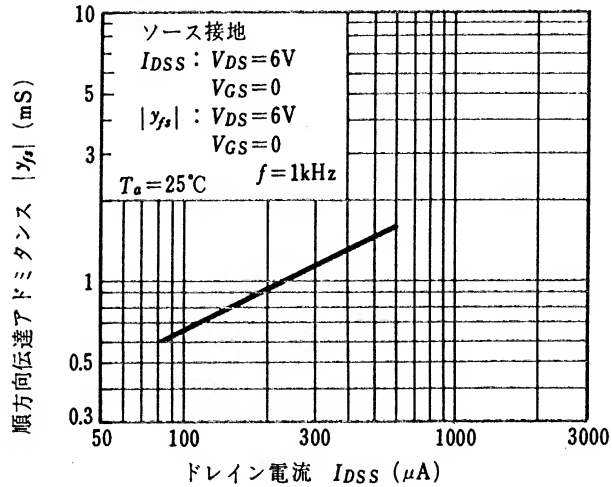
### $I_D - V_{DS}$ 特性



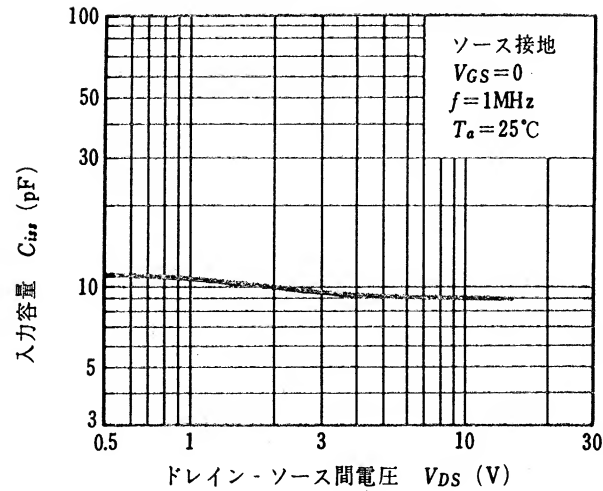
### $I_D - V_{GS}$ 特性



### $|y_{fs}| - I_{DSS}$ 特性



### $C_{iss} - V_{DS}$ 特性

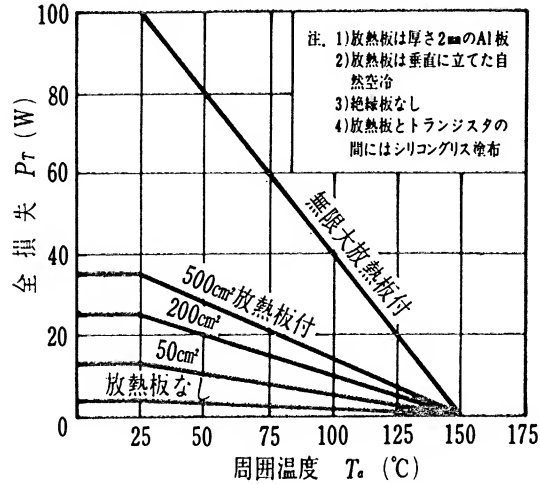


# 2SK277, 278

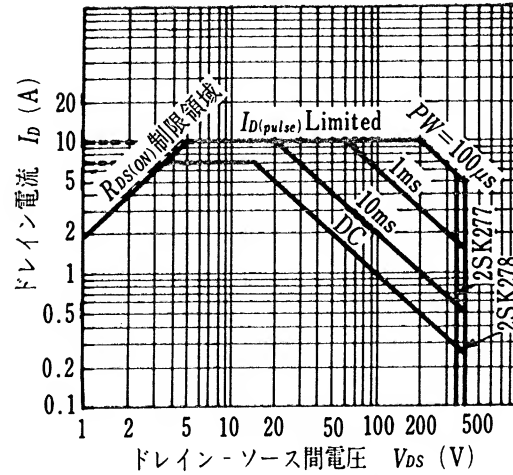
Si MOS型  
Nチャンネル

日 電

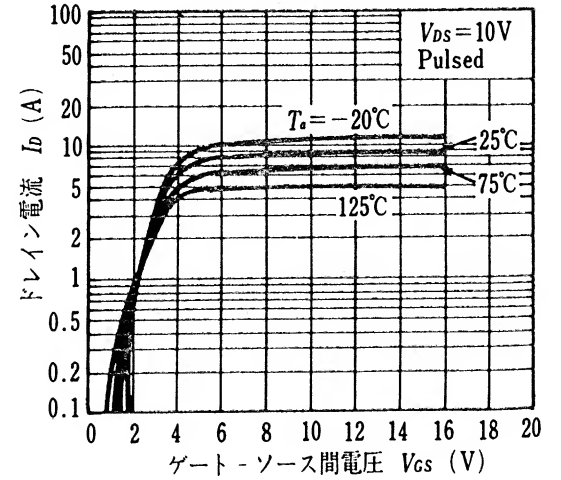
$P_T - T_a$  特性



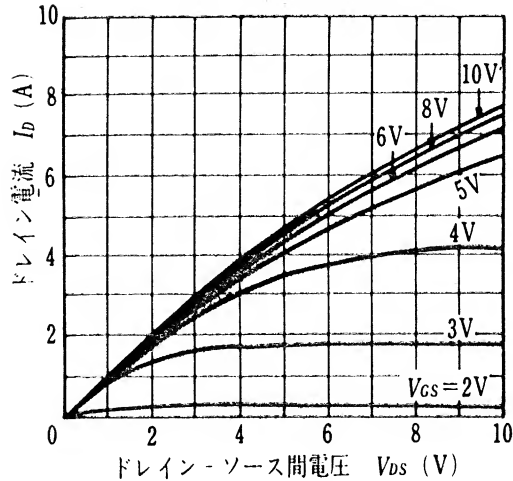
安全動作領域



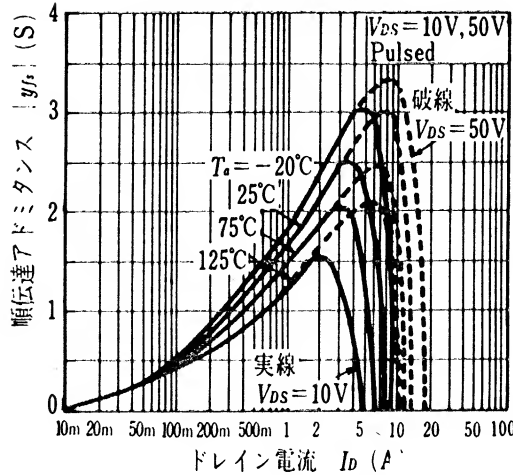
$I_D - V_{GS}$  特性



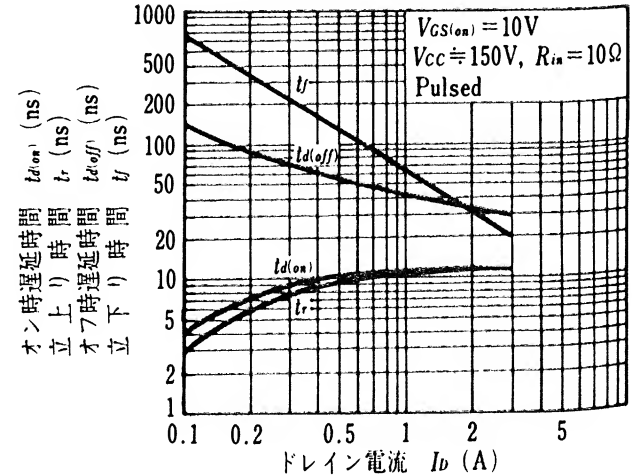
$I_D - V_{DS}$  特性



$|y_{fs}| - I_D$  特性



スイッチング特性

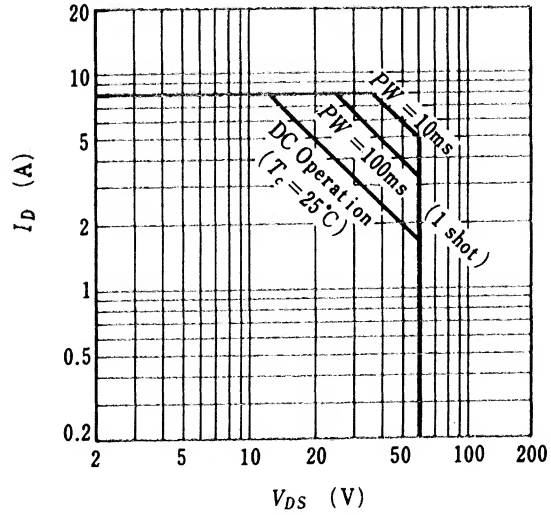


# 2SK286

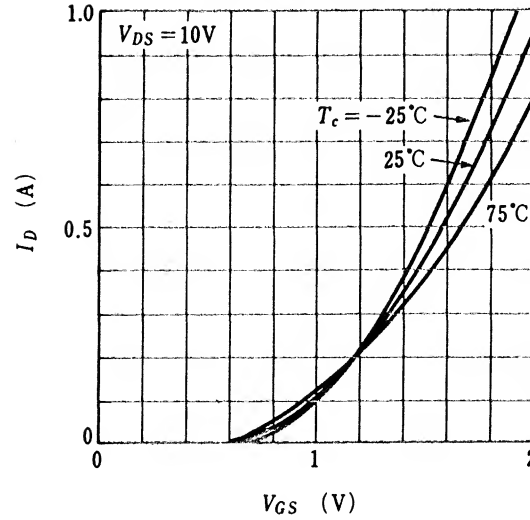
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

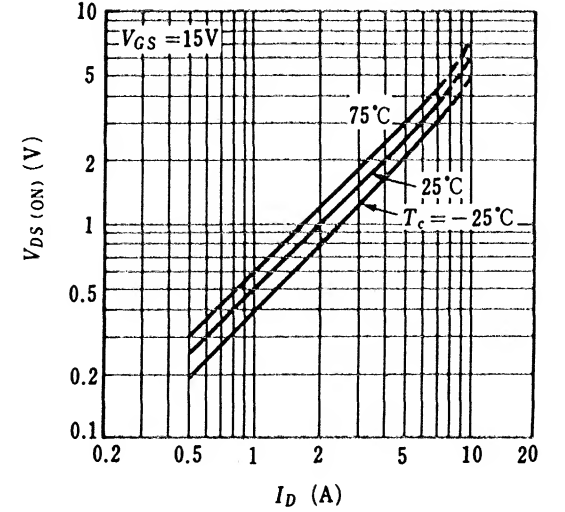
安全動作領域



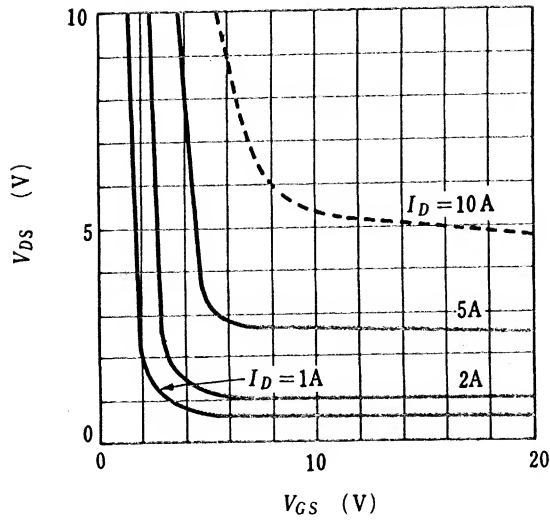
伝達特性



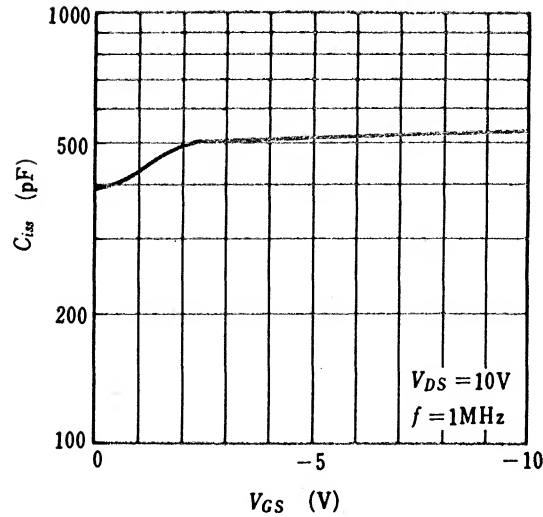
$V_{DS(ON)} - I_D$  特性



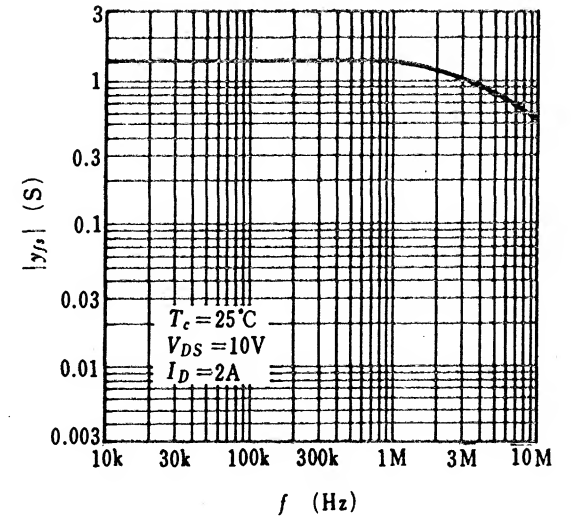
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



$C_{iss} - V_{GS}$  特性



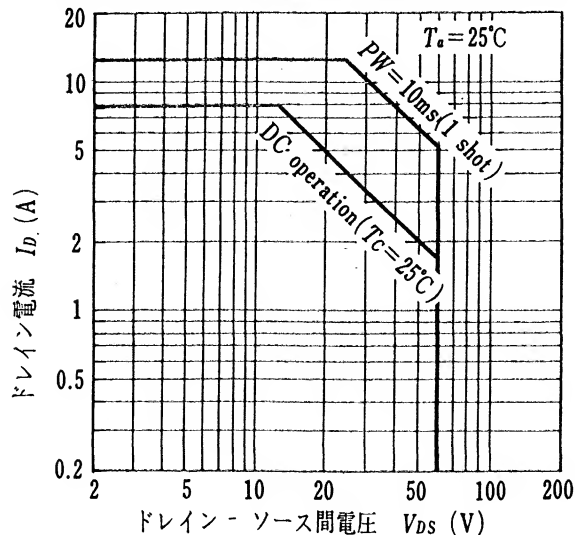
$|y_{fs}| - f$  特性



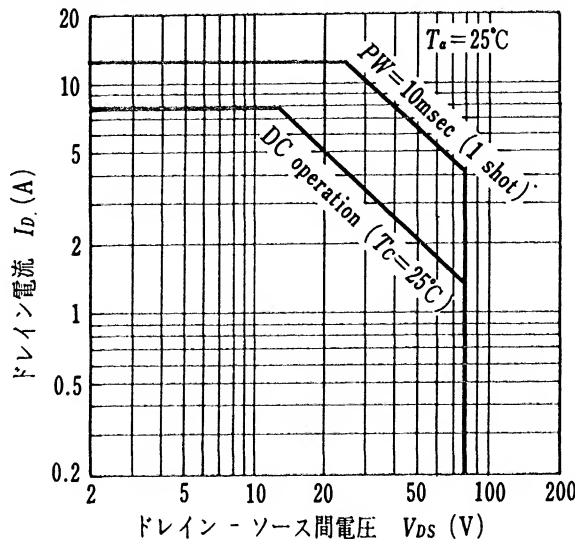
# 2SK287(K), 288(K)

Si MOS型  
Nチャンネル

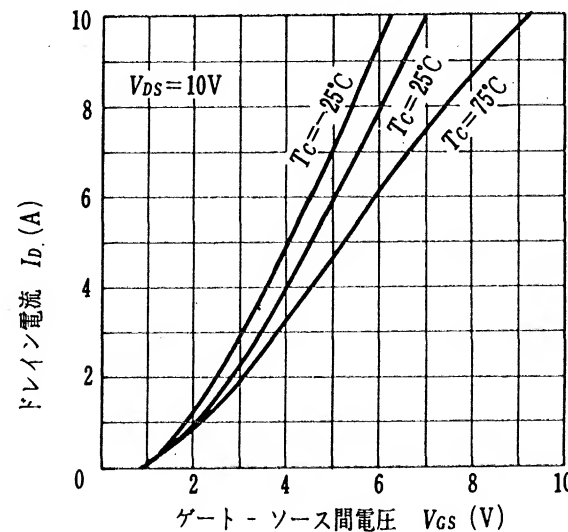
2SK287 (K) 安全動作領域 (A.S.O.)



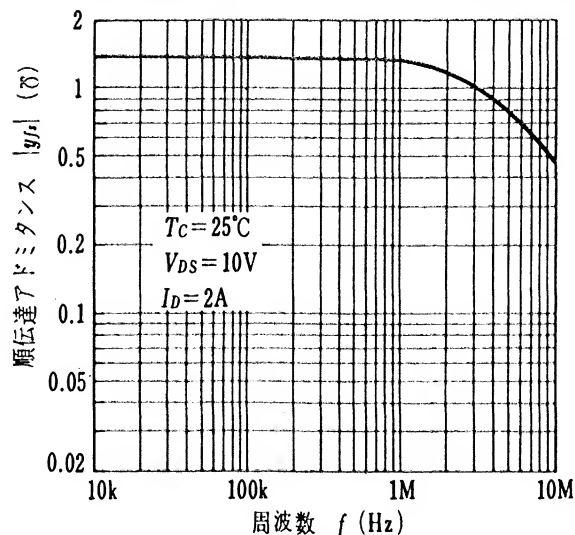
2SK288 (K) 安全動作領域 (A.S.O.)



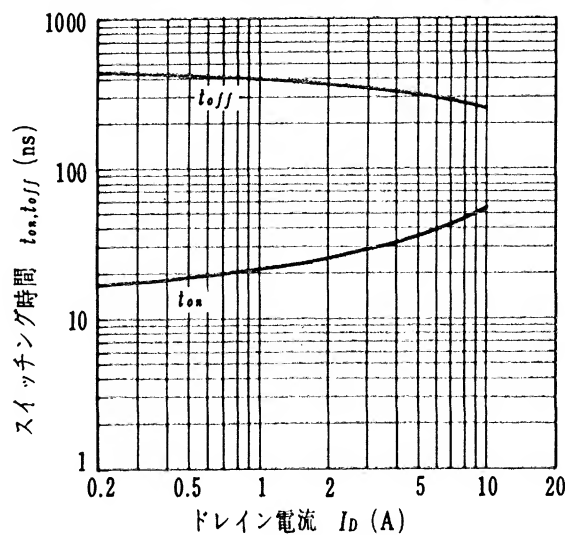
ソース接地伝達静特性



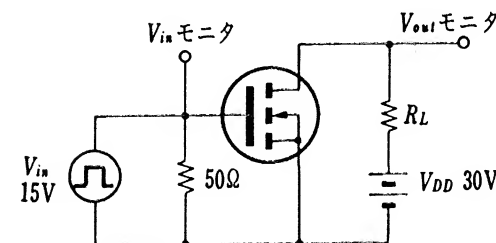
順伝達アドミタンス対周波数特性



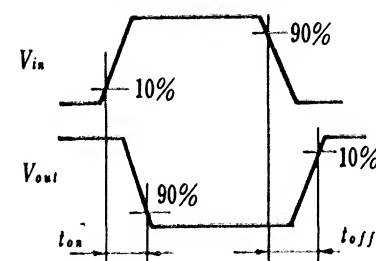
スイッチング時間対ドレイン電流特性



スイッチング時間測定回路



応答波形





# 2SK291

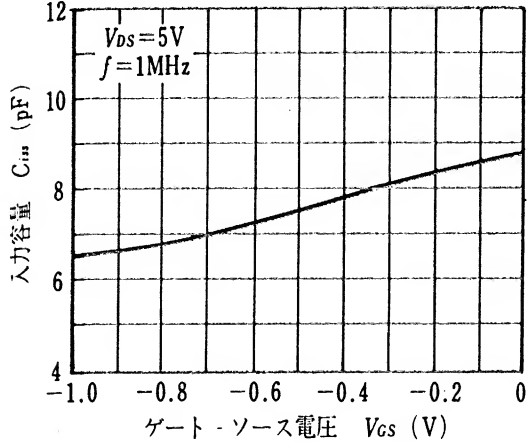
## Si 接合型 Nチャンネル

日立

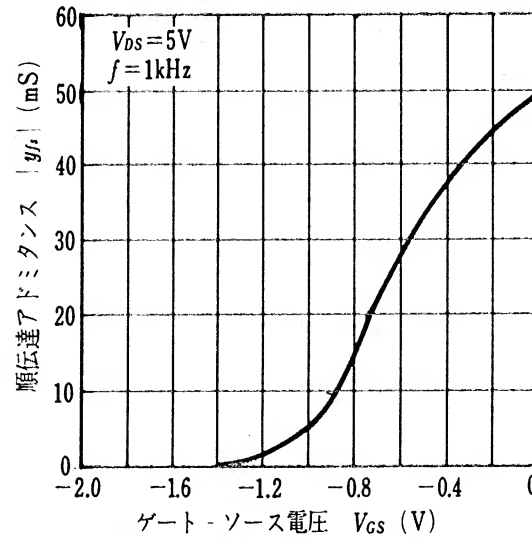
$I_{DSS}$ 区分

E	F	G	H
6~12	10~20	16~32	25~50

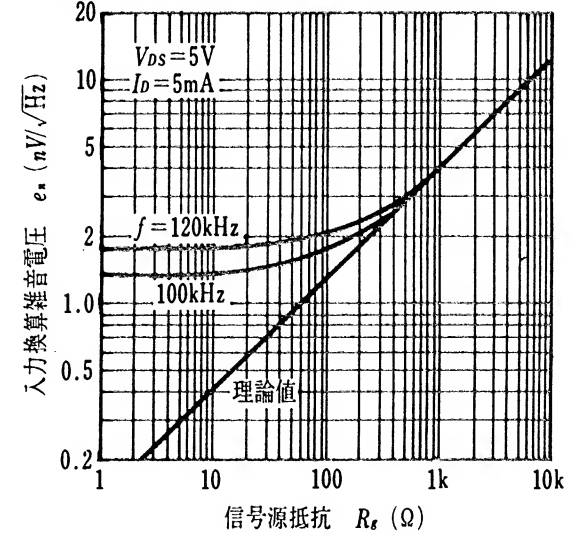
入力容量対ゲート・ソース電圧特性



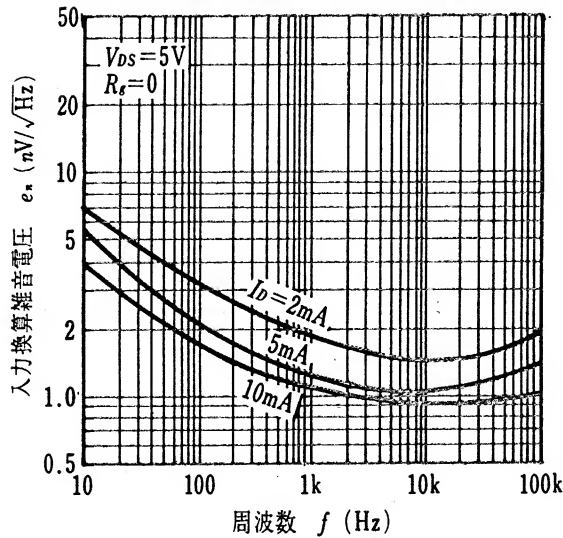
順伝達アドミタンス対  
ゲート・ソース電圧特性



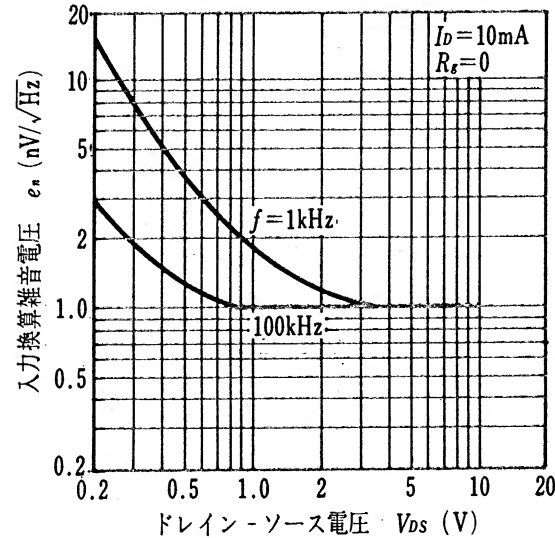
入力換算雑音電圧対信号源抵抗特性



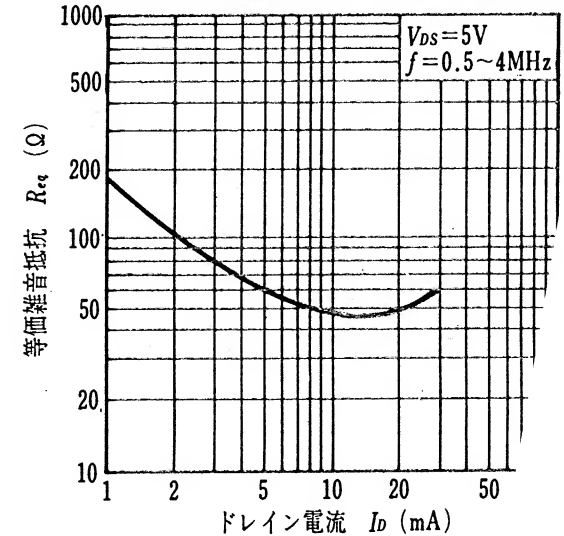
入力換算雑音電圧対周波数特性



入力換算雑音電圧対  
ドレイン・ソース電圧特性



等価雑音抵抗対ドレイン電流特性

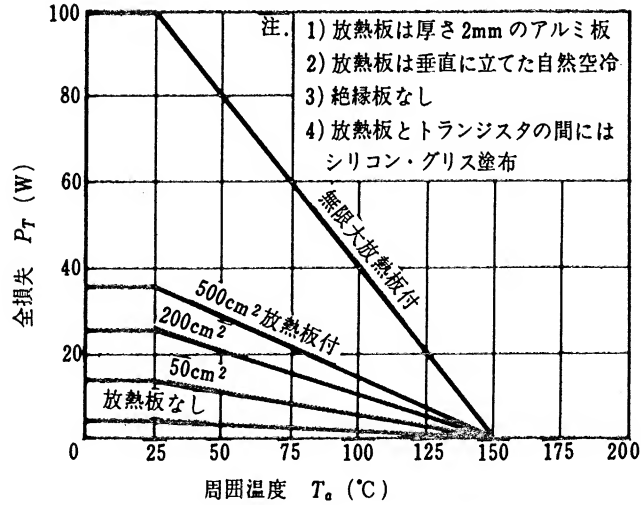


# 2SK293, 293A

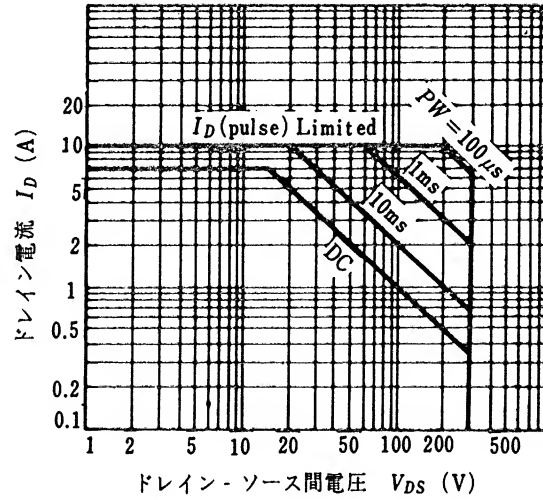
Si MOS 型  
Nチャンネル

日 電

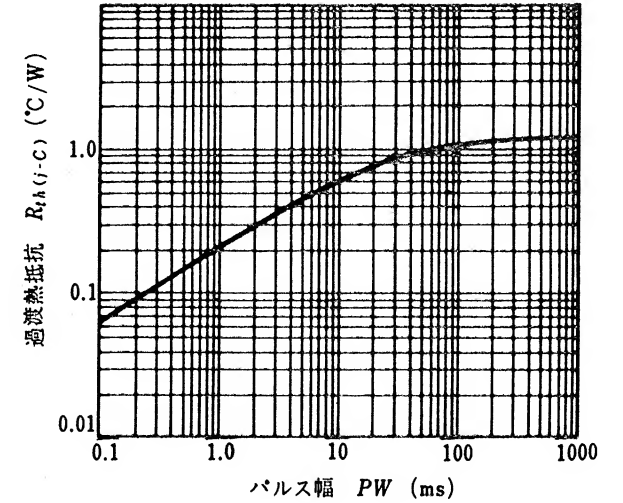
PT - Ta 特性



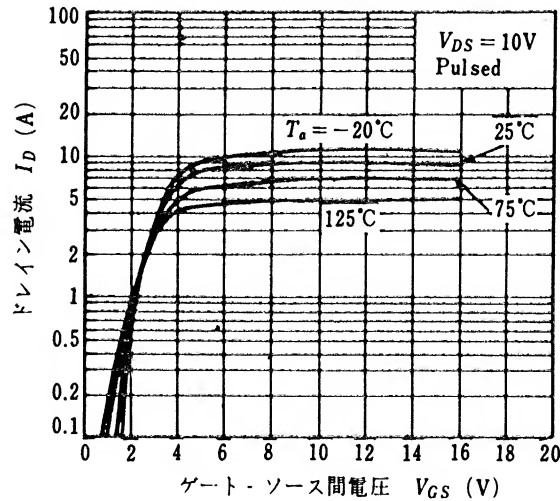
安全動作領域



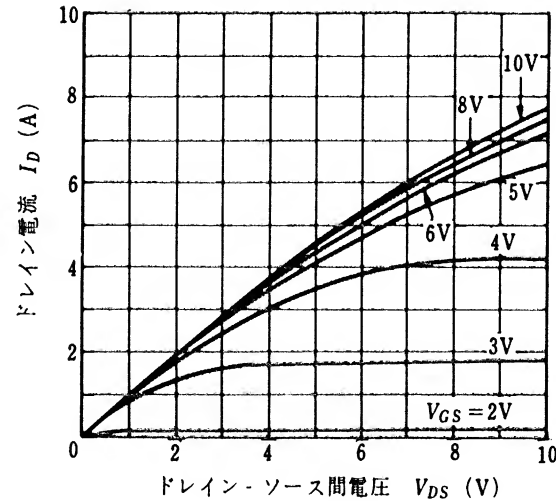
過渡熱抵抗特性



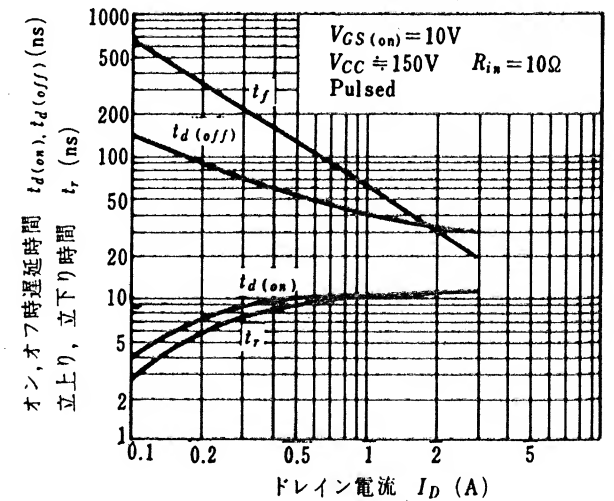
ID - VGS 特性



ID - VDS 特性



スイッチング特性

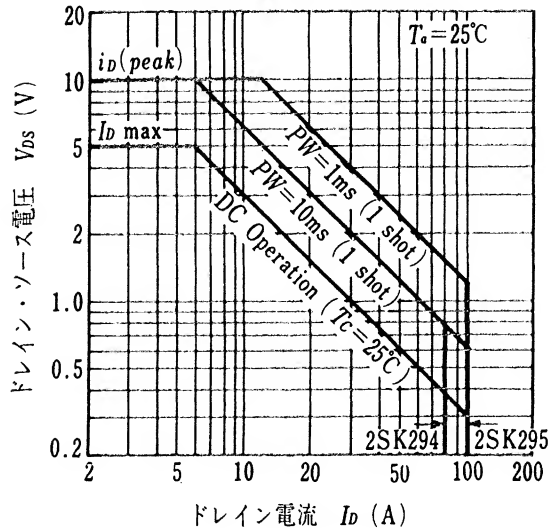


# 2SK294, 295

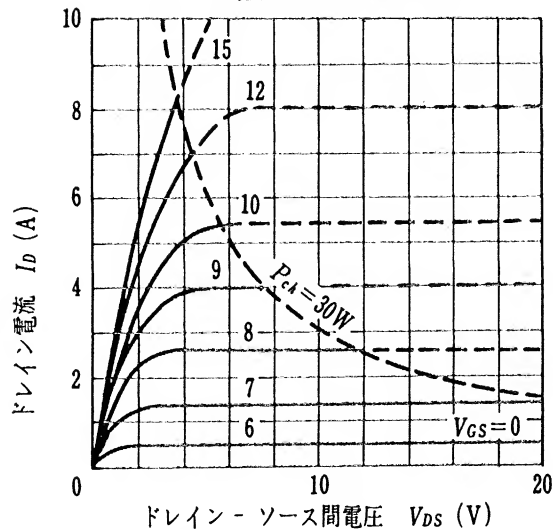
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

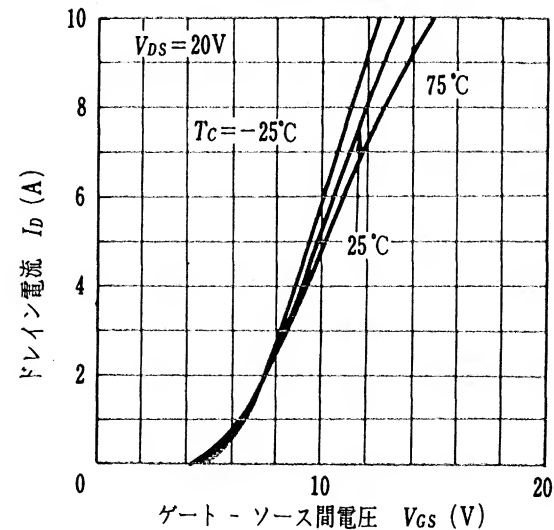
安全動作領域



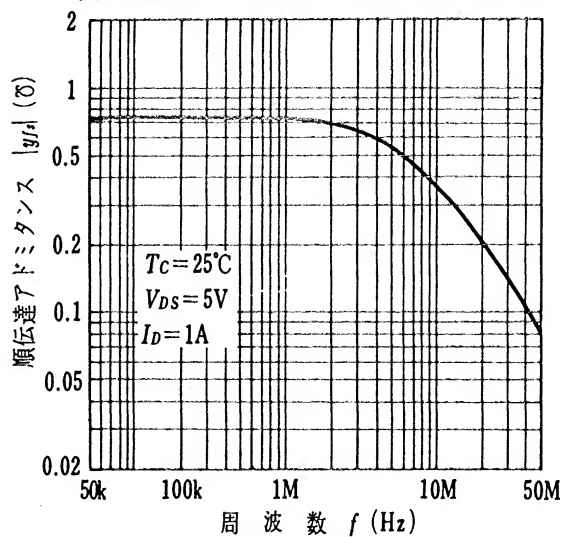
ソース接地出力静特性



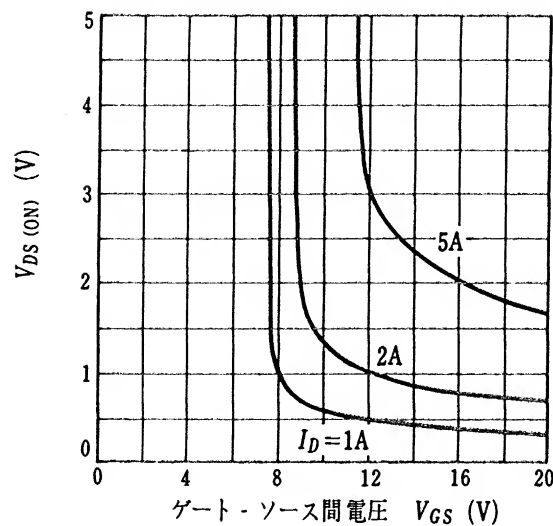
ソース接地伝達静特性



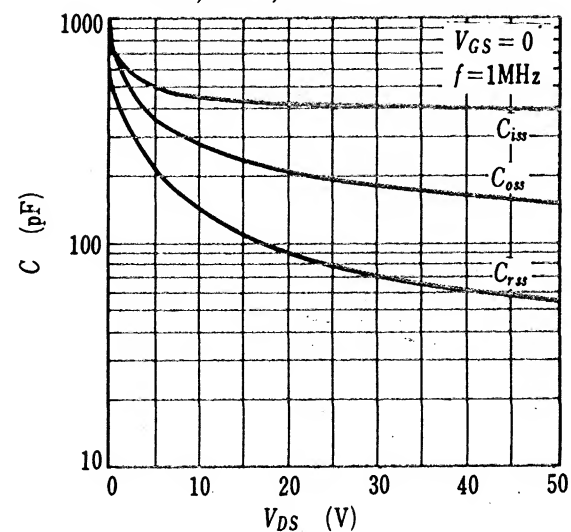
順伝達アドミタンス対周波数特性



V\_DS (ON) - V\_GS 特性



C<sub>iss</sub>, C<sub>oss</sub>, C<sub>rss</sub> - V\_DS 特性

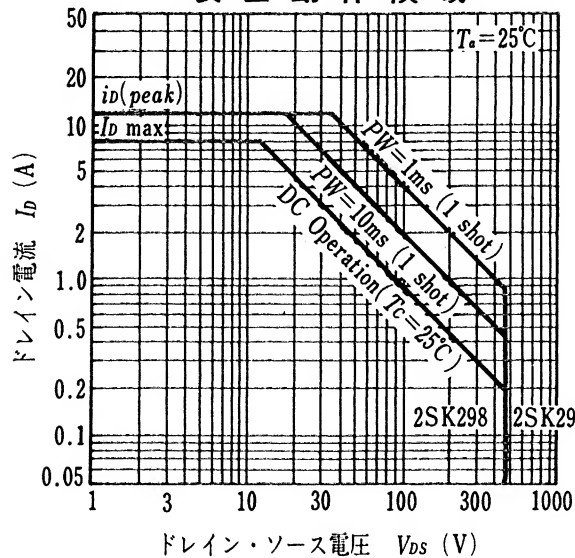


# 2SK298, 299

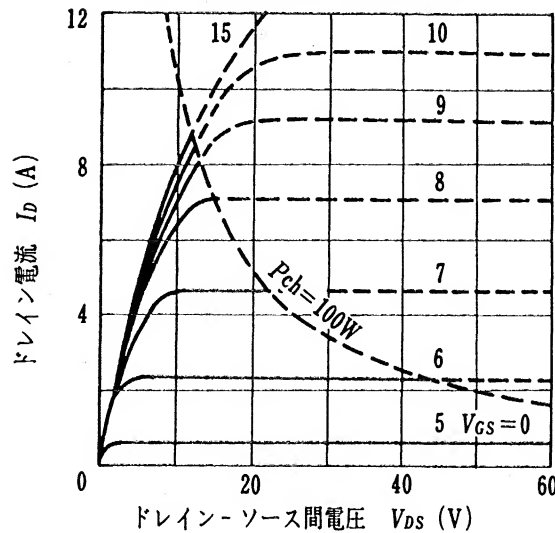
Si MOS型  
Nチャンネル

日立

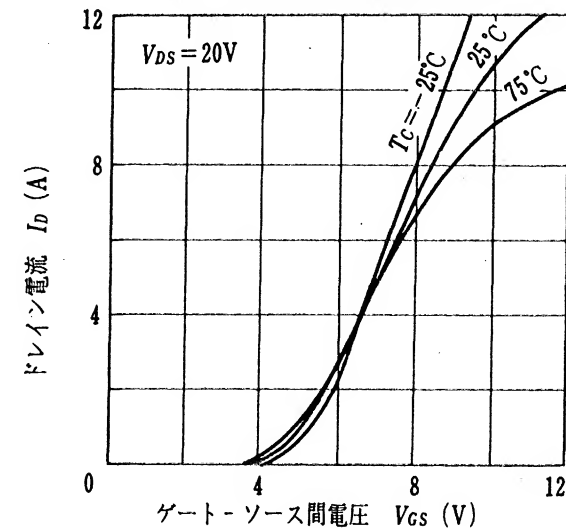
安全動作領域



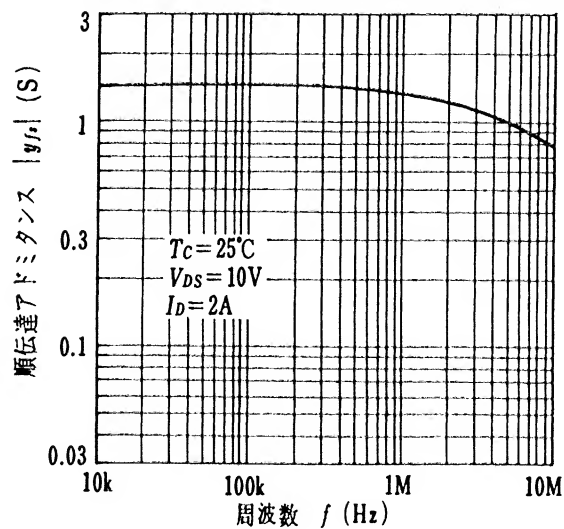
ソース接地出力静特性



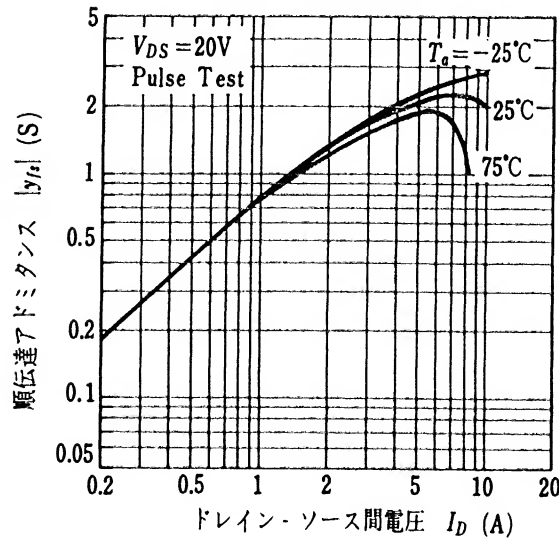
ソース接地伝達静特性



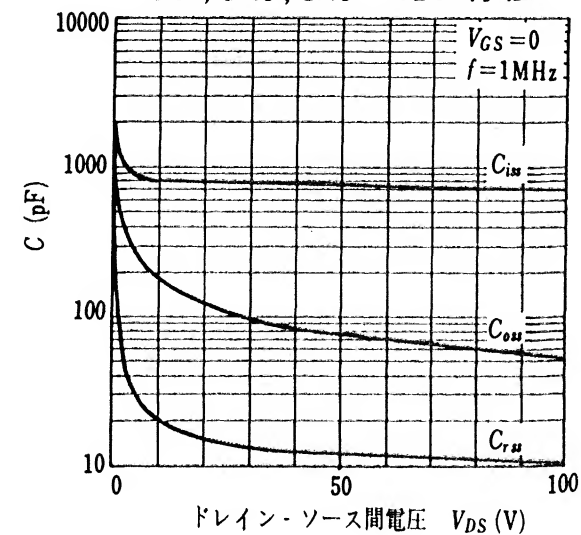
順伝達アドミタンス対周波数特性



|Yfs| - Id 特性



Ciss, Coss, Crss - Vds 特性



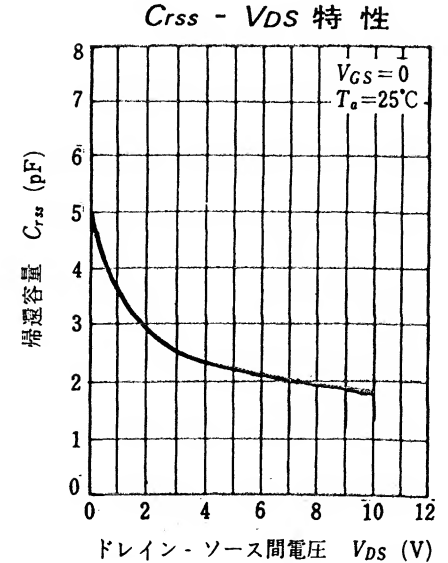
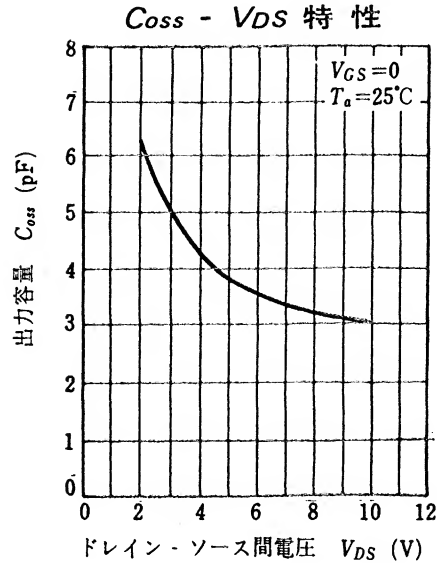
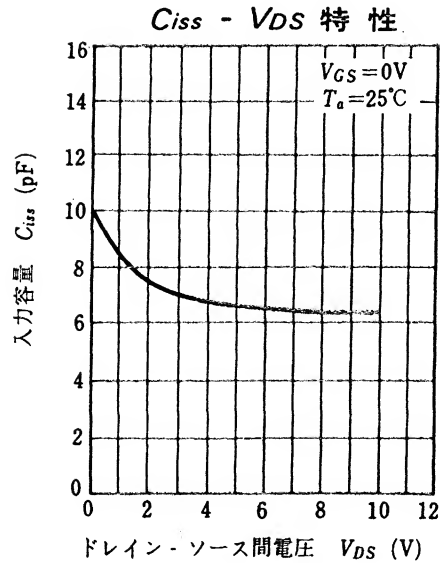
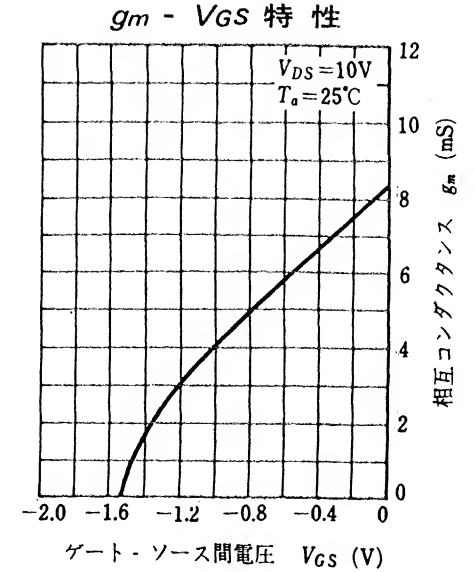
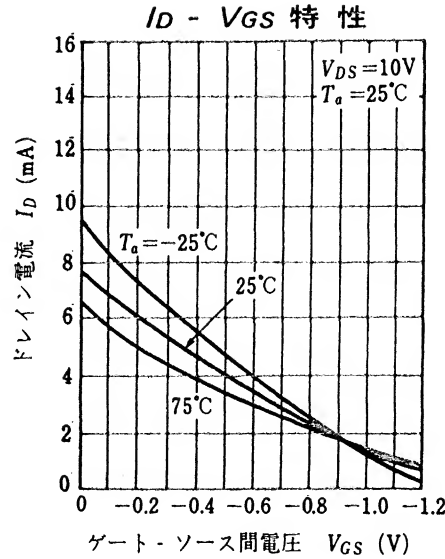
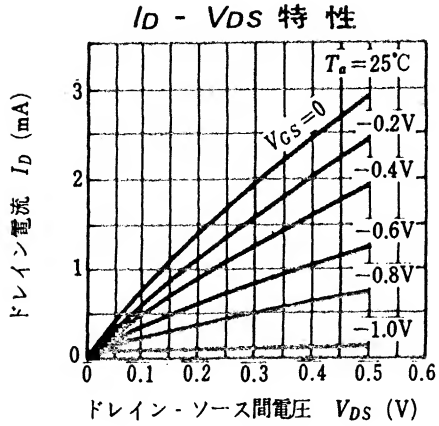
# 2SK301, 374

Si 接合型  
Nチャンネル

松下

$I_{DSS}$  ランク分類

	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	1~3	2~6.5	5~12	10~20



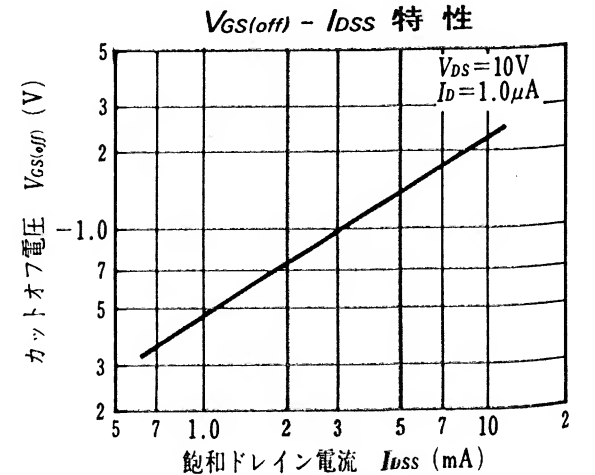
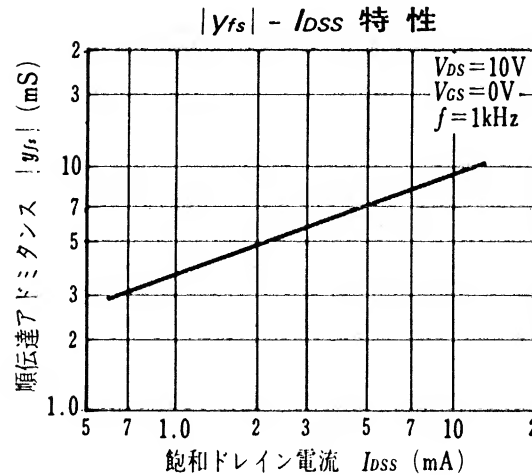
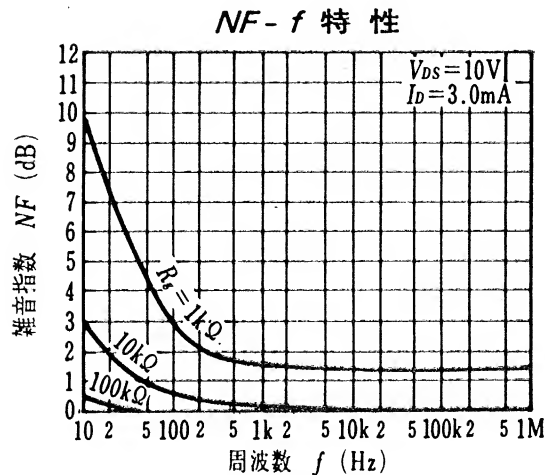
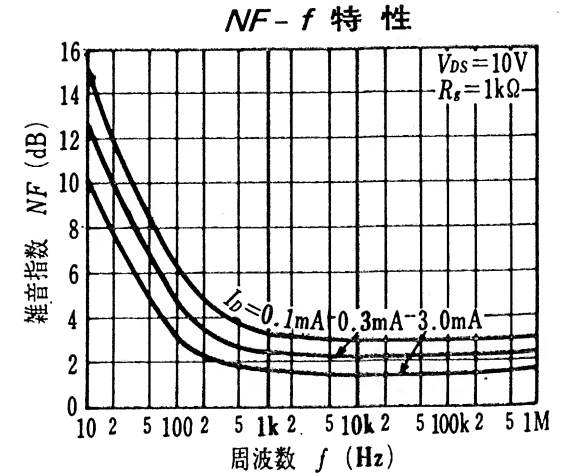
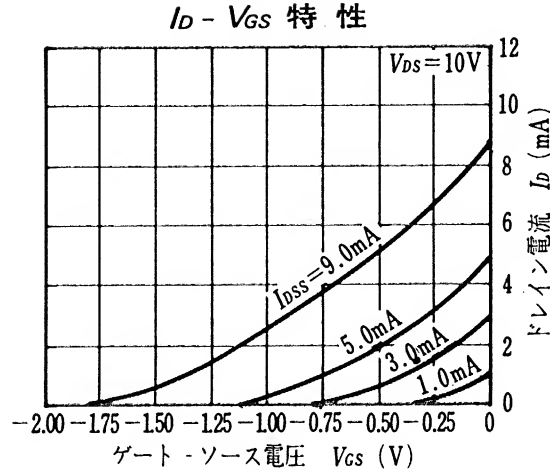
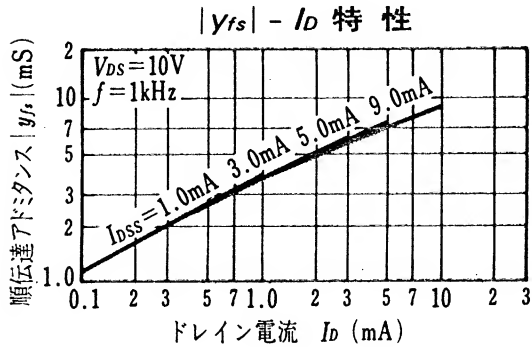
# 2SK303, 304

Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

0.6 C	1.5	1.2 D	3.0	2.5 E	6.0	5.0 F	12.0
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	------

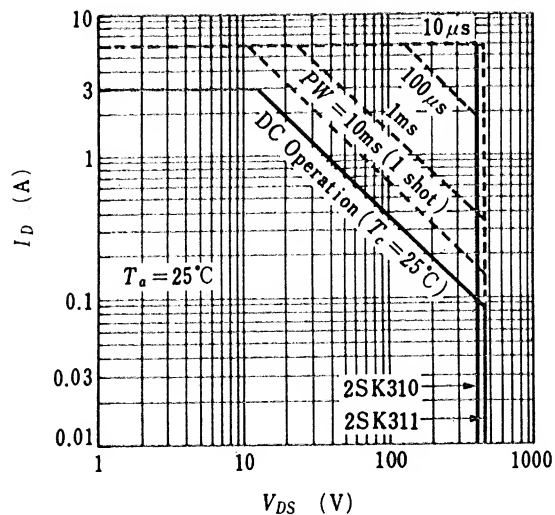


# 2SK310, 311

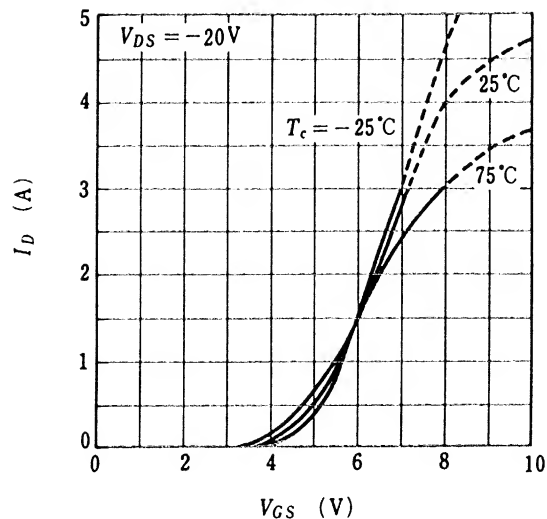
Si MOS型  
Nチャンネル

日立

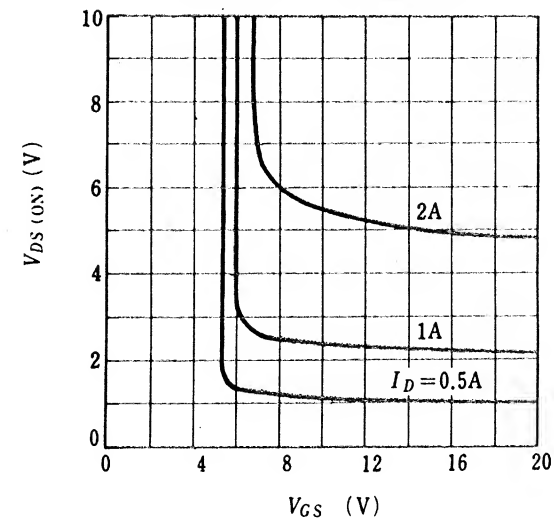
安全動作領域



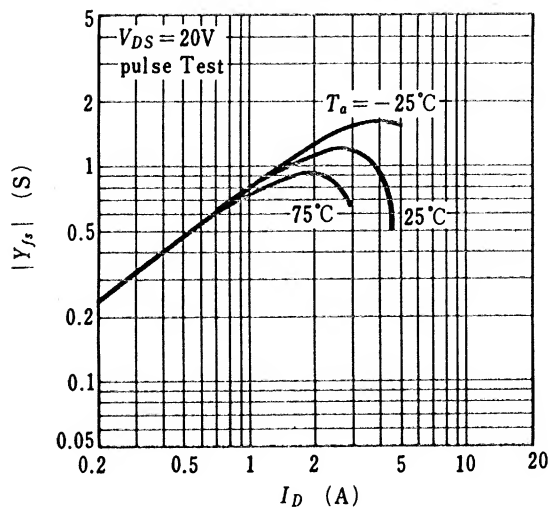
伝達特性



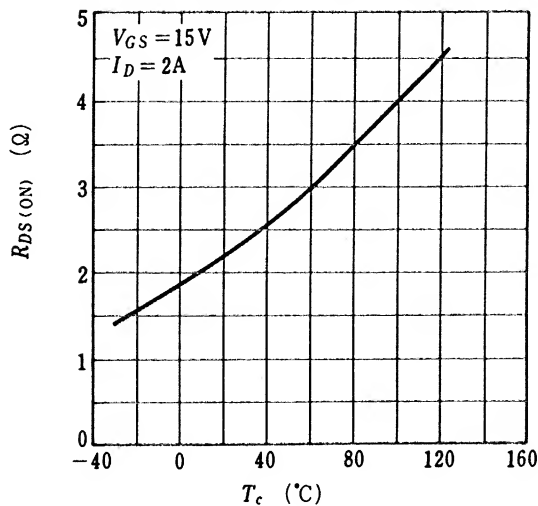
$V_{DS}$  (ON) -  $V_{GS}$  特性



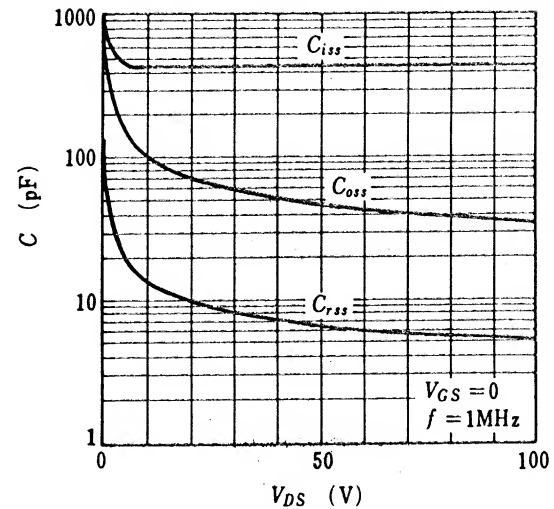
$|Y_{fs}|$  -  $I_D$  特性



$R_{DS}$  (ON) -  $T_c$  特性



$C_{iss}$ ,  $C_{oss}$ ,  $C_{rss}$  -  $V_{DS}$  特性



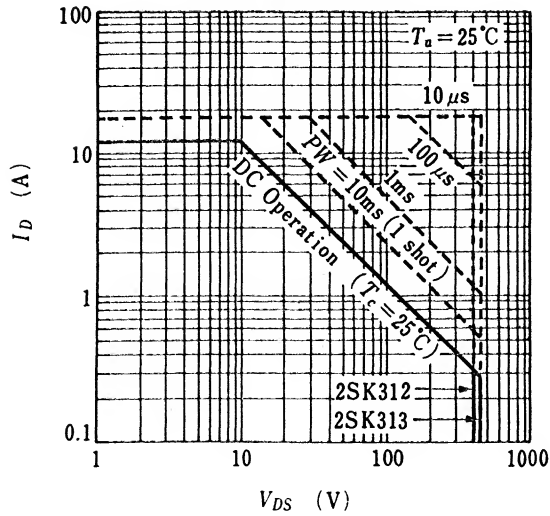


# 2SK312, 313

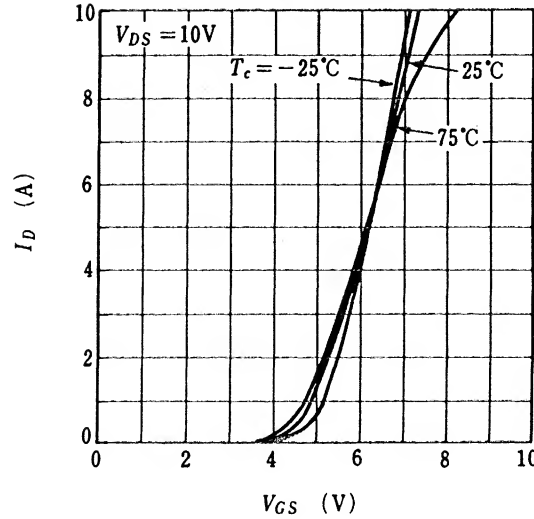
Si MOS 型  
Nチャンネル

日 立

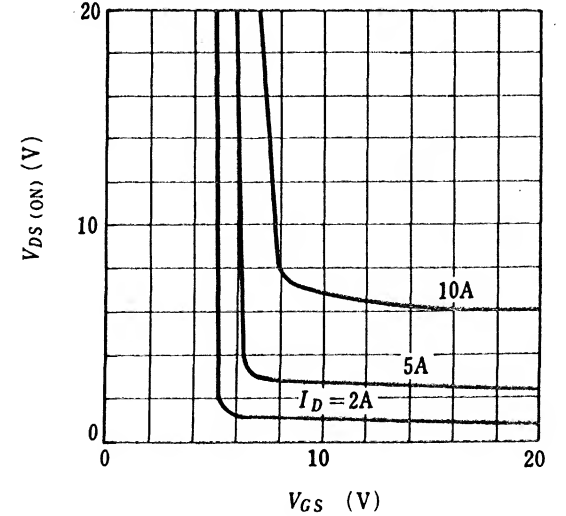
安全動作領域



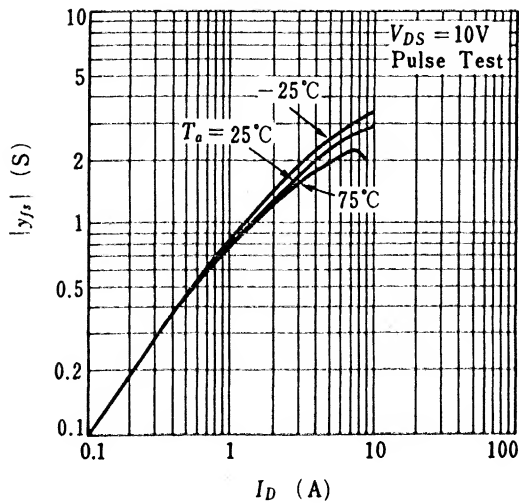
伝達特性



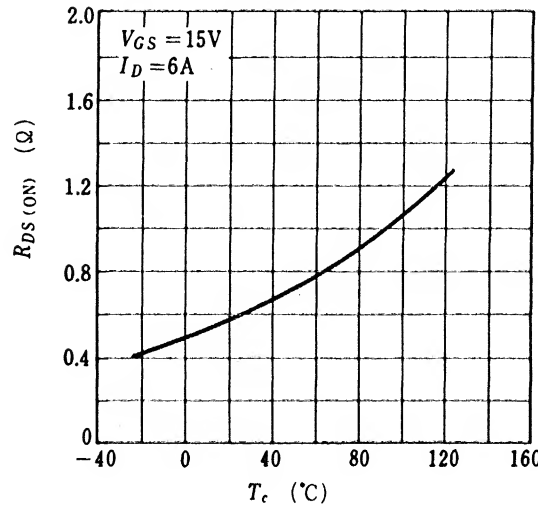
VDS(ON) - VGS 特性



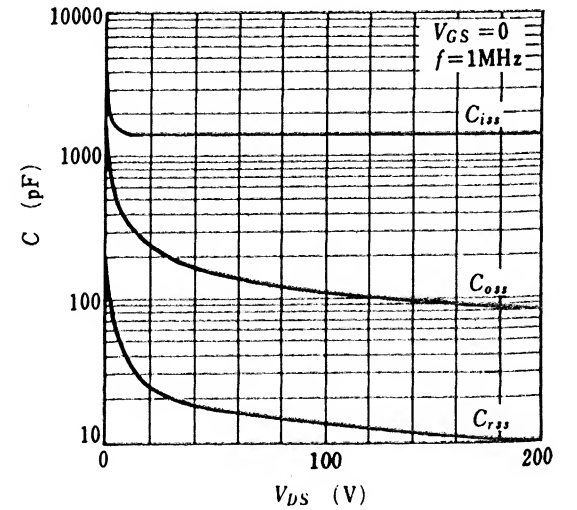
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(ON)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性





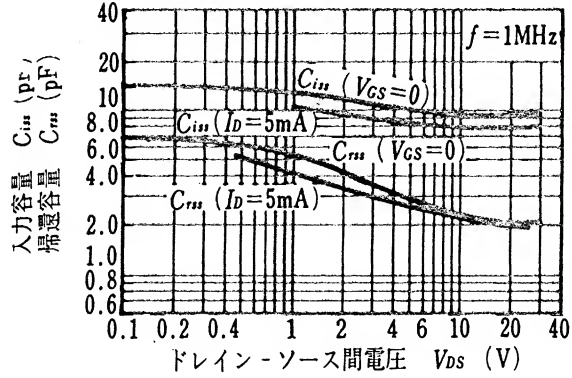
# 2SK314

## Si 接合型 Nチャンネル

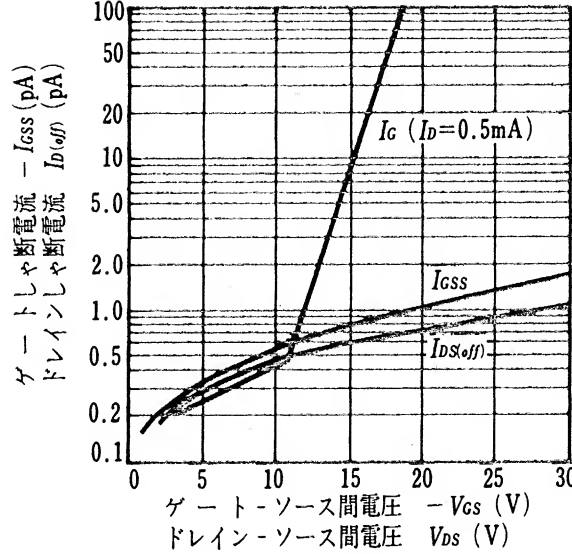
日 電

$I_{DSS}$ 区分 K: 5~12mA L: 11~18mA  
M: 17~24mA N: 23~30mA

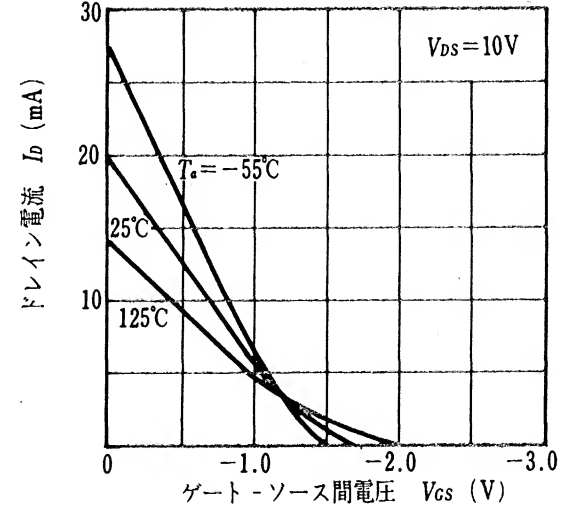
$C_{iss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



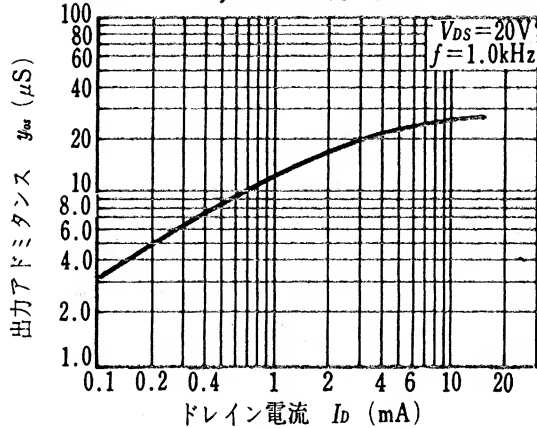
$I_{GSS} - V_{GS}$  特性  
 $I_{D(off)} - V_{DS}$  特性



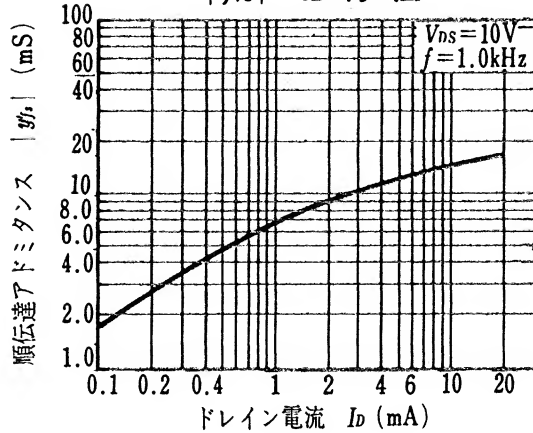
$I_D - V_{GS}$  特性



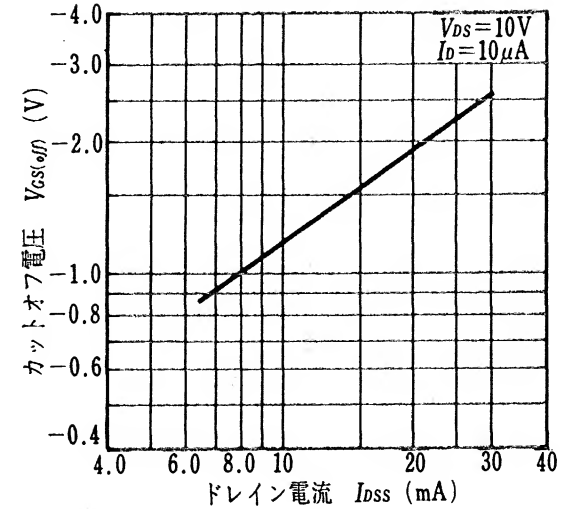
$y_{os} - I_D$  特性



$|y_{fs}| - I_D$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$

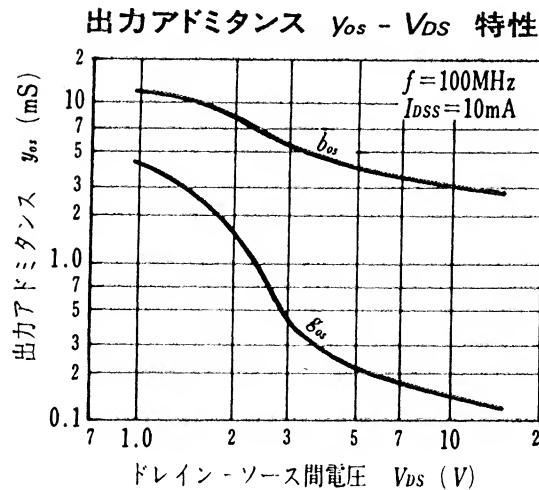
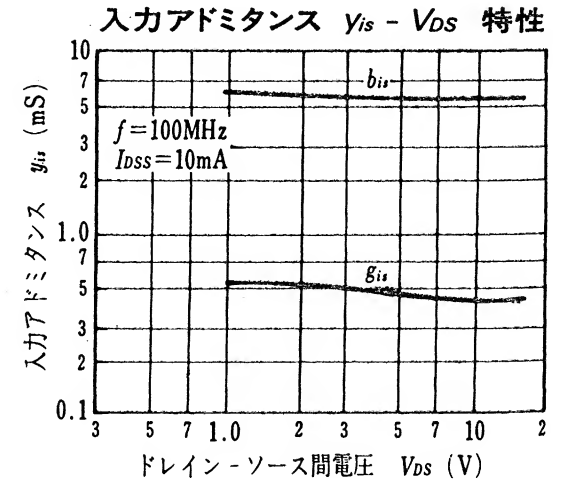
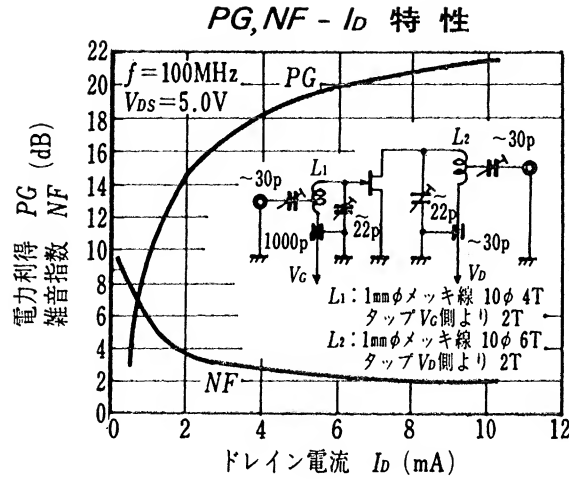
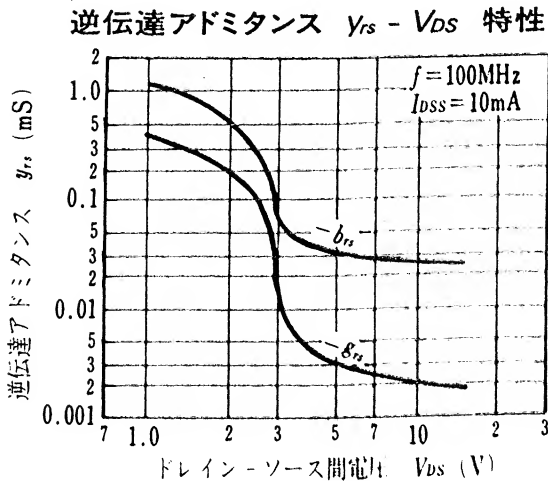
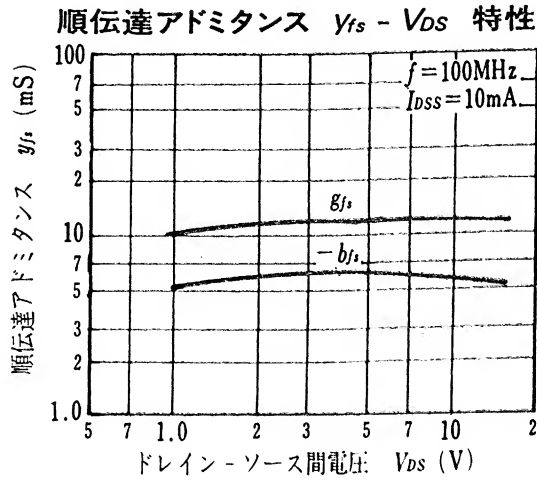


# 2SK315

## Si 接合型 Nチャンネル

$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

2.5	E	6.0	5.0	F	12.0	10.0	G	24.0
-----	---	-----	-----	---	------	------	---	------



# 2SK316

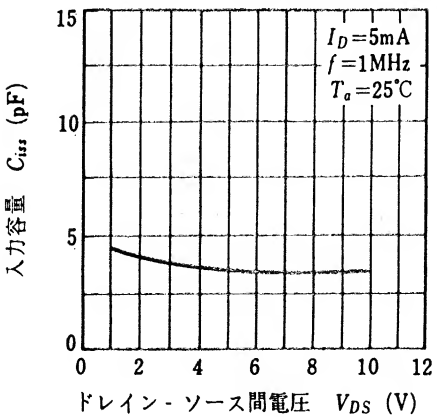
Si 接合型  
Nチャンネル

松下

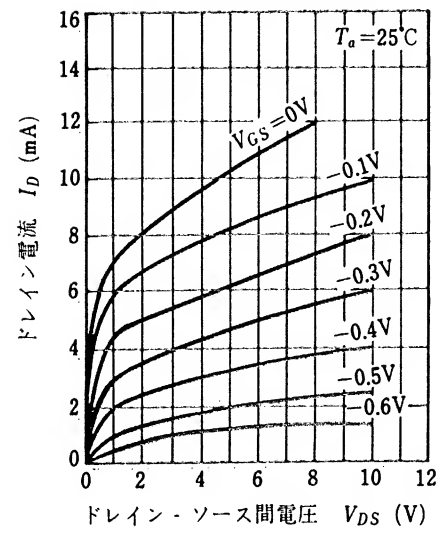
$I_{DSS}$  ランク分類

	P	Q
$I_{DSS}$ (mA)	5~16	14~24

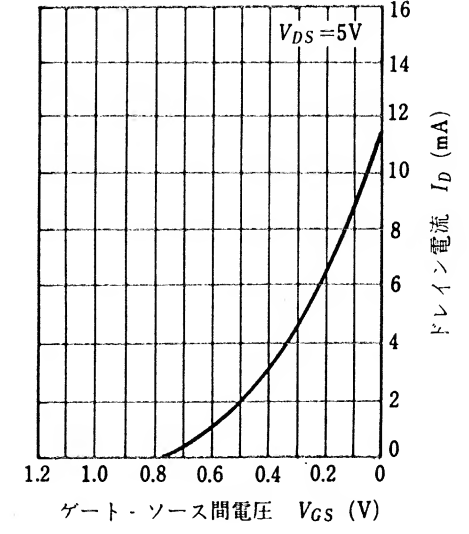
$C_{iss}$  -  $V_{DS}$  特性



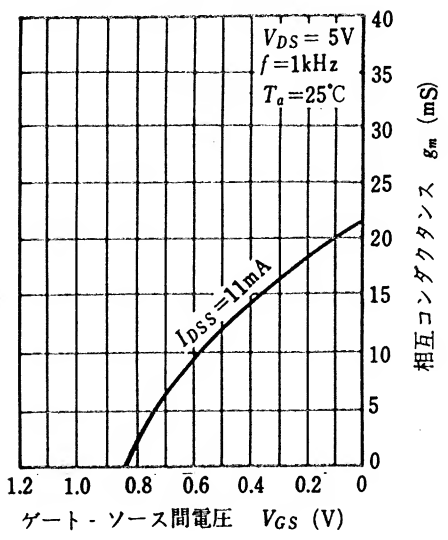
$I_D$  -  $V_{DS}$  特性



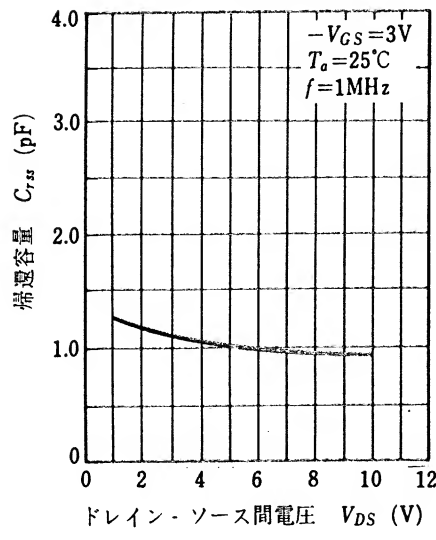
$I_D$  -  $V_{GS}$  特性



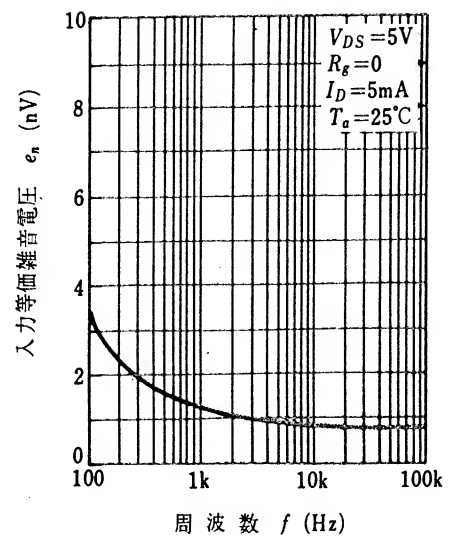
$g_m$  -  $V_{GS}$  特性



$C_{rss}$  -  $V_{DS}$  特性



$e_n$  -  $f$  特性

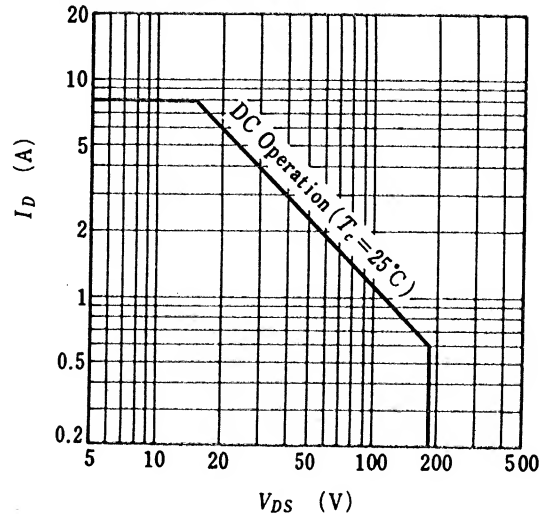


# 2SK317

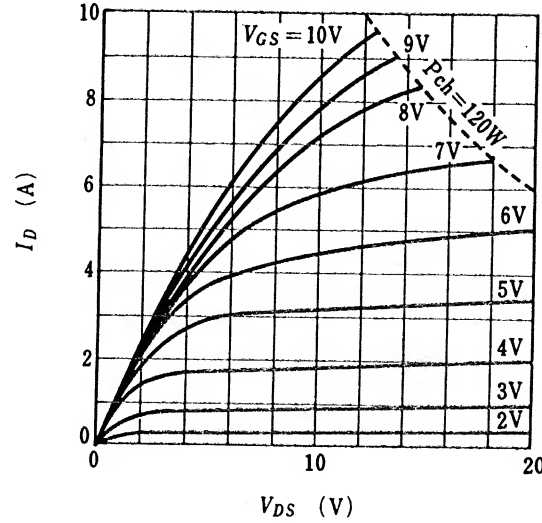
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

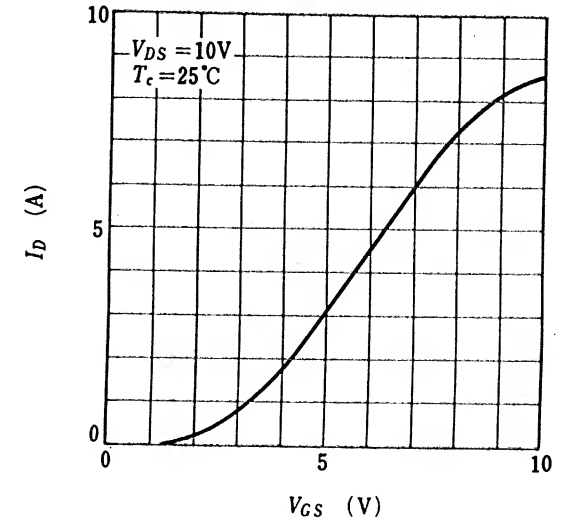
安全動作領域



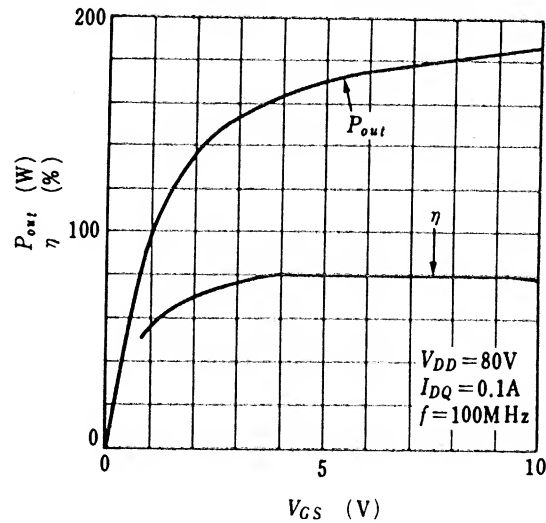
出力特性



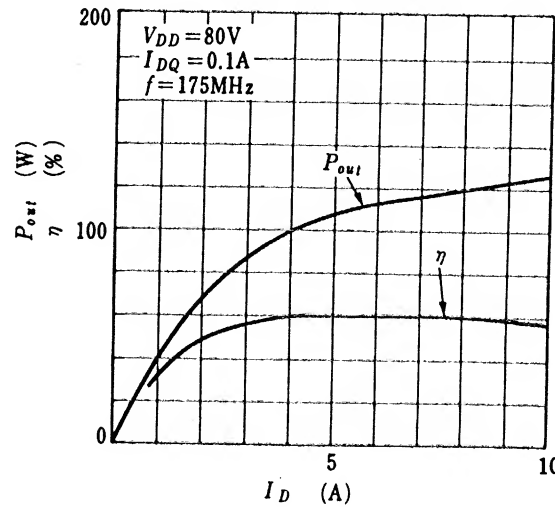
伝達特性



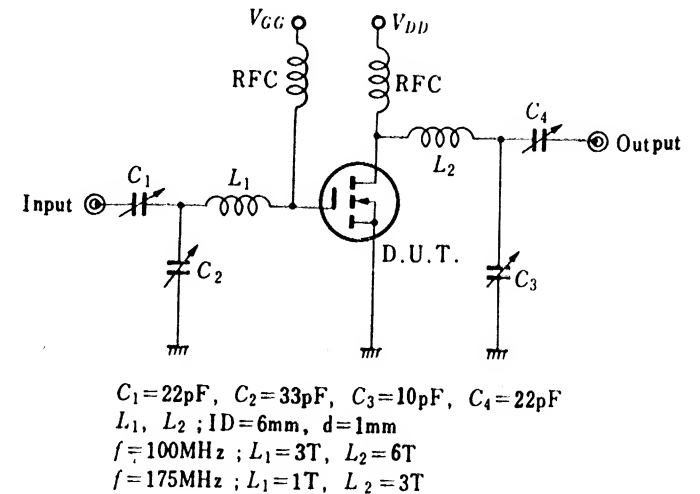
$P_{out}, \eta - V_{GS}$  特性



$P_{out}, \eta - I_D$  特性



電力測定回路

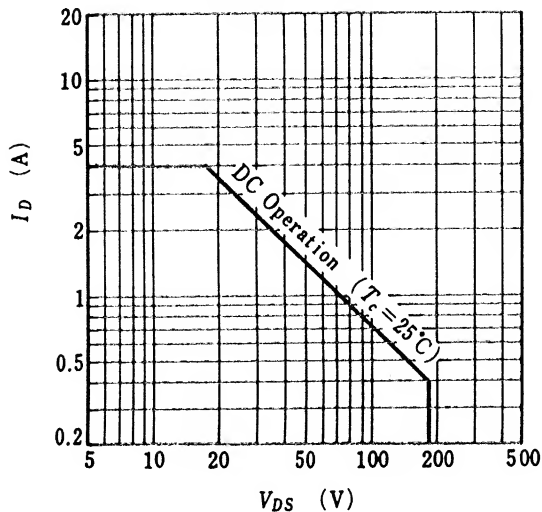


# 2SK318

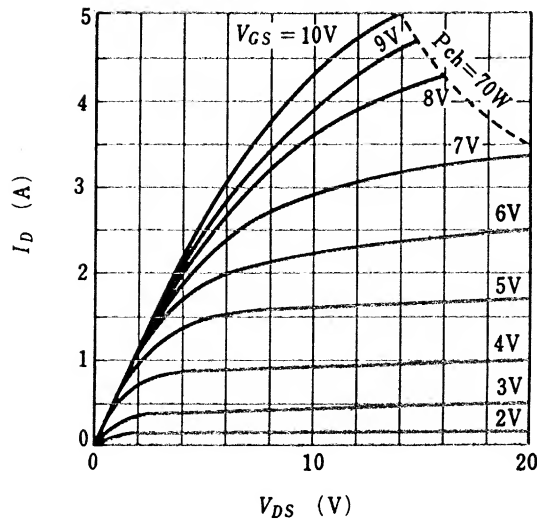
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

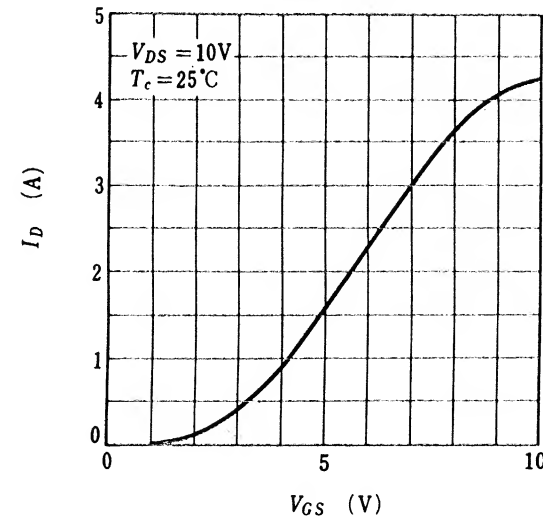
安全動作領域



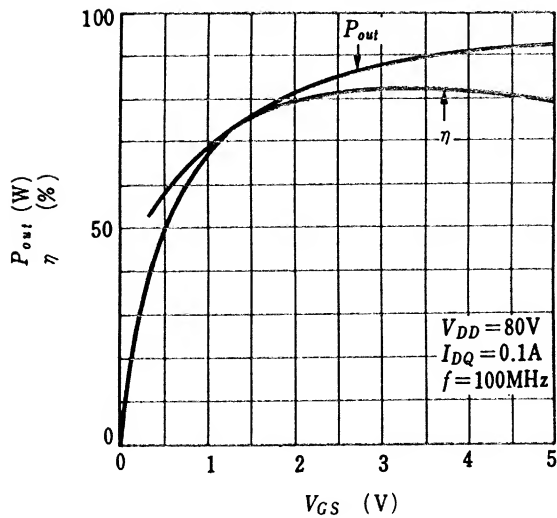
出力特性



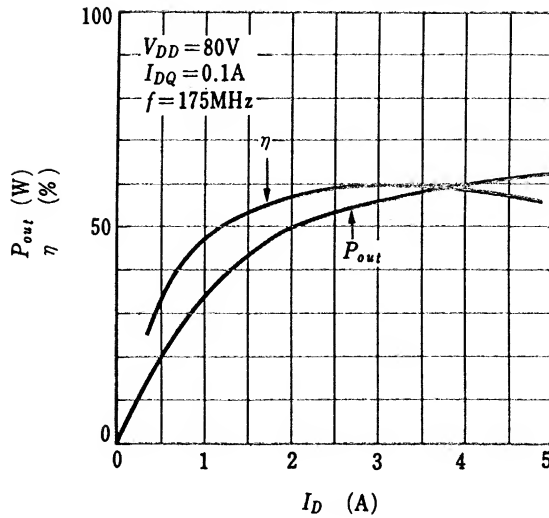
伝達特性



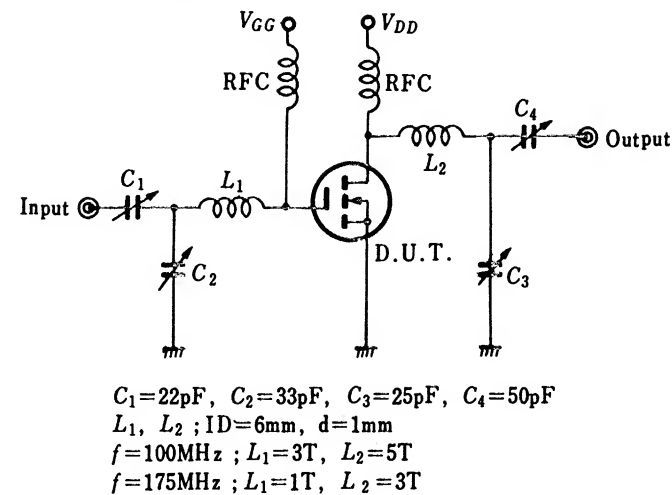
$P_{out}, \eta - V_{GS}$  特性



$P_{out}, \eta - I_D$  特性



電力測定回路

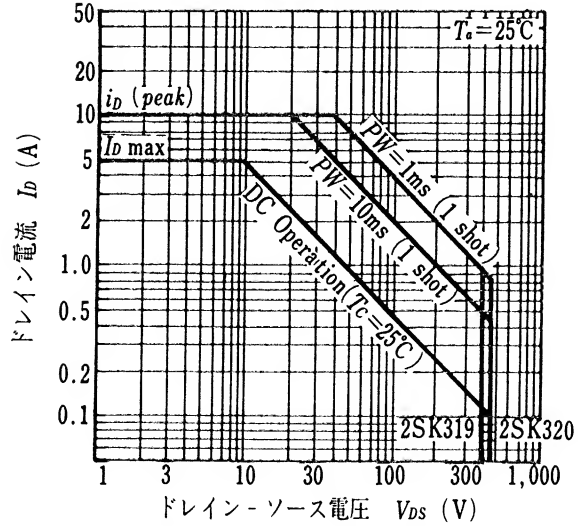


# 2SK319, 320

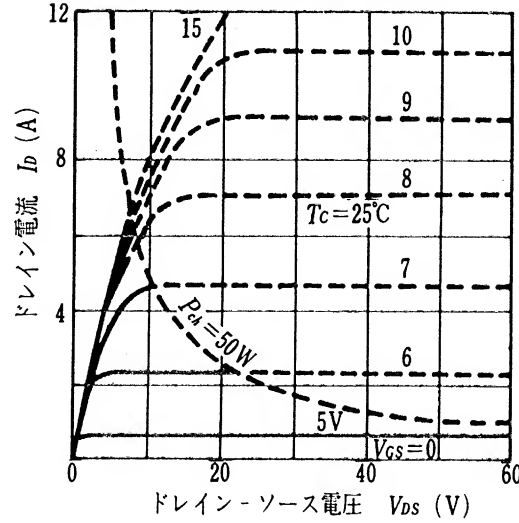
Si MOS型  
Nチャンネル

日立

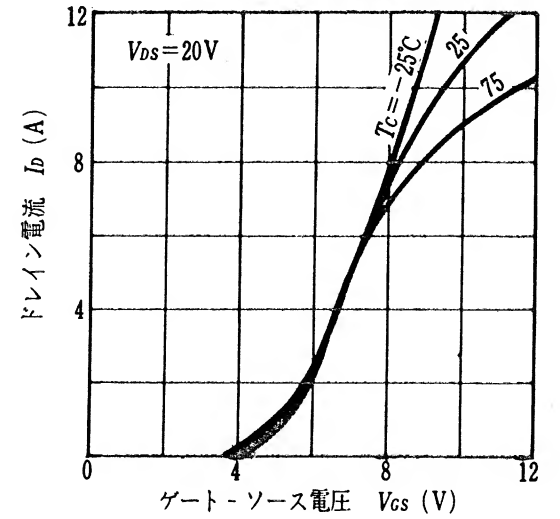
安全動作領域



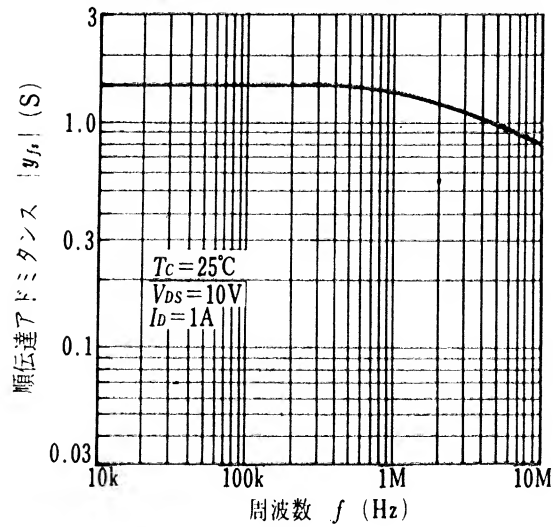
ソース接地出力静特性



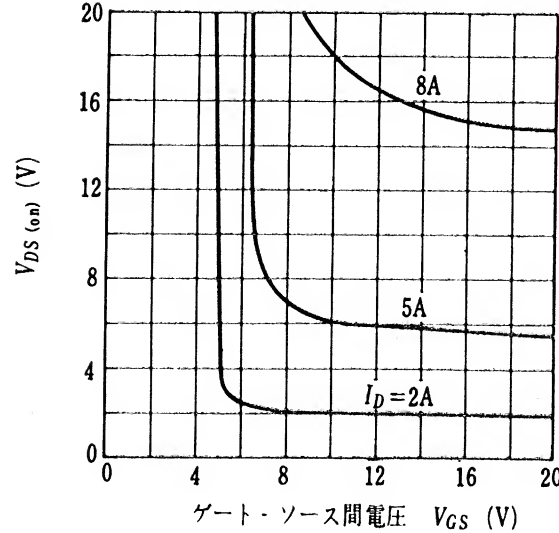
ソース接地伝達静特性



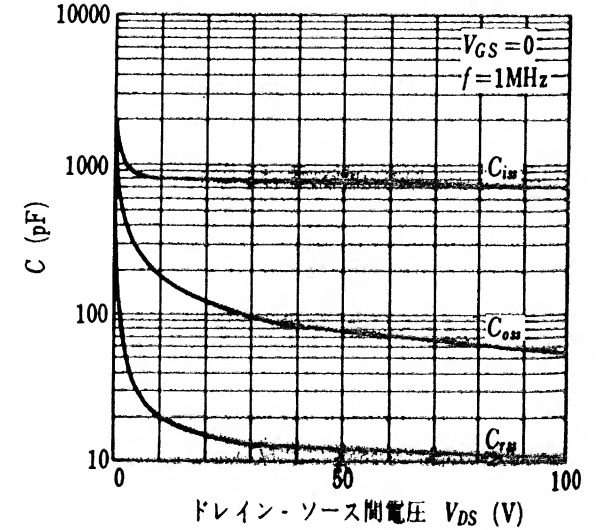
順伝達アドミタンス対周波数特性



VDS(ON) - VGS 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性







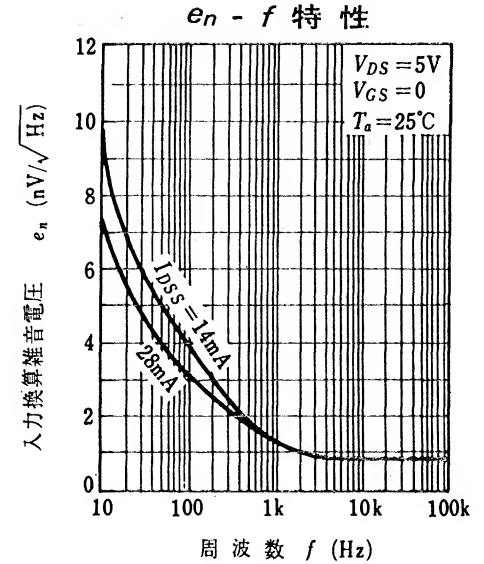
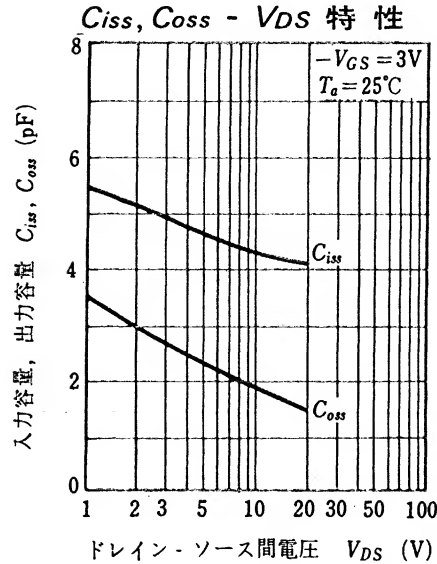
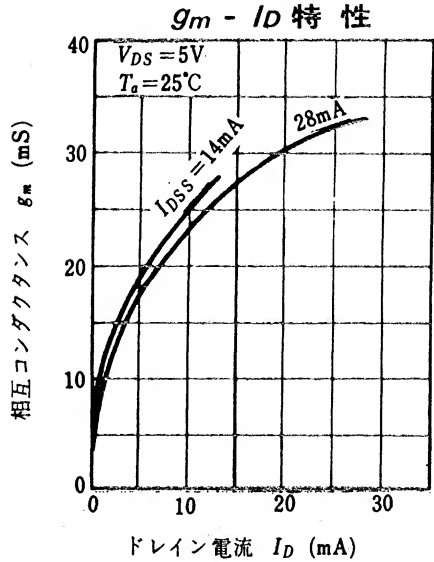
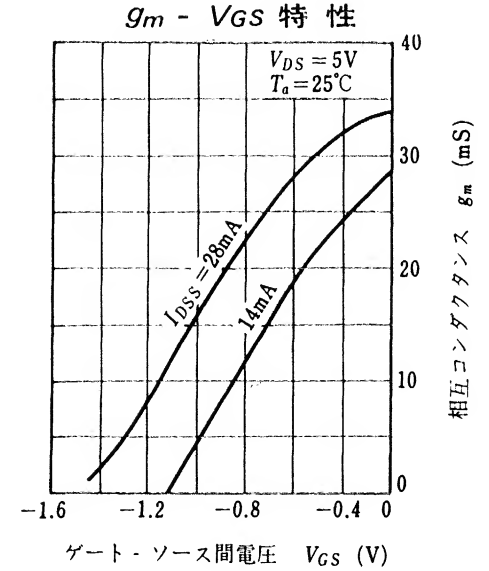
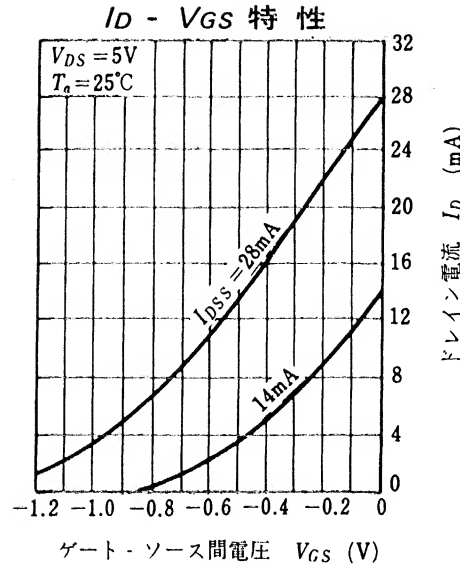
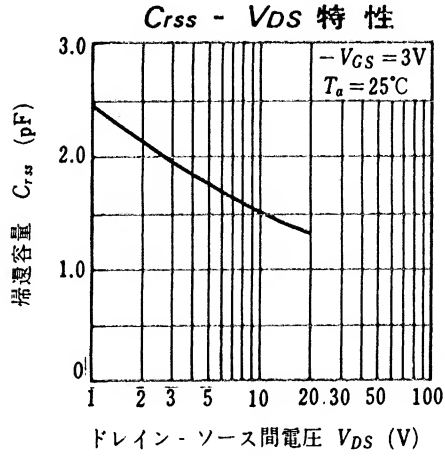
# 2SK321

Si 接合型  
Nチャンネル

松下

$I_{DSS}$  ランク分類

	P	Q	R	S
$I_{DSS}$ (mA)	5~16	14~24	20~32	28~42



# 2SK322

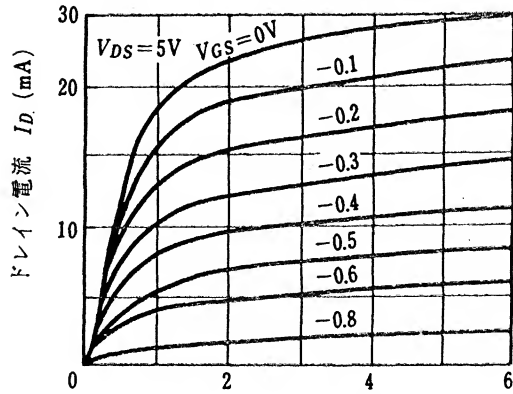
## Si 接合型 Nチャンネル

日立

$I_{DSS}$  ランク分類

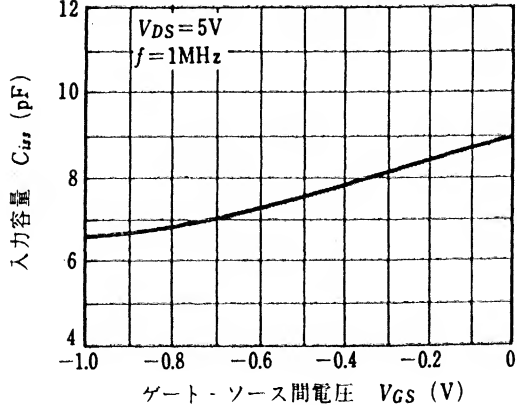
Grade	P	Q	R	S	T
Mark	WP	WQ	WR	WS	WT
$I_{DSS}$	5~16	14~24	20~32	28~42	36~50

ソース接地出力静特性

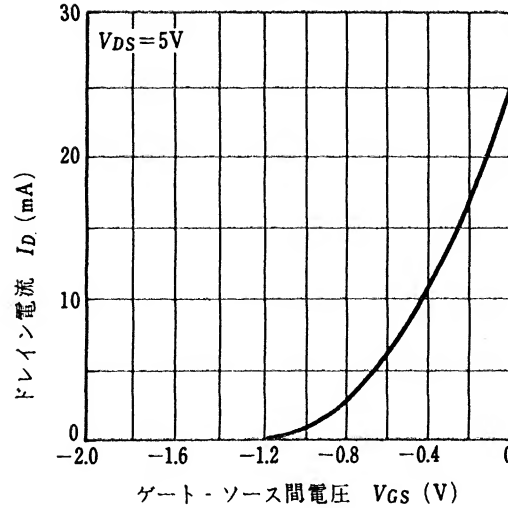


ドレイン・ソース間電圧  $V_{DS}$  (V)

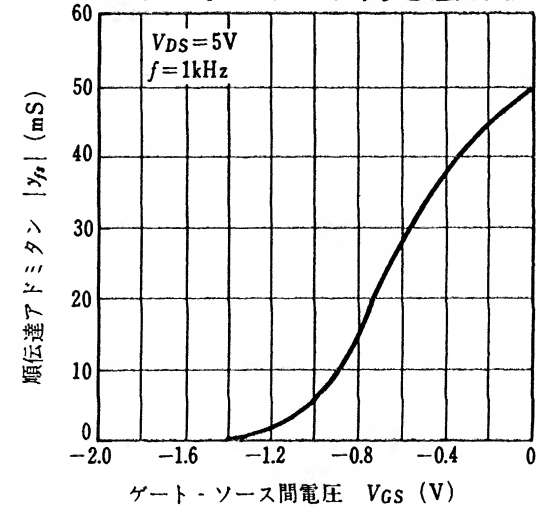
入力容量対ゲート - ソース電圧特性



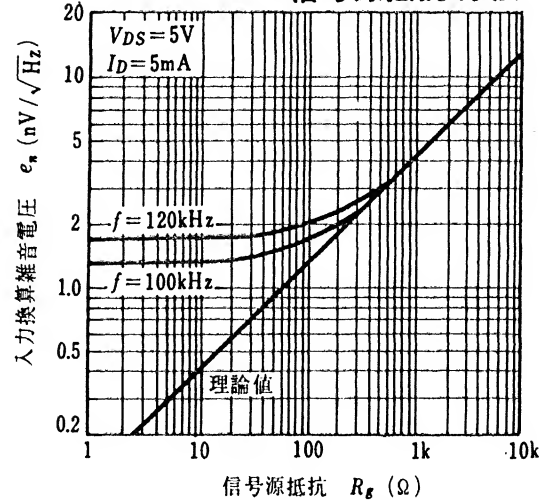
ソース接地伝達静特性



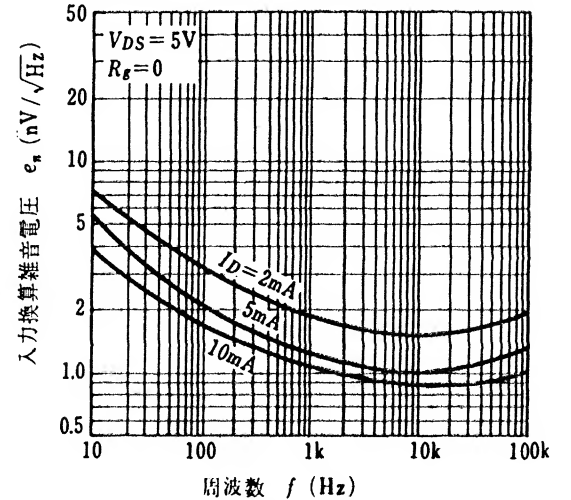
順伝達アドミタンス対  
ゲート - ソース間電圧特性



入力換算雑音電圧対  
信号源抵抗特性



入力換算雑音電圧対周波数特性



# 2SK323

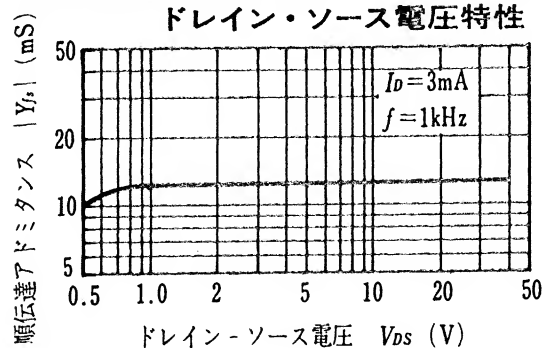
## Si 接合型 Nチャンネル

日 立

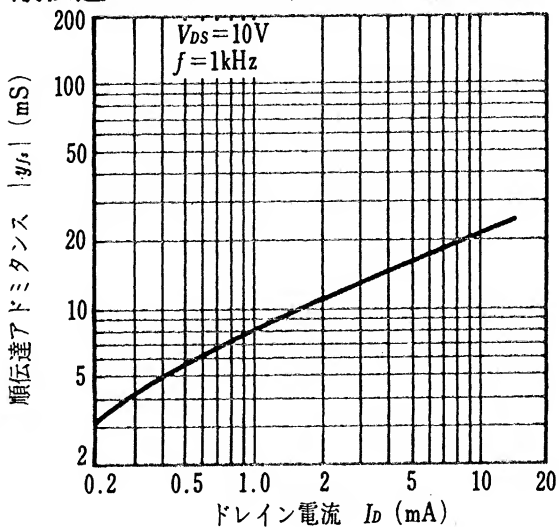
$I_{DSS}$ 区分

Grade	B	C	D	E
Mark	KB	KC	KD	KE
$I_{DSS}$	1.6~3.2	2.5~5	4~8	6~12

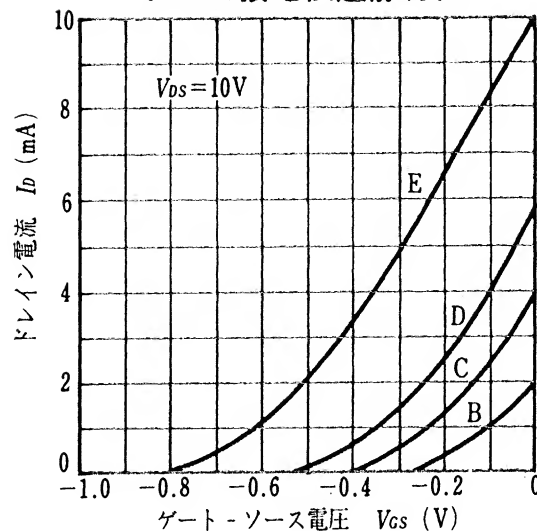
順伝達アドミタンス対  
ドレイン・ソース電圧特性



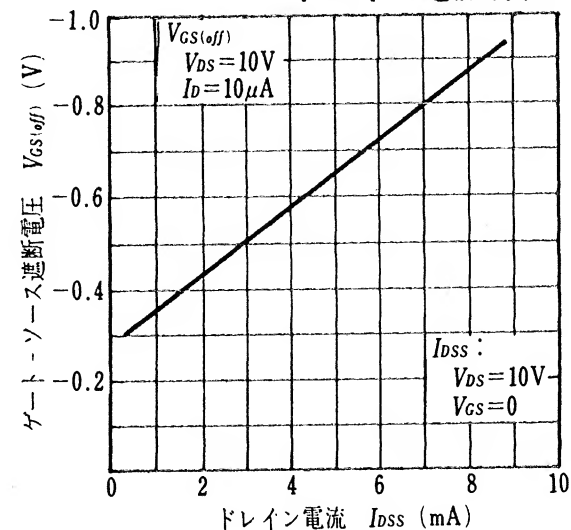
順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性



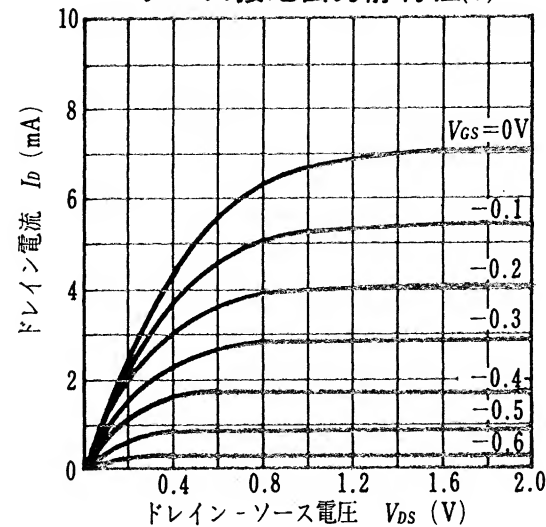
ソース接地伝達静特性



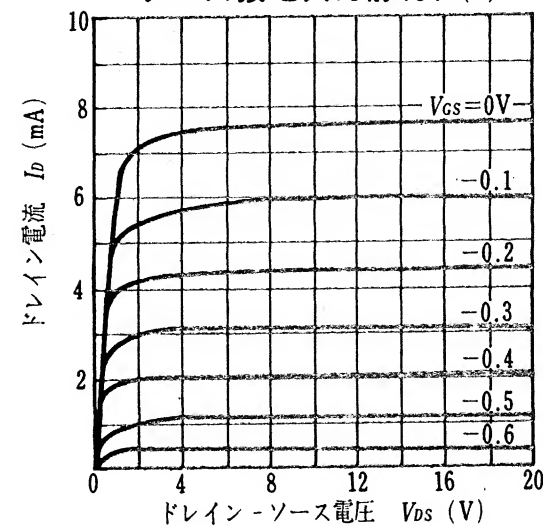
ゲート・ソース遮断電圧対  
ドレイン電流特性



ソース接地出力静特性(1)



ソース接地出力静特性(2)

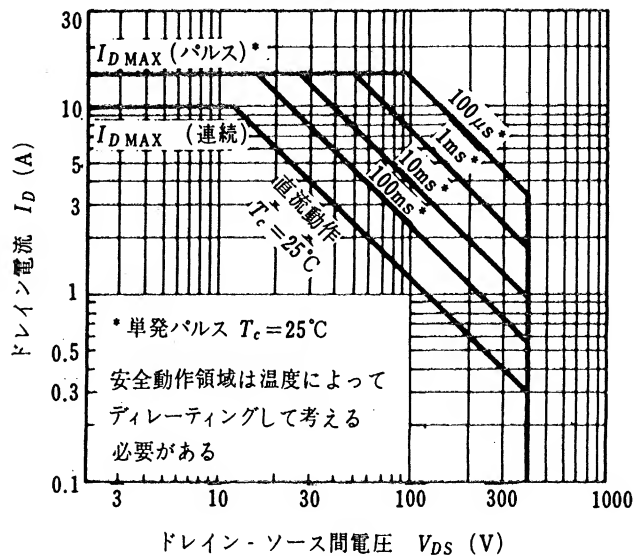


# 2SK324

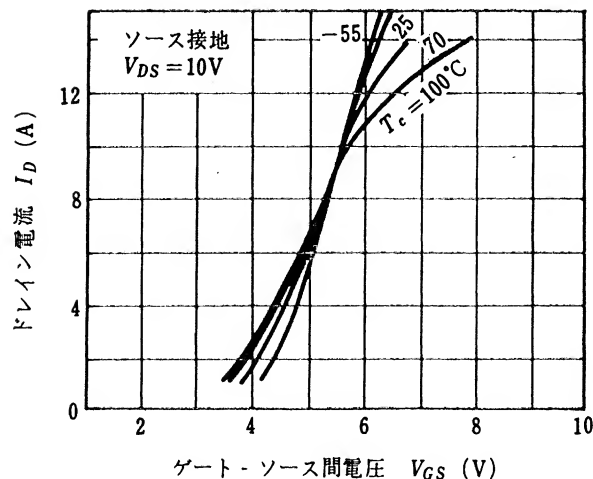
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

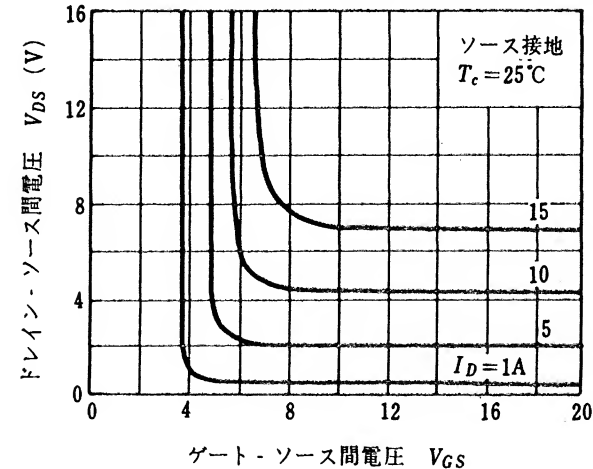
安全動作領域



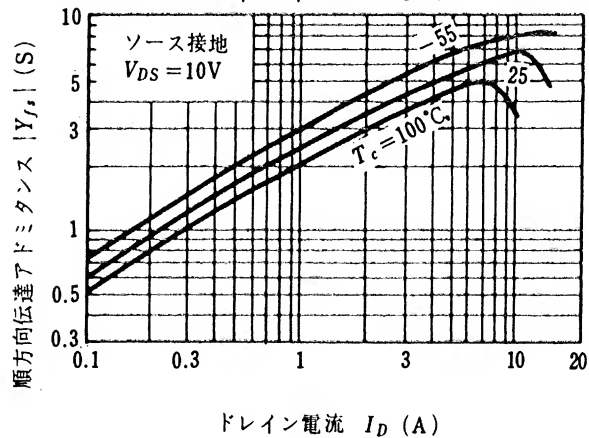
$I_D - V_{GS}$  特性



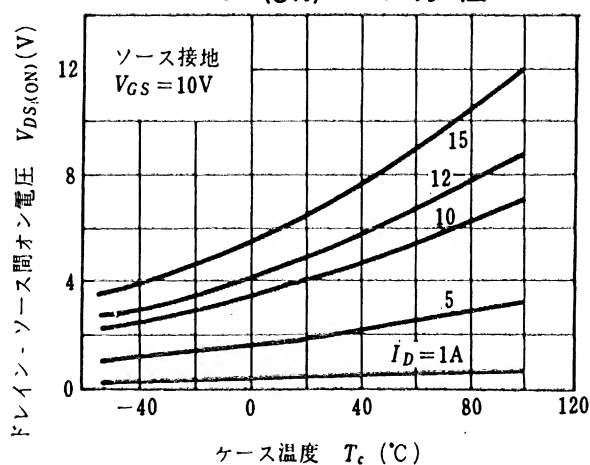
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



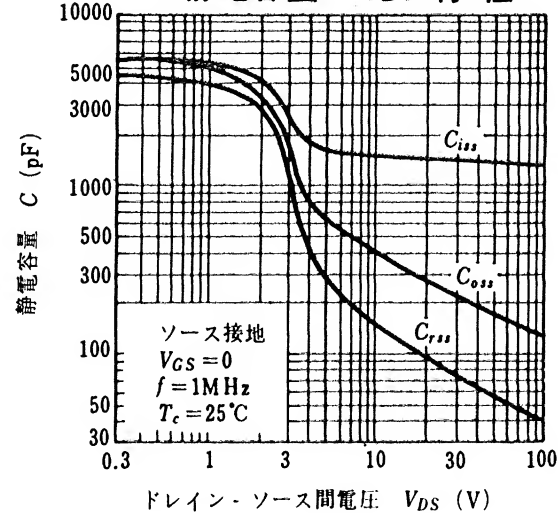
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$V_{DS(ON)} - T_c$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

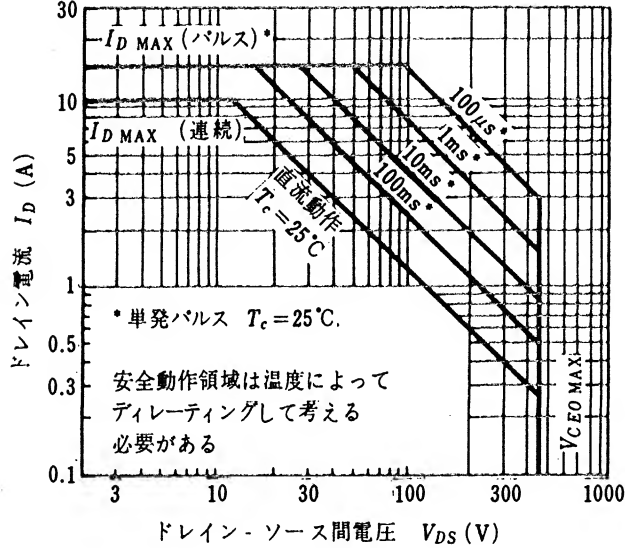


# 2SK325

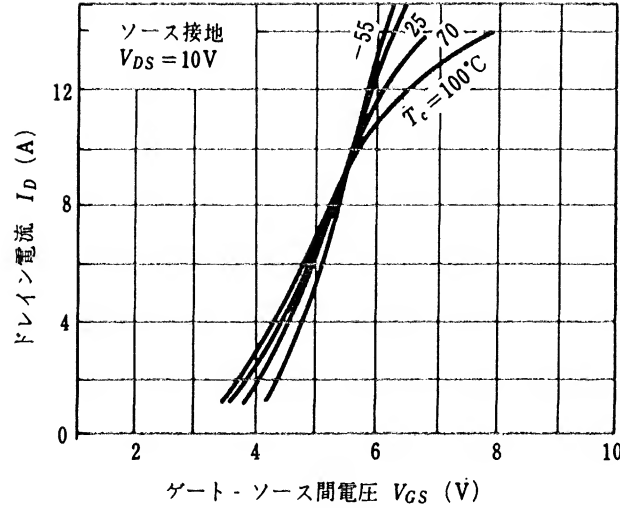
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

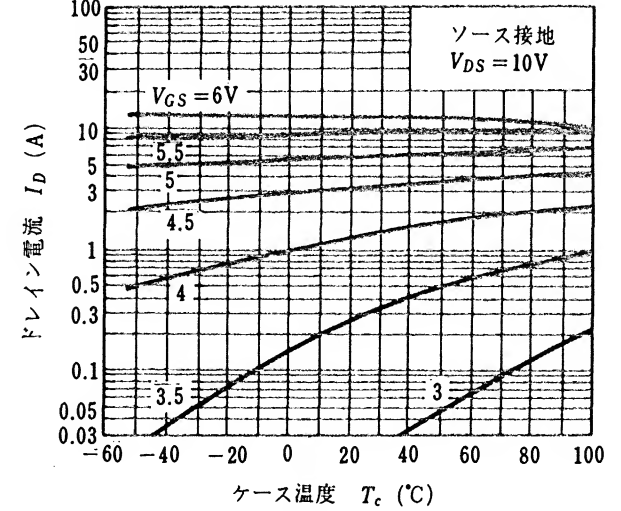
### 安全動作領域



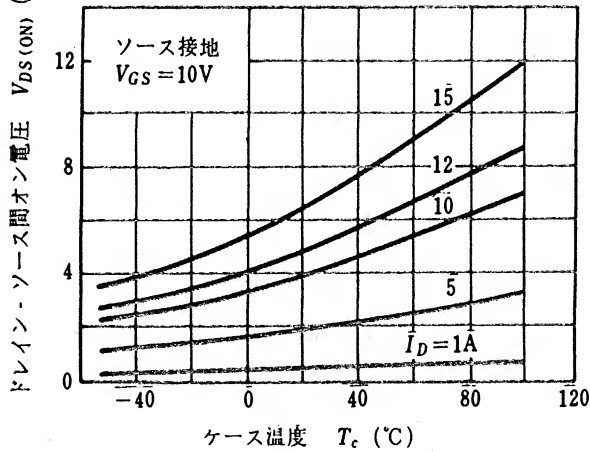
### ID - VGS 特性



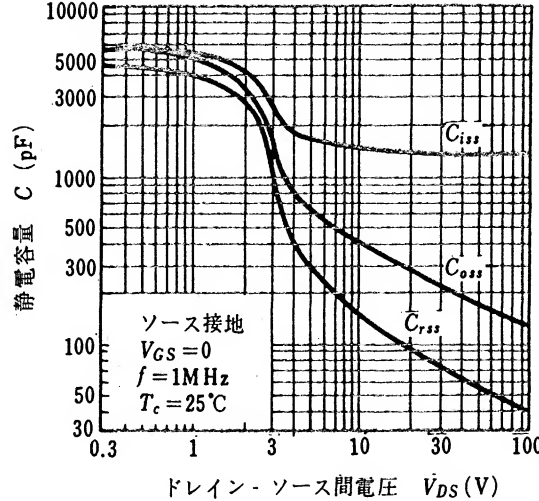
### ID - Tc 特性



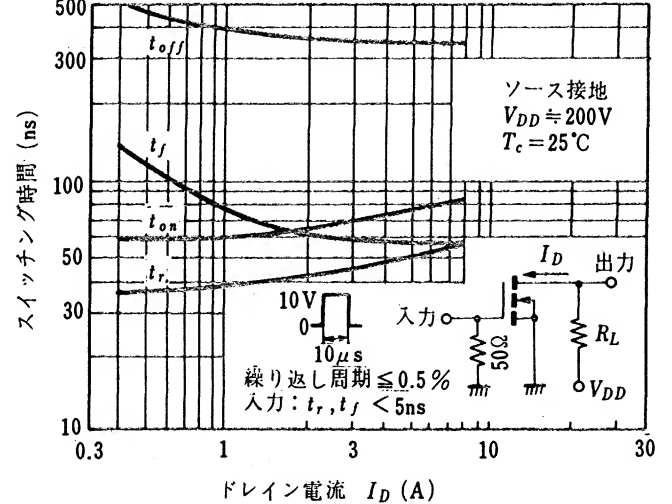
### VDS(ON) - Tc 特性



### 静電容量 - VDS 特性



### スイッチング時間 - ID 特性

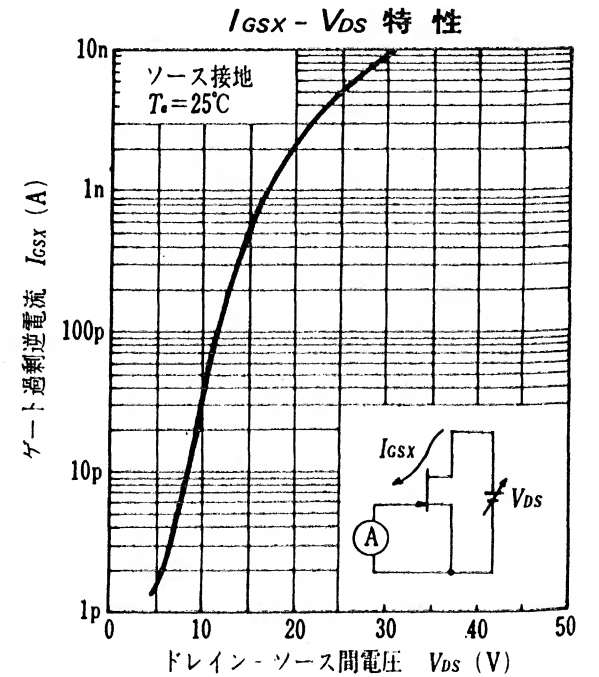
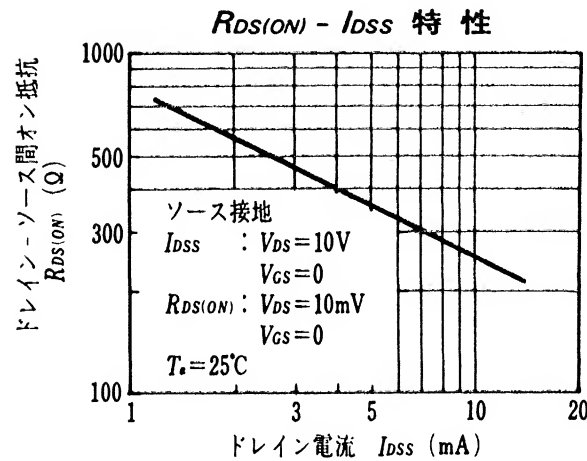
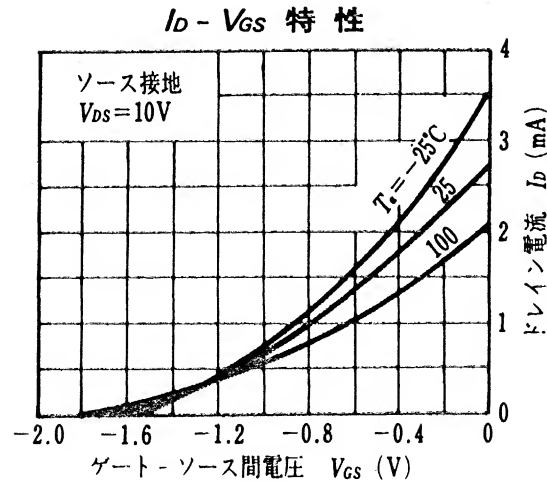
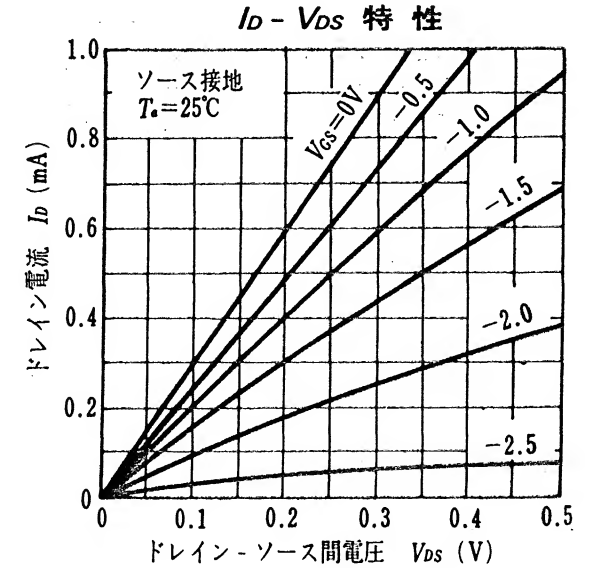
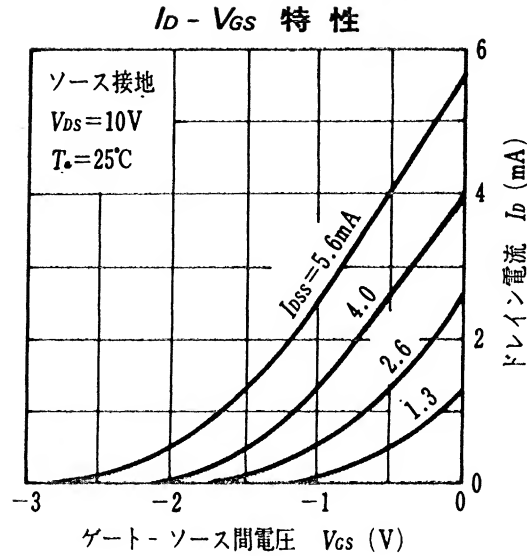
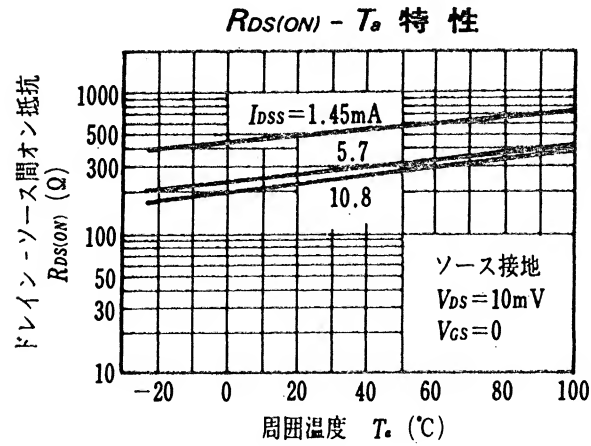


# 2SK330

## Si 接合型 Nチャンネル

東 芝

$I_{DSS}$ 分類 Y: 1.2~3.0mA, GR: 2.6~6.5mA,  
BL: 6~14mA



# 2SK332

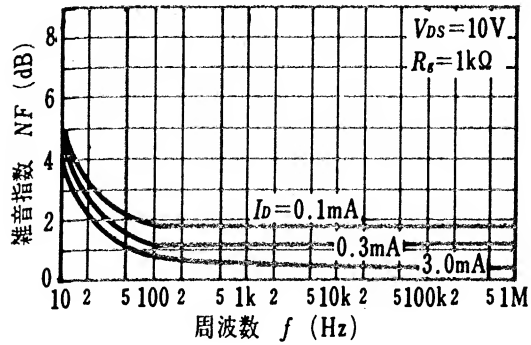
## Si 接合型 複合Nチャンネル

三 洋

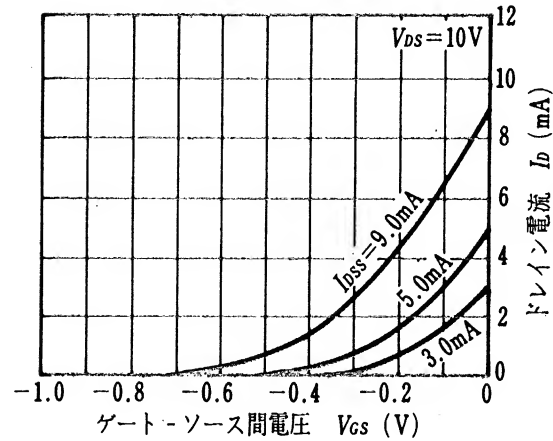
$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

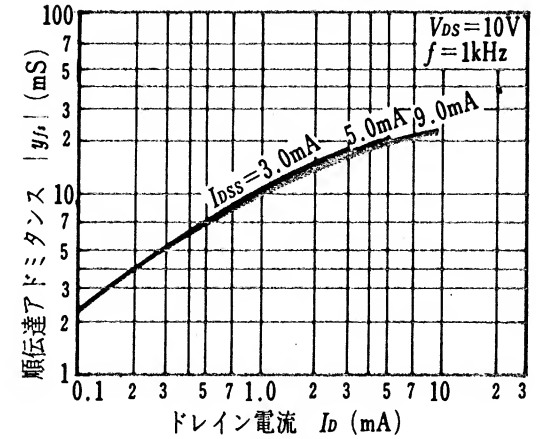
NF - f 特性



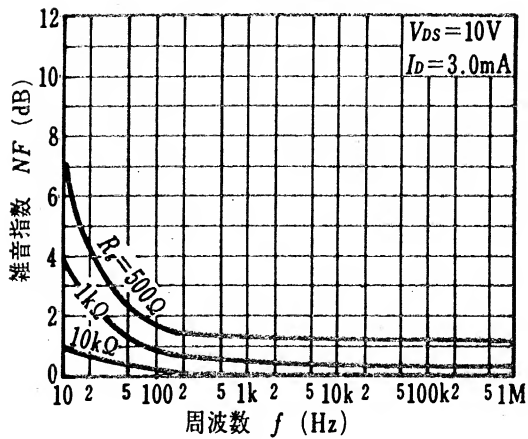
$I_D - V_{GS}$  特性



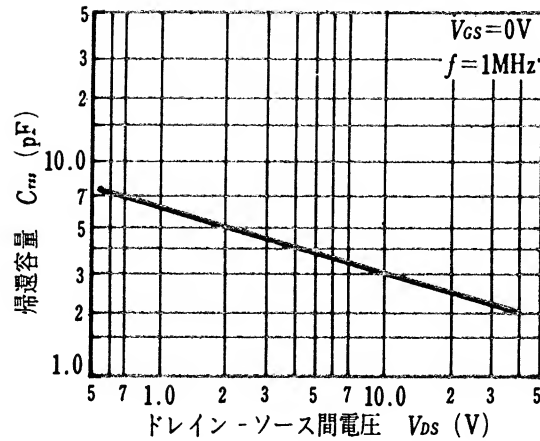
$|y_{fs}| - I_D$  特性



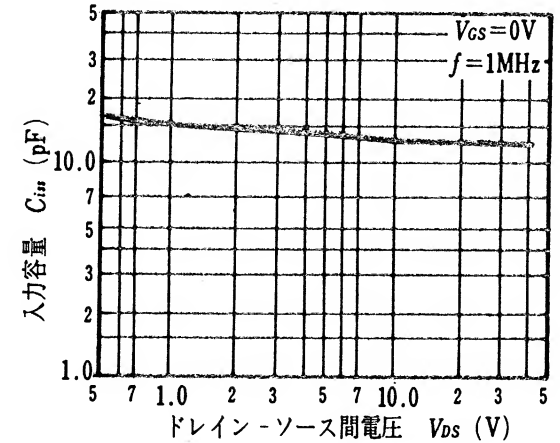
NF - f 特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$C_{iss} - V_{DS}$  特性





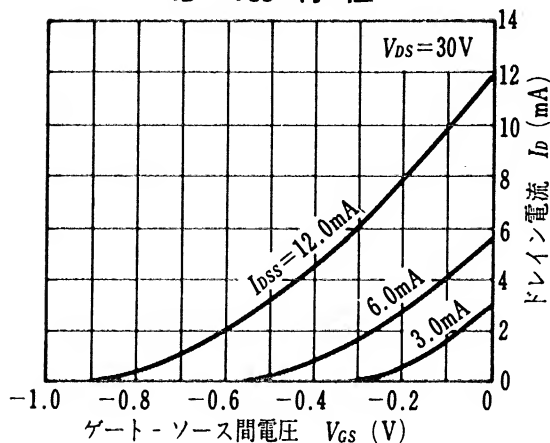
# 2SK333

## Si 接合型 複合Nチャンネル

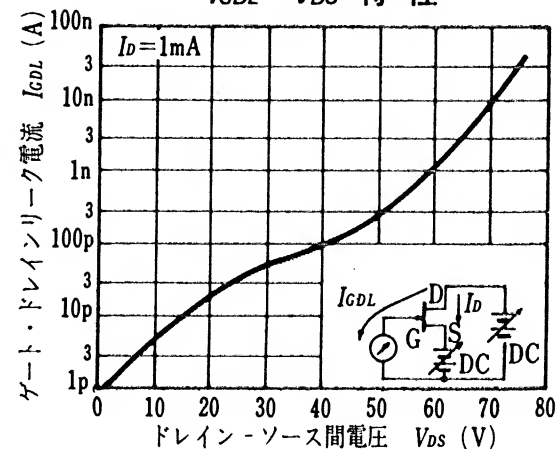
$I_{DSS}$ により次のように分類している。(単位 mA)

1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

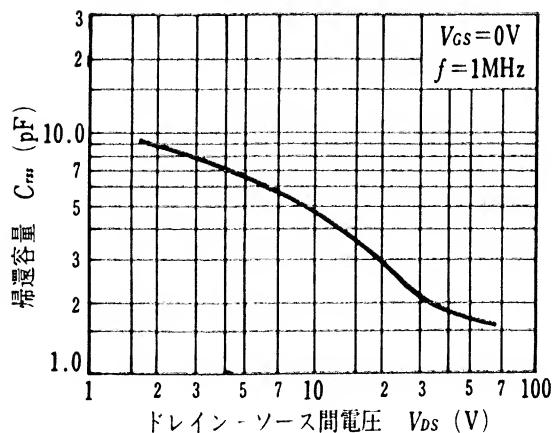
$I_D - V_{GS}$  特性



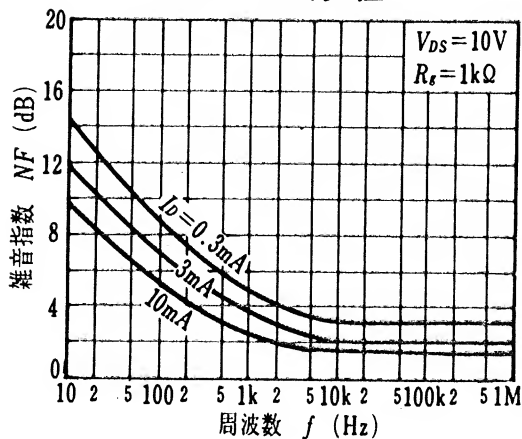
$I_{GDL} - V_{DS}$  特性



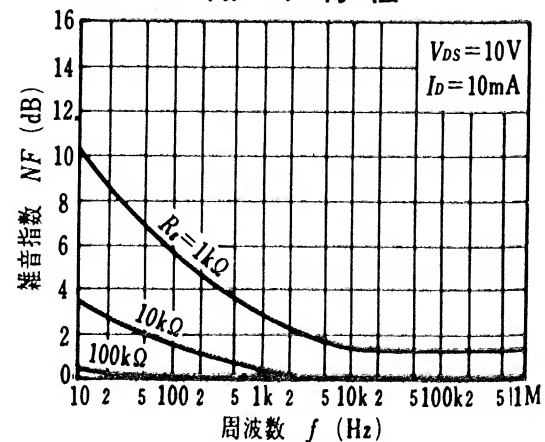
$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$NF - f$  特性



$NF - f$  特性

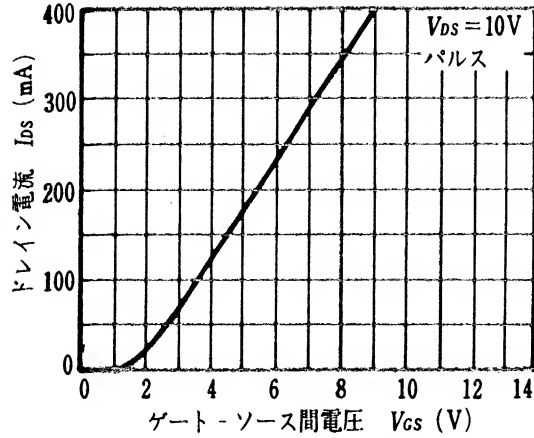


# 2SK336

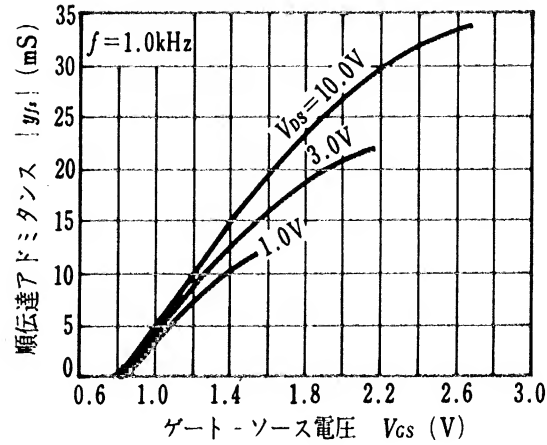
## Si MOS型 Nチャンネル

三 洋

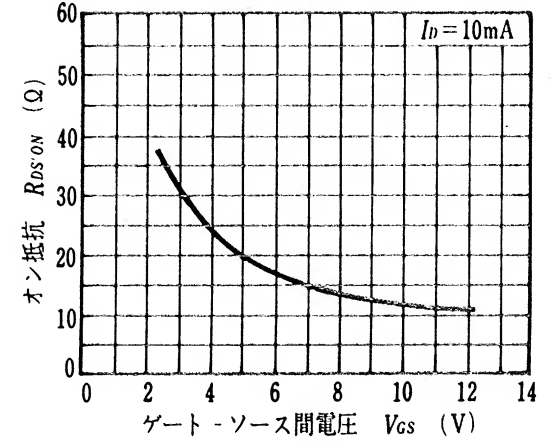
### $I_{DS} - V_{GS}$ 特性



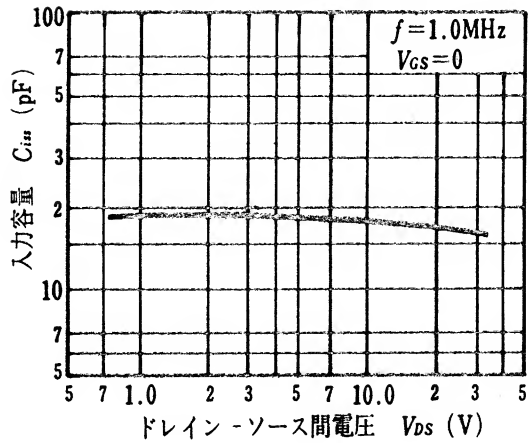
### $|y_{fs}|, V_{GS(off)} - V_{GS}$ 特性



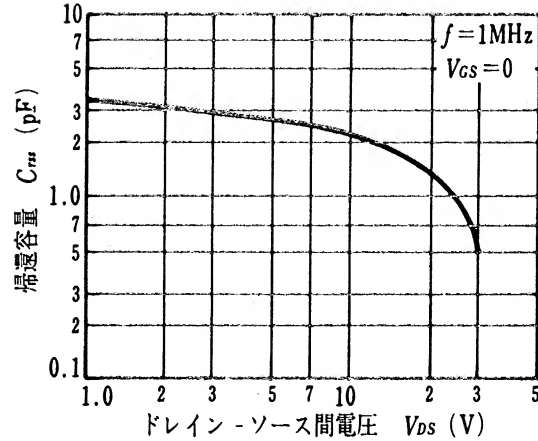
### $R_{DS(ON)} - V_{GS}$ 特性



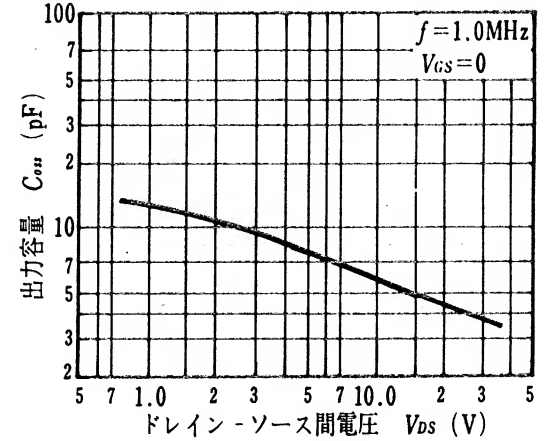
### $C_{iss} - V_{DS}$ 特性



### $C_{rss} - V_{DS}$ 特性



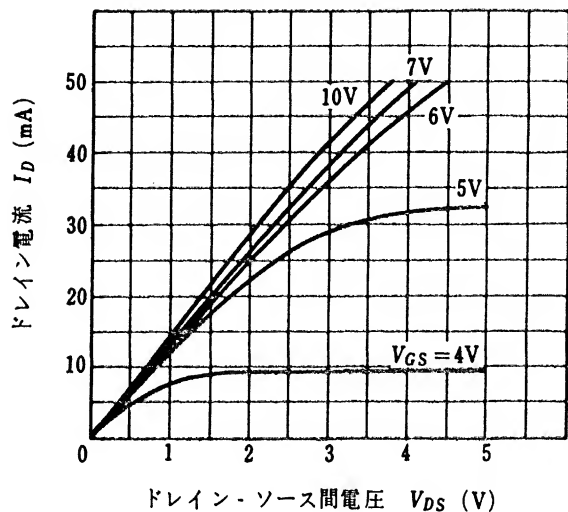
### $C_{oss} - V_{DS}$ 特性



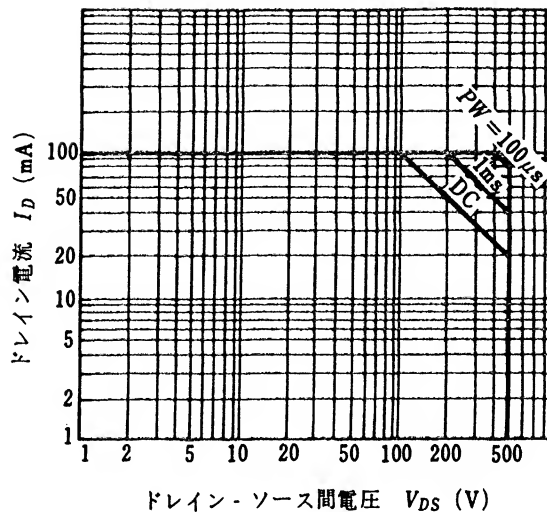
# 2SK337

## Si MOS型 Nチャンネル

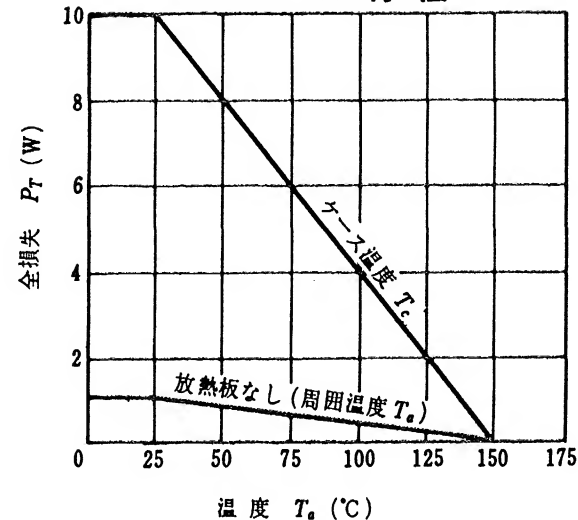
$I_D - V_{DS}$  特性



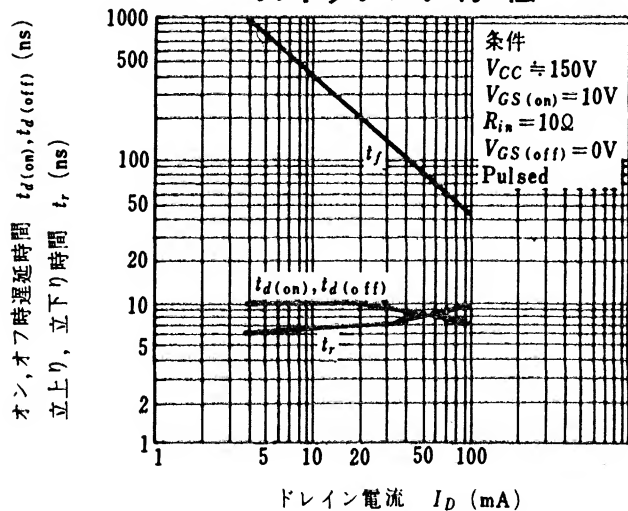
安全動作領域



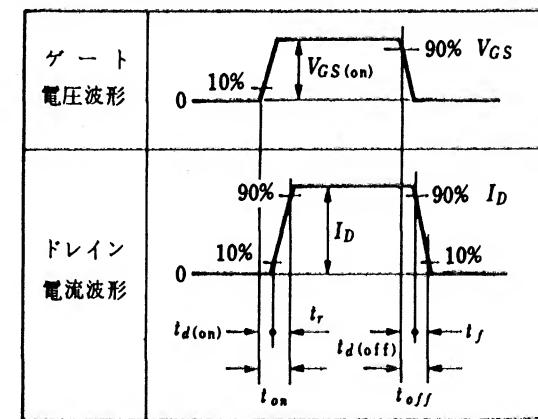
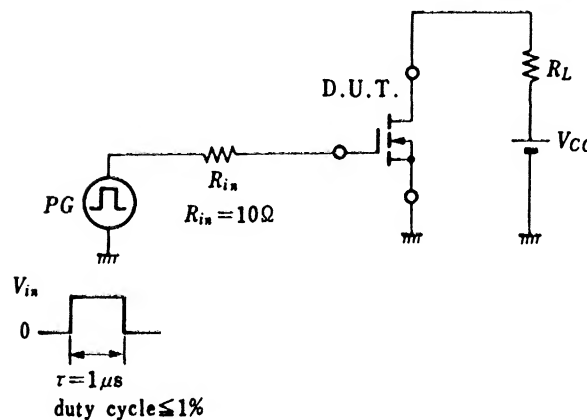
$P_T - T_a$  特性



スイッチング特性



スイッチングタイム測定回路, 測定条件 (抵抗負荷)

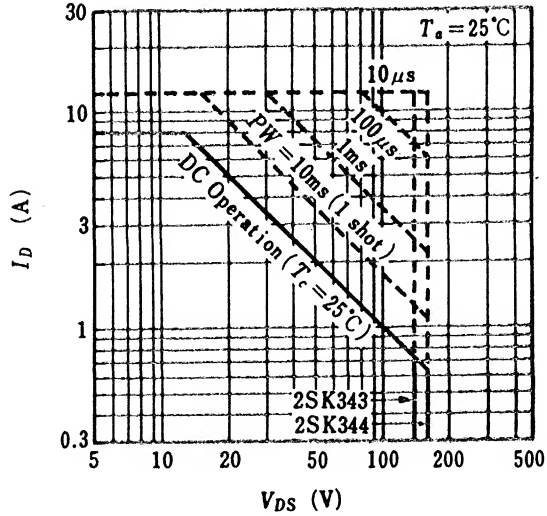


# 2SK343, 344

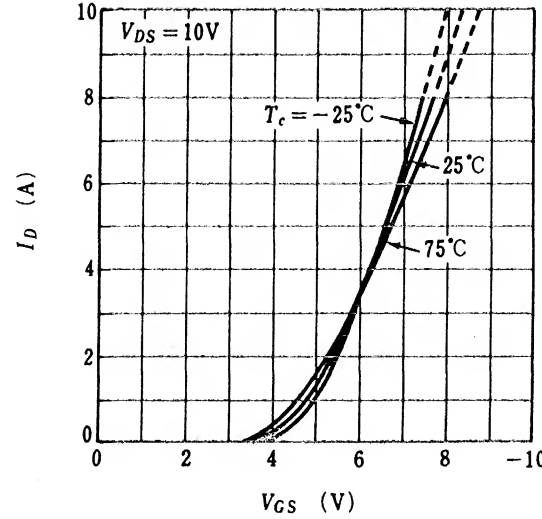
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

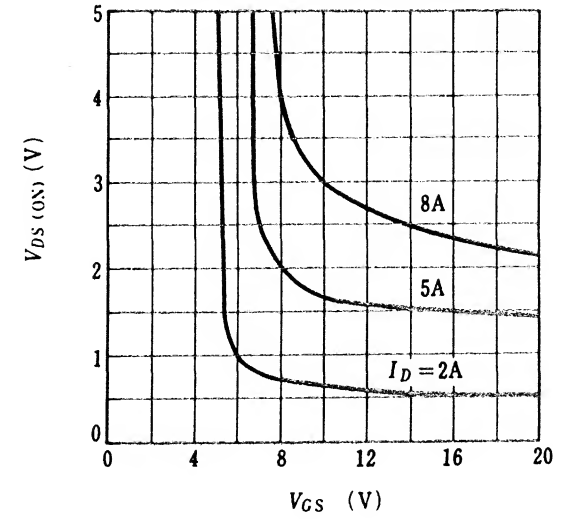
安全動作領域



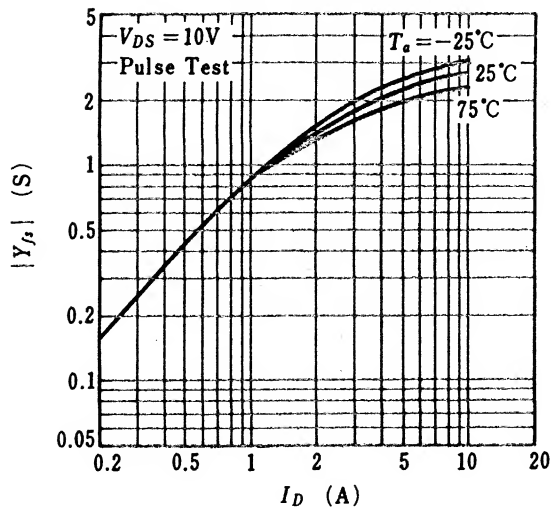
伝達特性



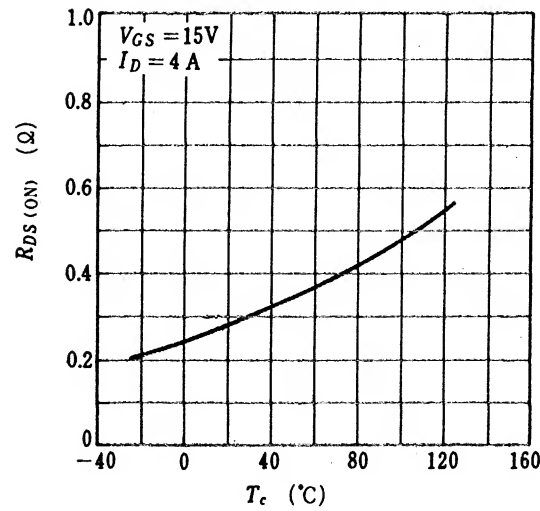
VDS(ON) - VGS 特性



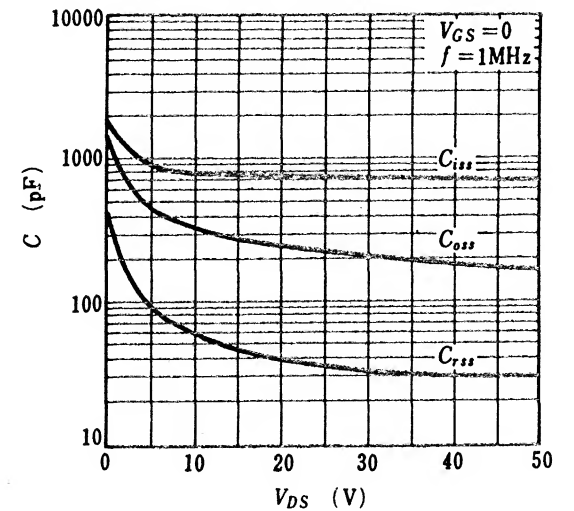
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

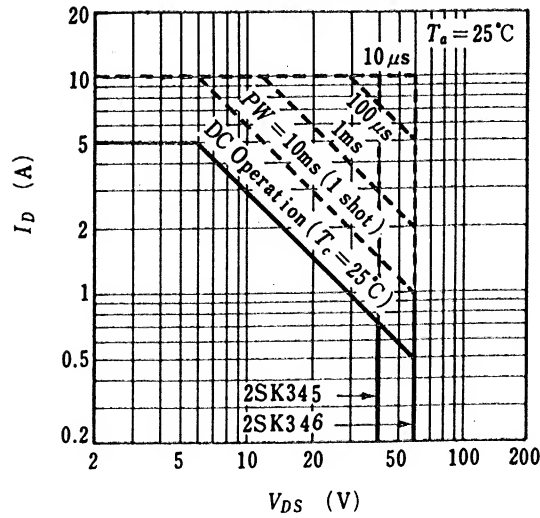


# 2SK345, 346

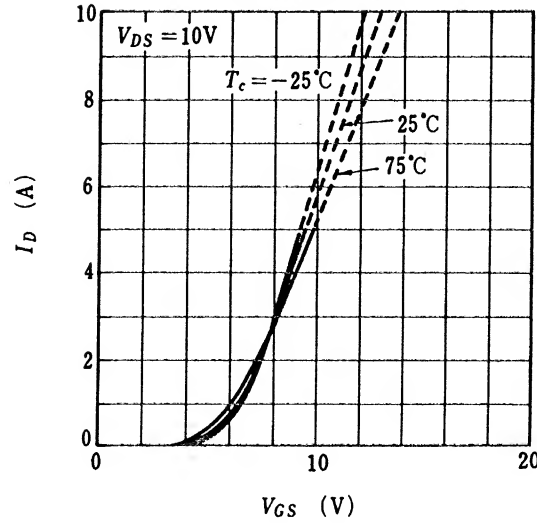
Si MOS 型  
Nチャンネル

日立

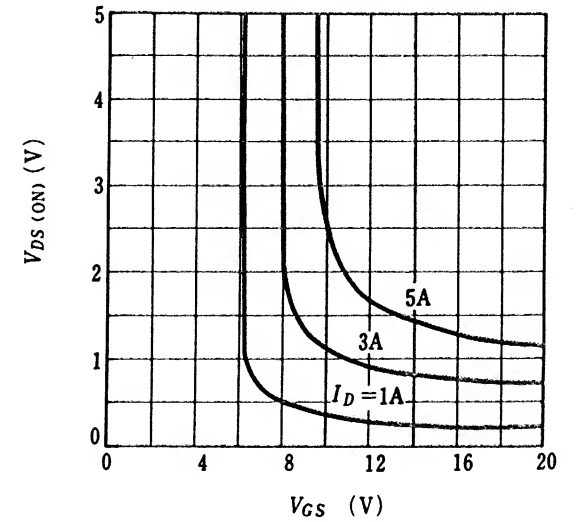
安全動作領域



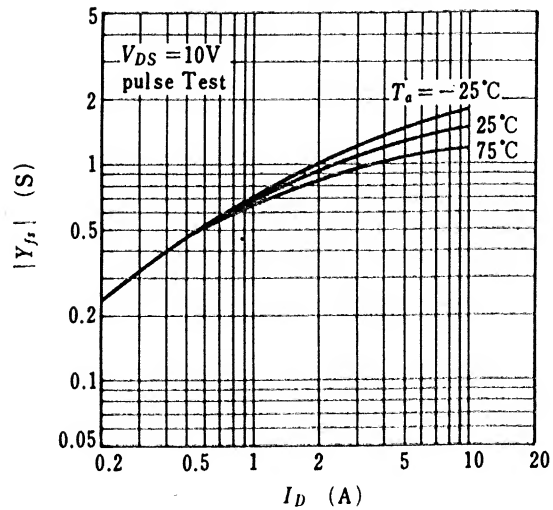
伝達特性



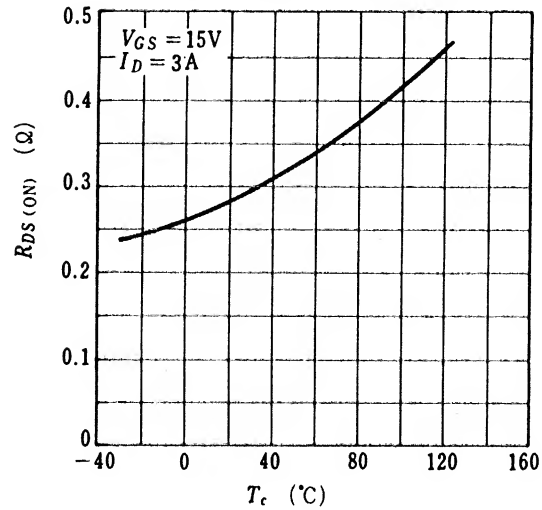
V\_DS (ON) - V\_GS 特性



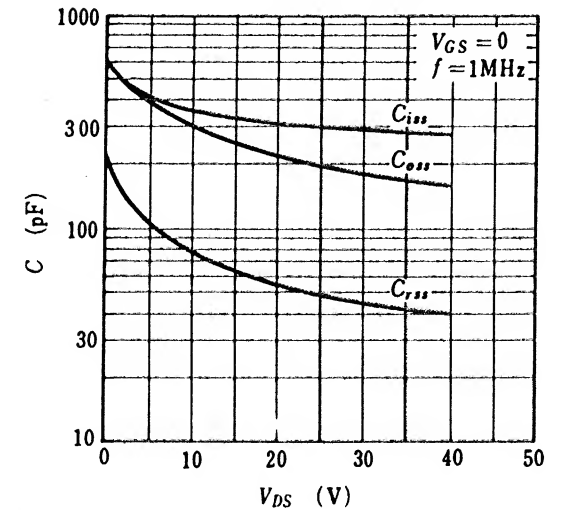
|Y<sub>fs</sub>| - I<sub>D</sub> 特性



R\_DS (ON) - T\_c 特性



C<sub>iss</sub>, C<sub>oss</sub>, C<sub>rss</sub> - V\_DS 特性

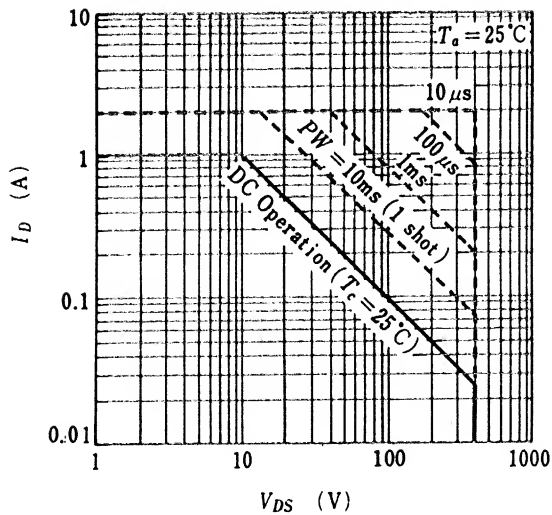


# 2SK347

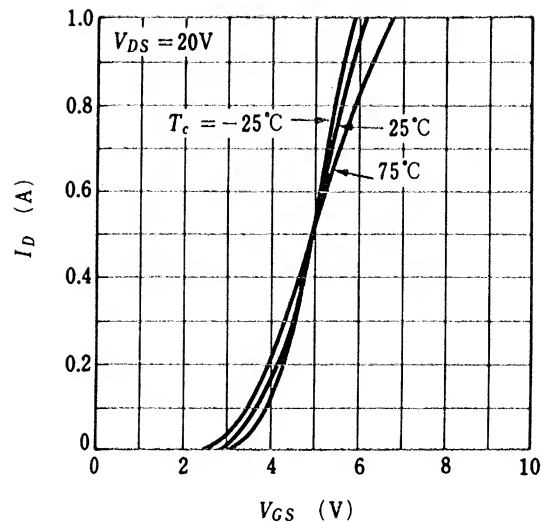
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

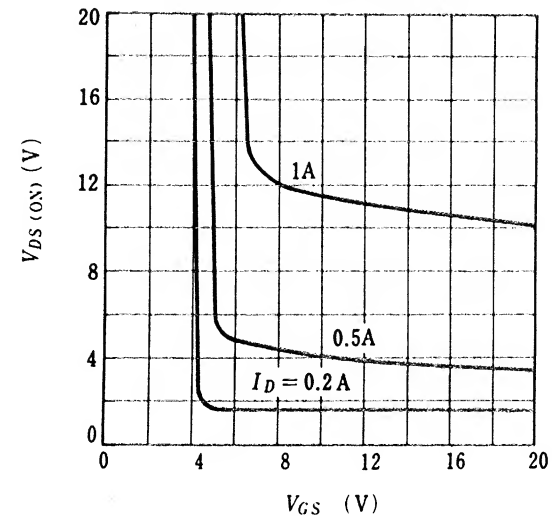
安全動作領域



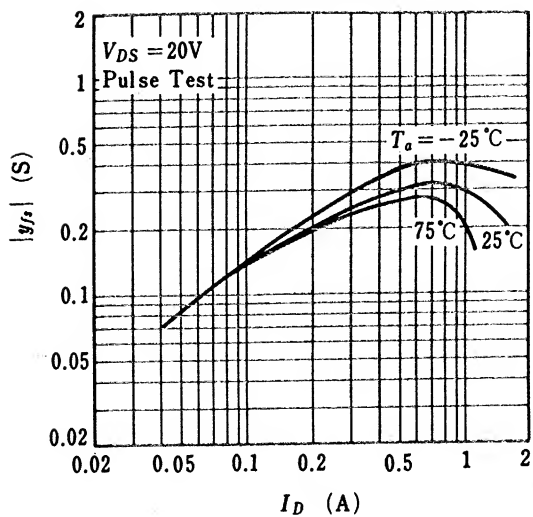
伝達特性



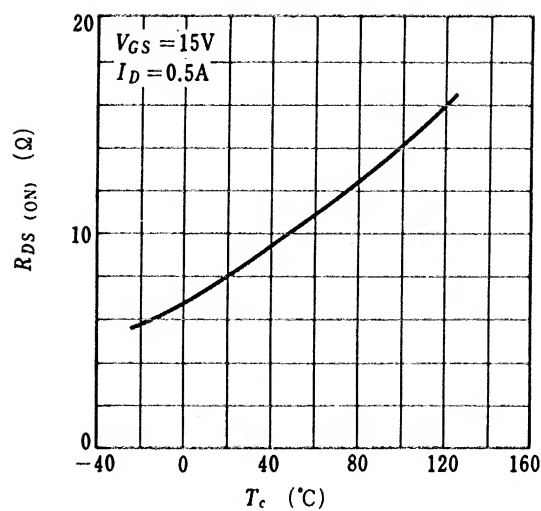
VDS(ON) - VGS 特性



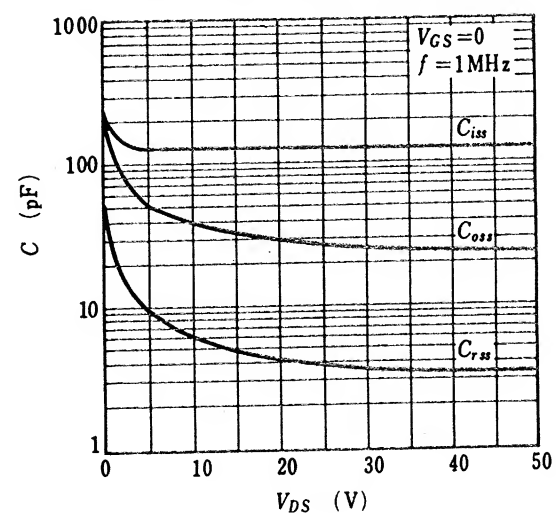
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

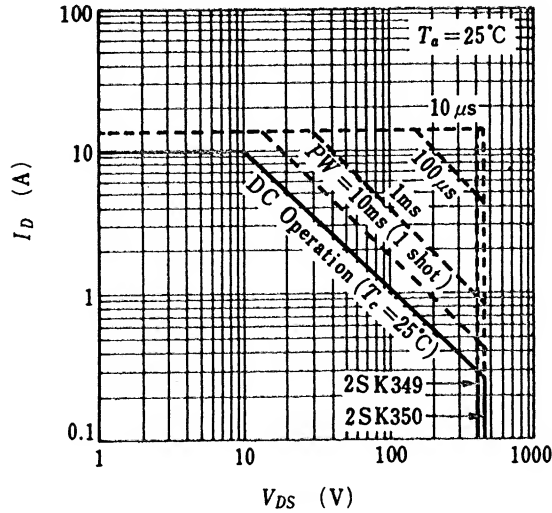


# 2SK349, 350

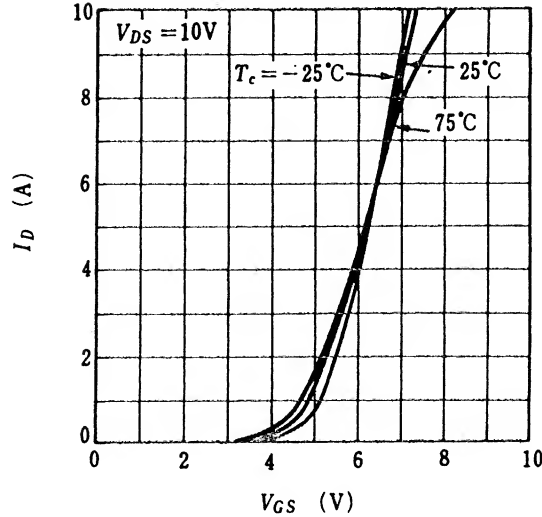
Si MOS 型  
Nチャンネル

日立

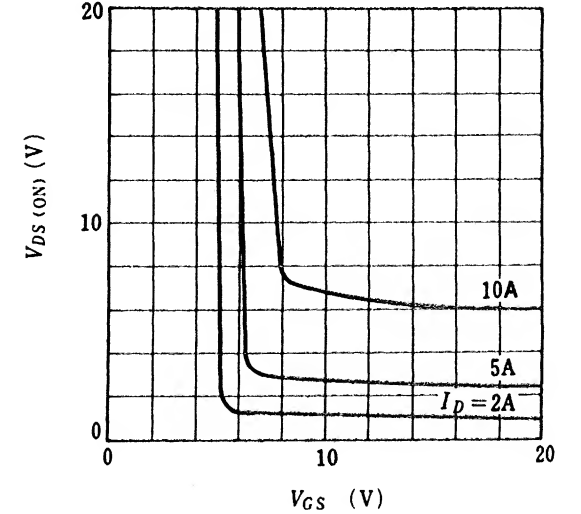
安全動作領域



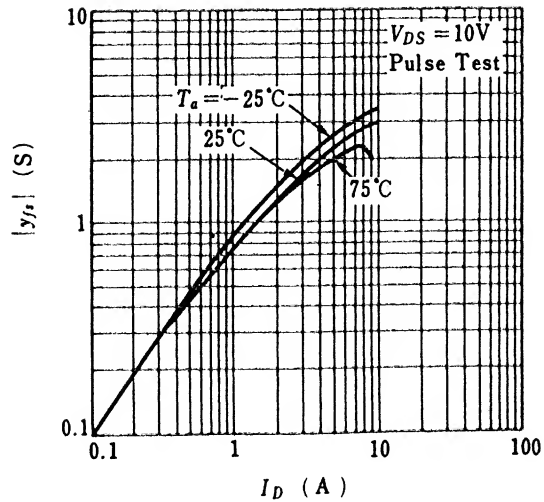
伝達特性



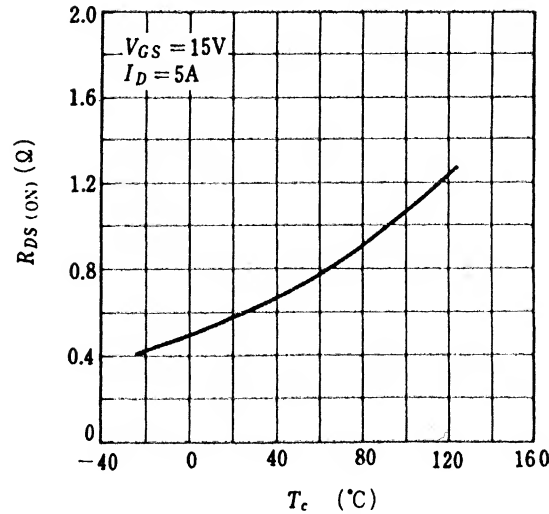
VDS (ON) - VGS 特性



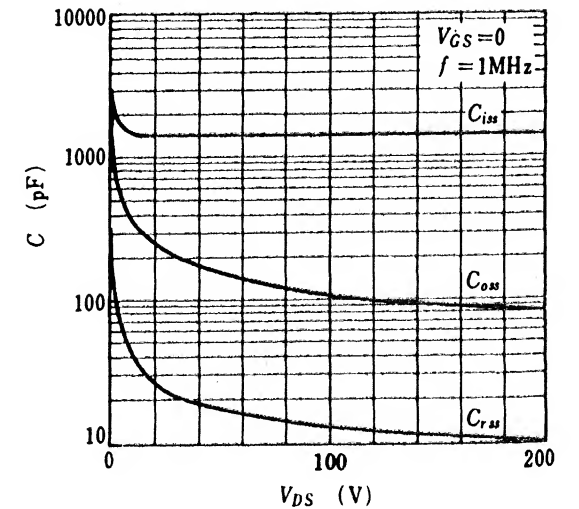
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性



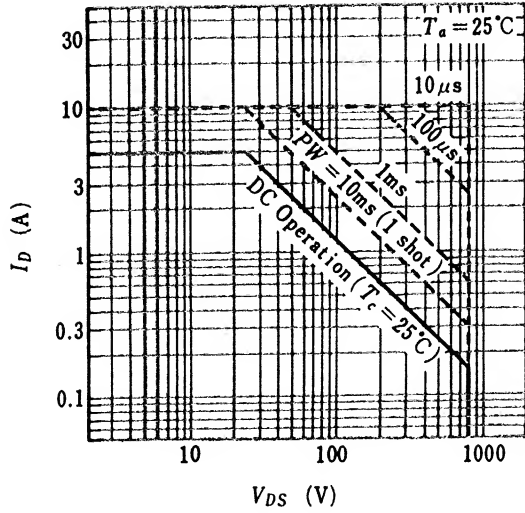


# 2SK351

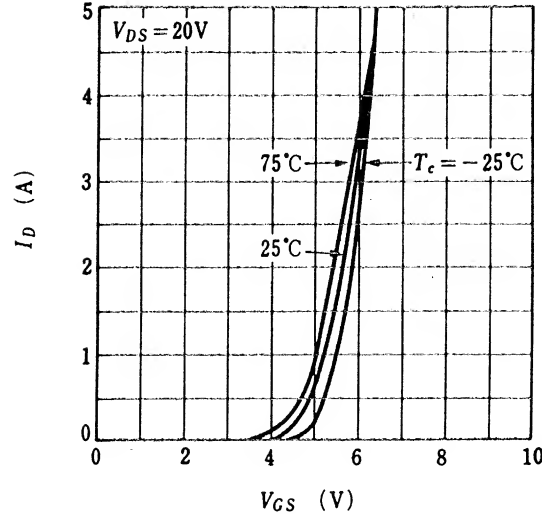
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

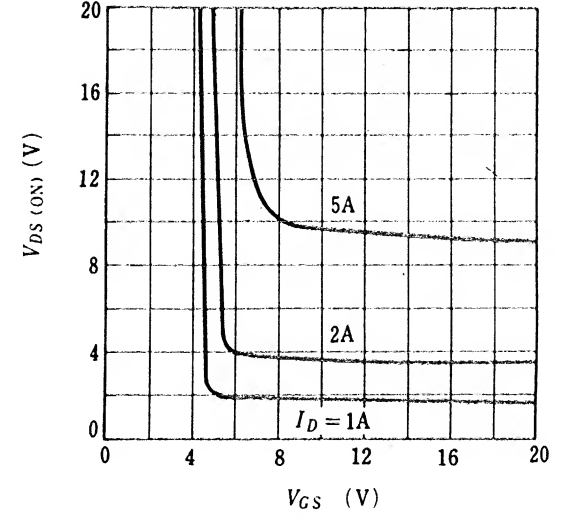
### 安全動作領域



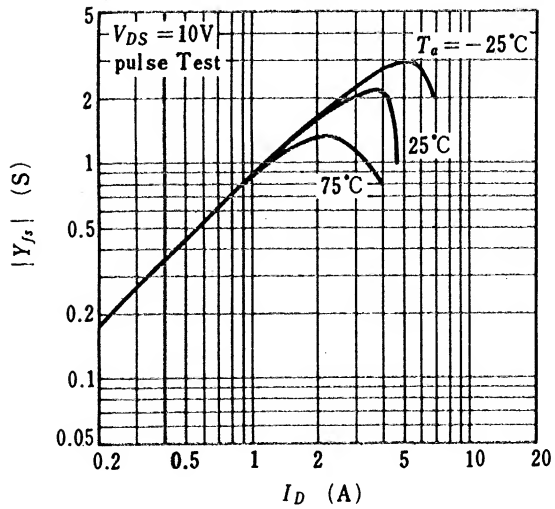
### 伝達特性



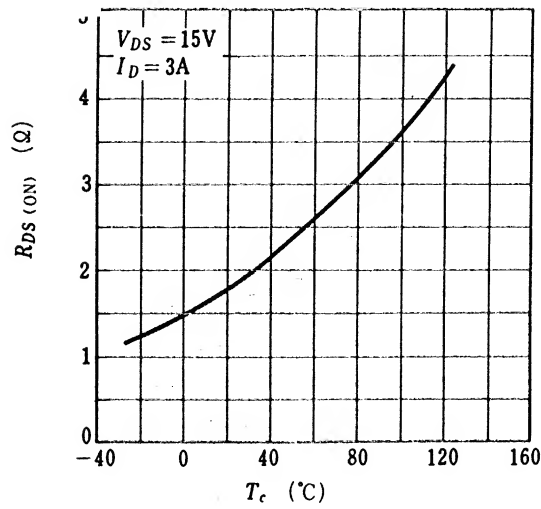
### VDS (ON) - VGS 特性



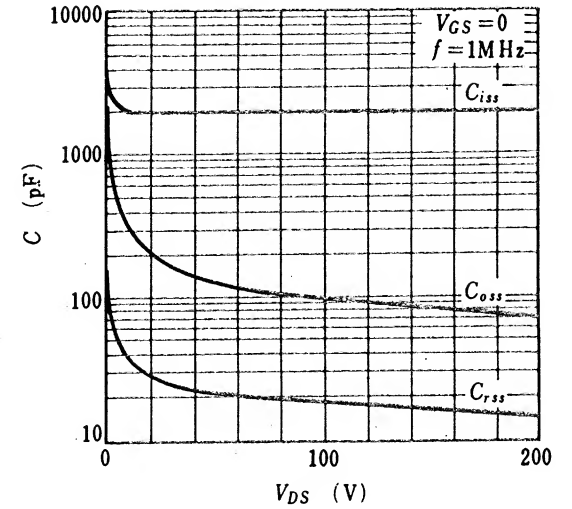
### |Yfs| - ID 特性



### RDS(ON) - Tc 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

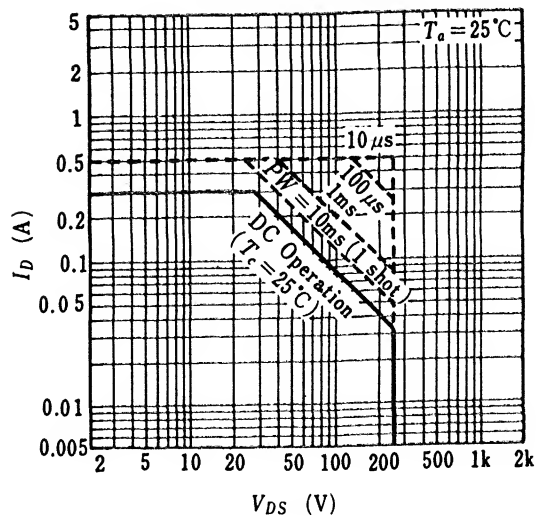


# 2SK352

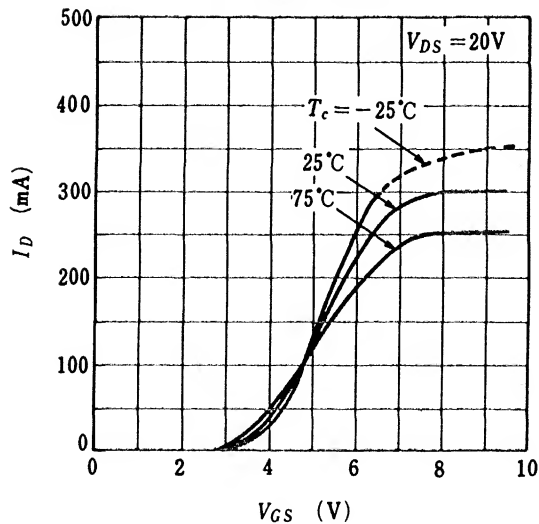
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

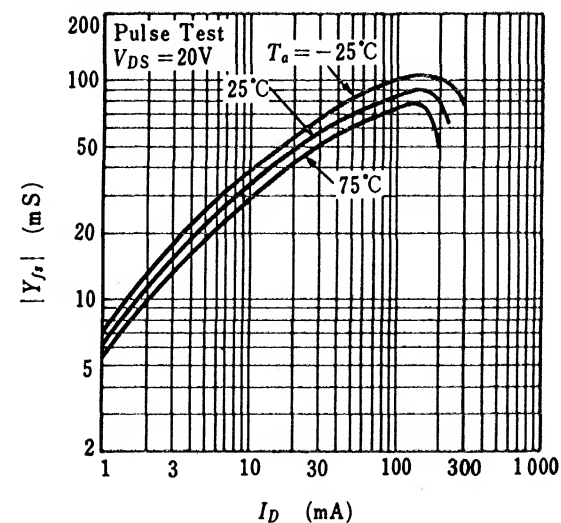
安全動作領域



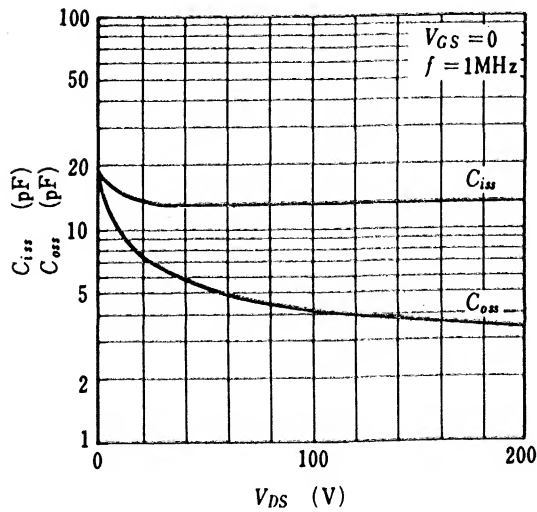
伝達特性



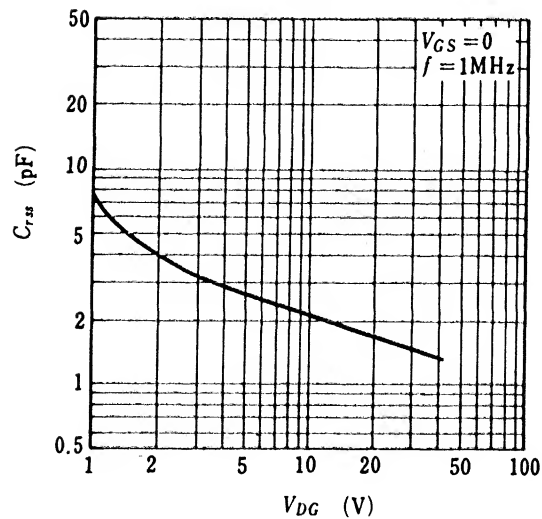
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



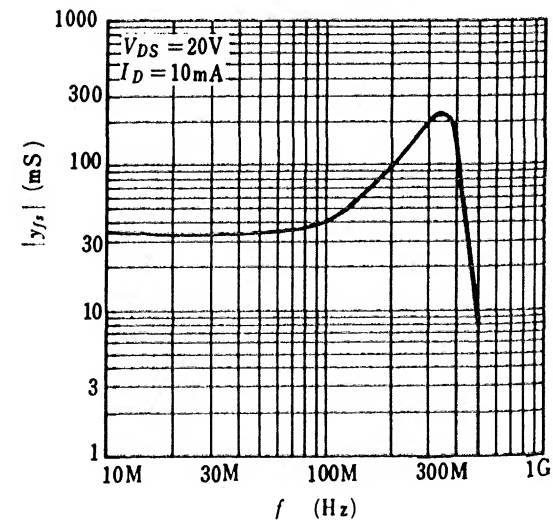
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



$C_{rss} - V_{DG}$  特性



$|Y_{fs}| - f$  特性

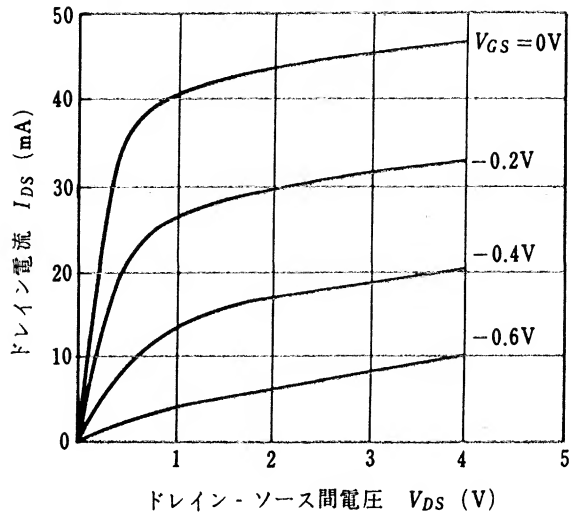


# 2SK353

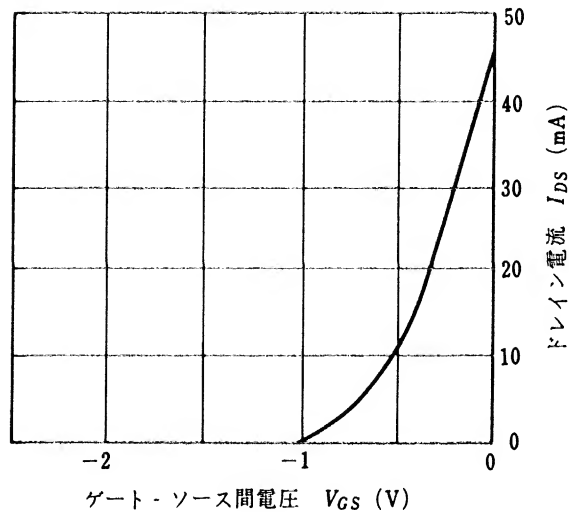
## GaAs 型 Nチャンネル

日 電

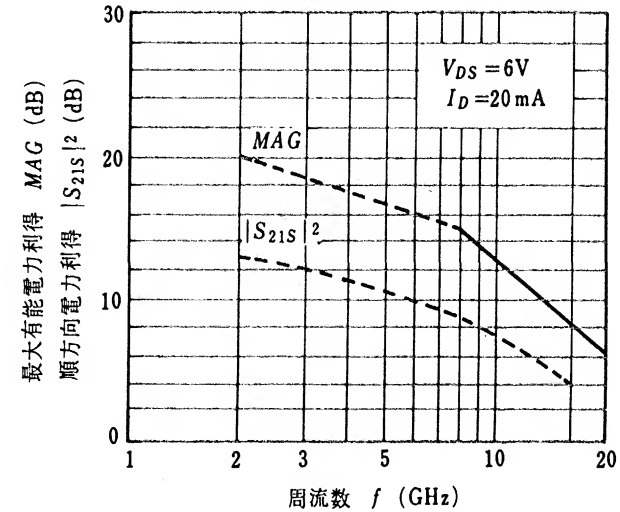
$I_{DS} - V_{DS}$  特性



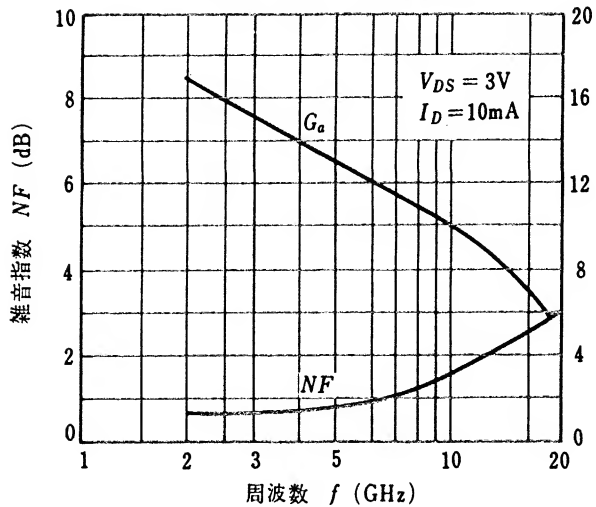
$I_{DS} - V_{GS}$  特性



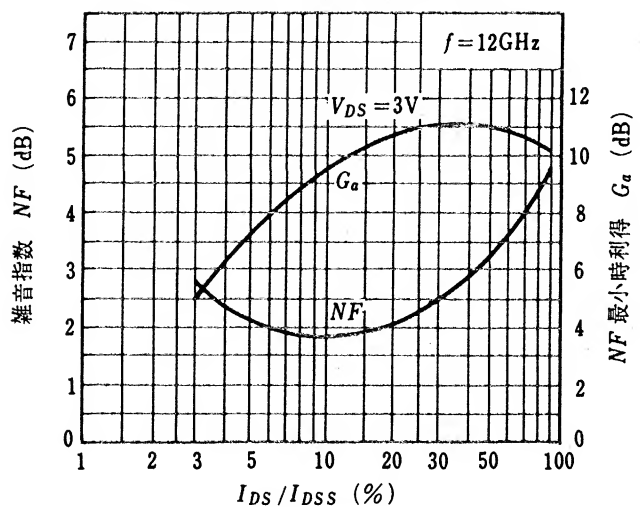
MAG,  $|S_{21s}|^2 - f$  特性



NF,  $G_a - f$  特性



NF,  $G_a - I_D/I_{DSS}$  特性

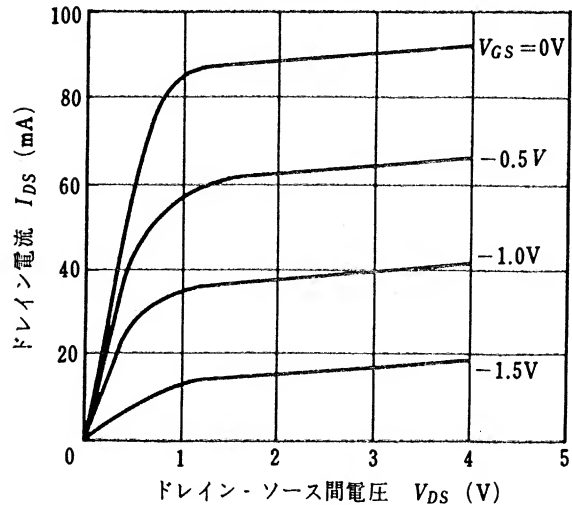


# 2SK354, 354A

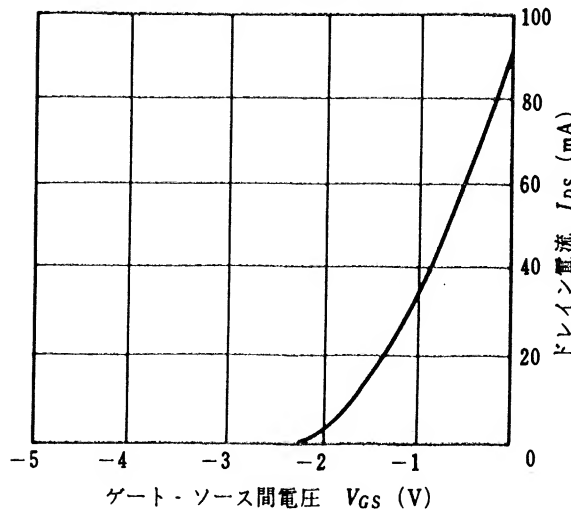
GaAs 型  
Nチャンネル

日 電

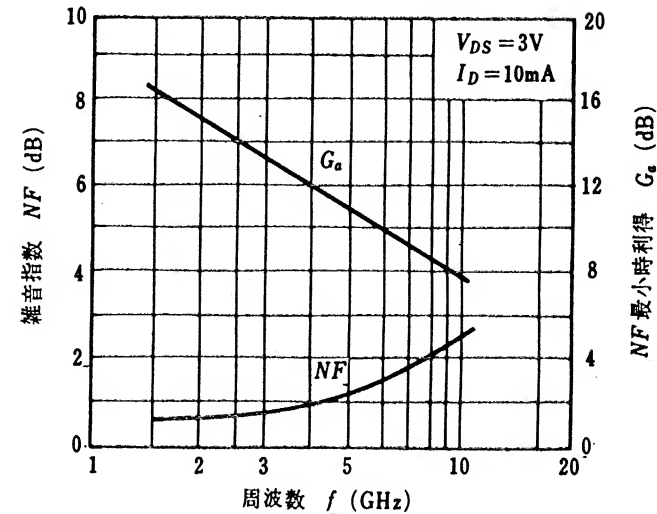
$I_{DS} - V_{DS}$  特性



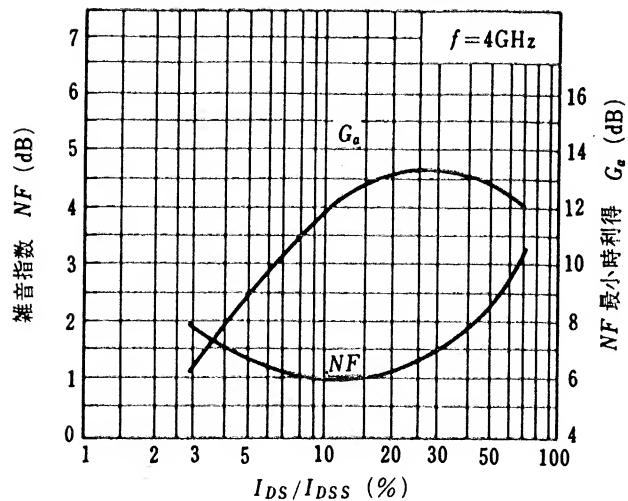
$I_{DS} - V_{GS}$  特性



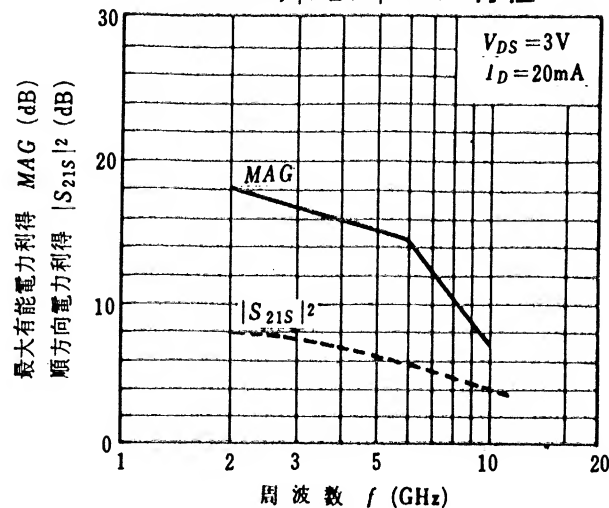
$NF, G_a - f$  特性



$NF, G_a - I_{DS}/I_{DSS}$  特性



$MAG, |S_{21S}|^2 - f$  特性

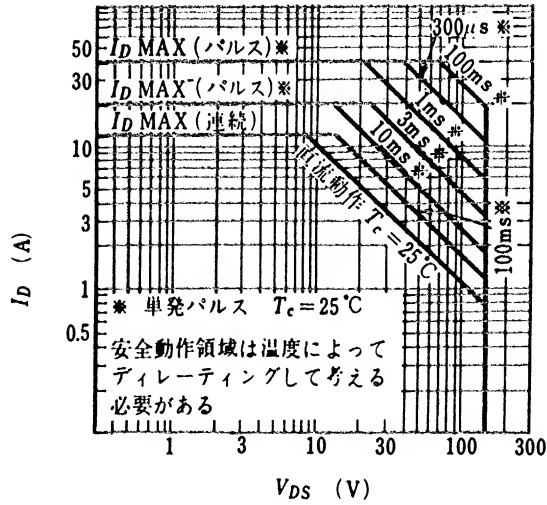


# 2SK355

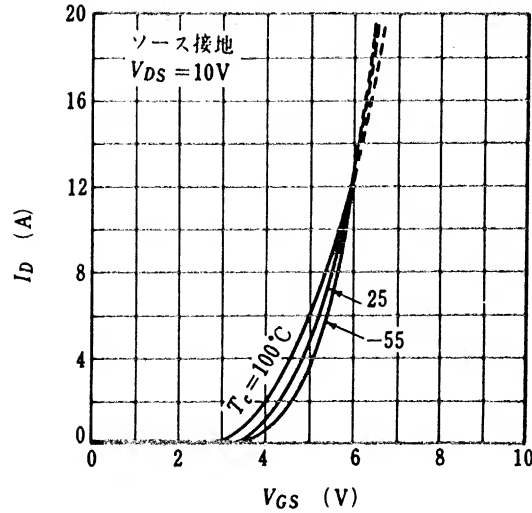
## Si MOS 型 Pチャンネル

東 芝

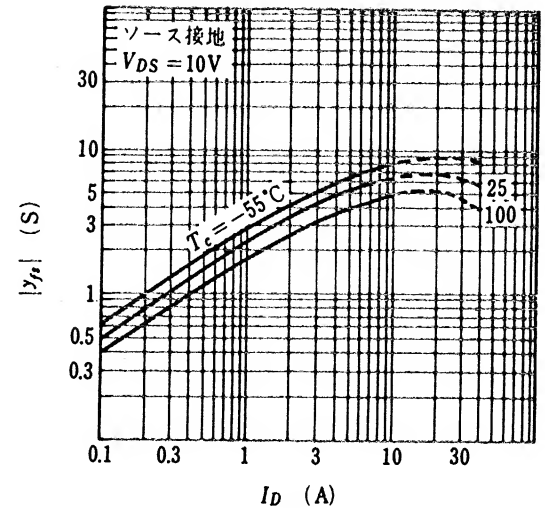
安全動作領域



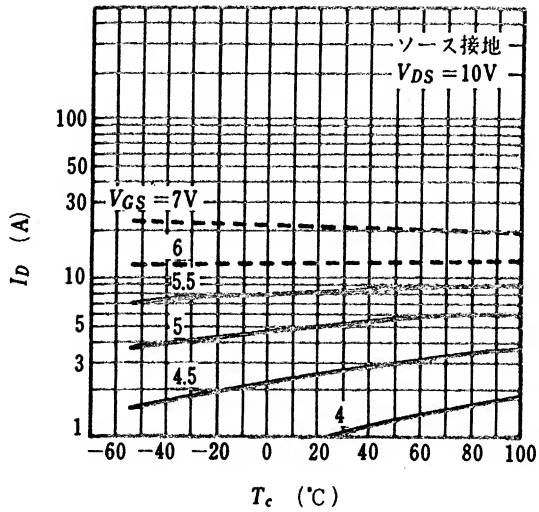
$I_D - V_{GS}$  特性



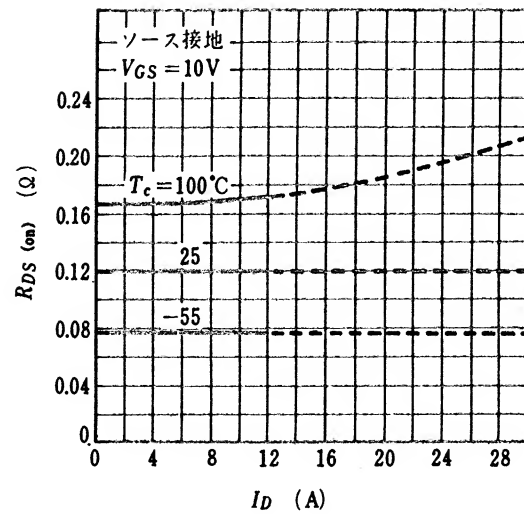
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



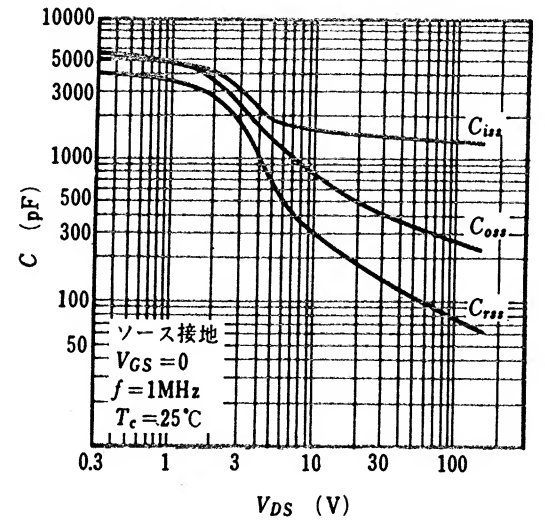
$I_D - T_c$  特性



$R_{DS(on)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

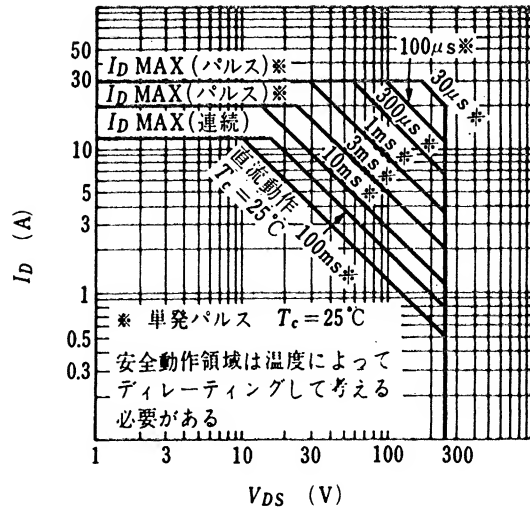


# 2SK356

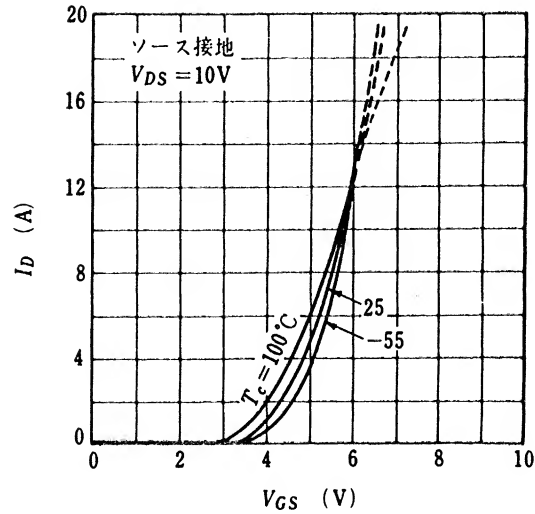
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

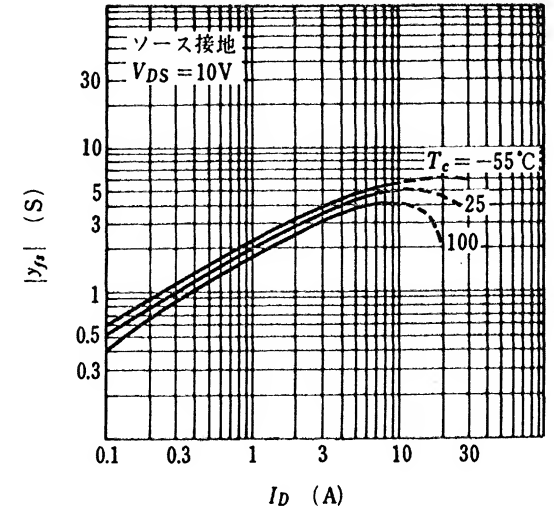
安全動作領域



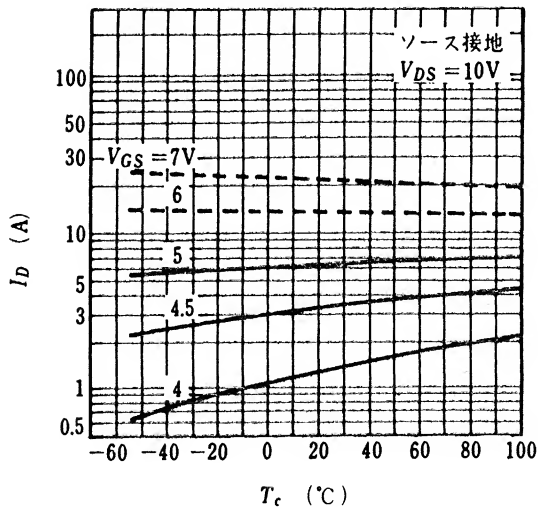
$I_D - V_{GS}$  特性



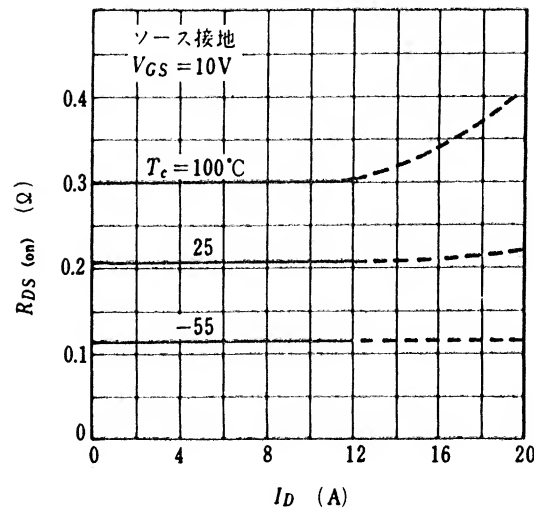
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



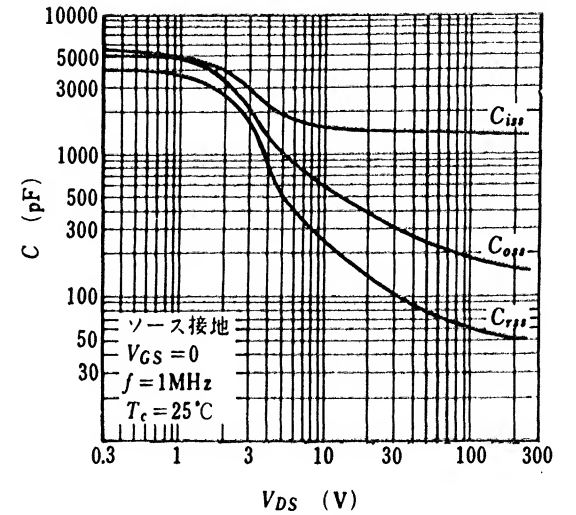
$I_D - T_c$  特性



$R_{DS(on)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

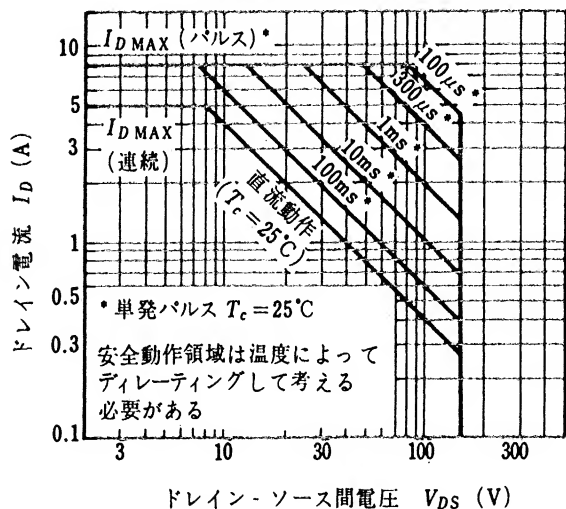


# 2SK357

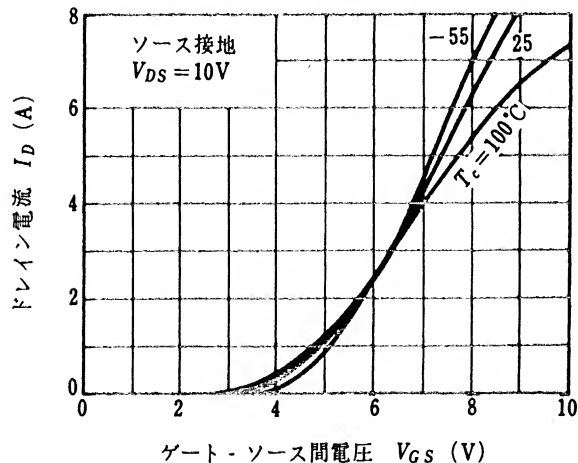
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

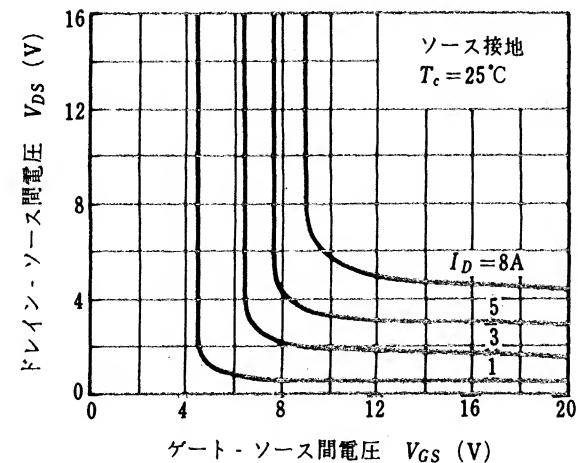
安全動作領域



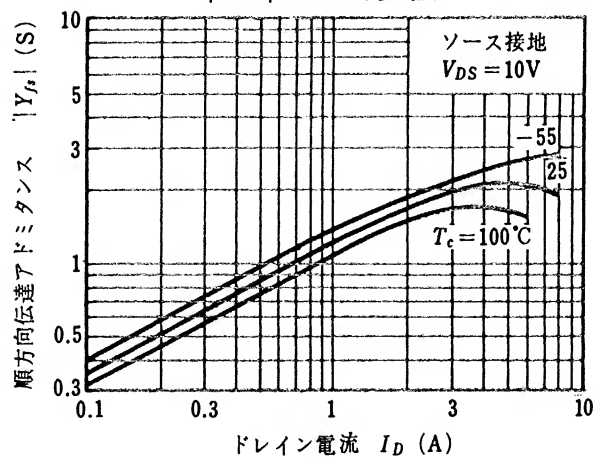
$I_D - V_{GS}$  特性



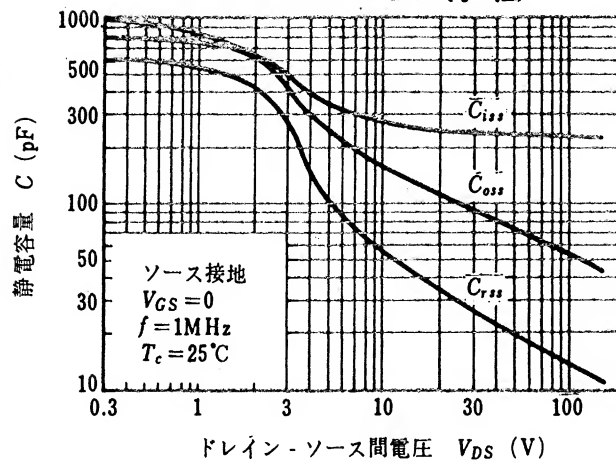
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



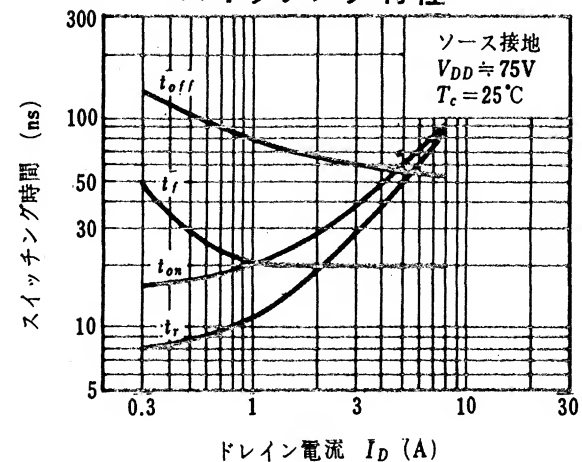
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$C - V_{DS}$  特性



スイッチング特性



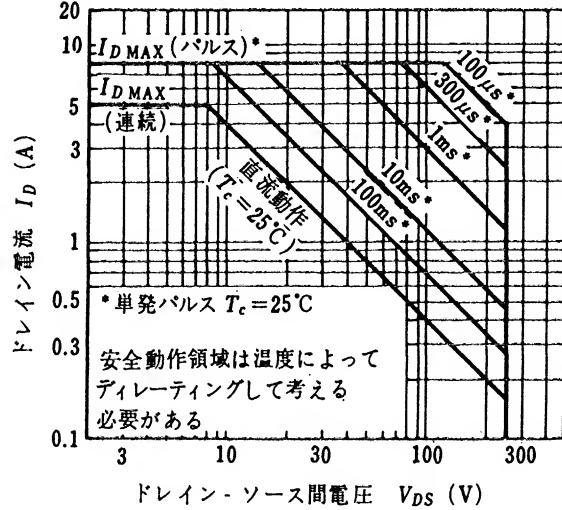


# 2SK358

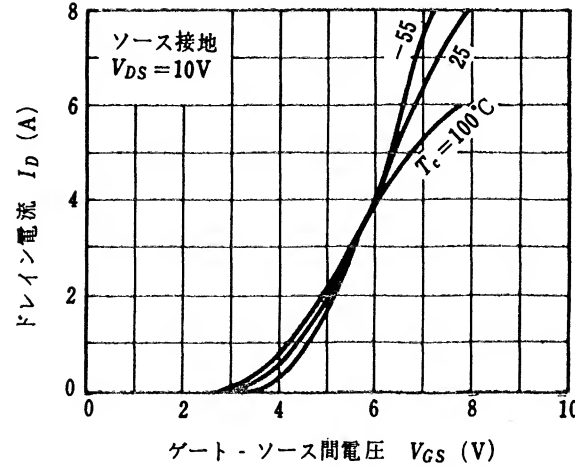
## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

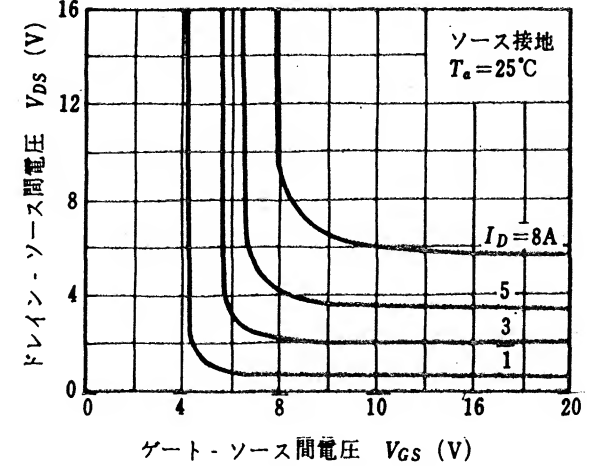
安全動作領域



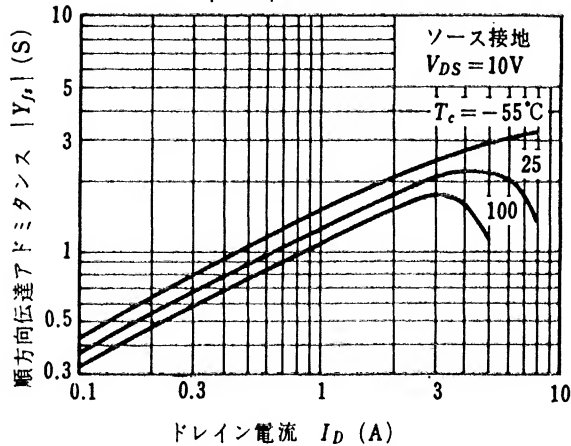
$I_D - V_{DS}$  特性



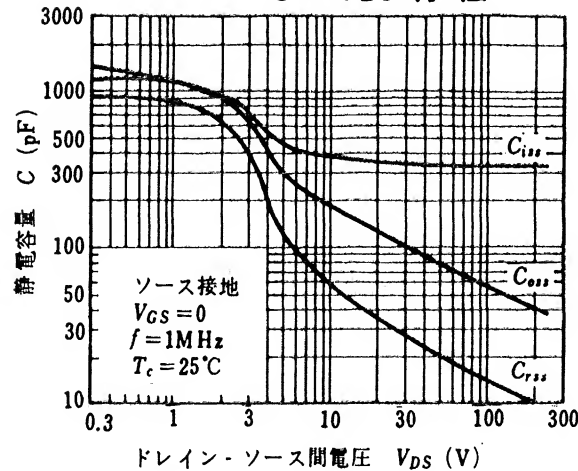
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



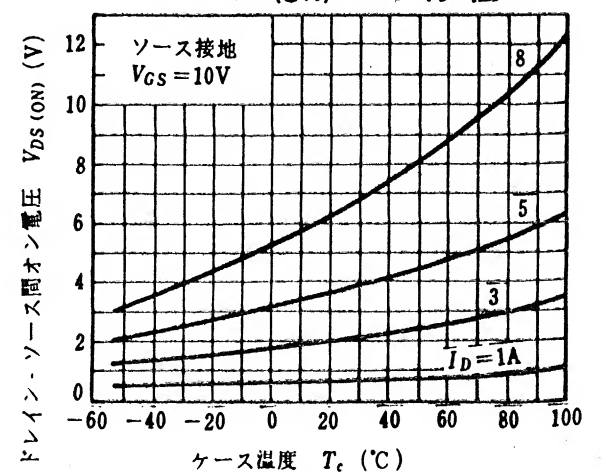
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$C - V_{DS}$  特性



$V_{DS(ON)} - T_c$  特性



# 2SK359, 360, 439

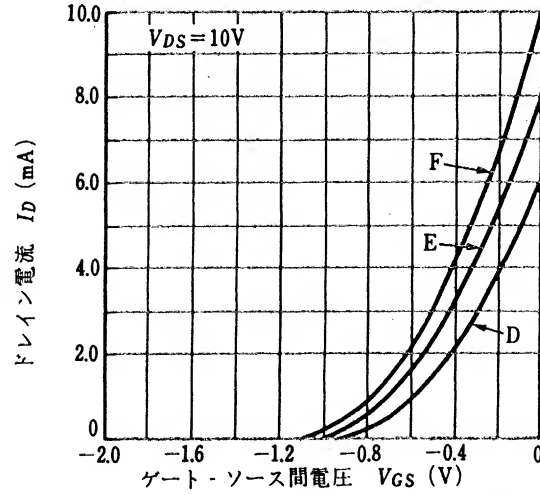
Si MOS 型  
Nチャンネル

日 立

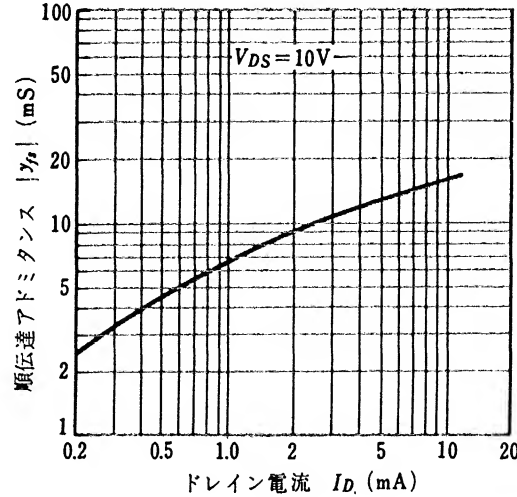
2SC360/439  $I_{DSS}$  分類

	D	E	F
$I_{DSS}$ (mA)	4~8	6~10	8~12

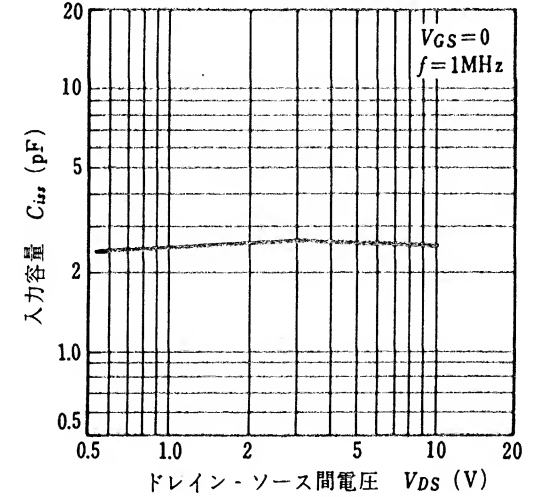
ソース接地伝達静特性



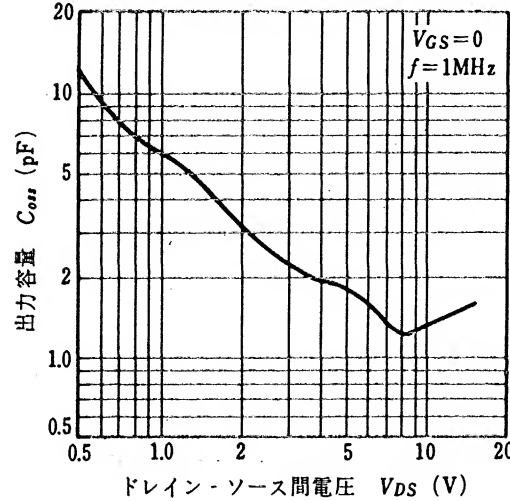
順伝達アドミタンス対ドレイン電流特性



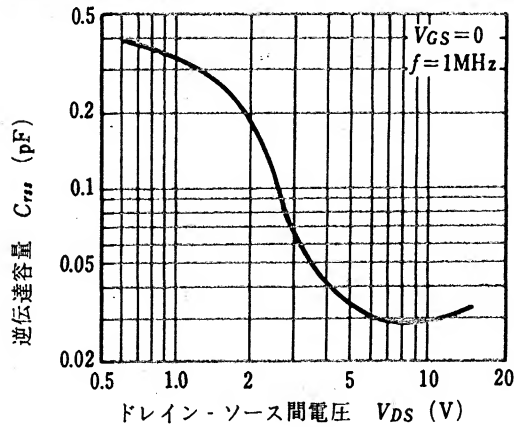
入力容量対ドレイン-ソース間電圧特性



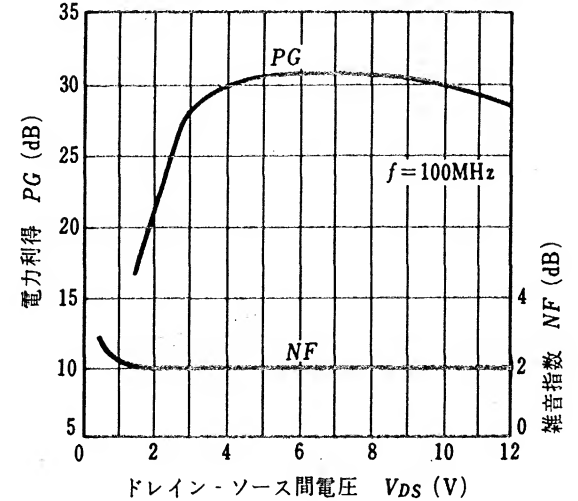
出力容量対ドレイン-ソース間電圧特性



逆伝達容量対ドレイン-ソース間電圧特性



電力利得, 雑音指数対ドレイン-ソース間電圧特性



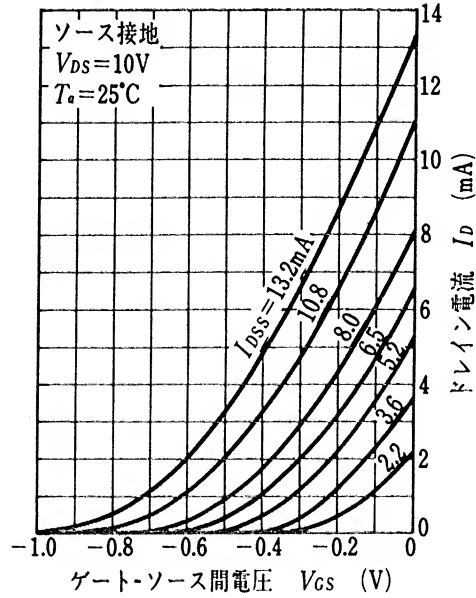
# 2SK362,365

Si 接合型  
Nチャンネル

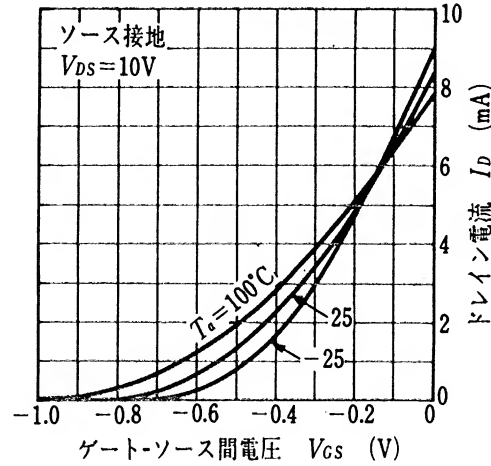
東 芝

$I_{DSS}$ 分類 Y: 1.2~3.0, GR: 2.6~6.5, BL: 6~14

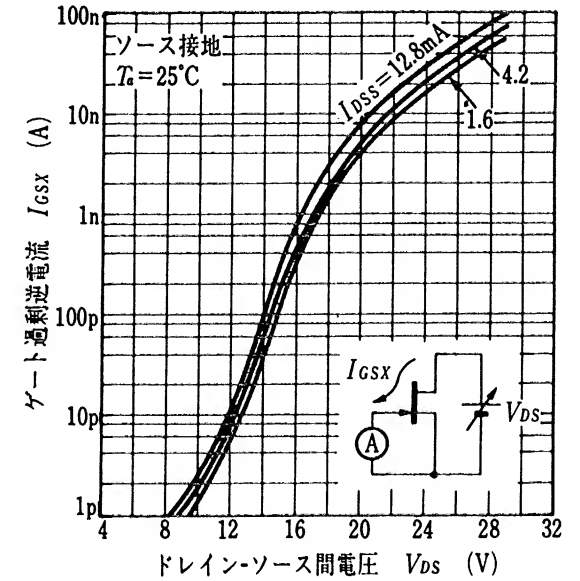
$I_D - V_{GS}$



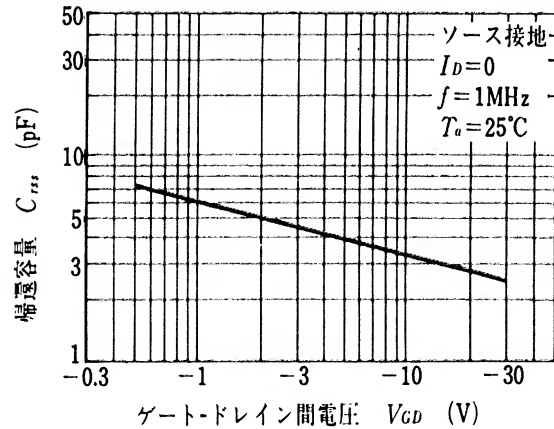
$I_D - V_{GS}$  (温度依存性)



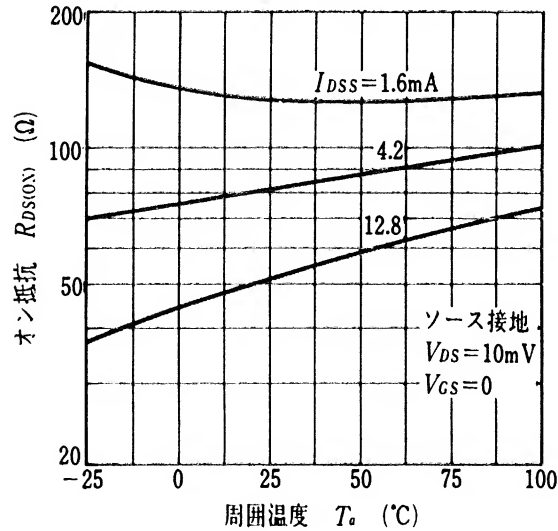
$I_{GSX} - V_{DS}$



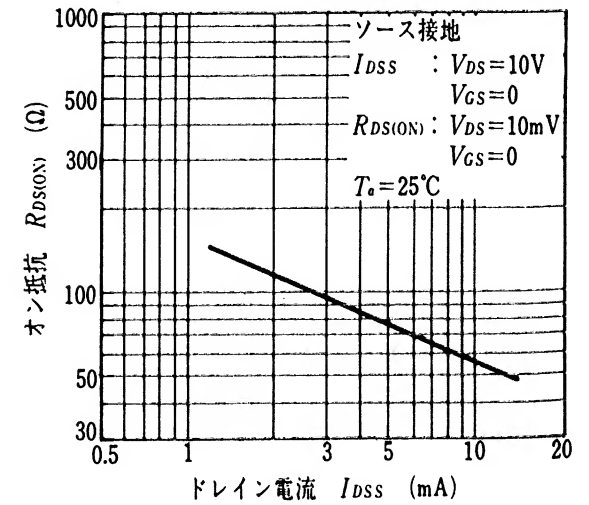
$C_{rss} - V_{GD}$



$R_{DS(ON)} - T_a$



$R_{DS(ON)} - I_{DSS}$



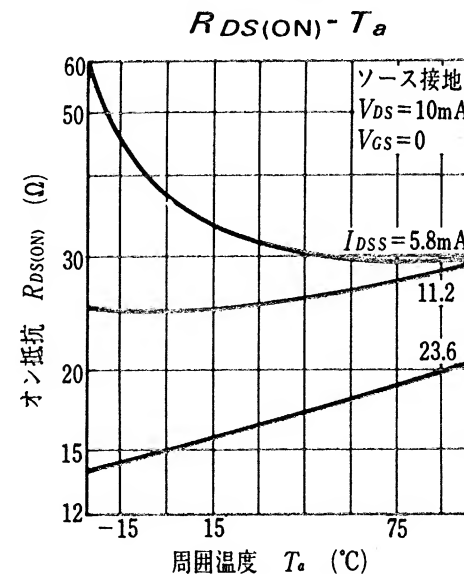
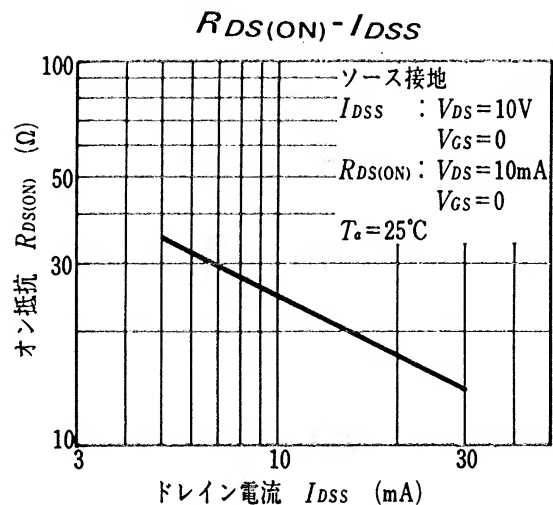
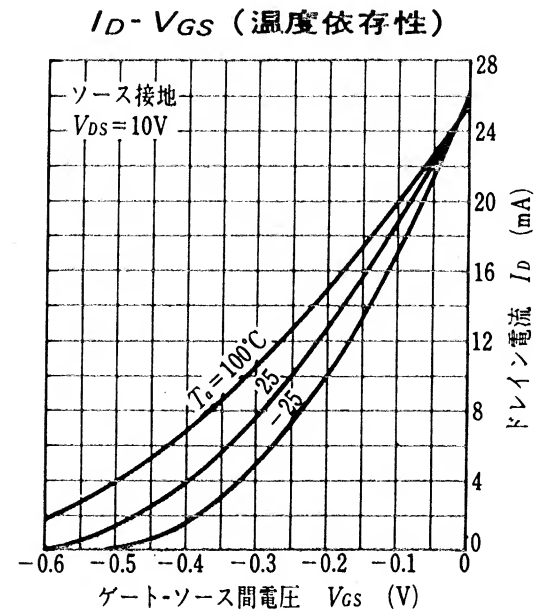
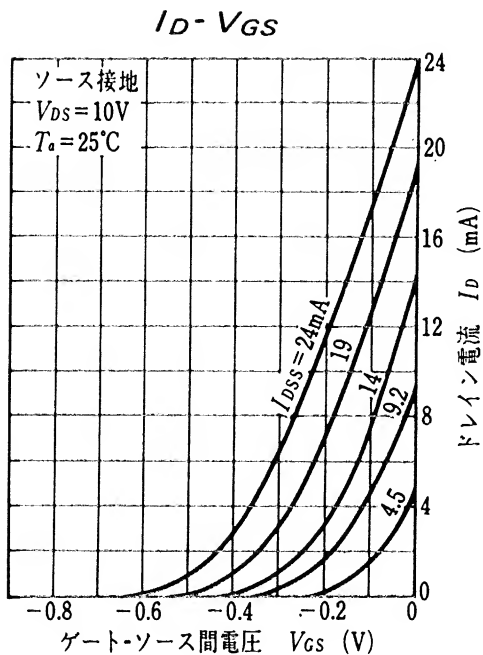
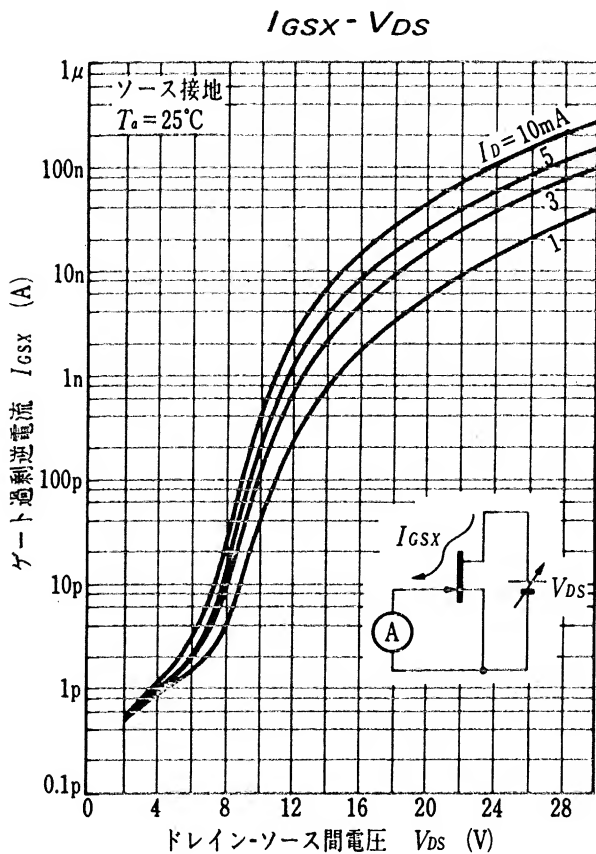


# 2SK363,372

## Si 接合型 Nチャンネル

東 芝

$I_{DSS}$ 分類 GR: 5.0~10.0, BL: 8.0~16.0, V: 14.0~30.0

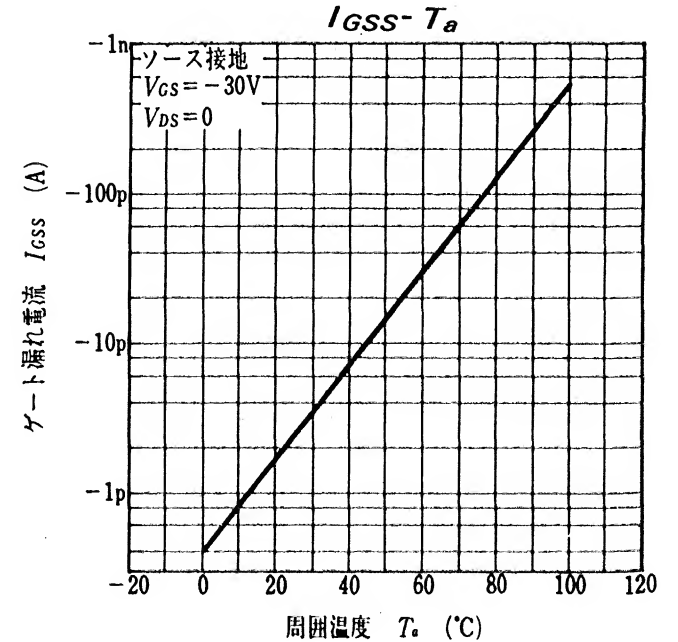
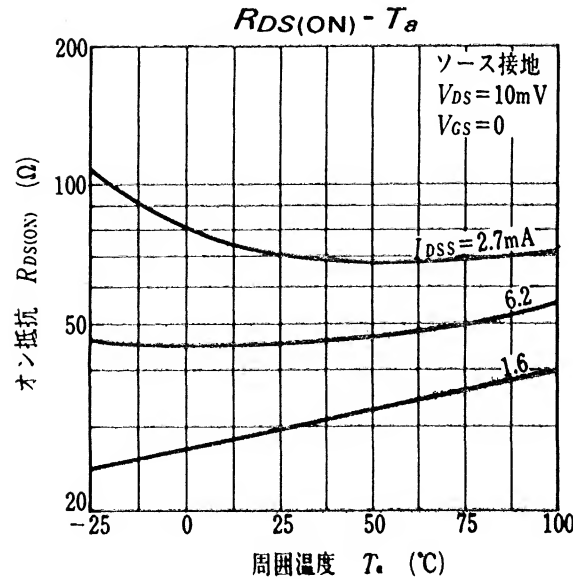
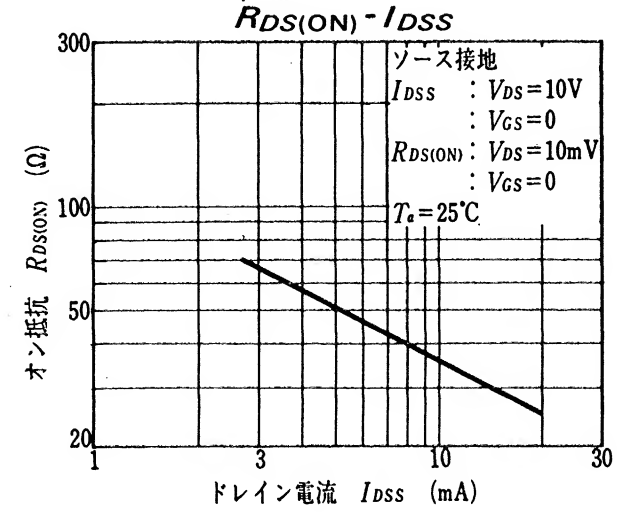
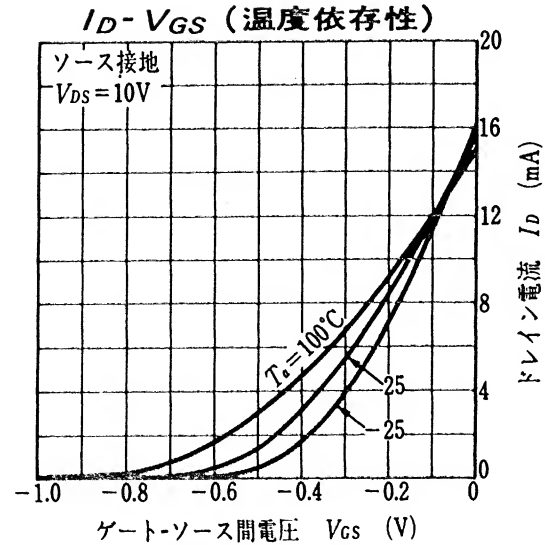
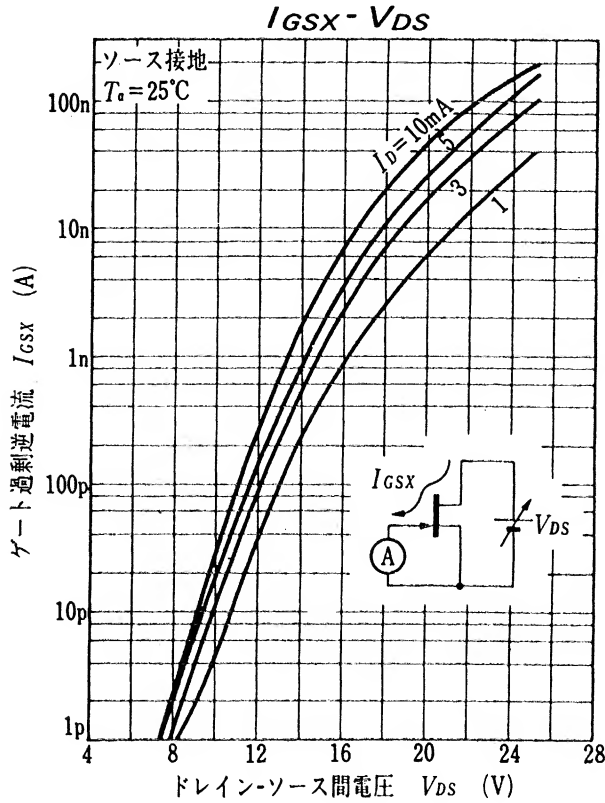


# 2SK364, 366

Si 接合型  
Nチャンネル

東 芝

$I_{DSS}$ 分類 GR: 2.6~6.5, BL: 6~12, V: 10~20

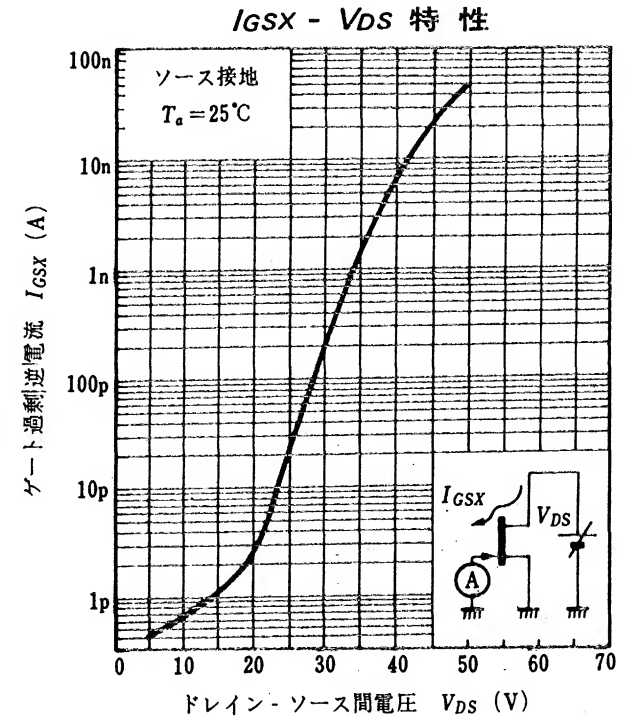
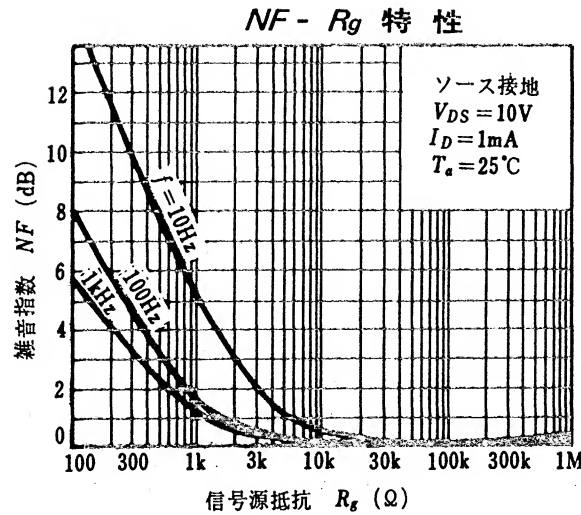
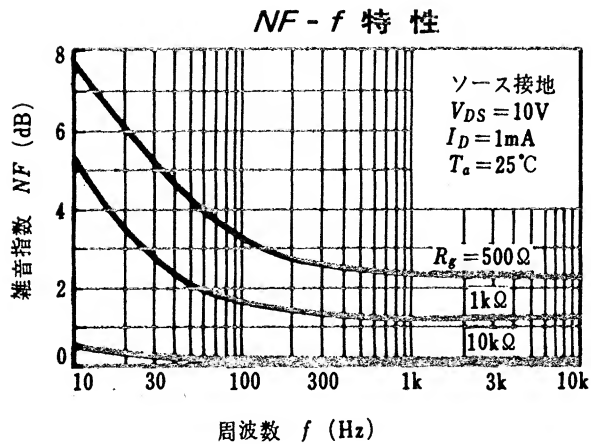
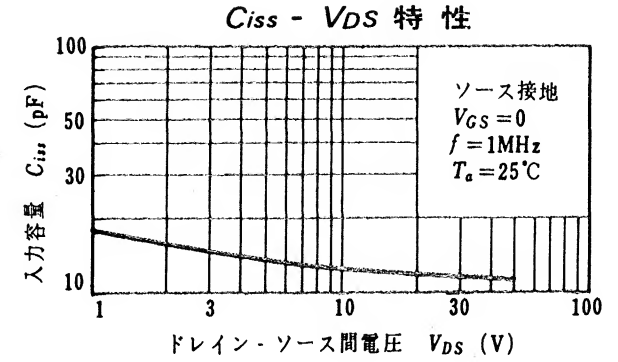
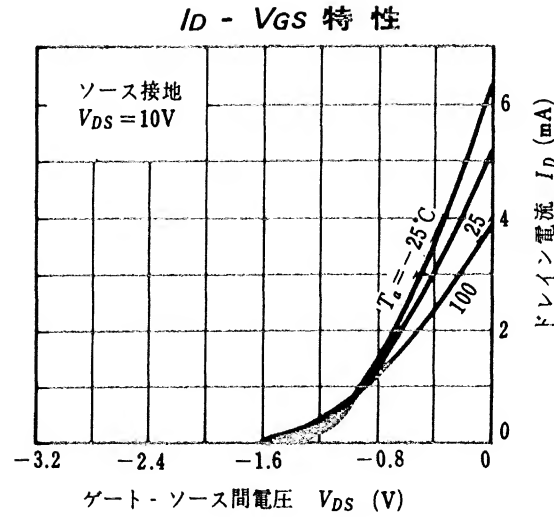
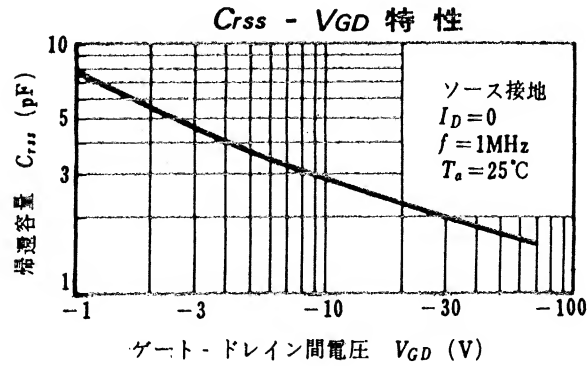


# 2SK367, 368

## Si 接合型 Nチャンネル

## 東 芝

$I_{DSS}$  分類 O: 0.6~1.4, Y: 1.2~3.0, GR: 2.6~6.5 (mA)



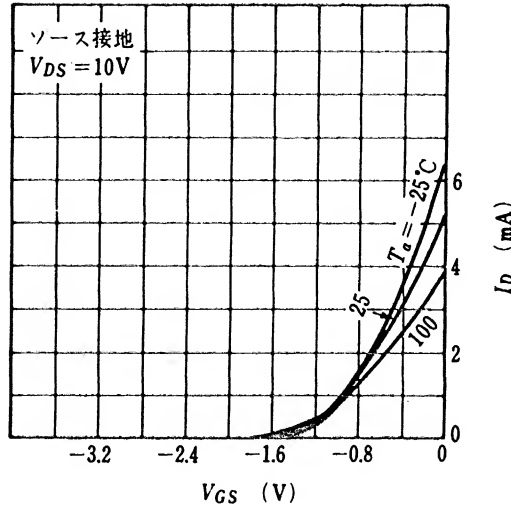
# 2SK373

Si 接合型  
Nチャンネル

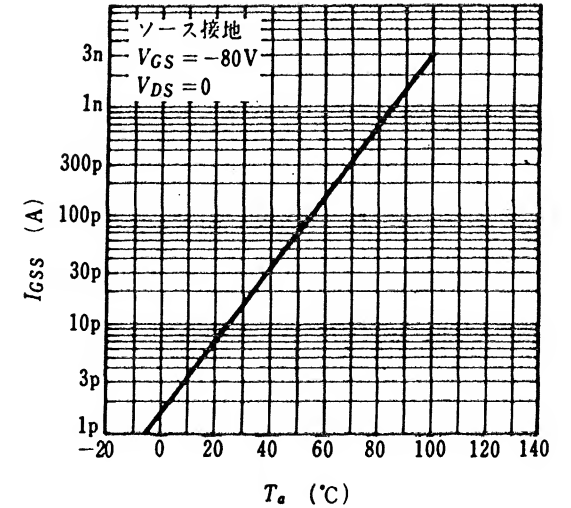
東 芝

$I_{DSS}$  分類 O: 0.6~1.4mA, Y: 1.2~3.0mA, GR: 2.6~6.5mA

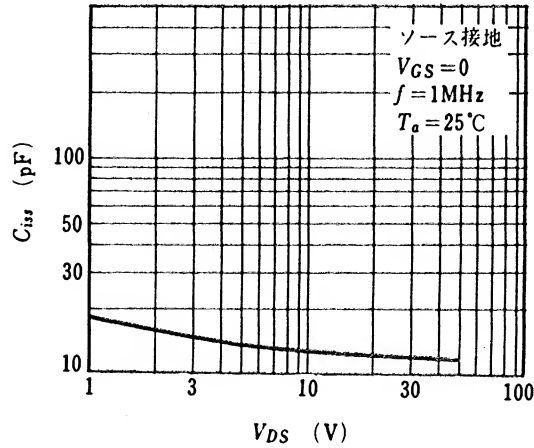
$I_D - V_{GS}$  特性



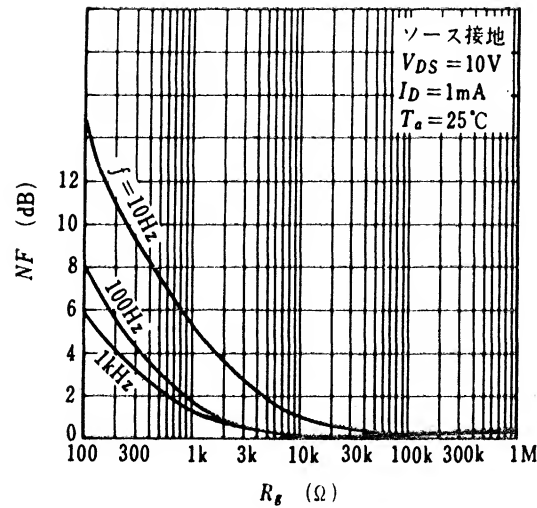
$I_{GSS} - V_{GS}$  特性



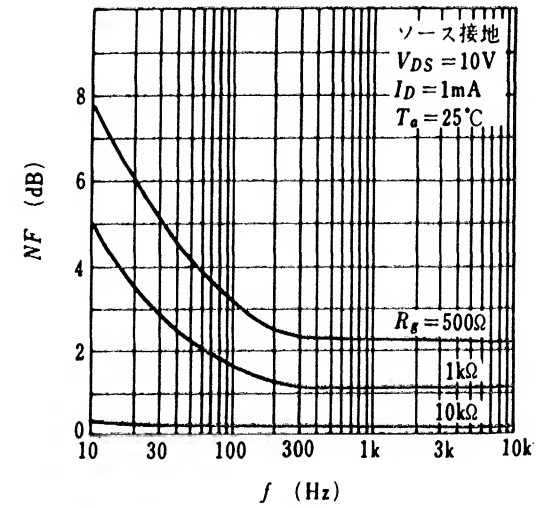
$C_{iss} - V_{DS}$  特性



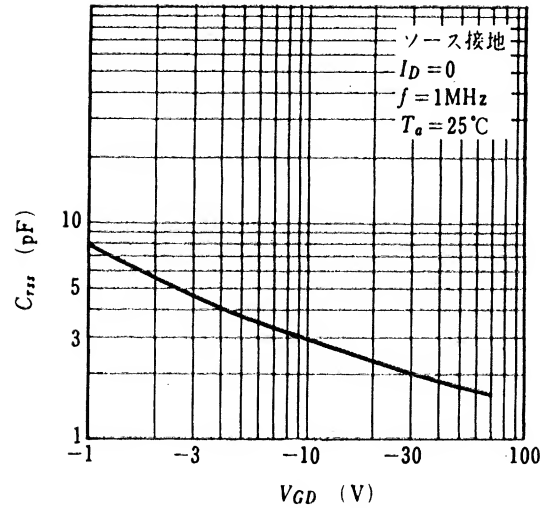
NF -  $R_g$  特性



NF -  $f$  特性



$C_{rss} - V_{GD}$  特性



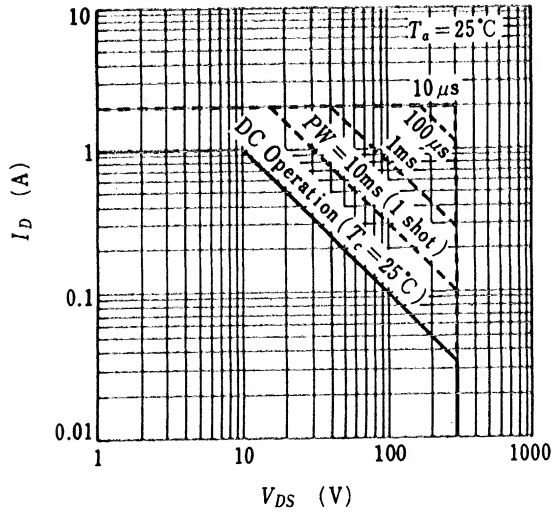


# 2SK375

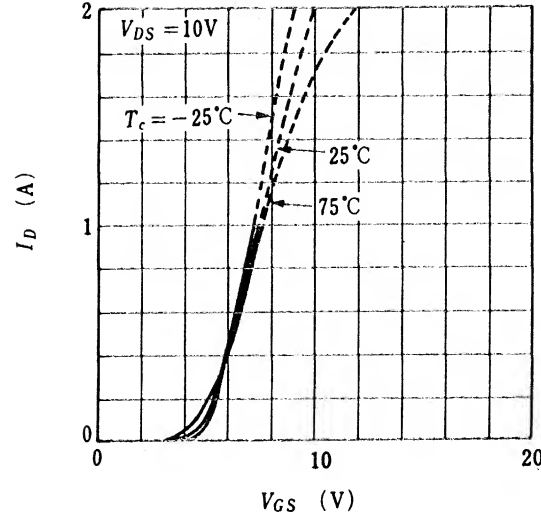
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

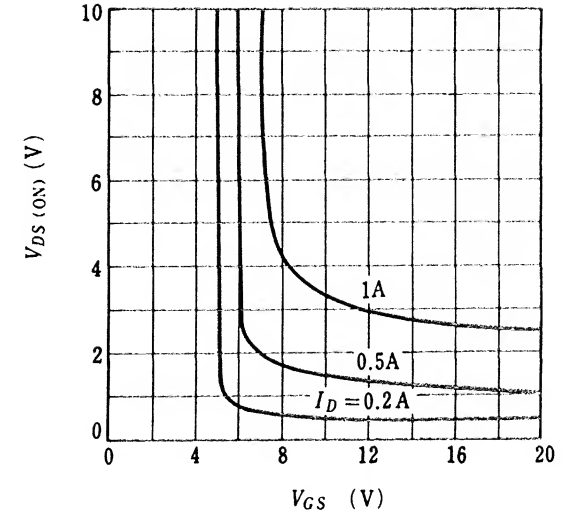
### 安全動作領域



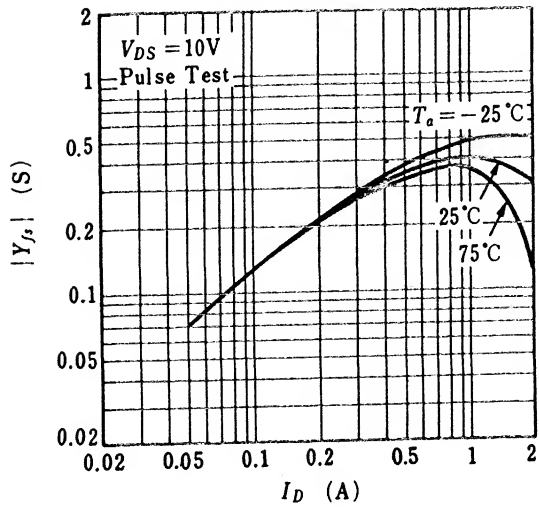
### 伝達特性



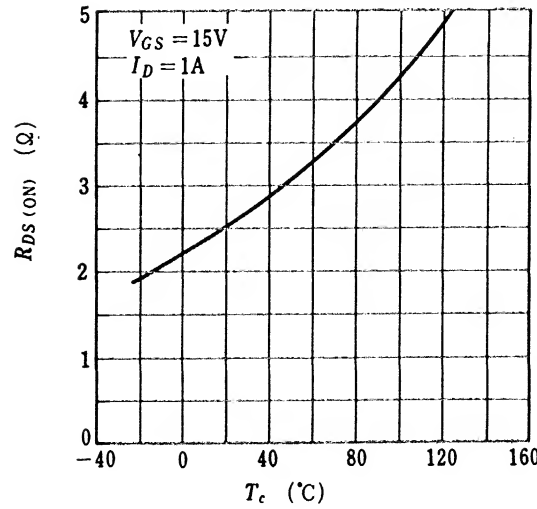
### VDS (ON) - VGS 特性



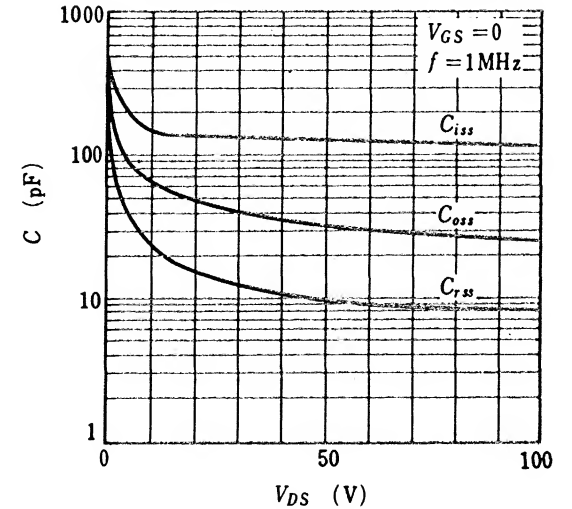
### |Yfs| - ID 特性



### RDS(ON) - Tc 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性



# 2SK376, 377

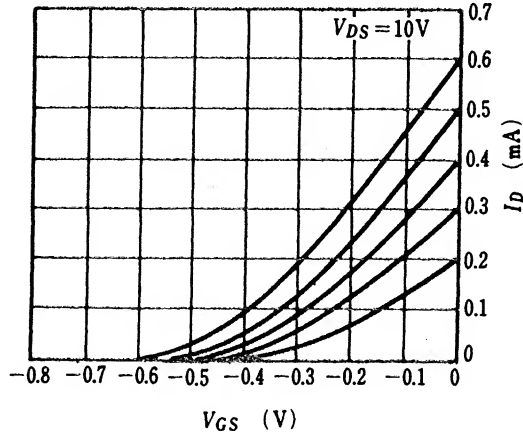
Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

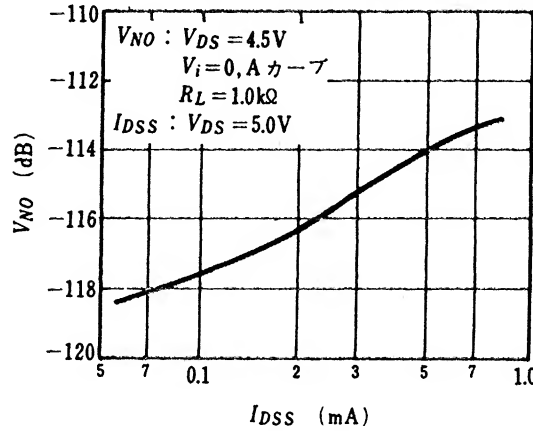
$I_{DSS}$  により次のように分類する (単位:  $\mu A$ )

60	J	180	150	K	300	250	L	500	400	M	800
----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

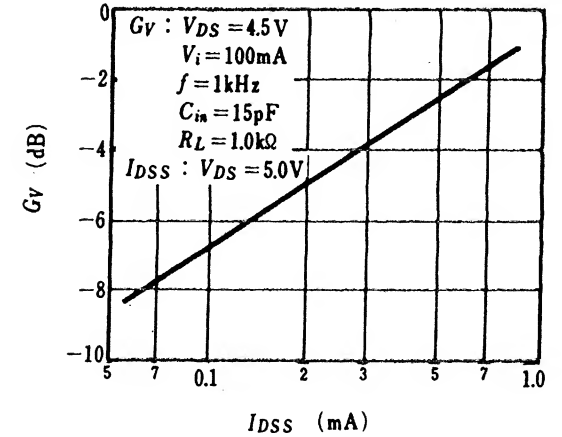
$I_D - V_{GS}$  特性



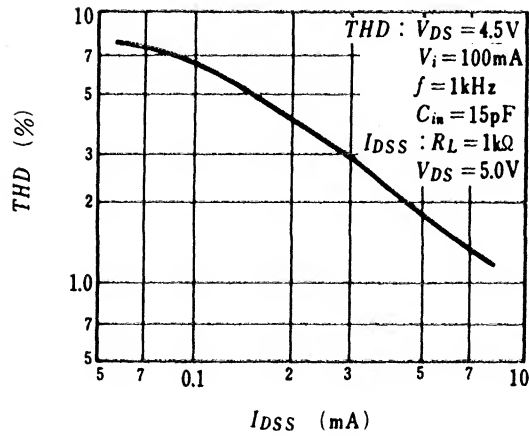
$V_{NO} - I_{DSS}$  特性



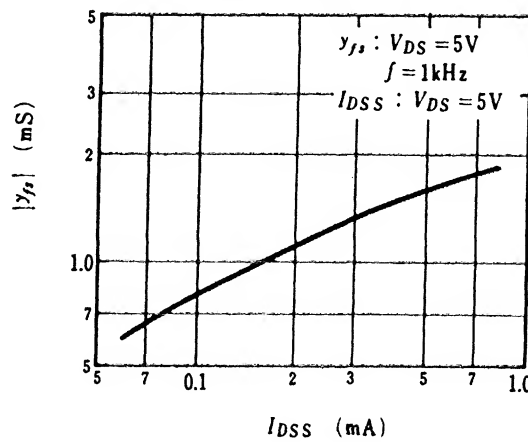
$G_v - I_{DSS}$  特性



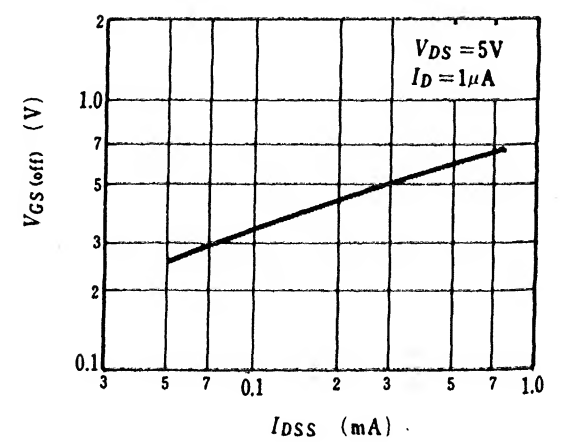
THD -  $I_{DSS}$  特性



$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



GaAs 型  
Nチャンネル

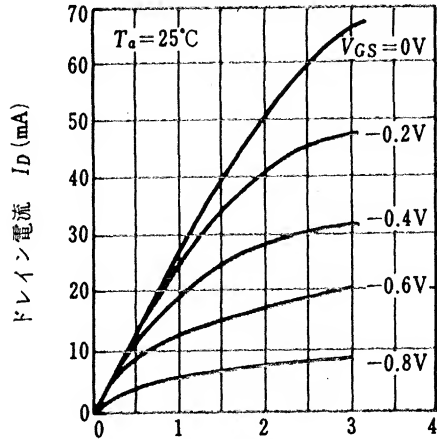
松下

2SK378

$I_{DSS}$  ランク分類

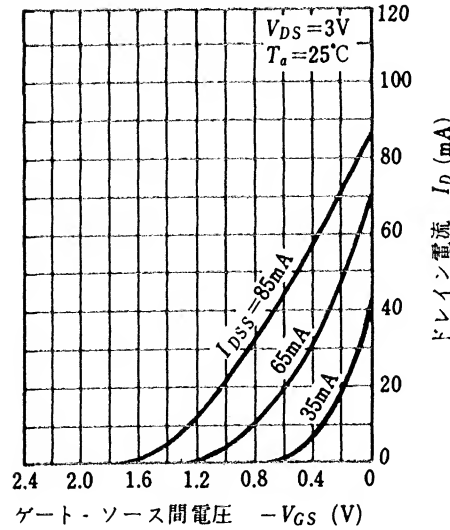
	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	15~50	40~80	70~130

$I_D - V_{DS}$  特性



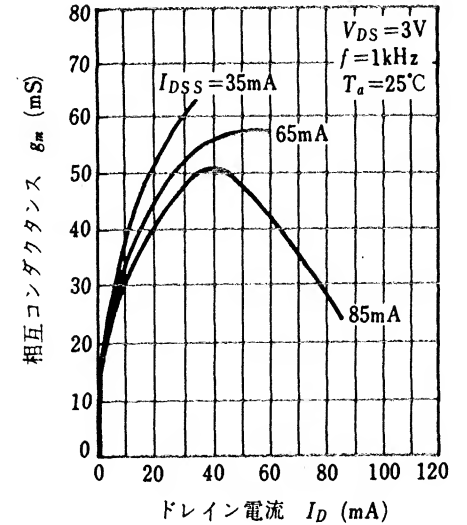
ドレイン-ソース間電圧  $V_{GS}$  (V)

$I_D - V_{GS}$  特性

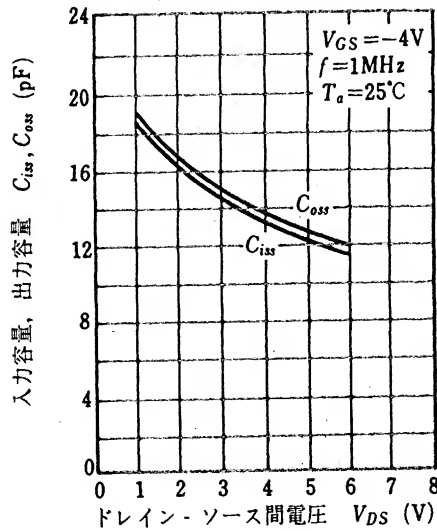


ゲート-ソース間電圧  $-V_{GS}$  (V)

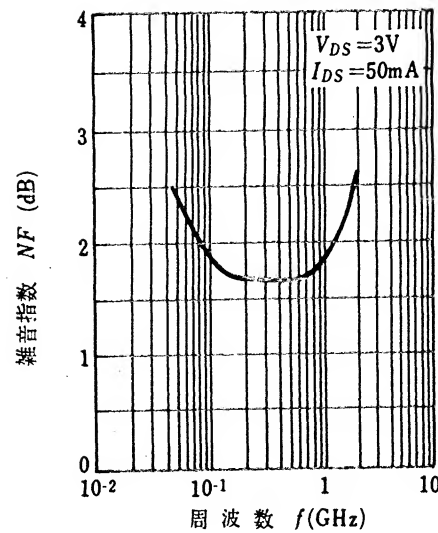
$g_m - I_D$  特性



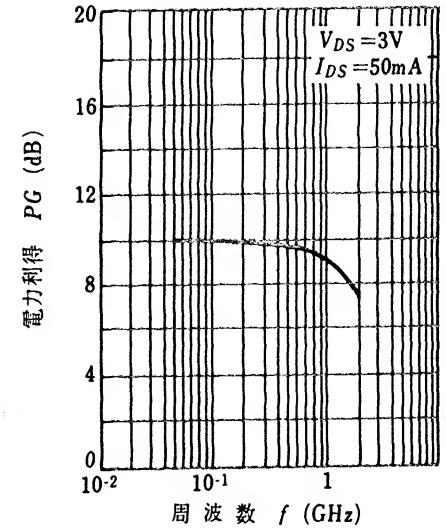
$C_{iss}, C_{oss} - V_{DS}$  特性



NF - f 特性



PG - f 特性

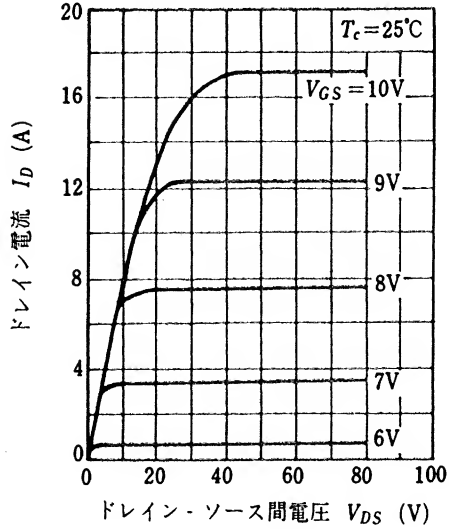


# 2SK379

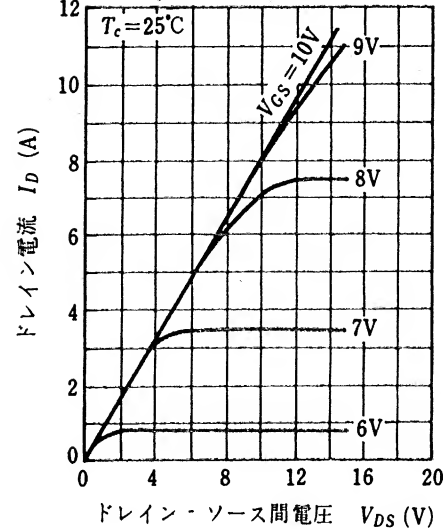
## Si MOS型 Nチャンネル

松下

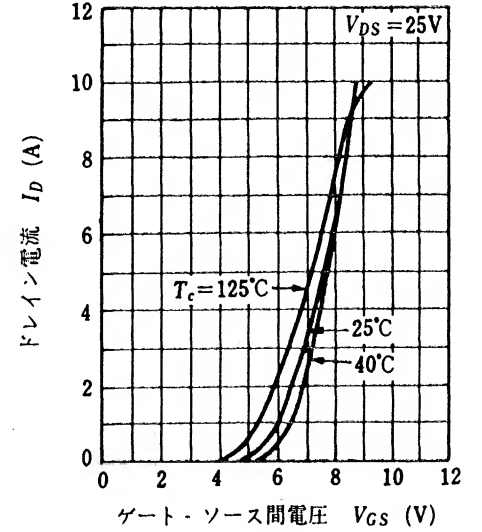
$I_D - V_{DS}$  特性



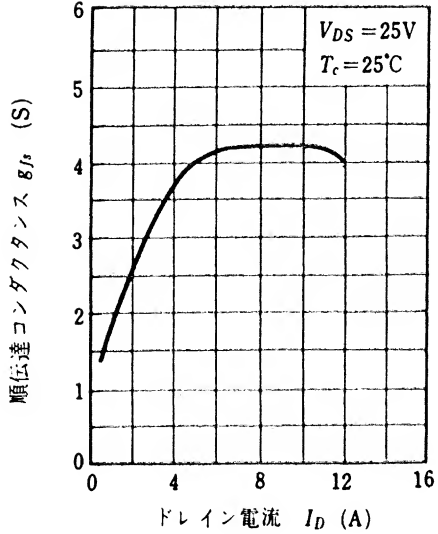
$I_D - V_{DS}$  特性



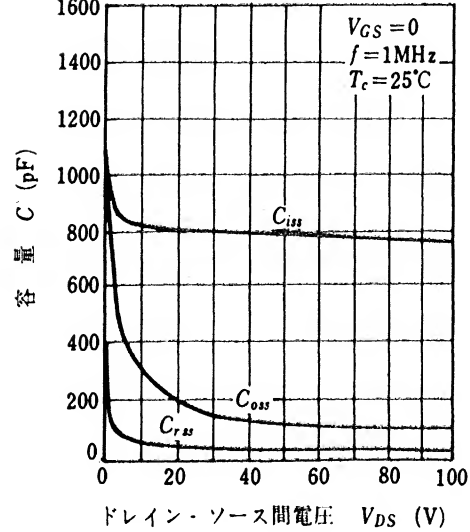
$I_D - V_{GS}$  特性



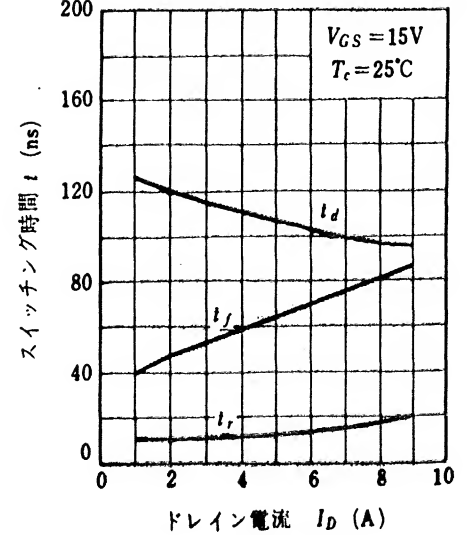
$g_{fs} - I_D$  特性



$C - V_{DS}$  特性



$t - I_D$  特性

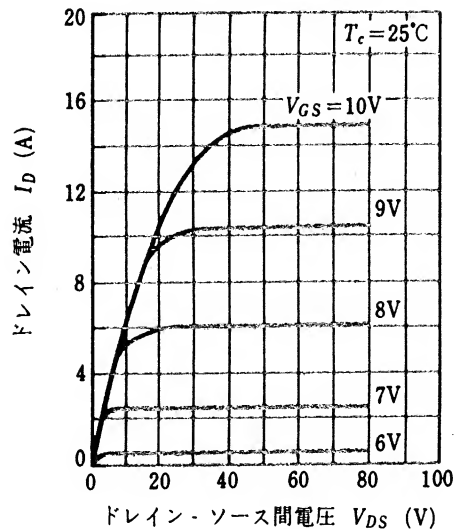


# 2SK380

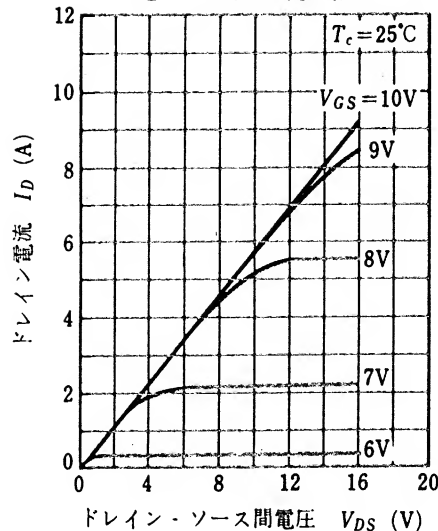
## Si MOS型 Nチャンネル

松下

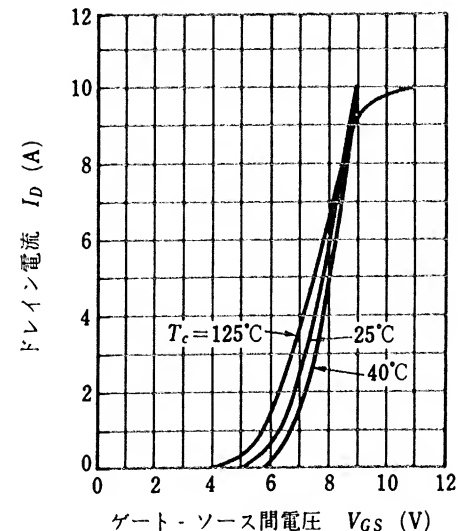
$I_D - V_{DS}$  特性



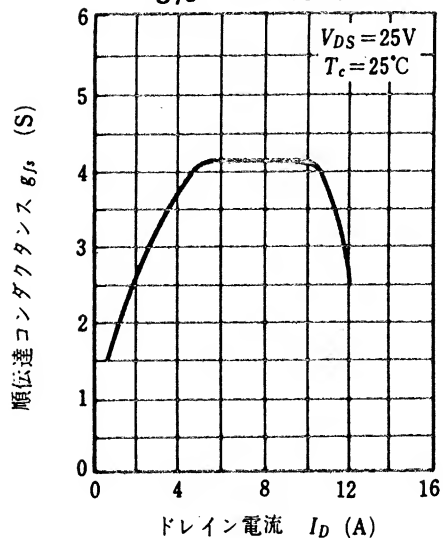
$I_D - V_{DS}$  特性



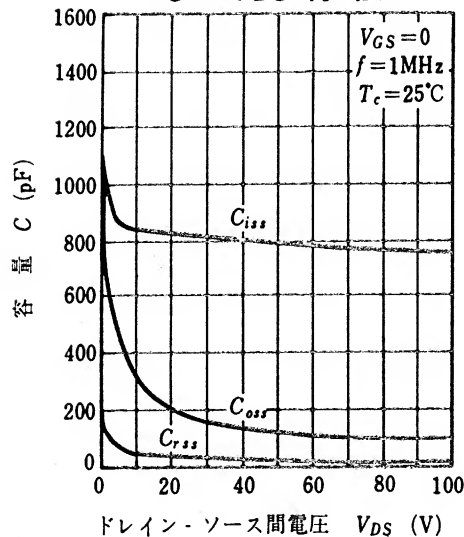
$I_D - V_{GS}$  特性



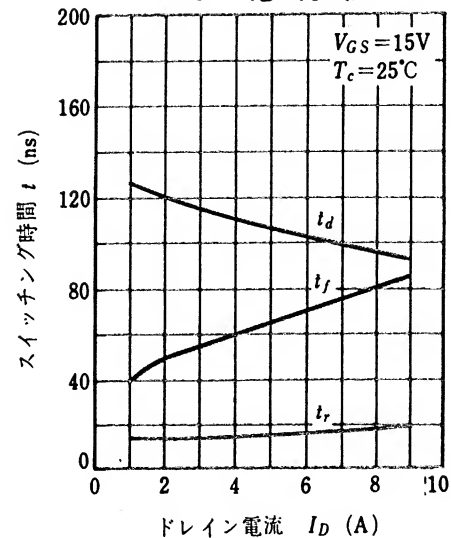
$g_{fs} - I_D$  特性



$C - V_{DS}$  特性



$t - I_D$  特性



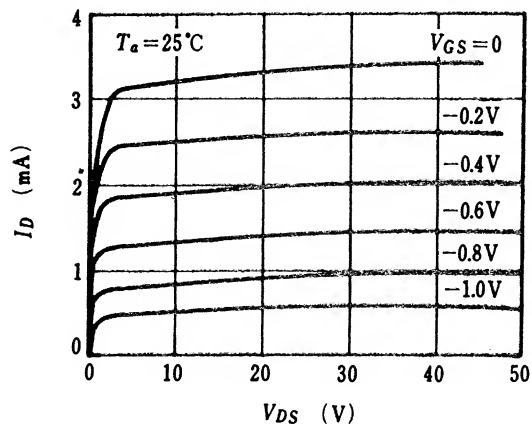
# 2SK381, 433

Si 接合型  
Nチャンネル

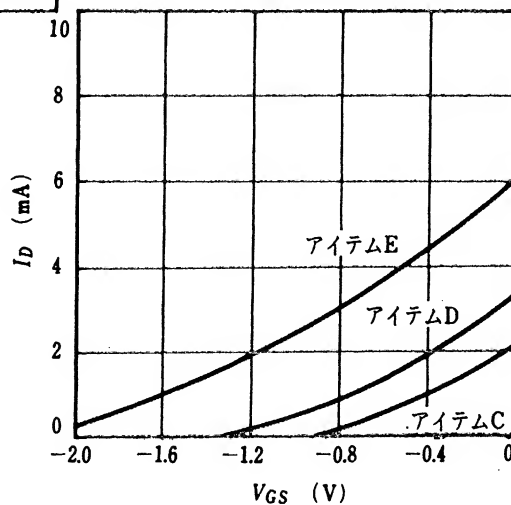
三 菱

アイテム	A	B	C	D	E
$I_{DSS}$ (mA)	0.3~0.8	0.6~1.5	1.0~3.0	2.5~6.0	5.0~12

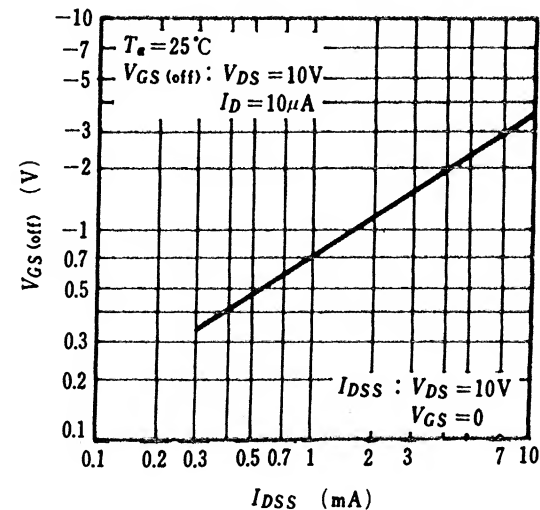
ソース接地出力特性



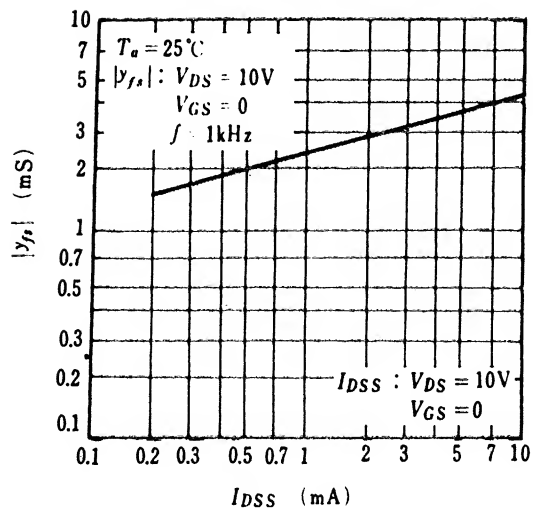
ソース接地伝達特性



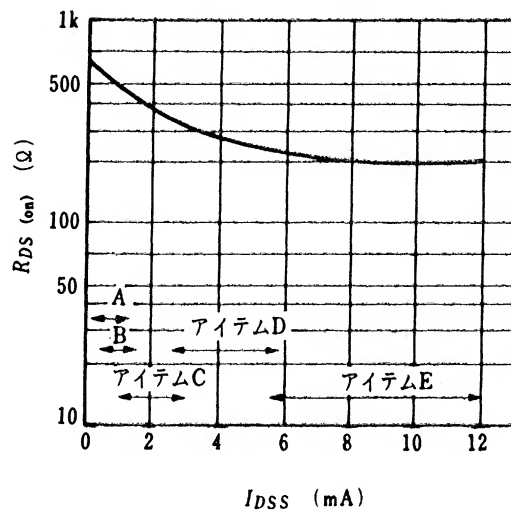
$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



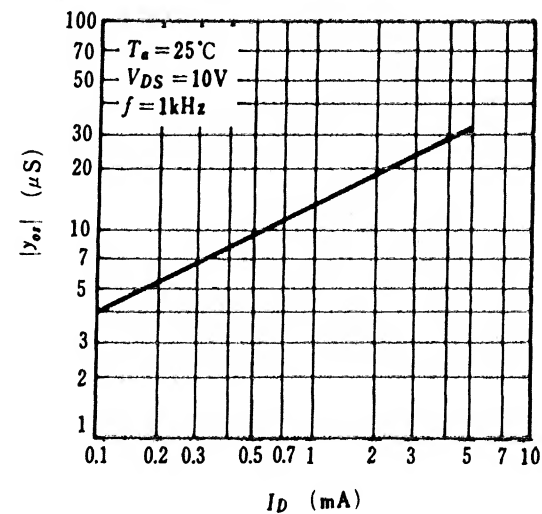
$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$R_{DS(on)} - I_{DSS}$  特性



$|y_{os}| - I_D$  特性

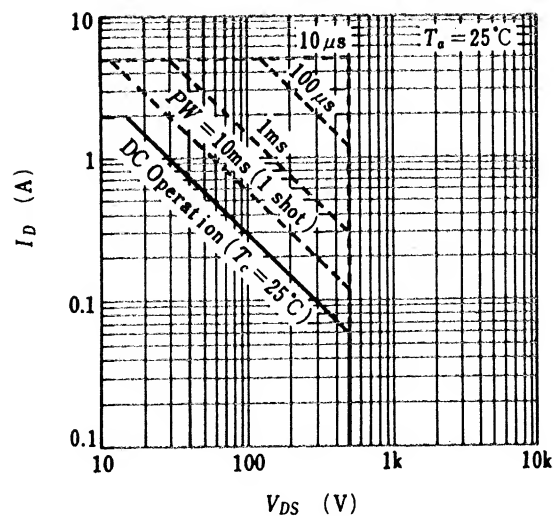


2SK382

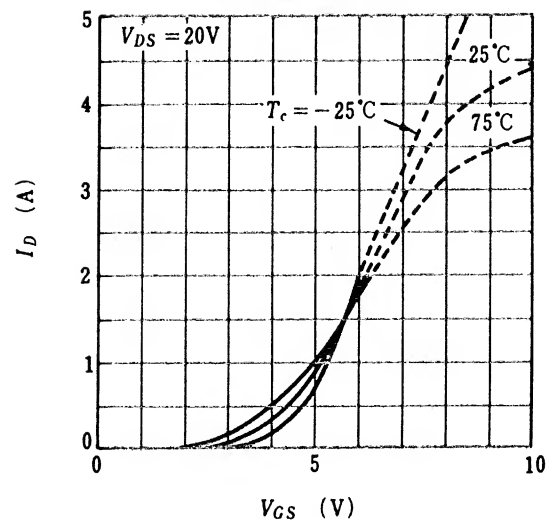
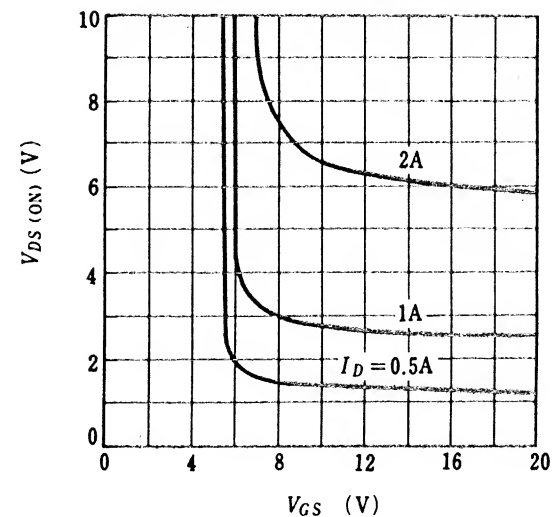
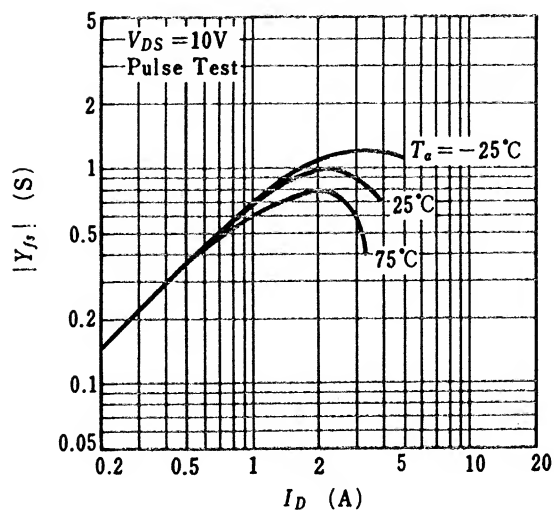
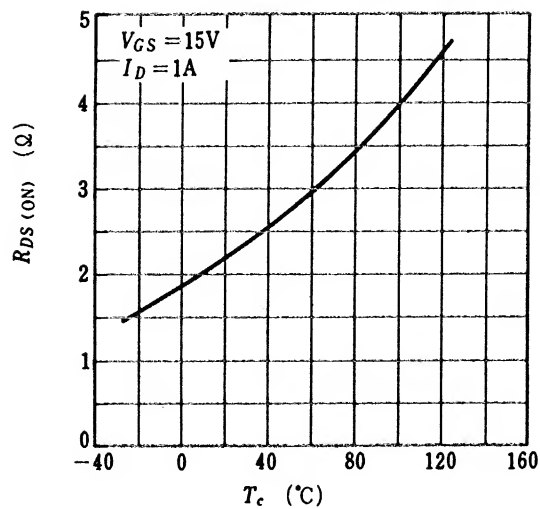
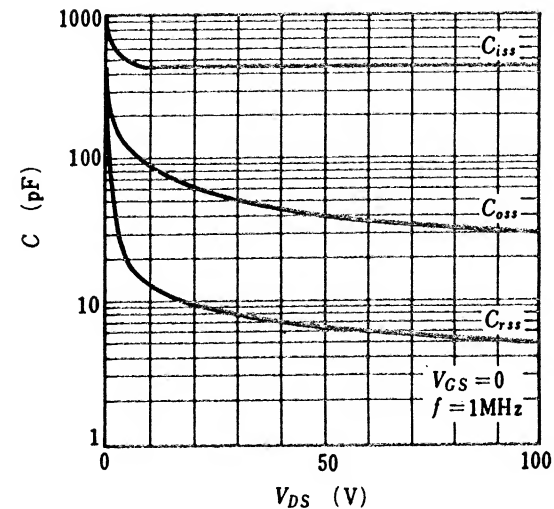
Si MOS 型  
Nチャンネル

日 立

安全動作領域



伝達特性

 $V_{DS(ON)} - V_{GS}$  特性 $|Y_{fs}| - I_D$  特性 $R_{DS(ON)} - T_c$  特性 $C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性

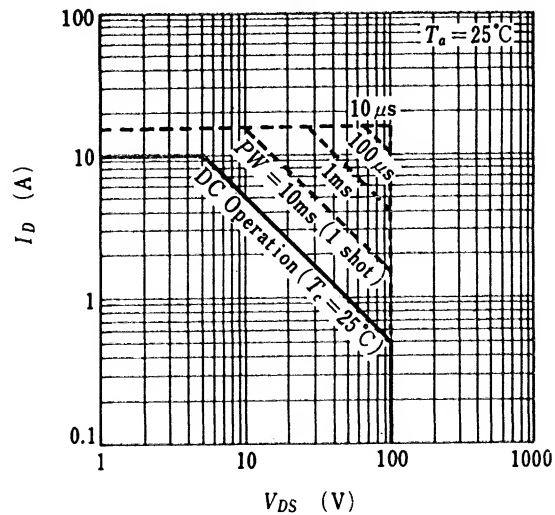


# 2SK383

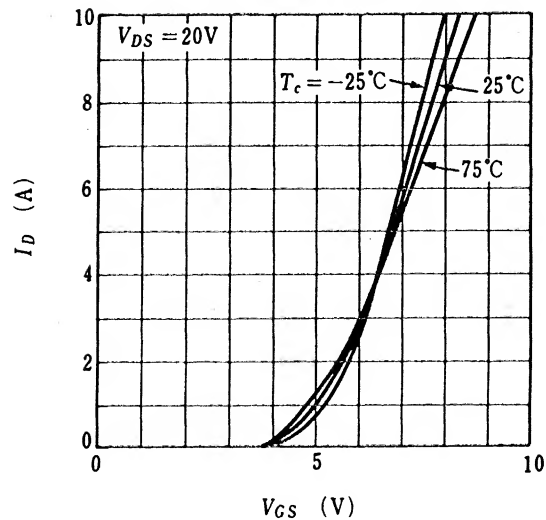
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

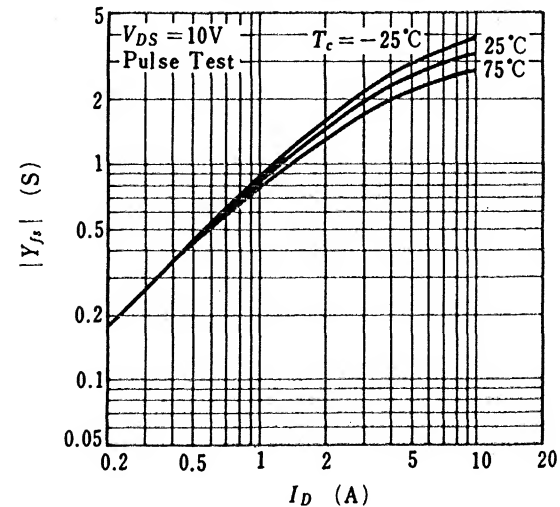
安全動作領域



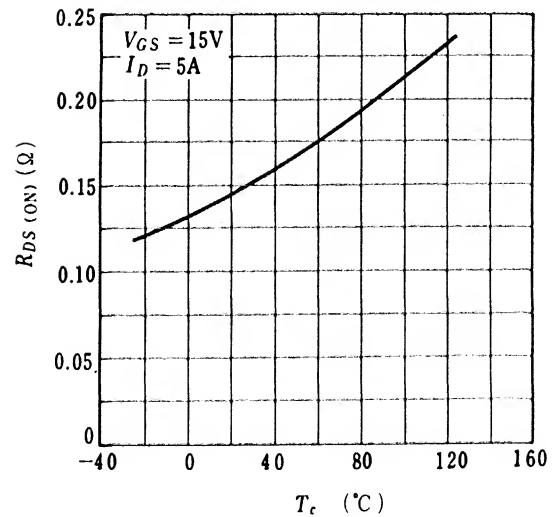
伝達特性



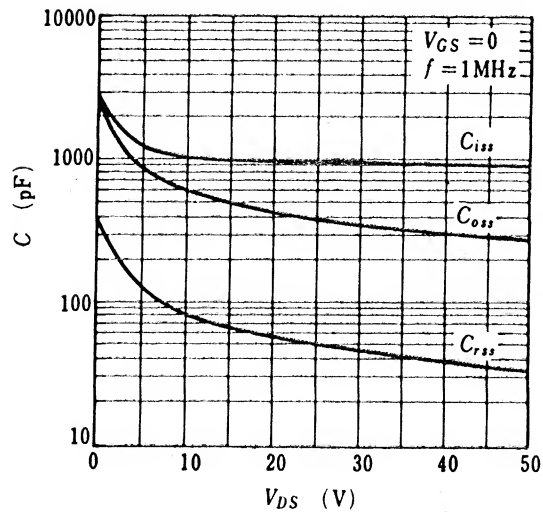
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



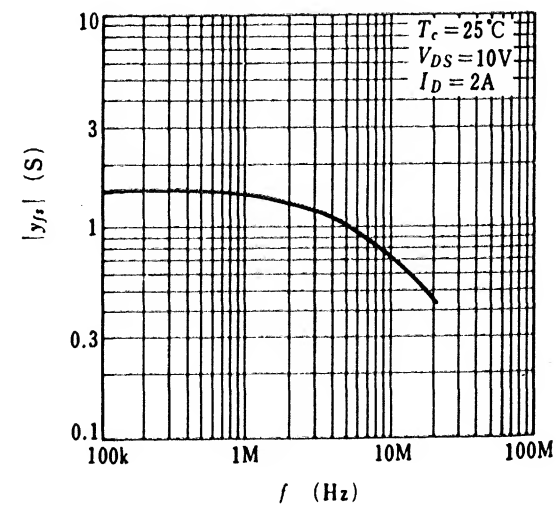
$R_{DS(ON)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



$|Y_{fs}| - f$  特性



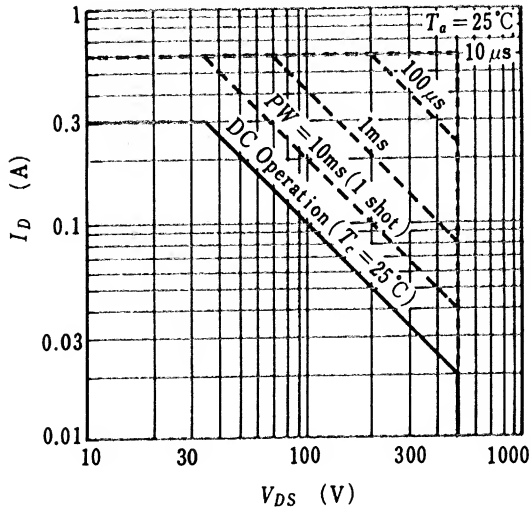


# 2SK384

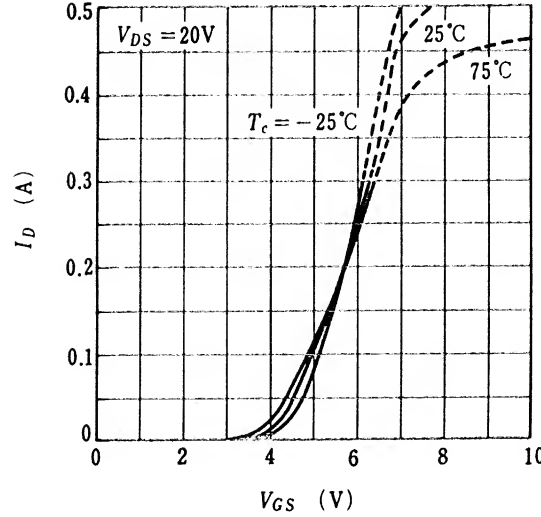
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

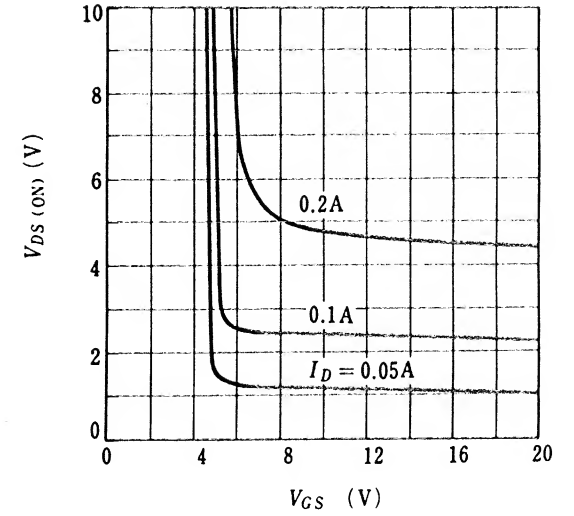
### 安全動作領域



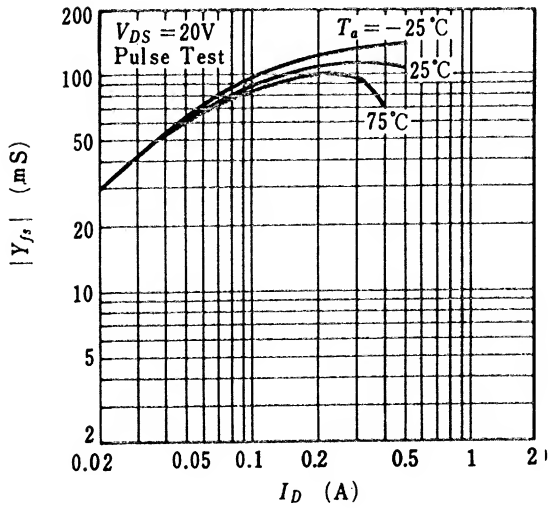
### 伝達特性



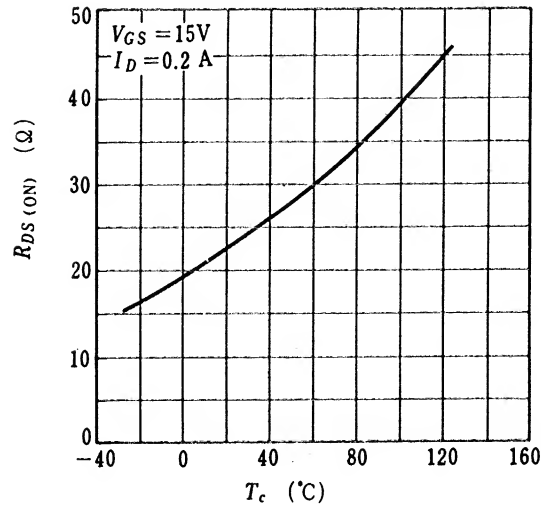
### $V_{DS(ON)} - V_{GS}$ 特性



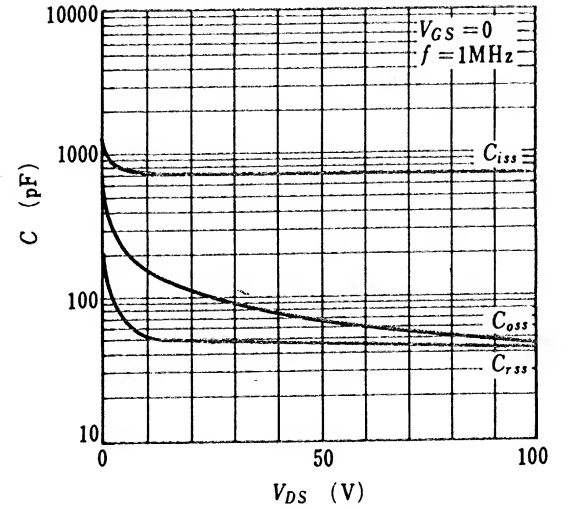
### $|Y_{fs}| - I_D$ 特性



### $R_{DS(ON)} - T_c$ 特性



### $C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$ 特性

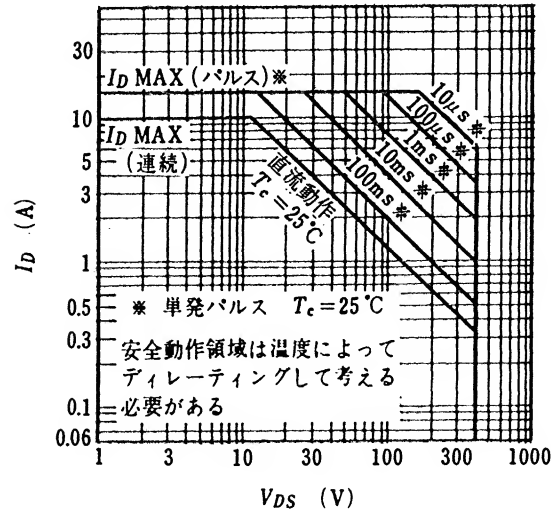


# 2SK385

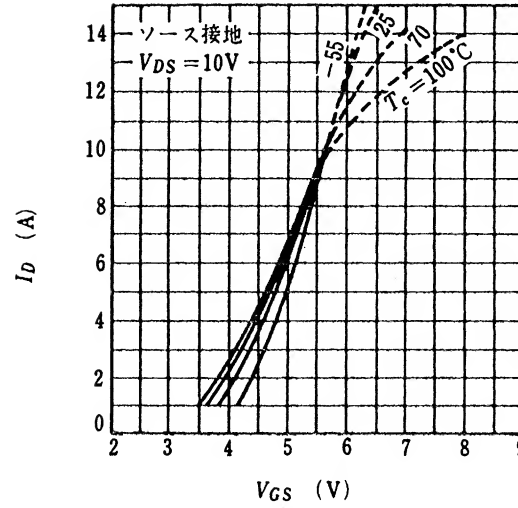
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

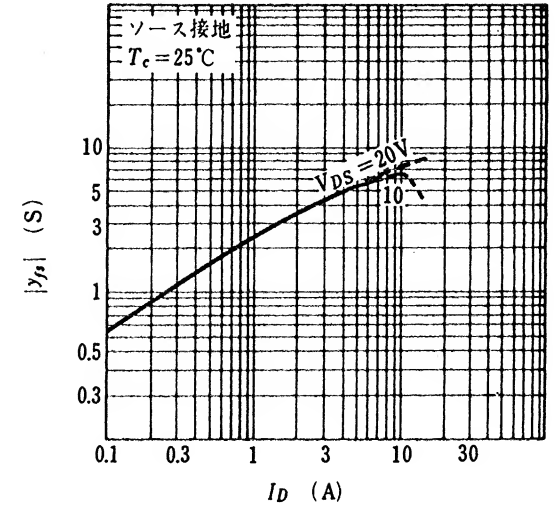
安全動作領域



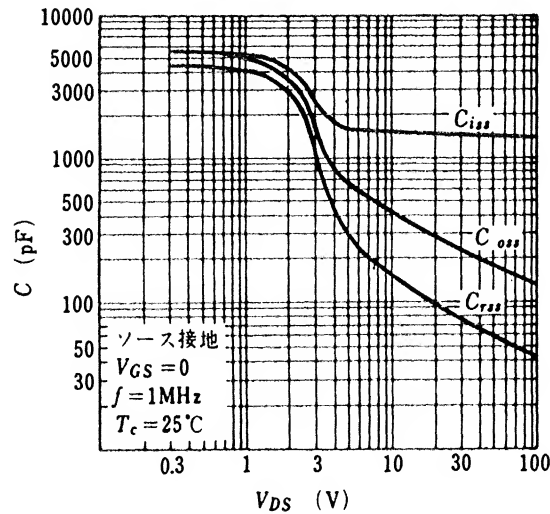
$I_D - V_{GS}$  特性



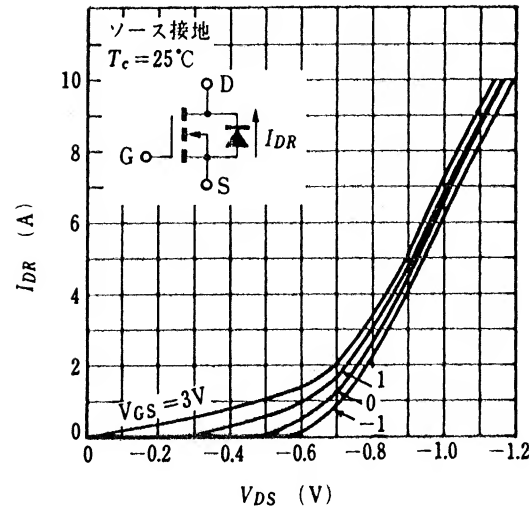
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



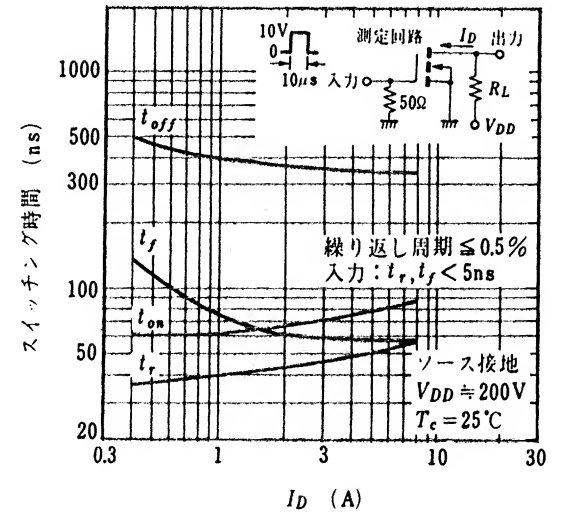
静電容量 -  $V_{DS}$  特性



$I_{DR} - V_{DS}$  特性



スイッチング特性

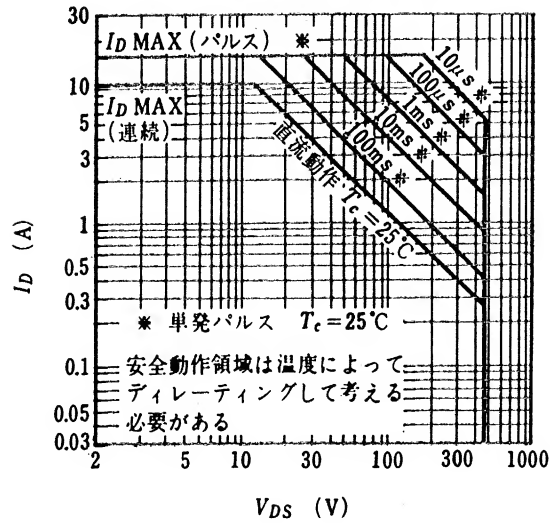


# 2SK386

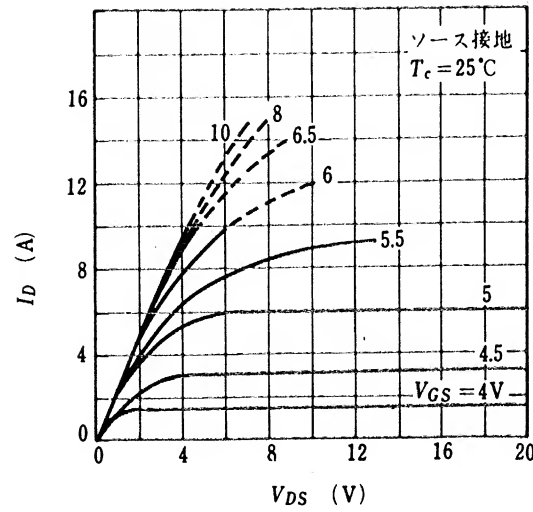
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

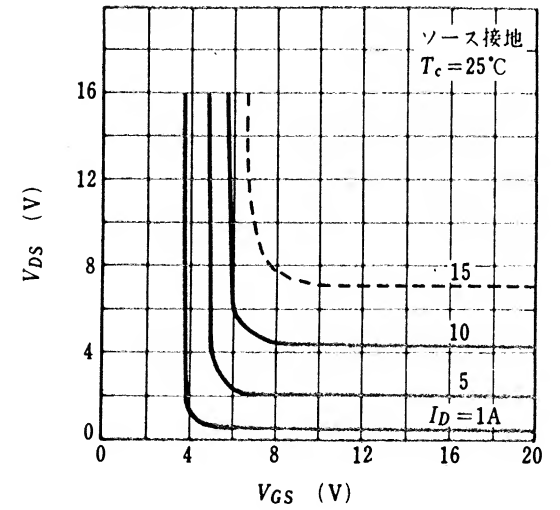
安全動作領域



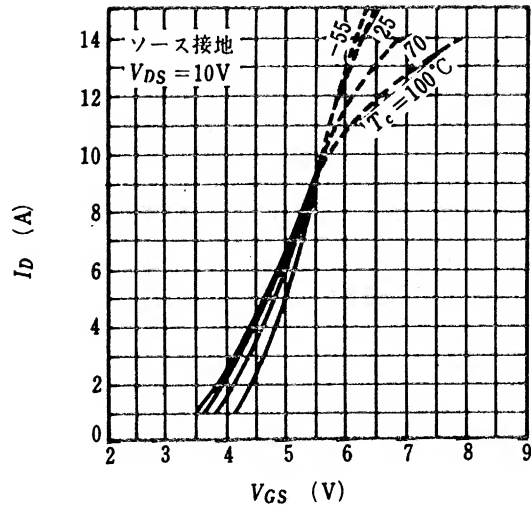
$I_D - V_{DS}$  特性



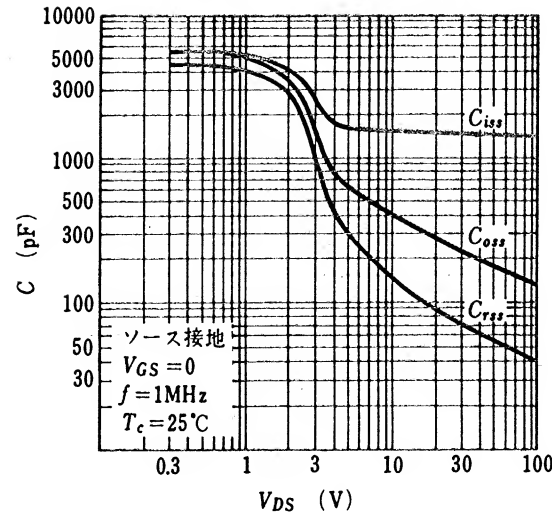
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



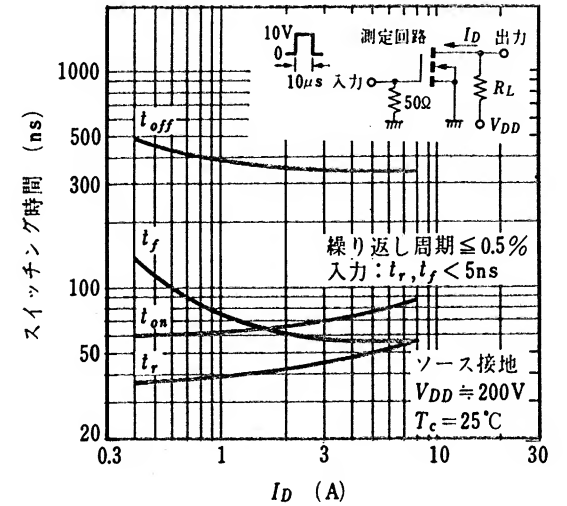
$I_D - V_{GS}$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性



スイッチング特性

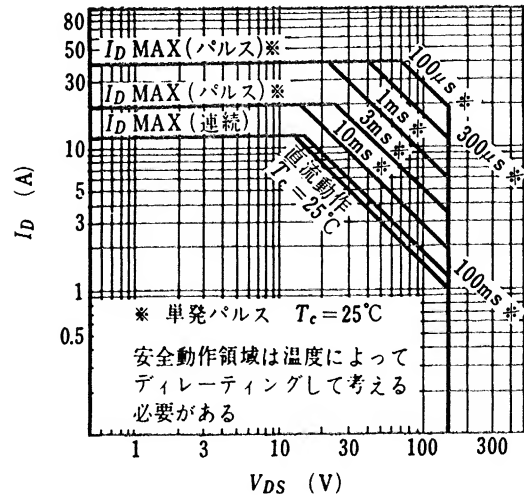


# 2SK387

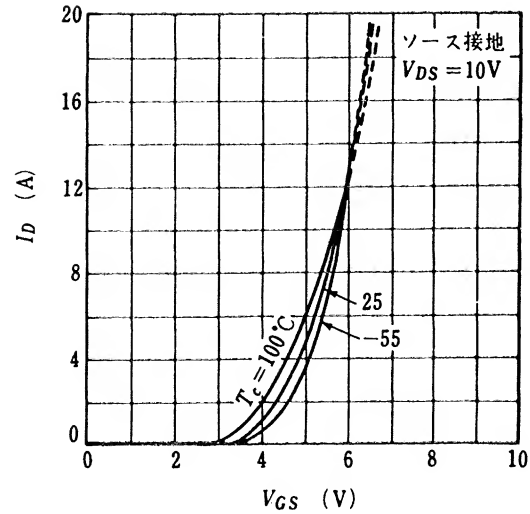
## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

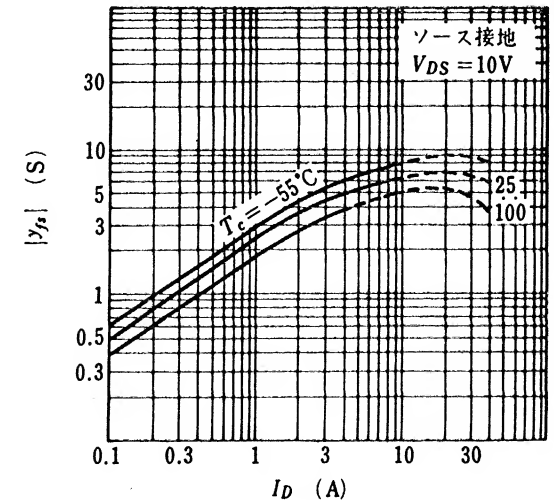
安全動作領域



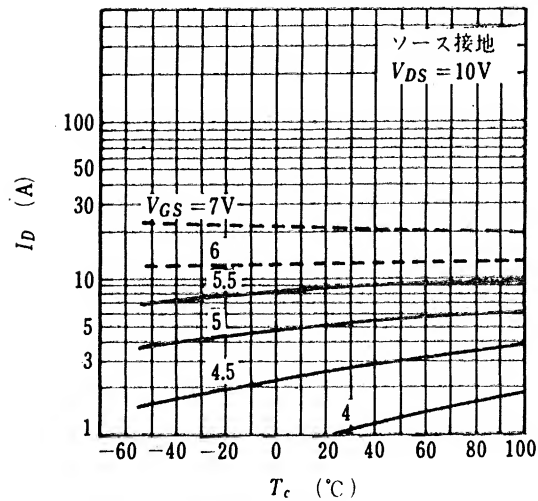
$I_D - V_{GS}$  特性



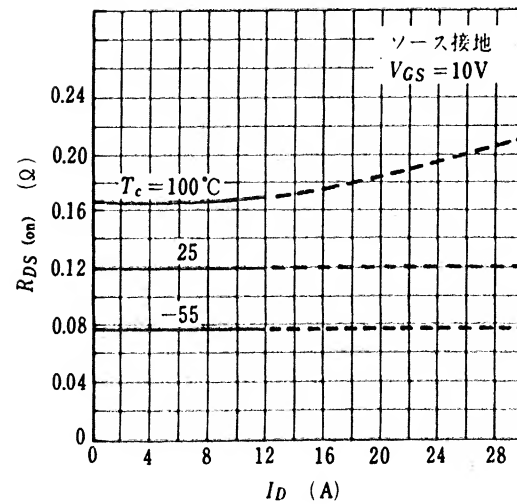
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



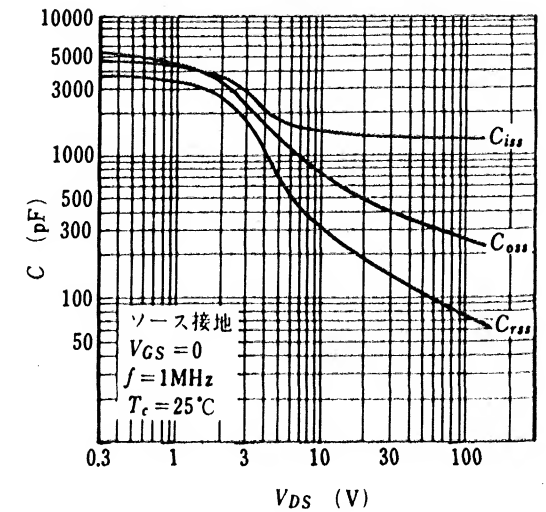
$I_D - T_c$  特性



$R_{DS(on)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

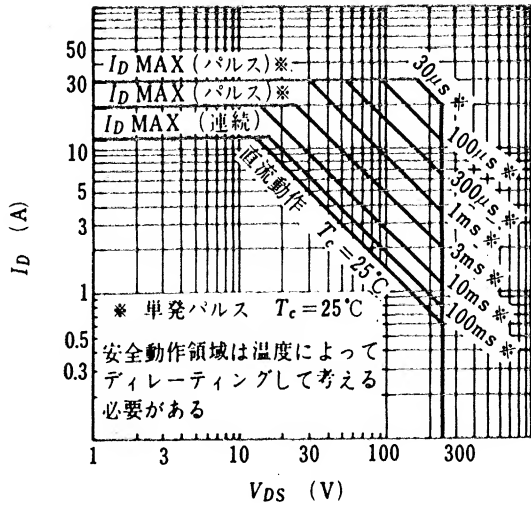


# 2SK388

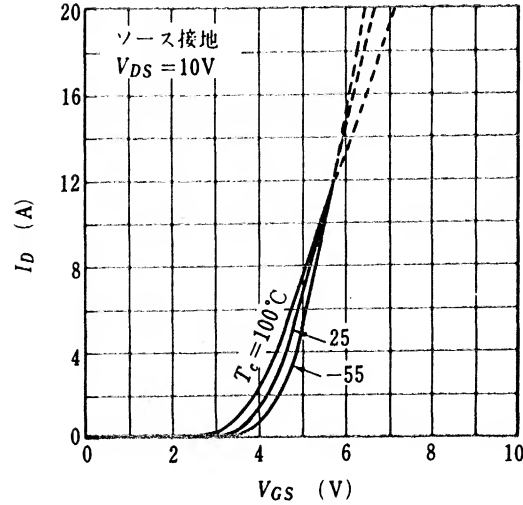
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

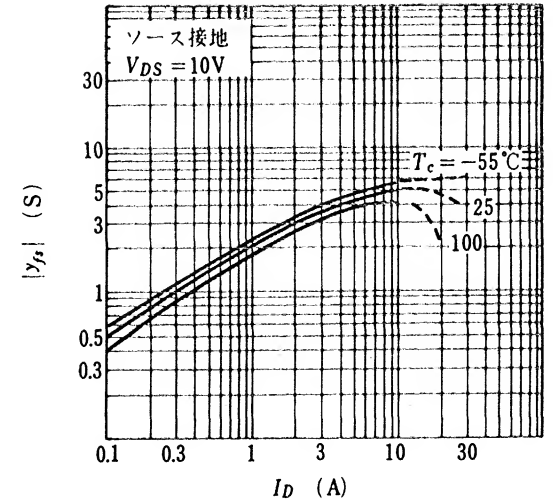
### 安全動作領域



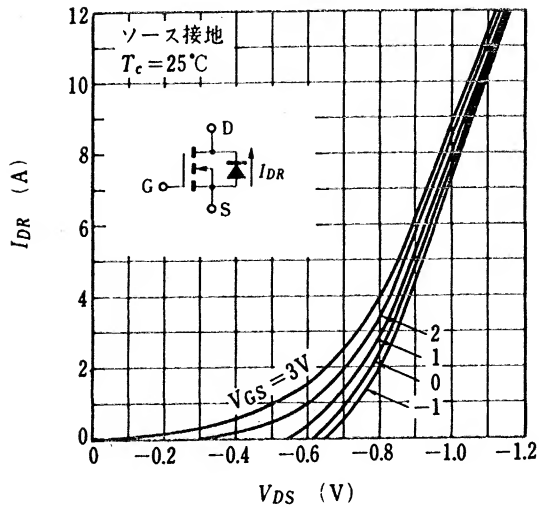
### ID - VGS 特性



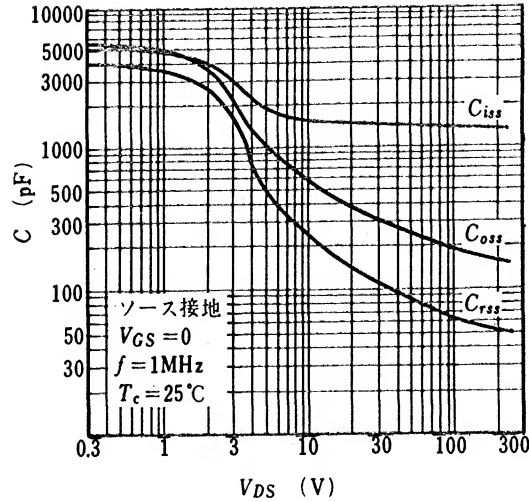
### |Yfs| - ID 特性



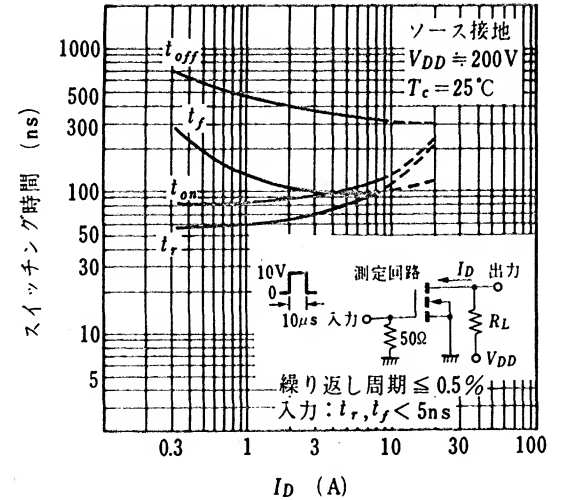
### IDR - VDS 特性



### 静電容量 - VDS 特性



### スイッチング特性



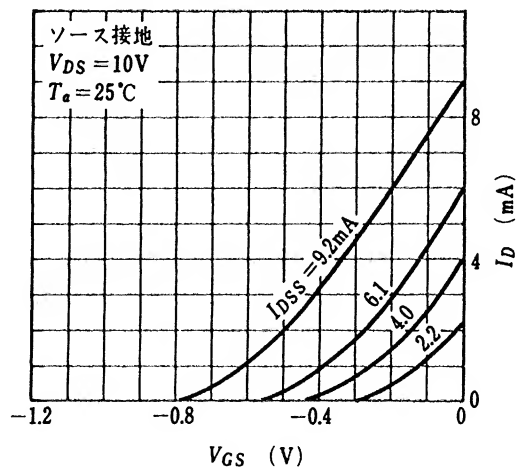
# 2SK389

## Si MOS型 複合Nチャンネル

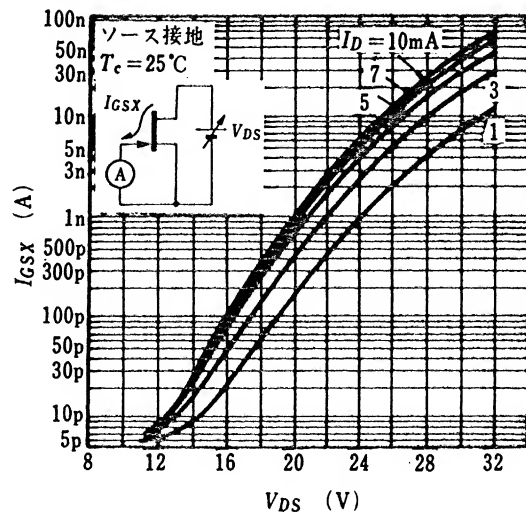
東 芝

$I_{DSS}$  分類: GR=2.6~6.5mA, BL=6~12mA, V=10~20mA

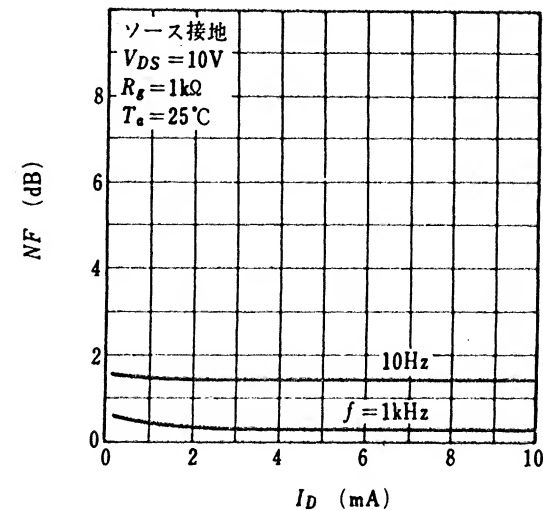
$I_D - V_{GS}$  特性



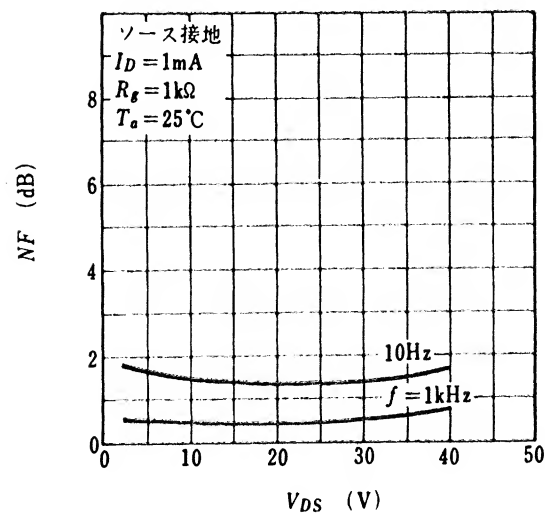
$I_{GSX} - V_{DS}$  特性



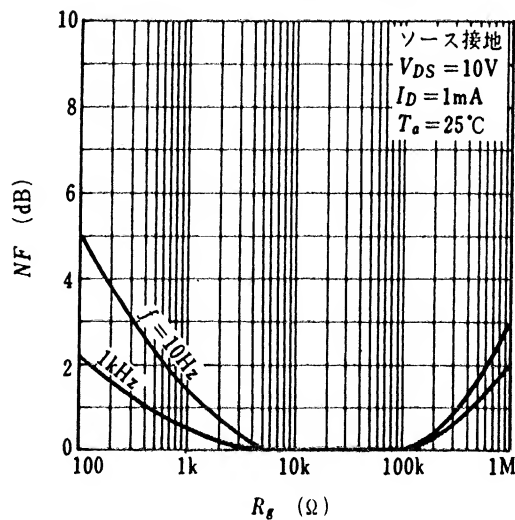
$NF - I_D$  特性



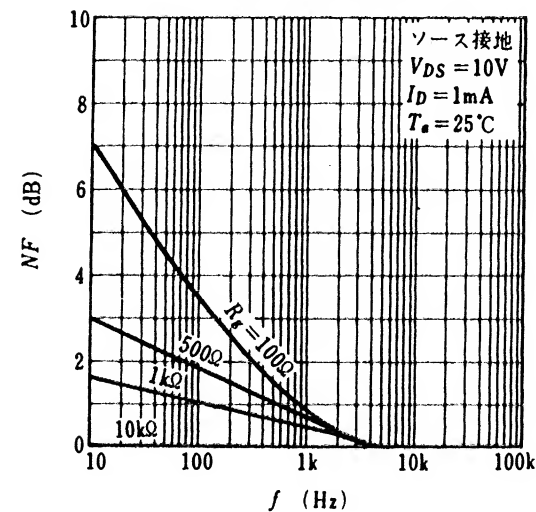
$NF - V_{DS}$  特性



$NF - R_g$  特性



$NF - f$  特性





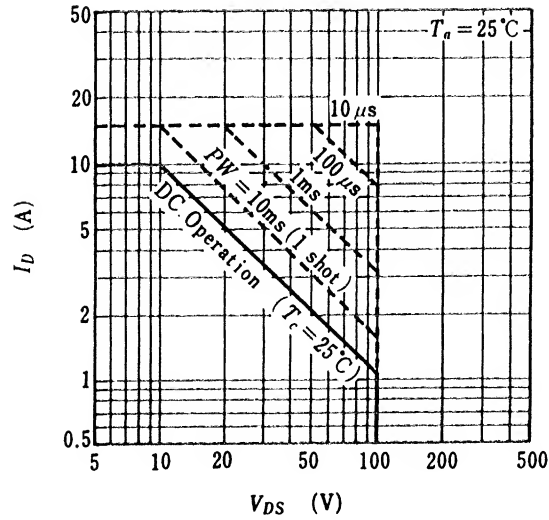


# 2SK398

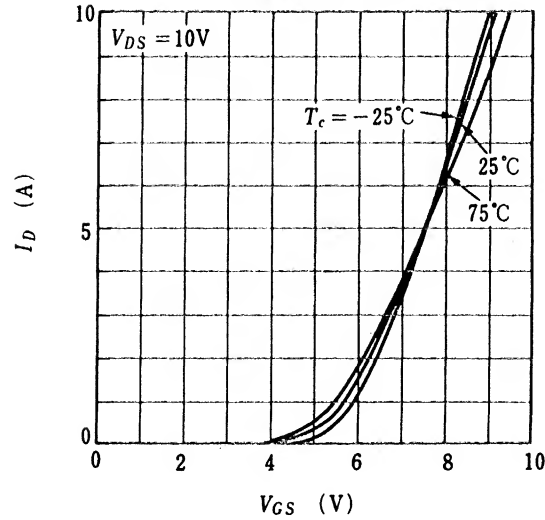
## Si MOS型 Nチャンネル

日 立

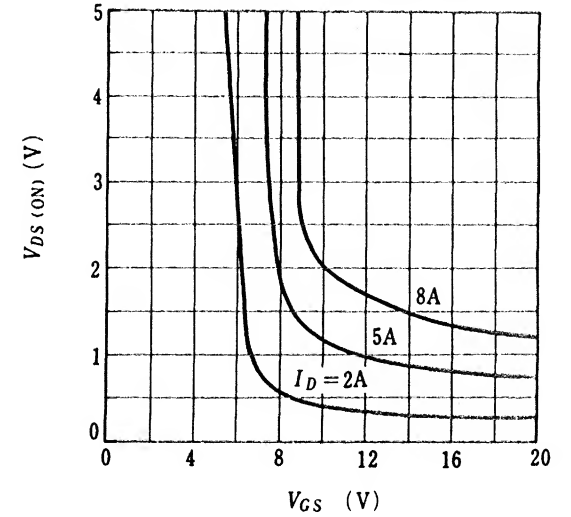
### 安全動作領域



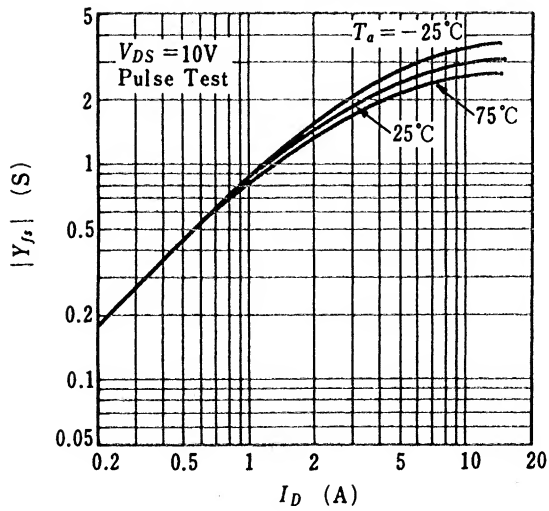
### 伝達特性



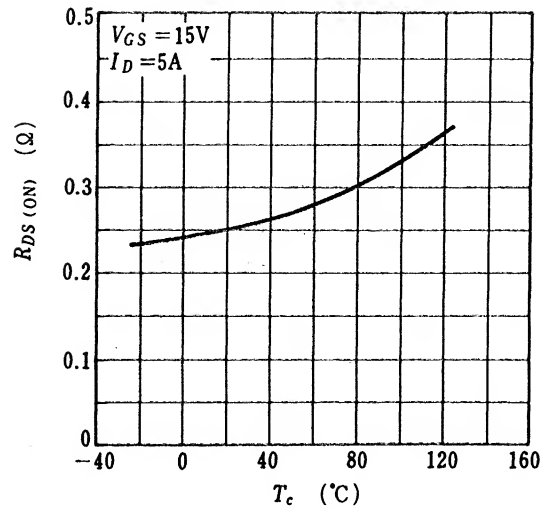
### $V_{DS(ON)} - V_{GS}$ 特性



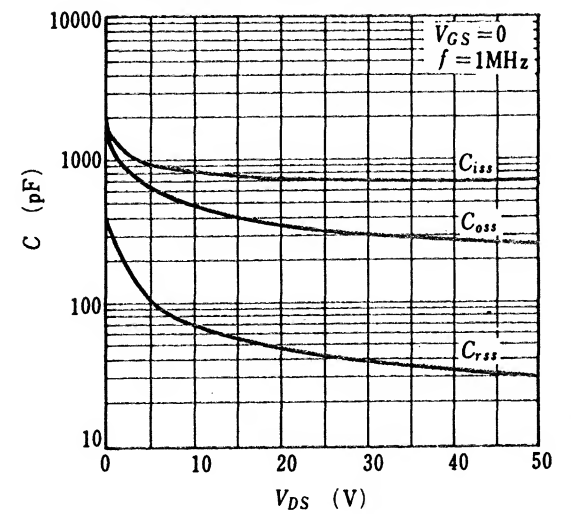
### $|Y_{fs}| - I_D$ 特性



### $R_{DS(ON)} - T_c$ 特性



### $C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$ 特性

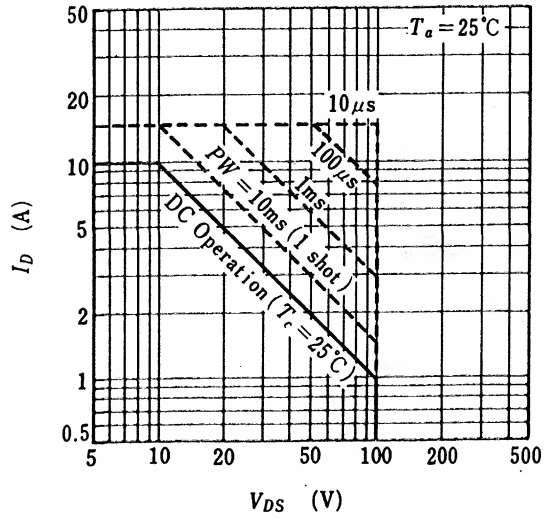


# 2SK399

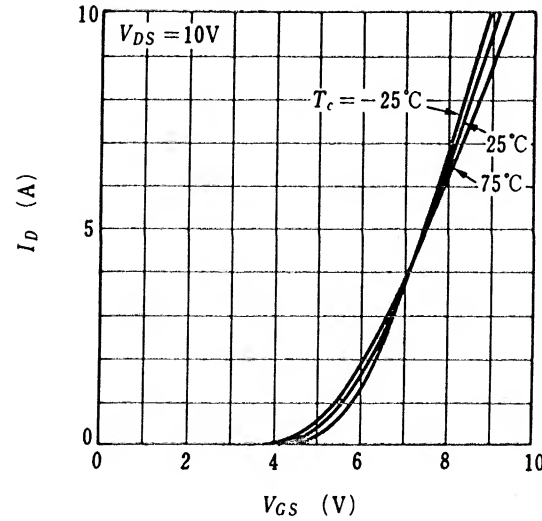
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

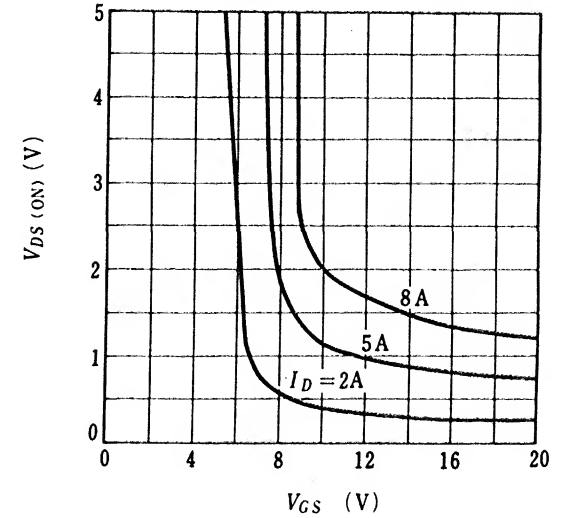
安全動作領域



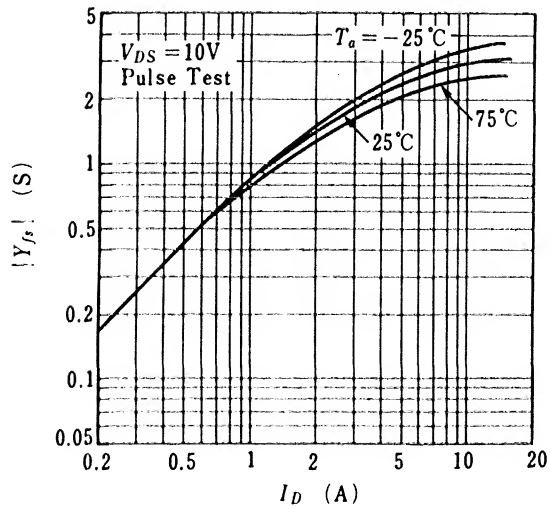
伝達特性



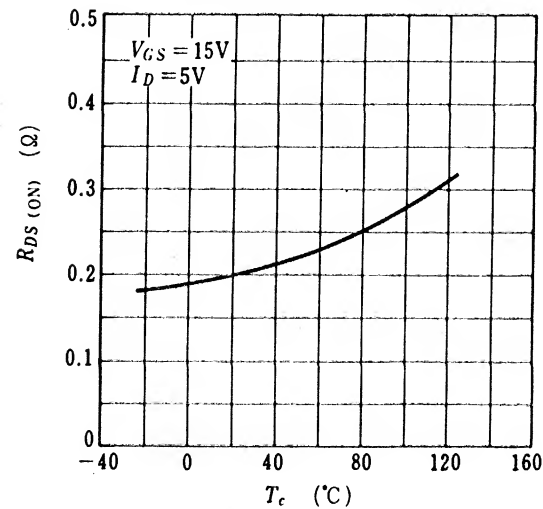
V\_DS (ON) - V\_GS 特性



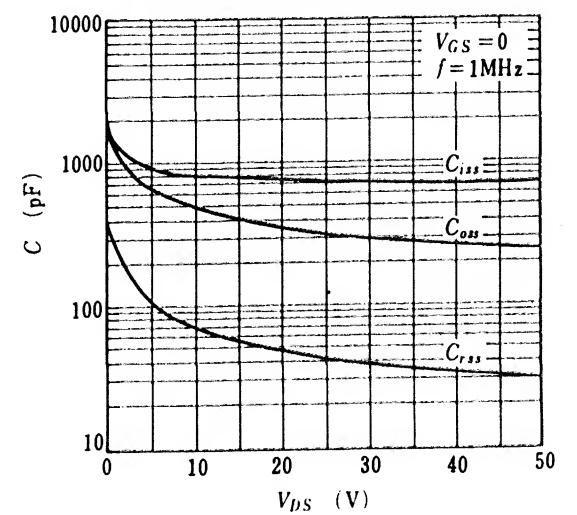
$|Y_{fs}|$  -  $I_D$  特性



R\_DS(ON) - T\_c 特性



C<sub>iss</sub>, C<sub>oss</sub>, C<sub>rss</sub> - V\_DS 特性

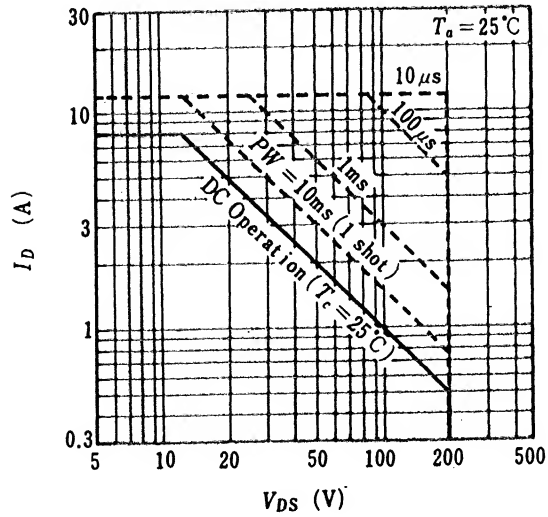


# 2SK400

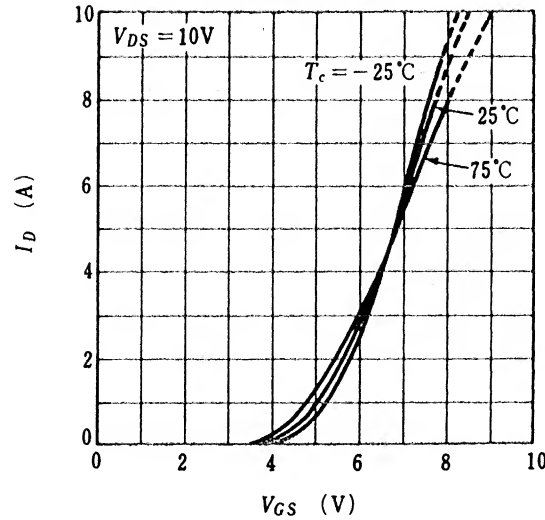
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

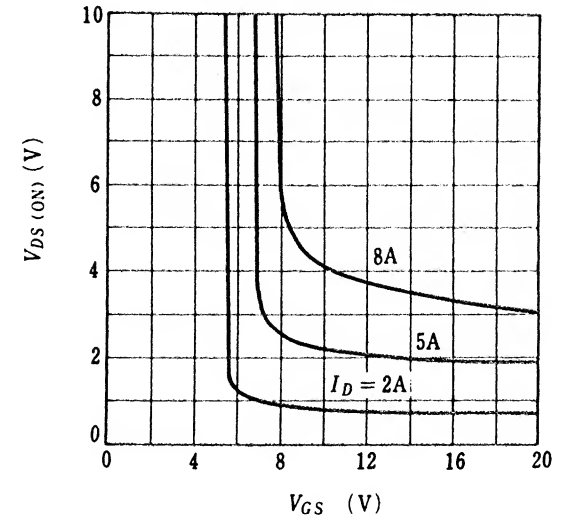
### 安全動作領域



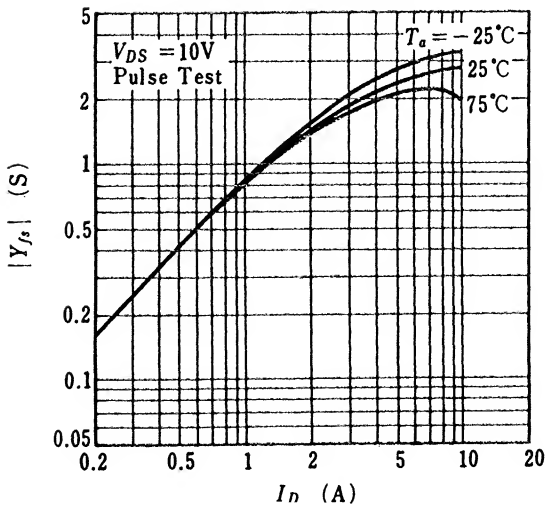
### 伝達特性



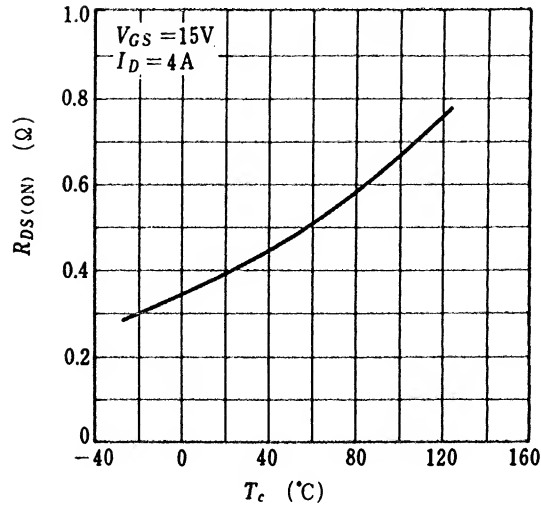
### VDS (ON) - VGS 特性



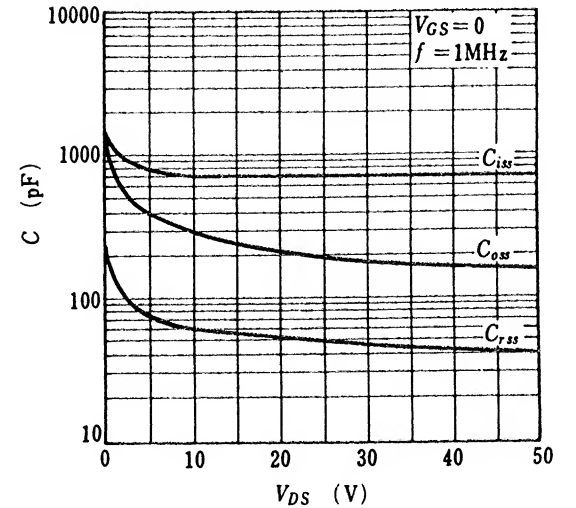
### |Yfs| - ID 特性



### RDS(ON) - Tc 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

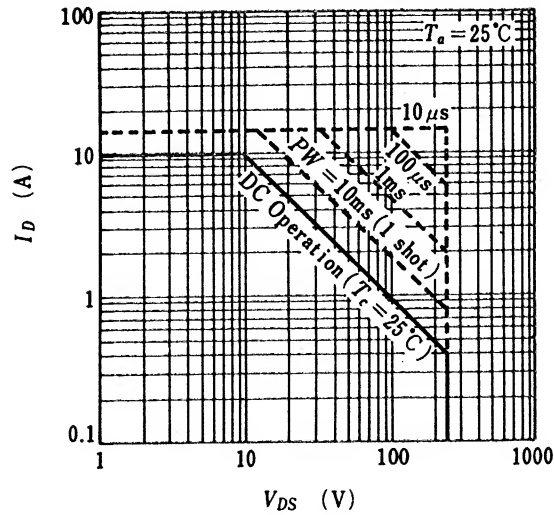


# 2SK401

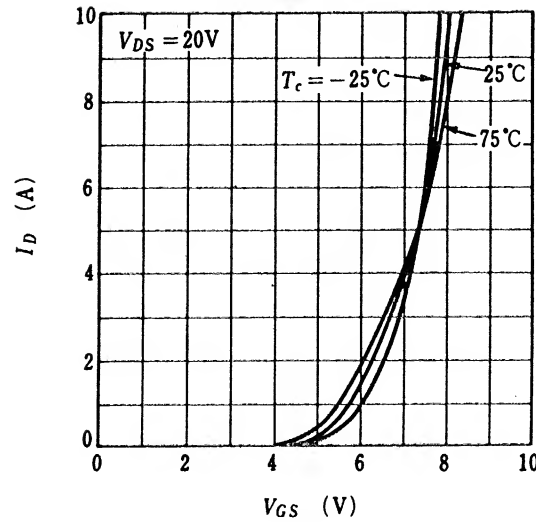
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

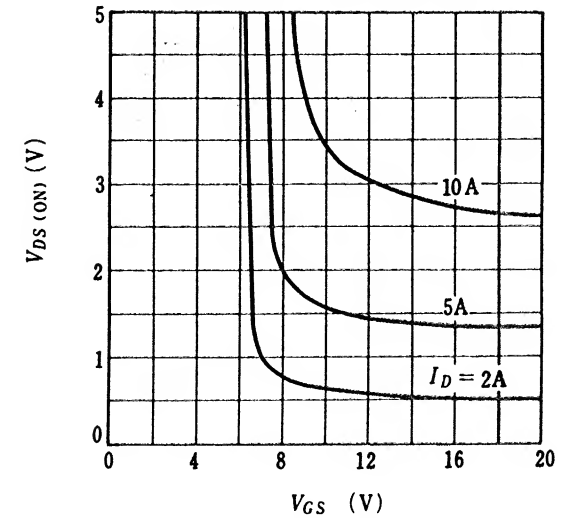
安全動作領域



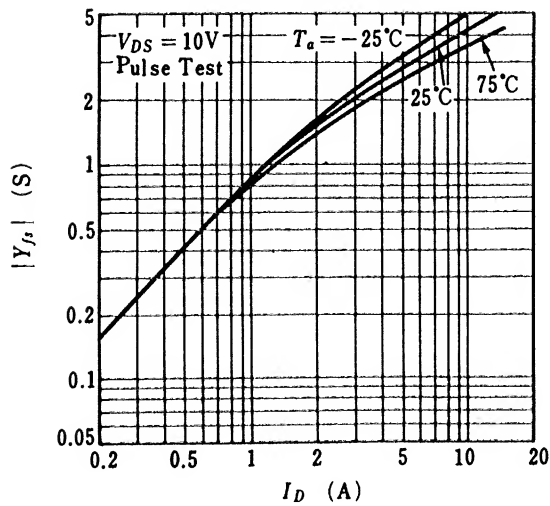
伝達特性



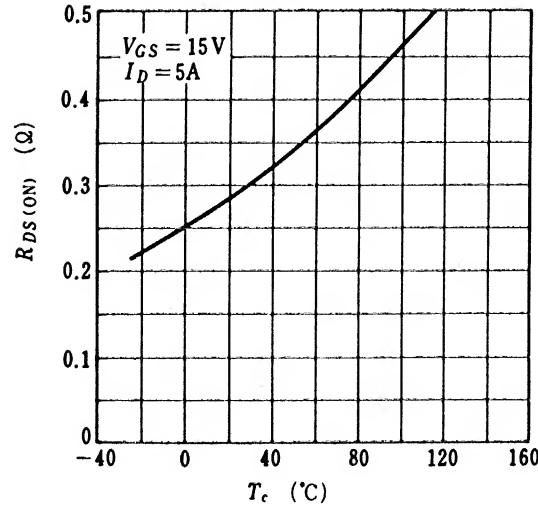
VDS(ON) - VGS 特性



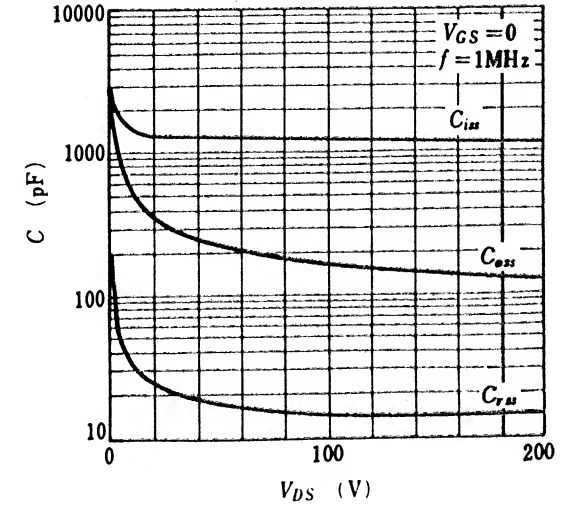
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

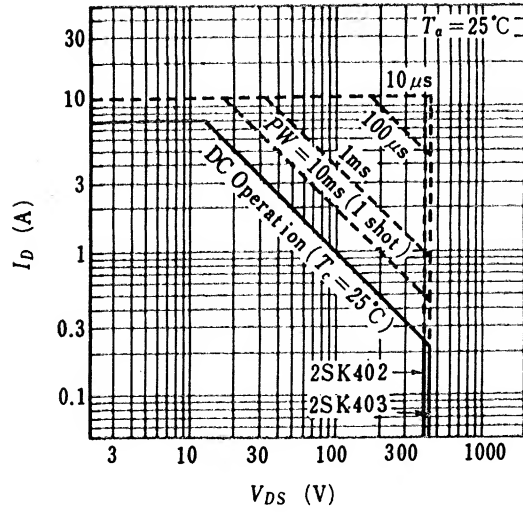


# 2SK402, 403

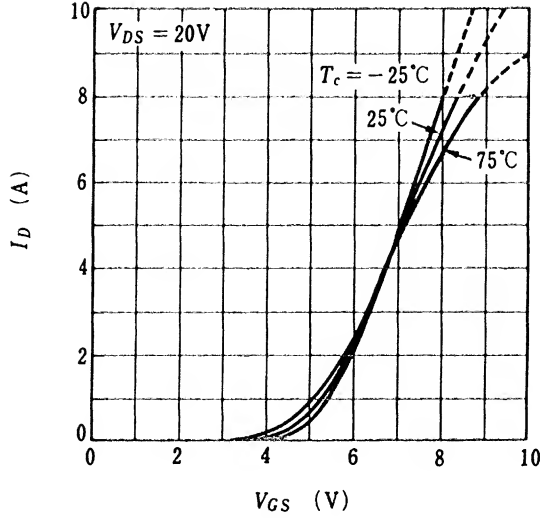
## Si MOS型 Nチャンネル

日 立

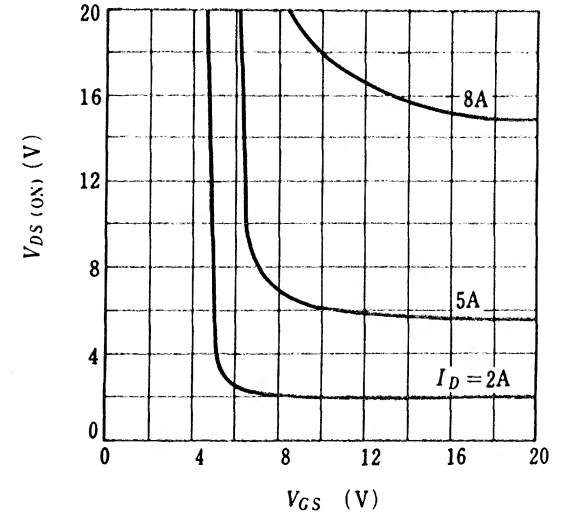
安全動作領域



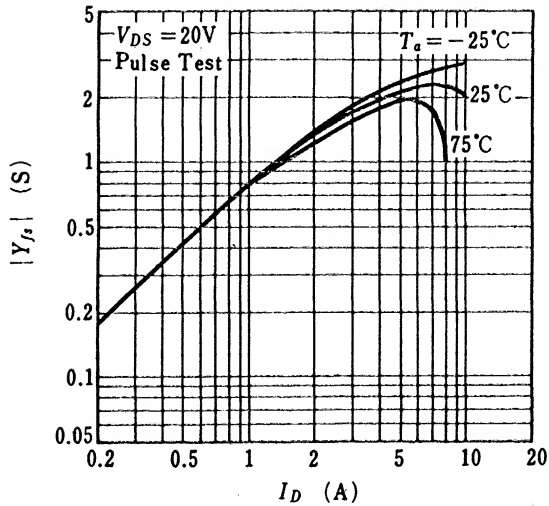
伝達特性



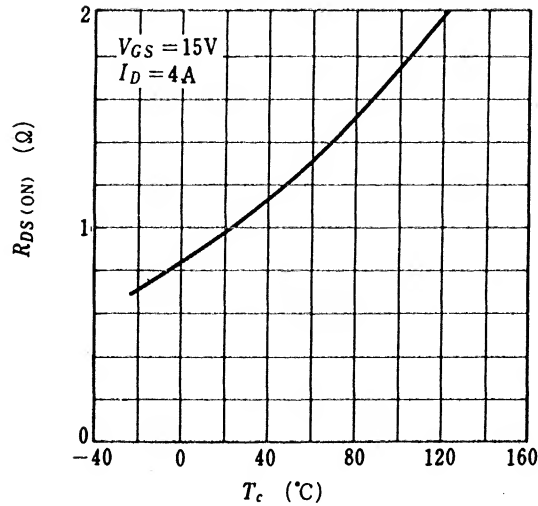
VDS(ON) - VGS 特性



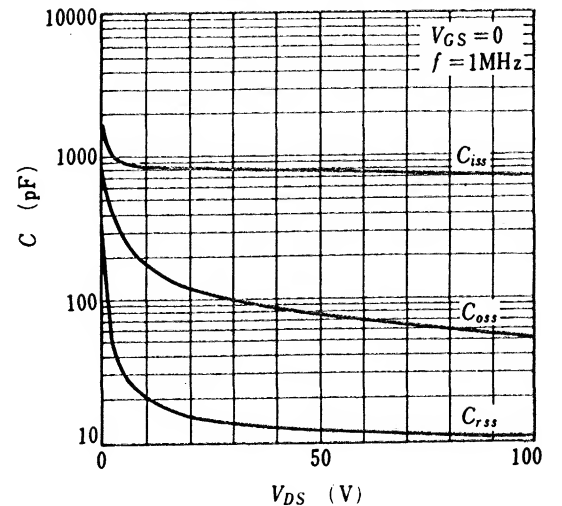
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - Tc 特性



Ciss, Coss, Crss - VDS 特性



# 2SK404

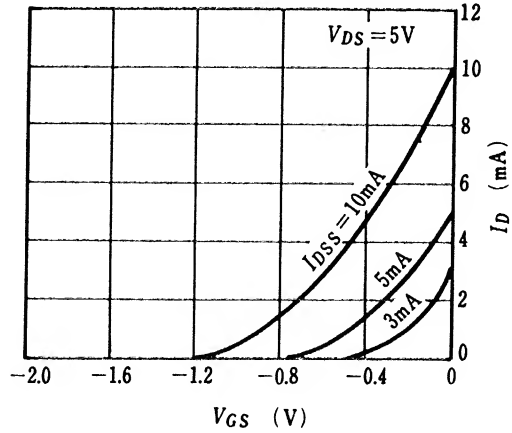
Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

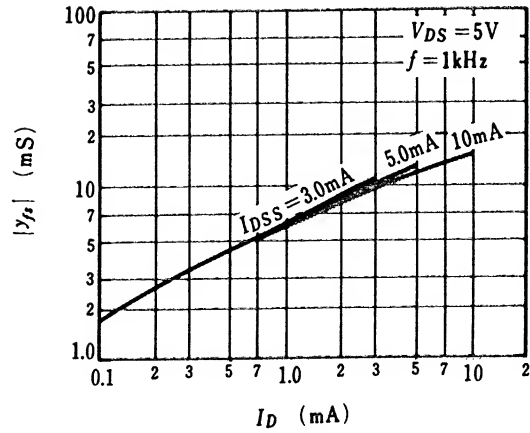
$V_{DS}=5V$  により次のように分類している.

1.2	D	3.0	2.5	E	6.0	5.0	F	12.0
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	------

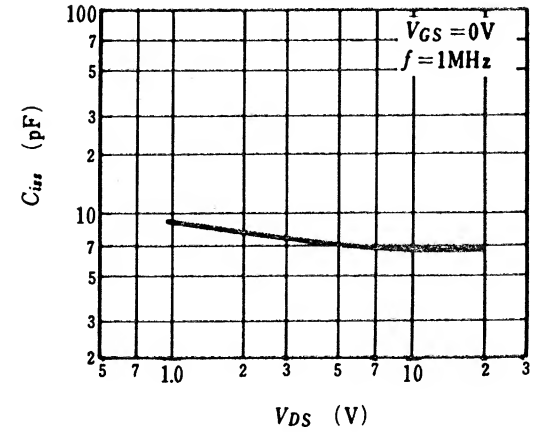
$I_D - V_{GS}$  特性



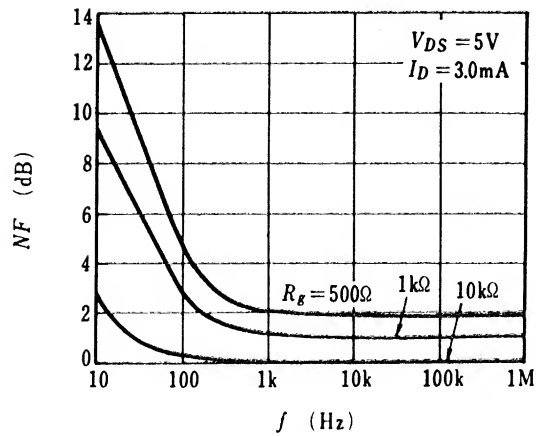
$|y_{fs}| - I_D$  特性



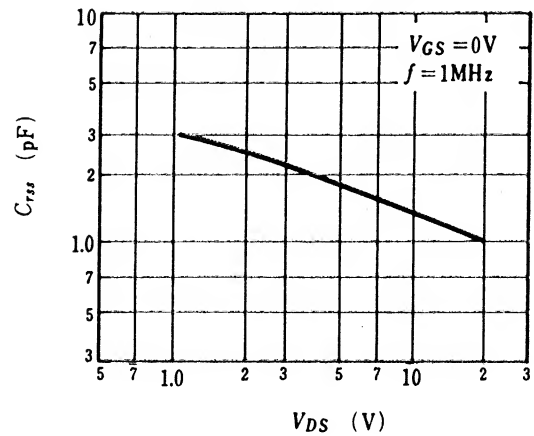
$C_{iss} - V_{DS}$  特性



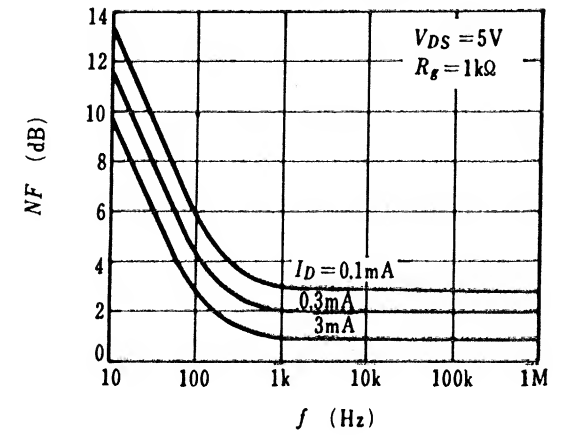
$NF - f$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$NF - f$  特性

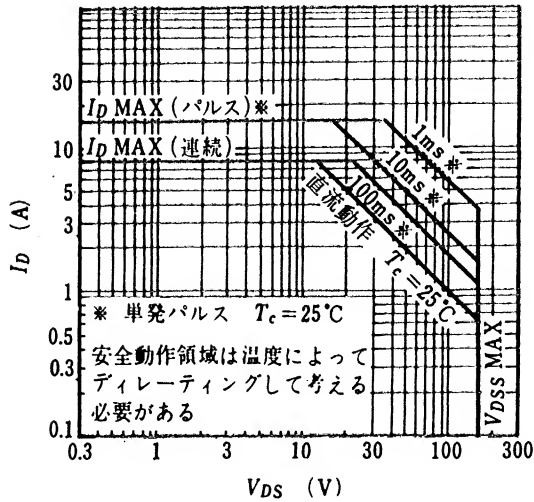


# 2SK405

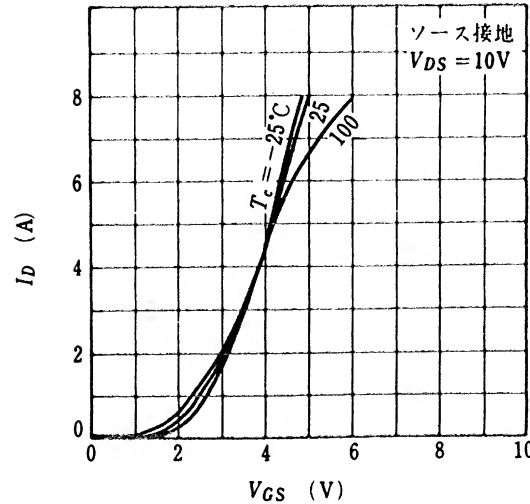
## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

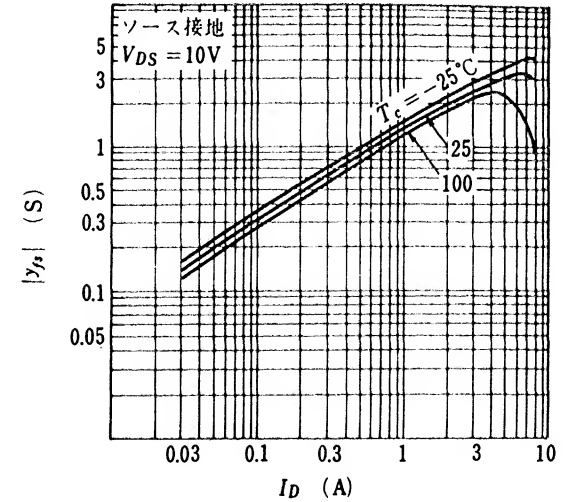
安全動作領域



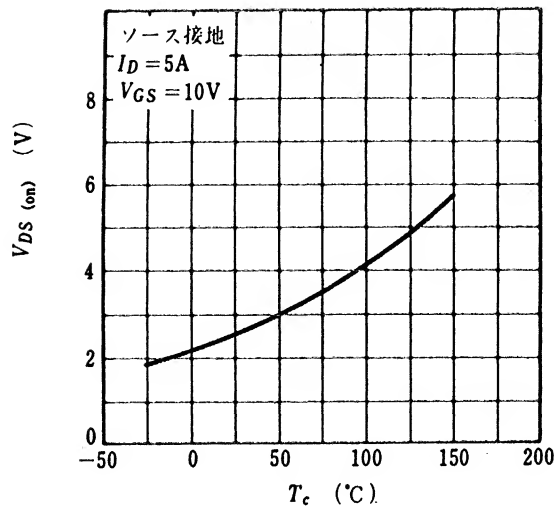
$I_D - V_{GS}$  特性



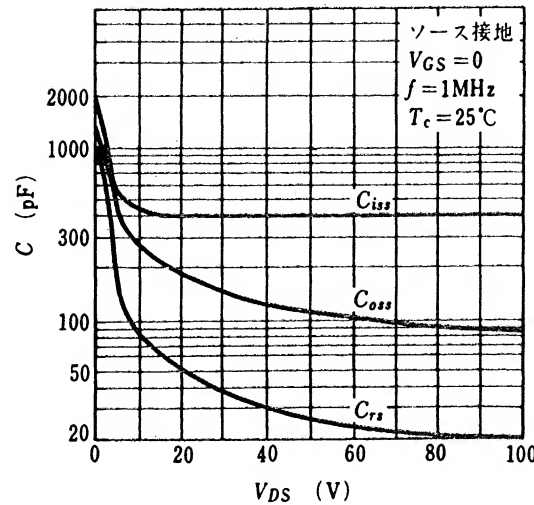
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



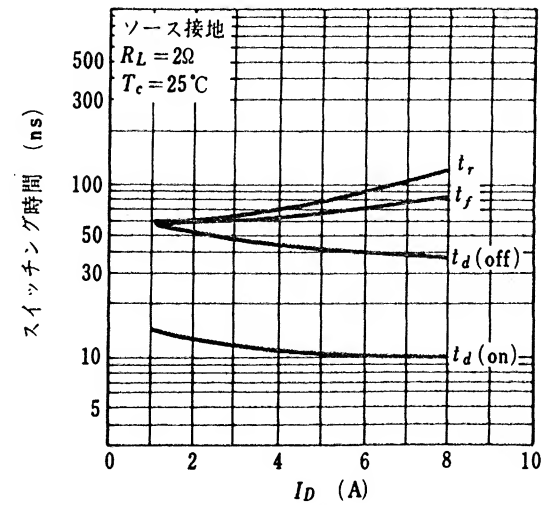
$V_{DS(on)} - T_c$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性



スイッチング特性



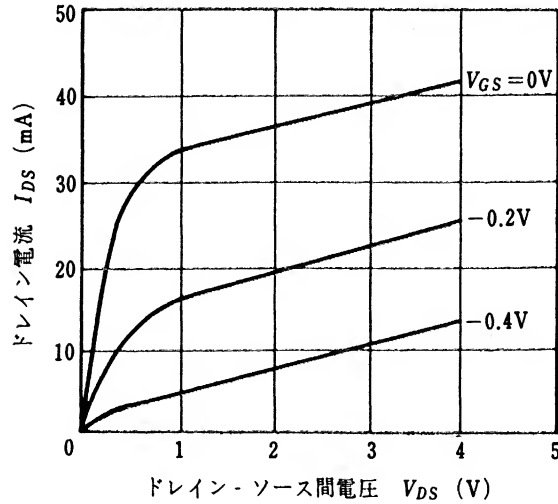


# 2SK406, 407

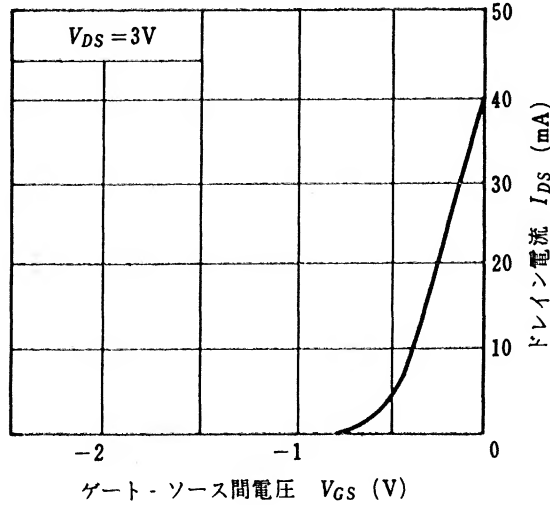
GaAs 型  
Nチャンネル

日 電

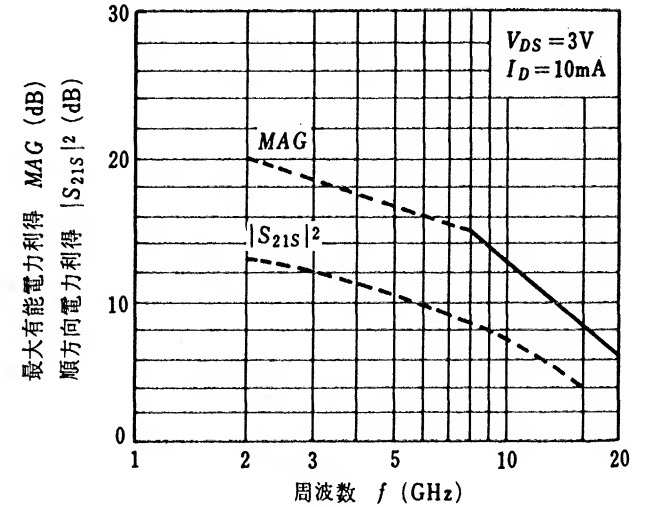
$I_{DS} - V_{DS}$  特性



$I_{DS} - V_{GS}$  特性

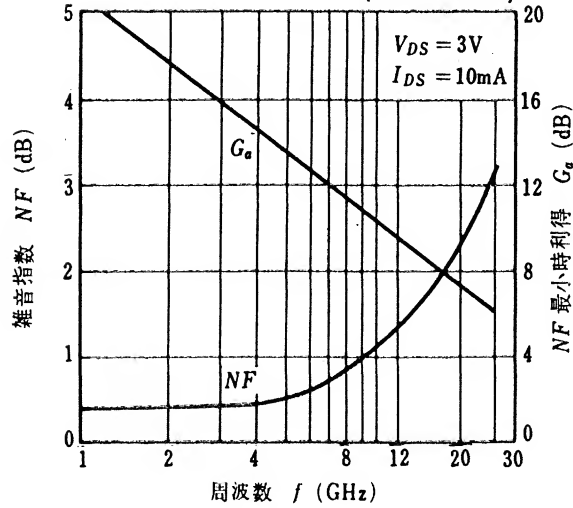


MAG,  $|S_{21s}|^2 - f$  特性



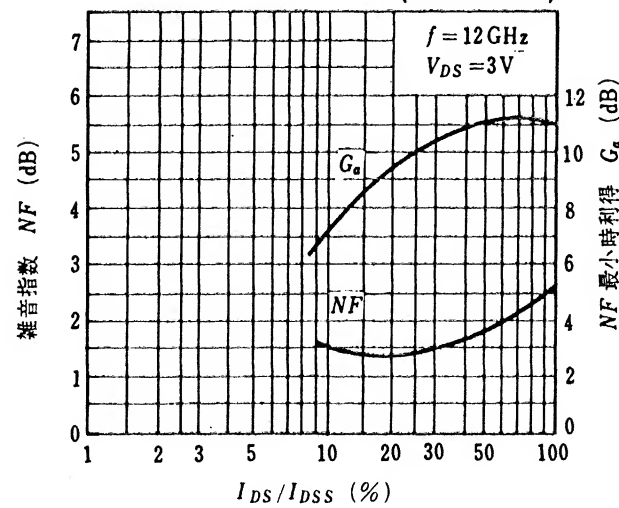
NF,  $G_a - f$  特性

(2SK407)



NF,  $G_a - I_{DS}/I_{DSS}$  特性

(2SK407)

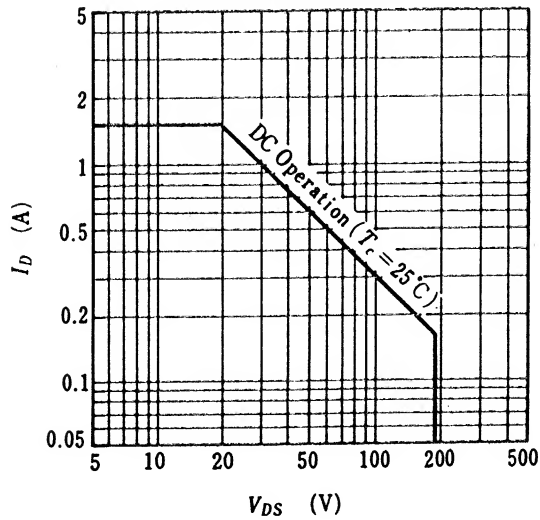


# 2SK408, 409

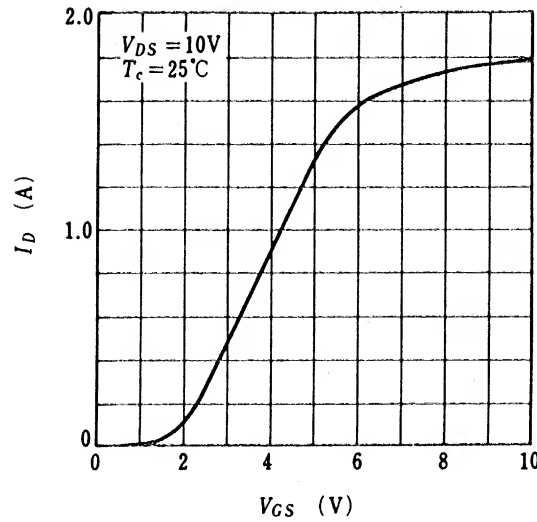
Si MOS 型  
Nチャンネル

日立

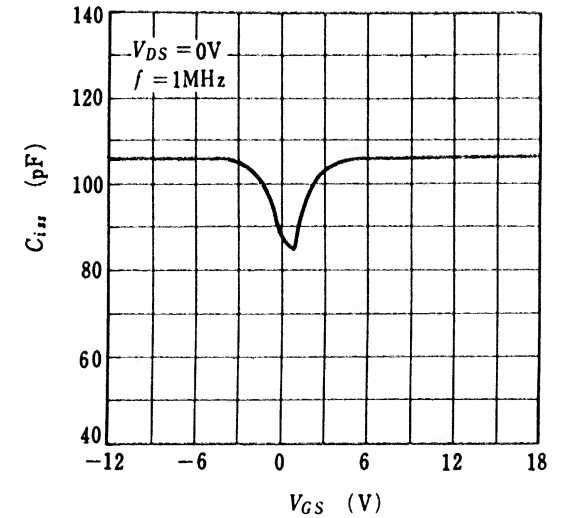
安全動作領域



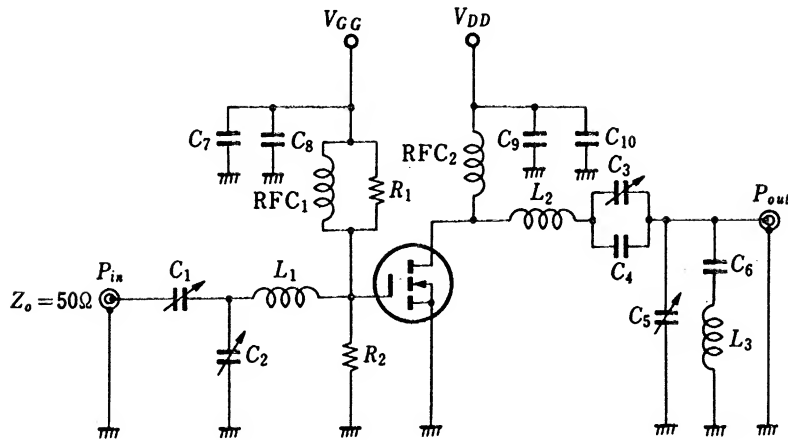
伝達特性



$C_{iss} - V_{GS}$  特性



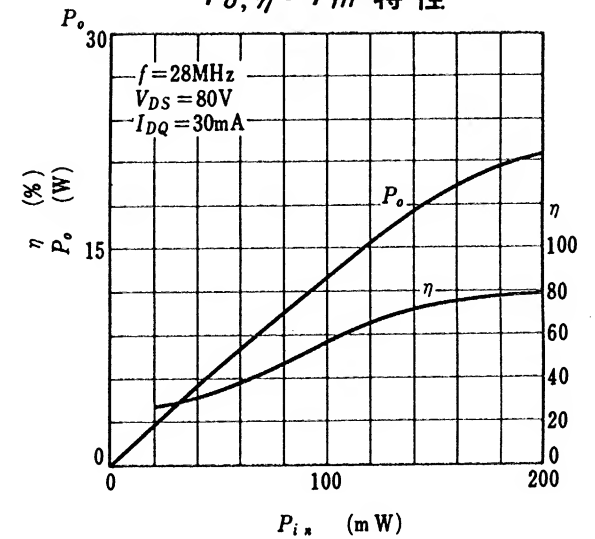
28MHz 電力測定回路



- $C_1, C_2, C_3 \sim 50\text{pF}$
- $C_4 = 68\text{pF}$
- $C_5 \sim 20\text{pF}$
- $C_6 = 1.5\text{pF}$
- $C_7, C_9 = 0.1\mu\text{F}$
- $C_8 = 4.7\mu\text{F}$
- $C_{10} = 22\mu\text{F}$

- $L_1$ : ID=12mm, d=1.5mm, T=6T
- $L_2$ : ID=12mm, d=1.5mm, T=9T
- $L_3$ : ID=12mm, d=1.5mm, T=5T

$P_o, \eta - P_{in}$  特性

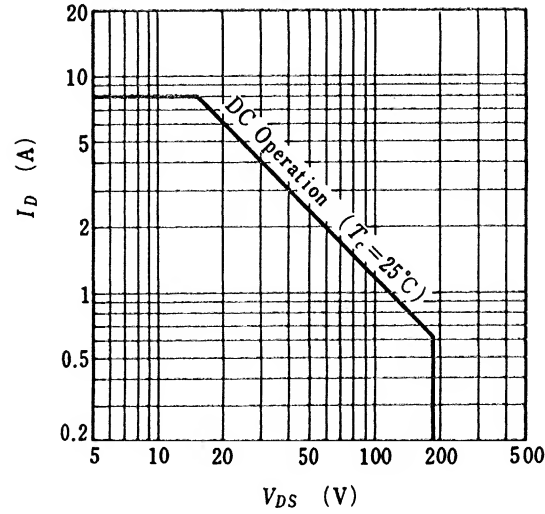


# 2SK410

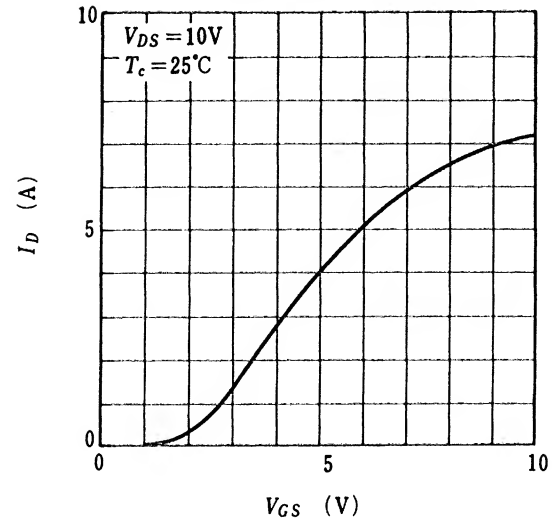
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

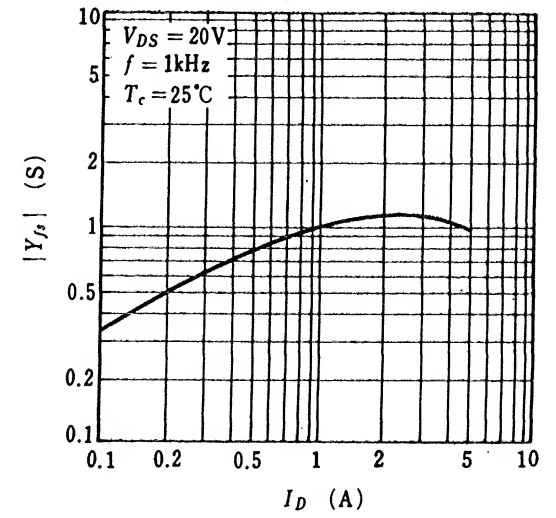
安全動作領域



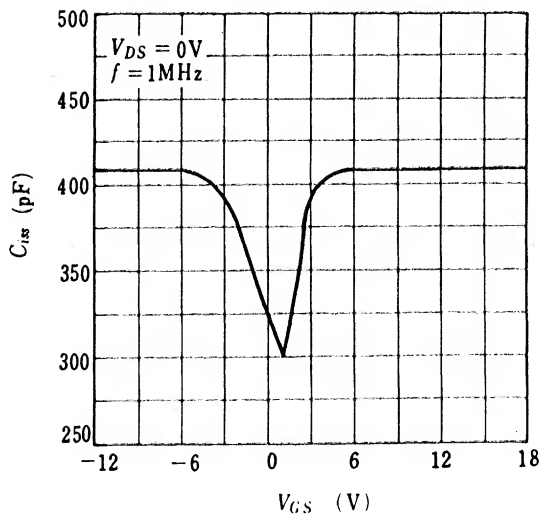
伝達特性



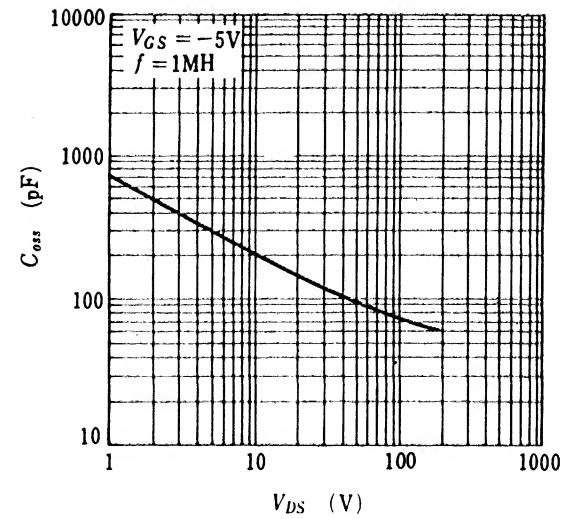
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



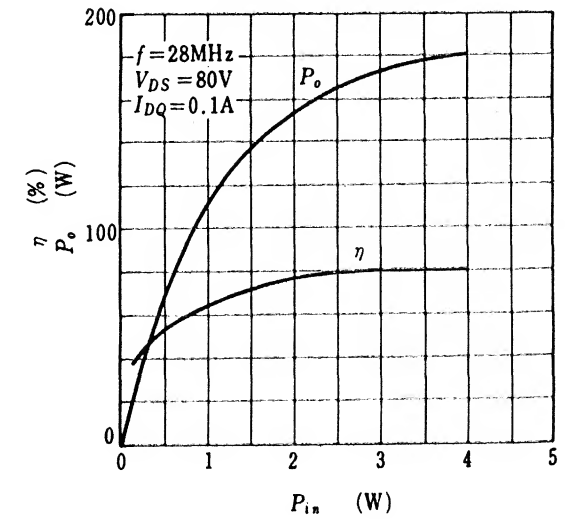
$C_{iss} - V_{GS}$  特性



$C_{oss} - V_{DS}$  特性



$P_o, \eta - P_{in}$  特性

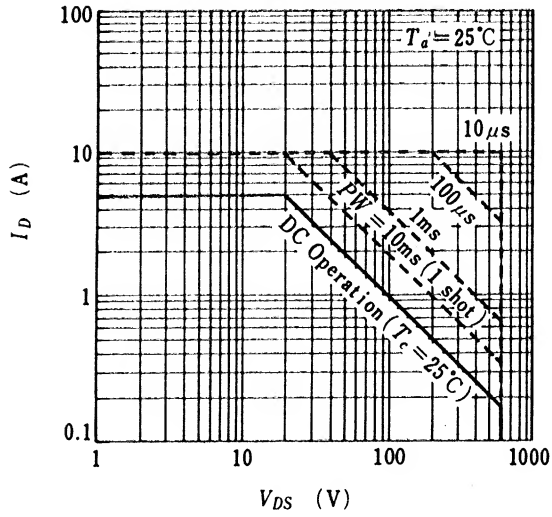


# 2SK411

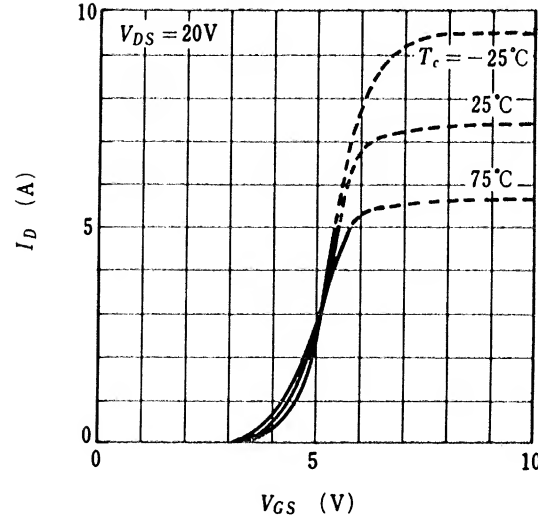
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

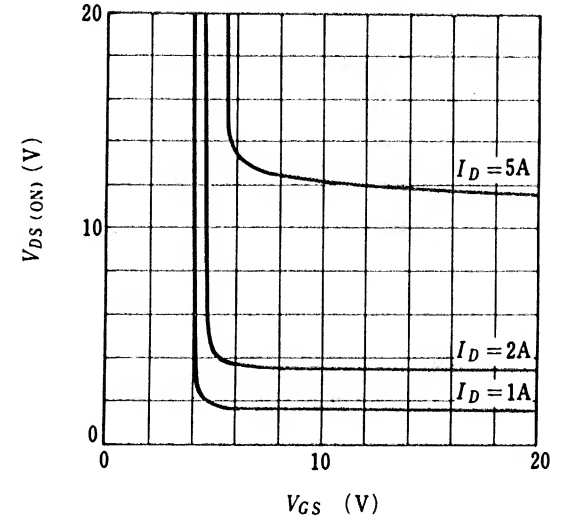
### 安全動作領域



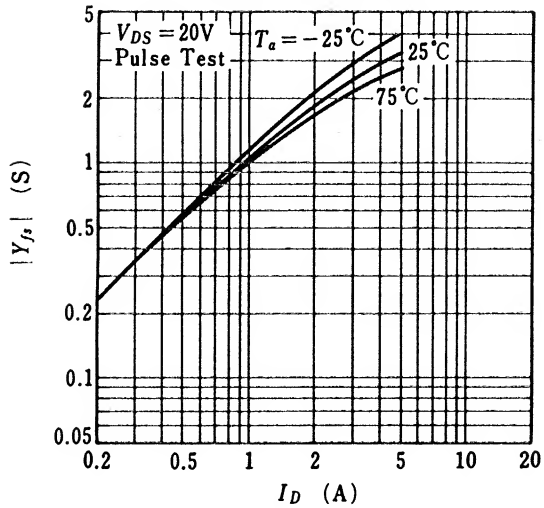
### 伝達特性



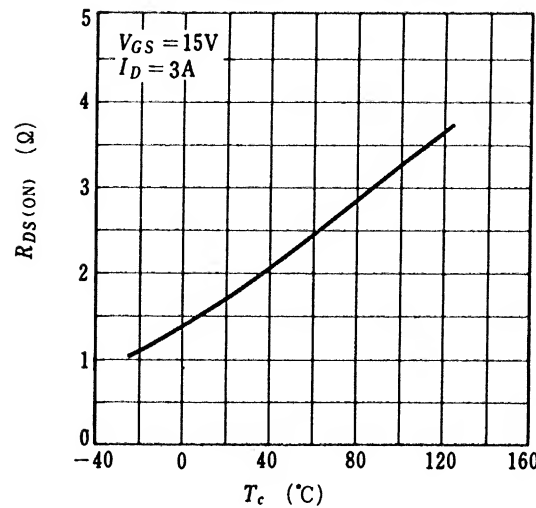
### VDS(ON) - VGS 特性



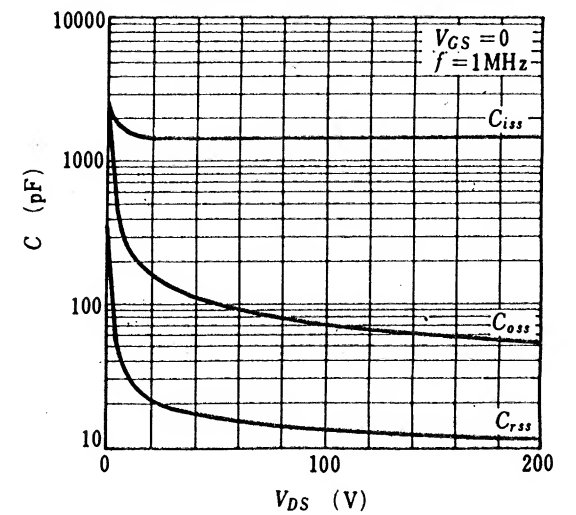
### |Yfs| - ID 特性



### RDS(ON) - Tc 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

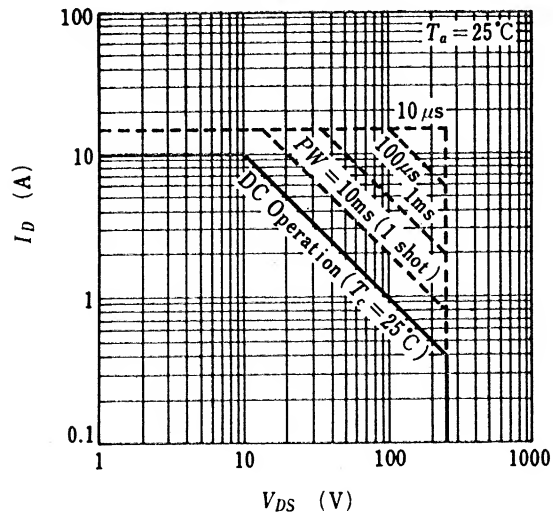


# 2SK412

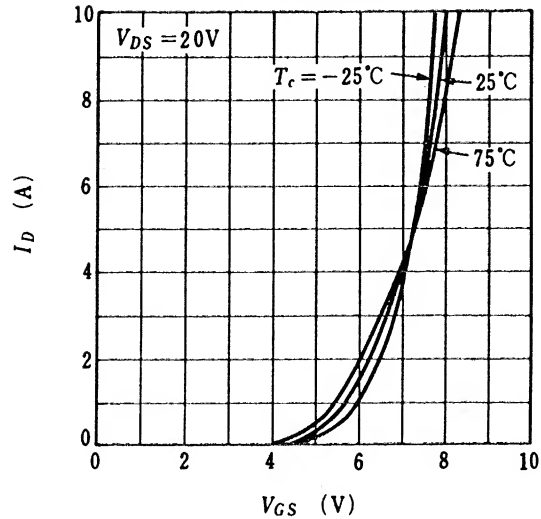
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

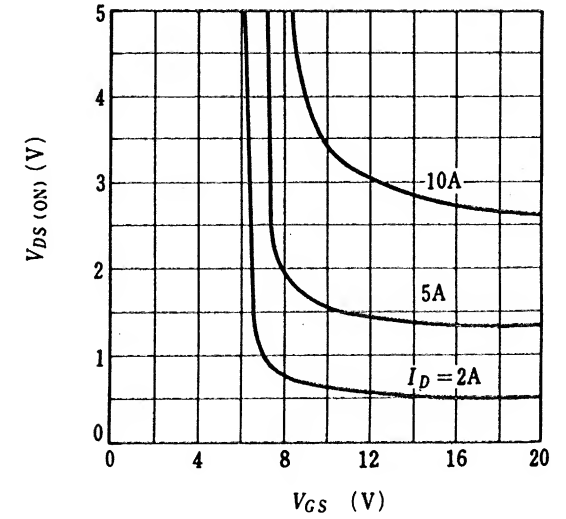
安全動作領域



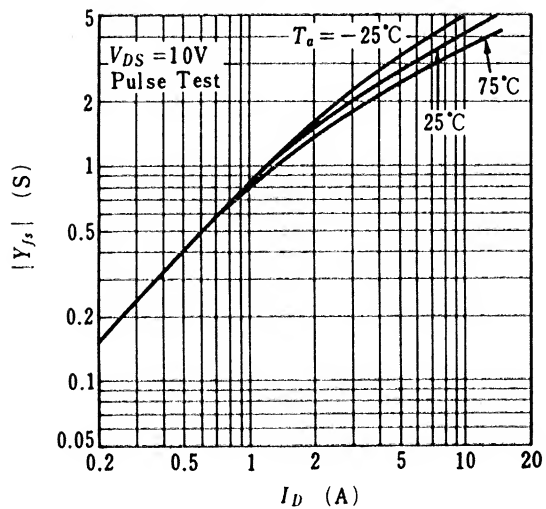
伝達特性



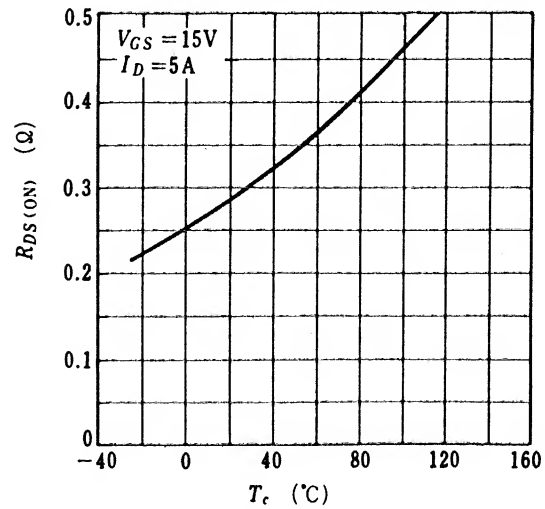
$V_{DS(ON)} - V_{GS}$  特性



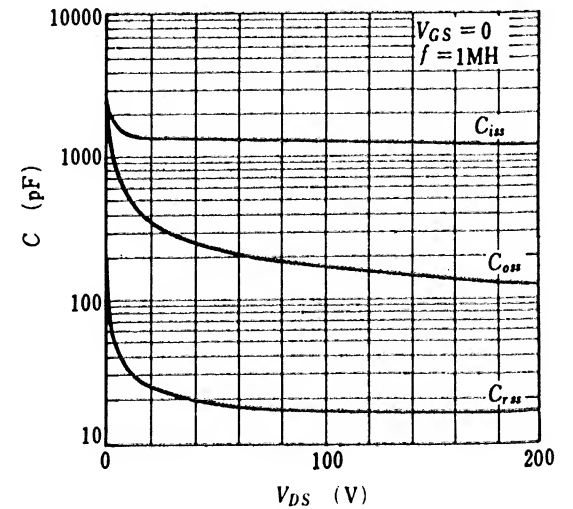
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(ON)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性

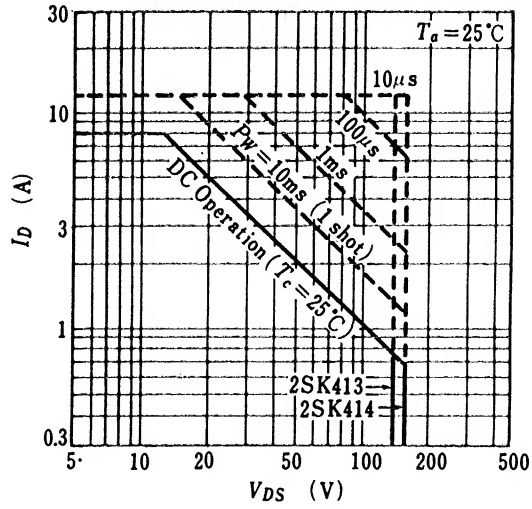


# 2SK413, 414

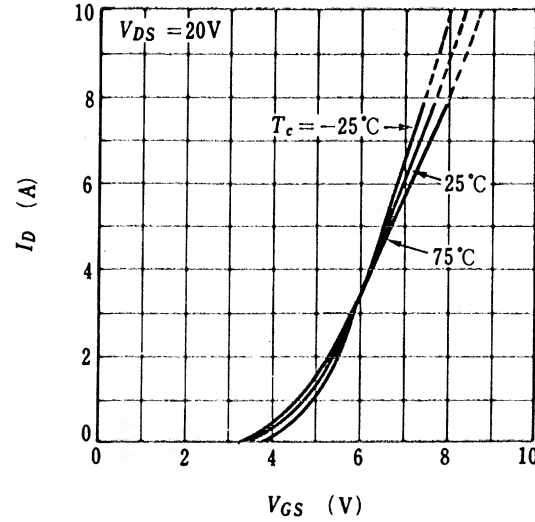
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

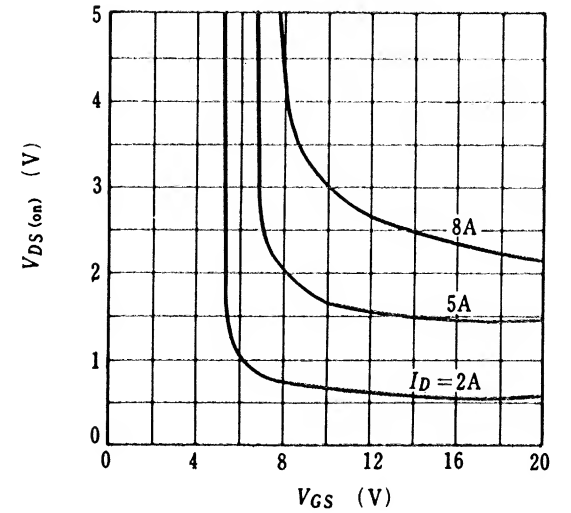
### 安全動作領域



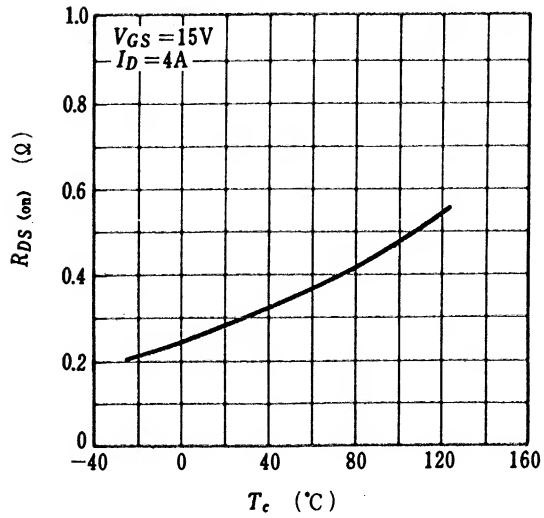
### ID - VGS 特性



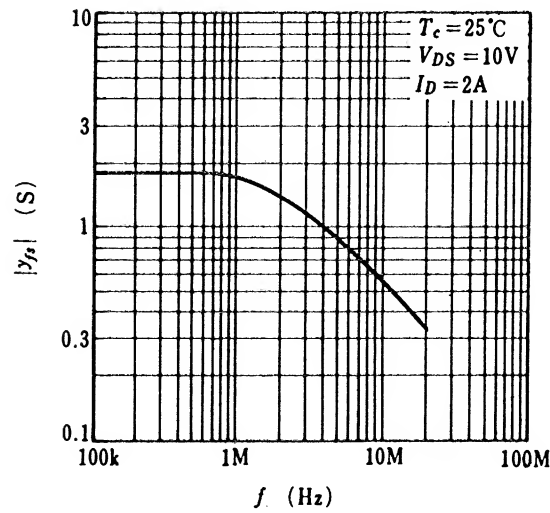
### VDS(on) - VGS 特性



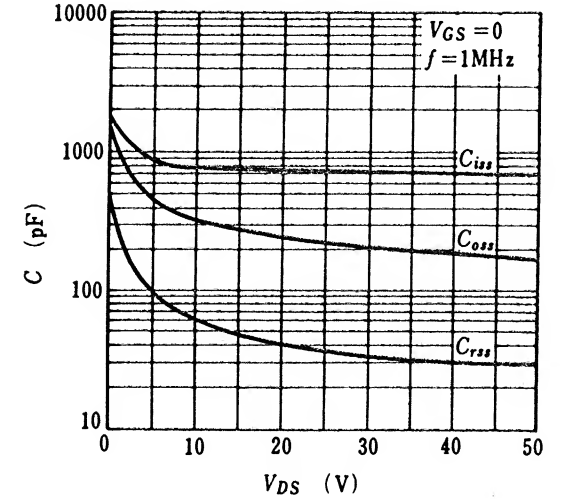
### PDS(on) - Tc 特性



### |yfs| - f 特性



### Ciss, Coss, Crss - VDS 特性

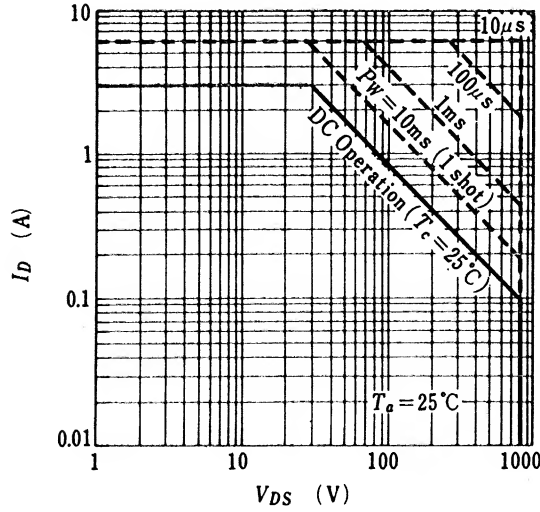


# 2SK415

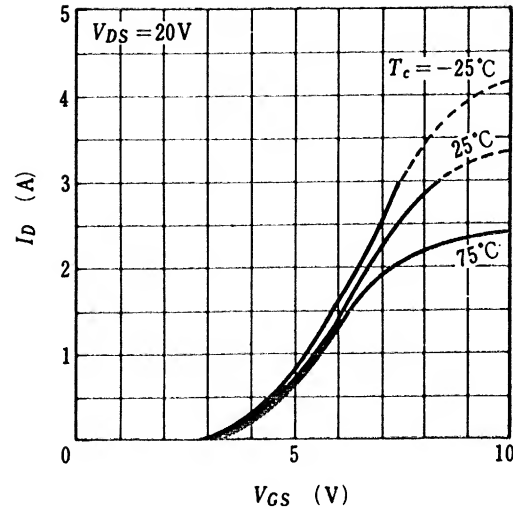
Si MOS 型  
Nチャンネル

日立

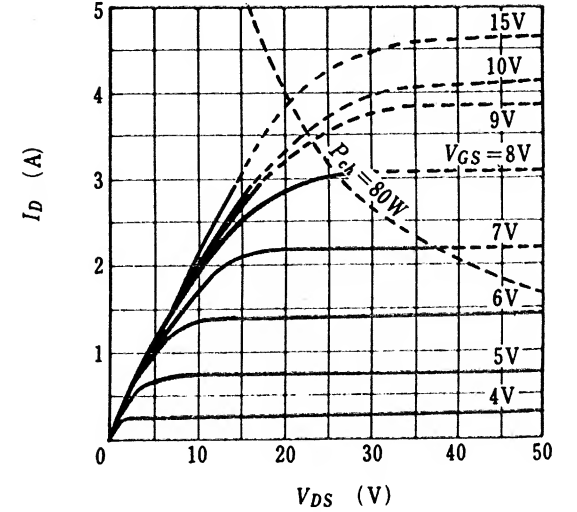
安全動作領域



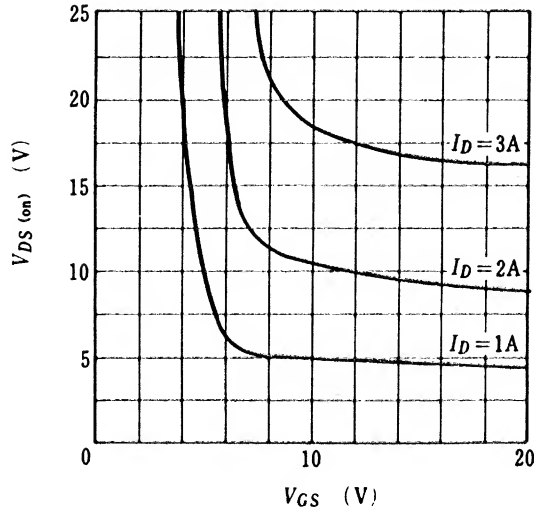
$I_D - V_{GS}$  特性



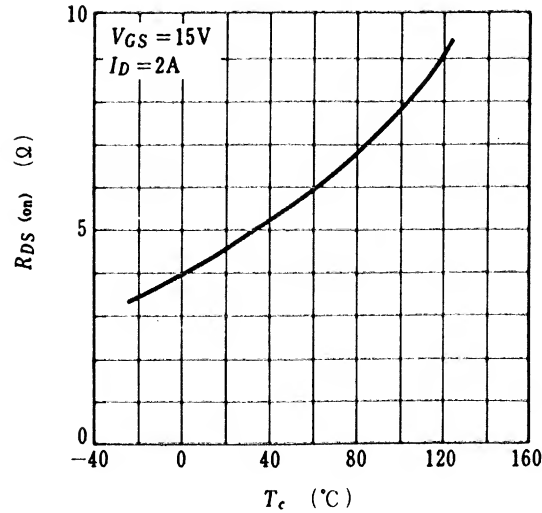
$I_D - V_{DS}$  特性



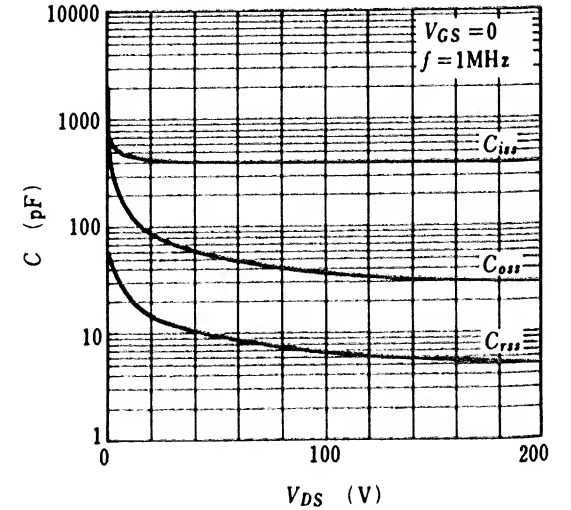
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



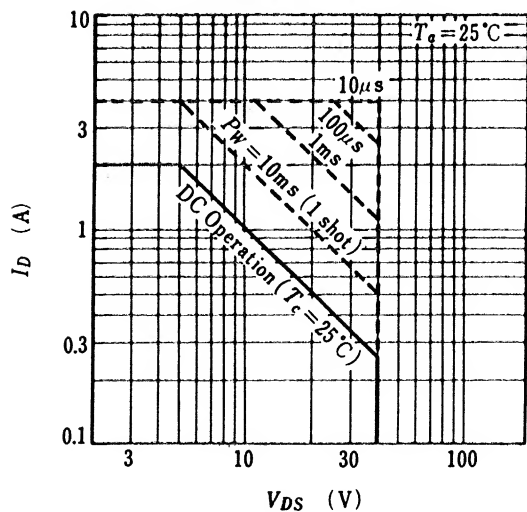


# 2SK416

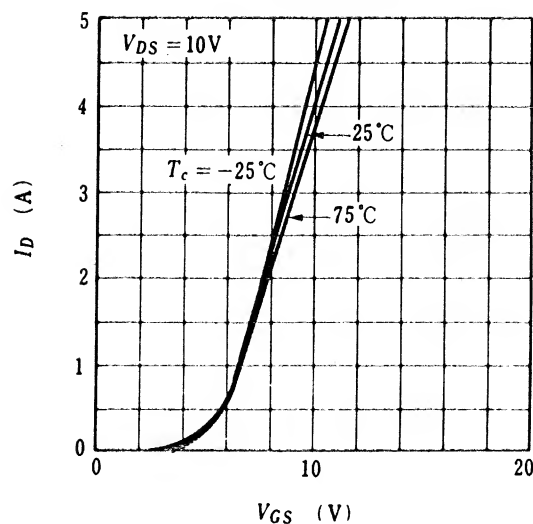
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

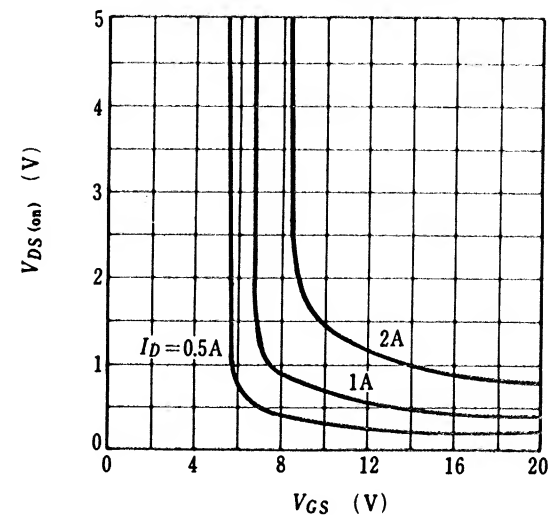
安全動作領域



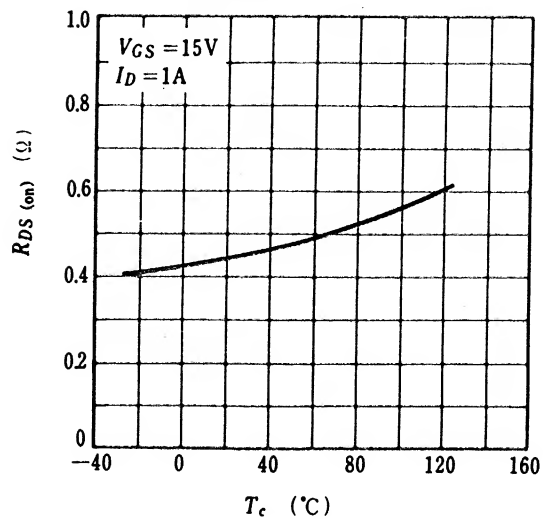
$I_D - V_{GS}$  特性



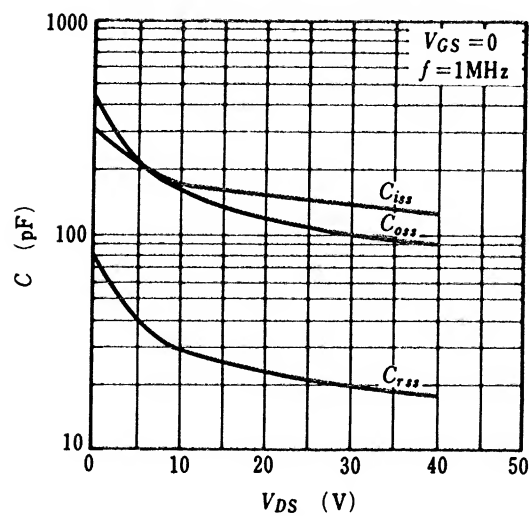
$V_{DS(ON)} - V_{GS}$  特性



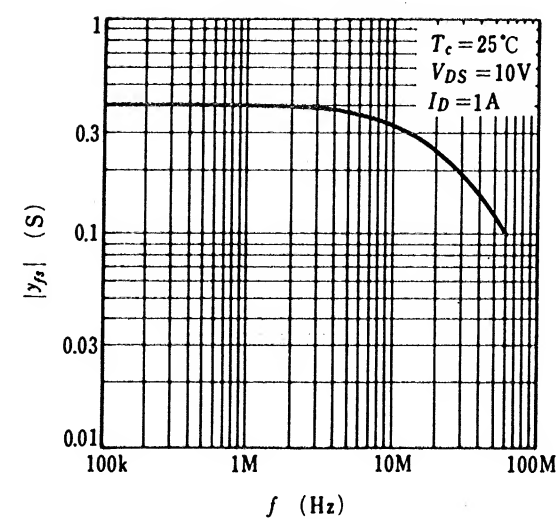
$R_{DS(ON)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



$|y_{fs}| - f$  特性

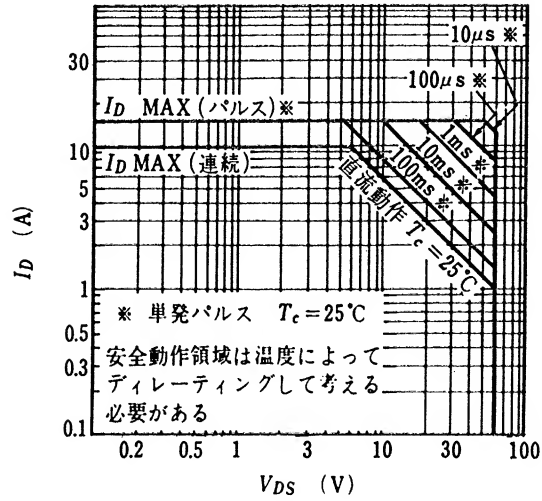


# 2SK417

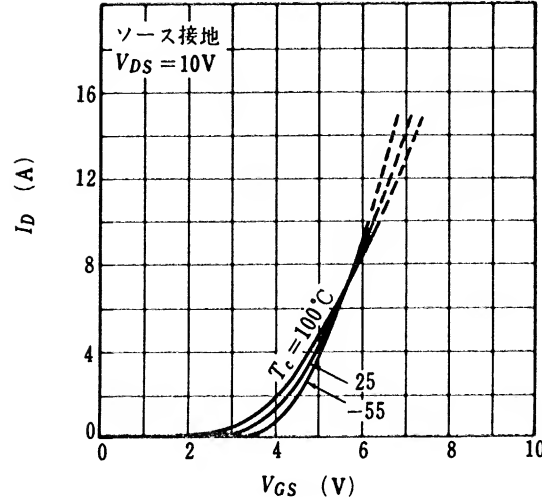
## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

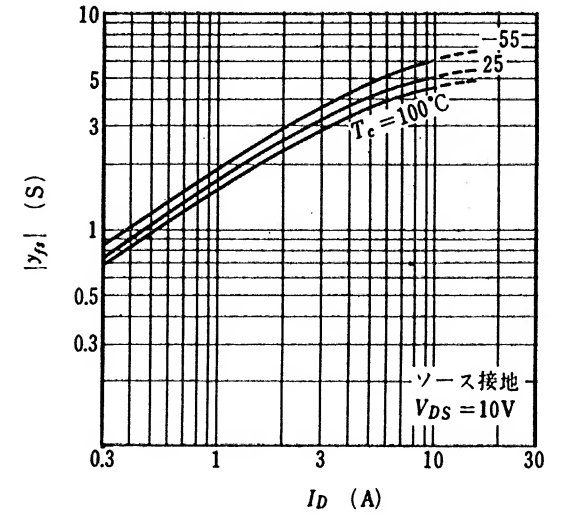
安全動作領域



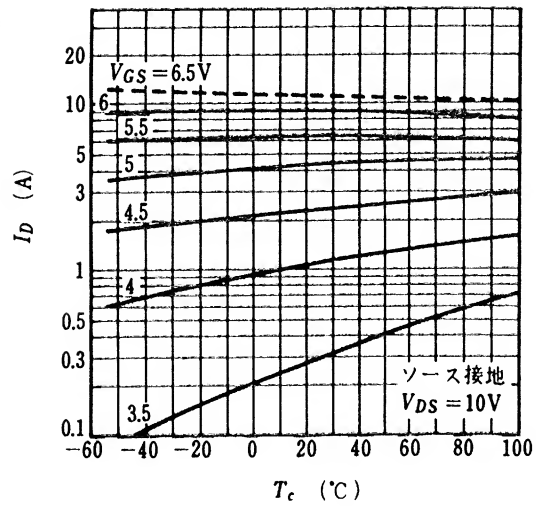
$I_D - V_{GS}$  特性



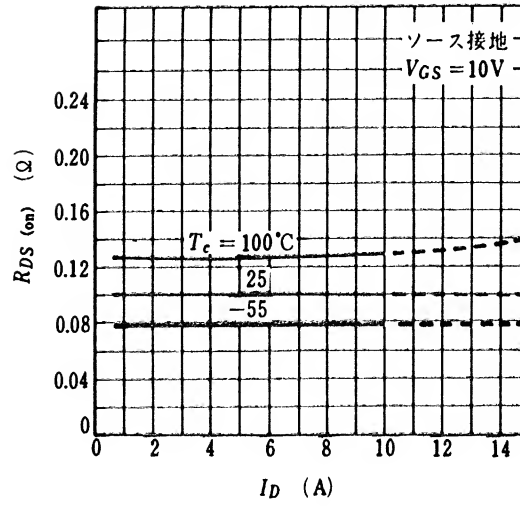
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



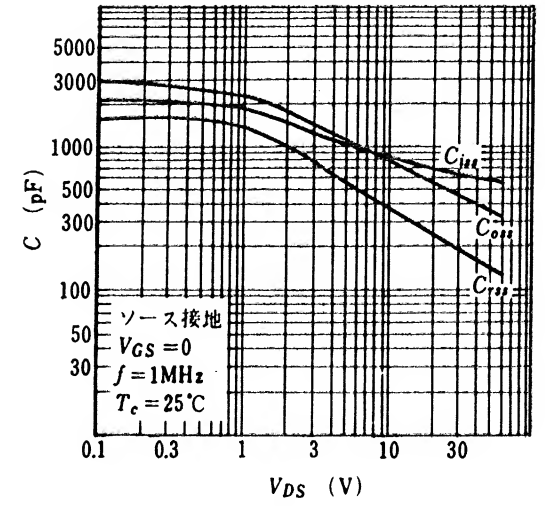
$I_D - T_c$  特性



$R_{DS(on)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

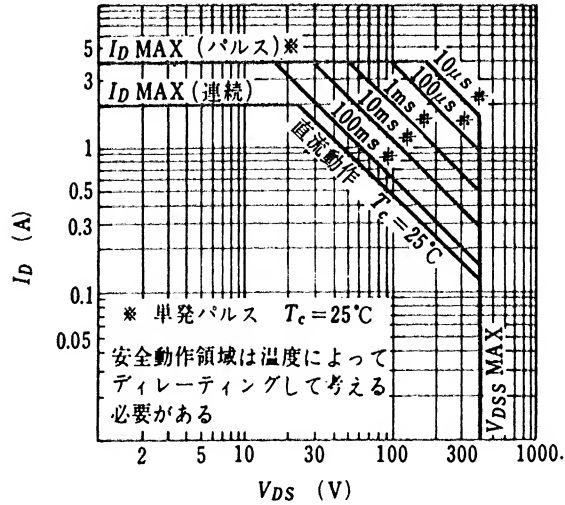


# 2SK418

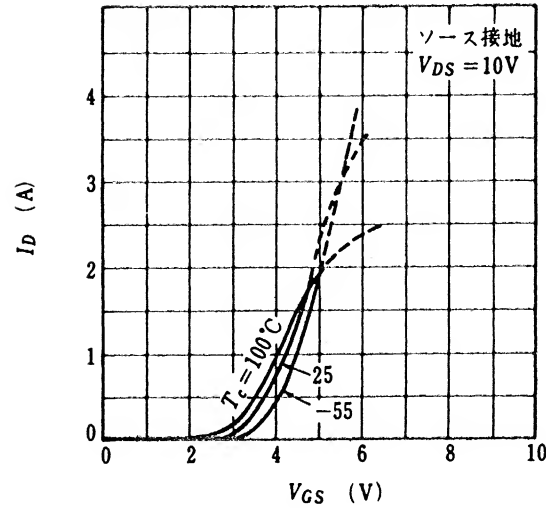
## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

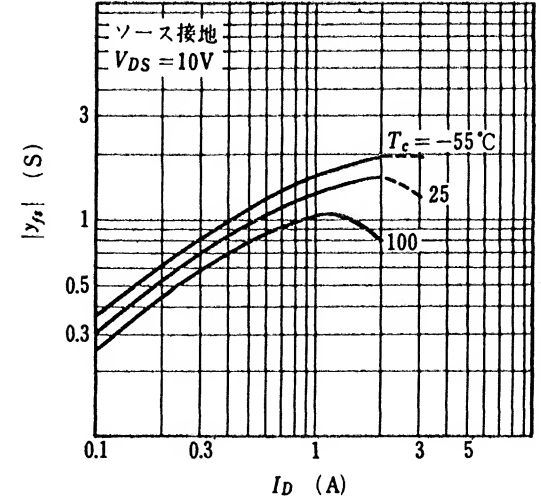
安全動作領域



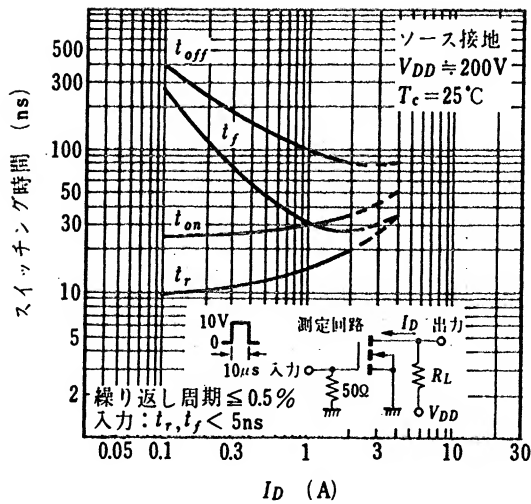
$I_D - V_{GS}$  特性



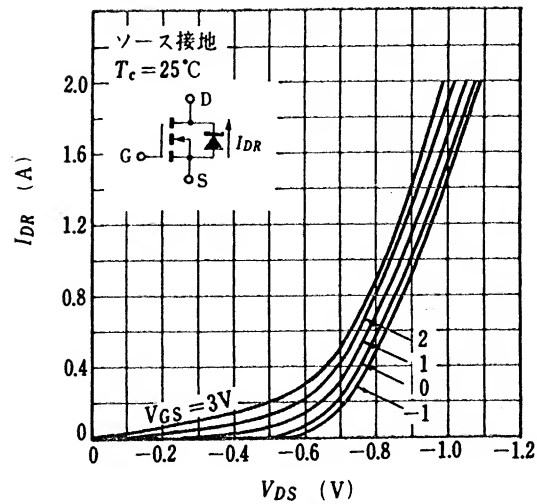
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



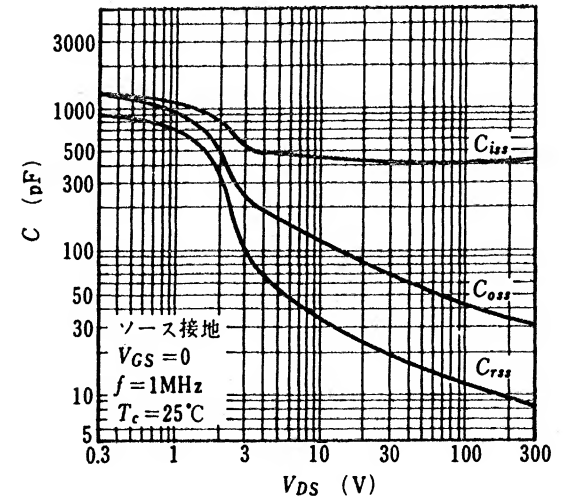
スイッチング特性



$I_{DR} - V_{DS}$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

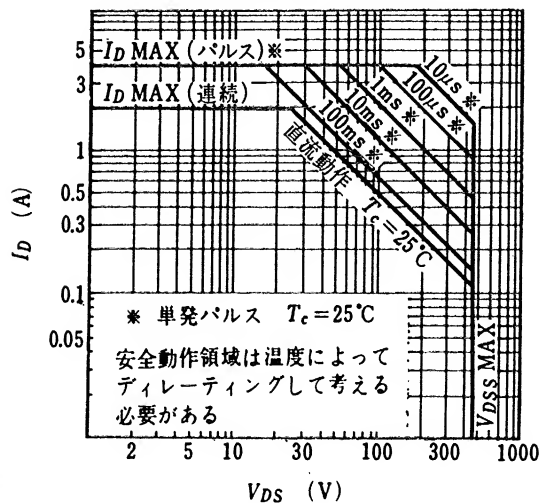


# 2SK419

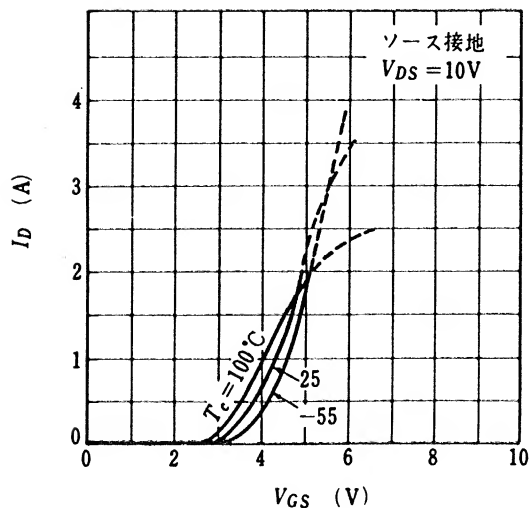
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

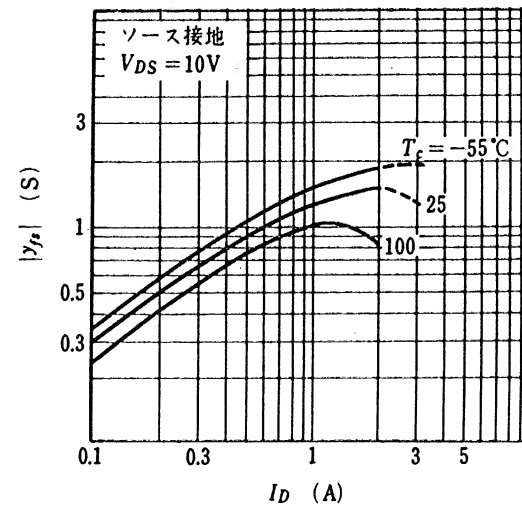
安全動作領域



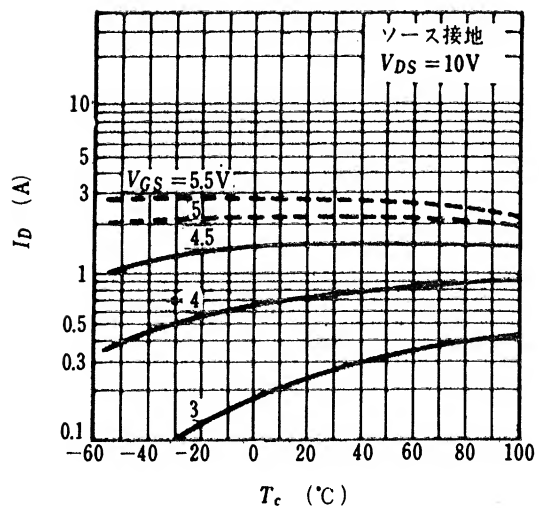
$I_D - V_{GS}$  特性



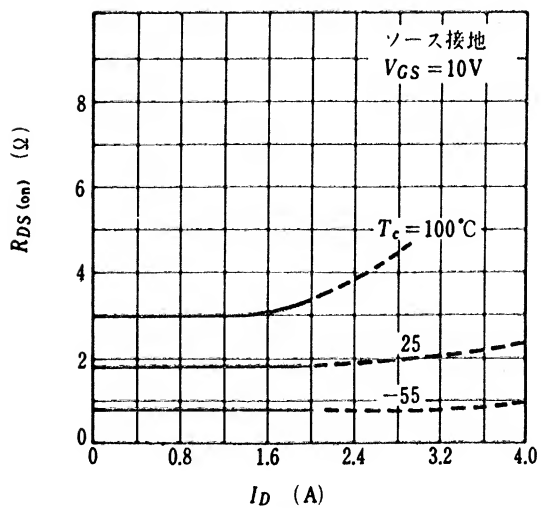
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



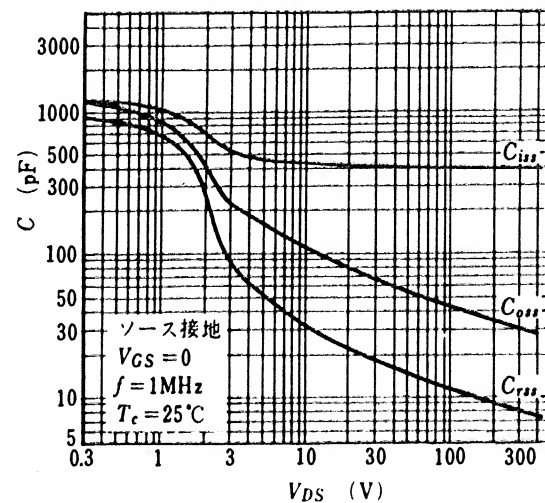
$I_D - T_c$  特性



$R_{DS(on)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

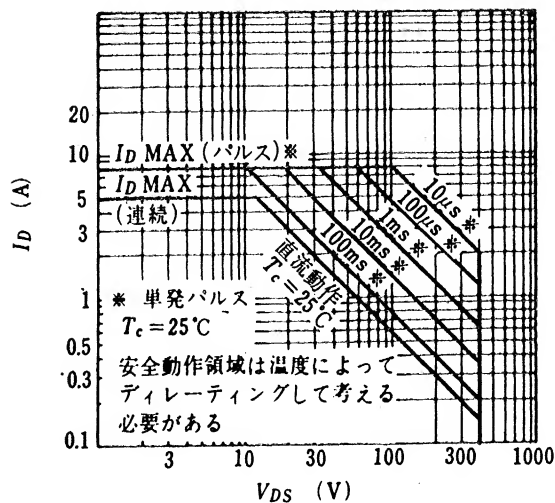


# 2SK420

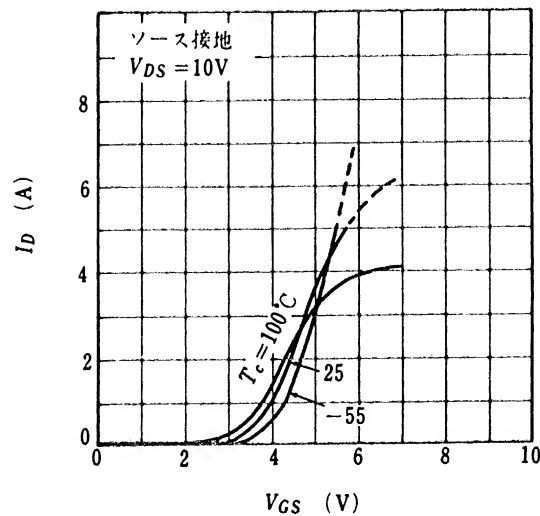
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

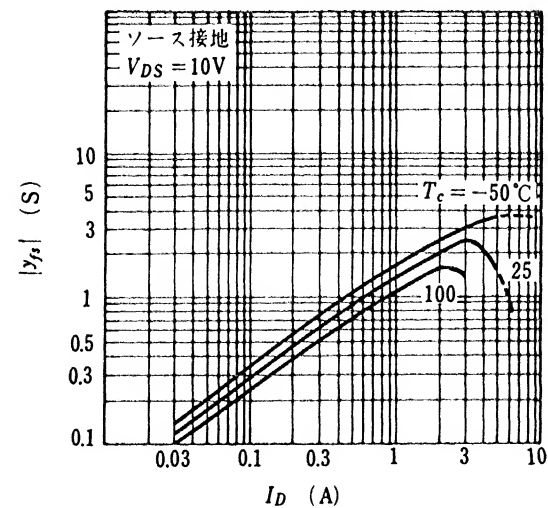
安全動作領域



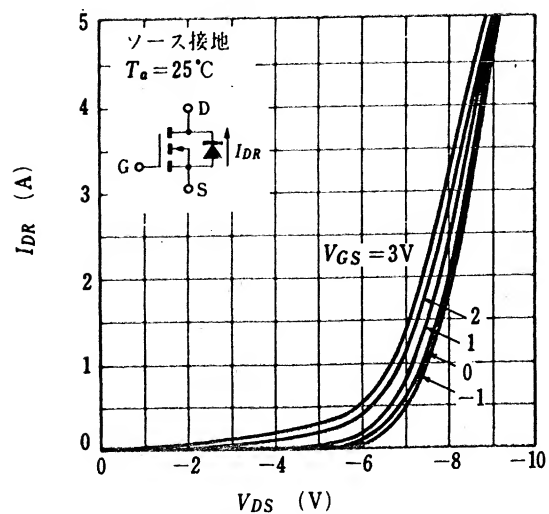
$I_D - V_{GS}$  特性



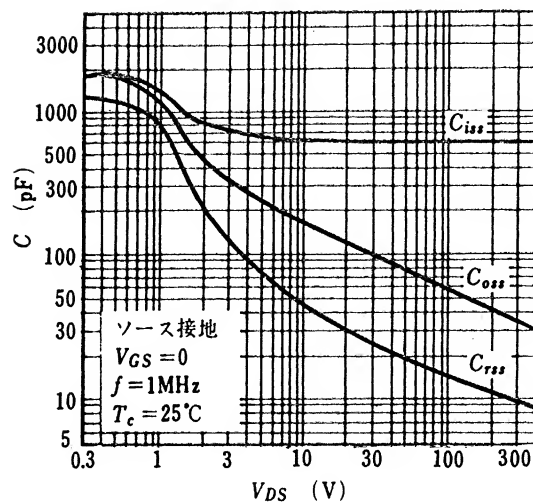
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



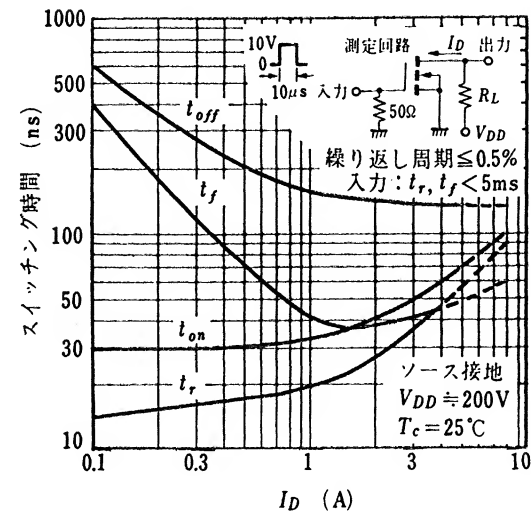
$I_{DR} - V_{DS}$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性



スイッチング特性

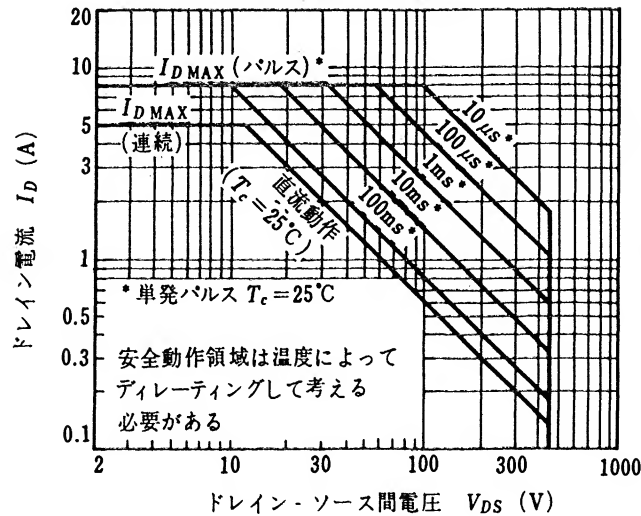


# 2SK421

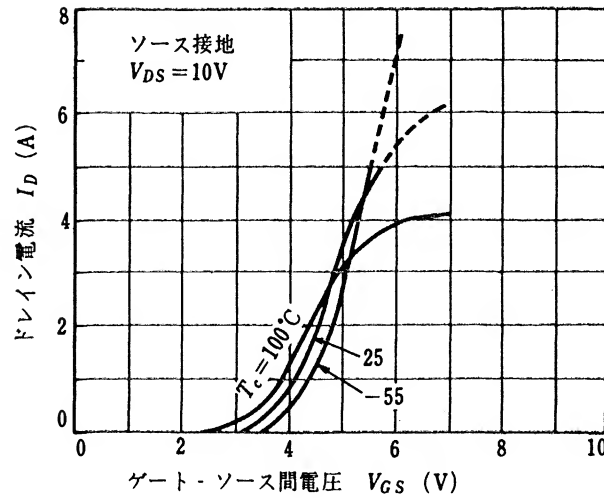
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

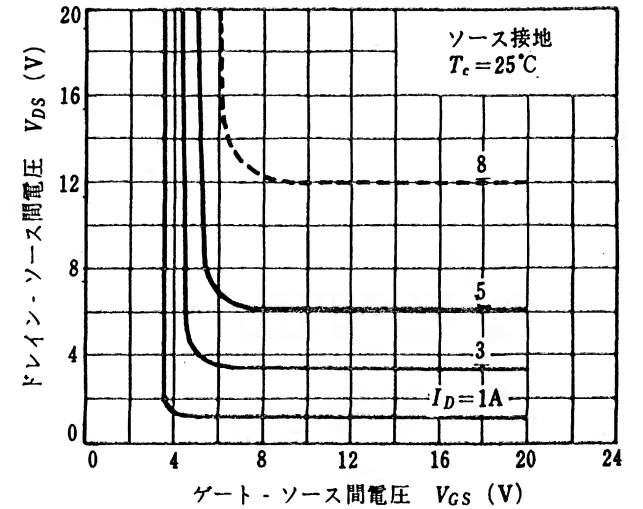
安全動作領域



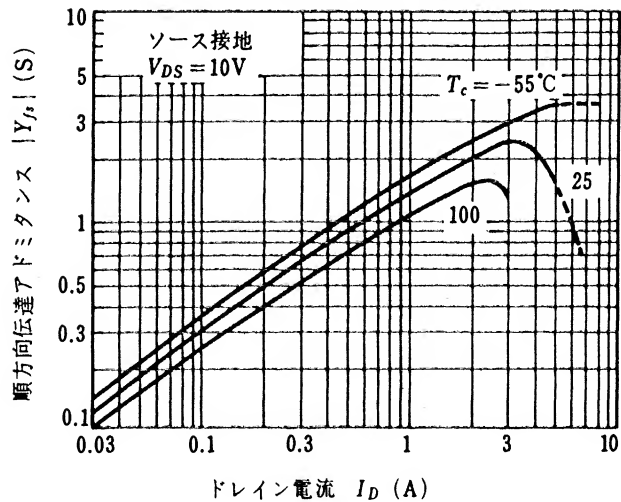
$I_D - V_{GS}$  特性



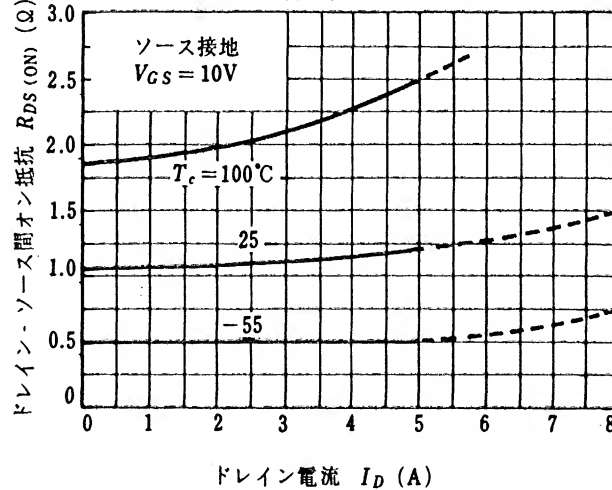
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



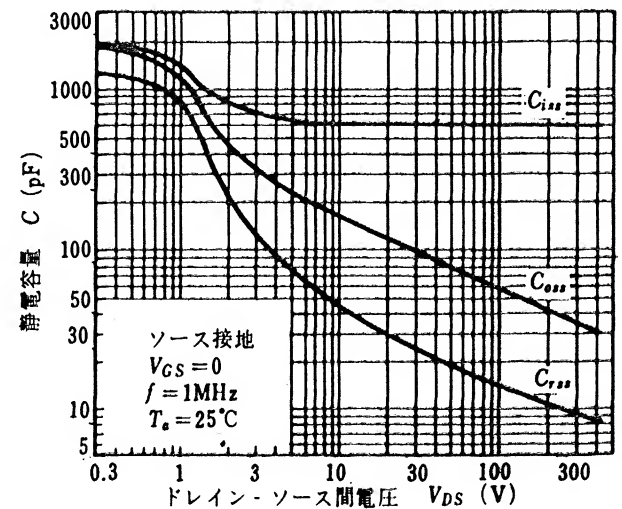
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(ON)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性

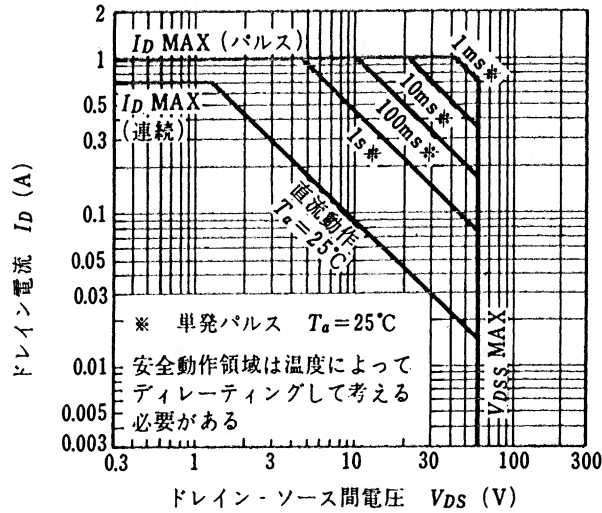


Si MOS型  
Nチャンネル

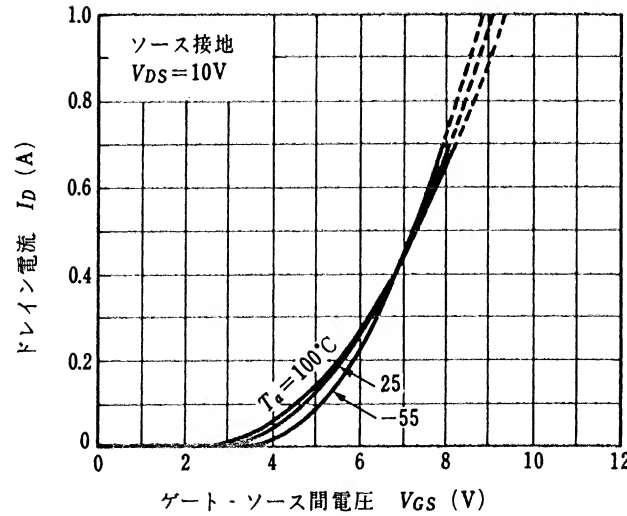
東 芝

2SK422

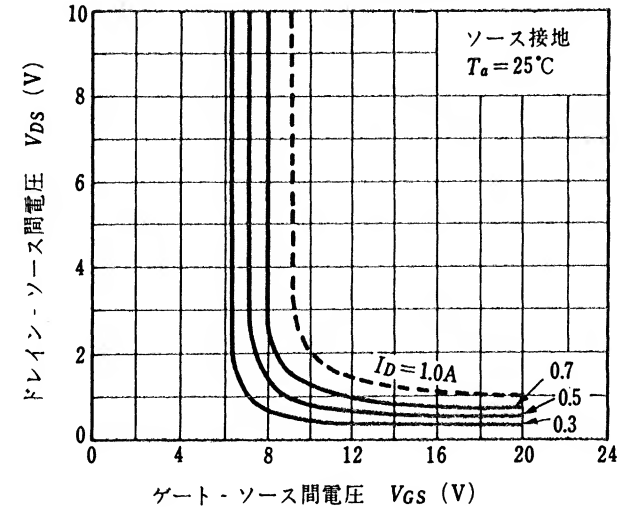
安全動作領域



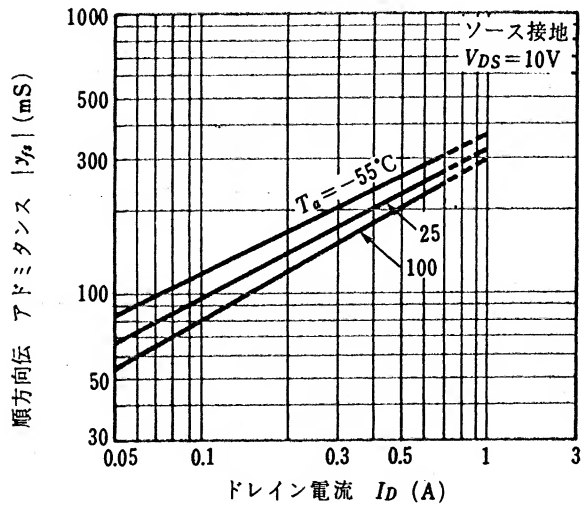
ID - VGS 特性



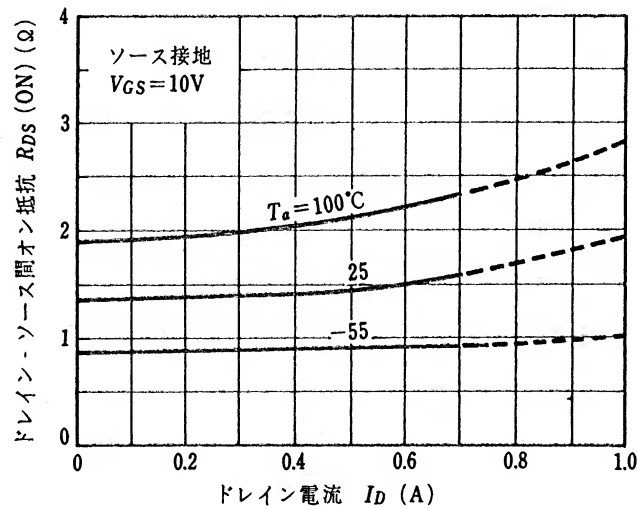
VDS - VGS 特性



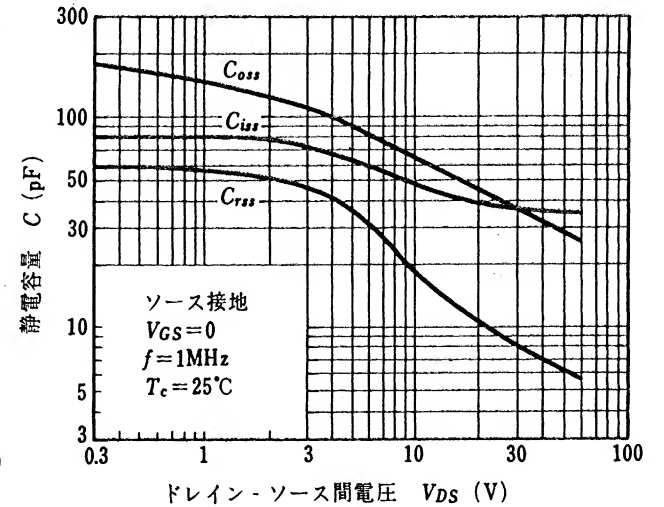
|Yfs| - ID 特性



RDS(ON) - ID 特性



静電容量 - VDS 特性

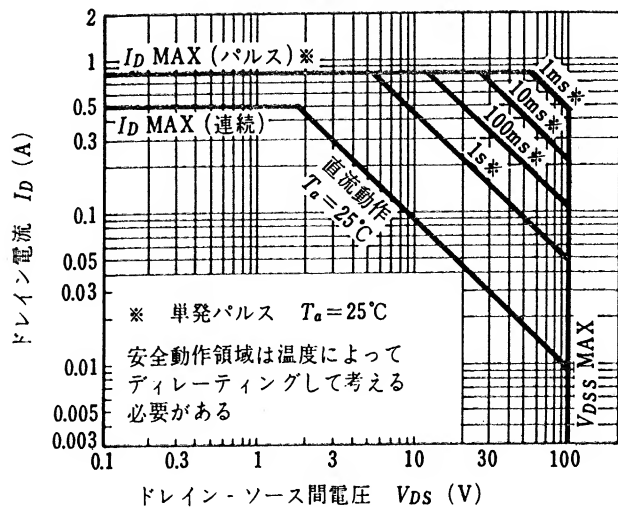


# 2SK423

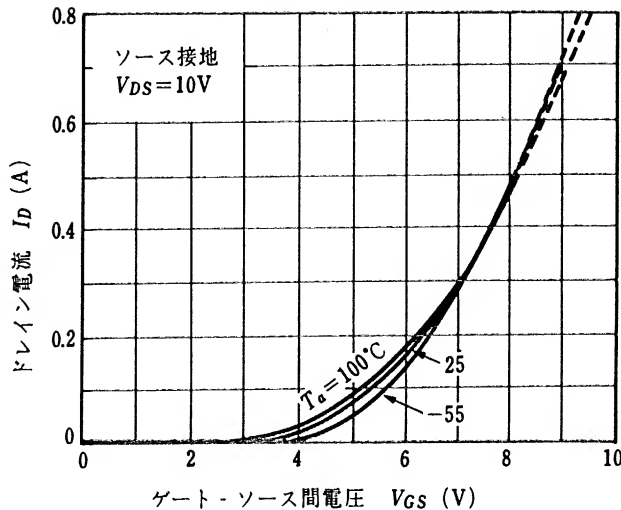
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

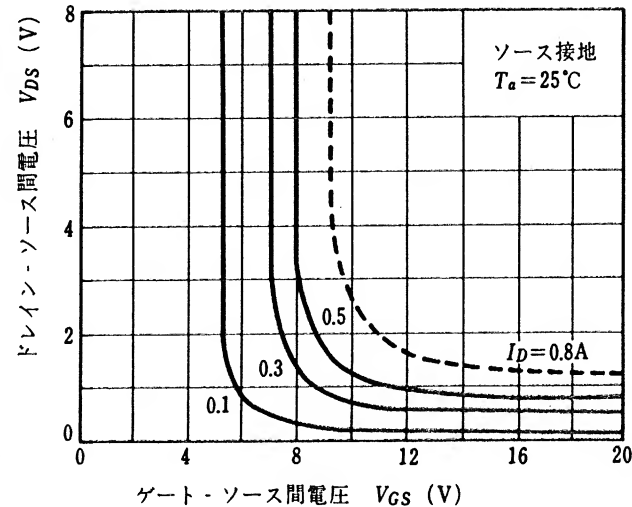
安全動作領域



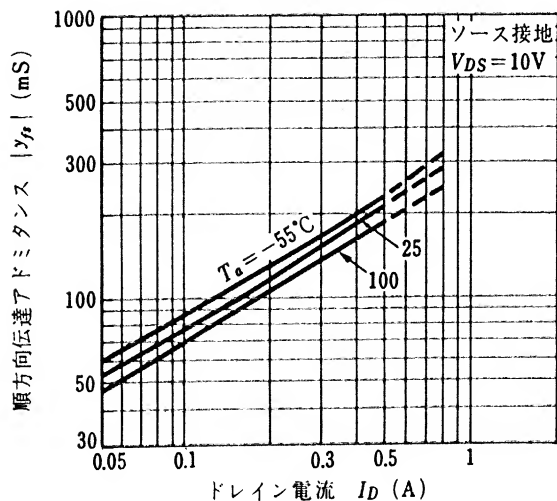
$I_D - V_{GS}$  特性



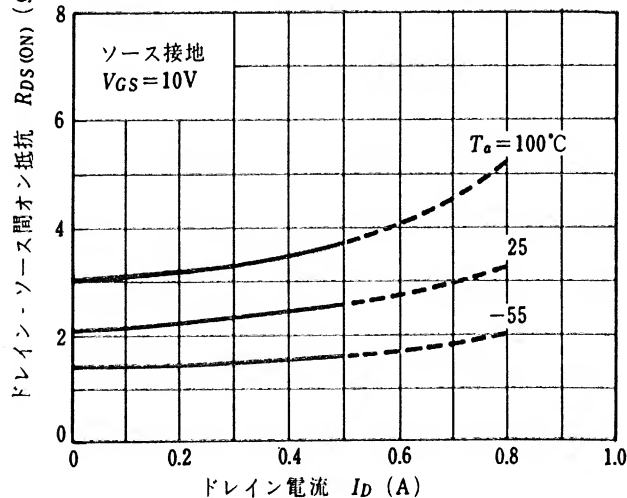
$V_{DS} - V_{GS}$  特性



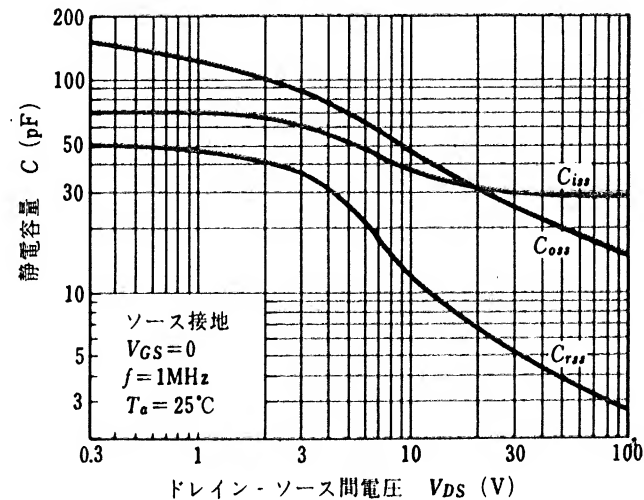
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(ON)} - I_D$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性



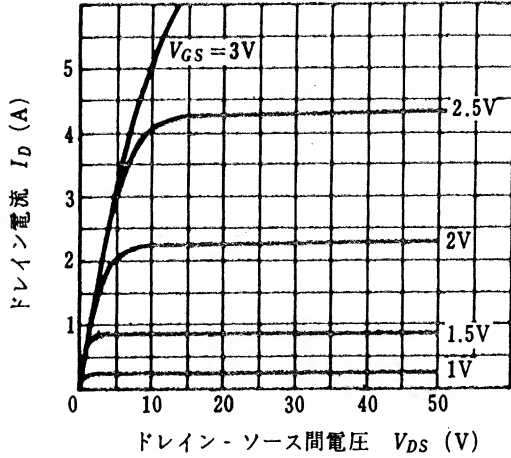


# 2SK424

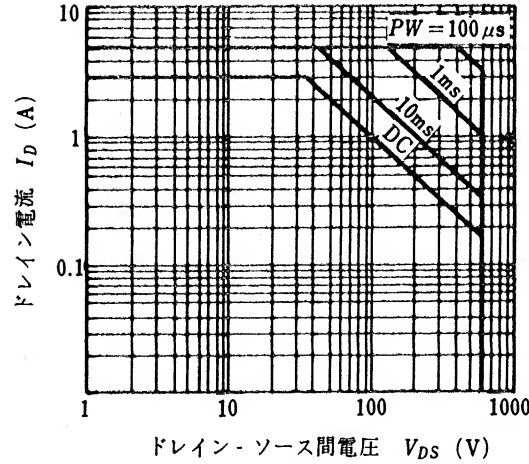
## Si MOS型 Nチャンネル

日 電

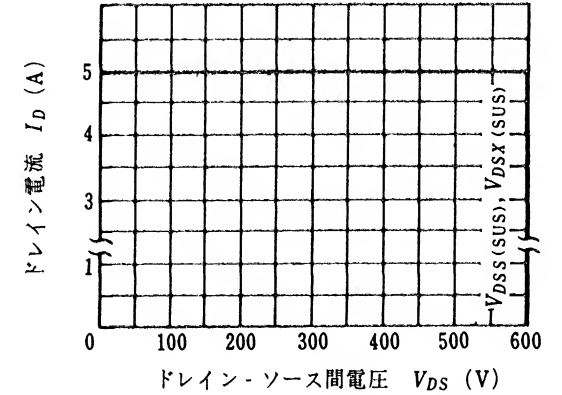
### $I_D - V_{DS}$ 特性



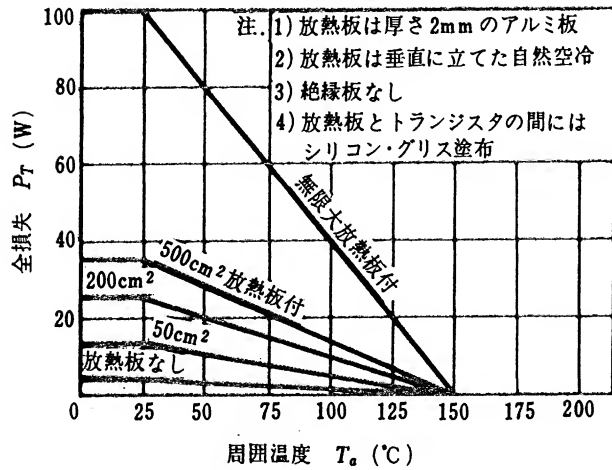
### 順バイアス安全動作領域



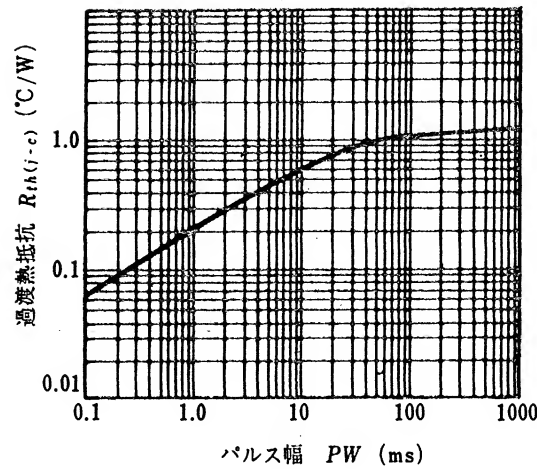
### 逆バイアス安全動作領域



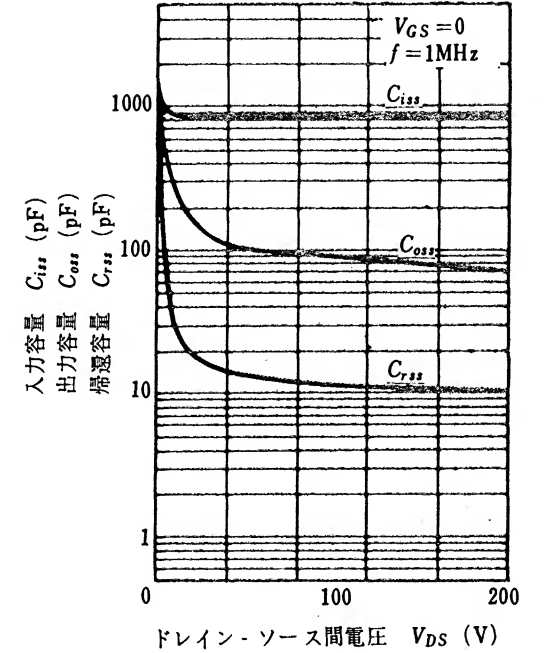
### $P_T - T_a$ 特性



### 過渡熱抵抗特性



### $C_{iss}, C_{rss}, C_{oss} - V_{DS}$ 特性



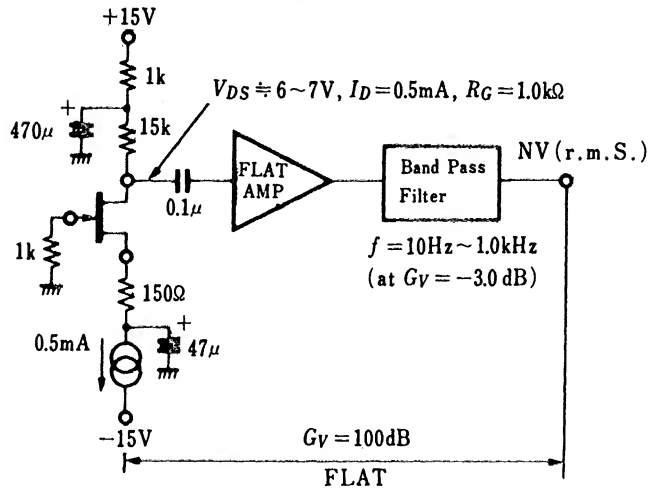
# 2SK425, 426

Si 接合型  
Nチャンネル

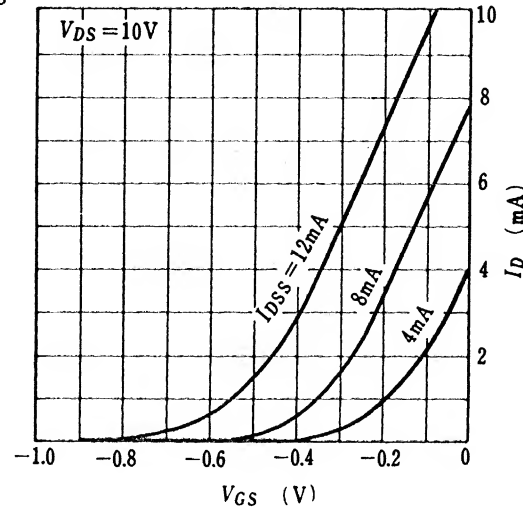
日 電

$I_{DSS}$ (mA)	1~4	3~6	5~8	7~10	9~12	11~14	13~16	15~18
2SK425	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18
2SK426	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28

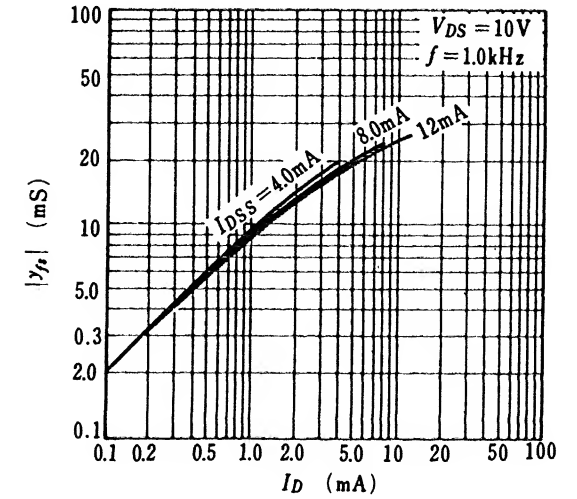
雑音電圧測定回路



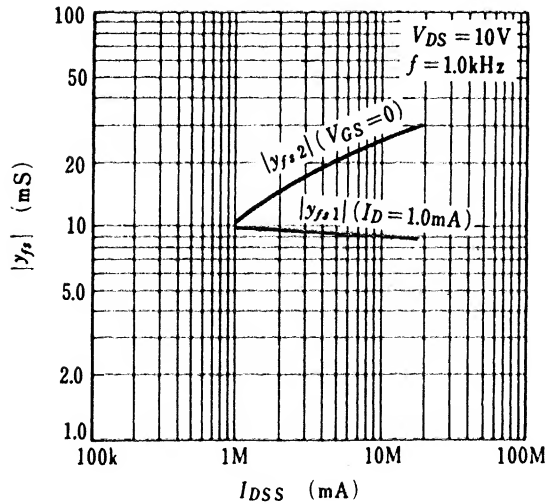
$I_D - V_{GS}$  特性



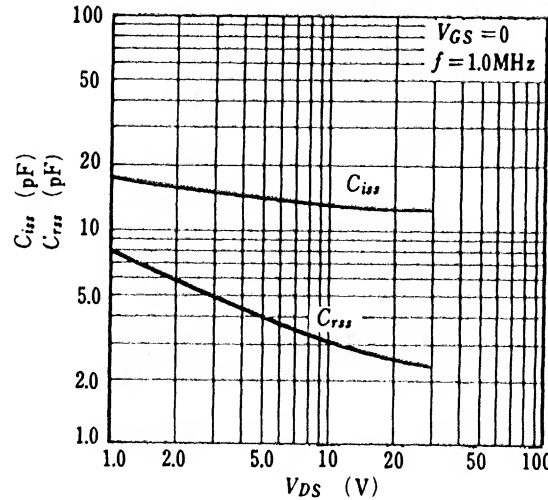
$|y_{fs}| - I_D$  特性



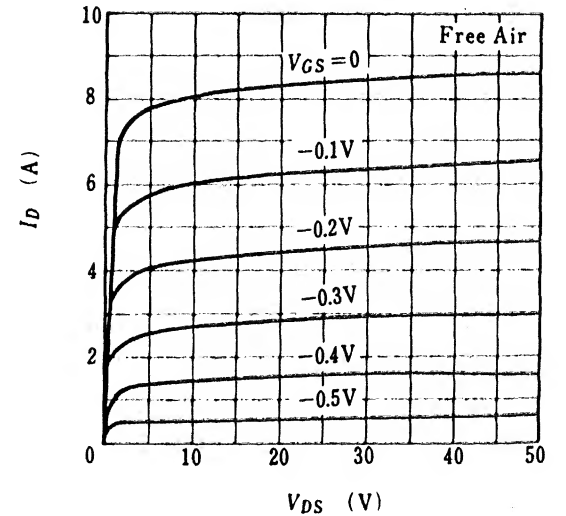
$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$C_{iss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



$I_D - V_{DS}$  特性



# 2SK427, 436

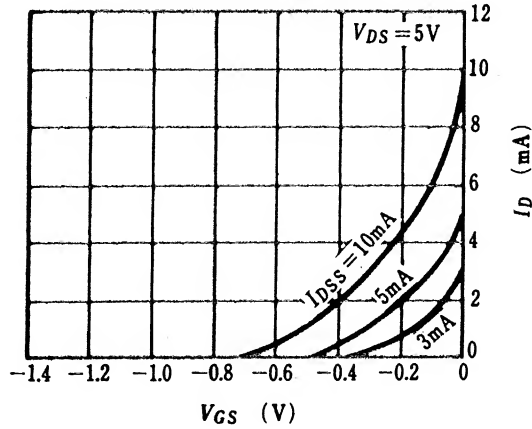
Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

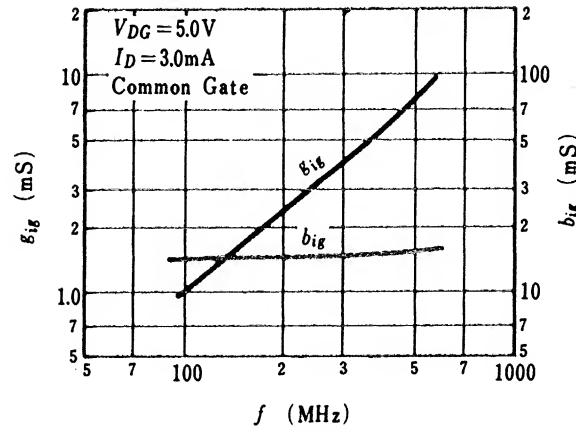
$I_{DSS}$  により次のように分類している (単位: mA)

1.2	P	2.1	1.7	Q	3.0	2.5	R	4.2
3.5	S	6.0	5.0	T	8.5	7.3	U	12.0

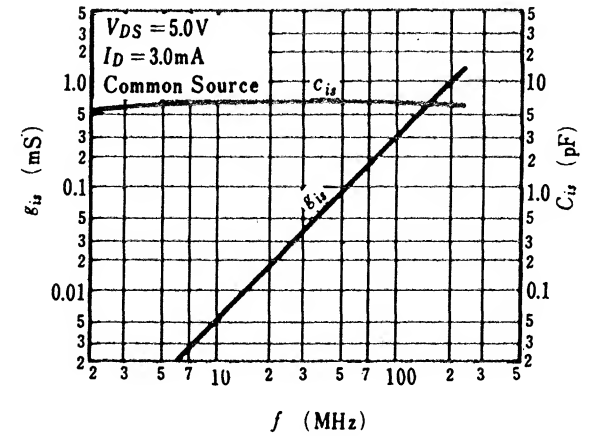
$I_D - V_{GS}$  特性



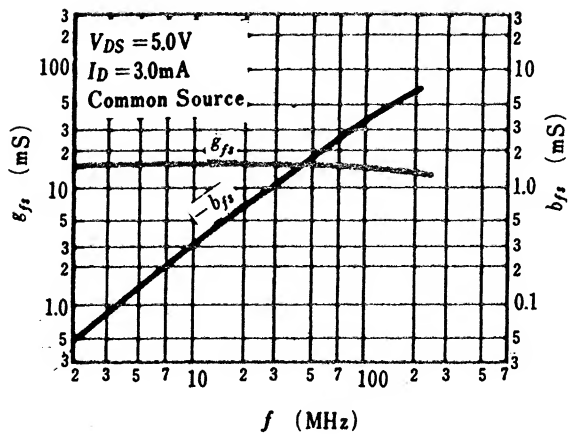
$Y_{ig} - f$  特性



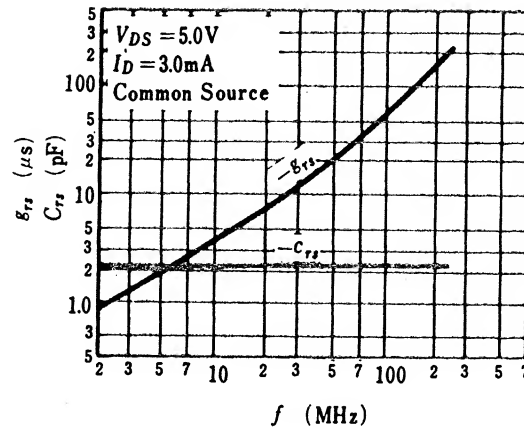
$Y_{is} - f$  特性



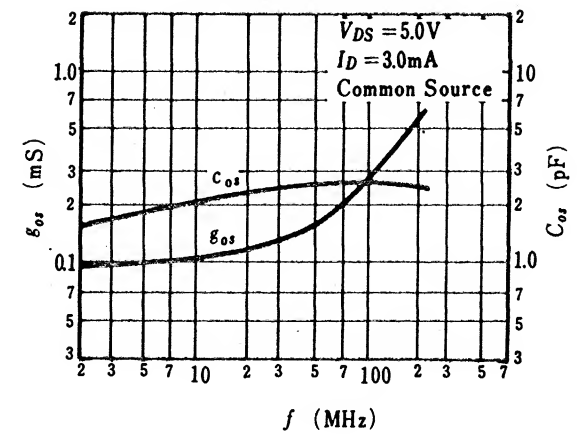
$Y_{fs} - f$  特性



$Y_{rs} - f$  特性



$Y_{os} - f$  特性

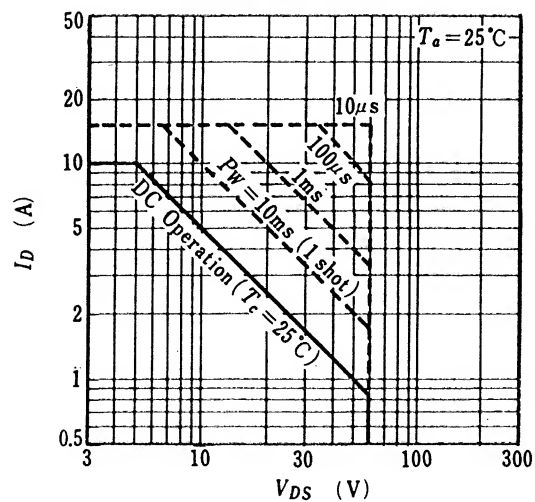


# 2SK428

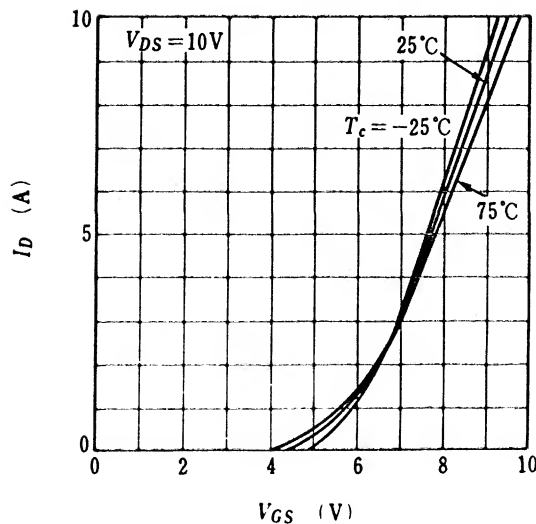
Si MOS 型  
Nチャンネル

日 立

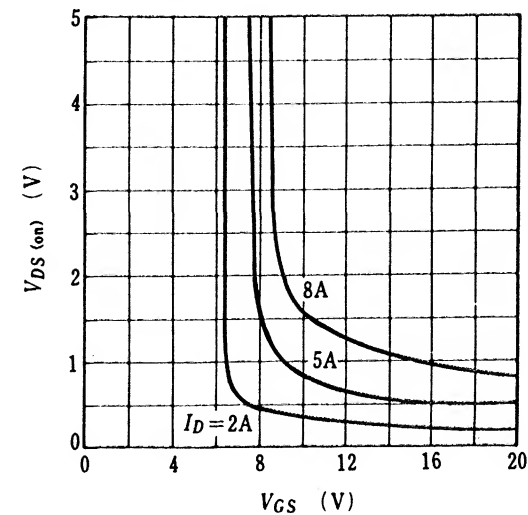
安全動作領域



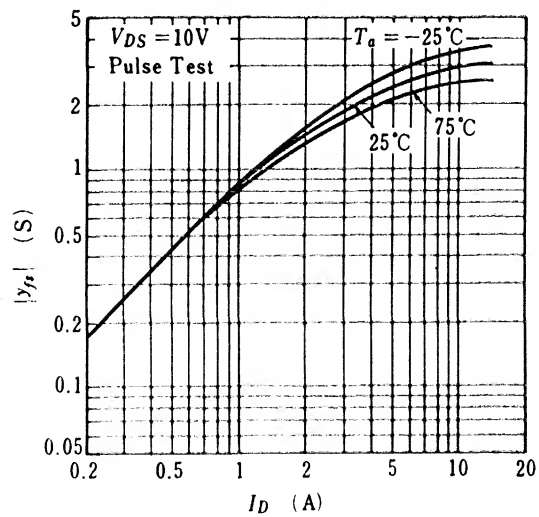
$I_D - V_{GS}$  特性



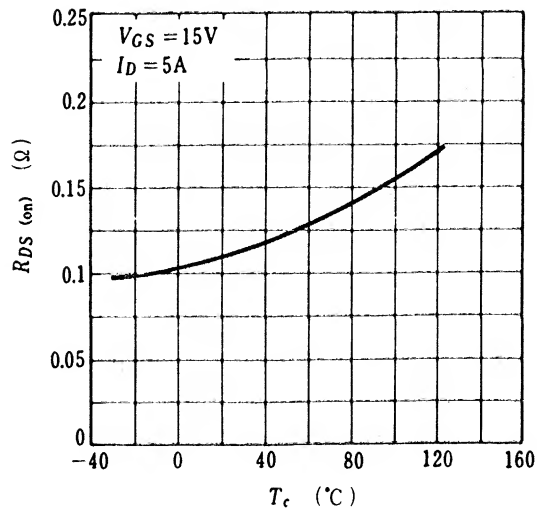
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



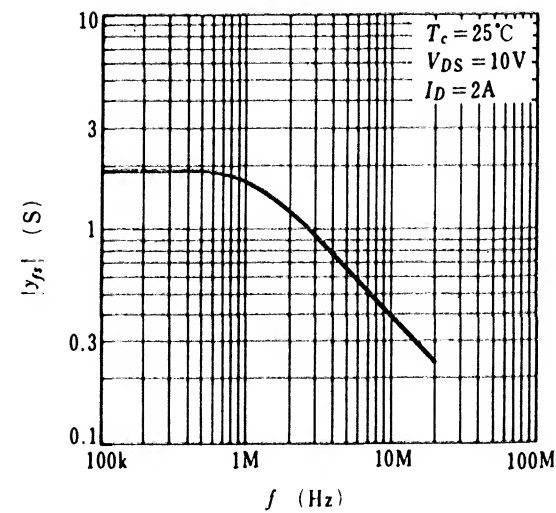
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$|y_{fs}| - f$  特性

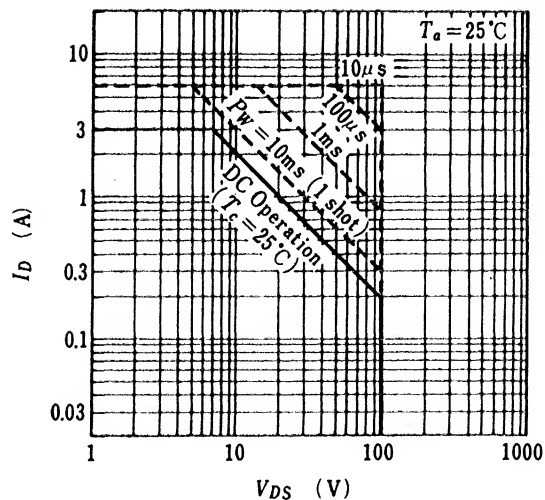


# 2SK429

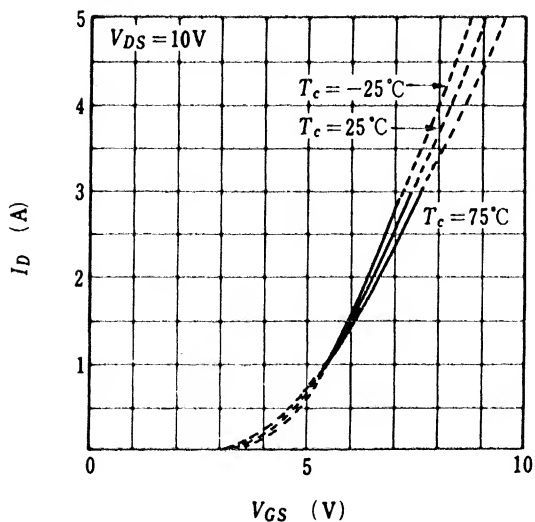
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

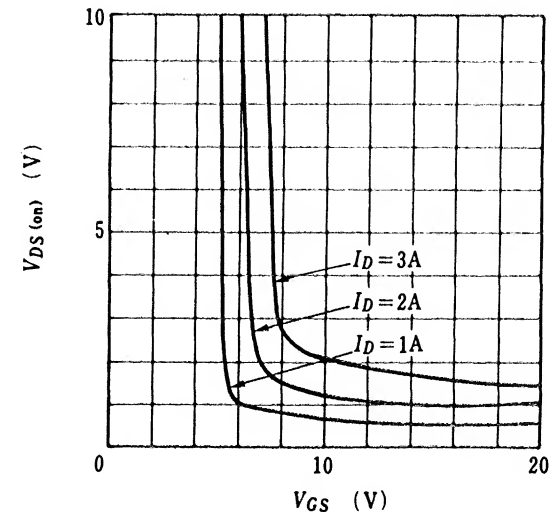
安全動作領域



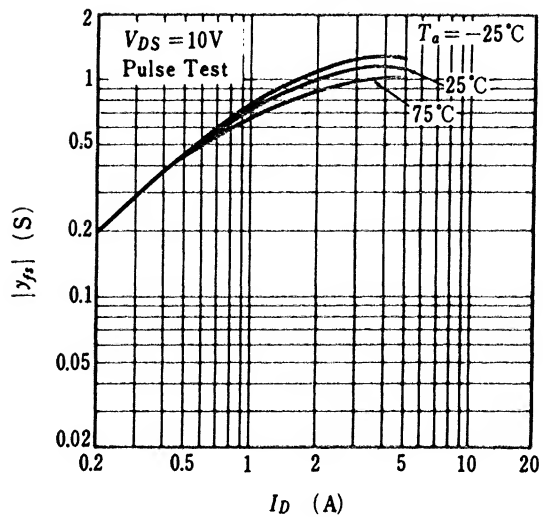
$I_D - V_{GS}$  特性



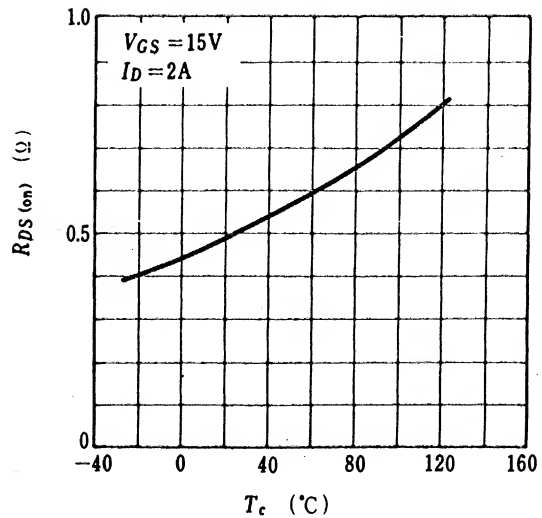
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



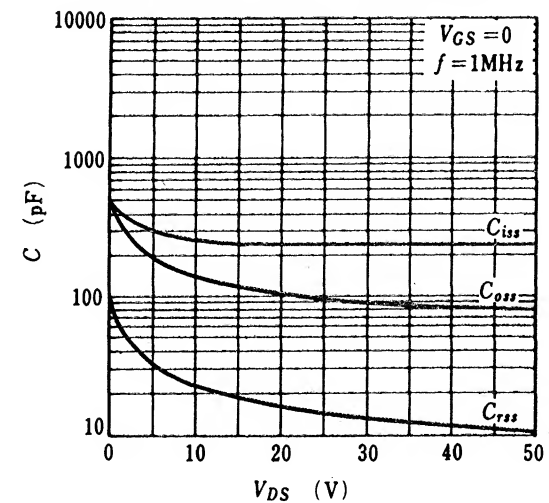
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性

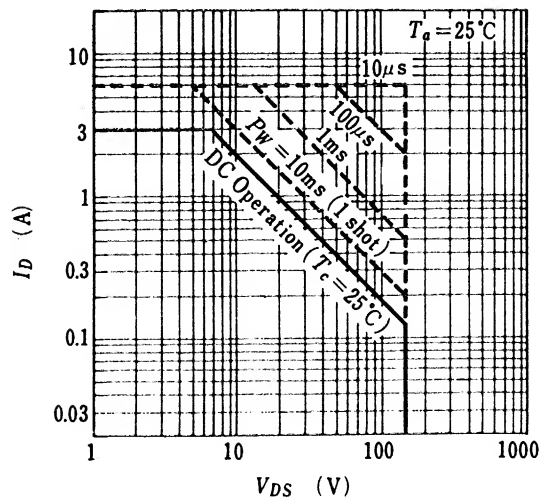


# 2SK430

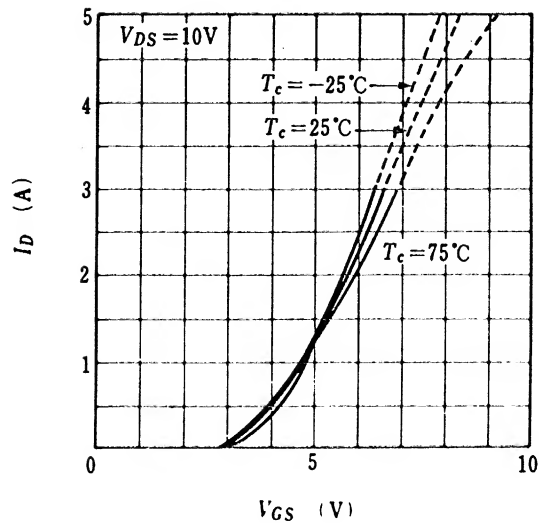
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

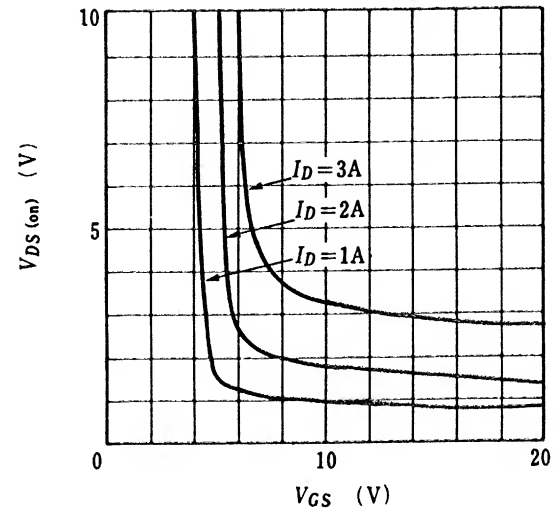
安全動作領域



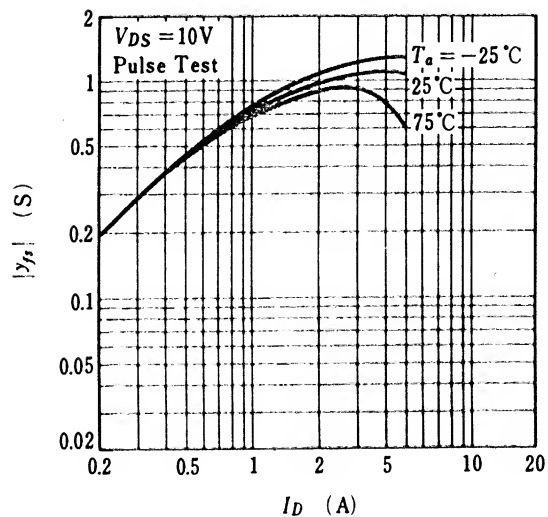
$I_D - V_{GS}$  特性



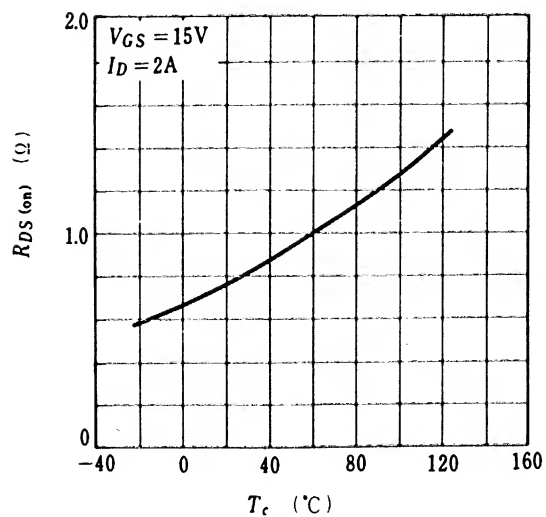
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



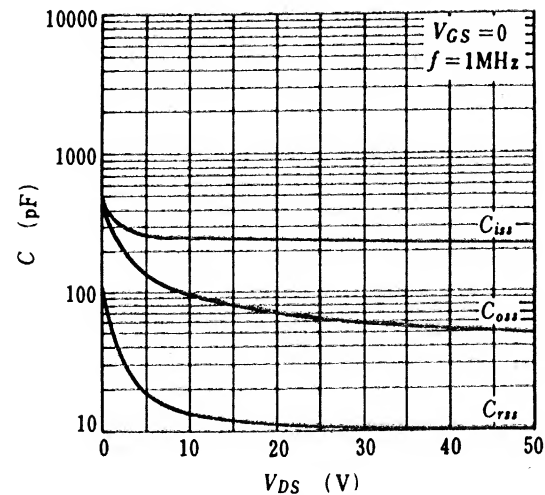
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



# 2SK435, 494

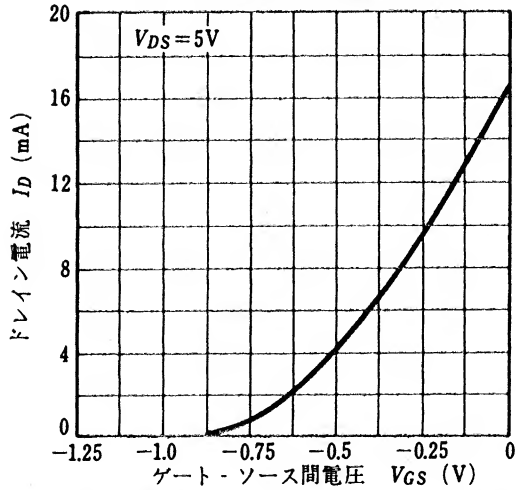
Si 接合型  
Nチャンネル

日立

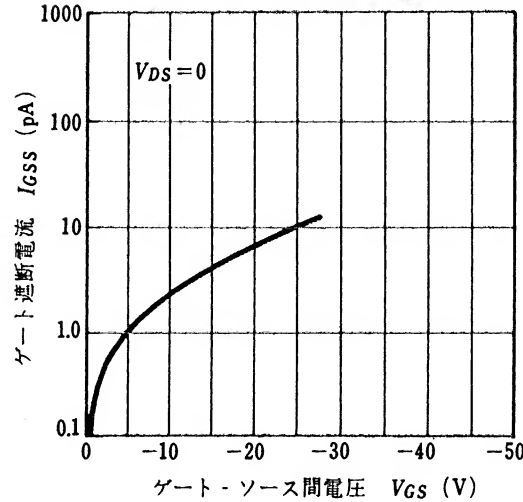
$I_{DSS}$  区分

B	C	D	E
6~14	12~22	18~30	26~40

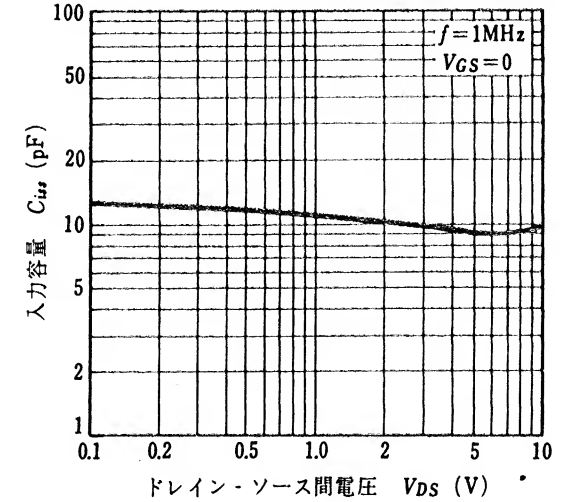
ソース接地伝達静特性



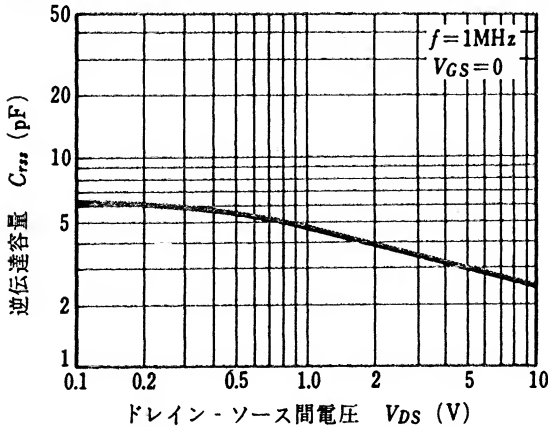
ゲート遮断電流対  
ゲート-ソース間電圧特性



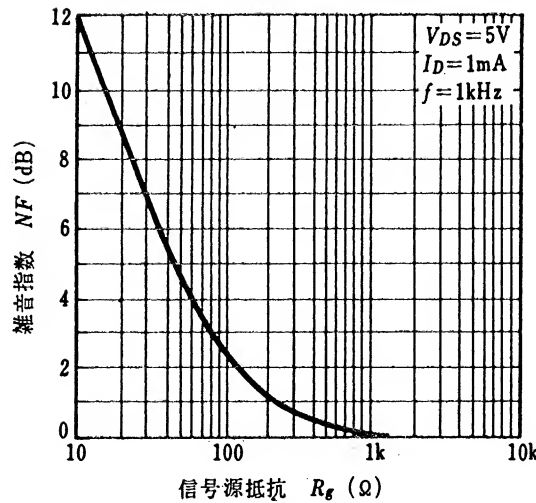
入力容量対ドレイン-  
ソース間電圧特性



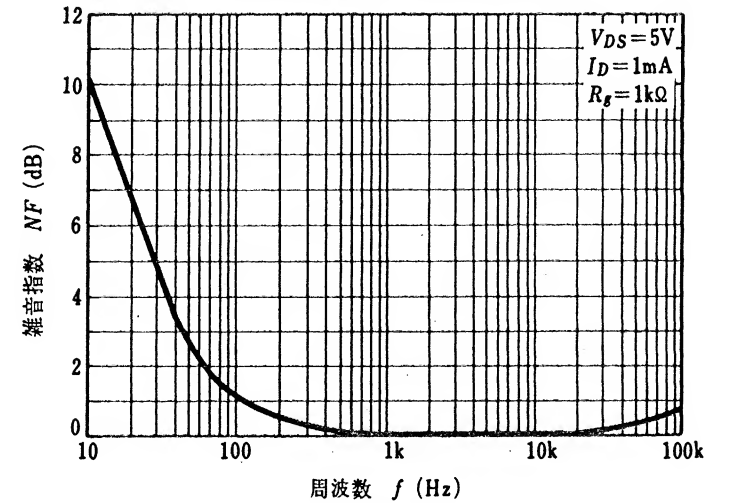
逆伝達容量対ドレイン-ソース間電圧特性



雑音指数対信号源抵抗特性



雑音指数対周波数特性

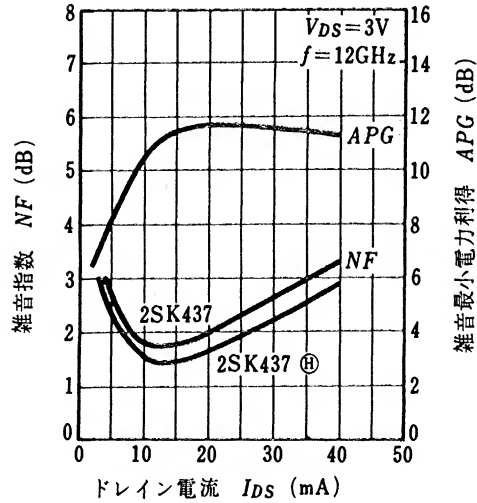


# 2SK437, 437(H), 438

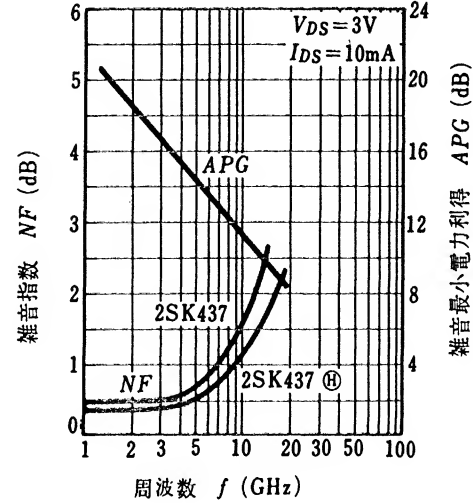
GaAs MES型  
Nチャンネル

松下

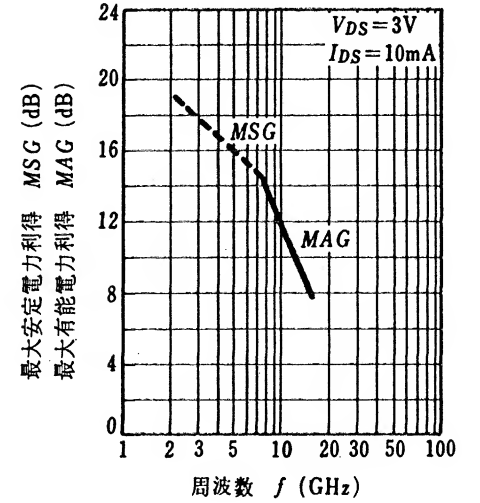
NF, APG -  $I_{DS}$  特性



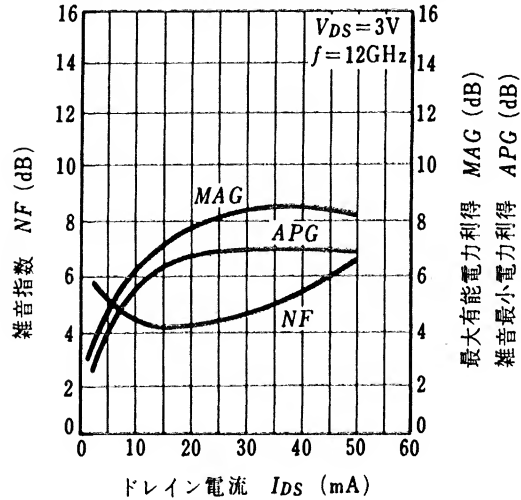
NF, APG -  $f$  特性



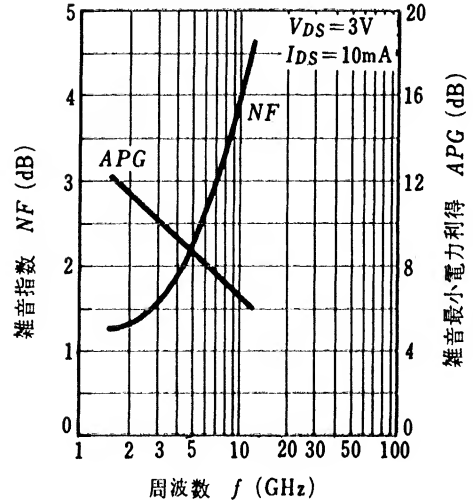
MAG, MSG -  $f$  特性



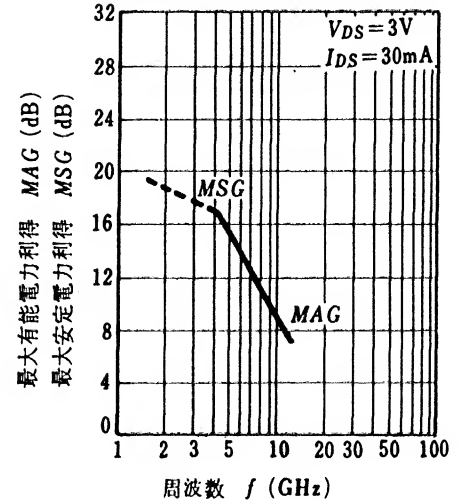
NF, APG, MAG -  $I_{DS}$  特性



NF, APG -  $f$  特性



MSG, MAG -  $f$  特性



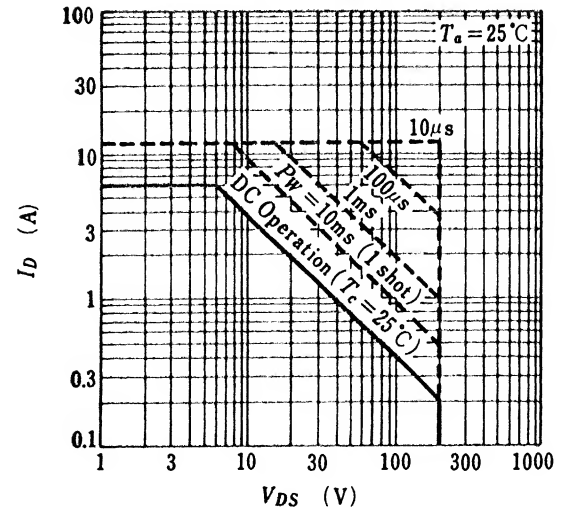


# 2SK440

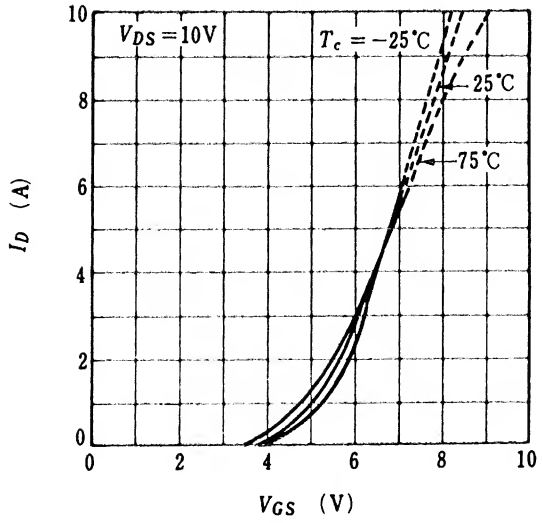
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

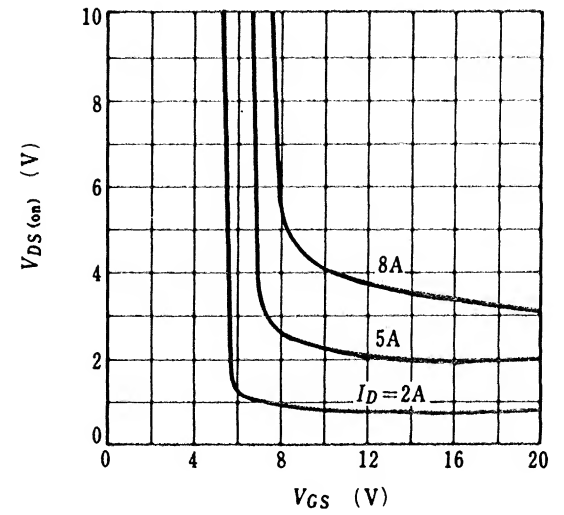
安全動作領域



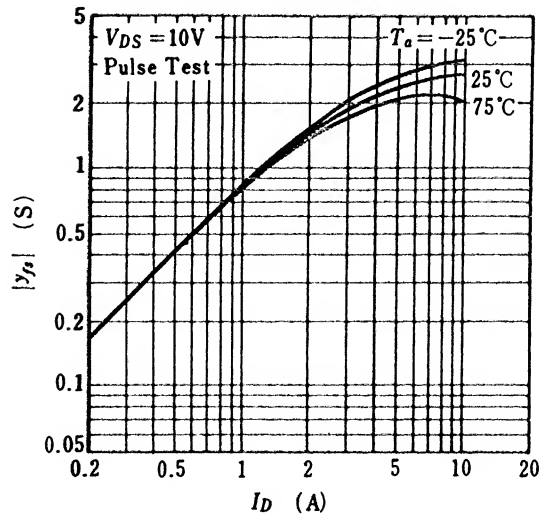
$I_D - V_{GS}$  特性



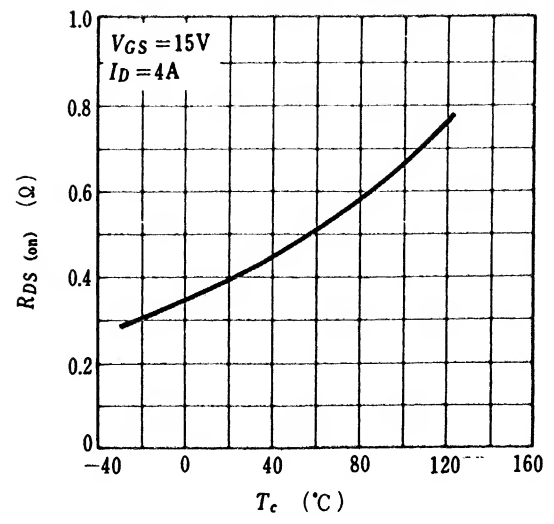
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



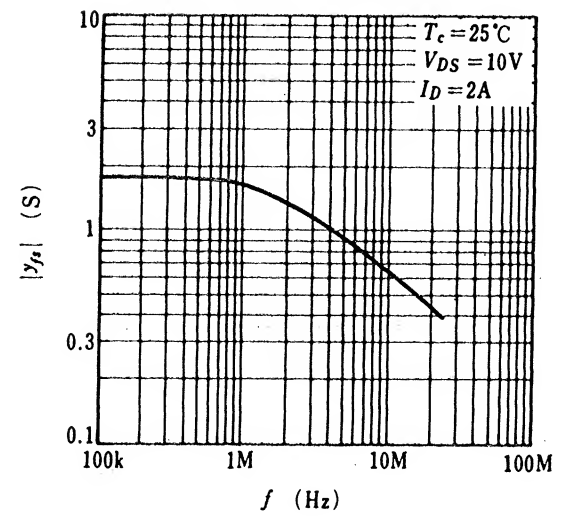
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$|y_{fs}| - f$  特性

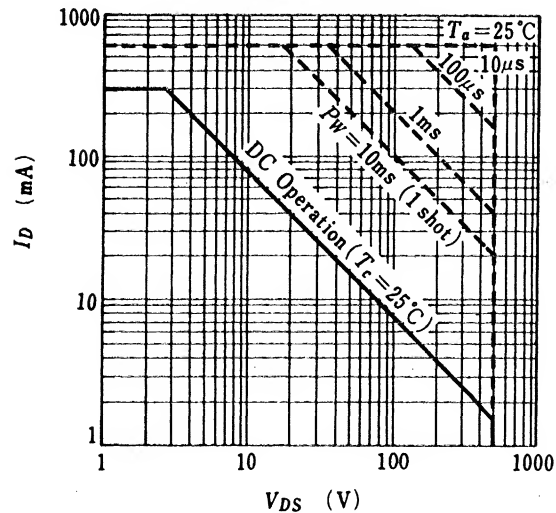


# 2SK441

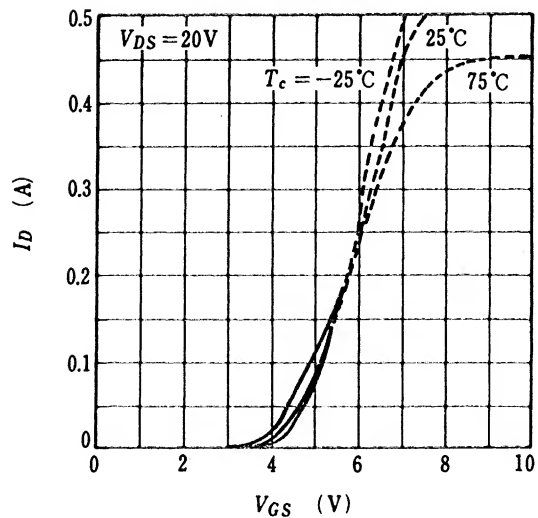
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

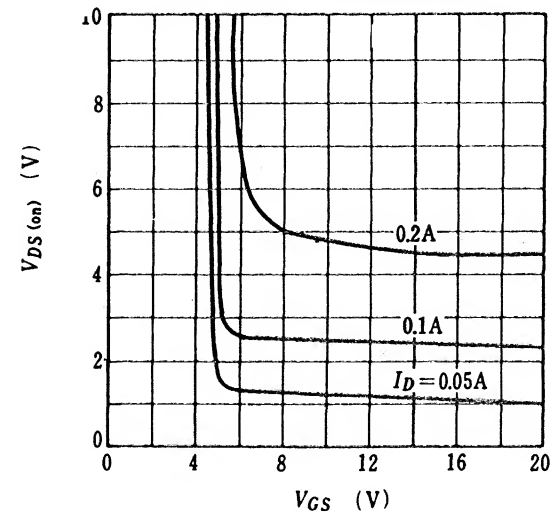
安全動作領域



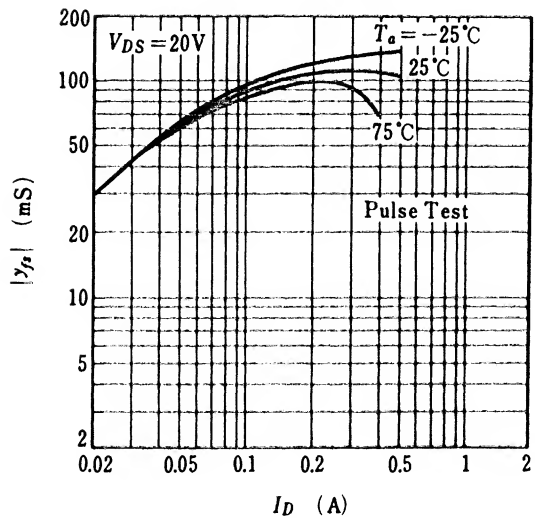
$I_D - V_{GS}$  特性



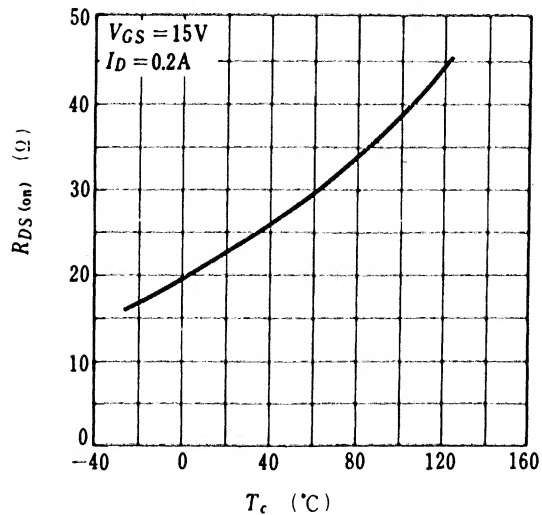
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



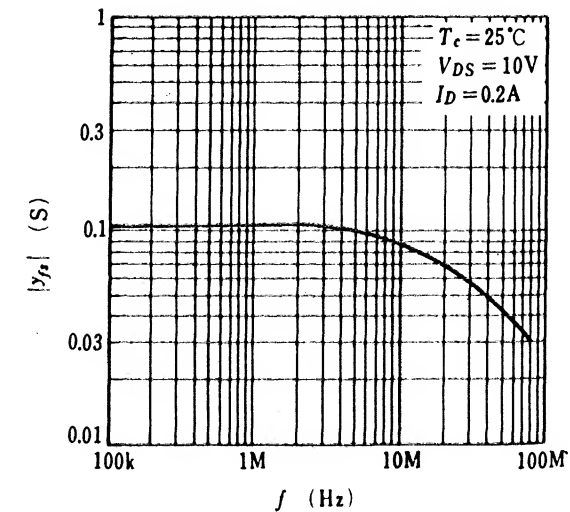
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$|y_{fs}| - f$  特性

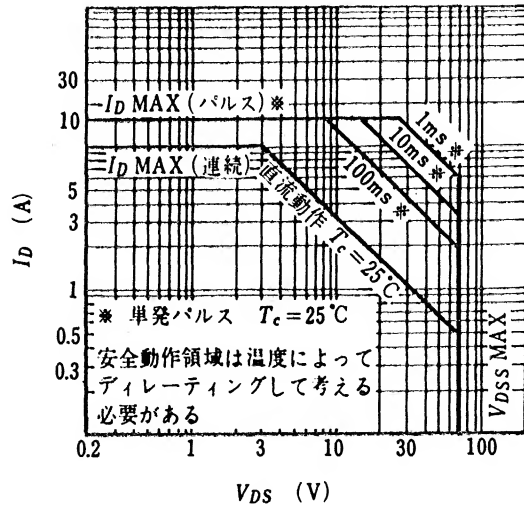


# 2SK442

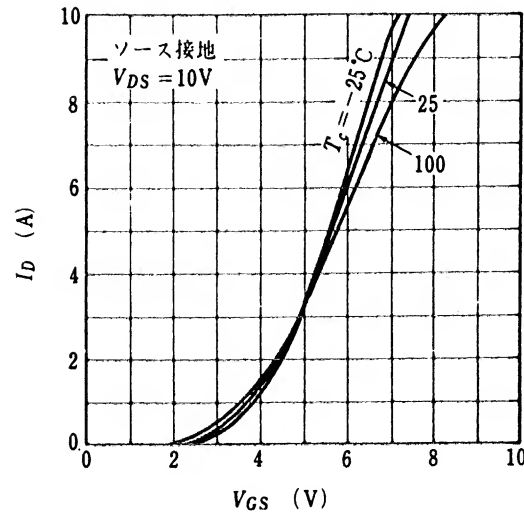
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

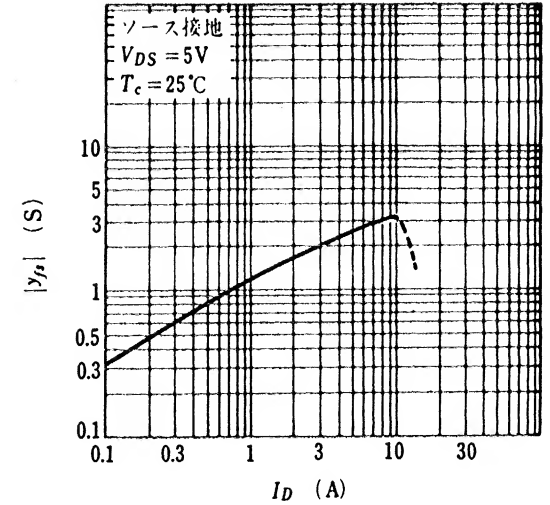
安全動作領域



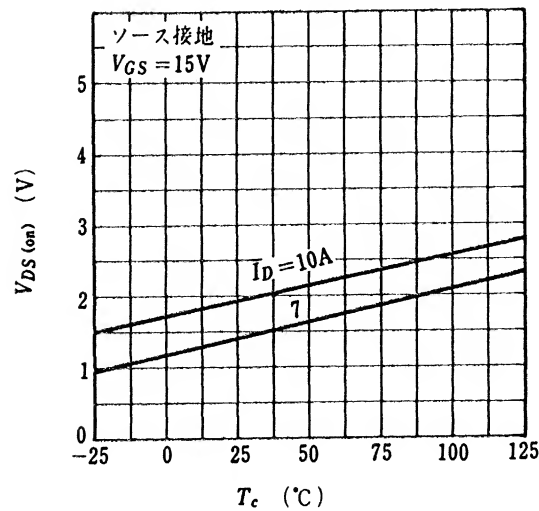
$I_D - V_{GS}$  特性



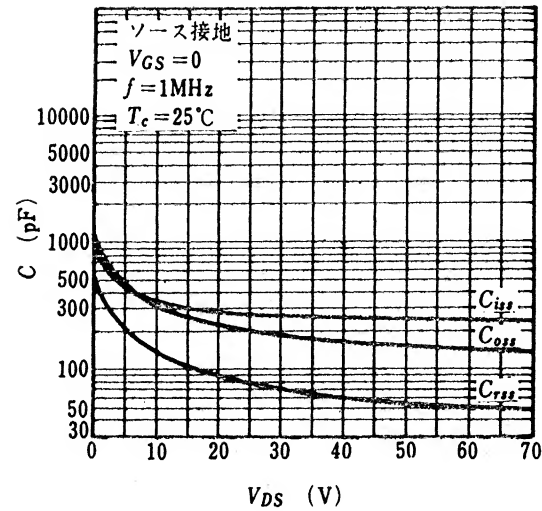
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



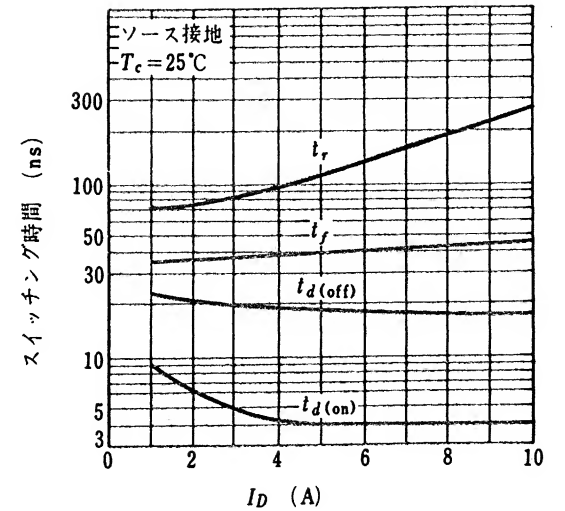
$V_{DS(on)} - T_c$  特性



静電容量 -  $V_{DS}$  特性



スイッチング特性



# 2SK443, 444, 445

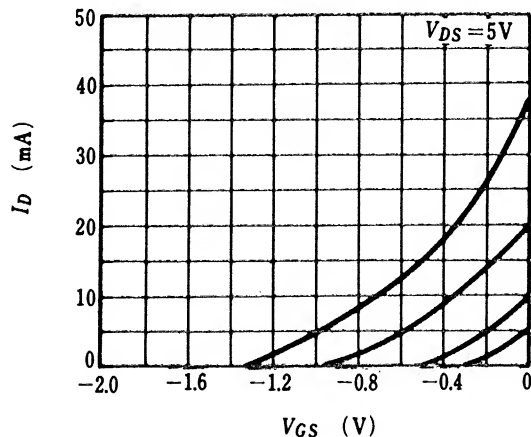
Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

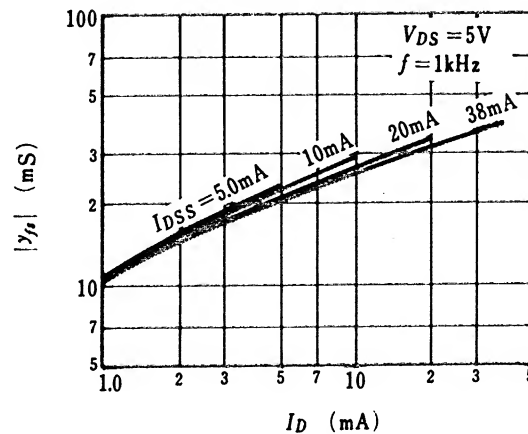
$V_{DS}=5V$  により次のように分類する。

5.0	AJ5	12.0	10.0	AJ6	24.0	16.0	AJ7	38.0
-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	------

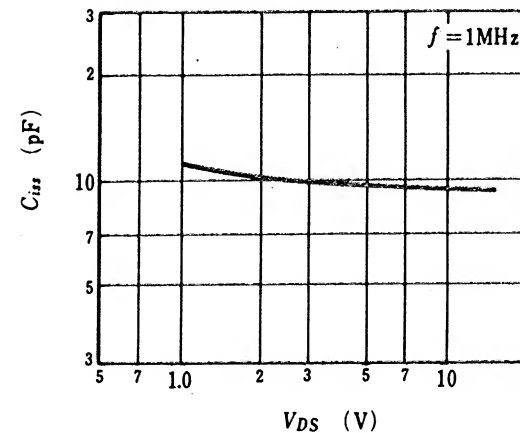
$I_D - V_{GS}$  特性



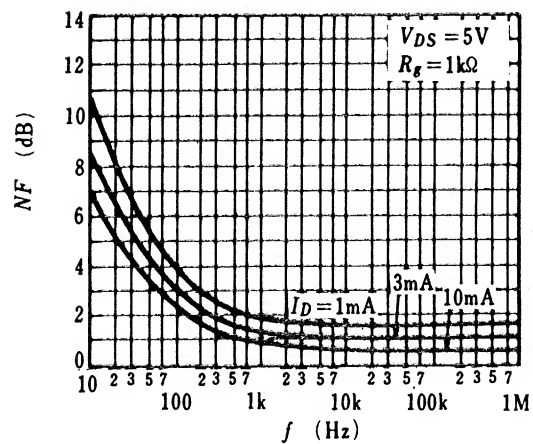
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



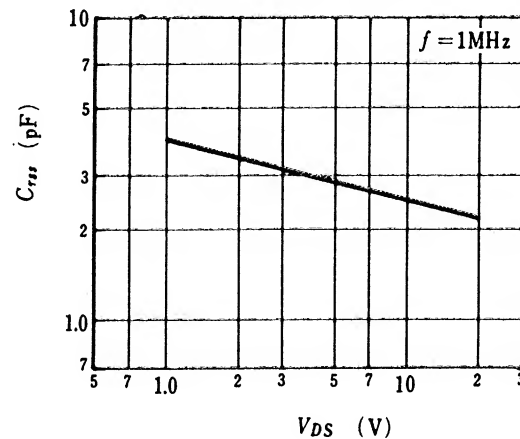
$C_{iss} - V_{DS}$  特性



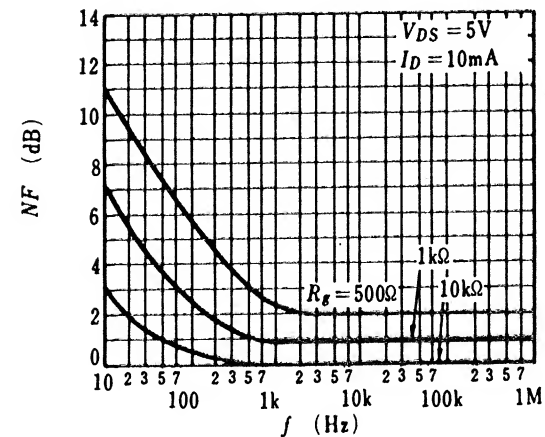
$NF - f$  特性



$C_{rss} - V_{DS}$  特性



$NF - f$  特性

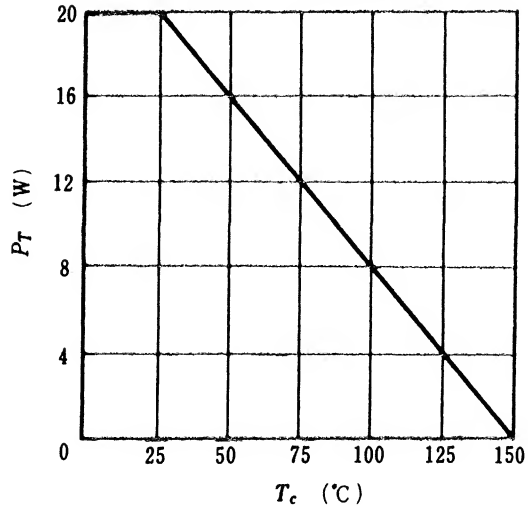


# 2SK446

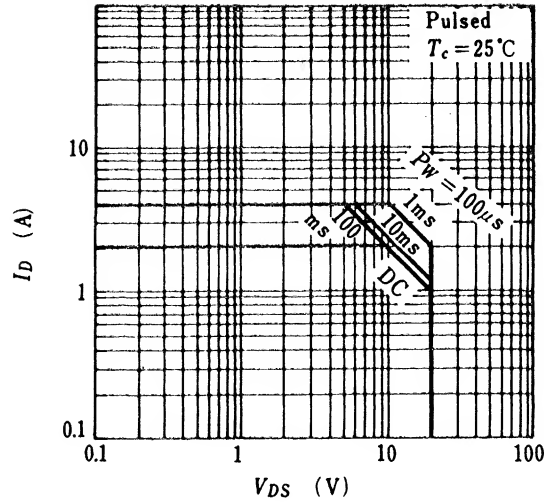
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 電

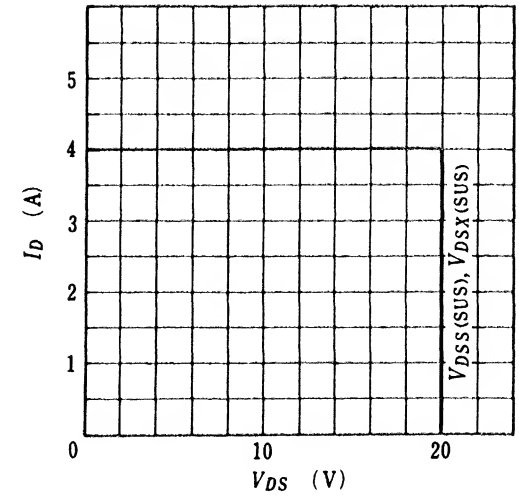
$P_T - T_c$  特性



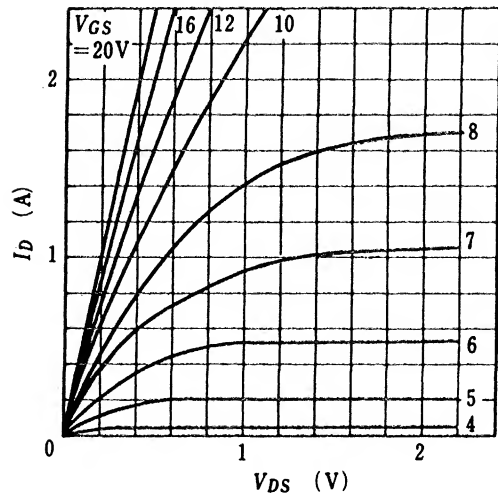
順方向バイアス安全動作領域



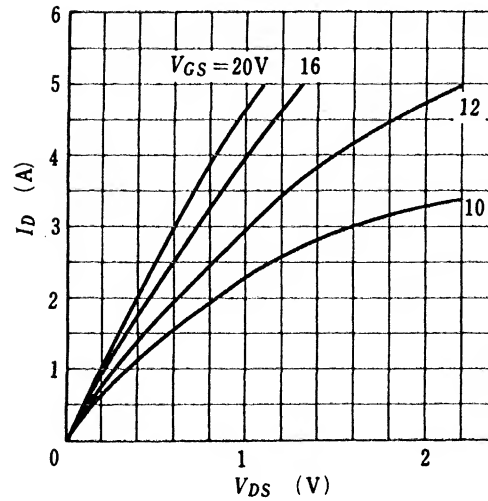
逆方向バイアス安全動作領域



$I_D - V_{DS}$  特性



$I_D - V_{DS}$  特性

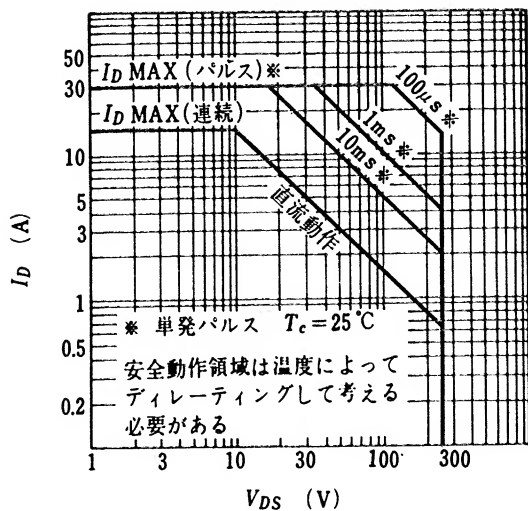


# 2SK447

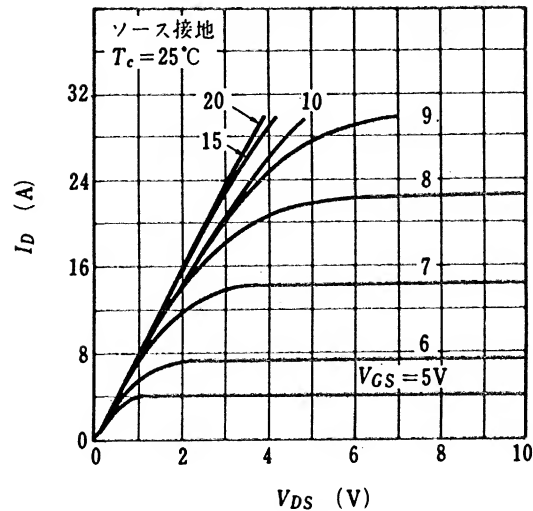
## Si MOS型 Nチャンネル

東 芝

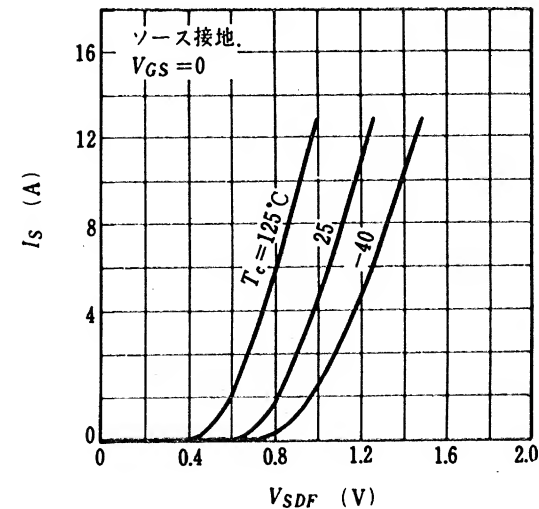
安全動作領域



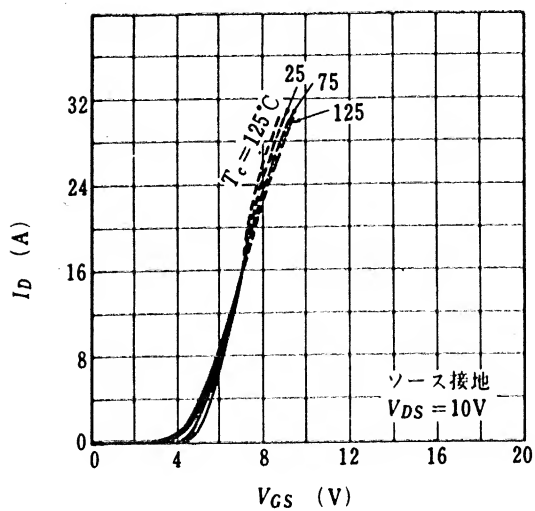
$I_D - V_{DS}$  特性



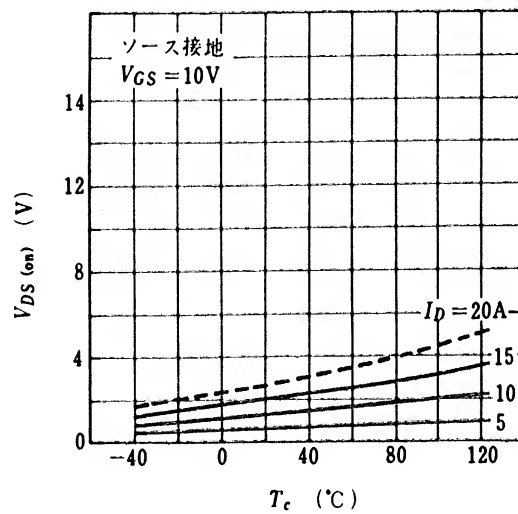
$I_S - V_{SDF}$  特性



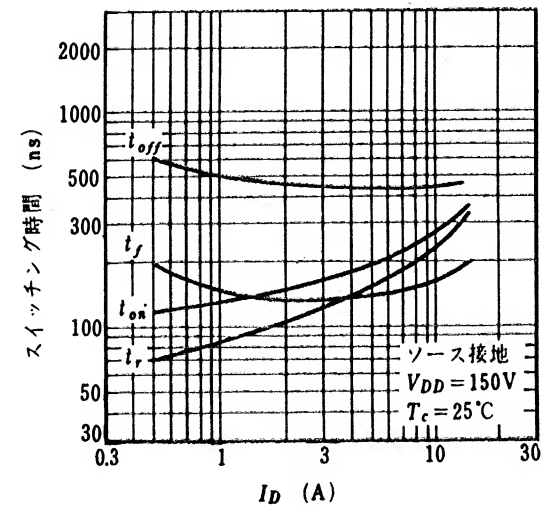
$I_D - V_{GS}$  特性



$V_{DS(on)} - T_c$  特性



スイッチング特性

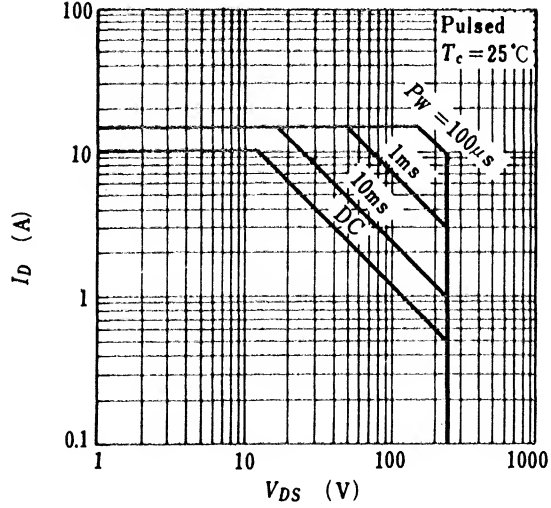


# 2SK448

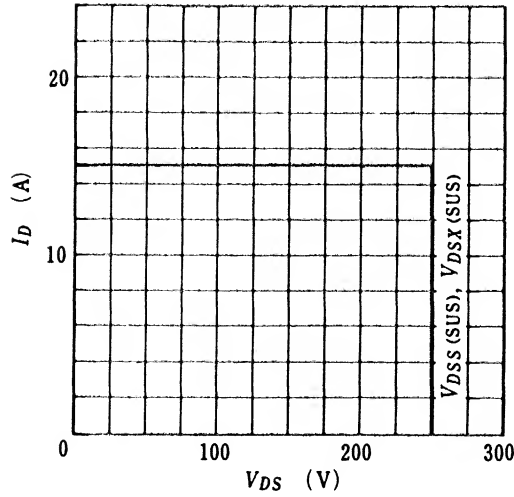
## Si MOS型 Nチャンネル

日 電

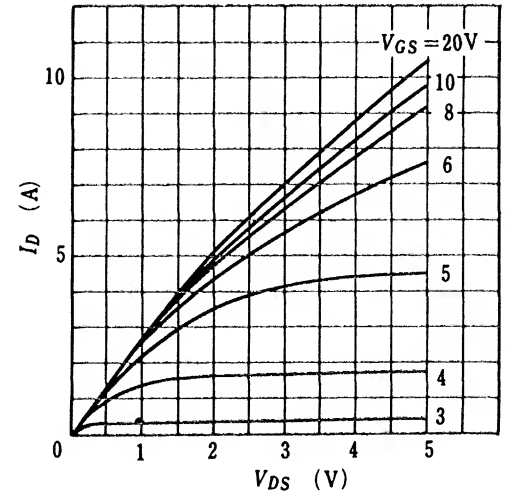
順方向バイアス安全動作領域



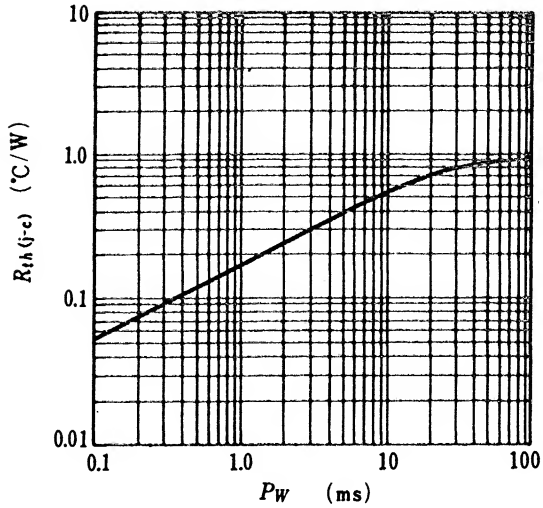
逆方向バイアス安全動作領域



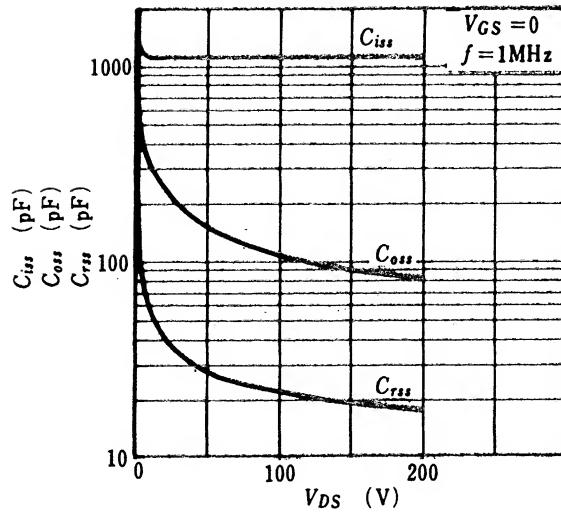
Id - Vds 特性



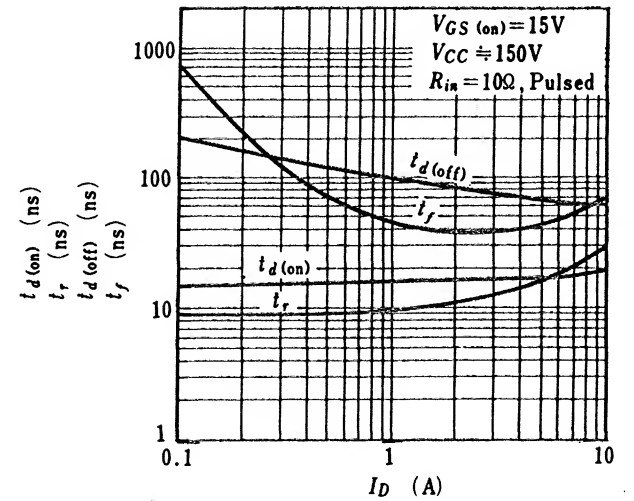
Rth(j-c) - Pw 特性



Ciss, Coss, Crss - Vds 特性



スイッチング特性

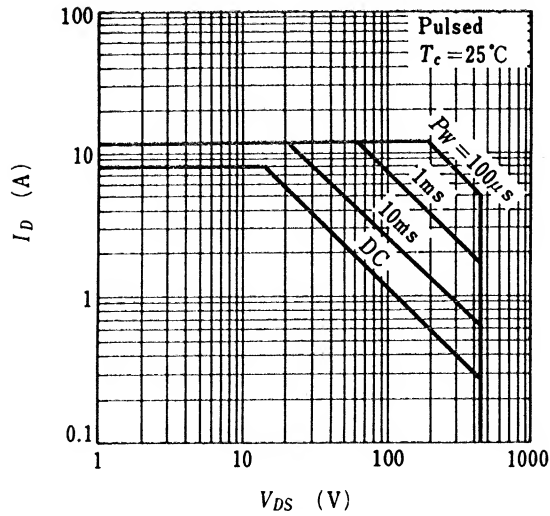


# 2SK449

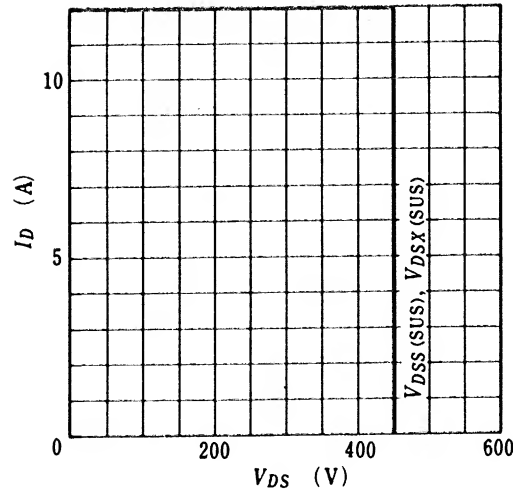
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 電

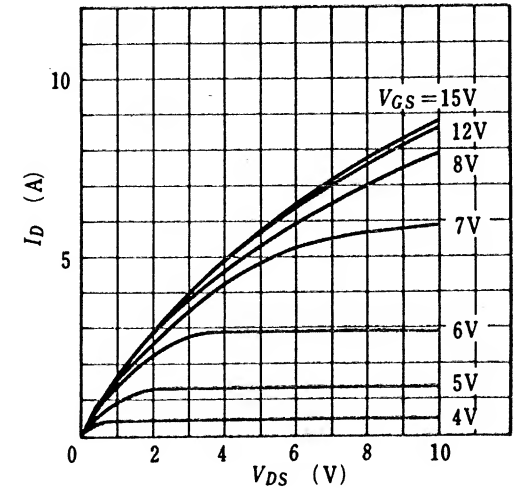
順方向バイアス安全動作領域



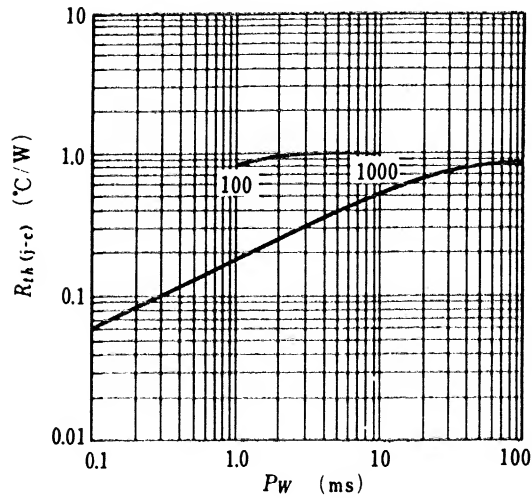
逆方向バイアス安全動作領域



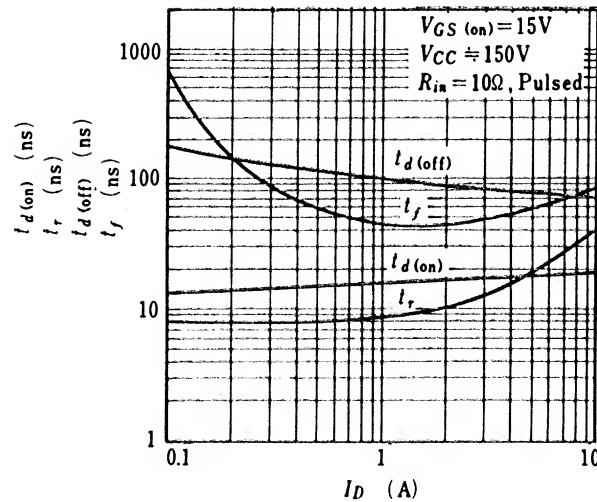
$I_D - V_{DS}$  特性



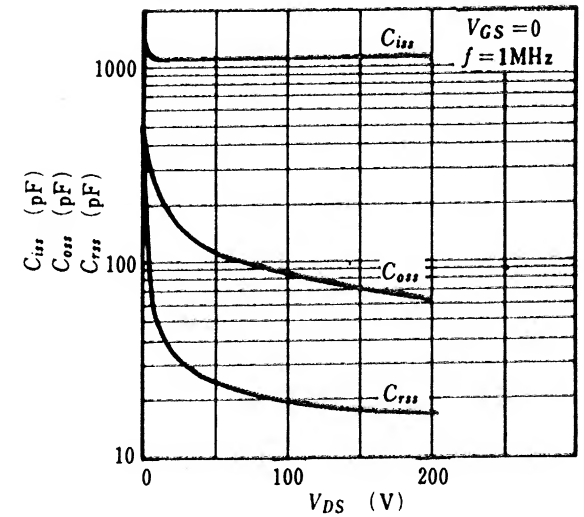
$R_{th(j-c)} - P_W$  特性



スイッチング特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性





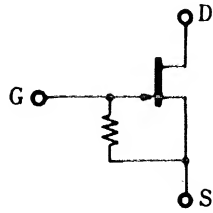
# 2SK455, 456

Si 接合型  
Nチャンネル

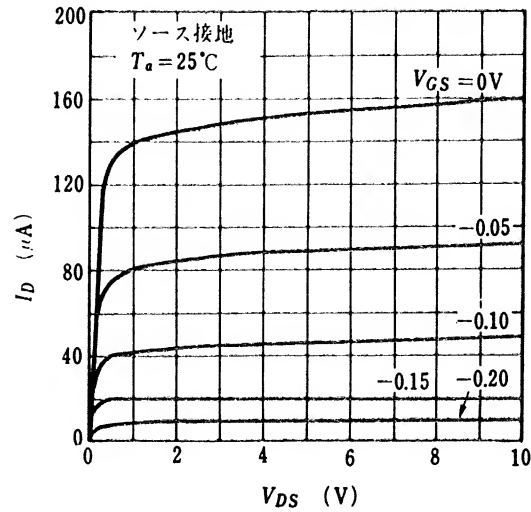
東 芝

$I_{DSS}$  分類 R: 60~120 O: 100~200 Y: 150~300 G: 250~500 $\mu$ A

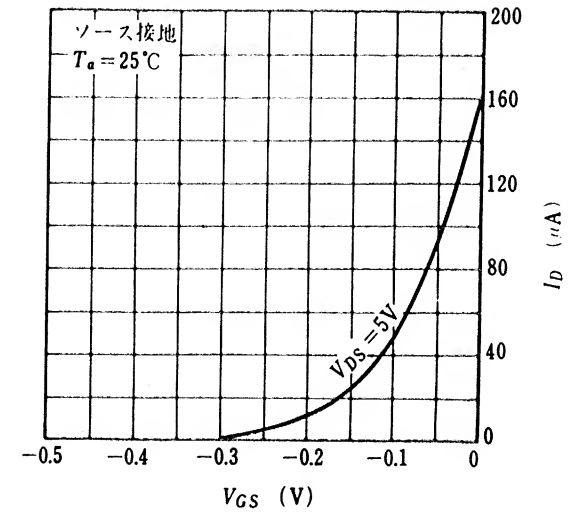
等価回路



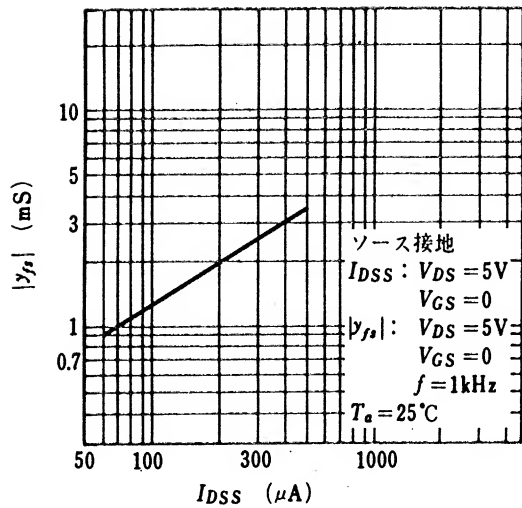
$I_D - V_{DS}$  特性



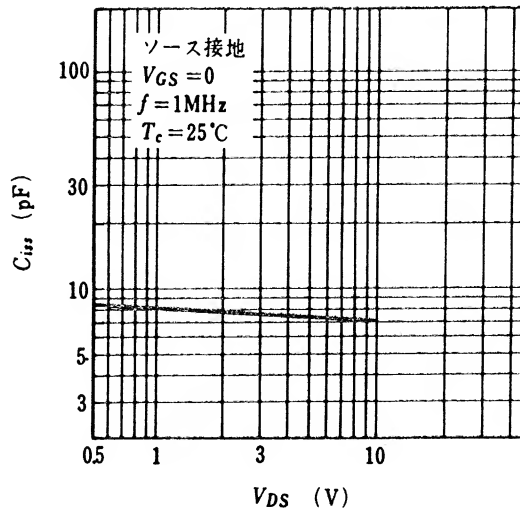
$I_D - V_{GS}$  特性



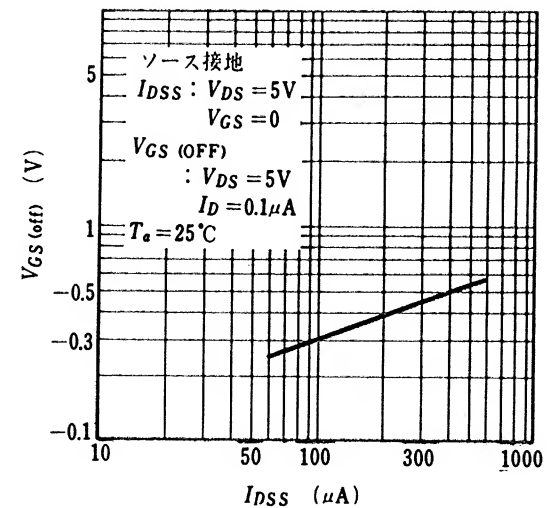
$|Y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$C_{iss} - V_{DS}$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性

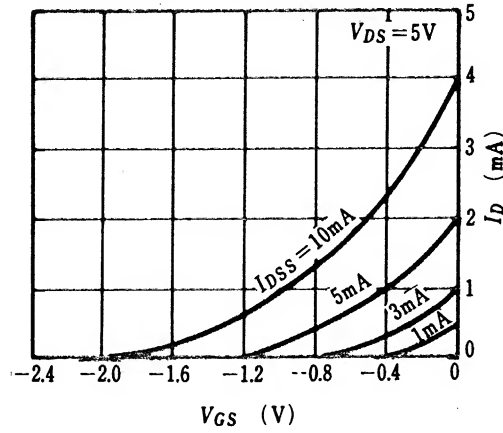


# 2SK493

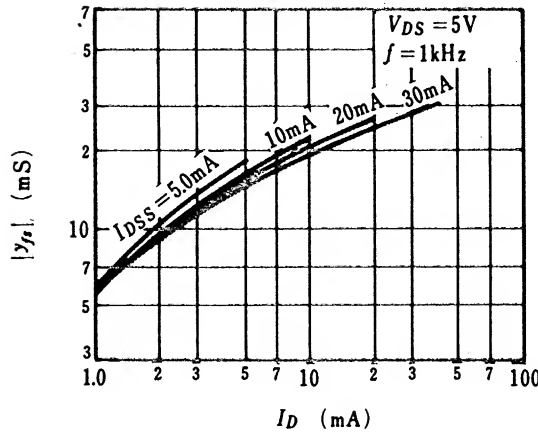
Si 接合型  
Nチャンネル

三 洋

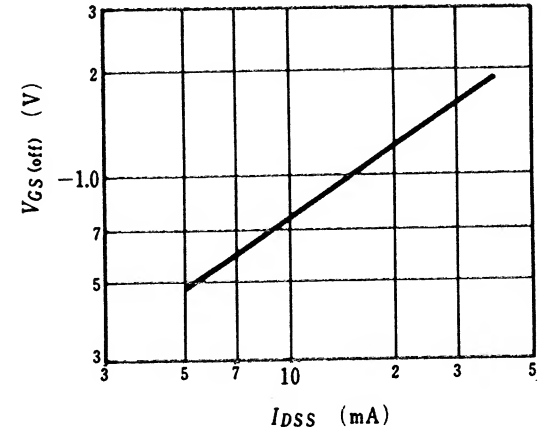
$I_D - V_{GS}$  特性



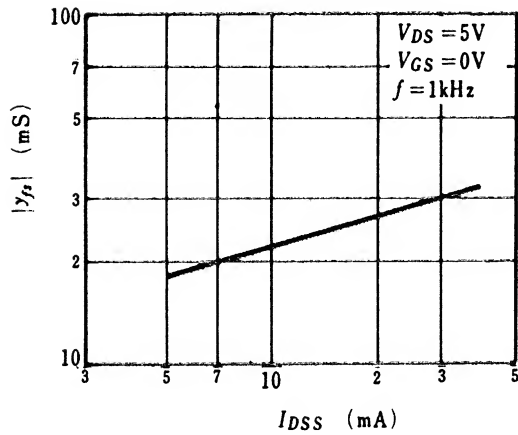
$|y_{fs}| - I_D$  特性



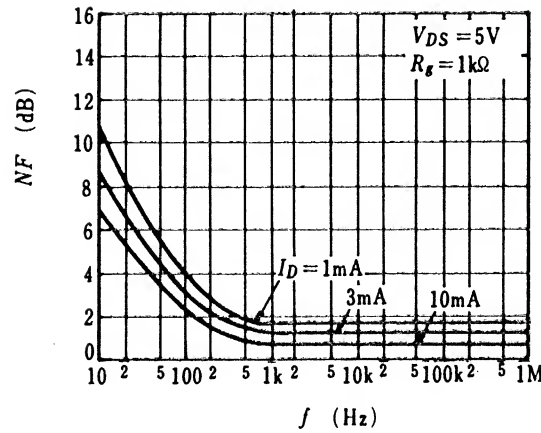
$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



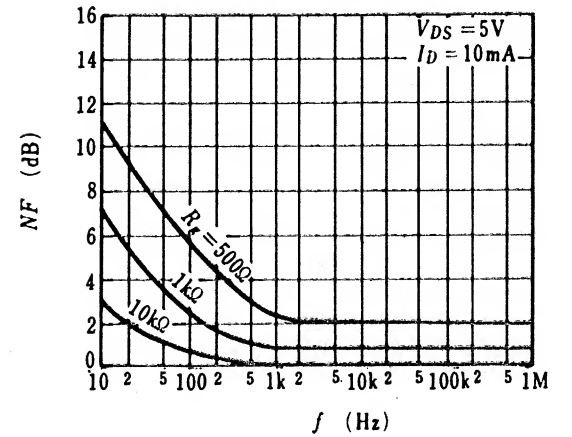
$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



NF - f 特性



NF - f 特性



# 2SK505, 507, 508

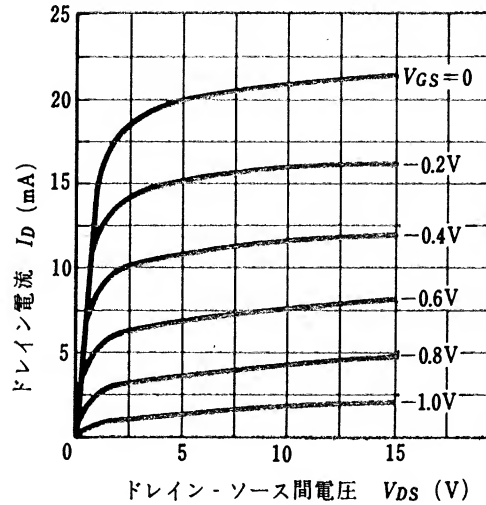
Si 接合型  
Nチャンネル

日 電

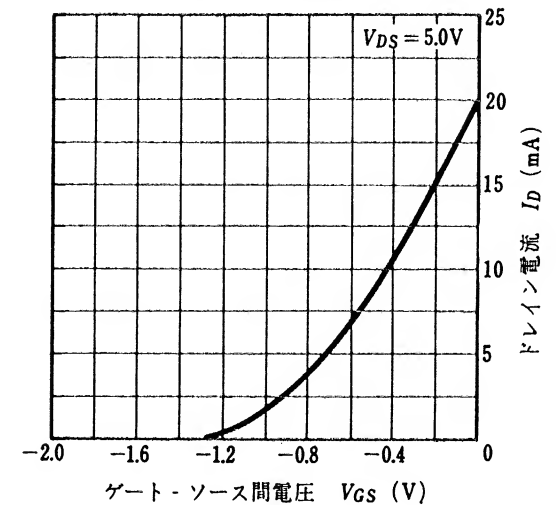
$I_{DSS}$  区分

	10~20	15~30	25~50
2SK505, 507	E	F	H
2SK 508	K51	K52	K53

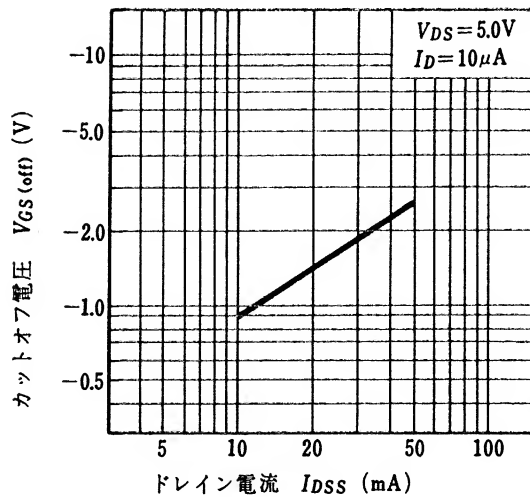
$I_D - V_{DS}$  特性



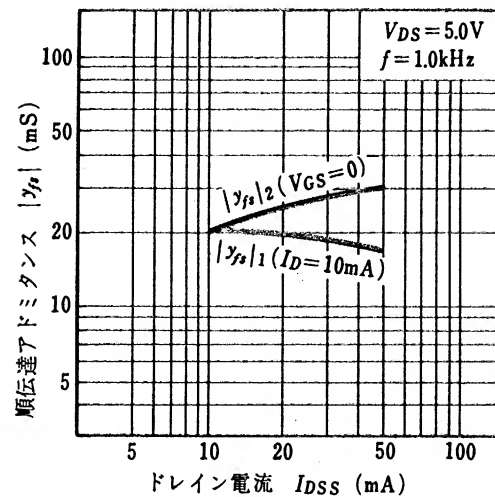
$I_D - V_{GS}$  特性



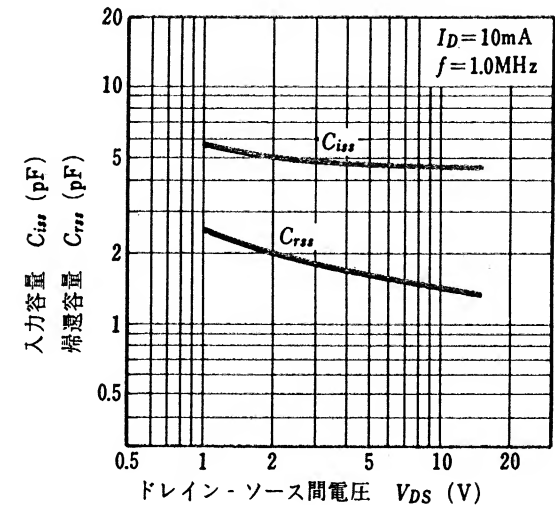
$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$C - V_{DS}$  特性

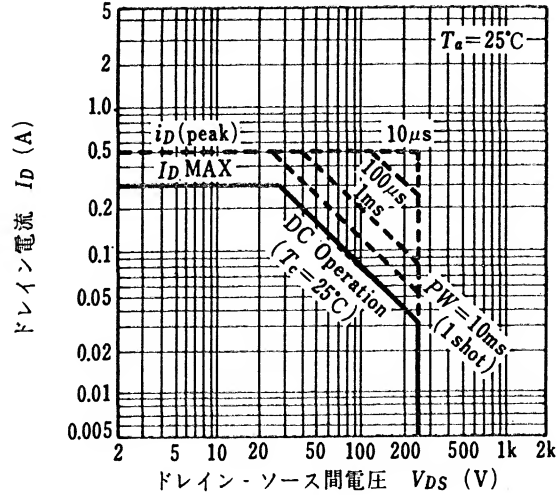


# 2SK511

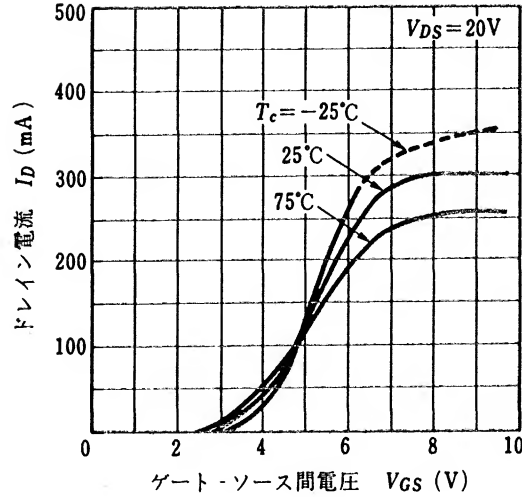
## Si MOS 型 Nチャンネル

日 立

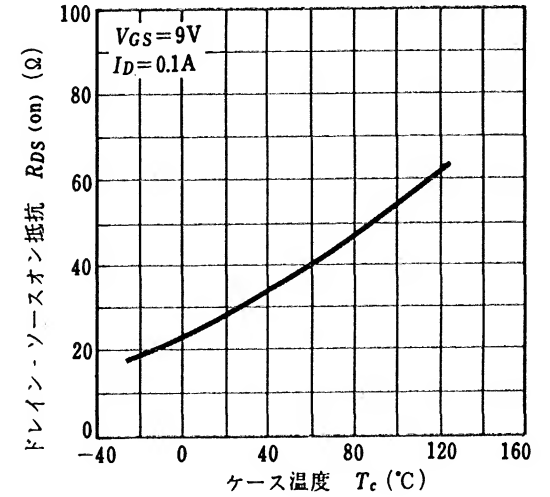
安全動作領域



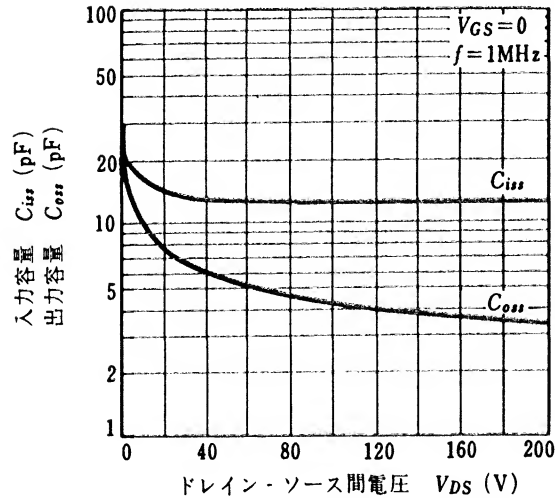
ソース接地伝達特性



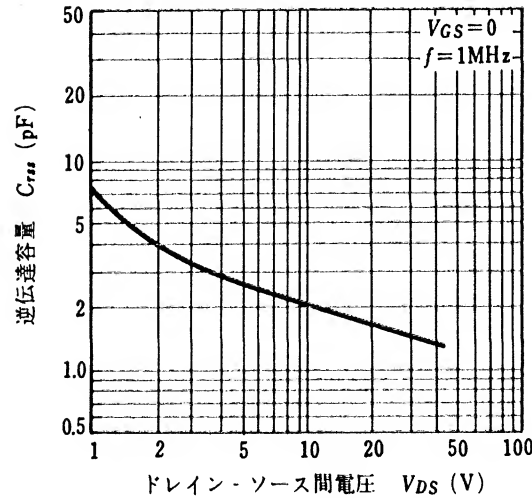
ドレイン-ソースオン抵抗  
対ケース温度特性



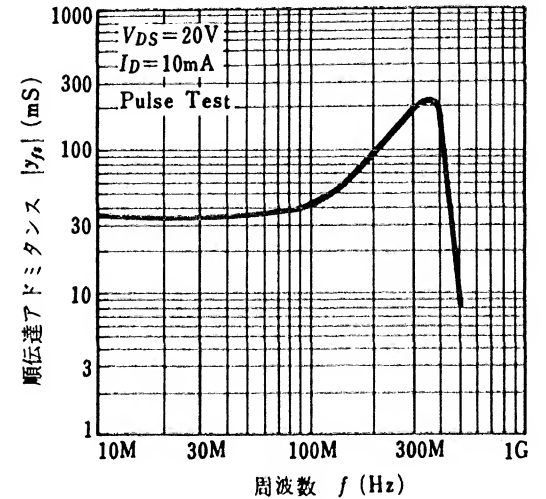
入力, 出力容量対  
ドレイン-ソース間電圧特性



逆伝達容量対  
ドレイン-ゲート電圧特性



順伝達アドミタンス対周波数特性



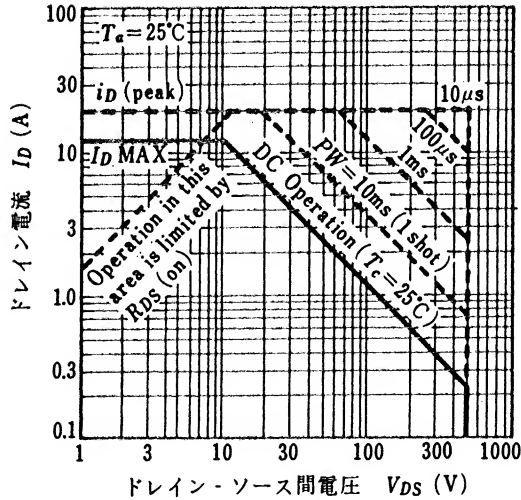


# 2SK512

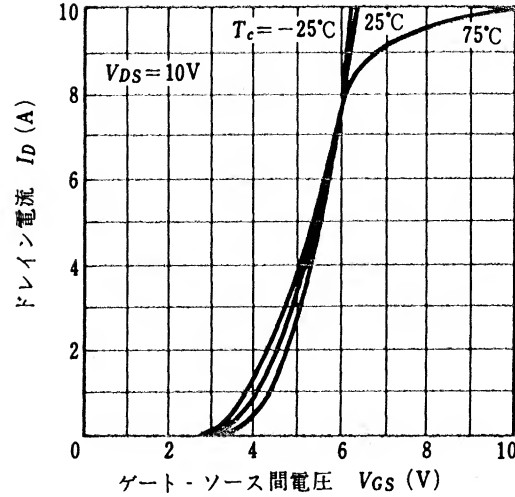
## Si MOS 型 Nチャンネル

日立

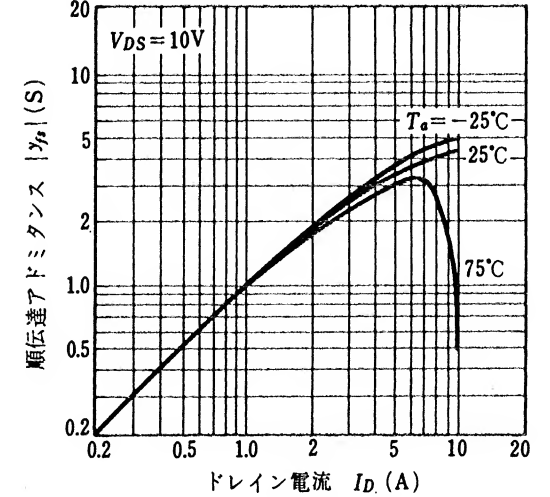
### 安全動作領域



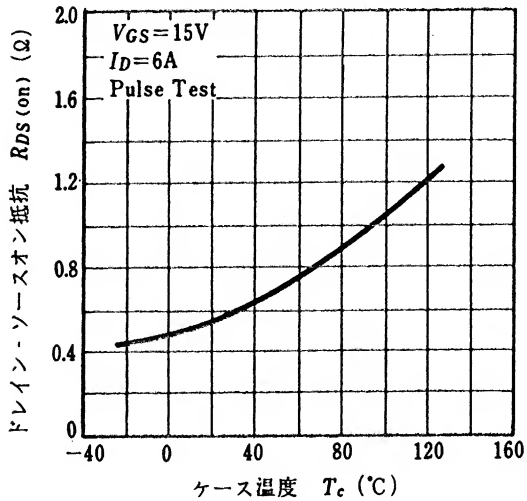
### ソース接地伝達静特性



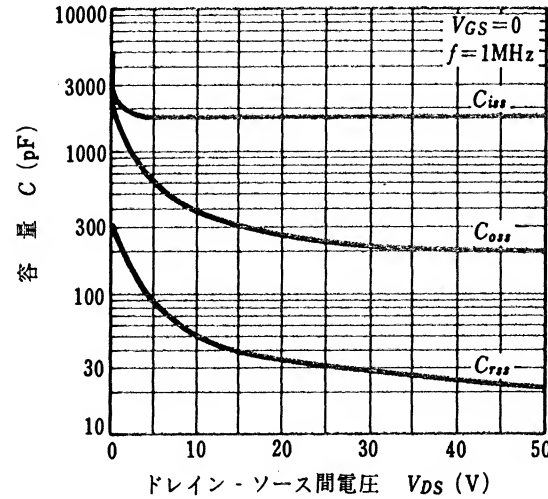
### 順伝達アドミタンス対 ドレイン電流特性



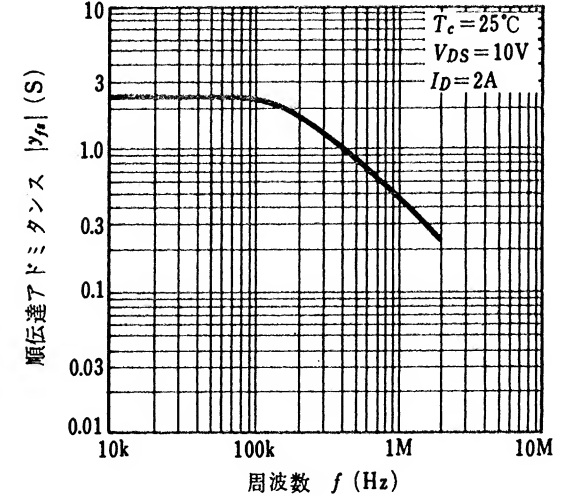
### ドレイン-ソースオン抵抗対 ケース温度特性



### 容量対ドレイン-ソース間電圧特性



### 順伝達アドミタンス対周波数特性

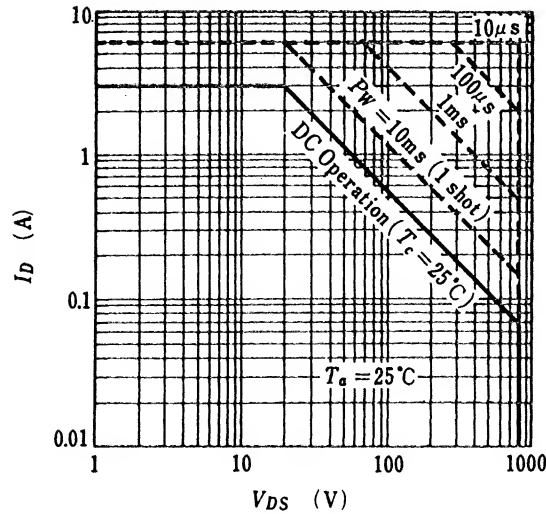


# 2SK513

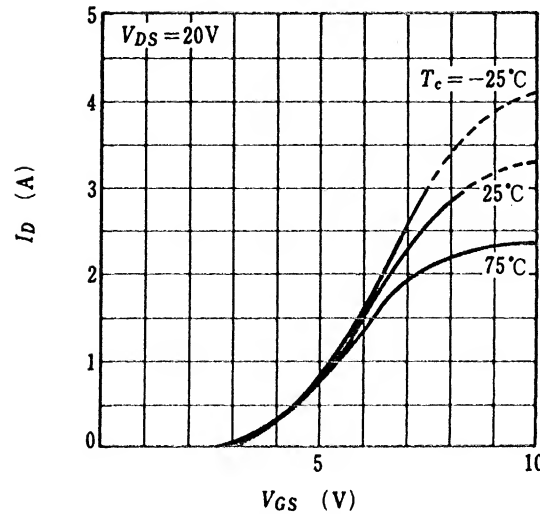
## Si MOS 型 N チャンネル

日 立

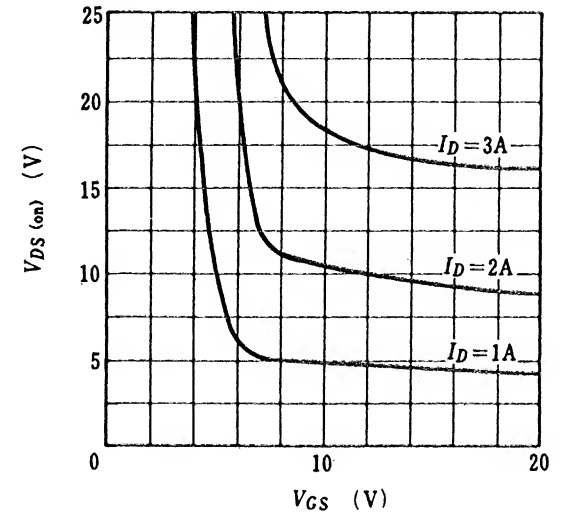
安全動作領域



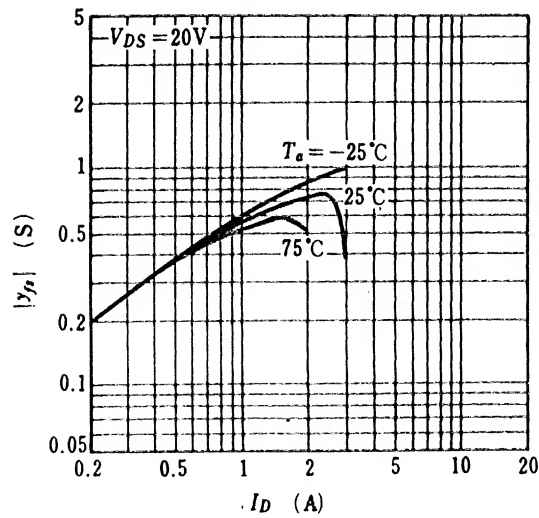
$I_D - V_{GS}$  特性



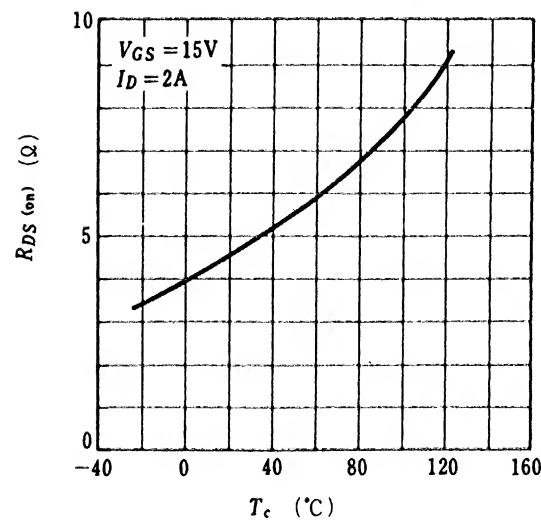
$V_{DS(on)} - V_{GS}$  特性



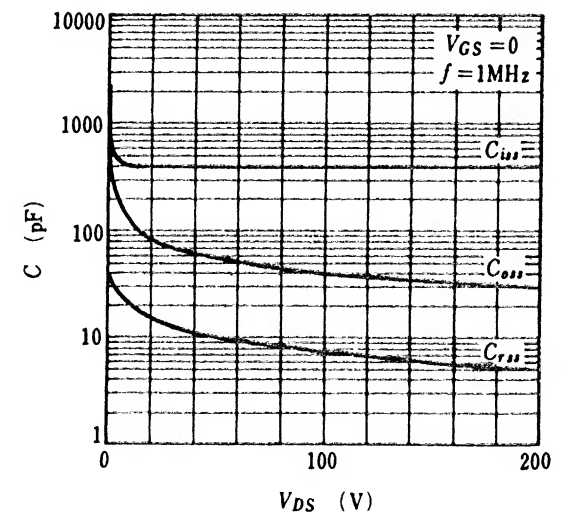
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



$C_{iss}, C_{oss}, C_{rss} - V_{DS}$  特性



# 2SK518, 519, 520

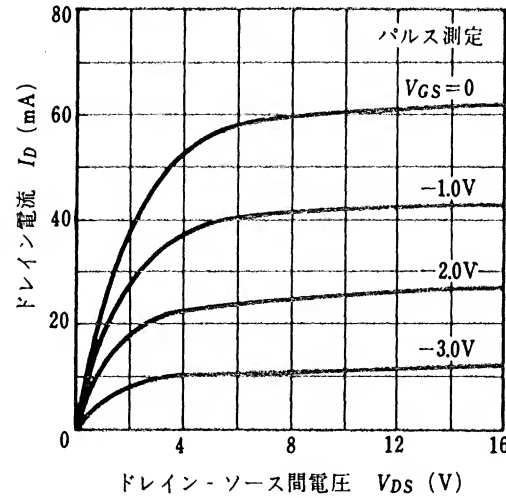
Si 接合型  
Nチャンネル

日 電

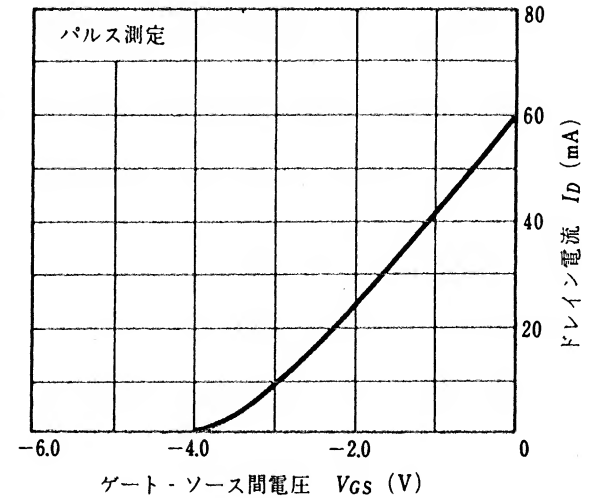
$I_{DSS}$  区分

	30~50	45~65	60~80	75~95	90~110
2SK518, 519	E	F	H	J	K
2SK520	K41	K42	K43	K44	K45

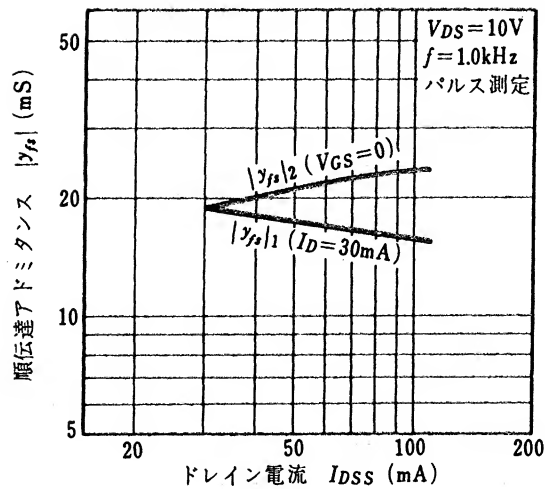
$I_D - V_{DS}$  特性



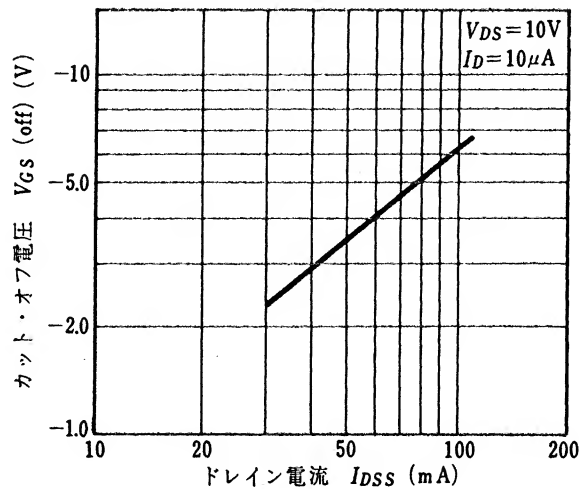
$I_D - V_{GS}$  特性



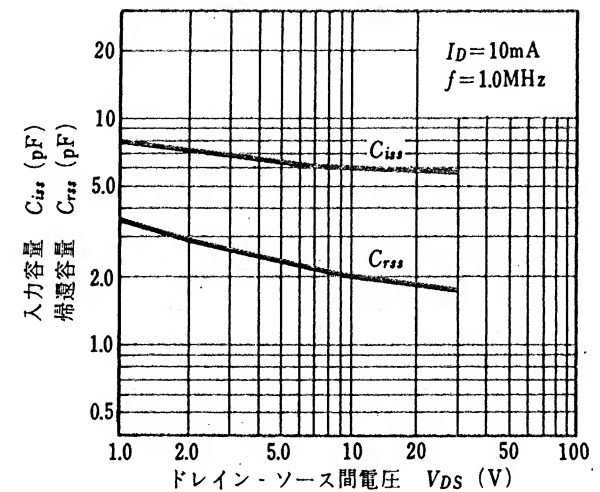
$|y_{fs}| - I_{DSS}$  特性



$V_{GS(off)} - I_{DSS}$  特性



$C - V_{DS}$  特性

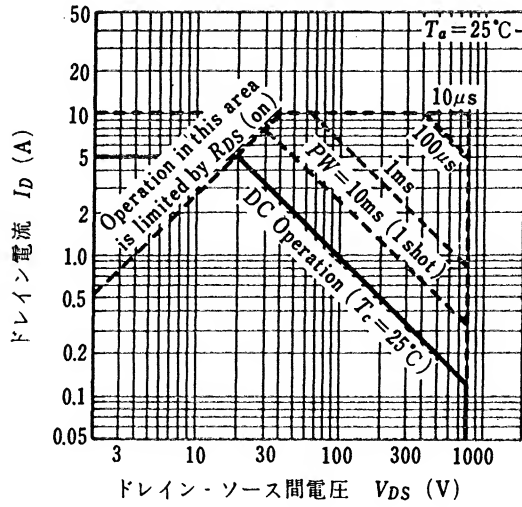


# 2SK534

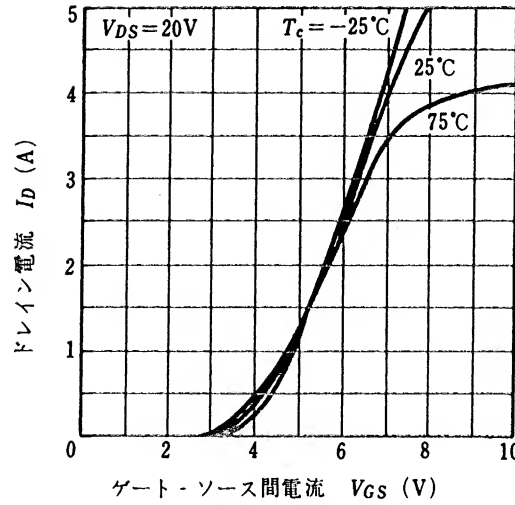
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

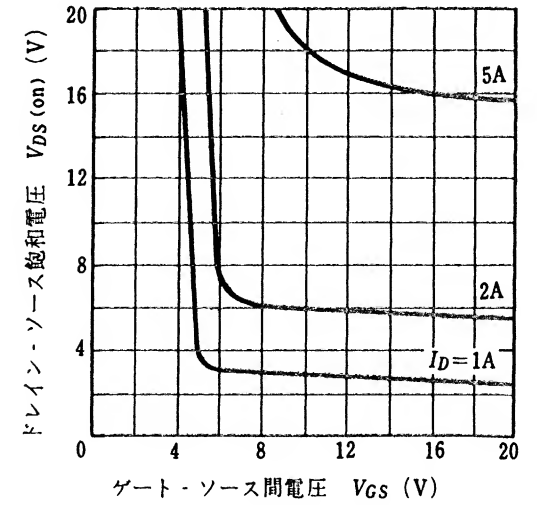
安全動作領域



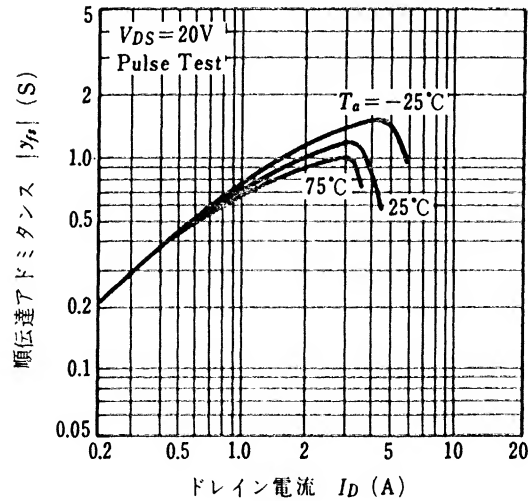
ソース接地伝達静特性



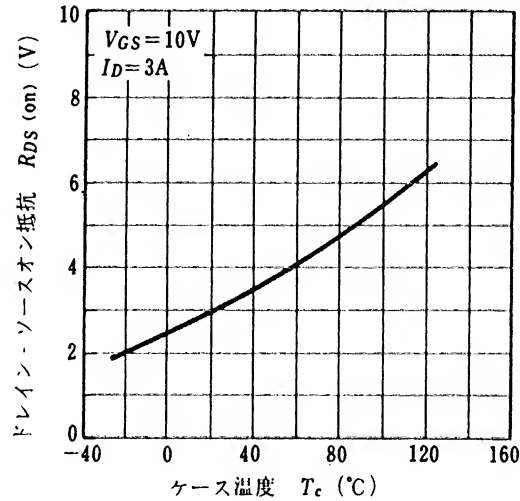
ドレイン-ソース飽和電圧対  
ゲート-ソース間電圧特性



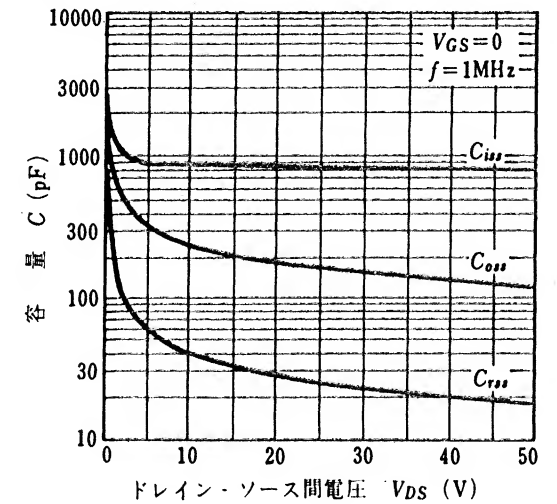
順伝達アドミタンス対  
ドレイン電流特性



ドレイン-ソースオン抵抗対  
ケース温度特性



容量対ドレイン-ソース間電圧特性



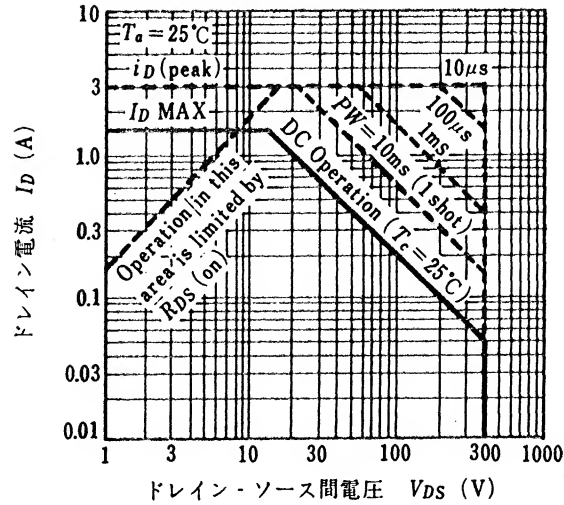


# 2SK535

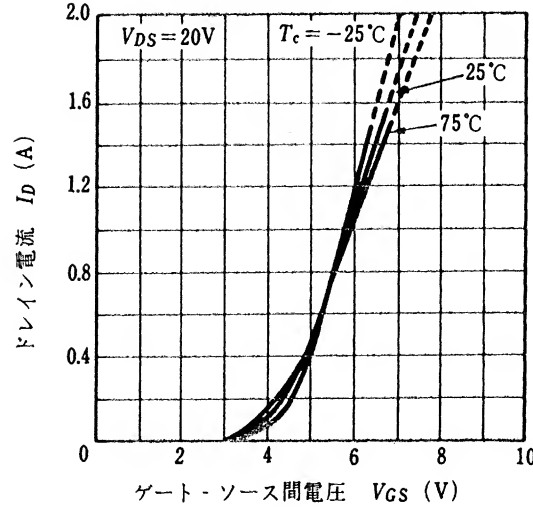
## Si MOS型 Nチャンネル

日立

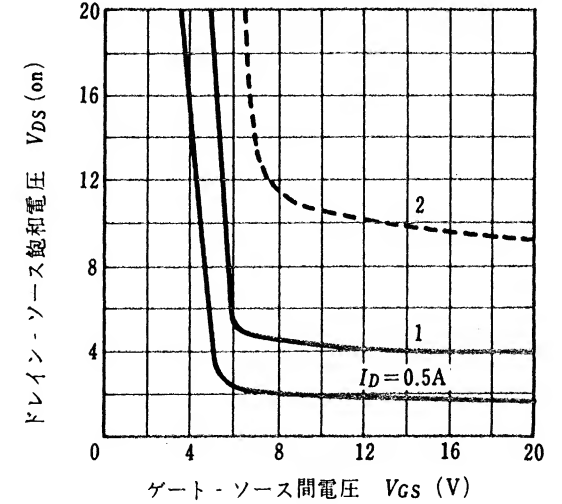
### 安全動作領域



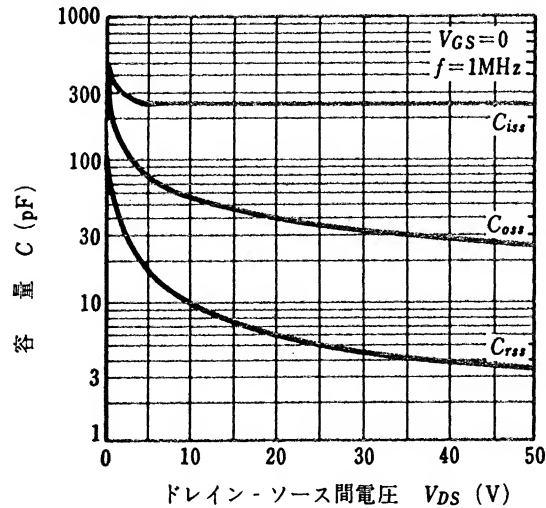
### ソース接地伝達静特性



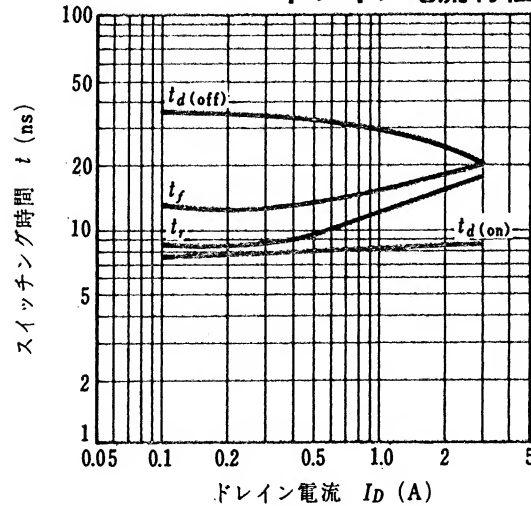
### ドレイン-ソース飽和電圧対 ゲート-ソース間電圧特性



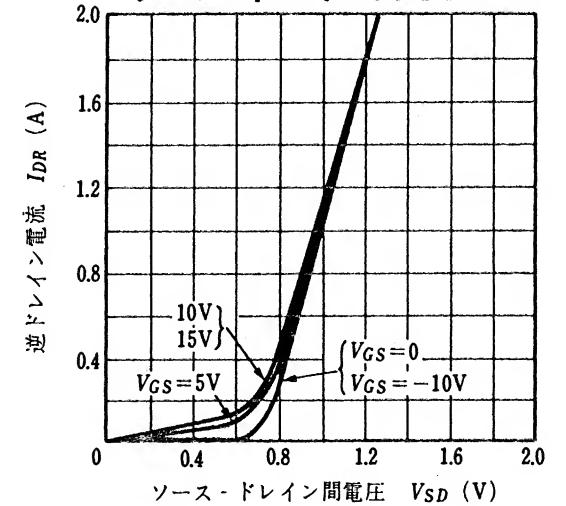
### 容量対ドレイン-ソース間電圧特性



### スイッチング時間対 ドレイン電流特性



### 逆ドレイン電流対 ソース-ドレイン間電圧特性



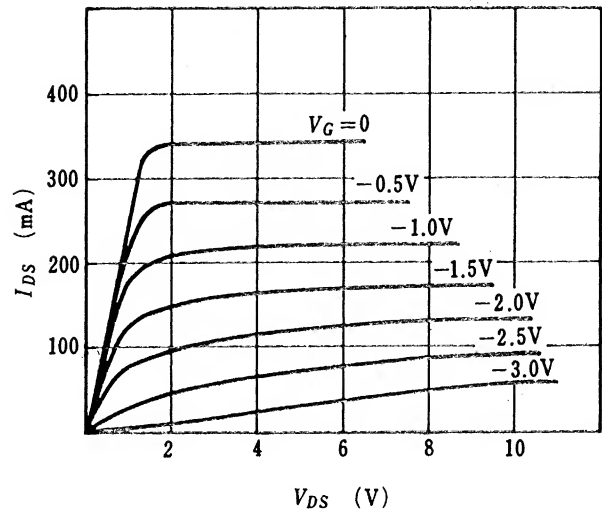


FLC08ME, 15ME, 30ME

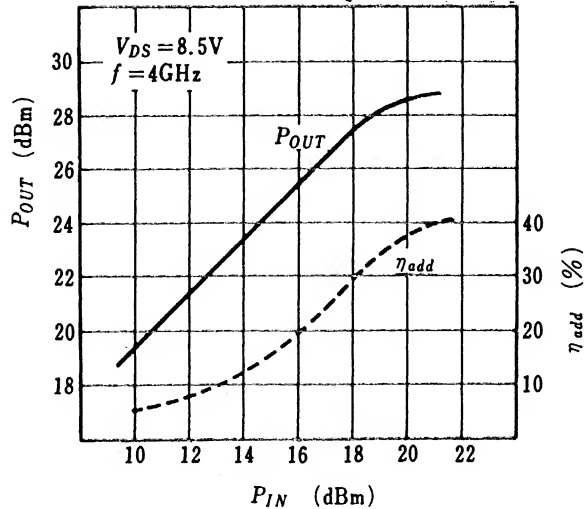
GaAs 型  
Nチャンネル

富士通

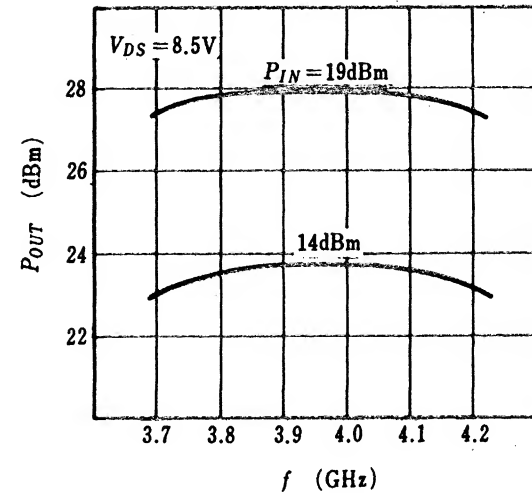
$I_{DS} - V_{DS}$  特性  
(FLC08ME)



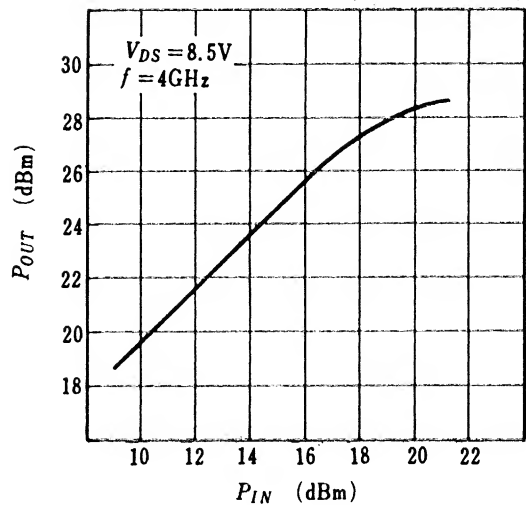
$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC08ME)



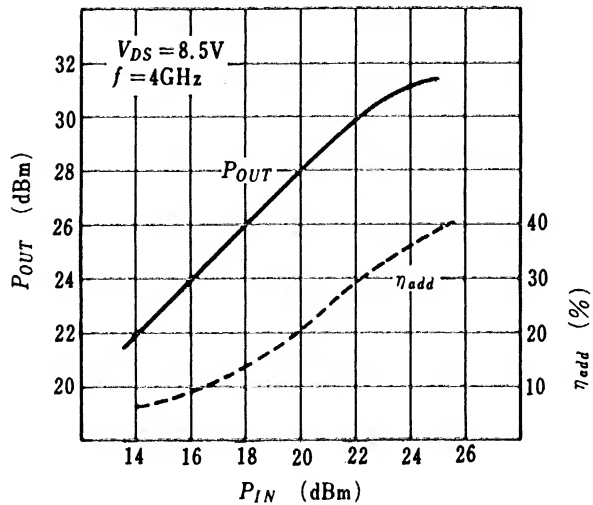
$P_{OUT} - f$  特性  
(FLC08ME)



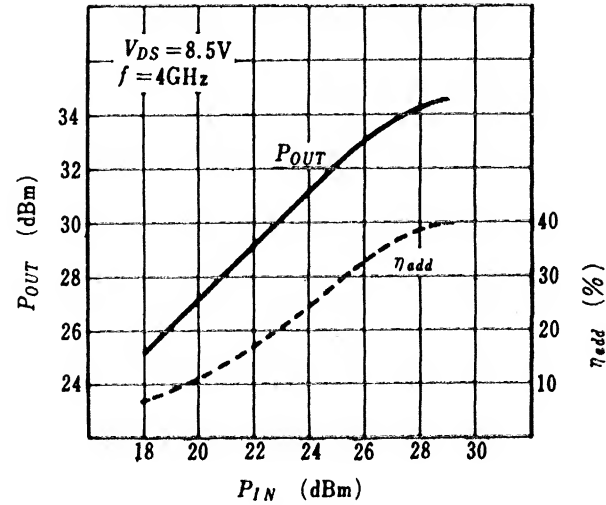
$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC08ME)



$P_{out} - P_{IN}$  特性  
(FLS 15ME)



$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC30ME)



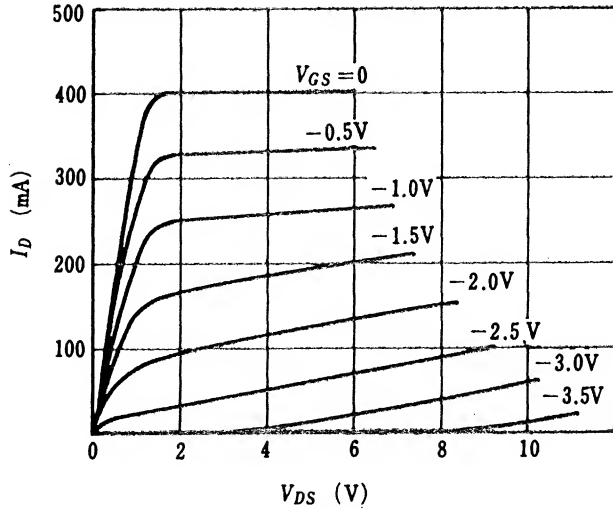


FLC081WF, 151WF, 301MG

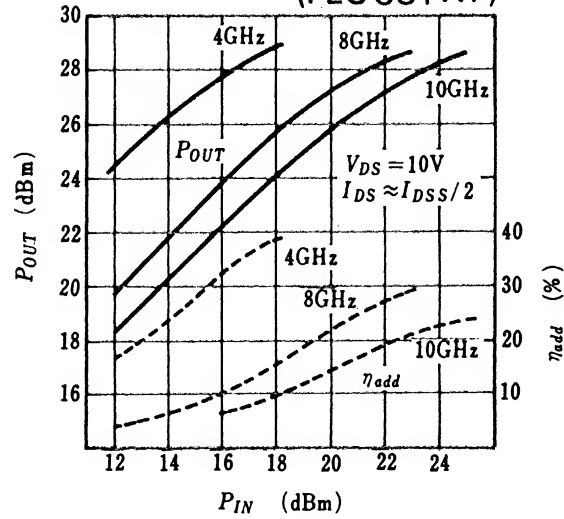
GaAs型  
Nチャンネル

富士通

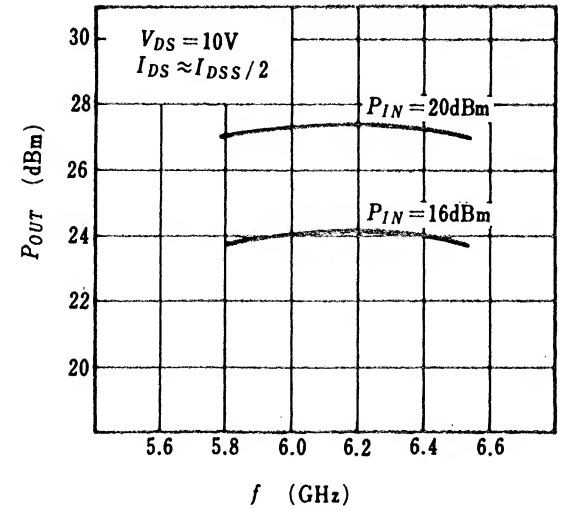
$I_D - V_{DS}$  特性  
(FLC081WF)



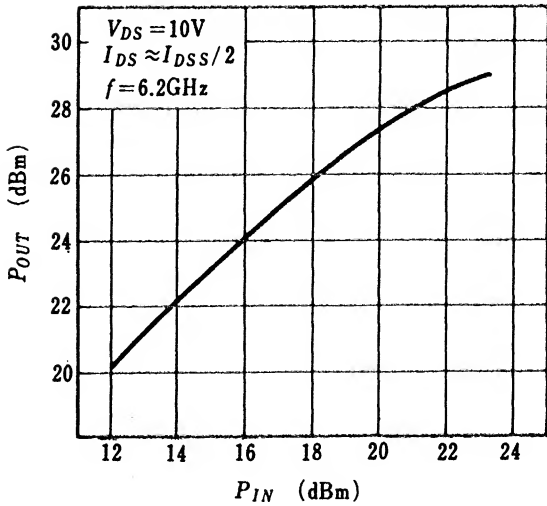
$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC081WF)



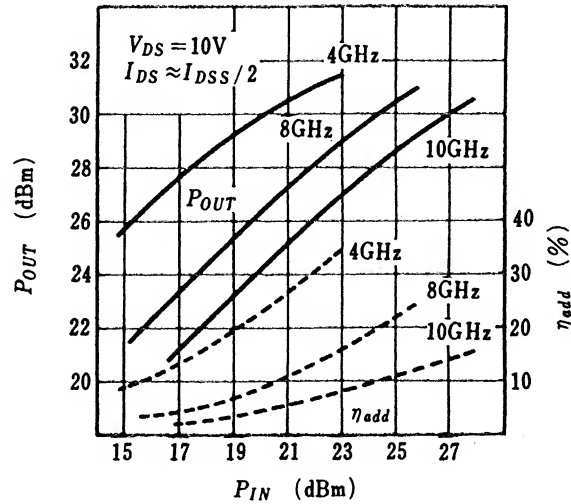
$P_{OUT} - f$  特性  
(FLC081WF)



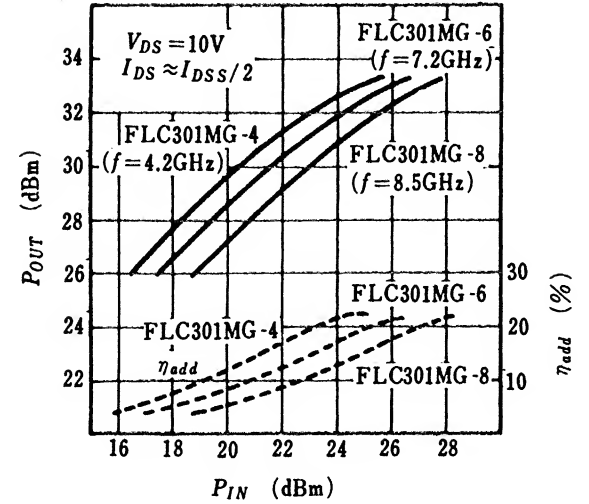
$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC081WF)



$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC151WF)



$P_{OUT} - P_{IN}$  特性  
(FLC301MG)

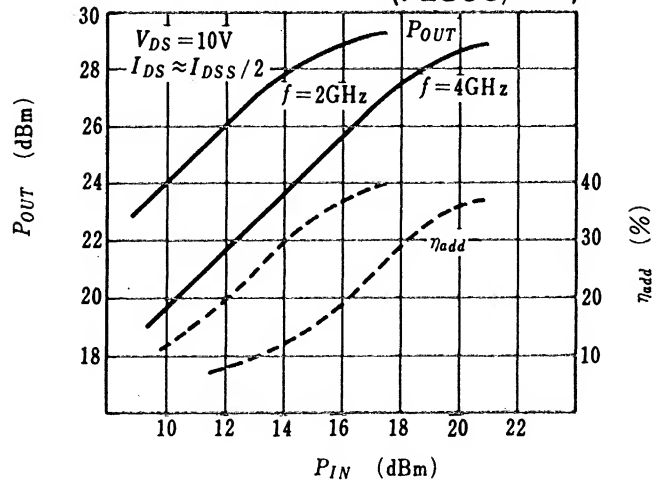


FLS09/ME, 16/ME, 31/ME, 50/ME

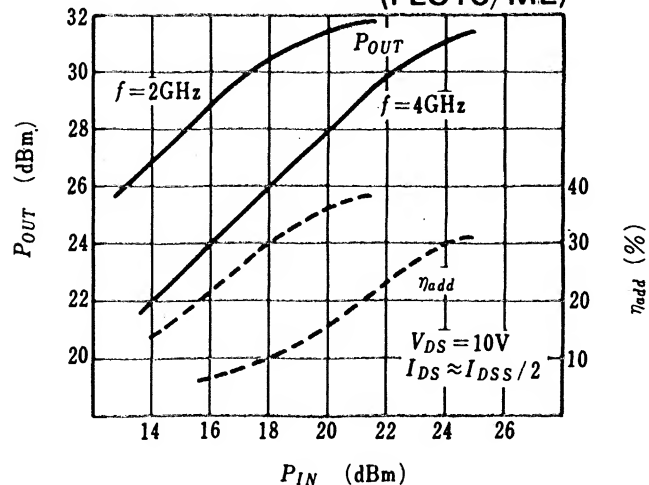
GaAs型  
Nチャンネル

富士通

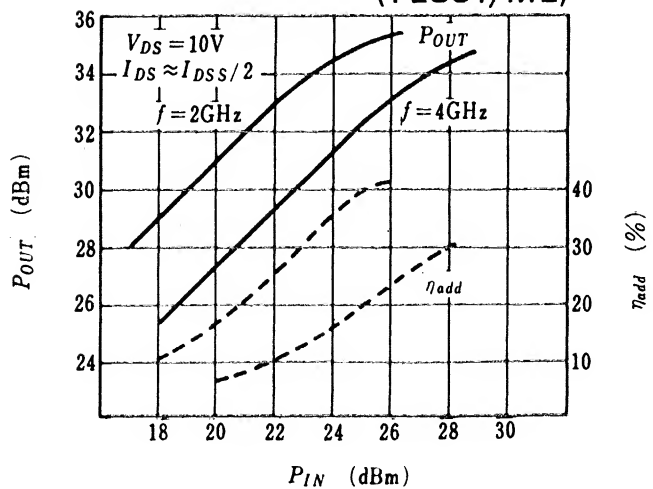
POUT - PIN 特性  
(FLS09/ME)



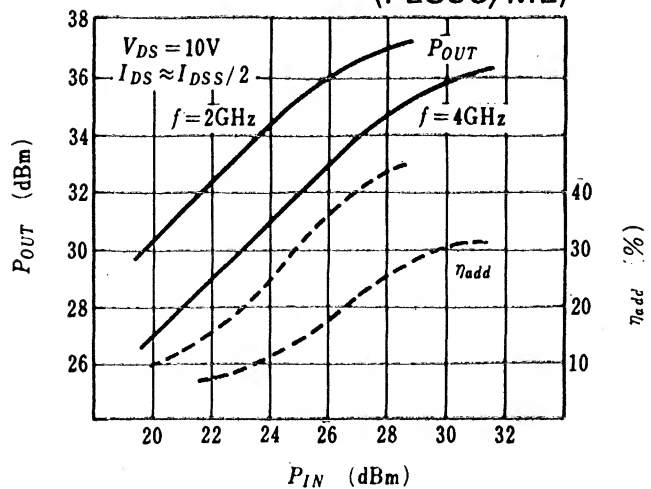
POUT - PIN 特性  
(FLS16/ME)



POUT - PIN 特性  
(FLS31/ME)



POUT - PIN 特性  
(FLS50/ME)



# M47F

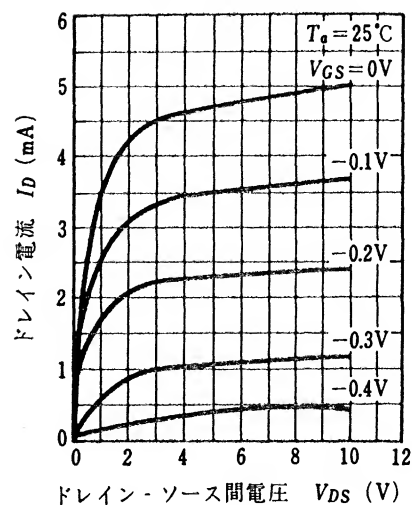
## Si 接合型 Nチャンネル

松下

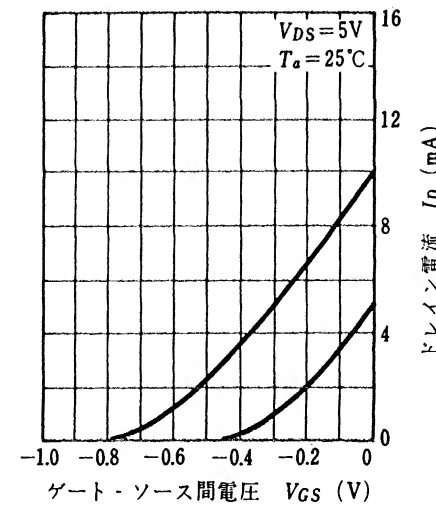
$I_{DSS}$  ランク分類

Class	A	B	C	D
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~3	2~6	5~12	10~20

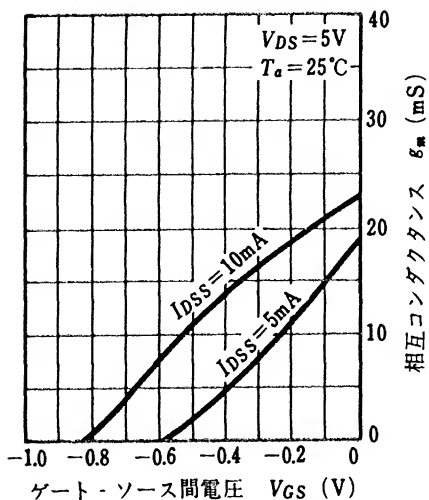
$I_D - V_{DS}$  特性



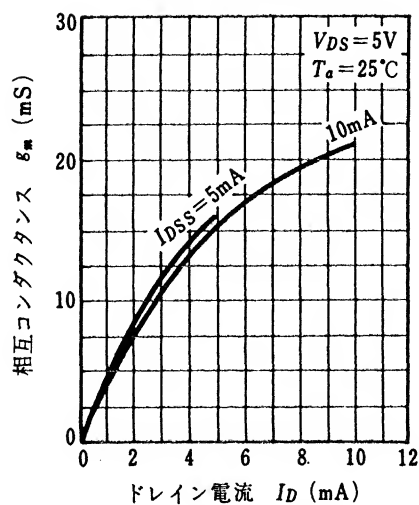
$I_D - V_{GS}$  特性



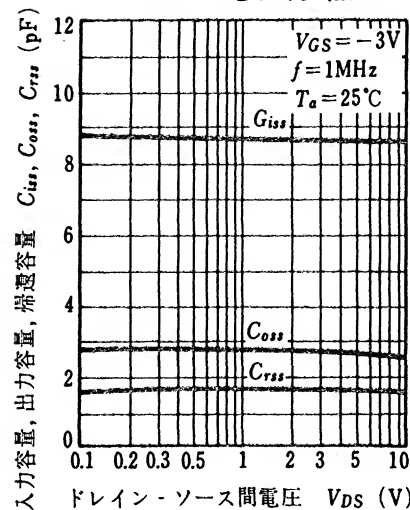
$g_m - V_{GS}$  特性



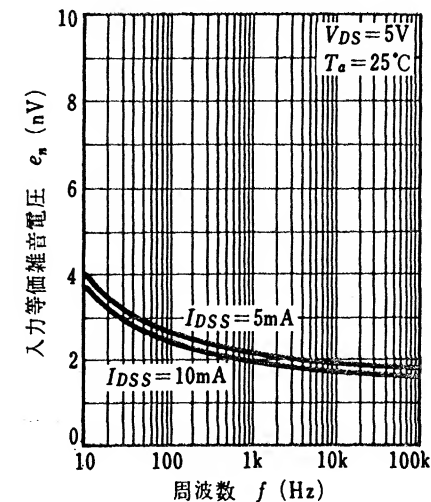
$g_m - I_D$  特性



$C - V_{DS}$  特性



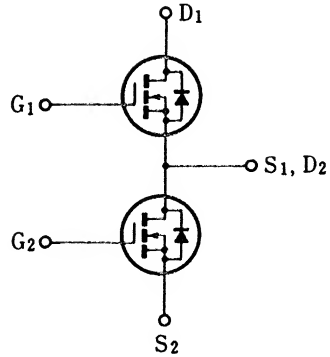
$e_n - f$  特性



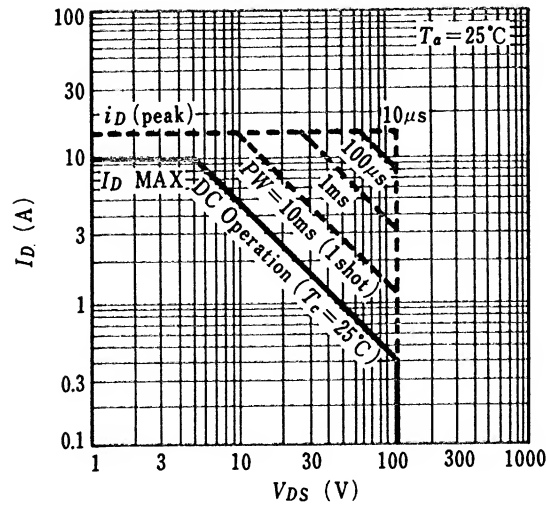
# PM1210B

## Si MOS型 複合Nチャンネル

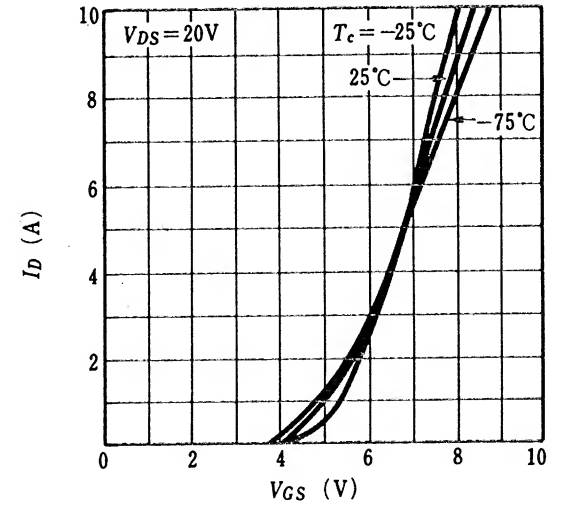
日立



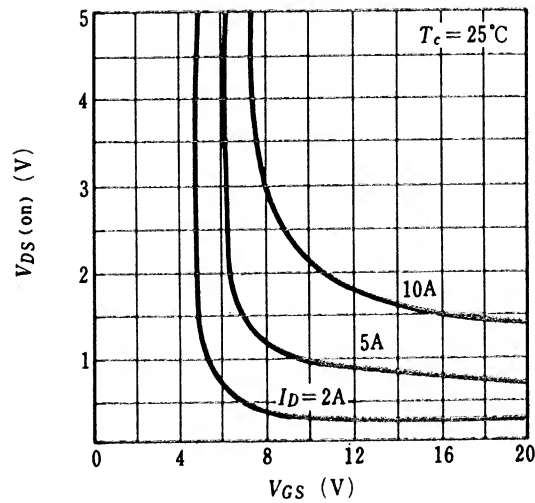
安全動作領域



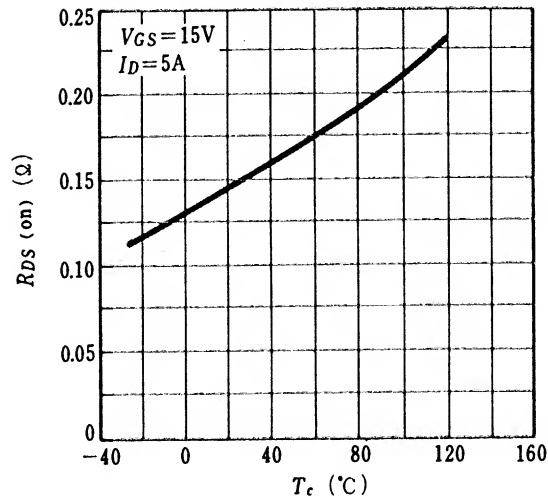
ソース接地伝達特性



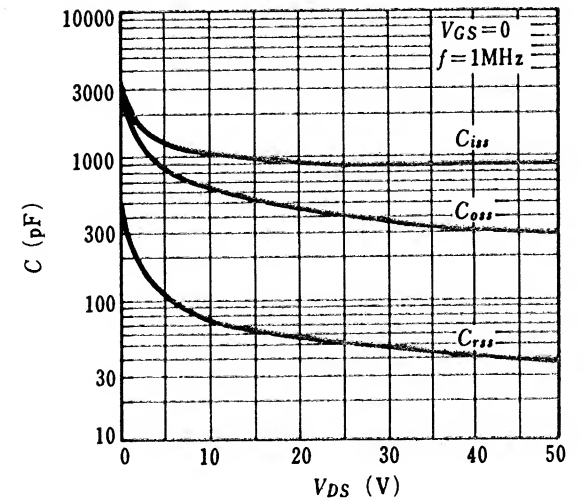
$V_{DS(on)}$  -  $V_{GS}$  特性



$R_{DS(on)}$  -  $T_c$  特性



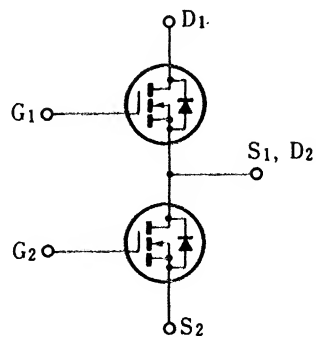
C -  $V_{DS}$  特性



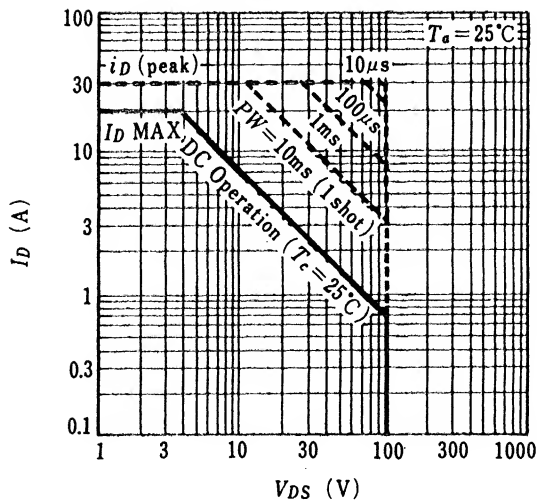
# PM1220B

## Si MOS型 複合Nチャンネル

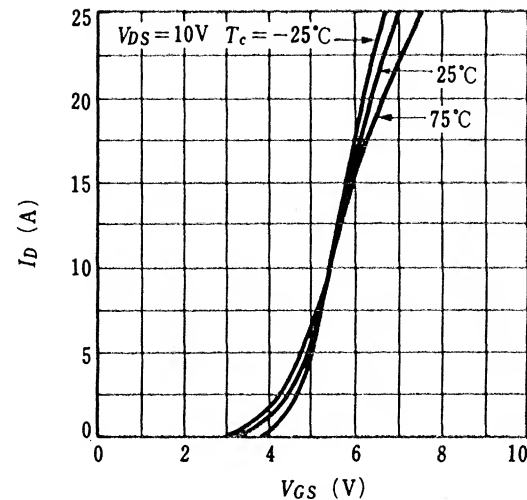
日立



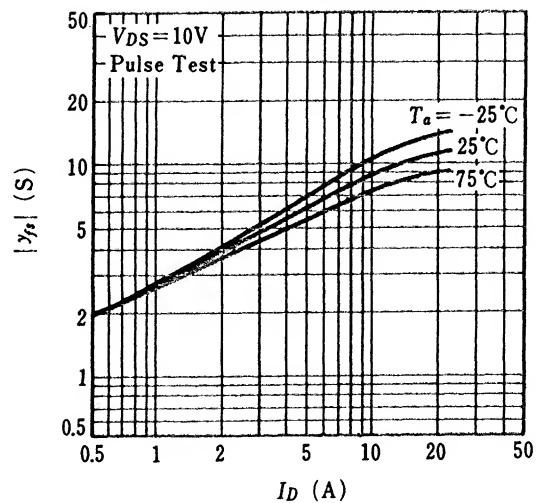
安全動作領域



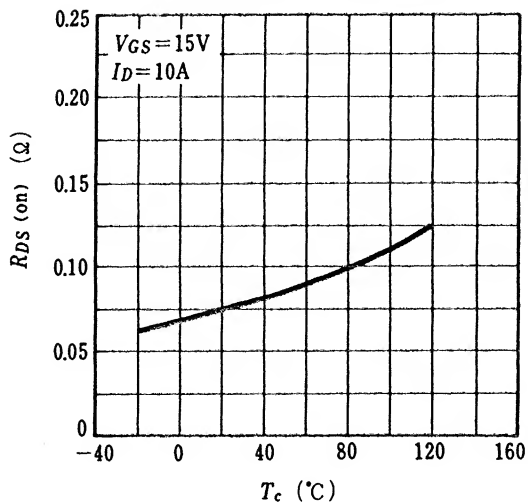
ソース接地伝達特性



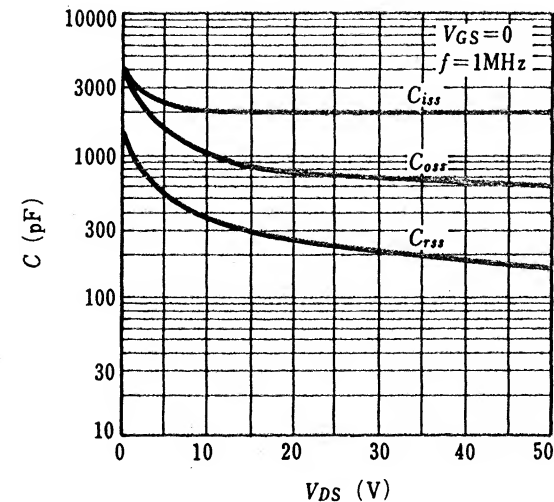
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



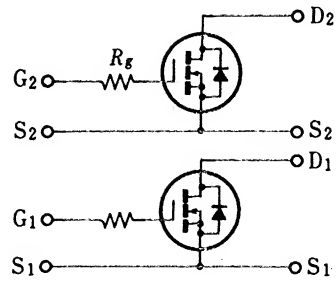
C - VDS 特性



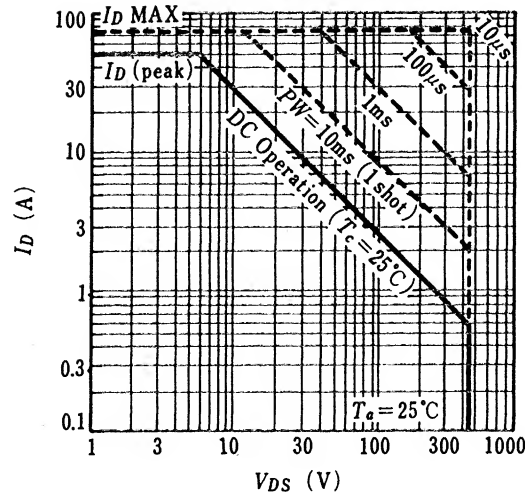
# PM4550C

## Si MOS型 複合Nチャンネル

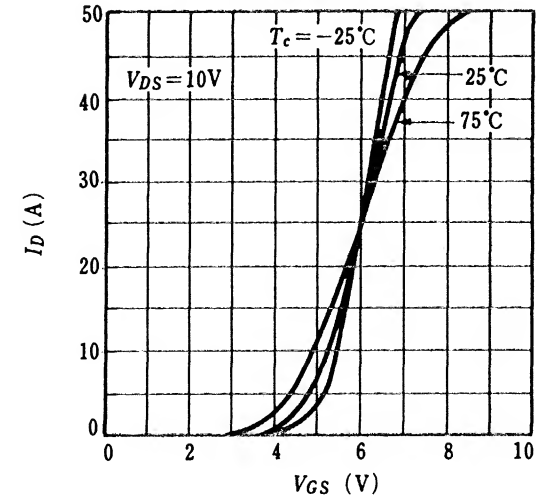
日立



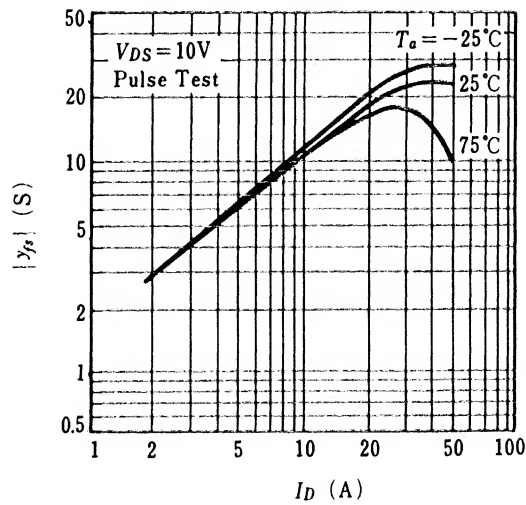
安全動作領域



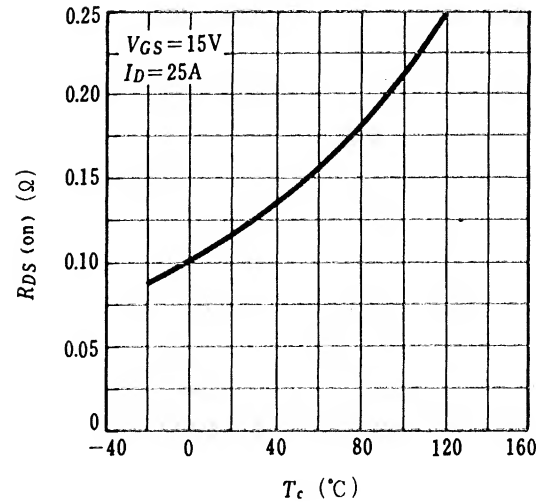
ソース接地伝達特性



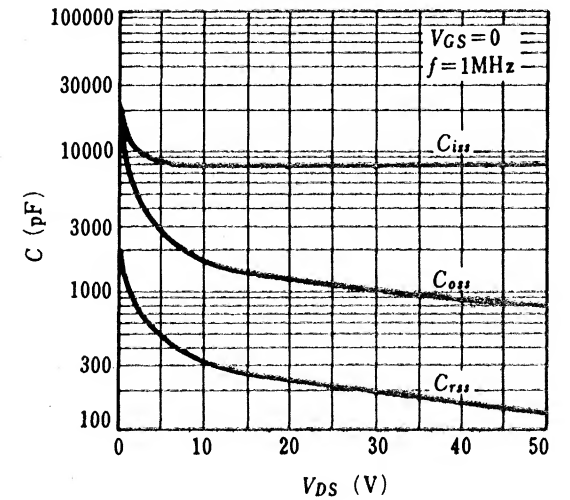
$|y_{fs}| - I_D$  特性



$R_{DS(on)} - T_c$  特性



C - VDS 特性



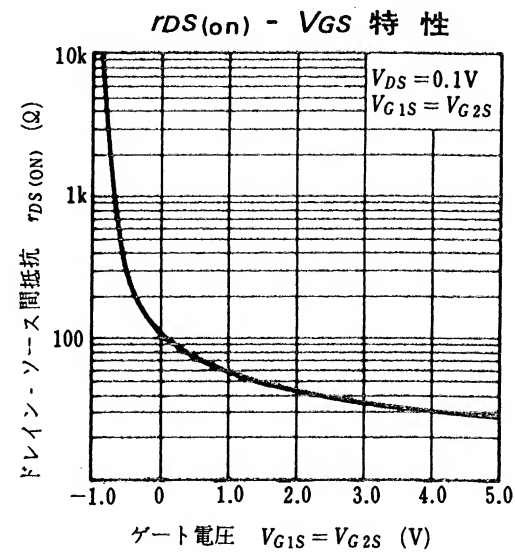
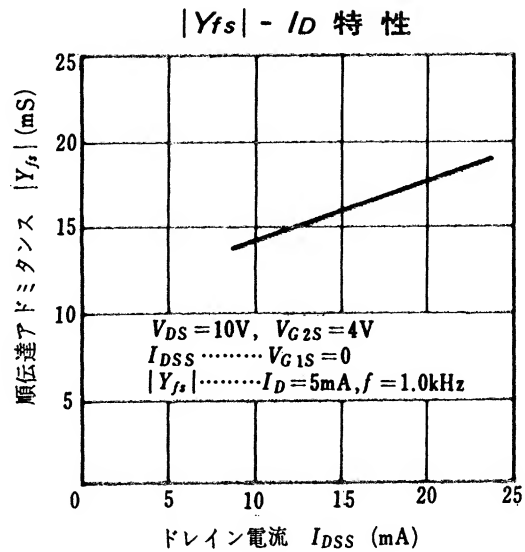
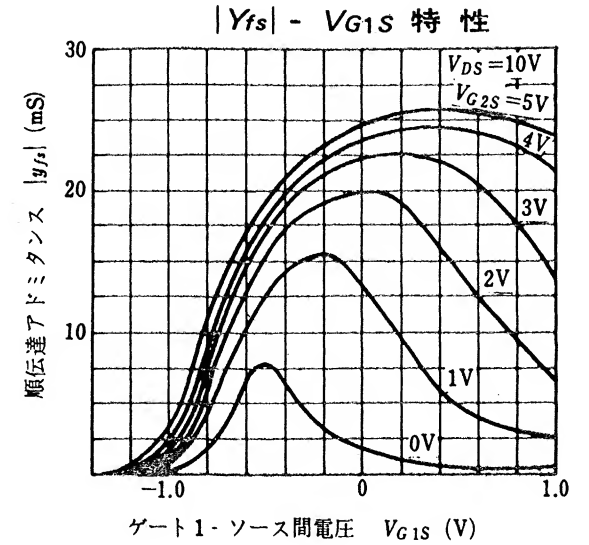
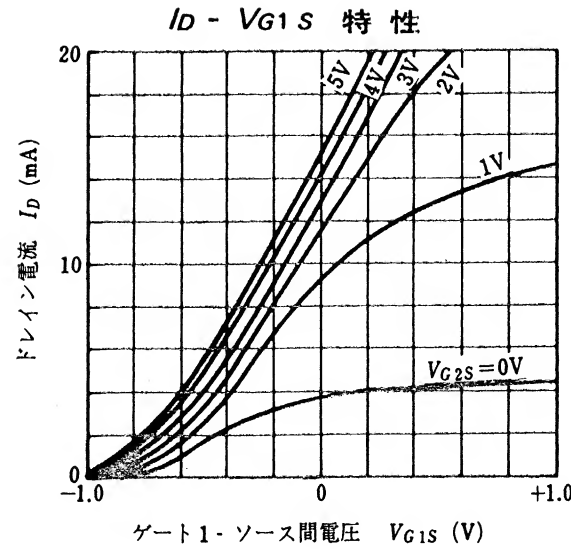
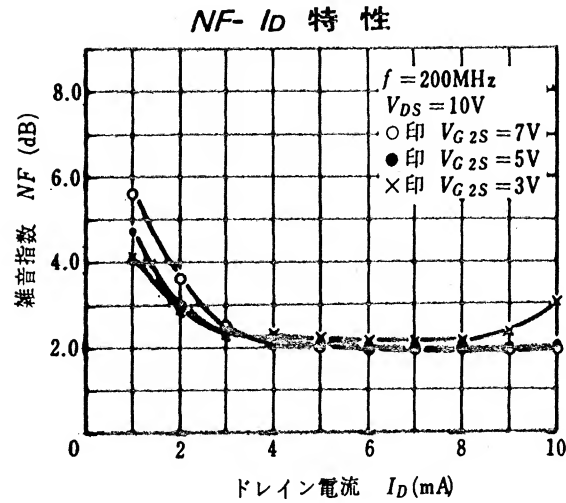


# 3SK47

## Si MOS 型 Nチャンネル

日 電

$I_{DSS}$  区分 / M: 4~11mA L: 9~19mA K: 17~25mA

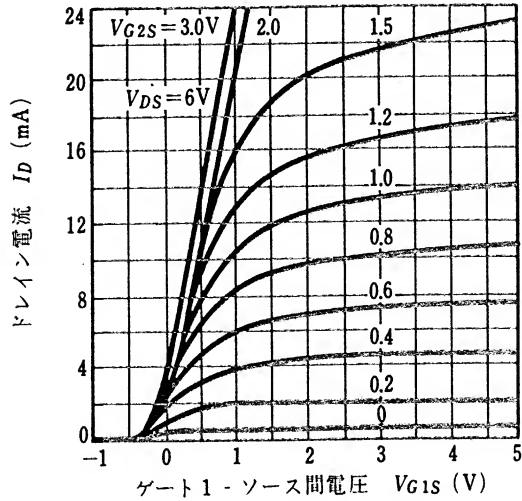


# 3SK60

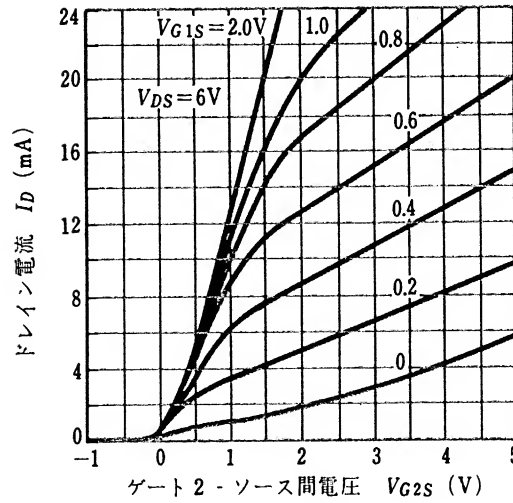
## Si MOS型 複合Nチャンネル

日立

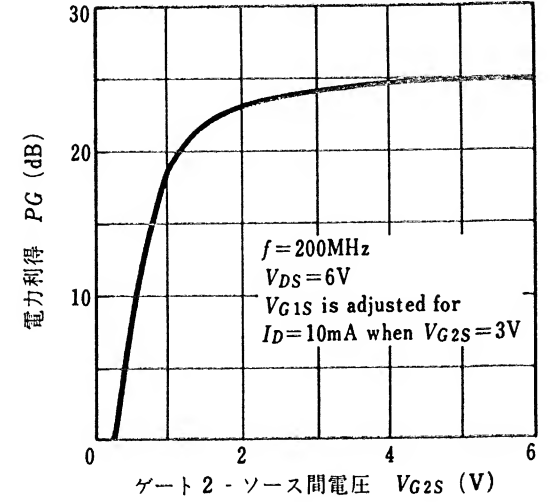
ドレイン電流対  
ゲート1-ソース間電圧特性



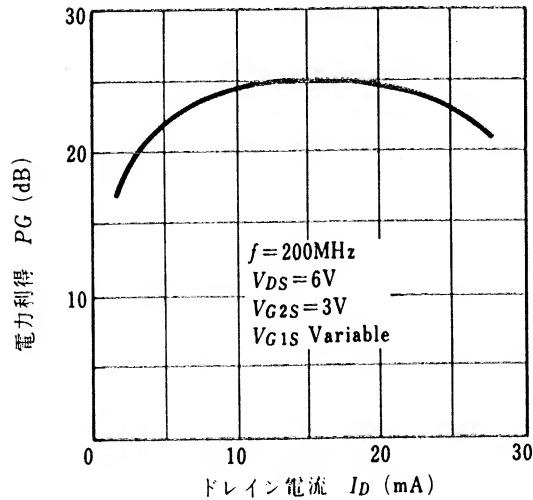
ドレイン電流対  
ゲート2-ソース間電圧特性



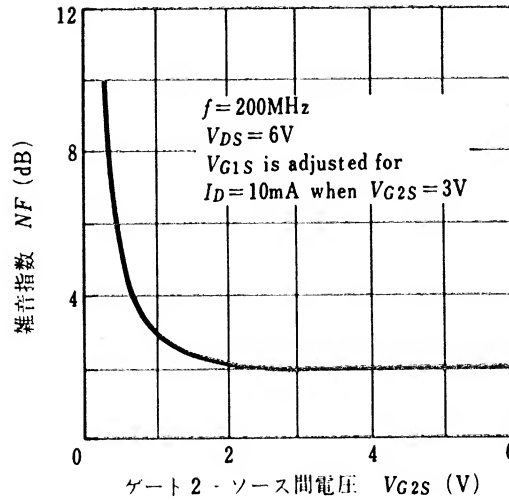
電力利得対  
ゲート2-ソース間電圧特性



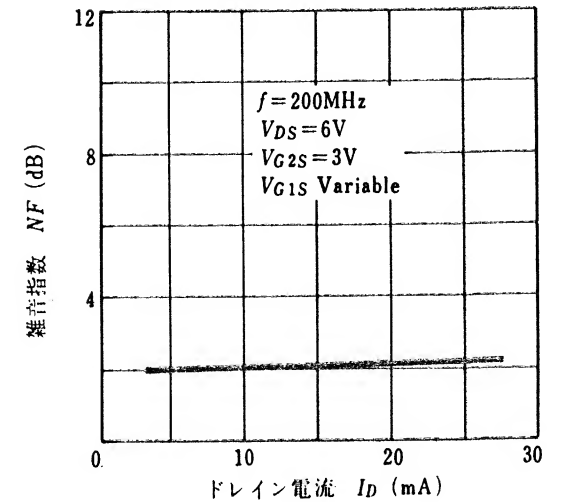
電力利得対ドレイン電流特性



雑音指数対  
ゲート2-ソース間電圧特性



雑音指数対ドレイン電流特性

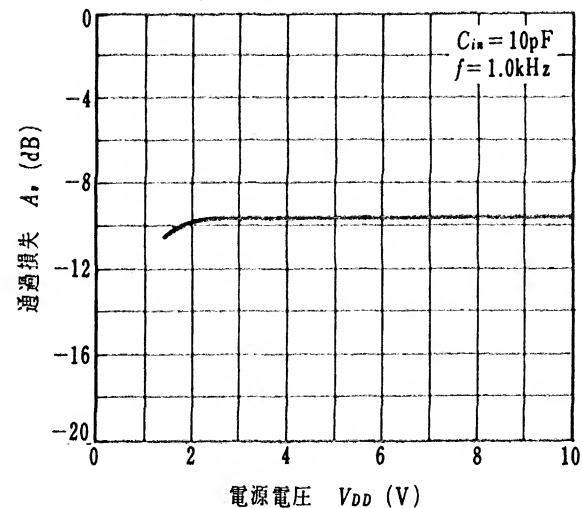


# 3SK71

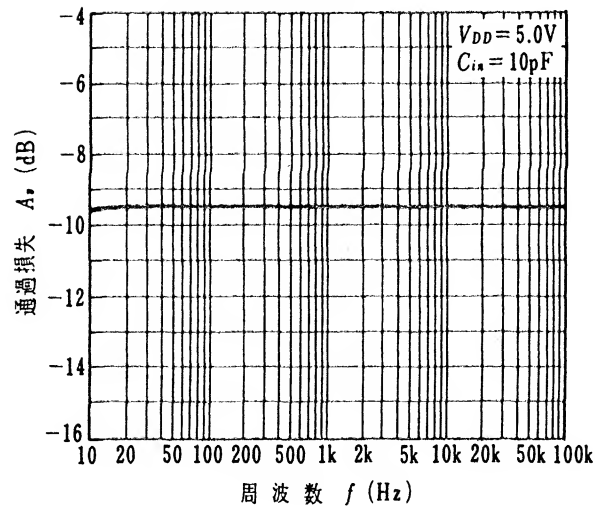
## Si接合型 Nチャンネル

日 電

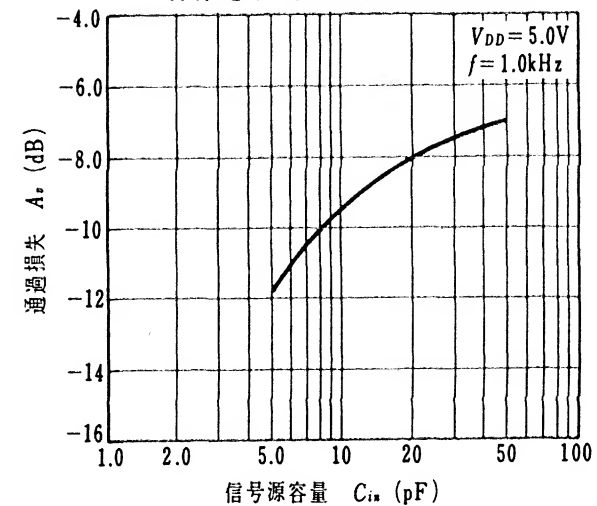
VOLTAGE GAIN vs.  
SUPPLY VOLTAGE



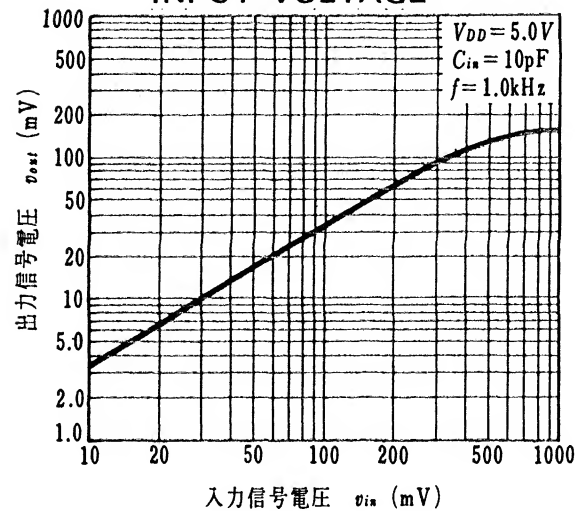
VOLTAGE GAIN vs.  
FREQUENCY



VOLTAGE GAIN vs.  
INPUT CAPACITANCE



OUTPUT VOLTAGE vs.  
INPUT VOLTAGE

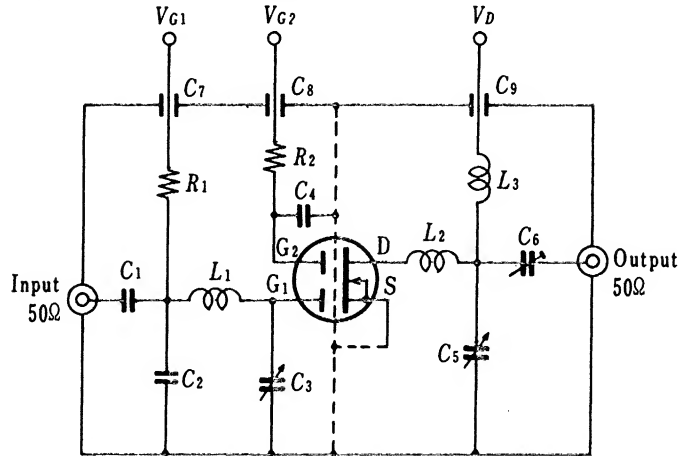


# 3SK81, 136

## Si MOS型 Nチャンネル

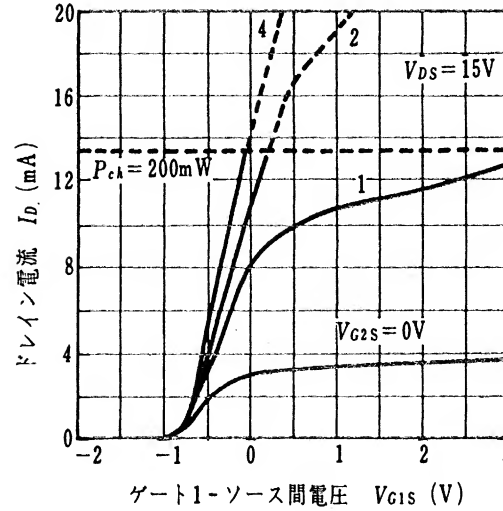
日 立

電力利得，雑音指数測定回路

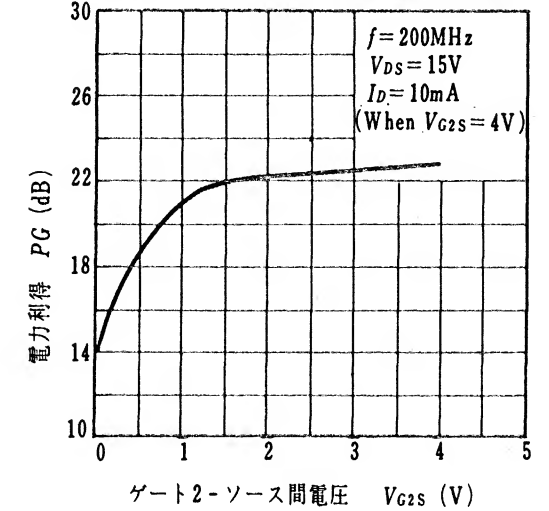


- $R_1$ : 15k $\Omega$
- $R_2$ : 11k $\Omega$
- $C_1$ : 1000pF
- $C_2$ : 47pF
- $C_3, C_5, C_6$ : 10pF max 可変コンデンサ
- $C_4$ : 1000pF 裸円板コンデンサ
- $C_7, C_8, C_9$ : 1000pF 貫通形コンデンサ
- $L_1, L_2$ :  $\phi 0.8$ mm エナメル線 2.5T, 内径6mm
- $L_3$ :  $\phi 0.8$ mm エナメル線 1.5T, 内径6mm

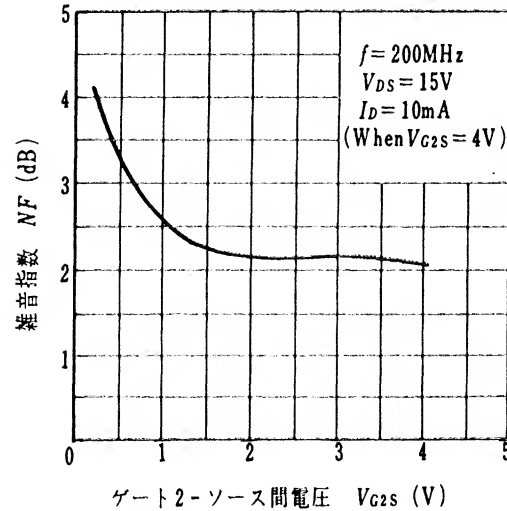
ドレイン電流対  
ゲート1-ソース間電圧特性



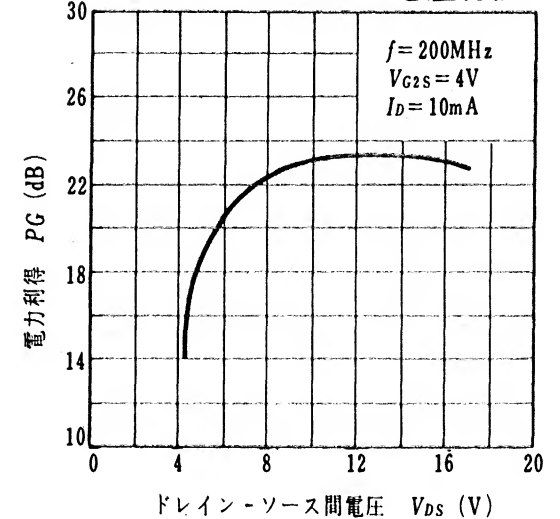
電力利得対  
ゲート2-ソース間電圧特性



雑音指数対  
ゲート2-ソース間電圧特性



電力利得対  
ドレイン-ソース間電圧特性

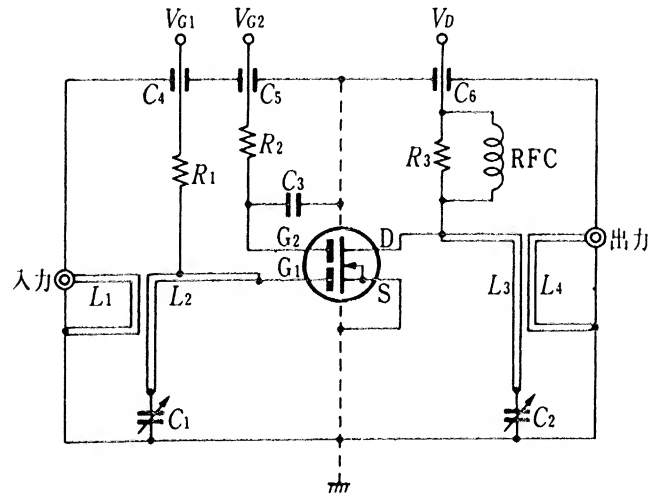


# Si MOS型 Nチャンネル

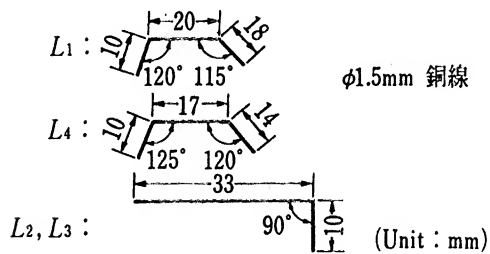
日 立

## 3SK82

電力利得, 雑音指数測定回路

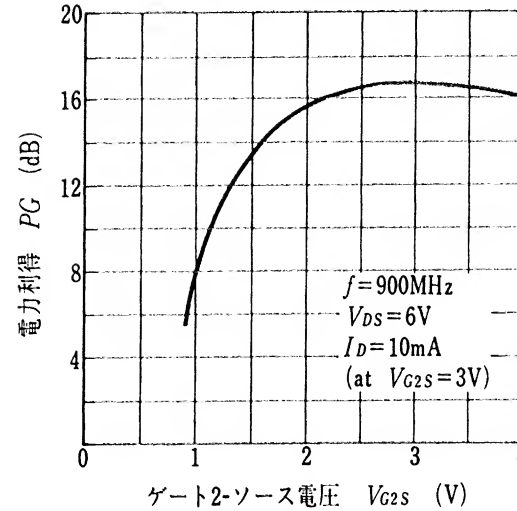


$C_1, C_2$  : 10pF max可変コンデンサ  
 $C_3$  : 1000pF 裸円板コンデンサ  
 $C_4 \sim C_6$  : 1000pF 貫通形コンデンサ  
 $R_1$  : 90k $\Omega$     $R_2$  : 47k $\Omega$     $R_3$  : 3.3k $\Omega$

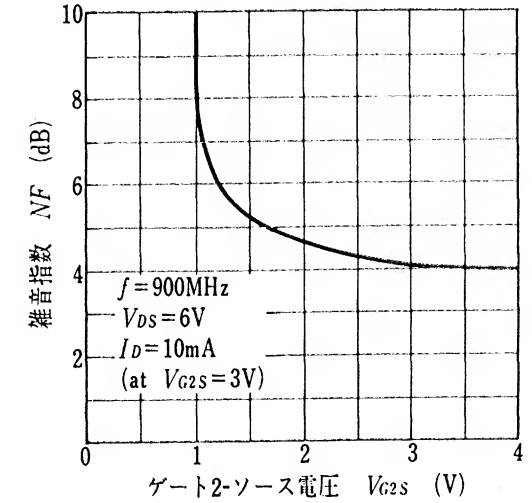


RFC :  $\phi 1.0\text{mm}$  エナメル線4T, 内径7mm

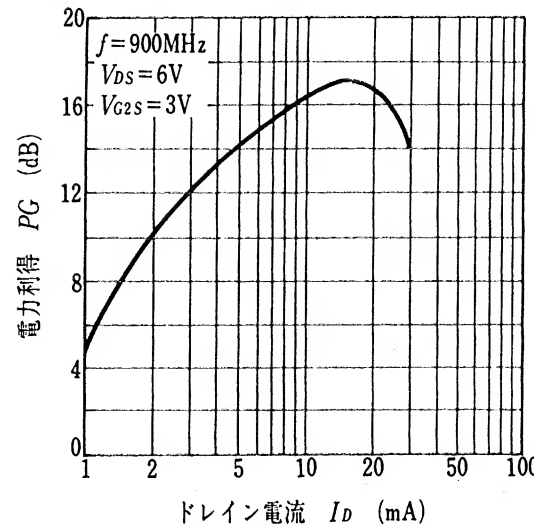
電力利得対ゲート2-  
ソース電圧特性



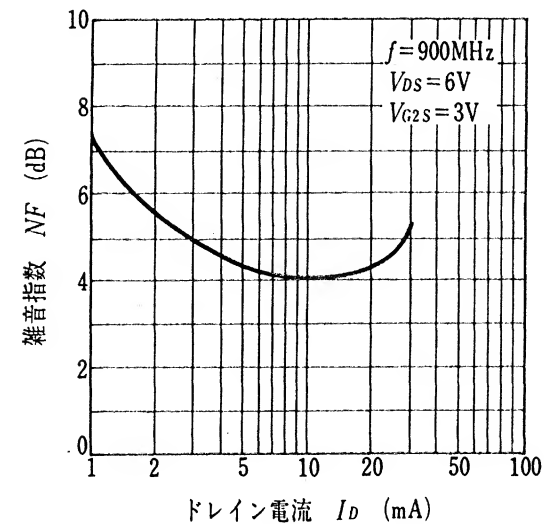
雑音指数対ゲート2-  
ソース電圧特性



電力利得対ドレイン電流特性



雑音指数対ドレイン電流特性

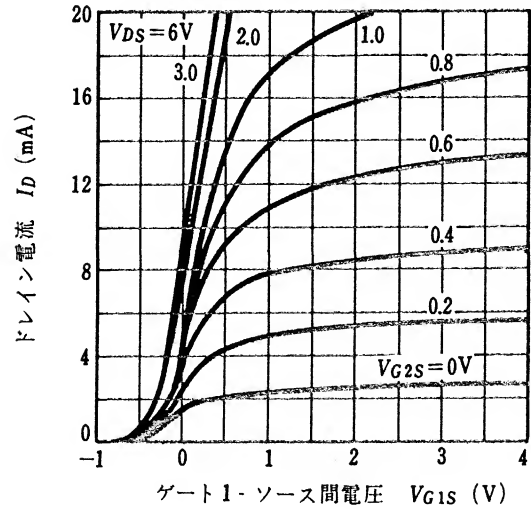


# 3SK96

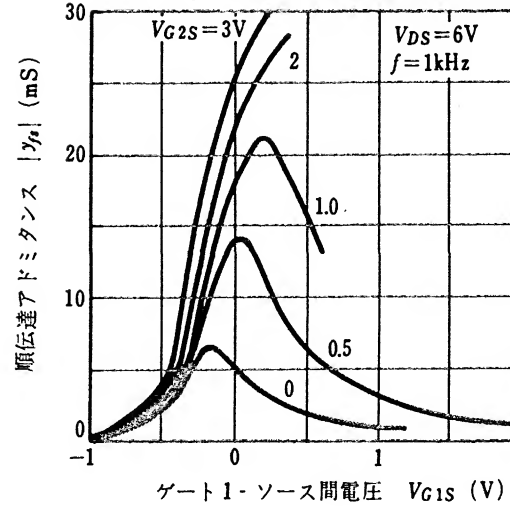
## Si MOS型 複合Nチャンネル

日立

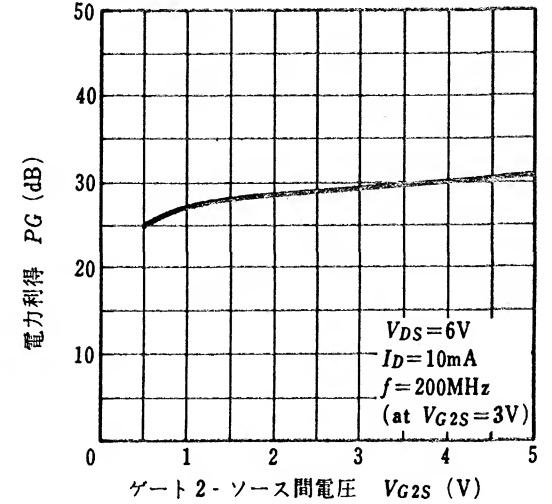
### ドレイン電流対 ゲート1-ソース間電圧特性



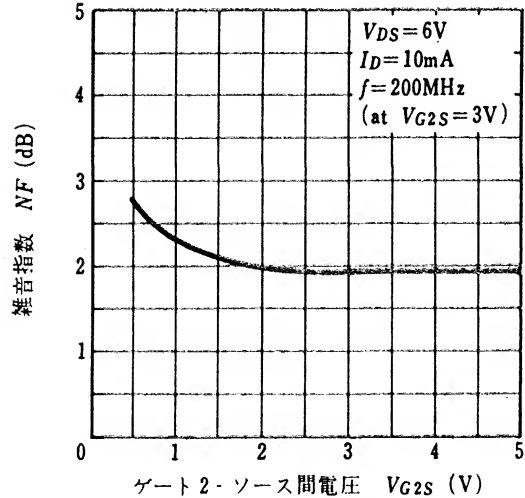
### 順伝達アドミタンス対 ゲート1-ソース間電圧特性



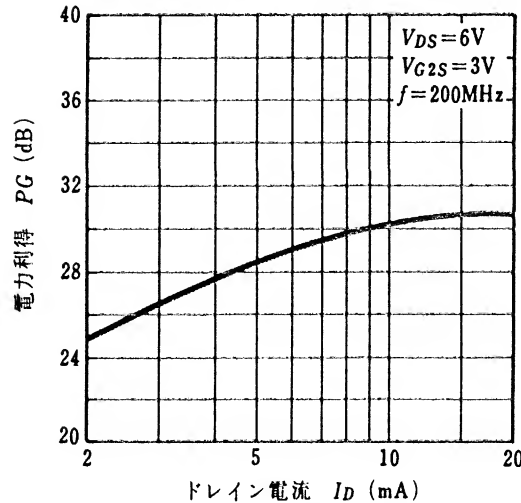
### 電力利得対 ゲート2-ソース間電圧特性



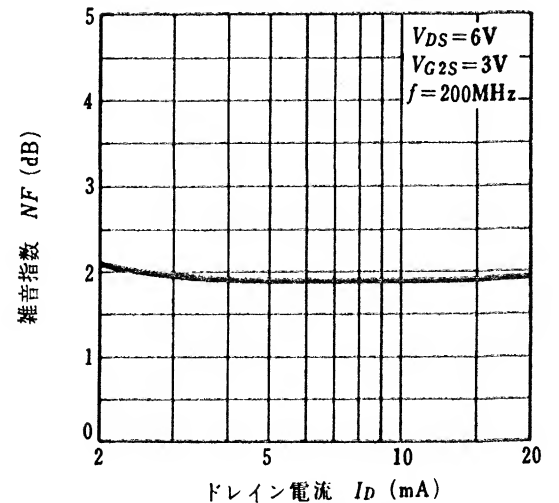
### 雑音指数対 ゲート2-ソース間電圧特性



### 電力利得対ドレイン電流特性



### 雑音指数対ドレイン電流特性



# 3SK100

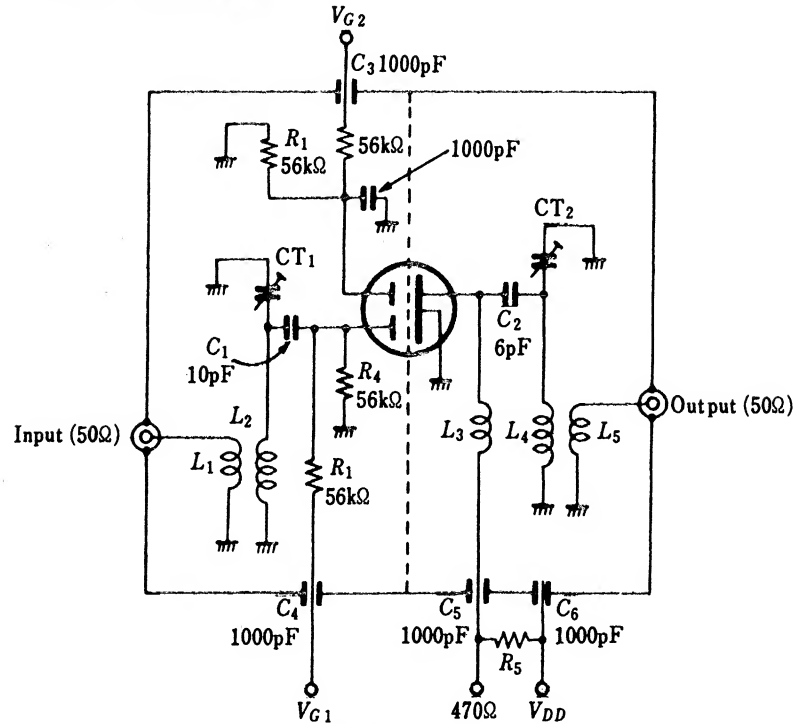
## Si MOS型 Nチャンネル

松下

$I_{DSS}$  ランク分類

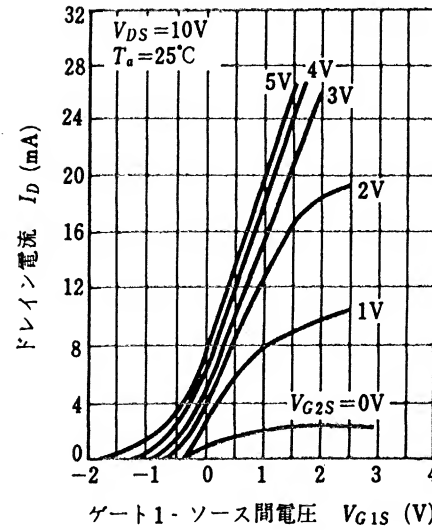
	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	0.5~2	1.2~6	4~8

PG, NF 測定回路

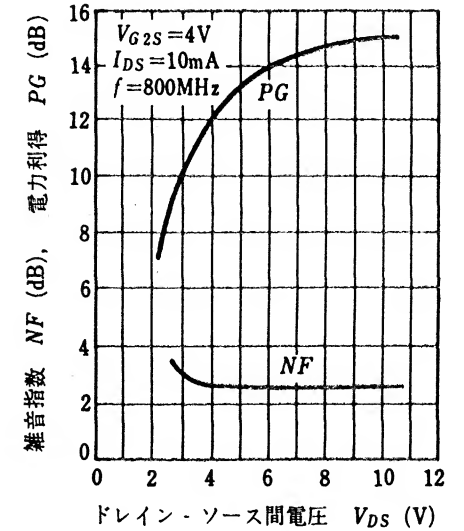


- $L_1, L_5$  : 長さ 1.5φ のニッケル線
- $L_3$  : 0.15φ 7 ターン
- $L_2, L_4$  : 6.0×28×0.8 銅板
- CT, CT<sub>2</sub> : 3~9pF シリンドラ・トリマ

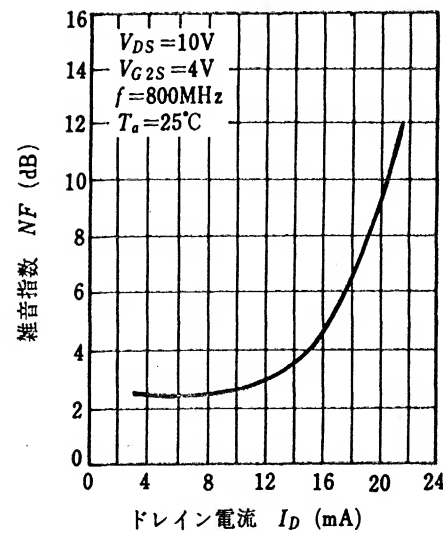
$I_D - V_{G1S}$  特性



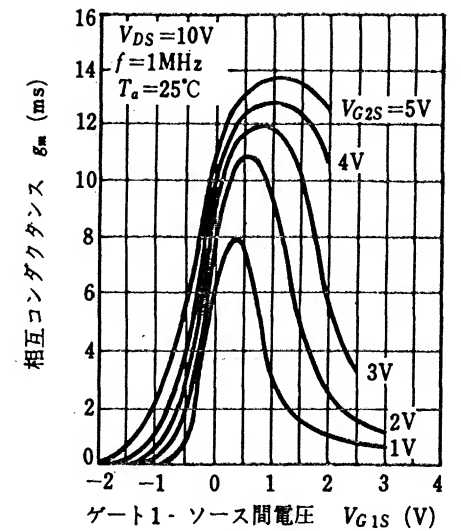
NF, PG -  $V_{DS}$  特性



NF -  $I_D$  特性



$g_m - V_{G1S}$  特性

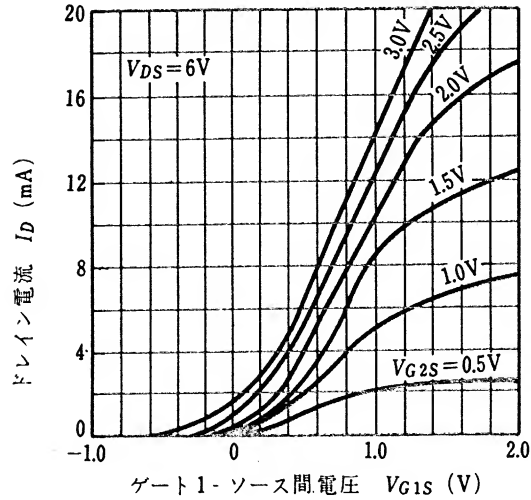


# 3SK103, 138

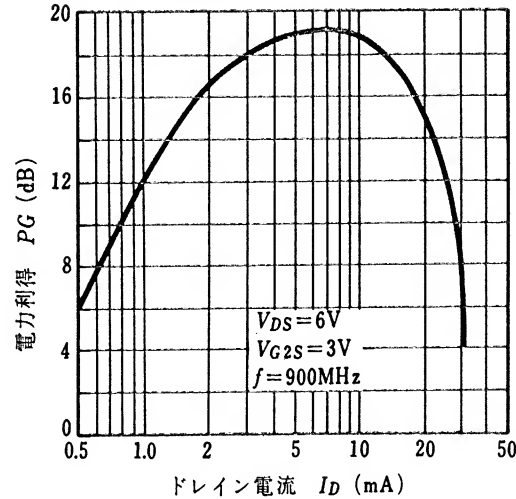
## Si MOS型 複合Nチャンネル

日立

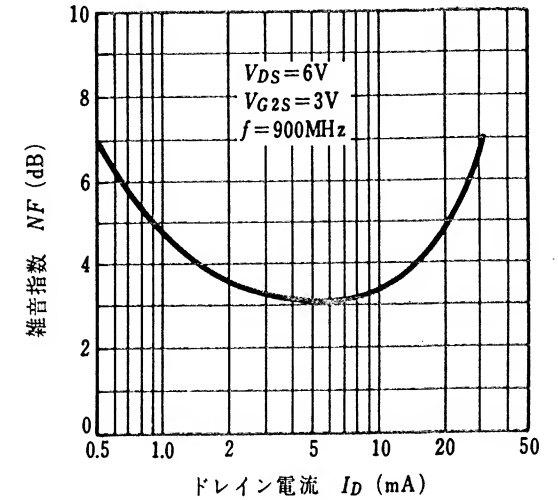
### ドレイン電流対 ゲート1-ソース間電圧特性



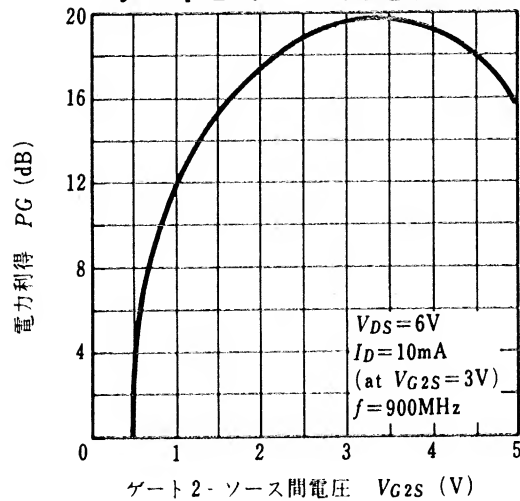
### 電力利得対ドレイン電流特性



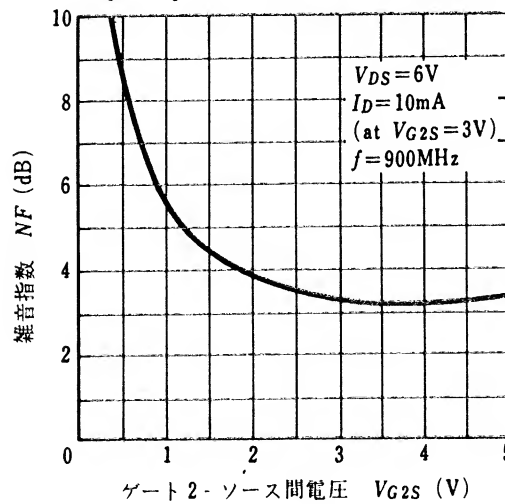
### 雑音指数対ドレイン電流特性



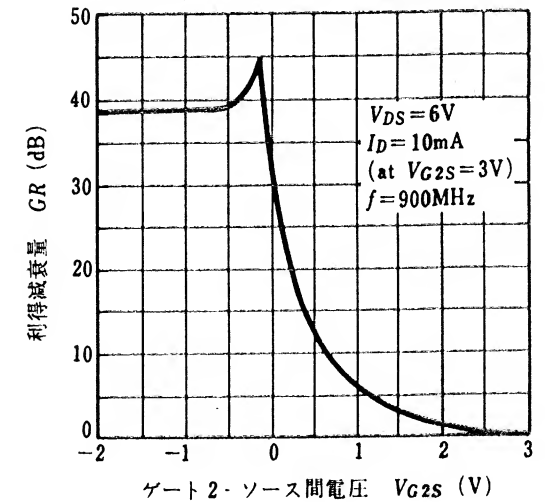
### 電力利得対 ゲート2-ソース間電圧特性



### 雑音指数対 ゲート2-ソース間電圧特性



### 利得減衰量対 ゲート2-ソース間電圧特性

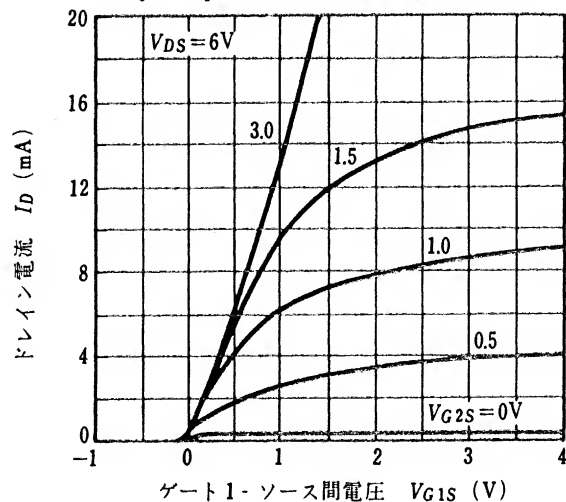




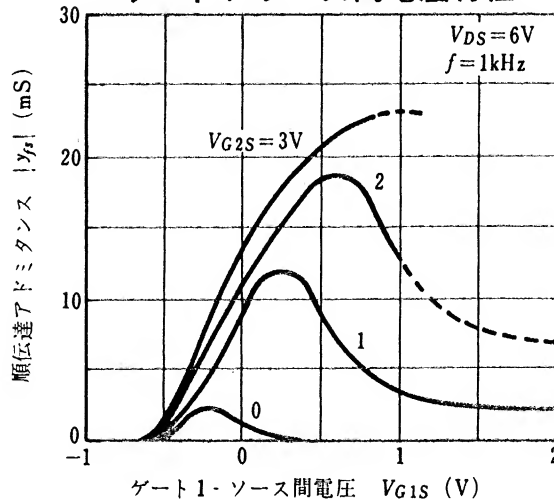
# 3SK104, 104V, 137 Si MOS型 複合Nチャンネル

日立

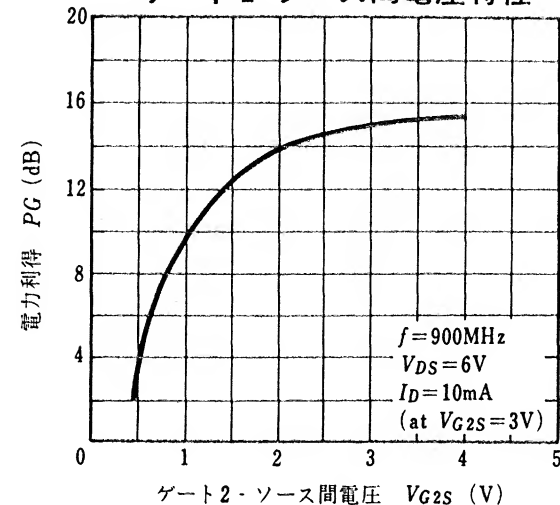
ドレイン電流対  
ゲート1-ソース間電圧特性



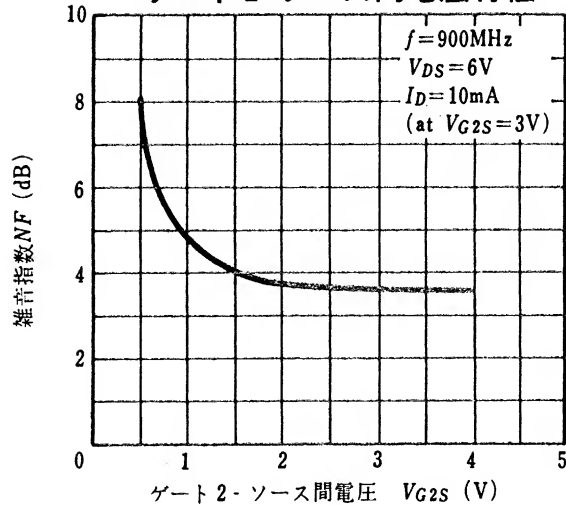
順伝達アドミタンス対  
ゲート1-ソース間電圧特性



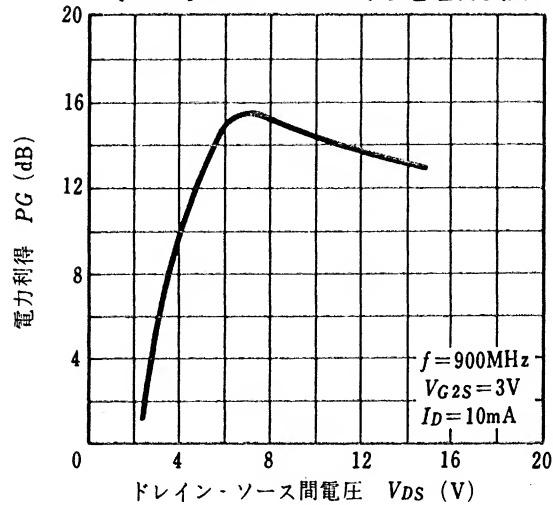
電力利得対  
ゲート2-ソース間電圧特性



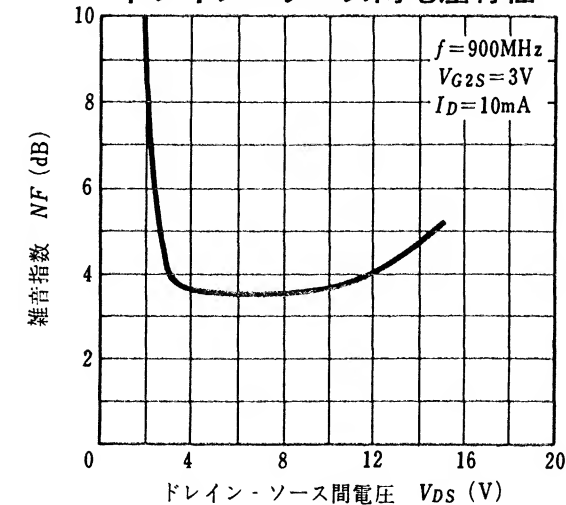
雑音指数対  
ゲート2-ソース間電圧特性



電力利得対  
ドレイン-ソース間電圧特性



雑音指数対  
ドレイン-ソース間電圧特性

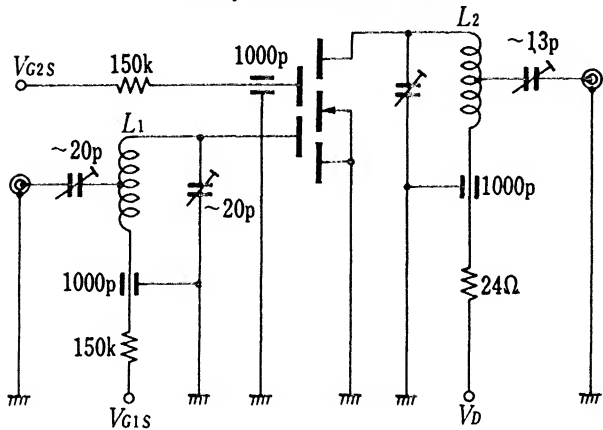


# 3SK108

## Si MOS型 複合Nチャンネル

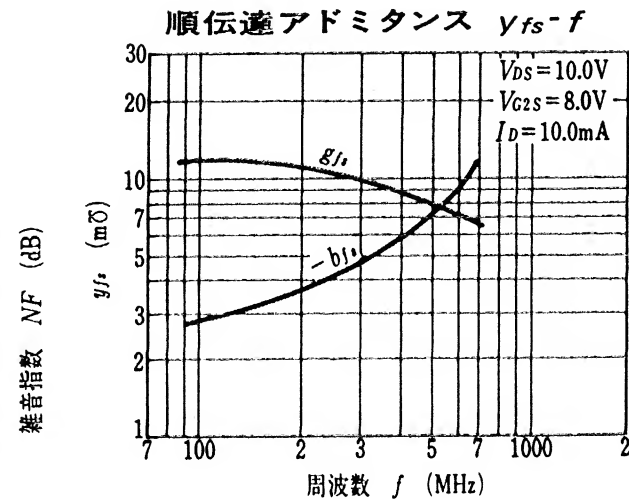
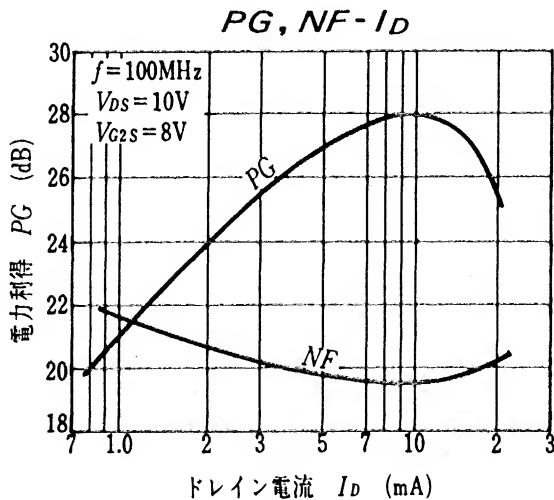
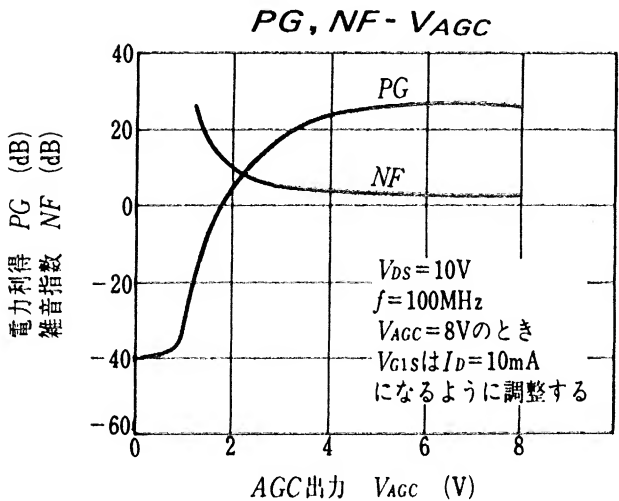
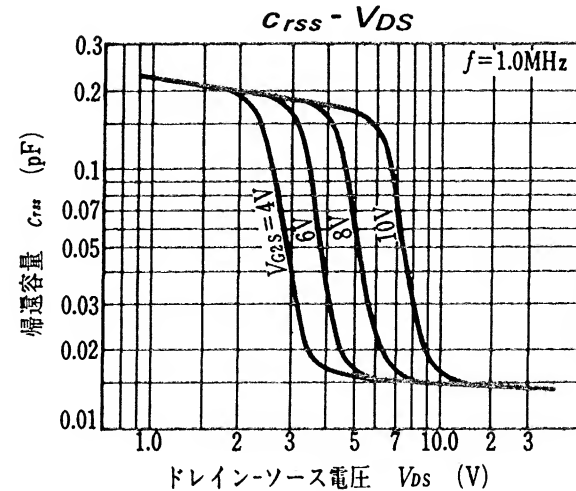
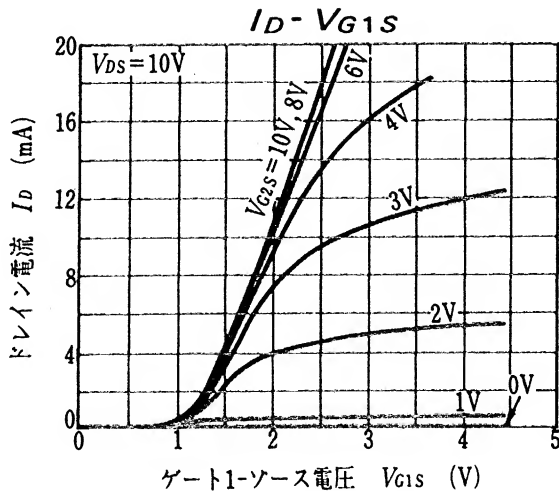
$I_{DSX}$ 分類	3 Q 10	7 R 14	10 S 17	14 T 21
--------------	--------	--------	---------	---------

PG, NF測定回路



$L_1$ : 1mmφメッキ線を10mmφ 4T,  
Gate側より1Tにタップ.

$L_2$ : 1mmφメッキ線を10mmφ 6T,  
Drain側より1Tにタップ.



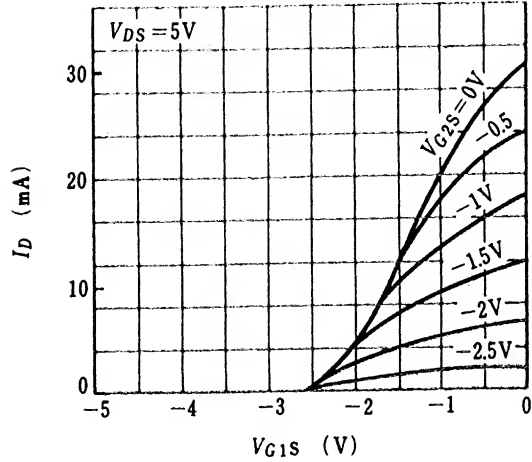
# 3SK113

## GaAs 型 複合 Nチャンネル

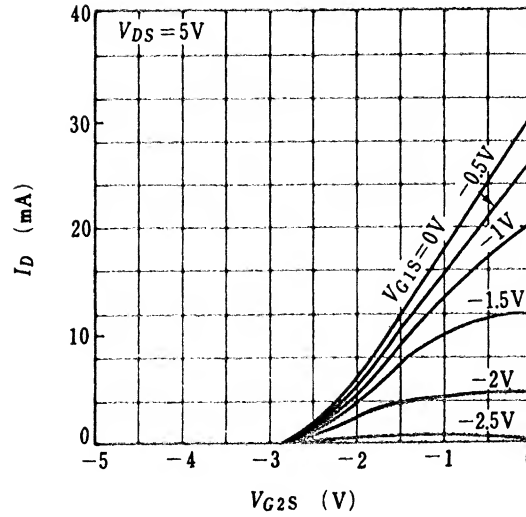
日 立

F	G	H	J	
10~20	16~32	25~50	40~80	mA

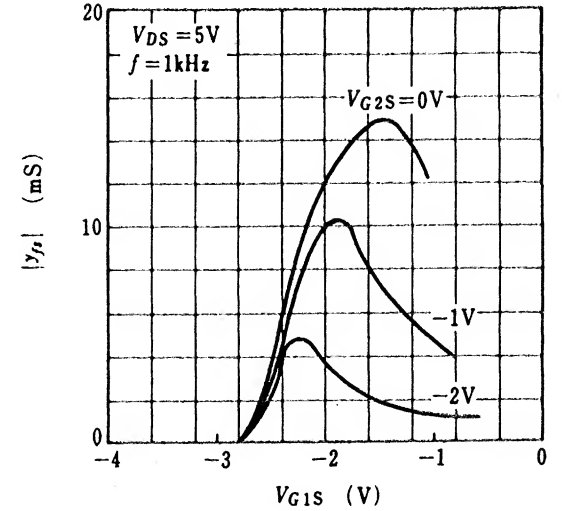
$I_D - V_{G1S}$  特性



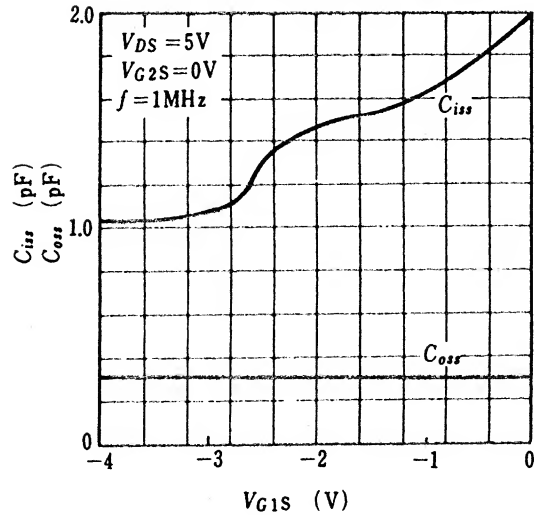
$I_D - V_{G2S}$  特性



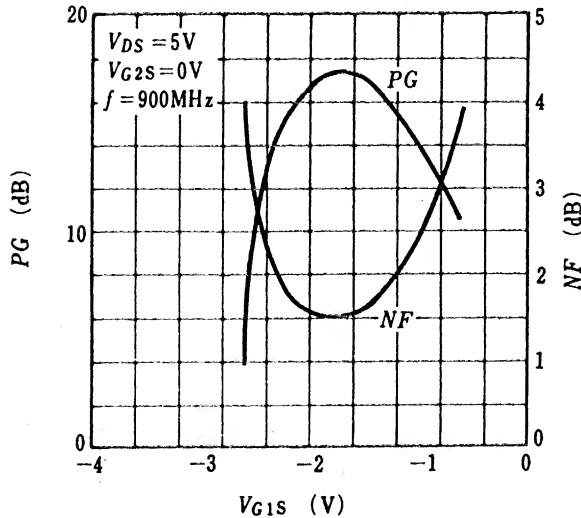
$|y_{fs}| - V_{G1S}$  特性



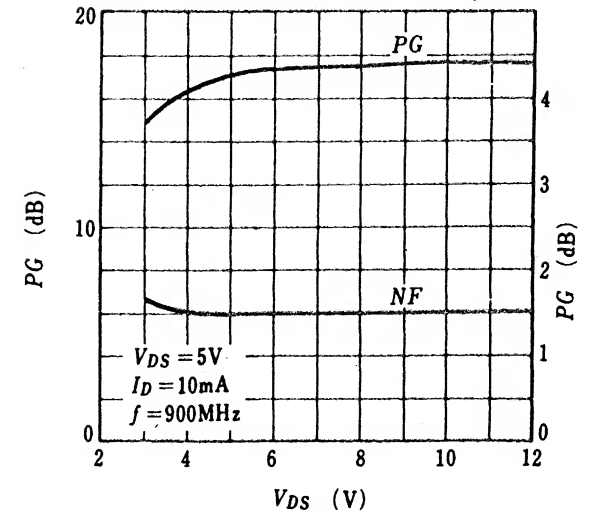
$C_{iss}, C_{oss} - V_{G1S}$  特性



$PG - V_{G1S}$  特性



$PG - V_{DS}$  特性

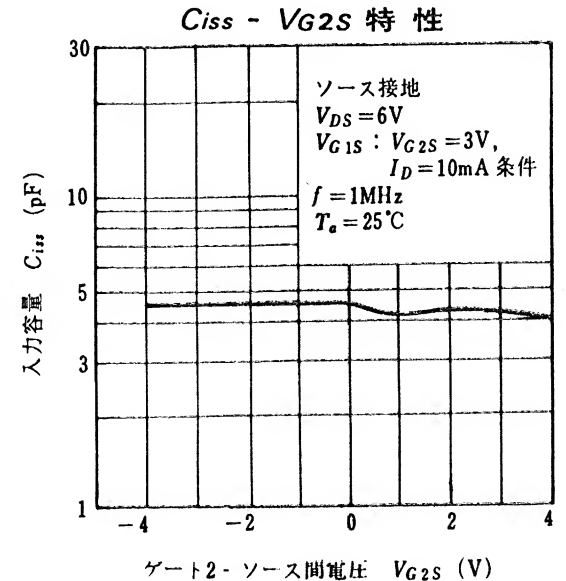
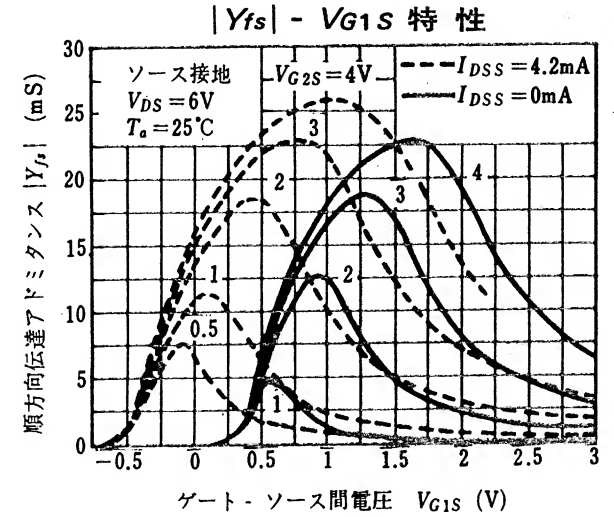
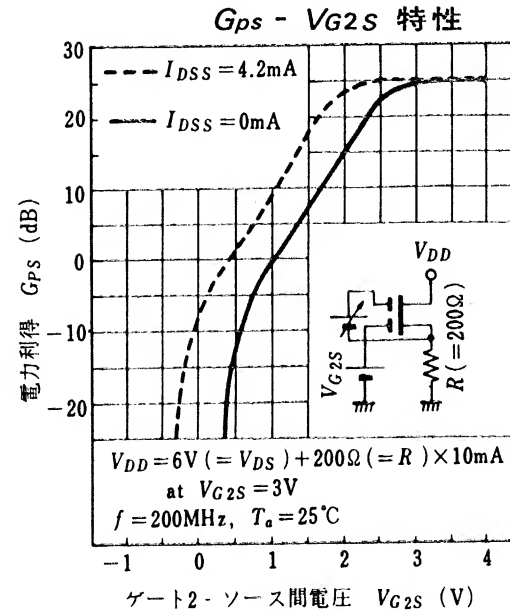
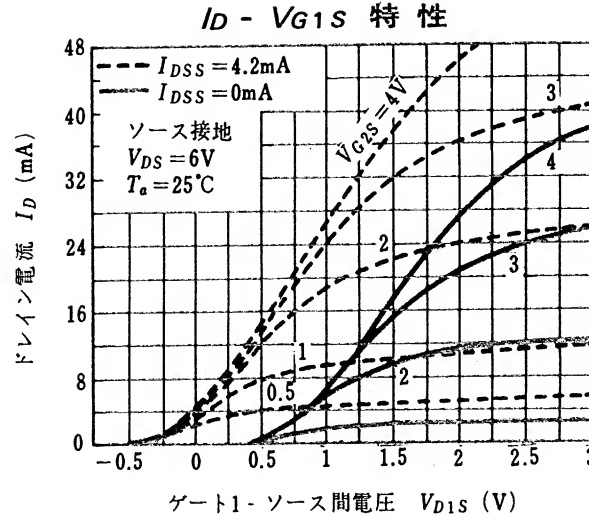
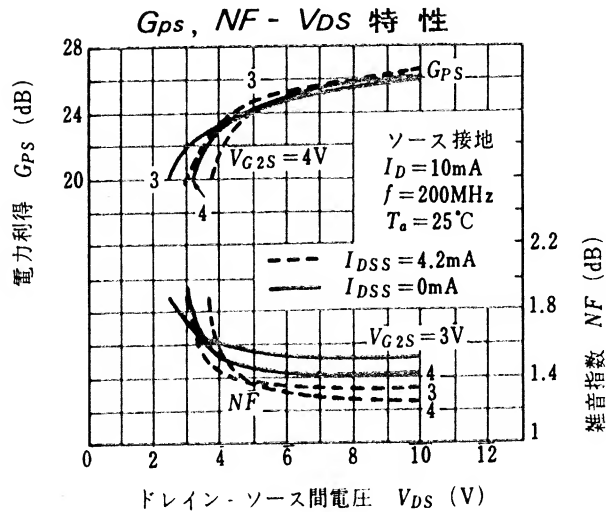
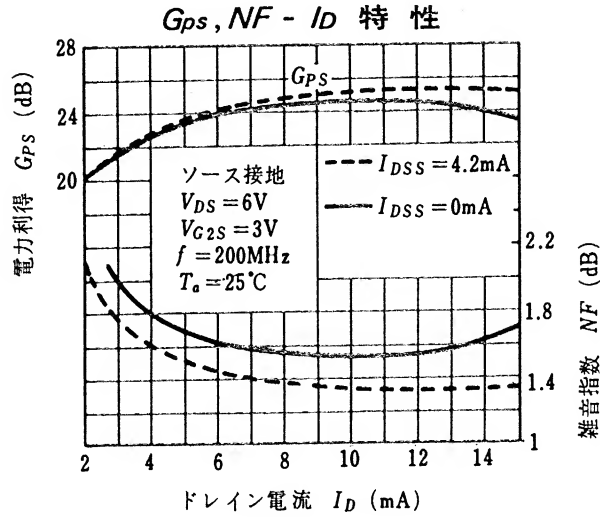


# 3SK114

## Si MOS 型 Nチャンネル

東 芝

$I_{DSS}$  区分 0:0~2, Y:1~6 (mA)



# 3SK116

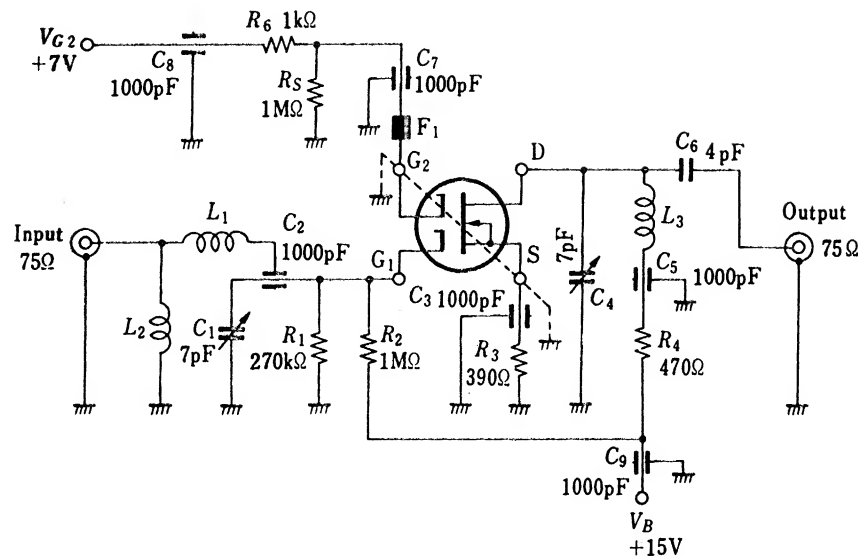
## Si MOS型 Nチャンネル

松 下

$I_{DSS}$  ランク分類

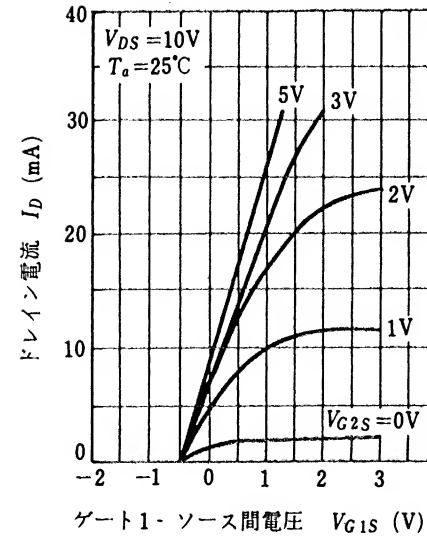
	P	Q	R
$I_{DSS}$ (mA)	2.5~8	6~17	13~30

PG, NF 測定回路

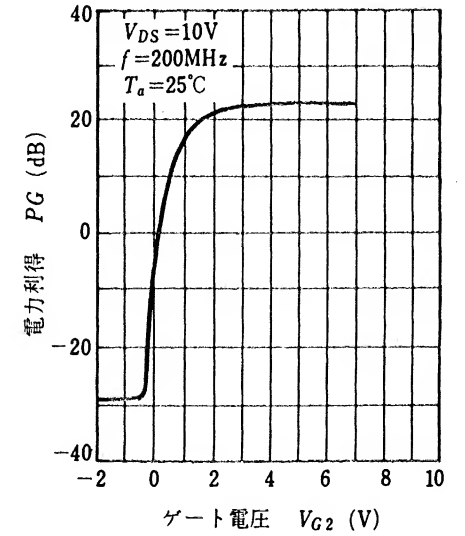


$L_1$ : 0.3φ PUW 4.9φ 3.5T  
 $L_2$ : 0.3φ PUW 3.2φ 1.5T  
 $L_3$ : 0.3φ PUW 3.2φ 4.0T  
 $f=200\text{MHz}$ , BW: 8MHz

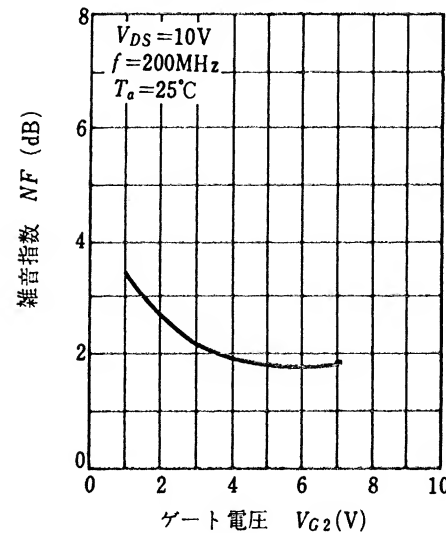
$I_D - V_{G2S}$  特性



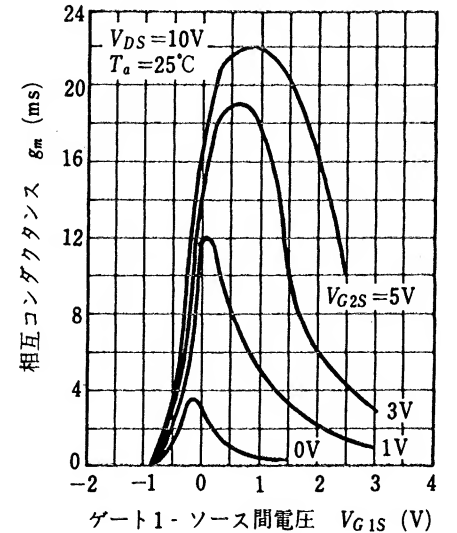
PG -  $V_{G2}$  特性



NF -  $V_{G2}$  特性



$g_m - V_{G1S}$  特性



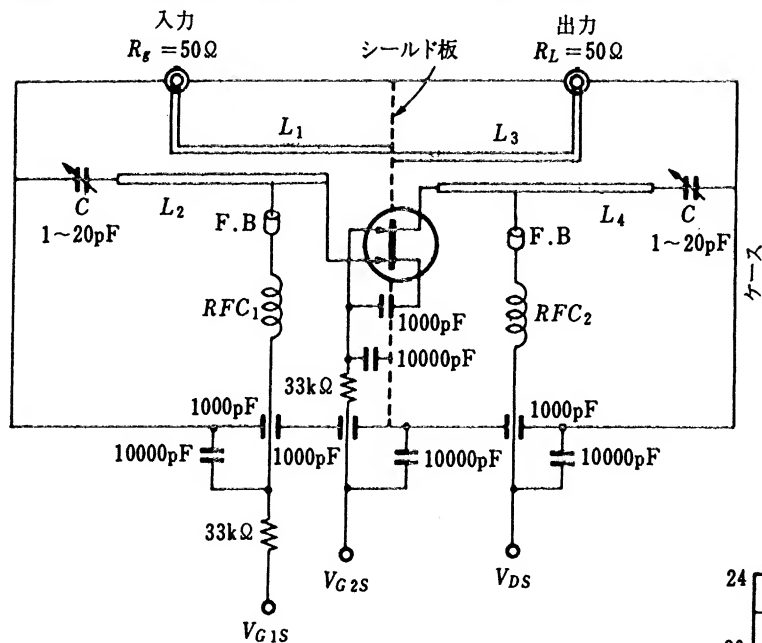
# 3SK121

## GaAs 型 Nチャンネル

東 芝

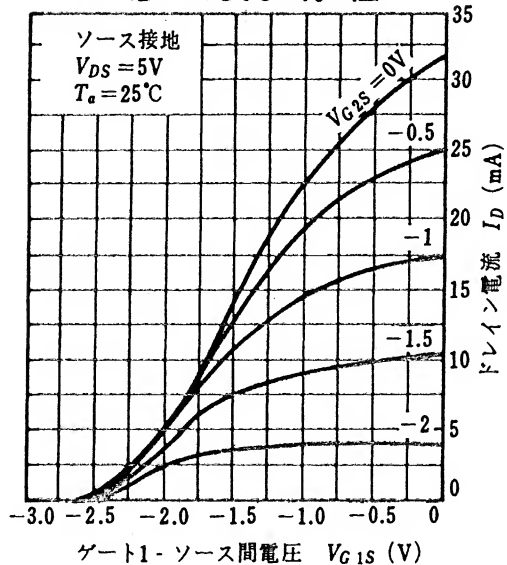
$I_{DSS}$  区分 Y: 20~35, GR: 30~45 (mA)

### 電力利得, 雑音指数および GR 測定回路

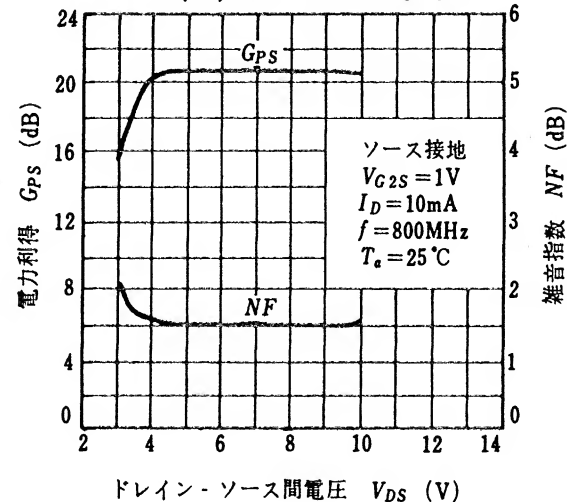


- $L_1 \sim L_4$ :  $\phi 0.8\text{mm}$  銀メッキ線
- C : エアトリマ 村田 TTA25A 200A
- RFC<sub>1</sub> :  $\phi 0.35\text{mm}$  UEW 3 ID 7T
- RFC<sub>2</sub> :  $\phi 0.35\text{mm}$  UEW 3 ID 10T

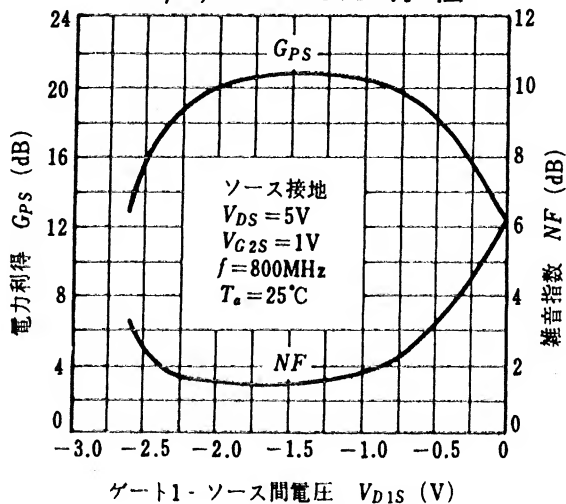
$I_D - V_{G1S}$  特性



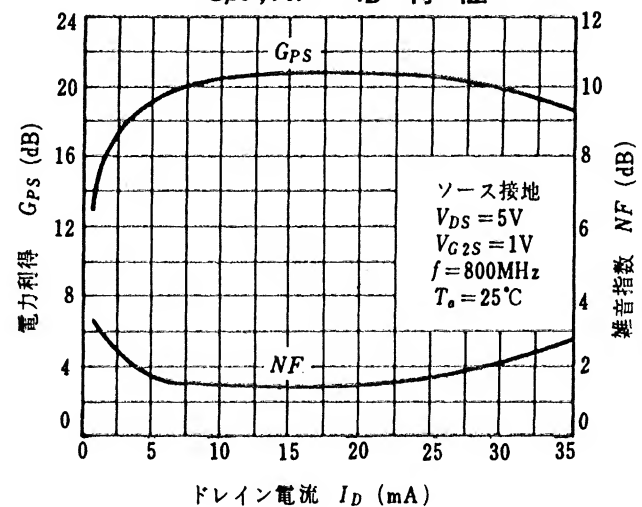
$G_{ps}, NF - V_{DS}$  特性



$G_{ps}, NF - V_{G1S}$  特性



$G_{ps}, NF - I_D$  特性



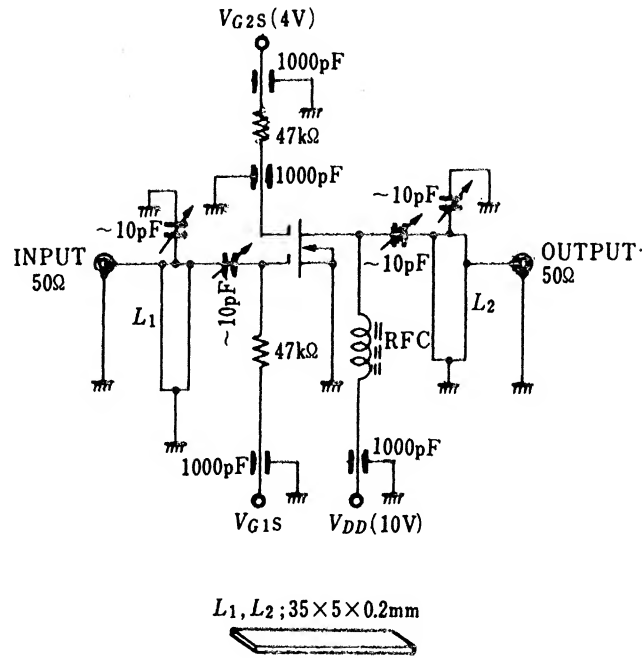
# 3SK123

## Si MOS型 複合Nチャンネル

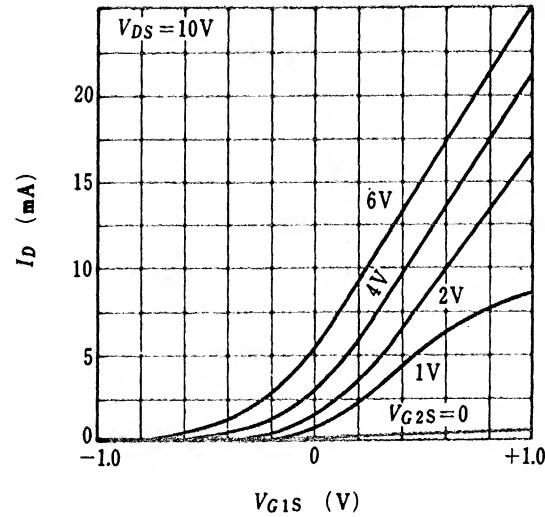
日電

$I_{DSS}$  区分 L: 0.01~2mA K: 1~6mA

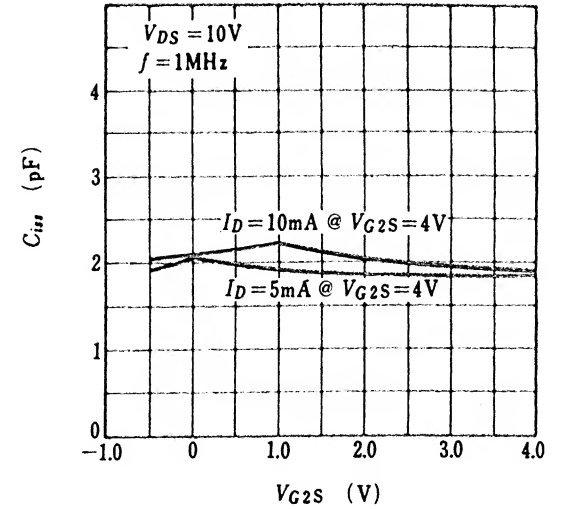
### 900MHz GPS, NF 測定回路



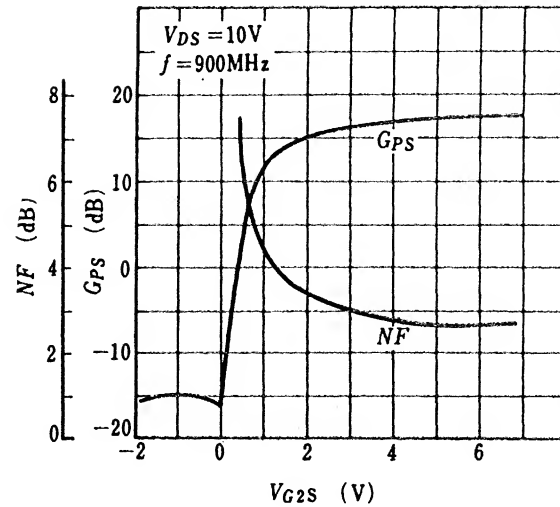
$I_D - V_{G1S}$  特性



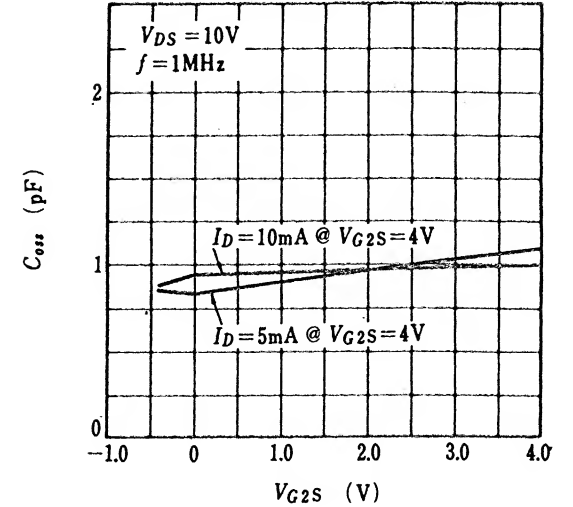
$C_{iss} - V_{G2S}$  特性



GPS, NF -  $V_{G2S}$  特性



$C_{oss} - V_{G2S}$  特性



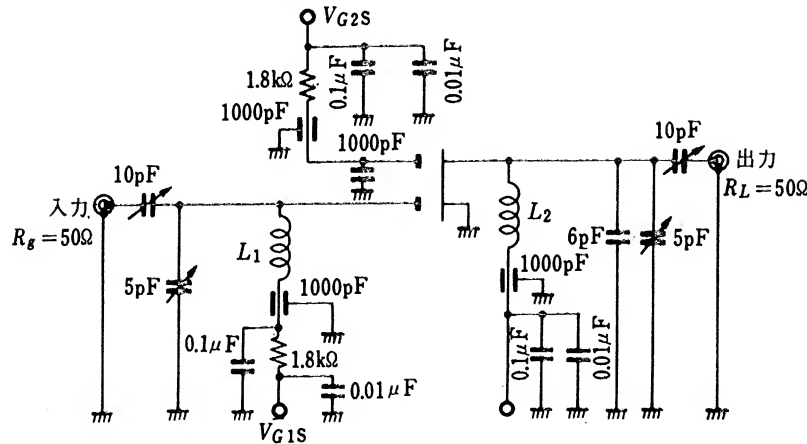
# 3SK126

## Si MOS型 複合Nチャンネル

東 芝

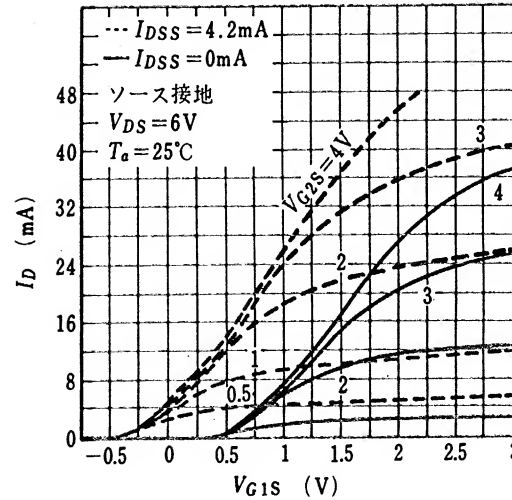
$I_{DSS}$  区分 O: 0~2mA, Y: 1~6mA

200MHz 電力利得, 雑音指数 測定回路

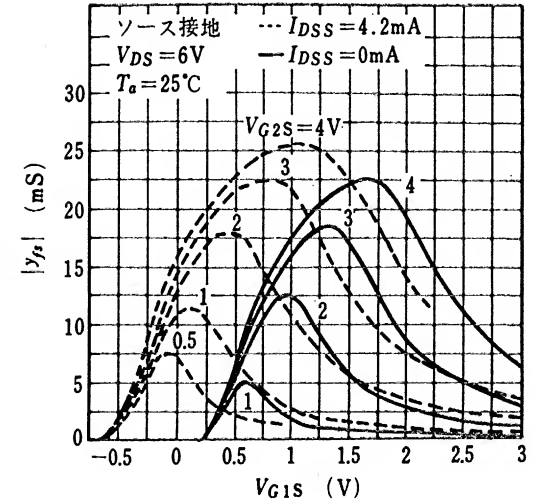


$L_1$ : 1mmφ 銀メッキ銅線, 2T, 8mm 内径  
 $L_2$ : 1mmφ 銀メッキ銅線, 2.5T, 8mm 内径

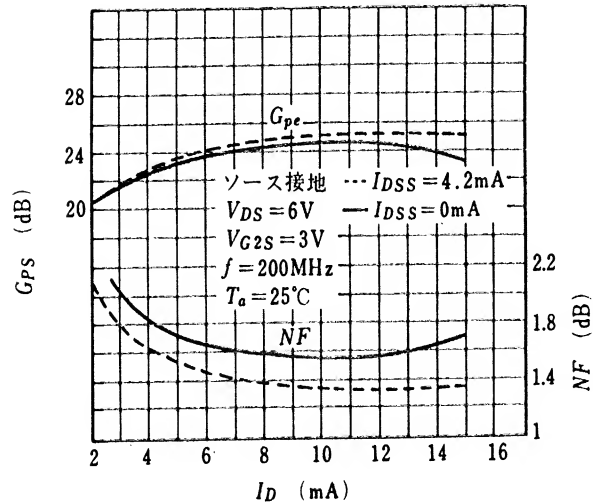
$I_D - V_{G1S}$  特性



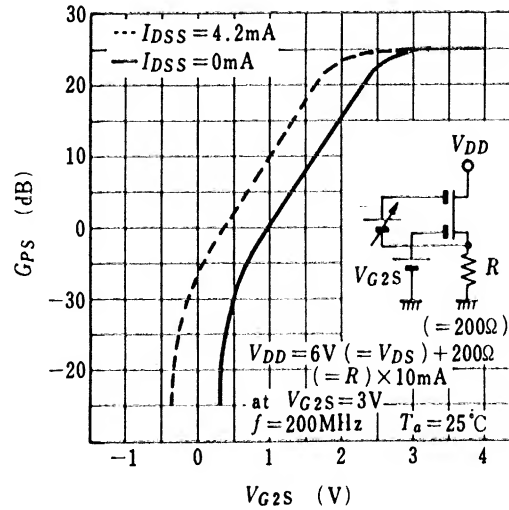
$|Y_{fs}| - V_{G1S}$  特性



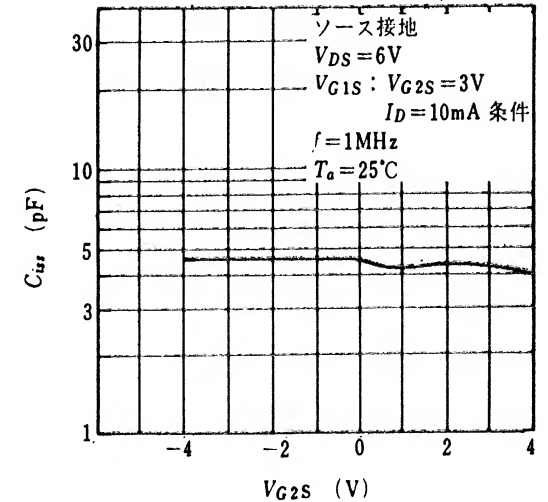
$G_{ps}, NF - I_D$  特性



$G_{ps} - V_{G2S}$  特性



$C_{iss} - V_{G2S}$  特性





# 3SK127

## Si MOS型 複合Nチャンネル

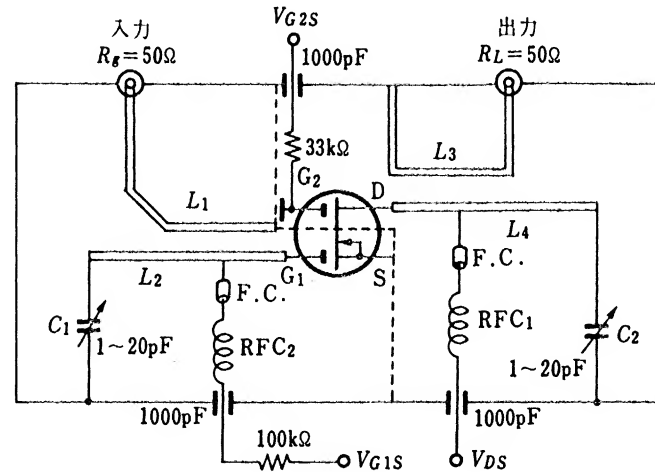
東 芝

$I_{DSS}$  区分

O : 0~2mA

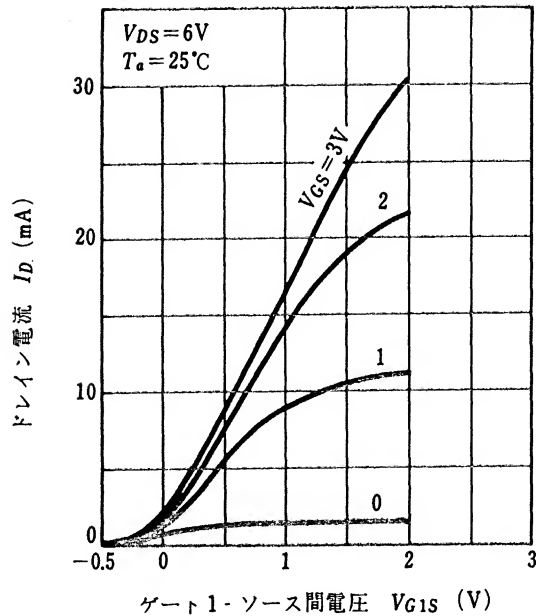
Y : 1~6mA

800MHz 電力利得, 雑音指数 測定回路

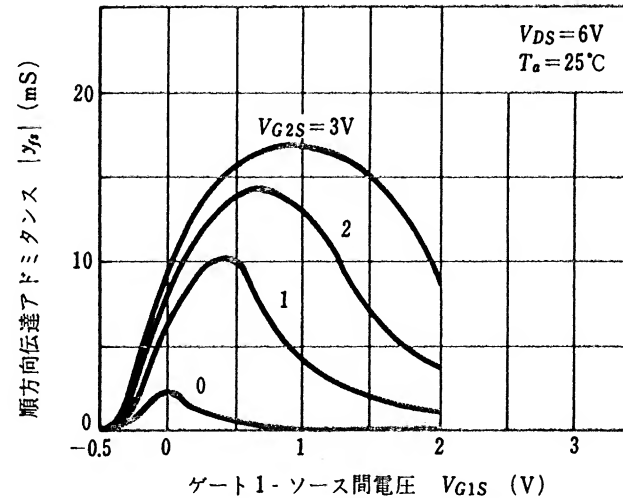


- $L_1 \sim L_4$  :  $\phi 1.0\text{mm}$  銀メッキ銅線
- $RFC_1$  :  $\phi 0.35\text{mm}$  銅線, 7.0T, 内径 3mm
- $RFC_2$  :  $\phi 0.35\text{mm}$  銅線, 10.0T, 内径 3mm
- $C_1, C_2$  : エアトリマ TTA 25A 200A  
村田製作所あるいは相当品
- $C_3$  : 1000pF (ディスクコンデンサ)
- F.C. : フェライト・コア

$I_D - V_{G1S}$  特性



$|y_{fs}| - V_{G1S}$  特性



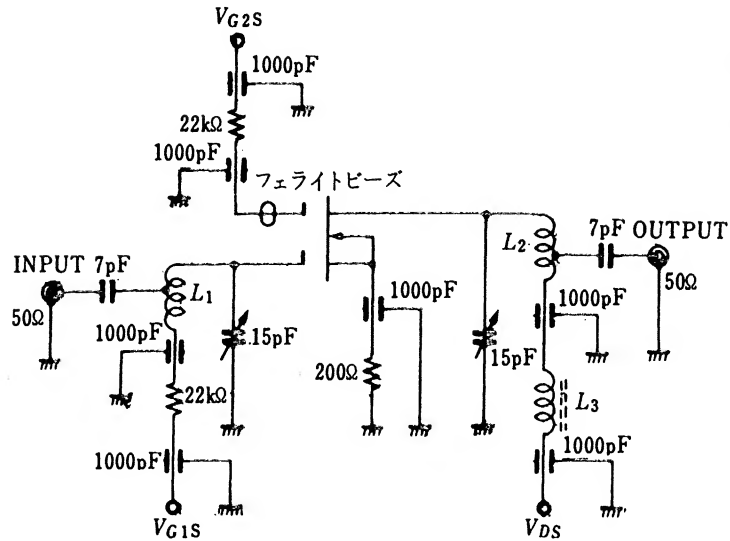
# 3SK131

## Si MOS型 複合Nチャンネル

日 電

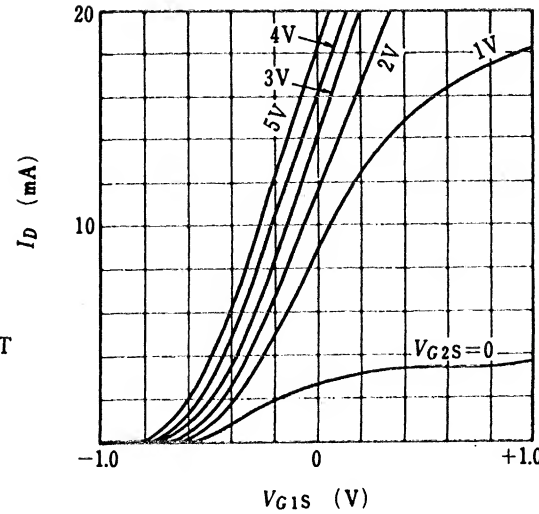
$I_{DSS}$  区分 V10 7~13mA V11 11~19mA V12 17~25mA

200MHz GPS, NF 測定回路

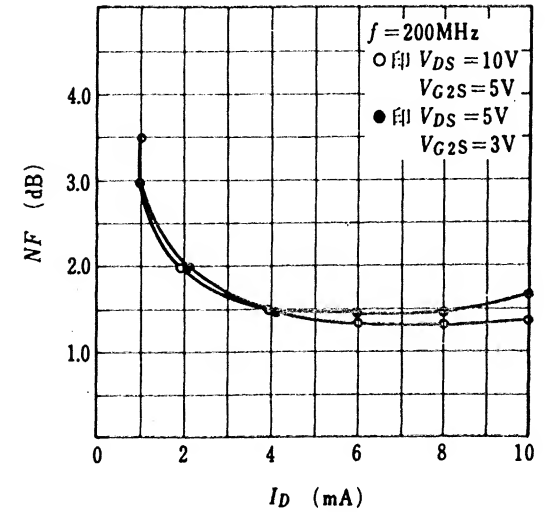


$L_1$ :  $\phi 0.6$ mm U.E.W. 7mm 3T  
 $L_2$ :  $\phi 0.6$ mm U.E.W. 7mm 3T  
 $L_3$ : RFC 2.2 $\mu$ H

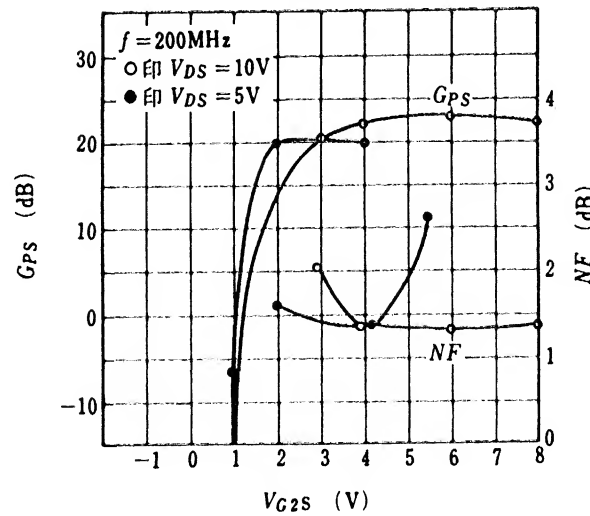
$I_D - V_{G1S}$  特性



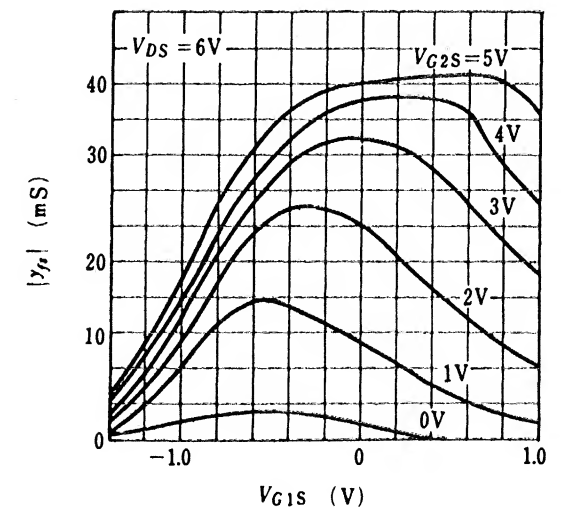
NF -  $I_D$  特性



GPS -  $V_{G2S}$  特性



$|y_{rs}| - V_{G1S}$  特性



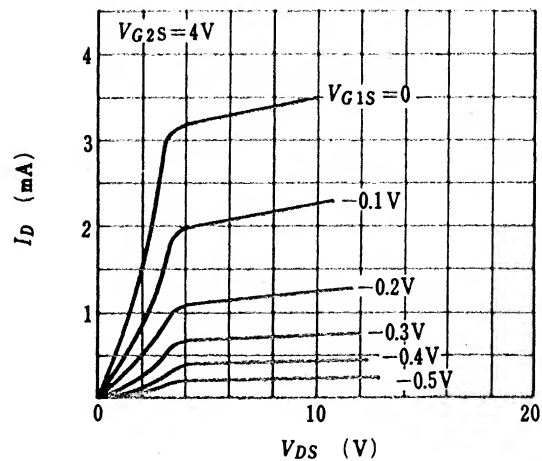
# 3SK132

## Si MOS 型 複合 N チャンネル

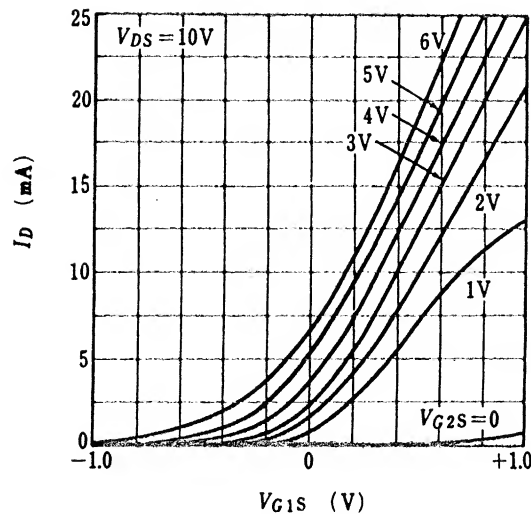
日 電

$I_{DSS}$  ランク U32 0.5~5mA U33 3~8mA

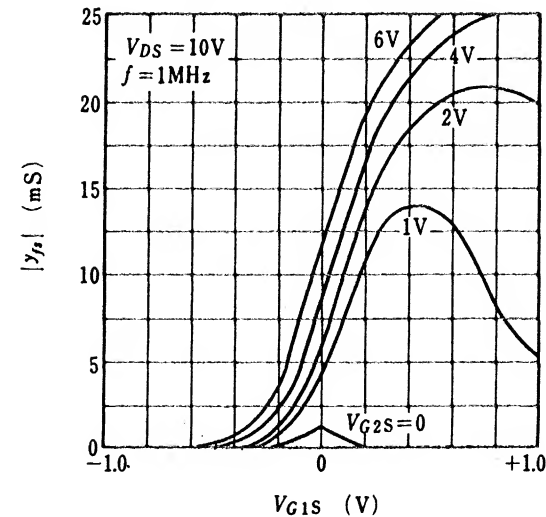
$I_D - V_{DS}$  特性



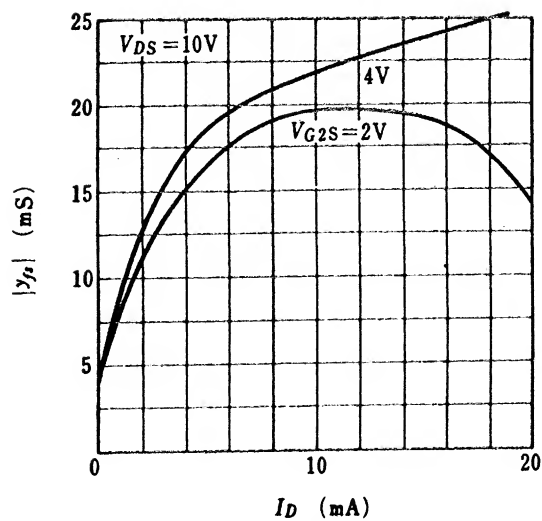
$I_D - V_{G1S}$  特性



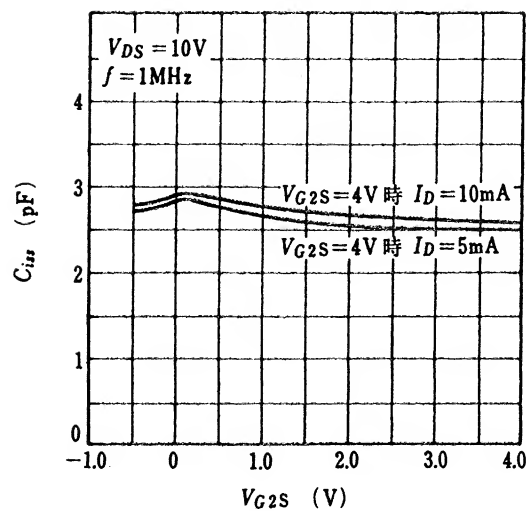
$|y_{fs}| - V_{G1S}$  特性



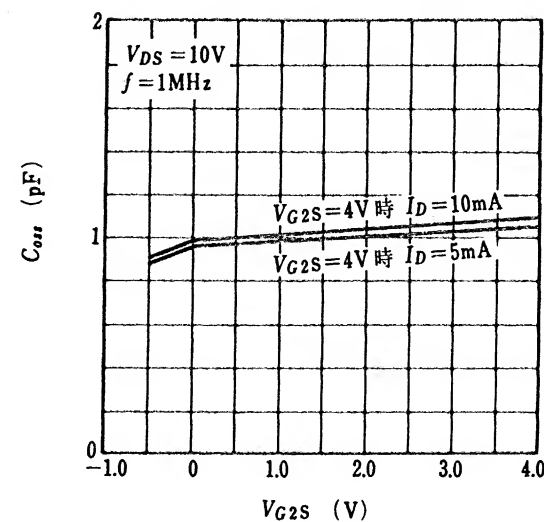
$|Y_{fs}| - I_D$  特性



$C_{iss} - V_{G2S}$  特性



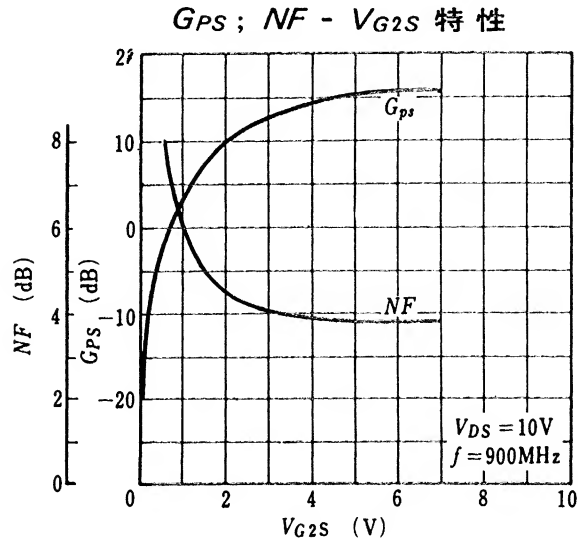
$C_{oss} - V_{G2S}$  特性



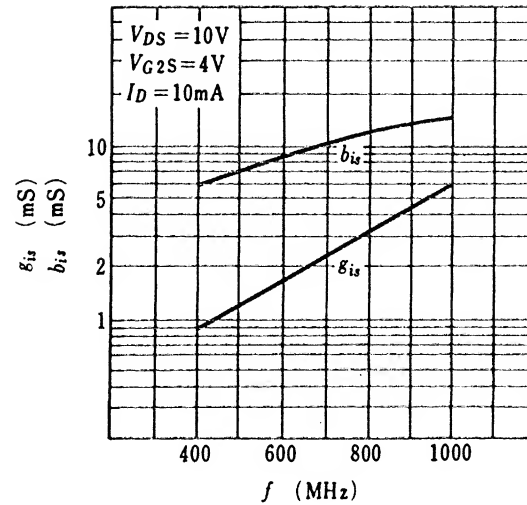
# 3SK133

## Si MOS 型 複合 N チャンネル

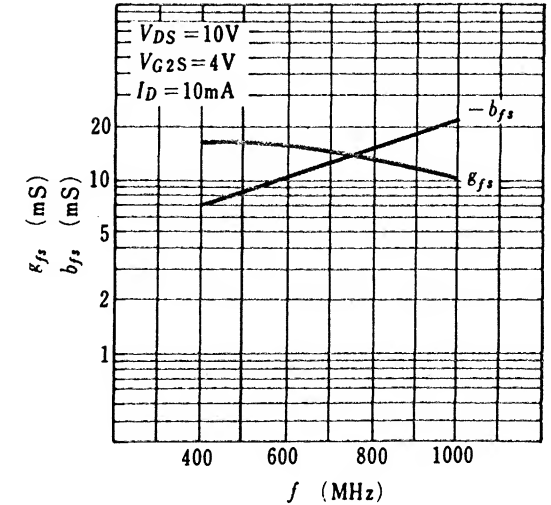
$I_{DSS}$  区分 U42 0.01~2mA U43 1~6mA



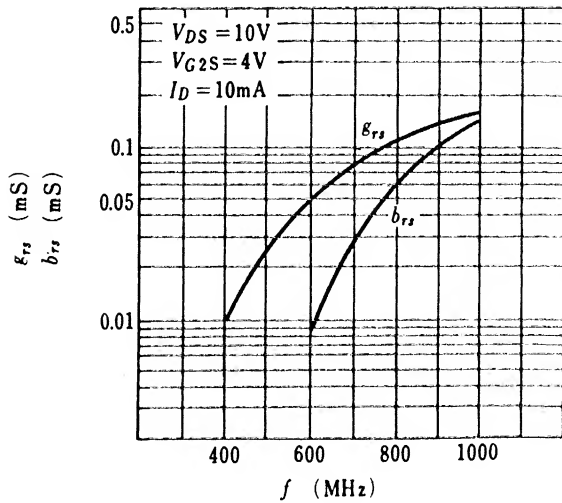
**$g_{is}, b_{is} - f$  特性**



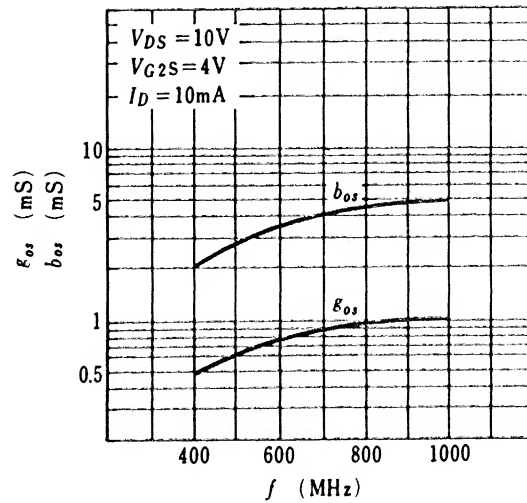
**$g_{fs}, b_{fs} - f$  特性**



**$g_{rs}, b_{rs} - f$  特性**



**$g_{os}, b_{os} - f$  特性**



# 3SK140

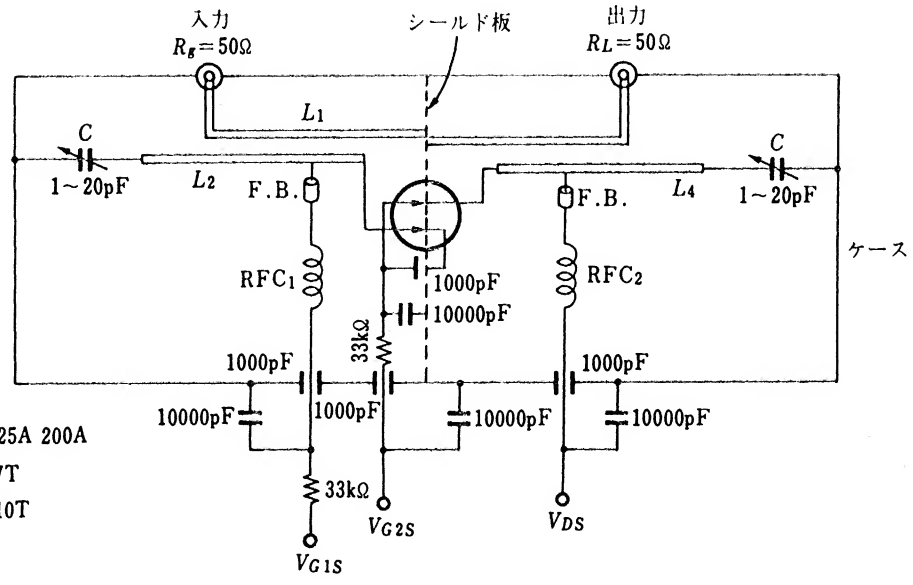
## GaAs MES型 複合Nチャンネル

東 芝

### 電力利得, 雑音指数および GR 測定回路

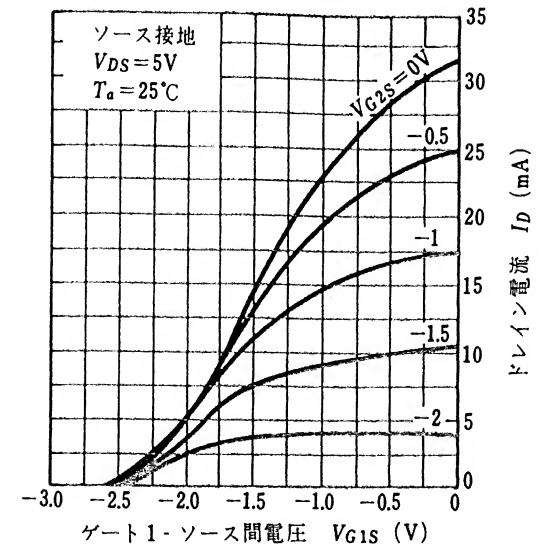
$I_{DSS}$  区分

Y : 20~35mA  
GR : 30~45mA

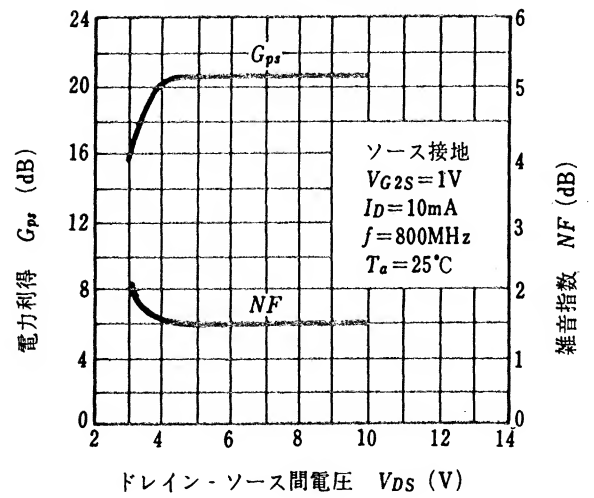


$L_1 \sim L_4$  : 0.8mmφ 銀メッキ線  
 C : エアトリマ 村田 TTA25A 200A  
 RFC<sub>1</sub> : 0.35mmφ UEW 3I. D. 7T  
 RFC<sub>2</sub> : 0.35mmφ UEW 3I. D. 10T

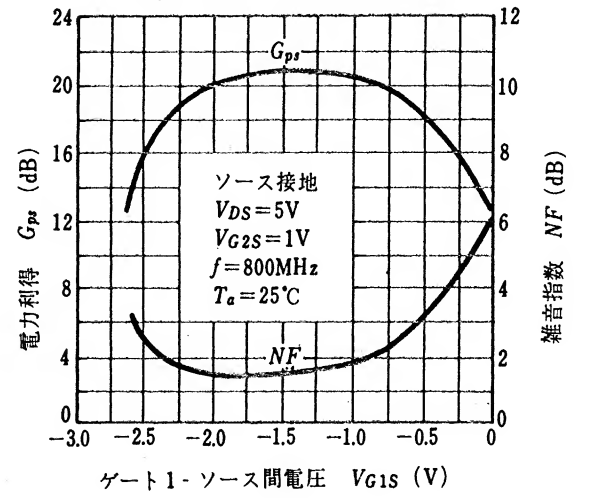
### $I_D - V_{G1S}$ 特性



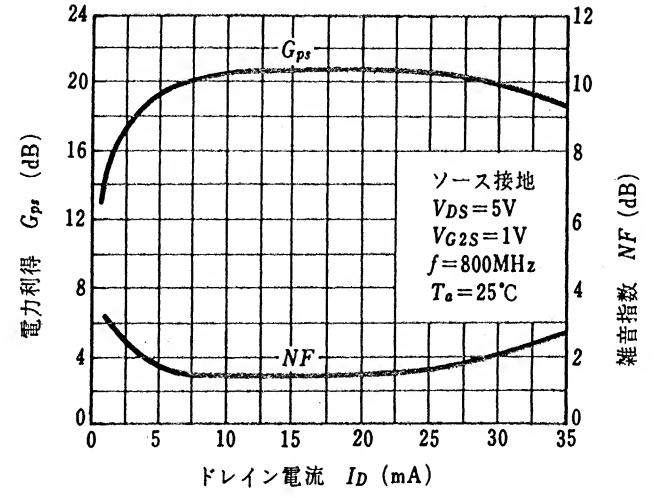
### $G_{ps}, NF - V_{DS}$ 特性



### $G_{ps}, NF - V_{G1S}$ 特性



### $G_{ps}, NF - I_D$ 特性



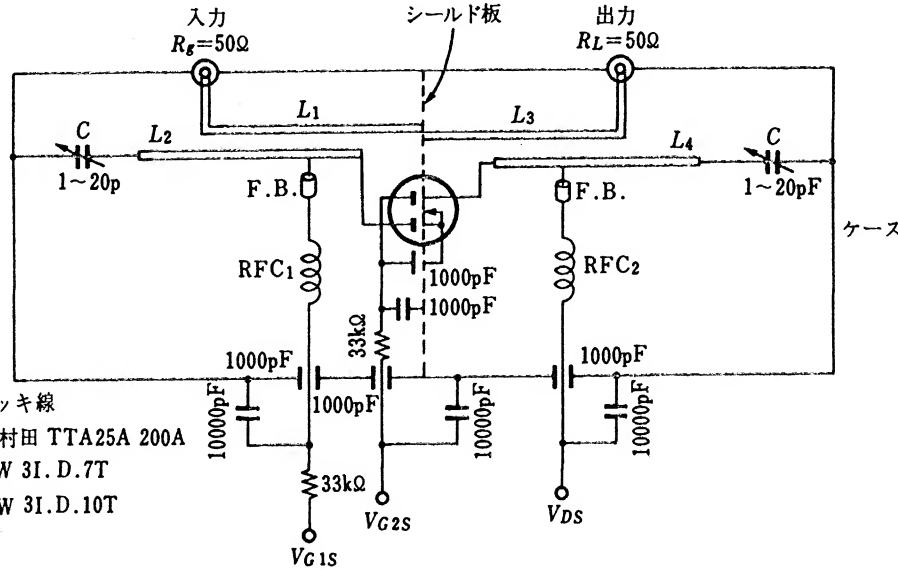
# 3SK145, 146

## Si MOS型 複合Nチャンネル

電力利得および雑音指数測定回路

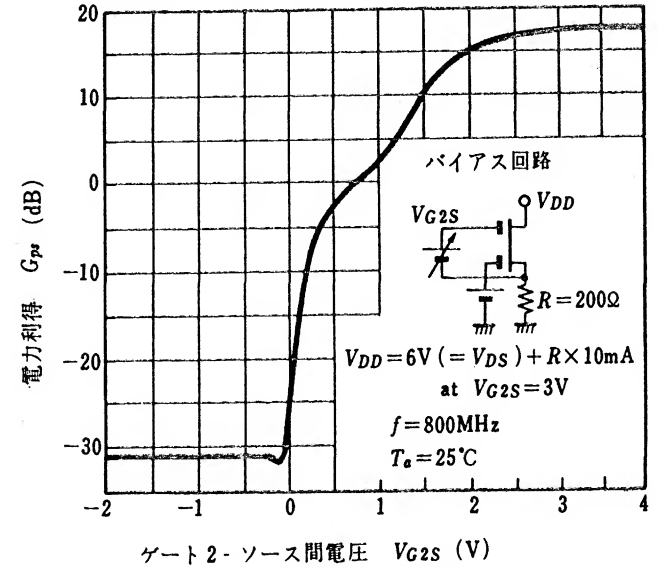
$I_{DSS}$  区分

- O : 0~2mA
- Y : 1~6mA

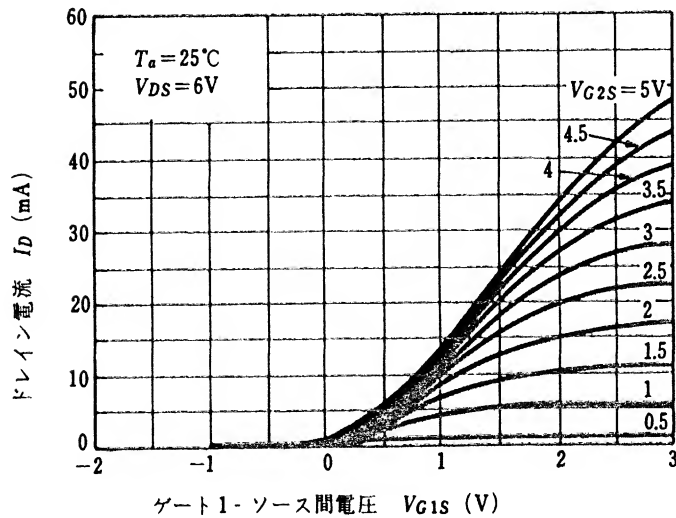


- $L_1 \sim L_4$  :  $\phi 0.8\text{mm}$  銀メッキ線
- C : エアトリマ 村田 TTA25A 200A
- RFC1 :  $0.35\text{mm}\phi$  UEW 3I.D.7T
- RFC2 :  $0.35\text{mm}\phi$  UEW 3I.D.10T

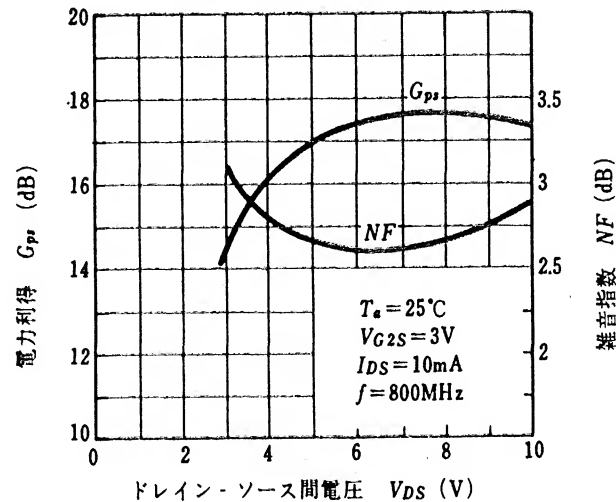
$G_{ps} - V_{G2S}$  特性



$I_D - V_{G1S}$  特性



$G_{ps}, NF - V_{DS}$  特性



# 3SK150, 151

## Si MOS型 複合Nチャンネル

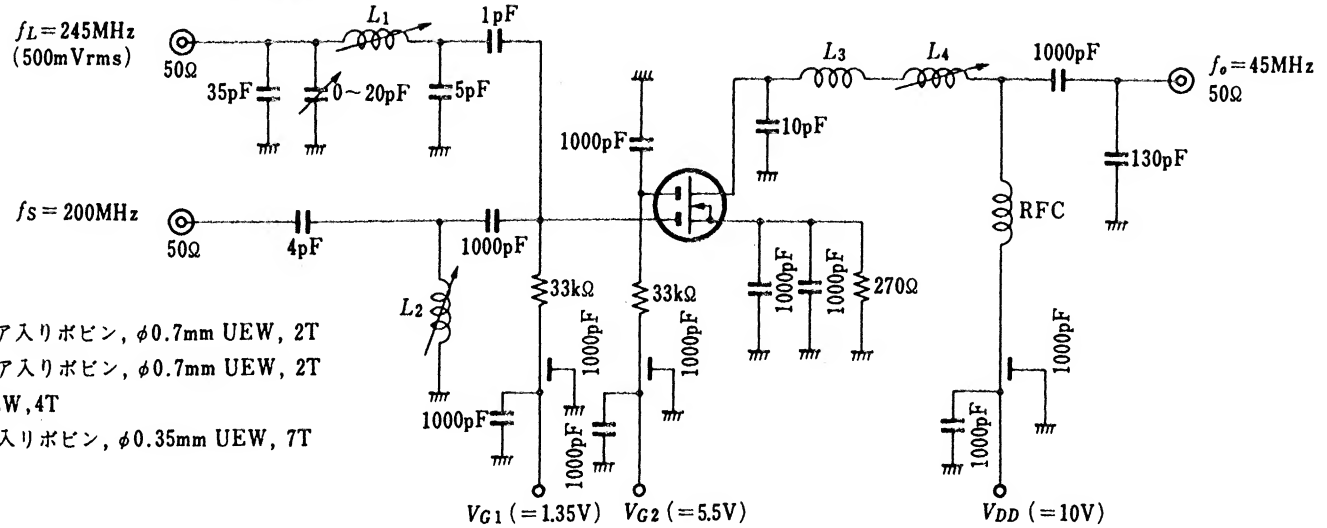
東 芝

$I_{DSS}$  区分

Y : 3~7mA

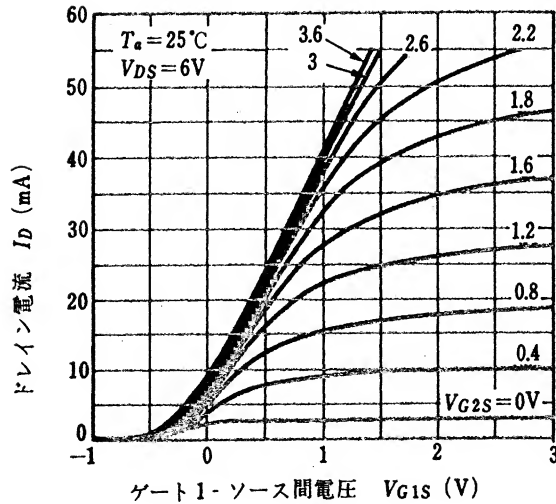
GR : 6~14mA

$G_{cs}, NF_{cs}$  測定回路

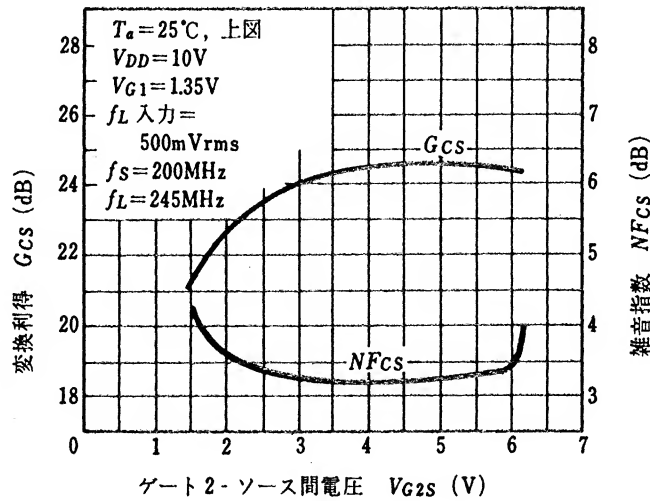


- $L_1$  :  $\phi 6.5\text{mm}$  フェライトコア入りボビン,  $\phi 0.7\text{mm}$  UEW, 2T
- $L_2$  :  $\phi 6.5\text{mm}$  フェライトコア入りボビン,  $\phi 0.7\text{mm}$  UEW, 2T
- $L_3$  :  $3\text{mm I. D.}$   $\phi 0.5\text{mm}$  UEW, 4T
- $L_4$  :  $\phi 8\text{mm}$  フェライトコア入りボビン,  $\phi 0.35\text{mm}$  UEW, 7T
- RFC :  $100\mu\text{H}$

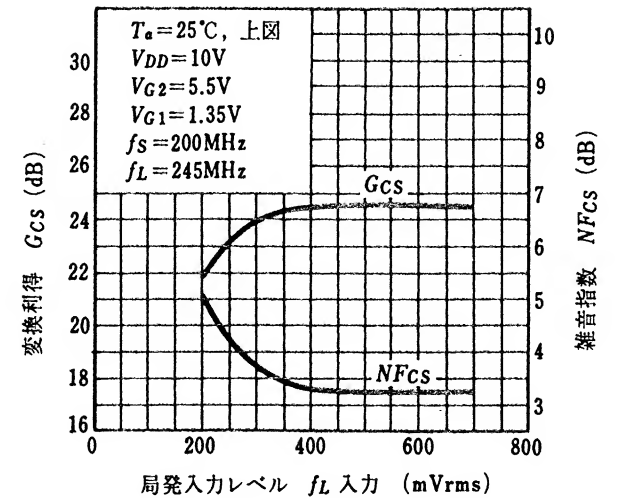
$I_D - V_{G1S}$  特性



$G_{cs}, NF_{cs} - V_{G2S}$  特性



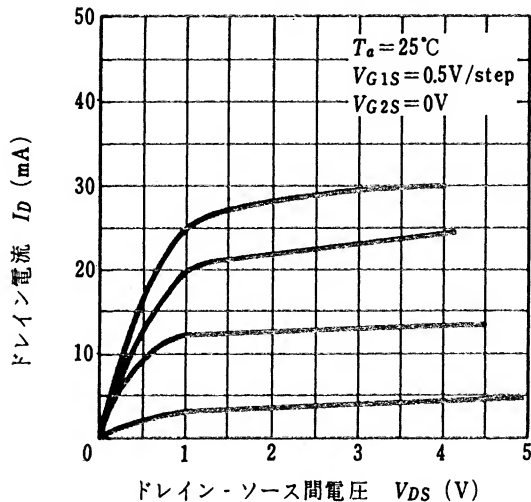
$G_{cs}, NF_{cs} - f_L$  入力特性



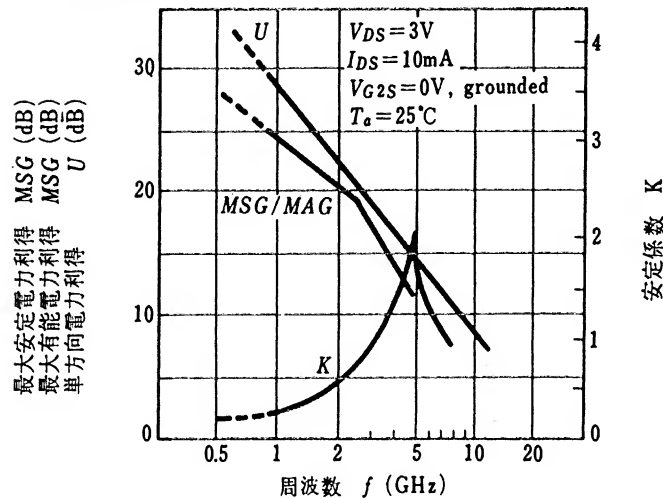
# MGF1100

## GaAs型 複合Nチャンネル

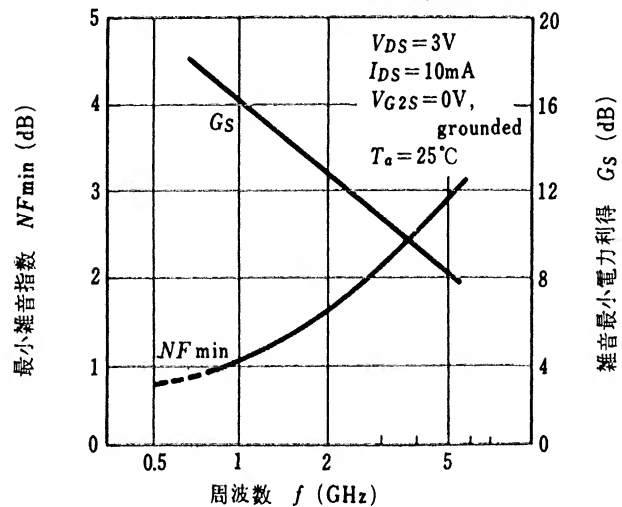
ソース接地出力特性



最大安定電力利得, 最大有能電力利得,  
単方向電力利得, 安定係数 - 周波数特性



最小雑音指数, 雑音最小電力利得  
- 周波数特性



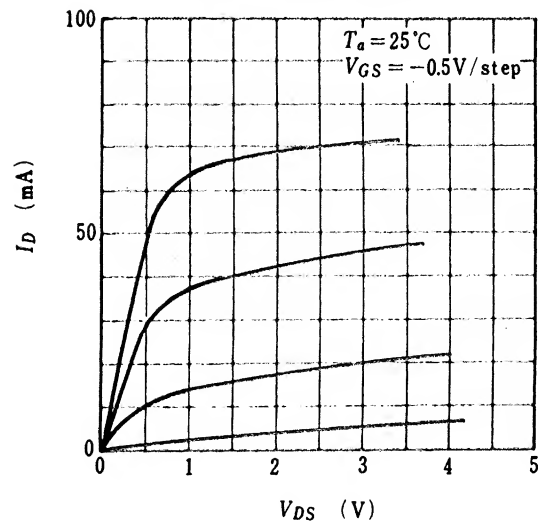


# MGF1202

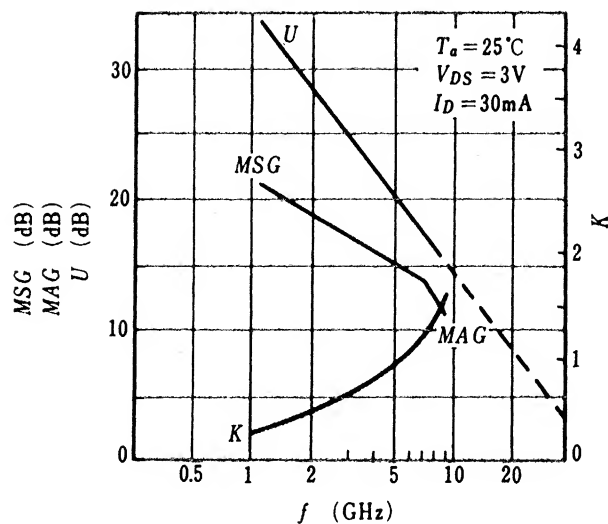
GaAs 型  
Nチャンネル

三菱

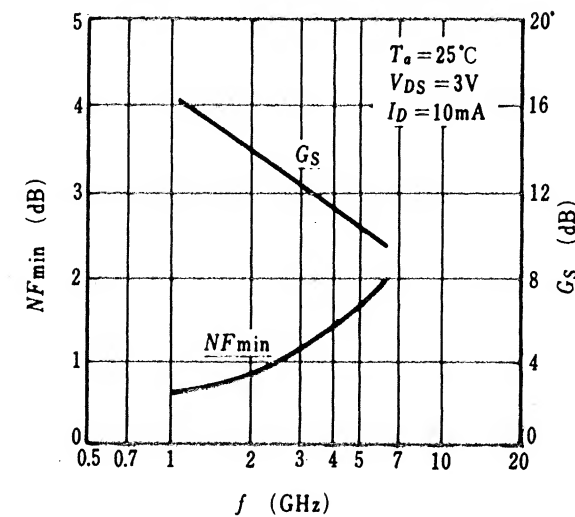
ソース接地出力特性



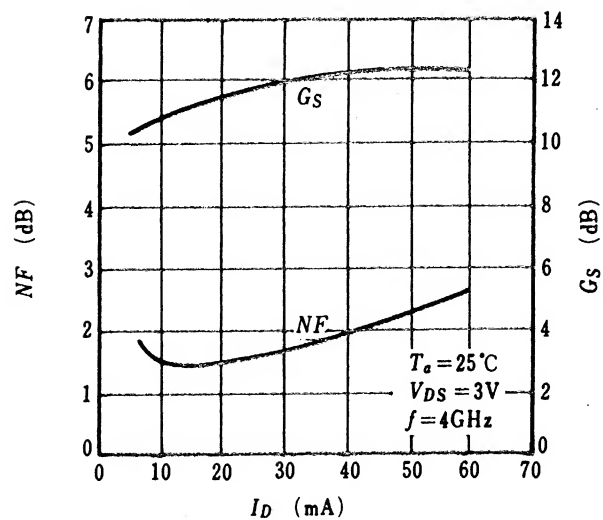
MSG, MAG, U, K - f 特性



NFmin,  $G_s$  - f 特性



NF,  $G_s$  -  $I_D$  特性

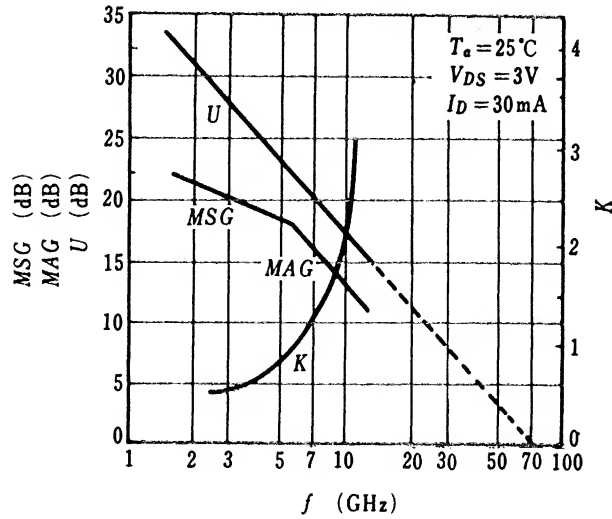


# MGF1402, 1421

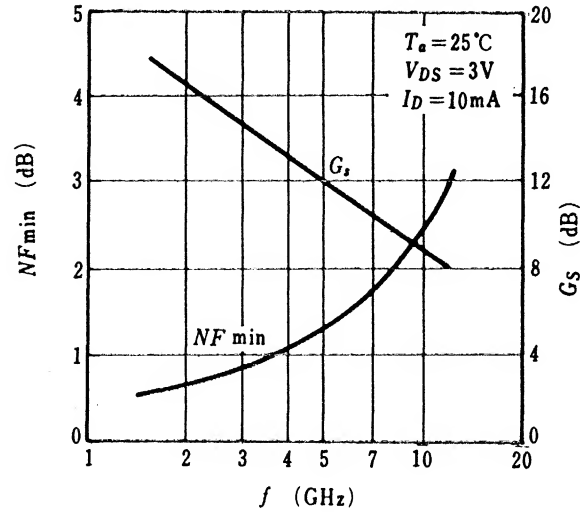
GaAs 型  
Nチャンネル

三 菱

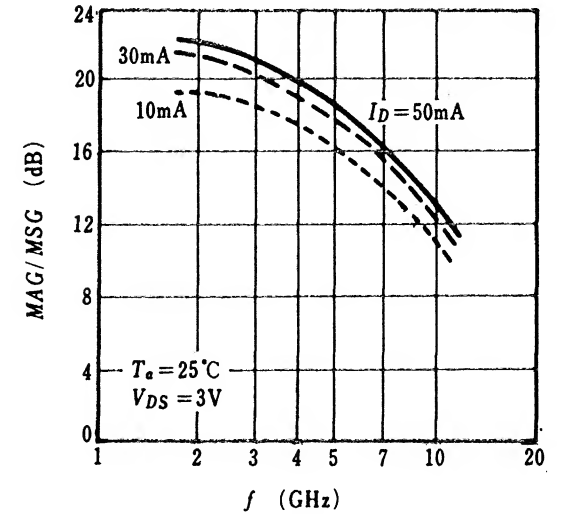
MSG, MAG, U, K - f 特性



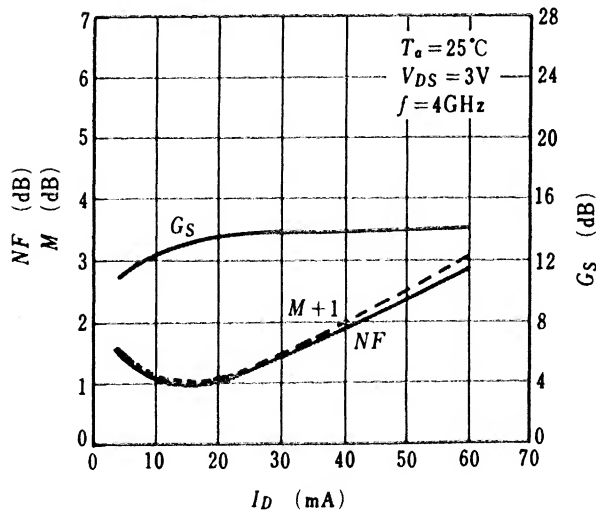
NFmin,  $G_s$  - f 特性



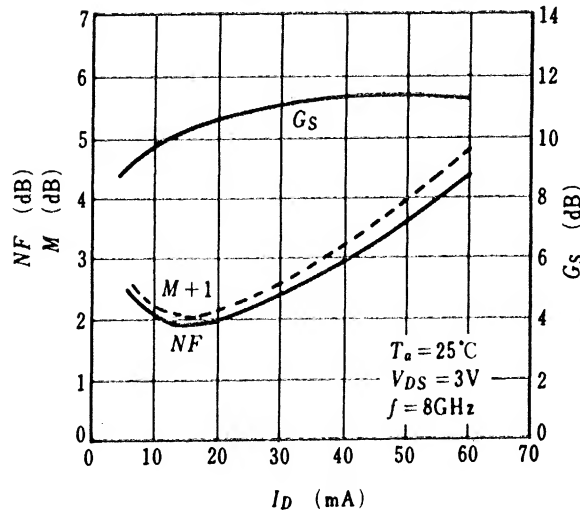
MAG, MSG, - f 特性



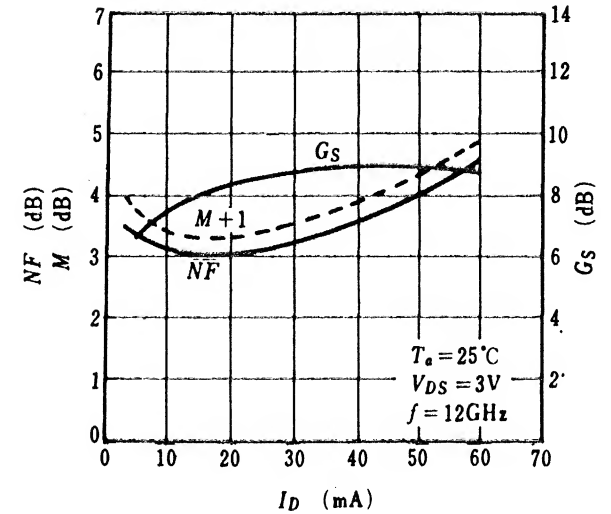
NF, M,  $G_s$  -  $I_D$  特性



NF, M,  $G_s$  -  $I_D$  特性



NF, M,  $G_s$  -  $I_D$  特性

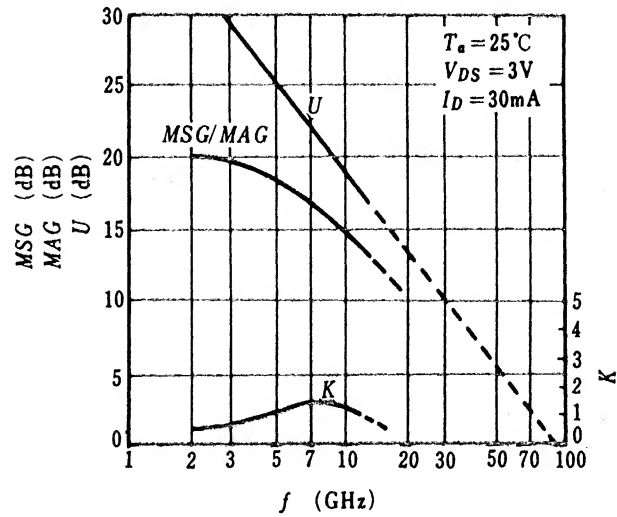


# MGF1403

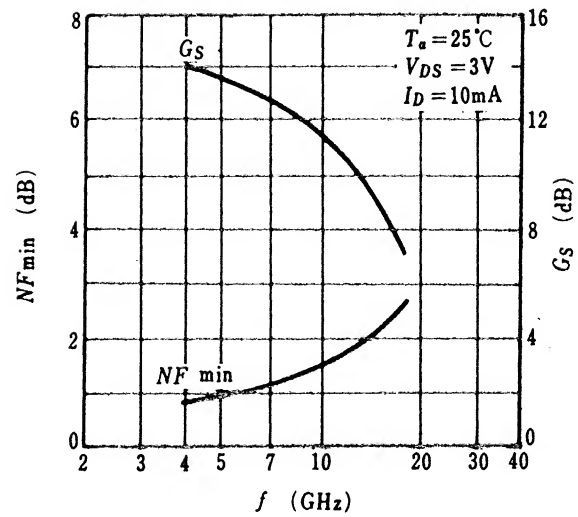
## GaAs型 Nチャンネル

三菱

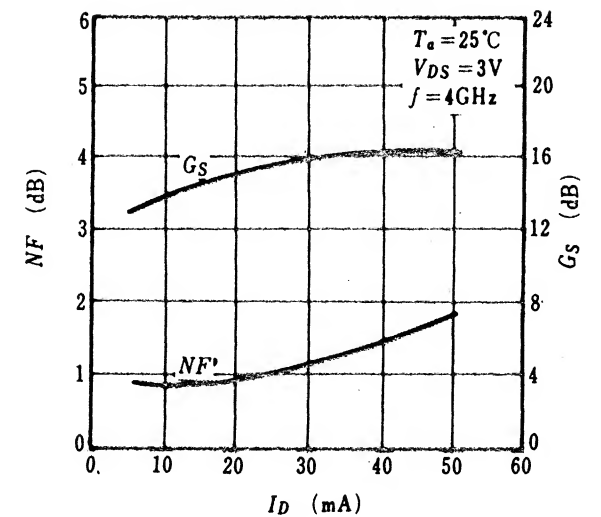
### MSG, MAG, U, K - f 特性



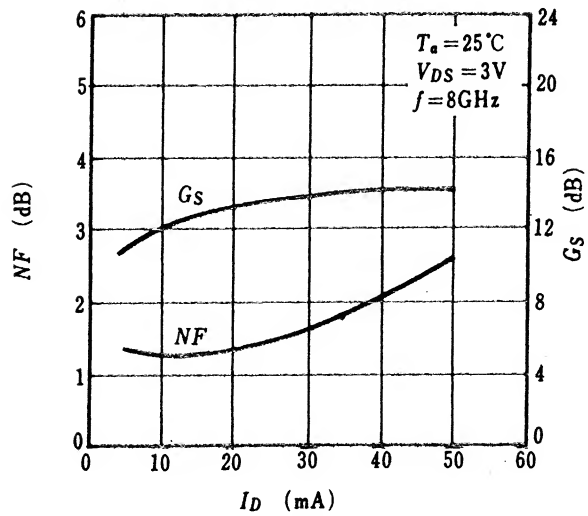
### NFmin, $G_s - f$ 特性



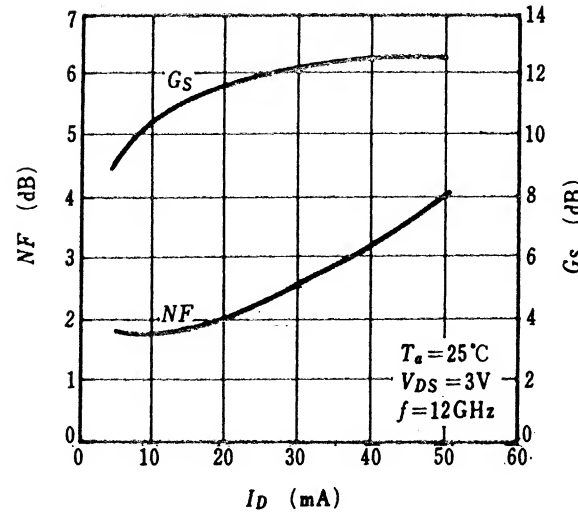
### NF, $G_s - I_D$ 特性



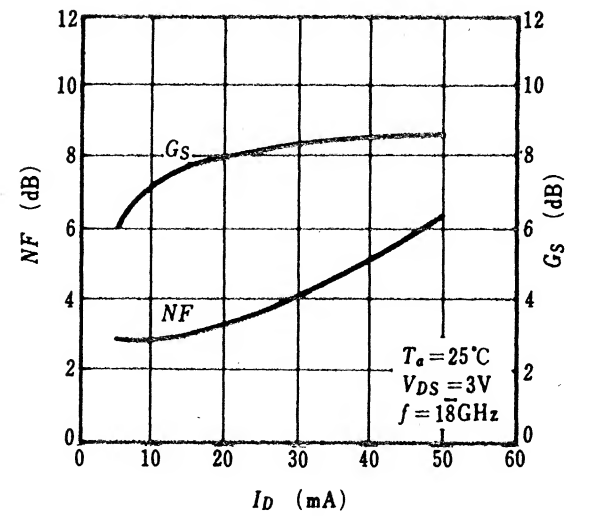
### NF, $G_s - I_D$ 特性



### NF, $G_s - I_D$ 特性



### NF, $G_s - I_D$ 特性



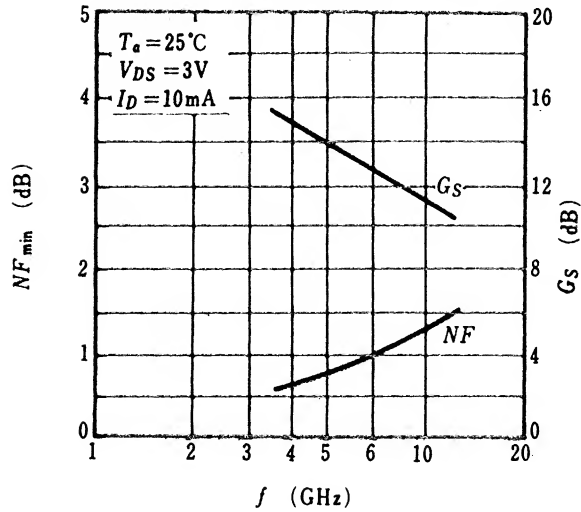


# MGF1404, 1412

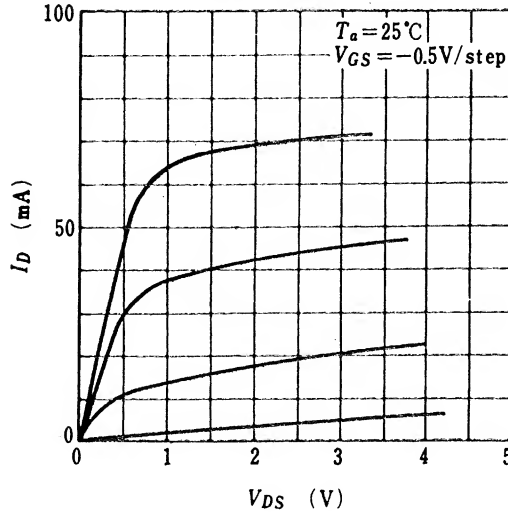
GaAs 型  
Nチャンネル

三 菱

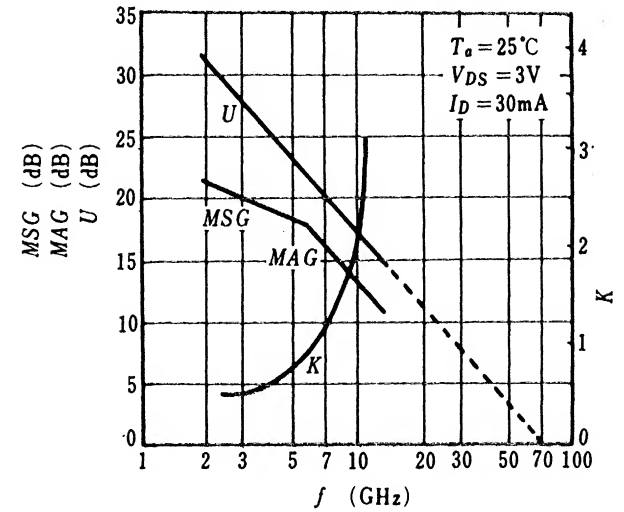
MGF1404  
NFmin,  $G_s - f$  特性



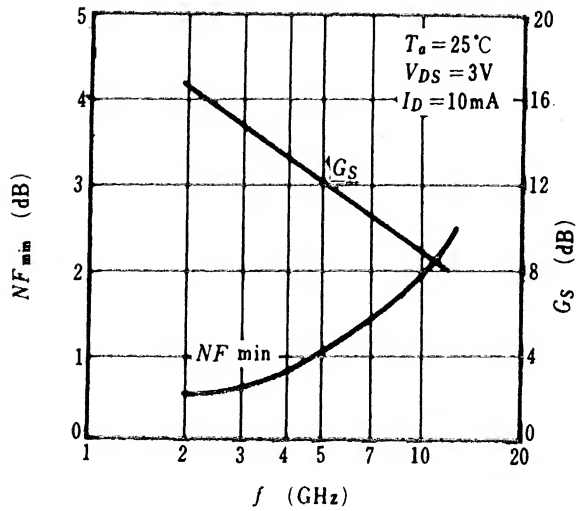
MGF1412  
ソース接地出力特性



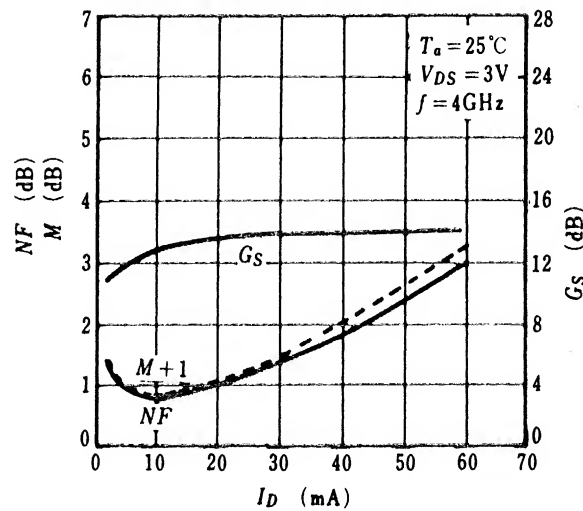
MGF1412  
MSG, MAG, U, K - f 特性



MGF1412  
NFmin,  $G_s - f$  特性



MGF1412  
NF, M,  $G_s - I_D$  特性



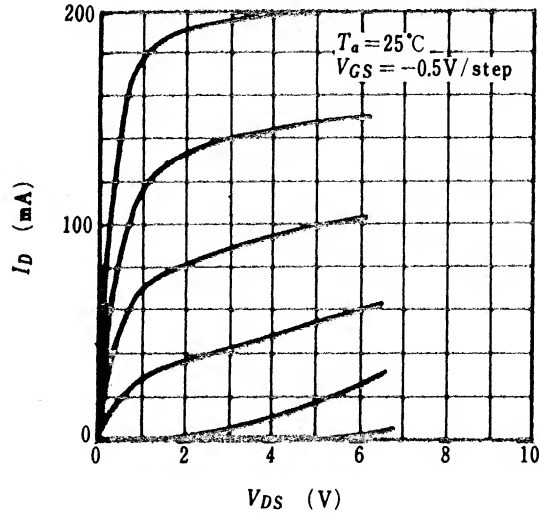


# MGF1801, 1802

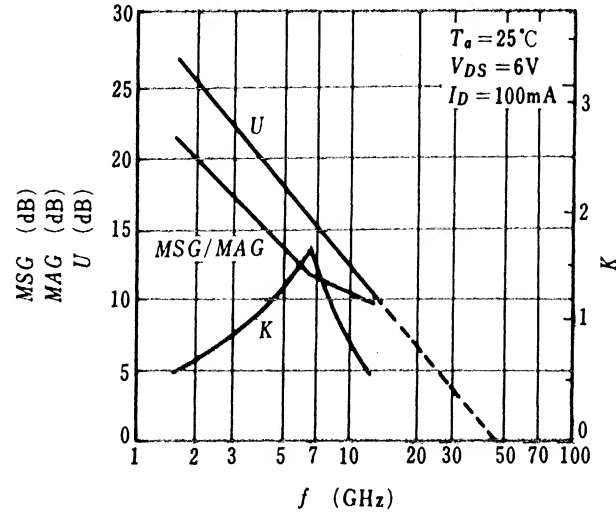
GaAs 型  
Nチャンネル

三 菱

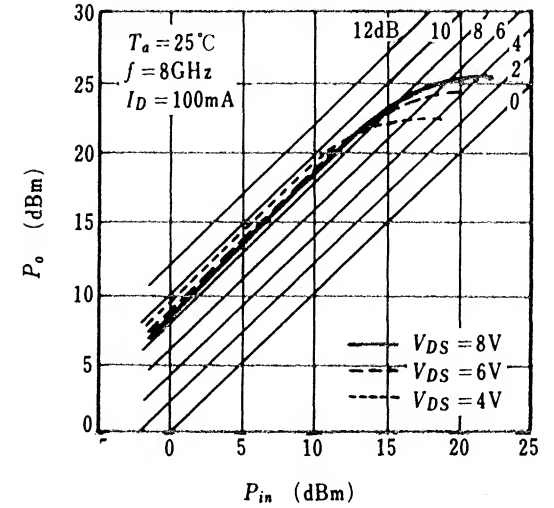
MGF1801  
ソース接地出力特性



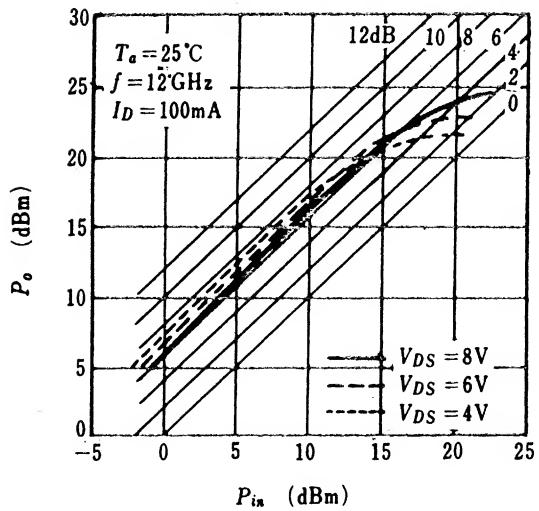
MGF1801  
MSG, MAG, U, K - f 特性



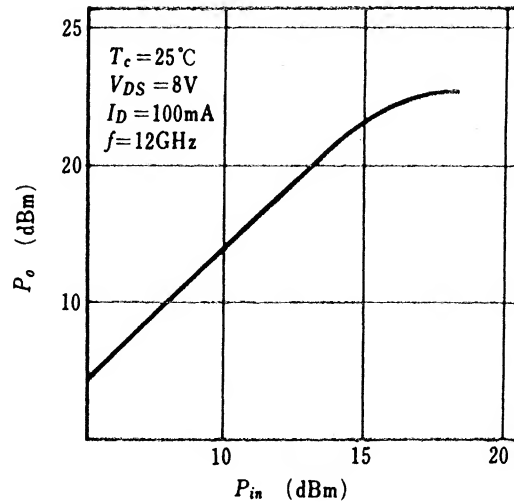
MGF1801  
 $P_o - P_{in}$  特性



MGF1801  
 $P_o - P_{in}$  特性



MGF1802  
 $P_o - P_{in}$  特性

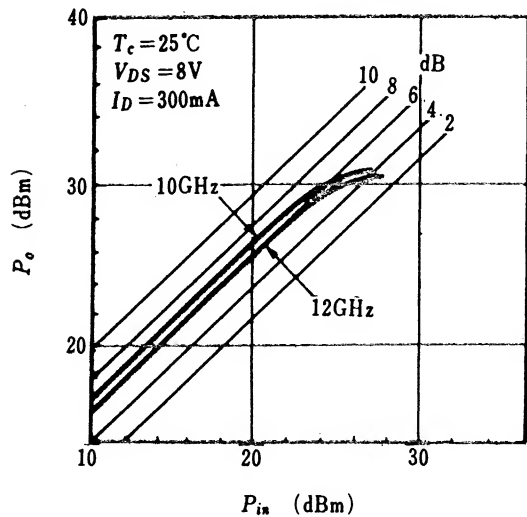


# MGF2124, F, G

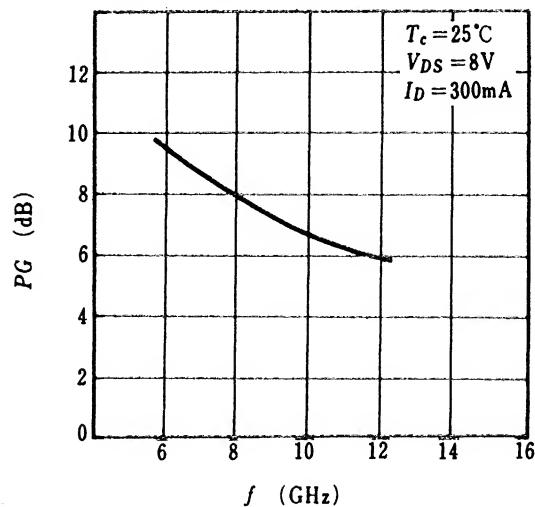
GaAs 型  
Nチャンネル

三 菱

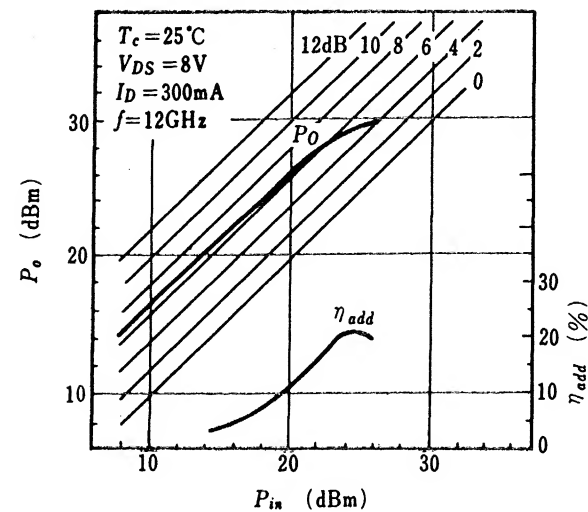
MGF2124  
 $P_o - P_{in}$  特性



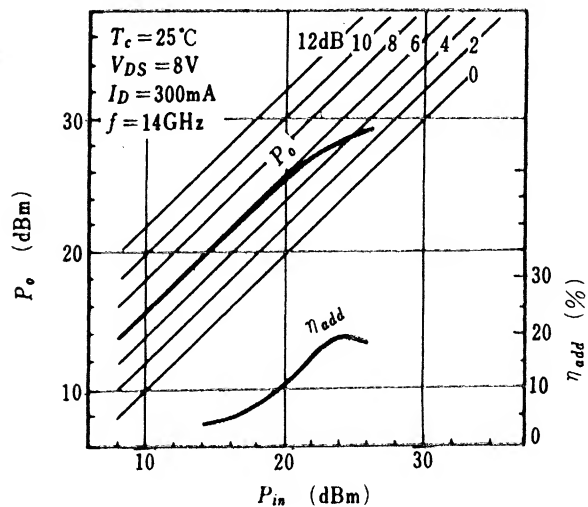
MGF2124  
 $GP - f$  特性



MGF2124F, G  
 $P_o - P_{in}$  特性



MGF2124F, G  
 $P_o - P_{in}$  特性



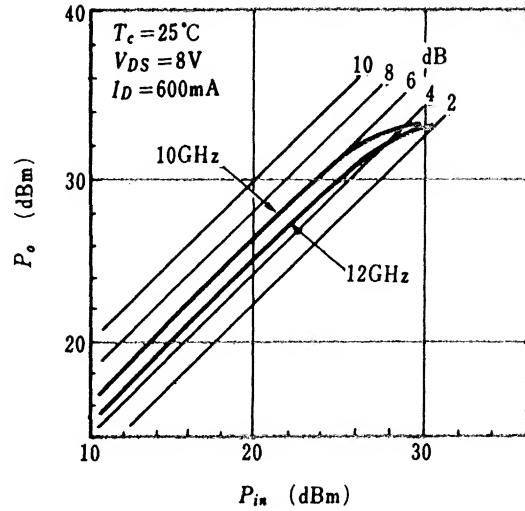
# MGF2148, F, G

GaAs 型  
Nチャンネル

三 菱

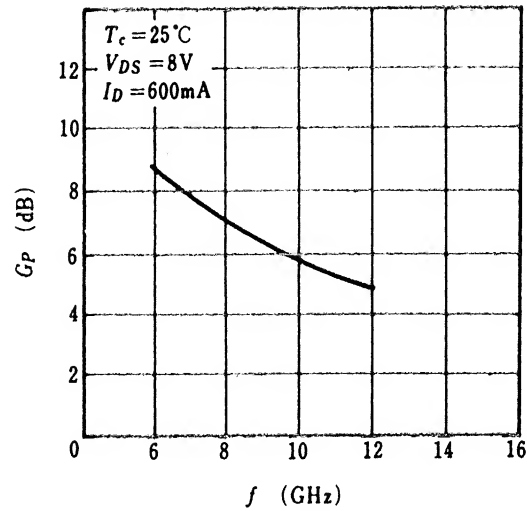
MGF2148

$P_o - P_{in}$  特性



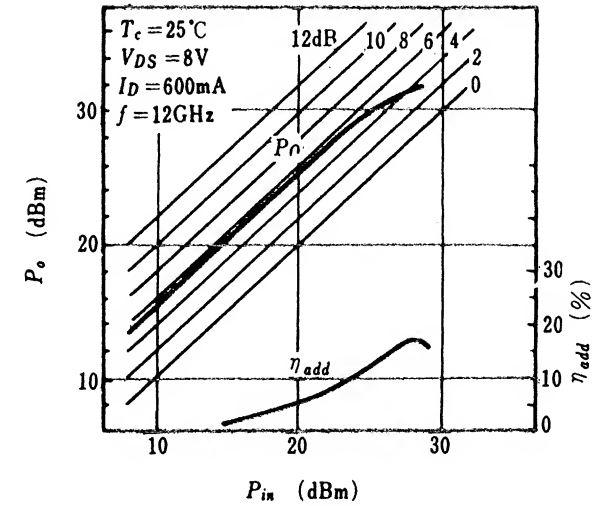
MGF2148

$G_P - f$  特性



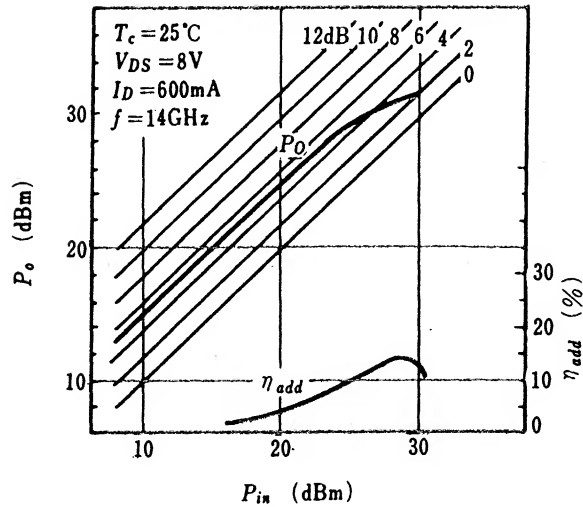
MGF2148F, G

$P_o - P_{in}$  特性



MGF2148F, G

$P_o - P_{in}$  特性

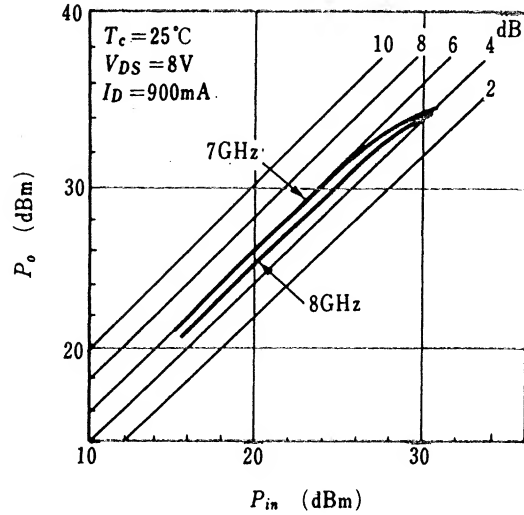




# MGF2172, 2205, X34M GaAs型 Nチャンネル

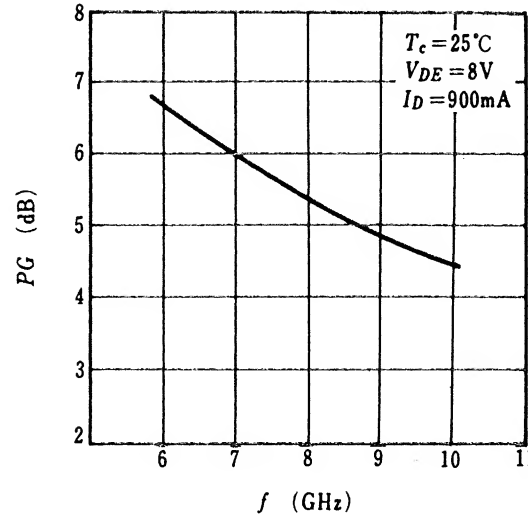
MGF2172

$P_o - P_{in}$  特性



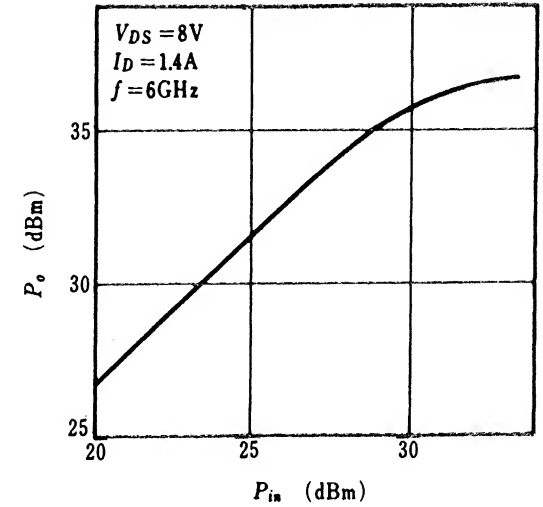
MGF2172

$G_P - f$  特性



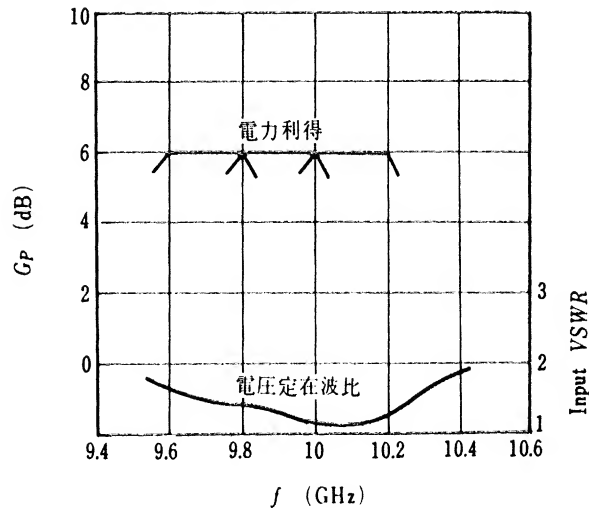
MGF2205

$P_o - P_{in}$  特性



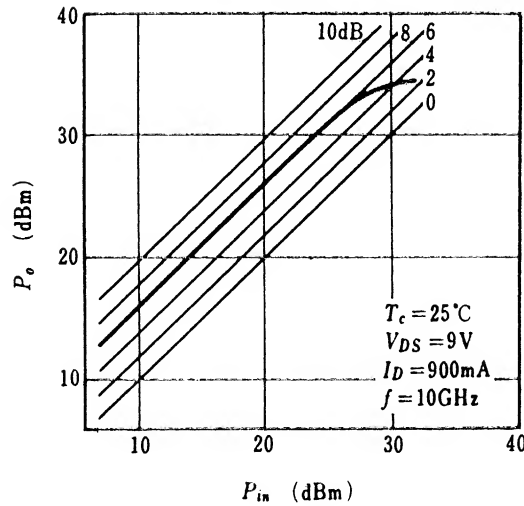
MGF - X34M

$G_P, V_{SWR} - f$  特性

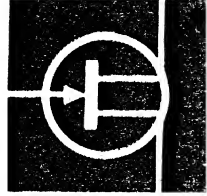


MGF - X34M

$P_o - P_{in}$  特性







パワーMOS FET  
主要規格一覧表  
(外国製)

## 規格表の見方

(1) 社名

ITS : Intersil Inc.

RCA : RCA Corp.

SL : Siliconix Inc.

SPT : Supertex Inc.

(2) チャンネルの欄のP/Nは、1パッケージ内にPチャンネルとNチャンネルの両方のFETが入っていることを示します。

(3) 最大消費電力の欄の/Uは、1パッケージ内に複数個入っているFETの、1個当りの最大消費電力を示します。

(4) 外囲器の欄のPDIP, CDIPは、それぞれプラスチックDIP, セラミックDIPのことです。

(5) 備考の欄の“\*”は、1パッケージ内のFETの個数を示します。

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
2N6656	SL	N	35					2				25	TO-3	
2N6657	SL	N	60					2				25	TO-3	
2N6658	SL	N	90					1.9				25	TO-3	
2N6659	SL	N	35					1.4				6.25	TO-39	
2N6660	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
2N6660	SPT	N	60					1.1				6.25	TO-39	
2N6660	SL	N	60					1.1				6.25	TO-39	
2N6661	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
2N6661	SPT	N	90				0.9					6.25	TO-39	
2N6661	SL	N	90				0.9					6.25	TO-39	
AN0120NA	SPT	N		200			0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0120NB	SPT	N		200			0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0120ND	SPT	N		200										CHIP
AN0130NA	SPT	N		300			0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0130NB	SPT	N		300			0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0130ND	SPT	N		300										CHIP
AN0140NA	SPT	N			400		0.03					1.5/U	PDIP18P	2SK*8
AN0140NB	SPT	N			400		0.04					2/U	CDIP18P	2SK*8
AN0140ND	SPT	N			400									CHIP
AP0120NA	SPT	P		-200			-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0120NB	SPT	P		-200			-.015					2/U	CDIP18P	2SJ*8
AP0120ND	SPT	P		-200										CHIP
AP0130NA	SPT	P		-300			-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0130NB	SPT	P		-300			-.015					2/U	CDIP18P	2SJ*8
AP0130ND	SPT	P		-300										CHIP
AP0140NA	SPT	P			-400		-.015					1.5/U	PDIP18P	2SJ*8
AP0140NB	SPT	P			-400		-.015					2/U	CDIP18P	
AP0140ND	SPT	P			-400									CHIP
INV5000ANF	ITS	N	80				0.7					2	TO-237	
INV5000ANH	ITS	N	100				0.7					2	TO-237	

型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外囲器	備考	
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1				
INV5001TND	ITS	N	40					1.2				6.25	TO-39		
IRF120	SL	N	100								8	40	TO-3		
IRF121	SL	N	60								8	40	TO-3		
IRF122	SL	N	100								7	40	TO-3		
IRF123	SL	N	60								7	40	TO-3		
IRF130	RCA	N	100									14	75	TO-204AE/AA	
IRF130	SL	N	100									14	75	TO-3	
IRF131	RCA	N	60									14	75	TO-204AE/AA	
IRF131	SL	N	60									14	75	TO-3	
IRF132	RCA	N	100									12	75	TO-204AE/AA	
IRF132	SL	N	100									12	75	TO-3	
IRF133	RCA	N	60									12	75	TO-204AE/AA	
IRF133	SL	N	60									12	75	TO-3	
IRF140	SL	N	100									27	125	TO-3	
IRF141	SL	N	60									27	125	TO-3	
IRF142	SL	N	100									24	125	TO-3	
IRF143	SL	N	60									24	125	TO-3	
IRF150	SL	N	100									40	150	TO-3	
IRF151	SL	N	60									40	150	TO-3	
IRF152	SL	N	100									33	150	TO-3	
IRF153	SL	N	60									33	150	TO-3	
IRF220	SL	N		200							5	40	TO-3		
IRF221	SL	N		150							5	40	TO-3		
IRF222	SL	N		200							4	40	TO-3		
IRF223	SL	N		150							4	40	TO-3		
IRF230	SL	N		200								9	75	TO-3	
IRF231	SL	N		150								9	75	TO-3	
IRF232	SL	N		200								8	75	TO-3	
IRF233	SL	N		150								8	75	TO-3	
IRF240	SL	N		200									18	125	TO-3

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) $T_c=25^\circ\text{C}$	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IRF241	SL	N		150							18	125	TO-3	
IRF242	SL	N		200							16	125	TO-3	
IRF243	SL	N		150							16	125	TO-3	
IRF250	SL	N		200							30	150	TO-3	
IRF251	RCA	N		150							30	150	TO-204AE/AA	
IRF251	SL	N		150							30	150	TO-3	
IRF252	SL	N		200							25	150	TO-3	
IRF253	RCA	N		150							25	150	TO-204AE/AA	
IRF253	SL	N		150							25	150	TO-3	
IRF320	SL	N			400			3				40	TO-3	
IRF321	SL	N			350			3				40	TO-3	
IRF322	SL	N			400			2.5				40	TO-3	
IRF323	SL	N			350			2.5				40	TO-3	
IRF330	SL	N			400					5.5		75	TO-3	
IRF331	SL	N			350					5.5		75	TO-3	
IRF332	SL	N			400				4.5			75	TO-3	
IRF333	SL	N			350				4.5			75	TO-3	
IRF340	SL	N			400						10	125	TO-3	
IRF341	SL	N			350					10		125	TO-3	
IRF342	SL	N			400					8		125	TO-3	
IRF343	SL	N			350					8		125	TO-3	
IRF350	SL	N			400						15	150	TO-3	
IRF351	SL	N			350						15	150	TO-3	
IRF352	SL	N			400						13	150	TO-3	
IRF353	SL	N			350						13	150	TO-3	
IRF420	RCA	N			500			2.5				40	TO-204AE/AA	
IRF420	SL	N			500			2.5				40	TO-3	
IRF421	RCA	N			450			2.5				40	TO-204AE/AA	
IRF421	SL	N			450			2.5				40	TO-3	
IRF422	RCA	N			500			2				40	TO-204AE/AA	

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IRF422	SL	N			500			2				40	TO-3	
IRF423	RCA	N			450			2				40	TO-204AE/AA	
IRF423	SL	N			450			2				40	TO-3	
IRF430	SL	N			500				4.5			75	TO-3	
IRF431	SL	N			450				4.5			75	TO-3	
IRF432	SL	N			500				4			75	TO-3	
IRF433	SL	N			450				4			75	TO-3	
IRF440	SL	N			500					8		125	TO-3	
IRF441	SL	N			450					8		125	TO-3	
IRF442	SL	N			500					7		125	TO-3	
IRF443	SL	N			450					7		125	TO-3	
IRF450	SL	N			500						13	150	TO-3	
IRF451	SL	N			450						13	150	TO-3	
IRF452	SL	N			500						12	150	TO-3	
IRF453	SL	N			450						12	150	TO-3	
IRF510	RCA	N	100						4			20	TO-220AB	
IRF511	RCA	N	60						4			20	TO-220AB	
IRF512	RCA	N	100						3.5			20	TO-220AB	
IRF513	RCA	N	60						3.5			20	TO-220AB	
IRF520	RCA	N	100							8		40	TO-220AB	
IRF520	SL	N	100							8		40	TO-220AB	
IRF521	RCA	N	60							8		40	TO-220AB	
IRF521	SL	N	60							8		40	TO-220AB	
IRF522	RCA	N	100							7		40	TO-220AB	
IRF522	SL	N	100							7		40	TO-220AB	
IRF523	RCA	N	60							7		40	TO-220AB	
IRF523	SL	N	60							7		40	TO-220AB	
IRF530	RCA	N	100								14	75	TO-220AB	
IRF530	SL	N	100								14	75	TO-220AB	
IRF531	RCA	N	60								14	75	TO-220AB	

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) T <sub>c</sub> =25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IRF531	SL	N	60								14	75	TO-220AB	
IRF532	RCA	N	100								12	75	TO-220AB	
IRF532	SL	N	100								12	75	TO-220AB	
IRF533	RCA	N	60								12	75	TO-220AB	
IRF533	SL	N	60								12	75	TO-220AB	
IRF540	SL	N	100								27	125	TO-220AB	
IRF541	SL	N	60								27	125	TO-220AB	
IRF542	SL	N	100								24	125	TO-220AB	
IRF543	SL	N	60								24	125	TO-220AB	
IRF620	SL	N		200					5			40	TO-220AB	
IRF621	SL	N		150					5			40	TO-220AB	
IRF622	SL	N		200					4			40	TO-220AB	
IRF623	SL	N		150					4			40	TO-220AB	
IRF630	SL	N		200						9		75	TO-220AB	
IRF631	SL	N		150						9		75	TO-220AB	
IRF632	SL	N		200						8		75	TO-220AB	
IRF633	SL	N		150						8		75	TO-220AB	
IRF640	SL	N		200							18	125	TO-220AB	
IRF641	SL	N		150							18	125	TO-220AB	
IRF642	SL	N		200							16	125	TO-220AB	
IRF643	SL	N		150							16	125	TO-220AB	
IRF720	SL	N			400			3				40	TO-220AB	
IRF721	SL	N			350			3				40	TO-220AB	
IRF722	SL	N			400			2.5				40	TO-220AB	
IRF723	SL	N			350			2.5				40	TO-220AB	
IRF730	SL	N			400					5.5		75	TO-220AB	
IRF731	SL	N			350					5.5		75	TO-220AB	
IRF732	SL	N			400				4.5			75	TO-220AB	
IRF733	SL	N			350				4.5			75	TO-220AB	
IRF740	SL	N			400					10		125	TO-220AB	

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) T <sub>c</sub> =25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IRF741	SL	N			350					10		125	TO-220AB	
IRF742	SL	N			400					8		125	TO-220AB	
IRF743	SL	N			350					8		125	TO-220AB	
IRF820	SL	N			500			2.5				40	TO-220AB	
IRF821	SL	N			450			2.5				40	TO-220AB	
IRF822	SL	N			500			2				40	TO-220AB	
IRF823	SL	N			450			2				40	TO-220AB	
IRF830	SL	N			500				4.5			75	TO-220AB	
IRF831	SL	N			450				4.5			75	TO-220AB	
IRF832	SL	N			500				4			75	TO-220AB	
IRF833	SL	N			450				4			75	TO-220AB	
IRF840	SL	N			500					8		125	TO-220AB	
IRF841	SL	N			450					8		125	TO-220AB	
IRF842	SL	N			500					7		125	TO-220AB	
IRF843	SL	N			450					7		125	TO-220AB	
IRF9130	SL	P	-100								-12	75	TO-3	
IRF9131	SL	P	-60								-12	75	TO-3	
IRF9132	SL	P	-100							-10		75	TO-3	
IRF9133	SL	P	-60							-10		75	TO-3	
IRF9520	SL	P	-100							-6		40	TO-220AB	
IRF9521	SL	P	-60							-6		40	TO-220AB	
IRF9522	SL	P	-100						-5			40	TO-220AB	
IRF9523	SL	P	-60						-5			40	TO-220AB	
IRF9530	SL	P	-100								-12	75	TO-220AB	
IRF9531	SL	P	-60								-12	75	TO-220AB	
IRF9532	SL	P	-100							-10		75	TO-220AB	
IRF9533	SL	P	-60							-10		75	TO-220AB	
IRFF120	SL	N	100							6		20	TO-39	
IRFF121	SL	N	60							6		20	TO-39	
IRFF122	SL	N	100						5			20	TO-39	



型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IRFF123	SL	N	60					5				20	TO-39	
IRFF130	SL	N	100							8		25	TO-39	
IRFF132	SL	N	100							7		25	TO-39	
IVN5000AND	ITS	N	40				0.7					2	TO-237	
IVN5000ANE	ITS	N	60				0.7					2	TO-237	
IVN5000SND	ITS	N	40				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNE	ITS	N	60				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNF	ITS	N	80				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000SNH	ITS	N	100				0.9					3.13	TO-52	
IVN5000TND	ITS	N	40					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNE	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNF	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
IVN5000TNH	ITS	N	100					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001AND	ITS	N	40				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANE	ITS	N	60				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANF	ITS	N	80				0.7					2	TO-237	
IVN5001ANH	ITS	N	100				0.7					2	TO-237	
IVN5001SND	ITS	N	40				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNE	ITS	N	60				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNF	ITS	N	80				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001SNH	ITS	N	100				0.9					3.13	TO-52	
IVN5001TNE	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001TNF	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
IVN5001TNH	ITS	N	100					1.2				6.25	TO-39	
IVN5200HND	ITS	N	40						5			30	TO-66	
IVN5200HNE	ITS	N	60						5			30	TO-66	
IVN5200HNF	ITS	N	80						5			30	TO-66	
IVN5200HND	ITS	N	100						5			30	TO-66	
IVN5200KND	ITS	N	40						5			50	TO-3	
IVN5200KNE	ITS	N	60						5			50	TO-3	

型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25°C	外囲器	備考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IVN5200KNF	ITS	N	80					5				50	TO-3	
IVN5200KNH	ITS	N	100					5				50	TO-3	
IVN5200TND	ITS	N	40					4				12.5	TO-39	
IVN5200TNE	ITS	N	60					4				12.5	TO-39	
IVN5200TNF	ITS	N	80					4				12.5	TO-39	
IVN5200TNH	ITS	N	100					4				12.5	TO-39	
IVN5201CND	ITS	N	40					5				30	TO-220	
IVN5201CNE	ITS	N	60					5				30	TO-220	
IVN5201CNF	ITS	N	80					5				30	TO-220	
IVN5201CNH	ITS	N	100					5				30	TO-220	
IVN5201HND	ITS	N	40					5				30	TO-66	
IVN5201HNE	ITS	N	60					5				30	TO-66	
IVN5201HNF	ITS	N	80					5				30	TO-66	
IVN5201HNH	ITS	N	100					5				30	TO-66	
IVN5201KND	ITS	N	40					5				50	TO-3	
IVN5201KNE	ITS	N	60					5				50	TO-3	
IVN5201KNF	ITS	N	80					5				50	TO-3	
IVN5201KNH	ITS	N	100					5				50	TO-3	
IVN5201TND	ITS	N	40					4				12.5	TO-39	
IVN5201TNE	ITS	N	60					4				12.5	TO-39	
IVN5201TNF	ITS	N	80					4				12.5	TO-39	
IVN5201TNH	ITS	N	100					4				12.5	TO-39	
IVN6000CNS	ITS	N			400			2				30	TO-220	
IVN6000CNT	ITS	N			450			2				30	TO-220	
IVN6000CNU	ITS	N			500			1.75				30	TO-220	
IVN6000KNR	ITS	N			350			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNS	ITS	N			400			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNT	ITS	N			450			2.5				41.7	TO-3	
IVN6000KNU	ITS	N			500			2				41.7	TO-3	
IVN6000TNS	ITS	N			400		1					12.5	TO-39	

型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外周器	備考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IVN6000TNT	ITS	N			450		1					12.5	TO-39	
IVN6000TNU	ITS	N			500		0.9					12.5	TO-39	
IVN6100TNS	ITS	N			400		0.3					6.25	TO-39	
IVN6100TNT	ITS	N			450		0.3					6.25	TO-39	
IVN6100TNU	ITS	N			500		0.3					6.25	TO-39	
IVN6200CNE	ITS	N	60							10		100	TO-220	
IVN6200CNF	ITS	N	80							10		100	TO-220	
IVN6200CNH	ITS	N	100							10		100	TO-220	
IVN6200CNM	ITS	N		200						10		100	TO-220	
IVN6200CNP	ITS	N		250						10		100	TO-220	
IVN6200CNS	ITS	N			400				5			100	TO-220	
IVN6200CNT	ITS	N			450				5			100	TO-220	
IVN6200CNU	ITS	N			500				5			100	TO-220	
IVN6200CNW	ITS	N				700		3				100	TO-220	
IVN6200CNX	ITS	N				800		2				100	TO-220	
IVN6200KNE	ITS	N	60							10		100	TO-3	
IVN6200KNF	ITS	N	80							10		100	TO-3	
IVN6200KNH	ITS	N	100							10		100	TO-3	
IVN6200KNM	ITS	N		200						10		100	TO-3	
IVN6200KNP	ITS	N		250						10		100	TO-3	
IVN6200KNS	ITS	N			400				5			100	TO-3	
IVN6200KNT	ITS	N			450				5			100	TO-3	
IVN6200KNU	ITS	N			500				5			100	TO-3	
IVN6200KNW	ITS	N				700		3				100	TO-3	
IVN6200KNX	ITS	N				800		2.5				100	TO-3	
IVN6300ANE	ITS	N	60				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANF	ITS	N	80				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANH	ITS	N	100				0.25					1.5	TO-237	
IVN6300ANM	ITS	N		200			0.12					1.5	TO-237	
IVN6300ANP	ITS	N		250			0.12					1.5	TO-237	

型 名	社 名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
IVN6300ANS	ITS	N			400		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300ANT	ITS	N			450		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300ANU	ITS	N			500		0.1					1.5	TO-237	
IVN6300SNE	ITS	N	60				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNF	ITS	N	80				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNH	ITS	N	100				0.25					1.5	TO-52	
IVN6300SNM	ITS	N		200			0.12					1.5	TO-52	
IVN6300SNP	ITS	N		250			0.12					1.5	TO-52	
IVN6300SNS	ITS	N			400		0.1					1.5	TO-52	
IVN6300SNT	ITS	N			450		0.1					1.5	TO-52	
IVN6300SNU	ITS	N			500		0.1					1.5	TO-52	
IVN6660	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
IVN6661	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
OCF25N18	RCA	N		180							25			CHIP
PCF10N12	RCA	N		120						10				CHIP
PCF10N45	RCA	N			450					10				CHIP
PCF12N08	RCA	N	80								12			CHIP
PCF12N18	RCA	N		180							12			CHIP
PCF12P08	RCA	P	-80								-12			CHIP
PCF15N05	RCA	N	50								15			CHIP
PCF15N12	RCA	N		120							15			CHIP
PCF18N08	RCA	N	80								18			CHIP
PCF2N05	RCA	N	50					2						CHIP
PCF2N08	RCA	N	80					2						CHIP
PCF2N12	RCA	N		120				2						CHIP
PCF2N18	RCA	N		180				2						CHIP
PCF30N12	RCA	N		120							30			CHIP
PCF35N08	RCA	N	80								35			CHIP
PCF3N45	RCA	N			450			3						CHIP
PCF45N05	RCA	N	50								45			CHIP

型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) T <sub>c</sub> =25°C	外 围 器	備 考	
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1				
PCF5P12	RCA	P		-120					-5						CHIP
PCF6P08	RCA	P	-80								-6				CHIP
PCF8N18	RCA	N		180							8				CHIP
PCF8P08	RCA	P	-80								-8				CHIP
RFH25P08	RCA	P	-80									-25			
RFH25P10	RCA	P	-100									-25			
RFH30N12	RCA	N		120								30			
RFH30N15	RCA	N		150								30			
RFK10N45	RCA	N			450						10		150	TO-204AE	
RFK10N50	RCA	N			500						10		150	TO-204AE	
RFK25N18	RCA	N		180								25	150	TO-204AE	
RFK25N20	RCA	N		200								25	150	TO-204AE	
RFK25P08	RCA	P	-80									-25	150	TO-204AE	
RFK25P10	RCA	P	-100									-25	150	TO-204AE	
RFK30N12	RCA	N		120								30	120	TO-204AE	
RFK30N15	RCA	N		150								30	120	TO-204AE	
RFK35N08	RCA	N	80									35	150	TO-204AE	
RFK35N10	RCA	N	100									35	150	TO-204AE	
RFK45N05	RCA	N	50									45	150	TO-204AE	
RFK45N06	RCA	N	60									45	150	TO-204AE	
RFL1N08	RCA	N	80					1					8.33	TO-39	
RFL1N08L	RCA	N	80					1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N10	RCA	N	100					1					8.33	TO-39	
RFL1N10L	RCA	N	100					1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N12	RCA	N		120				1					8.33	TO-39	
RFL1N12L	RCA	N		120				1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N15	RCA	N		150				1					8.33	TO-39	
RFL1N15L	RCA	N		150				1					8.33	TO-39	LL=5V
RFL1N18	RCA	N		180				1					8.33	TO-39	
RFL1N18L	RCA	N		180									8.33	TO-39	LL=5V

型 名	社 名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力(W) Tc=25°C	外 围 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
RFL1N20	RCA	N		200			1					8.33	TO-39	
RFL1N20L	RCA	N		200								8.33	TO-39	LL=5V
RFL1P08	RCA	P	-80				-1						TO-220	
RFL1P10	RCA	P	-100				-1						TO-220	
RFL2N05	RCA	N	50					2				8.33	TO-39	
RFL2N06	RCA	N	60					2				8.33	TO-39	
RFL4N12	RCA	N		120					4			8.33	TO-39	
RFL4N15	RCA	N		150					4			8.33	TO-39	
RFM10N12	RCA	N		120						10		75	TO-204MA	
RFM10N15	RCA	N		150						10		75	TO-204MA	
RFM10P12	RCA	P		-120						-10				
RFM10P15	RCA	P		-150						-10				
RFM12N08	RCA	N	80								12	75	TO-204MA	
RFM12N08L	RCA	N	80								12	75	TO-204MA	LL=5V
RFM12N10	RCA	N	100								12	75	TO-204MA	
RFM12N10L	RCA	N	100								12	75	TO-204MA	LL=5V
RFM12N18	RCA	N		180							12	100	TO-204MA	
RFM12N20	RCA	N		200							12	100	TO-204MA	
RFM12P08	RCA	P	-80								-12	100	TO-204MA	
RFM12P10	RCA	P	-100								-12	100	TO-204MA	
RFM15N05	RCA	N	50								15	75	TO-204MA	
RFM15N05L	RCA	N	50								15		TO-3	LL=5V
RFM15N06	RCA	N	60								15	75	TO-204MA	
RFM15N06L	RCA	N	60								15		TO-3	LL=5V
RFM15N12	RCA	N		120							15	100	TO-204MA	
RFM15N15	RCA	N		150							15	100	TO-204MA	
RFM18N08	RCA	N	80								18	100	TO-204MA	
RFM18N10	RCA	N	100								18	100	TO-204MA	
RFM25N05	RCA	N	50								25		TO-3	LL=5V
RFM25N06	RCA	N	60								25		TO-3	LL=5V

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) T <sub>c</sub> =25°C	外 開 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
RFM3N45	RCA	N			450			3				75	TO-204MA	
RFM3N50	RCA	N			500			3				75	TO-204MA	
RFM5P12	RCA	P		-120					-5			75	TO-204MA	
RFM5P15	RCA	P		-150					-5			75	TO-204MA	
RFM6P08	RCA	P	-80							-6		75	TO-204MA	
RFM6P10	RCA	P	-100							-6		75	TO-204MA	
RFM8N18	RCA	N		180						8		75	TO-204MA	
RFM8N18L	RCA	N		180						8		75	TO-204MA	LL=5V
RFM8N20	RCA	N		200						8		75	TO-204MA	
RFM8P08	RCA	P	-80							-8		100	TO-204MA	
RFM8P10	RCA	P	-100							-8		100	TO-204MA	
RFP10N12	RCA	N		120						10		60	TO-220AB	
RFP10N15	RCA	N		150						10		60	TO-220AB	
RFP10P12	RCA	P		-120						-10			TO-220	
RFP10P15	RCA	P		-150						-10				
RFP12N08	RCA	N	80								12	60	TO-220AB	
RFP12N08L	RCA	N	80								12	60	TO-220AB	LL=5V
RFP12N10	RCA	N	100								12	60	TO-220AB	
RFP12N10L	RCA	N	100								12	60	TO-220AB	LL=5V
RFP12N18	RCA	N		180							12	75	TO-220AB	
RFP12N20	RCA	N		200							12	75	TO-220AB	
RFP12P08	RCA	P	-80							-12		75	TO-220AB	
RFP12P10	RCA	P	-100							-12		75	TO-220AB	
RFP15N05	RCA	N	50								15	60	TO-220AB	
RFP15N05L	RCA	N	50								15		TO-220	LL=5V
RFP15N06	RCA	N	60								15	60	TO-220AB	
RFP15N06L	RCA	N	60								15		TO-220	LL=5V
RFP15N12	RCA	N		120							15	75	TO-220AB	
RFP15N15	RCA	N		150							15	75	TO-220AB	
RFP18N08	RCA	N	80								18	75	TO-220AB	



型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
RFP18N10	RCA	N	100								18	75	TO-220AB	
RFP25N05	RCA	N	50								25		TO-220	LL=5V
RFP25N06	RCA	N	60								25		TO-220	
RFP2N08	RCA	N	80					2				25	TO-220AB	
RFP2N08L	RCA	N	80					2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N10	RCA	N	100					2				25	TO-220AB	
RFP2N10L	RCA	N	100					2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N12	RCA	N		120				2				25	TO-220AB	
RFP2N12L	RCA	N		120				2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N15	RCA	N		150				2				25	TO-220AB	
RFP2N15L	RCA	N		150				2				25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N18	RCA	N		180				2				25	TO-220AB	
RFP2N18L	RCA	N		180								25	TO-220AB	LL=5V
RFP2N20	RCA	N		200				2				25	TO-220AB	
RFP2N20L	RCA	N		200								25	TO-220AB	LL=5V
RFP2P08	RCA	P	-80					-2						
RFP2P10	RCA	P	-100					-2						
RFP3N45	RCA	N			450			3				60	TO-220AB	
RFP3N50	RCA	N			500			3				60	TO-220AB	
RFP4N05	RCA	N	50						4			25	TO-220AB	
RFP4N06	RCA	N	60						4			25	TO-220AB	
RFP5P12	RCA	P		-120					-5			60	TO-220AB	
RFP5P15	RCA	P		-150					-5			60	TO-220AB	
RFP6P08	RCA	P	-80							-6		60	TO-220AB	
RFP6P10	RCA	P	-100							-6		60	TO-220AB	
RFP8N18	RCA	N		180						8		60	TO-220AB	
RFP8N18L	RCA	N		180						8		60	TO-220AB	LL=5V
RFP8N20	RCA	N		200						8		60	TO-220AB	
RFP8N20L	RCA	N		200						8		60	TO-220AB	LL=5V
RFP8P08	RCA	P	-80							-8		75	TO-220AB	



型 名	社 名	チャ ネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) T <sub>c</sub> =25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
RFP8P10	RCA	P	-100									75	TO-220AB	
TA9437A	RCA	N			350								TO-204MA	
TA9437B	RCA	N			400								TO-204MA	
TA9438A	RCA	N			350								TO-220AB	
TA9438B	RCA	N			400								TO-220AB	
TFM8N20L	RCA	N		200								75	TO-204MA	LL=5V
TN0106N2	SPT	N	60				0.8					3.5	TO-39	
TN0106N3	SPT	N	60				0.5					1	TO-92	
TN0106ND	SPT	N	60											CHIP
TN0110N2	SPT	N	100				0.8					3.5	TO-39	
TN0110N3	SPT	N	100				0.5					1	TO-92	
TN0110ND	SPT	N	100											CHIP
TN0520N2	SPT	N		200			0.7					3.5	TO-39	
TN0520N3	SPT	N		200			0.3					1	TO-92	
TN0520ND	SPT	N		200										CHIP
TN0524N2	SPT	N		240			0.7					3.5	TO-39	
TN0524N3	SPT	N		240			0.3					1	TO-92	
TN0524ND	SPT	N		240										CHIP
VN0104N2	SPT	N	40				0.8					3.5	TO-39	
VN0104N3	SPT	N	40				0.5					1	TO-92	
VN0104N5	SPT	N	40					1.5				15	TO-220	
VN0104N6	SPT	N	40				0.7					0.6/U	PDIP14P	2SK*4
VN0104N7	SPT	N	40				0.7					0.6/U	CDIP14P	2SK*4
VN0104N9	SPT	N	40				0.5					1	TO-52	
VN0104ND	SPT	N	40											CHIP
VN0106N2	SPT	N	60				0.8					3.5	TO-39	
VN0106N3	SPT	N	60				0.5					1	TO-92	
VN0106N5	SPT	N	60					1.5				15	TO-220	
VN0106N6	SPT	N	60				0.7					0.6/U	PDIP14P	2SK*4
VN0106N7	SPT	N	60				0.7					0.6/U	CDIP14P	2SK*4





型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外 围 器	備 考
			100	10 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VN0360N1	SPT	N			600			2.5				100	TO-3	
VN0360N5	SPT	N			600			1.5				50	TO-220	
VN0360ND	SPT	N			600									CHIP
VN0400A	SL	N	40								18	100	TO-3	
VN0400D	SL	N	40								18	75	TO-220AB	
VN0401A	SL	N	40								16	100	TO-3	
VN0401D	SL	N	40								16	75	TO-220AB	
VN0535N2	SPT	N		350				0.25				6	TO-39	
VN0535N3	SPT	N		350				0.1				1	TO-92	
VN0535ND	SPT	N		350										CHIP
VN0540N2	SPT	N			400			0.25				6	TO-39	
VN0540N3	SPT	N			400			0.1				1	TO-92	
VN0540ND	SPT	N			400									CHIP
VN0545N2	SPT	N			450			0.1				6	TO-39	
VN0545N3	SPT	N			450			0.05				1	TO-92	
VN0545ND	SPT	N			450									CHIP
VN0550N2	SPT	N			500			0.1				6	TO-39	
VN0550N3	SPT	N			500			0.05				1	TO-92	
VN0550ND	SPT	N			500									CHIP
VN0600A	SL	N	60								18	100	TO-3	
VN0600D	SL	N	60								18	75	TO-220AB	
VN0601A	SL	N	60								16	100	TO-3	
VN0601D	SL	N	60								16	75	TO-220AB	
VN0606M	SL	N	60					0.4				1	TO-237	
VN0610L	SL	N	60					0.2				0.4	TO-92	
VN0800A	SL	N	80								14	100	TO-3	
VN0800D	SL	N	80								14	75	TO-220AB	
VN0801A	SL	N	80								12	100	TO-3	
VN0801D	SL	N	80								12	75	TO-220AB	
VN0808M	SL	N	80					0.35				1	TO-237	

型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) Tc=25°C	外 围 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VN1000A	SL	N	100								14	100	TO-3	
VN1000D	SL	N	100								14	75	TO-220AB	
VN1001A	SL	N	100								12	100	TO-3	
VN1001D	SL	N	100								12	75	TO-220AB	
VN10KE	SL	N	60				0.2					0.315	TO-52	
VN10KM	ITS	N	60				0.5					1	TO-237	
VN10KM	SL	N	60				0.3					1	TO-237	
VN10KN3	SPT	N	60				0.3					1	TO-92	
VN10LE	SL	N	60				0.2					0.315	TO-52	
VN10LM	SL	N	60				0.3					1	TO-237	
VN1106N1	SPT	N	60							9		75	TO-3	
VN1106N2	SPT	N	60					2.5				6	TO-39	
VN1106N5	SPT	N	60							7		45	TO-220	
VN1106ND	SPT	N	60											CHIP
VN1110N1	SPT	N	100							9		75	TO-3	
VN1110N2	SPT	N	100					2.5				6	TO-39	
VN1110N5	SPT	N	100							7		45	TO-220	
VN1110ND	SPT	N	100											CHIP
VN1116N1	SPT	N		160				3				100	TO-3	
VN1116N2	SPT	N		160			1					4	TO-39	
VN1116N5	SPT	N		160				2				45	TO-220	
VN1116ND	SPT	N		160										CHIP
VN1120N1	SPT	N		200				3				100	TO-3	
VN1120N2	SPT	N		200				1				4	TO-39	
VN1120N5	SPT	N		200				2				45	TO-220	
VN1120ND	SPT	N		200										CHIP
VN1200A	SL	N		120							14	75	TO-3	
VN1200D	SL	N		120							14	75	TO-220AB	
VN1201A	SL	N		120							12	100	TO-3	
VN1201D	SL	N		120							12	75	TO-220AB	

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			{ 100	101 { 300	301 { 500	501 { 1000	{ 1.0	1.1 { 3.0	3.1 { 5.0	5.1 { 10.0	10.1 {			
VN1204N1	SPT	N	40								12	100	TO-3	
VN1204N2	SPT	N	40						3.5			6.5	TO-39	
VN1204N5	SPT	N	40							9		45	TO-220	
VN1204ND	SPT	N	40											CHIP
VN1206B	SL	N		120			0.8					6.25	TO-39	
VN1206D	SL	N		120				1.4				20	TO-220AB	
VN1206L	SL	N		120			0.21					0.4	TO-92	
VN1206M	SL	N		120			0.3					1	TO-237	
VN1206N1	SPT	N	60								12	100	TO-3	
VN1206N2	SPT	N	60						3.5			6.5	TO-39	
VN1206N5	SPT	N	60							9		45	TO-220	
VN1206ND	SPT	N	60											CHIP
VN1210L	SL	N		120			0.16					0.4	TO-92	
VN1210M	SL	N		120			0.25					1	TO-237	
VN1210N1	SPT	N	100								12	100	TO-3	
VN1210N2	SPT	N	100						3.5			6.5	TO-39	
VN1210N5	SPT	N	100							9		45	TO-220	
VN1210ND	SPT	N	100											CHIP
VN1216N1	SPT	N		160						6		100	TO-3	
VN1216N2	SPT	N		160				3.0				6.5	TO-39	
VN1216N5	SPT	N		160					4.5			45	TO-220	
VN1216ND	SPT	N		160										CHIP
VN1220N1	SPT	N		200						6		100	TO-3	
VN1220N2	SPT	N		200				3				6.5	TO-39	
VN1220N5	SPT	N		200					4.5			45	TO-220	
VN1220ND	SPT	N		200										CHIP
VN1304N2	SPT	N	40				0.4					3	TO-39	
VN1304N3	SPT	N	40				0.25					1	TO-92	
VN1304N6	SPT	N	40				0.4					0.5/U	PDIP14P	2SK*4
VN1304N7	SPT	N	40				0.4					0.6/U	CDIP14P	2SK*4



型名	社名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) Tc=25°C	外囲器	備考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VN2316N1	SPT	N		160							18	125	TO-3	
VN2316N5	SPT	N		160							12	50	TO-220	
VN2316ND	SPT	N		160										CHIP
VN2320N1	SPT	N		200							18	125	TO-3	
VN2320N5	SPT	N		200							12	50	TO-220	
VN2320ND	SPT	N		200										CHIP
VN2335N1	SPT	N			350					8		125	TO-3	
VN2335N5	SPT	N			350					6		50	TO-220	
VN2335ND	SPT	N			350									CHIP
VN2340N1	SPT	N			400					8		125	TO-3	
VN2340N5	SPT	N			400					6		50	TO-220	
VN2340ND	SPT	N			400									CHIP
VN2345N1	SPT	N			450					6		125	TO-3	
VN2345N5	SPT	N			450				4			50	TO-220	
VN2345ND	SPT	N			450									CHIP
VN2350N1	SPT	N			500					6		125	TO-3	
VN2350N5	SPT	N			500				4			50	TO-220	
VN2350ND	SPT	N			500									CHIP
VN2406B	SL	N		240			0.8					6.25	TO-39	
VN2406D	SL	N		240				1.4				20	TO-220AB	
VN2406L	SL	N		240			0.21					0.4	TO-92	
VN2406M	SL	N		240			0.3					1	TO-237	
VN2410L	SL	N		240			0.16					0.4	TO-92	
VN2410M	SL	N		240			0.25					1	TO-237	
VN30AB	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN3500A	SL	N			350					6		125	TO-3	
VN3500D	SL	N			350					6		75	TO-220AB	
VN3501A	SL	N			350				5			125	TO-3	
VN3501D	SL	N			350				5			75	TO-220AB	
VN35AA	SL	N	35					2				25	TO-3	



型 名	社 名	チャ ネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) $T_c=25^\circ\text{C}$	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VN35AB	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN35AB	SL	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN35AK	ITS	N	35					1.2				6.25	TO-39	
VN4000A	SL	N			400					6		125	TO-3	
VN4000D	SL	N			400					6		75	TO-220AB	
VN4001A	SL	N			400				5			125	TO-3	
VN4001D	SL	N			400				5			75	TO-220AB	
VN40AD	SL	N	40					1.5				40	TO-220AB	
VN40AF	ITS	N	40					1.2				12	TO-202	
VN40AF	SL	N	40					1.3				15	TO-202AA	
VN4501A	SL	N			450				4.5			100	TO-3	
VN4501D	SL	N			450				4.5			75	TO-220AB	
VN4502A	SL	N			450				4			100	TO-3	
VN4502D	SL	N			450				4			75	TO-220AB	
VN46AD	SL	N	40					1.9				40	TO-220AB	
VN46AF	ITS	N	40					1.2				12	TO-202	
VN46AF	SL	N	40					1.6				15	TO-202AA	
VN5001A	SL	N			500				4.5			100	TO-3	
VN5001D	SL	N			500				4.5			75	TO-220AB	
VN5002A	SL	N			500				4			100	TO-3	
VN5002D	SL	N			500				4			75	TO-220AB	
VN64GA	SL	N	60							10		80	TO-3	
VN66AD	SL	N	60					1.9				20	TO-220AB	
VN66AF	ITS	N	60					1.2				12	TO-202	
VN66AF	SL	N	60					1.7				15	TO-202AA	
VN66AK	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN67AA	SL	N	60					2				25	TO-3	
VN67AB	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN67AB	SL	N	60				1					6.25	TO-39	
VN67AD	SL	N	60					1.8				20	TO-220AB	

型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) Tc=25°C	外 囲 器	備 考
			{ 100	101 { 300	301 { 500	501 { 1000	{ 1.0	1.1 { 3.0	3.1 { 5.0	5.1 { 10.0	10.1 {			
VN67AF	ITS	N	60					1.2				12	TO-202	
VN67AF	SL	N	60					1.6				15	TO-202AA	
VN67AK	ITS	N	60					1.2				6.25	TO-39	
VN80AF	SL	N	80					1.3				15	TO-202AA	
VN88AD	SL	N	80					1.7				20	TO-220AB	
VN88AF	ITS	N	80					1.2				12	TO-202	
VN88AF	SL	N	80					1.5				15	TO-202AA	
VN89AB	ITS	N	80					1.2				6.25	TO-39	
VN89AD	SL	N	80					1.6				20	TO-220AB	
VN89AF	ITS	N	80					1.2				12	TO-202	
VN89AF	SL	N	80					1.4				15	TO-202AA	
VN90AA	SL	N	90					1.7				25	TO-3	
VN90AB	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VN90AB	SL	N	90				0.8					6.25	TO-39	
VN98AK	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VN99AA	SL	N	90					1.8				25	TO-3	
VN99AB	SL	N	90				0.9					6.25	TO-39	
VN99AK	ITS	N	90					1.2				6.25	TO-39	
VNC003A	SL	N	60								60	250	TO-3	
VNC010B	SL	N	60						4			15	TO-39	
VNC011B	SL	N	60						4			15	TO-39	
VND010B	SL	N	80						4			15	TO-39	
VND011B	SL	N	80						4			15	TO-39	
VNE003A	SL	N	100								60	250	TO-3	
VNE010B	SL	N	100						4			15	TO-39	
VNE011B	SL	N	100						4			15	TO-39	
VNG004A	SL	N		150							45	250	TO-3	
VNJ004A	SL	N		200							45	250	TO-3	
VNL001A	SL	N			350					8		175	TO-3	
VNL005A	SL	N			350						25	250	TO-3	





型 名	社 名	チャネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) T <sub>c</sub> =25°C	外 囲 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VP0220N2	SPT	P		-200			-0.35					4	TO-39	
VP0220N3	SPT	P		-200			-0.2					1	TO-92	
VP0220N5	SPT	P		-200			-0.8					27	TO-220	
VP0220ND	SPT	P		-200										CHIP
VP0300B	SL	P	-30					-1.3				6.25	TO-39	
VP0300L	SL	P	-30				-0.48					1	TO-92	
VP0300M	SL	P	-30				-0.48					1	TO-237	
VP0335N1	SPT	P			-350			-2.7				100	TO-3	
VP0335N2	SPT	P			-350		-0.7					6	TO-39	
VP0335N5	SPT	P			-350			-1.6				50	TO-220	
VP0335ND	SPT	P			-350									CHIP
VP0340N1	SPT	P			-400			-2.7				100	TO-3	
VP0340N2	SPT	P			-400		-0.7					6	TO-39	
VP0340N5	SPT	P			-400			-1.6				50	TO-220	
VP0340ND	SPT	P			-400									CHIP
VP0345N1	SPT	P			-450			-1.5					TO-3	
VP0345N2	SPT	P			-450		-0.4					6	TO-39	
VP0345N5	SPT	P			-450		-1.0					50	TO-220	
VP0345ND	SPT	P			-450									CHIP
VP0350N1	SPT	P			-500			-1.5				100	TO-3	
VP0350N2	SPT	P			-500		-0.4					6	TO-39	
VP0350N5	SPT	P			-500		-1.0					50	TO-220	
VP0350ND	SPT	P			-500									CHIP
VP0535N2	SPT	P			-350		-0.2					3.5	TO-39	
VP0535N3	SPT	P			-350		-0.1					1	TO-92	
VP0535ND	SPT	P			-350									CHIP
VP0540N2	SPT	P			-400		-0.2					3.5	TO-39	
VP0540N3	SPT	P			-400		-0.1					1	TO-92	
VP0540ND	SPT	P			-400									CHIP
VP0545N2	SPT	P			-450		-0.125					3.5	TO-39	



型 名	社 名	チャ ネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費 電力(W) Tc=25°C	外 用 器	備 考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	1.1 3.0	3.1 5.0	5.1 10.0	10.1			
VP1206N1	SPT	P	-60							-7		100	TO-3	
VP1206N2	SPT	P	-60					-2.5				6.5	TO-39	
VP1206N5	SPT	P	-60						-5			45	TO-220	
VP1206ND	SPT	P	-60											CHIP
VP1210N1	SPT	P	-100							-7		100	TO-3	
VP1210N2	SPT	P	-100					-2.5				6.5	TO-39	
VP1210N5	SPT	P	-100						-5			45	TO-220	
VP1210ND	SPT	P	-100											CHIP
VP1216N1	SPT	P		-160						-4.5		100	TO-3	
VP1216N2	SPT	P		-160				-2				6.5	TO-39	
VP1216N5	SPT	P		-160						-3.5		45	TO-220	
VP1216ND	SPT	P		-160										CHIP
VP1220N1	SPT	P		-200						-4.5		100	TO-3	
VP1220N2	SPT	P		-200				-2				6.5	TO-39	
VP1220N5	SPT	P		-200						-3.5		45	TO-220	
VP1220ND	SPT	P		-200										CHIP
VP1304N2	SPT	P	-40				-0.25					3	TO-39	
VP1304N3	SPT	P	-40				-0.15					0.8	TO-92	
VP1304N6	SPT	P	-40				-0.2					0.5/U	PDIP14P	2SJ*4
VP1304N7	SPT	P	-40				-0.2					0.5/U	CDIP14P	2SJ*4
VP1304ND	SPT	P	-40											CHIP
VP1306N2	SPT	P	-60				-0.25					3	TO-39	
VP1306N3	SPT	P	-60				-0.15					0.8	TO-92	
VP1306N6	SPT	P	-60				-0.2					0.5/U	PDIP14P	2SJ*4
VP1306N7	SPT	P	-60				-0.2					0.5/U	CDIP14P	2SJ*4
VP1306ND	SPT	P	-60											CHIP
VP1310N2	SPT	P	-100				-0.25					3	TO-39	
VP1310N3	SPT	P	-100				-0.15					0.8	TO-92	
VP1310ND	SPT	P	-100											CHIP
VP1316N2	SPT	P		-160			-0.1					3	TO-39	



型名	社名	チャンネル	ドレイン・ソース間耐圧 (V)				最大直流ドレイン電流 (A)					最大消費電力 (W) $T_c=25^\circ\text{C}$	外囲器	備考
			100	101 300	301 500	501 1000	1.0	5.1 10.0	1.1 3.0	3.1 5.0	10.1			
VP1316N3	SPT	P		-160			-0.06					0.8	TO-92	
VP1316ND	SPT	P		-160										CHIP
VP1320N2	SPT	P		-200			-0.1					3	TO-39	
VP1320N3	SPT	P		-200			-0.06					0.8	TO-92	
VP1320ND	SPT	P		-200										CHIP
VQ0808B	SL	P	-80				-0.9					6.25	TO-39	
VQ1000CJ	ITS	N	60				0.3						DIP14P	2SK*4
VQ1000J	SL	N	60				0.225					0.5/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1000N6	SPT	N	60									1.2/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1000N7	SPT	N	60									2/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1000P	SL	N	60				0.225					0.5/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1001J	SL	N	30				0.85					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1001P	SL	N	30				0.85					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1004J	SL	N	60				0.46					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1004P	SL	N	60				0.46					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ1006J	SL	N	90				0.4					1.3/U	PDIP14P	2SK*4
VQ1006P	SL	N	90				0.4					1.3/U	CDIP14P	2SK*4
VQ2001J	SL	P	-30				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2001P	SL	P	-30				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ2004J	SL	P	-60				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2004P	SL	P	-60				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ2006J	SL	P	-90				-0.6					1.3/U	PDIP14P	2SJ*4
VQ2006P	SL	P	-90				-0.6					1.3/U	CDIP14P	2SJ*4
VQ3001J	SL	P/N										1.3/U	PDIP14P	J*2, K*2
VQ3001P	SL	P/N										1.3/U	CDIP14P	J*2, K*2
VQ7254J	SL	P/N										1.3/U	PDIP14P	J*2, K*2
VQ7254N6	SPT	P/N										1.5/U	PDIP14P	
VQ7254N7	SPT	P/N										2/U	CDIP14P	
VQ7254P	SL	P/N										1.3/U	CDIP14P	J*2, K*2



このページは空白です。

1985年版

## 最新FET【電界効果トランジスタ】規格表

昭和43年4月1日 初版発行

昭和60年6月20日 発行

S 60. 6. 20 第1刷

©1968

編著者 漆原 健彦

編集発行人 飛 坐 博

発行所 CQ出版株式会社

〒170 東京都豊島区巢鴨1-14-2

電話(03)947-6311(代表)

振替 東京0-10665

定価 900円

印刷・製本 株式会社 丹誠社

ISBN4-7898-4018-2 C3055 ¥900E